

Основана в 1947 году
Выпуск 1154

А. В. НЕФЕДОВ
В. И. ГОРДЕЕВА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ И ИХ ЗАРУБЕЖНЫЕ АНАЛОГИ

Справочник

3-е издание, переработанное и дополненное

Scan Pirat



МОСКВА „РАДИО И СВЯЗЬ„
1990

ББК 32.852
Н82
УДК 621.382(035)

Редакция литературы по электронике

Нефедов А. В., Гордеева В. И.

Н82 Отечественные полупроводниковые приборы и их зарубежные аналоги: Справочник.—3-е изд., перераб. и доп.— М.: Радио и связь, 1990.— 400 с.: ил. (Массовая радиобиблиотека; Вып. 1154).

ISBN 5-256-00695-9.

Приведены сведения об условных обозначениях, электрических параметрах, конструкциях корпусов отечественных и аналогичных зарубежных полупроводниковых приборов (диодов и транзисторов). По сравнению со вторым изданием (1985 г.) значительно расширена номенклатура приборов.

Для подготовленных радиолюбителей.

Н $\frac{2302030300-099}{046(01)-90}$ 70-90 **ББК 32.852**

Справочое издание

Массовая радиобиблиотека. Выпуск 1154

НЕФЕДОВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ГОРДЕЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ И ИХ ЗАРУБЕЖНЫЕ АНАЛОГИ

Справочник

Заведующий редакцией Ю Н. Рысев
Редактор И. П. Леонтьева
Переплет художника В Ф Громова
Художественный редактор Н С Шеин
Технический редактор И Л. Ткаченко
Корректор Н В Козлова

ИБ № 1679

Сдано в набор 12 09 89. Подписано в печать 11.04 90 Формат 60×90¹/₁₆ Бумага тип. № 2. Гарнитура литер Печать высокая. Усл печ. л. 25,0 Усл кр-отт 25,0. Уч-изд. л. 33,49: Тираж 240 000 экз (1 зав 1—150 000 экз.) Изд. № 22336. Заказ № 1141 Цена 5 р. Издательство «Радио и связь». 101000, Москва, Почтамт, а/я 693.

Областная ордена «Знак Почета» типография им. Смирнова Смоленского облуправления по печати. 214000, г. Смоленск, проспект им. Ю. Гагарина, 2.

ISBN 5-256-00695-9

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие 5

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. СИСТЕМЫ ОБОЗНАЧЕНИЙ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ 6

1.1. Условные обозначения и классификация отечественных полупроводниковых приборов 6
1.2. Условные обозначения и классификация зарубежных полупроводниковых приборов 12
1.3. Системы цветного кодирования диодов 16
1.4. Условные графические обозначения полупроводниковых приборов . . 17

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, РЕЖИМЫ РАБОТЫ И ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ 20

2.1. Особенности полупроводниковых приборов 20
2.2. Максимальные и максимально допустимые параметры 21
2.3. Рассеиваемая мощность 21
2.4. Пробивные (максимальные) и максимально допустимые напряжении . 23
2.5. Максимальные токи 25
2.6. Тепловые параметры 26
2.7. Коэффициент передачи тока 28
2.8. Емкости переходов и постоянная времени коллектора 29
2.9. Шумы транзисторов 29
2.10. Эквивалентные схемы и параметры четырехполюсника 31
2.11. Частотные свойства транзисторов 32
2.12. Обратные токи 33
2.13. Области работы и вольт-амперные характеристики транзисторов . . 34
2.14. Импульсный и ключевой режимы работы 35
2.15. Технология изготовления полупроводниковых приборов 38
2.16. Конструкции корпусов 40
2.17. Герметизация пластмассой 42
2.18. Надежность 44
2.19. Области применения транзисторов 44
2.20. Высокочастотные транзисторы 47
2.21. Составные транзисторы 49
2.22. Выпрямительные диоды 50
2.23. Стабилитроны 51

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ . . . 53
3.1. О взаимозаменяемости полупроводниковых приборов 53
3.2. Буквенные обозначения параметров биполярных и полевых транзисторов 54
3.3. Отечественные транзисторы и их зарубежные аналоги 63
РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ. ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ДИОДЫ 272
4.1. Буквенные обозначения параметров диодов 272
4.2. Отечественные диоды и их зарубежные аналоги 273
Приложение 1. Зарубежные транзисторы и их отечественные аналоги . . 318
Приложение 2. Зарубежные диоды и их отечественные аналоги 341
Приложение 3. Перечень отечественных транзисторов, включенных в справочник 355
Приложение 4. Перечень отечественных диодов, включенных в справочник 356
Приложение 5. Буквенные обозначения транзисторов зарубежных фирм . 357
Приложение 6. Буквенные обозначения диодов зарубежных фирм . . . 362
Приложение 7. Сокращенные обозначения зарубежных фирм 371
Приложение 8. Габаритные чертежи корпусов отечественных и зарубежных транзисторов 374
Приложение 9. Габаритные чертежи корпусов отечественных и зарубежных диодов 392

ПРЕДИСЛОВИЕ

В нашей стране используется широкий ассортимент импортной радиоэлектронной аппаратуры на полупроводниковых приборах: телевизоры, радиоприемники, магнитофоны, электронные измерительные приборы, приборы управления электроавтоматикой, станки с числовым программным управлением, автоматические линии, технологическое и испытательное оборудование, электронные телефонные станции и др. В связи с этим для читателей (радиолюбителей и специалистов), занимающихся ремонтом зарубежной аппаратуры, модернизацией и конструированием различных электронных устройств, схем и узлов с использованием зарубежного опыта, необходимы сведения об отечественных и зарубежных полупроводниковых приборах, сопоставимых или тождественных по назначению, электрическим характеристикам и параметрам, массогабаритным показателям.

Справочник состоит из четырех разделов. В первом разделе даны классификация и условные обозначения отечественных полупроводниковых приборов разных лет выпуска. Рассмотрены стандартные системы условных обозначений, принятые за рубежом, и цветная маркировка полупроводниковых диодов. Приведены условные графические обозначения приборов.

Во втором разделе описаны свойства, специфические особенности, основные электрические параметры, области применения и особенности конструкций корпусов отечественных и зарубежных полупроводниковых приборов (стабилитронов, выпрямительных диодов, транзисторов).

В третьем разделе даны рекомендации по подбору аналогов, условные буквенные обозначения параметров биполярных и полевых транзисторов, а также электрические параметры отечественных и зарубежных транзисторов (малой, средней и большой мощности низкой и высокой частот, для поверхностного монтажа, составных, генераторных и усилительных СВЧ-транзисторов). Для удобства читателей в приложении 1 приведена обобщенная таблица типономиналов зарубежных транзисторов и их отечественных аналогов в алфавитно-цифровой последовательности, а в приложении 8 — габаритные чертежи корпусов отечественных и зарубежных транзисторов с обозначением их внешних выводов.

В четвертом разделе приведены электрические параметры отечественных и зарубежных выпрямительных и импульсных диодов, стабилитронов, в приложении 2 — обобщенная таблица типономиналов зарубежных диодов и их отечественных аналогов, в приложении 9 — чертежи корпусов отечественных и зарубежных диодов.

В приложениях 3, 4 содержатся перечни отечественных диодов и транзисторов для аппаратуры широкого применения, включенных в справочник.

В отличие от предыдущего издания уточнены аналоги некоторых ранее выпущенных типов транзисторов и дополнительно приведены электрические параметры новых эквивалентных типов отечественных и зарубежных транзисторов, внесены изменения норм параметров, даны новые конструкции корпусов. В приложениях 5, 6 приведены внутрифирменные обозначения зарубежных транзисторов и диодов, в приложении 7 — сокращенные обозначения зарубежных фирм.

Названия стран — изготовителей полупроводниковых приборов приведены по состоянию на 1 сентября 1989 г.

Предисловие, разд. 1—3 и приложения 1, 3, 5—8 написаны А. В. Нефедовым, а разд. 4 и приложения 2, 4, 9 — В. И. Гордеевой.

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

СИСТЕМЫ ОБОЗНАЧЕНИЙ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ

1.1. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ

Информация о назначении, основных электрических параметрах, типе исходного материала, конструктивно-технологических особенностях включается в систему условных обозначений (маркировку) полупроводниковых приборов на основе буквенно-цифрового кода. Поскольку в справочник вошли приборы разных лет выпуска, то приводится несколько систем их обозначений.

Условные обозначения биполярных транзисторов, выпущенных до 1964 г., состоят из букв (П или МП) и цифр, определяющих тип исходного материала, допустимую рассеиваемую мощность и граничную частоту:

от 1 до 99 — германиевые маломощные низкой частоты;
от 101 до 199 — кремниевые маломощные низкой частоты;
от 201 до 299 — германиевые мощные низкой частоты;
от 301 до 399 — кремниевые мощные низкой частоты;
от 401 до 499 — германиевые маломощные высокой и сверхвысокой частот;
от 501 до 599 — кремниевые маломощные высокой и сверхвысокой частот;
от 601 до 699 — германиевые мощные высокой и сверхвысокой частот;
от 701 до 799 — кремниевые мощные высокой и сверхвысокой частот.

После цифр может стоять буква, определяющая разбраковку транзисторов по параметрам.

С 1964 г. маркировка полупроводниковых приборов проводилась по ГОСТ 10862—64, ГОСТ 10862—72, а затем по ОСТ 11.336.038—77, ОСТ 11.396.419—81.

Согласно ГОСТ 10862—64 обозначения полупроводниковых приборов состоят из четырех элементов.

Первый элемент

Исходный материал	Условное обозначение	Исходный материал	Условное обозначение
Германий	Г	Арсенид галлия и его соединения	А
Кремний	К		

Второй элемент

Подкласс приборов	Условное обозначение	Подкласс приборов	Условное обозначение
Сверхвысокочастотные диоды	А	Стабилитроны	С
Варикапы	В	Транзисторы	Т
Выпрямительные, универсальные, импульсные диоды	Д	Управляемые многослойные переключающие приборы	У
Туннельные диоды	И	Фотоприборы	Ф
Неуправляемые многослойные переключающие приборы	Н	Выпрямительные столбы и блоки	Ц

Третий элемент

Назначение приборов	Условное обозначение
Диоды низкой и высокой частот:	
выпрямительные	101...399
универсальные	401...499
импульсные	501...599
Варикапы	101...999
СВЧ-диоды:	
смесительные	101...199
видеодетекторы	201...299
модуляторные	301...399
параметрические	401...499
переключающие	501...599
умножительные	601...699
Фотодиоды	101...199
Фототранзисторы	201...299
Управляемые многослойные переключающие приборы (тиристоры):	
малой мощности	101...199
средней мощности	201...299
большой мощности	301...399
Неуправляемые многослойные переключающие приборы (динисторы):	
малой мощности	101...199
средней мощности	201...299
большой мощности	301...399
Туннельные диоды:	
усилительные	101...199
генераторные	201...299
переключающие	301...399
Стабилитроны с напряжением стабилизации, В:	
малой мощности ($P<0,3$ Вт):	
0,1...9,9	101...199
10...99	201...299
100...199	301...399

Окончание

Назначение приборов	Условное обозначение
средней мощности (P=0,3...5 Вт):	
0,1...9,9	401...499
10...99	501...599
100...199	601...699
большой мощности (P>5 Вт):	
0,1...9,9	701...799
10...99	801...899
100...199	900...999
Выпрямительные столбы:	
малой мощности	101...199
средней мощности	201...299
Выпрямительные блоки:	
малой мощности	301...399
средней мощности	401...499
большой мощности	501...599
Транзисторы:	
малой мощности:	
низкой частоты	101...199
средней частоты	201...299
высокой и сверхвысокой частот	301...399
средней мощности:	
низкой частоты	401...499
средней частоты	501...599
высокой и сверхвысокой частот	601...699
большой мощности:	
низкой частоты	701...799
средней частоты	801...899
высокой и сверхвысокой частот	901...999

Четвертый элемент — буква, обозначающая классификационную группу прибора (разновидность типа).

Обозначения полупроводниковых приборов могут состоять также из семи элементов.

Первый элемент

Исходный материал	Условное обозначение
Германий или его соединения	Г или 1
Кремний или его соединения	К или 2
Соединения галлия (например арсенид галлия)	А или 3
Соединения индия (например фосфид индия)	И или 4

Второй элемент

Подкласс (группа) приборов	Условное обозначение
Выпрямительные, импульсные диоды, магнитодиоды, термодиоды	Д
Транзисторы (за исключением полевых)	Т
Транзисторы полевые	П
Варикапы	В
Тиристоры диодные	Н
Тиристоры триодные	У
Туннельные диоды	И
Стабилитроны, стабисторы и ограничители	С
Выпрямительные столбы и блоки	Ц
Генераторы шума	Г
Приборы с объемным эффектом (приборы Ганна)	Б
Стабилизаторы тока	К
Сверхвысокочастотные диоды	А
Излучающие оптоэлектронные приборы	Л
Оптопары	О

Третий элемент

Назначение прибора	Условное обозначение
Диоды выпрямительные с прямым током, А:	
менее 0,3	1
0,3...10	2
Диоды прочие (магнитодиоды, термодиоды и др.)	3
Диоды импульсные:	
с временем восстановления, нс:	
более 500	4
150...500	5
30...150	6
5...30	7
1...5	8
с эффективным временем жизни неосновных носителей заряда менее 1 нс	9
СВЧ-диоды:	
смесительные	1
детекторные	2
усилительные	3
параметрические	4
переключательные и ограничительные	5
умножительные и настроечные	6
генераторные	7
прочие (импульсные и др.)	8
Триодные тиристоры с максимально допустимым средним током в открытом состоянии (или импульсным), А:	
незапираемые:	
менее 0,3 (менее 15)	1
0,3...10 (15...100)	2
более 10 (более 100)	7

Окончание

Назначение приборов	Условное обозначение
средней мощности (P=0,3...5 Вт):	
0,1...9,9	401...499
10...99	501...599
100...199	601...699
большой мощности (P>5 Вт):	
0,1...9,9	701...799
10...99	801...899
100...199	900...999
Выпрямительные столбы:	
малой мощности	101...199
средней мощности	201...299
Выпрямительные блоки:	
малой мощности	301...399
средней мощности	401...499
большой мощности	501...599
Транзисторы:	
малой мощности:	
низкой частоты	101...199
средней частоты	201...299
высокой и сверхвысокой частот	301...399
средней мощности:	
низкой частоты	401...499
средней частоты	501...599
высокой и сверхвысокой частот	601...699
большой мощности:	
низкой частоты	701...799
средней частоты	801...899
высокой и сверхвысокой частот	901...999

Четвертый элемент — буква, обозначающая классификационную группу прибора (разновидность типа).

Обозначения полупроводниковых приборов могут состоять также из семи элементов.

Первый элемент

Исходный материал	Условное обозначение
Германий или его соединения	Г или 1
Кремний или его соединения	К или 2
Соединения галлия (например арсенид галлия)	А или 3
Соединения индия (например фосфид индия)	И или 4

Второй элемент

Подкласс (группа) приборов	Условное обозначение
Выпрямительные, импульсные диоды, магнитодиоды, термодиоды	Д
Транзисторы (за исключением полевых)	Т
Транзисторы полевые	П
Варикапы	В
Тиристоры диодные	Н
Тиристоры триодные	У
Туннельные диоды	И
Стабилитроны, стабисторы и ограничители	С
Выпрямительные столбы и блоки	Ц
Генераторы шума	Г
Приборы с объемным эффектом (приборы Ганна)	Б
Стабилизаторы тока	К
Сверхвысокочастотные диоды	А
Излучающие оптоэлектронные приборы	Л
Оптопары	О

Третий элемент

Назначение прибора	Условное обозначение
Диоды выпрямительные с прямым током, А:	
менее 0,3	1
0,3...10	2
Диоды прочие (магнитодиоды, термодиоды и др.)	3
Диоды импульсные:	
с временем восстановления, нс:	
более 500	4
150...500	5
30...150	6
5...30	7
1...5	8
с эффективным временем жизни неосновных носителей заряда менее 1 нс	9
СВЧ-диоды:	
смесительные	1
детекторные	2
усилительные	3
параметрические	4
переключательные и ограничительные	5
умножительные и настроечные	6
генераторные	7
прочие (импульсные и др.)	8
Триодные тиристоры с максимально допустимым средним током в открытом состоянии (или импульсным), А:	
незапираемые:	
менее 0,3 (менее 15)	1
0,3...10 (15...100)	2
более 10 (более 100)	7

Назначение прибора	Условное обозначение
запираемые:	
менее 0,3 (менее 15)	3
0,3...10 (15...100)	4
более 10 (более 100)	8
симметричные:	
менее 0,3 (менее 15)	5
0,3...10 (15...100)	6
более 10 (более 100)	9
Туннельные диоды:	
усилительные	1
генераторные	2
переключательные	3
обращенные	4
Генераторы шума:	
низкочастотные	1
высокочастотные	2
Варикапы:	
подстроечные	1
умножительные (варакторы)	2
Стабилитроны, стабисторы и ограничители с напряжением стабилизации, В:	
мощностью менее 0,3 Вт:	
менее 10	1
10...100	2
более 100	3
мощностью 0,3...5 Вт:	
менее 10	4
10...100	5
более 100	6
мощностью 5...10 Вт:	
менее 10	7
10...100	8
более 100	9
Выпрямительные столбы с прямым током, А:	
менее 0,3	1
0,3...10	2
Выпрямительные блоки с прямым током, А:	
менее 0,3	3
0,3...10	4
Транзисторы биполярные:	
маломощные с рассеиваемой мощностью $P_К<0,3$ Вт:	
низкой частоты (граничная частота $f_{гр}<3$ МГц)	1
средней частоты ($f_{гр}=3...30$ МГц)	2
высокой и сверхвысокой частот	3
средней мощности ($P_К=0,3...1,5$ Вт):	
низкой частоты	4
средней частоты	5
высокой и сверхвысокой частот	6

Назначение прибора	Условное обозначение
большой мощности ($P_К>1,5$ Вт):	
низкой частоты	7
средней частоты	8
высокой и сверхвысокой частот	9
Транзисторы полевые:	
малой мощности ($P_К<0,3$ Вт):	
низкой частоты	1
средней частоты	2
высокой и сверхвысокой частот	3
средней мощности ($P_К=0,3...1,5$ Вт):	
низкой частоты	4
средней частоты	5
высокой и сверхвысокой частот	6
большой мощности ($P_К>1,5$ Вт):	
низкой частоты	7
средней частоты	8
высокой и сверхвысокой частот	9
Источники инфракрасного излучения:	
излучающие диоды	1
излучающие модули	2
Приборы визуального представления информации:	
светоизлучающие диоды	3
знаковые индикаторы	4
знаковые табло	5
шкалы	6
экраны	7
Оптопары:	
резисторные	Р
диодные	Д
тиристорные	У
транзисторные	Т

Четвертый, пятый и шестой элементы определяют порядковый номер разработки технологического типа и обозначаются числами от 01 до 999. Для стабилитронов и стабисторов четвертый и пятый элементы определяют напряжение стабилизации, а шестой — последовательность разработки с обозначением от А до Я.

Седьмой элемент — буква (от А до Я, кроме З, О и Ч, схожих по написанию с цифрами), определяющая классификацию (разбраковку) по параметрам приборов, изготовленных по единой технологии.

Для наборов приборов (матриц), не соединенных электрически или соединенных по одноименному выводу, добавляется буква С после второго элемента обозначения.

Для сверхвысокочастотных приборов, биполярных и полевых транзисторов с парным подбором в состав обозначения вводится буква Р после последнего элемента обозначения.

Для обозначения импульсных тиристоров после второго элемента ставится буква И.

Для бескорпусных приборов после условного обозначения (через дефис) добавляется цифра, показывающая конструктивное исполнение (модификацию):

1 — с гибкими выводами без кристаллодержателя (подложки);
2 — с гибкими выводами на кристаллодержателе (подложке);
3 — с жесткими (объемными) выводами без кристаллодержателя;
4 — с жесткими (объемными) выводами на кристаллодержателе;
5 — с контактными площадками без кристаллодержателя (кристалл без выводов);
6 — с контактными площадками на кристаллодержателе (кристалл без выводов на подложке).

Если малые габаритные размеры приборов не позволяют использовать буквенное или цифровое обозначение, то на корпус наносится цветная маркировка (точка или цветные полоски). Цветной код указывается в технических условиях (ТУ).

1.2. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ

За рубежом существуют различные системы обозначений полупроводниковых приборов. Наиболее распространенной является система обозначений JEDEC, принятая объединенным техническим советом по электронным приборам США. По этой системе приборы обозначаются индексом (кодом, маркировкой), в котором первая цифра соответствует числу p-n переходов: 1 — диод; 2 — транзистор; 3 — тетрод (тиристор). За цифрой следуют буква N и серийный номер, который регистрируется ассоциацией предприятий электронной промышленности (EIA). За номером могут стоять одна или несколько букв, указывающих на разбивку приборов одного типа на типономиналы по различным параметрам или характеристикам. Однако цифры серийного номера не определяют тип исходного материала, частотный диапазон, мощность рассеяния или область применения.

Следует отметить, что в зарубежных справочниках (DATA Book) по транзисторам и диодам зарегистрирован и ряд приборов СССР со своими серийными номерами.

Фирма-изготовитель, приборы которой по своим параметрам подобны приборам, зарегистрированным EIA, может представлять свои приборы с обозначением, принятым по системе JEDEC.

В Европе кроме JEDEC широко используется система, по которой обозначения полупроводниковым приборам присваиваются организацией Association International Pro Electron. По этой системе приборы для бытовой аппаратуры широкого применения обозначаются двумя буквами и тремя цифрами, для промышленной и специальной аппаратуры — тремя буквами и двумя цифрами. Так, у приборов широкого применения после двух букв стоит трехзначный порядковый номер от 100 до 999. У приборов, применяемых в промышленной и специальной аппаратуре, третий знак — буква (буквы используются в обратном алфавитном порядке: Z, Y, X и т. д.), за которой следует порядковый номер от 10 до 99.

Если в одном корпусе имеется несколько одинаковых приборов, то обозначение производится в соответствии с кодом (маркировкой) для одиночных дискретных приборов. При наличии в одном корпусе нескольких разных приборов в качестве второй буквы обозначения используется буква G. К основному обозначению может добавляться буква, указывающая на отличие прибора от основного типа по каким-либо параметрам или корпусу.

В системе Pro Electron приняты следующие условные обозначения:

Первый элемент

Исходный материал	Ширина запрещенной зоны, эВ	Условное обозначение
Германий	0,6...1	A
Кремний	1...1,3	B
Арсенид галлия	более 1,3	C
Антимонид индия	менее 0,6	D

Примечание. Приборы на основе других полупроводниковых материалов обозначаются буквой R.

Второй элемент

Подкласс приборов	Условное обозначение
Диоды детекторные, быстродействующие, смесительные	A
Диоды с переменной емкостью	B
Транзисторы низкочастотные маломощные ($R_{thja}>15°$ С/Вт)	C
Транзисторы низкочастотные мощные ($R_{thja}<15°$ С/Вт)	D
Диоды туннельные	E
Транзисторы высокочастотные маломощные ($R_{thja}>15°$ С/Вт)	F
Генераторные диоды, сложные приборы (в одном корпусе несколько различных приборов)	G
Измерители напряженности поля (магниточувствительные диоды)	H
Генератор Холла (приборы на основе эффекта Холла)	K
Транзисторы высокочастотные мощные ($R_{thja}<15°$ С/Вт)	L
Модуляторы и умножители на основе эффекта Холла	M
Светочувствительные (фотоприемные) приборы (фотодиоды, фототранзисторы и др.)	P
Излучающие приборы	Q
Приборы, работающие в области пробоя	R
Транзисторы переключающие маломощные	S
Регулирующие и переключающие приборы, мощные управляемые выпрямители ($R_{thja}<15°$ С/Вт)	T
Транзисторы переключающие мощные	U
Диоды умножительные	X
Диоды выпрямительные мощные	Y
Стабилитроны	Z

Для некоторых типов приборов, таких как стабилитроны, мощные диоды и тиристоры, может применяться дополнительная классификация, согласно которой к основному пятизначному обозначению через дефис или дробь добавляется дополнительный код. Например, для стабилитронов дополнительный код содержит сведения о номинальном напряжении и его допусках в процентах. Первая буква указывает допуск: A — 1%, B — 2%, C — 5%, D — 10%, E — 15%. После буквы в дополнительном коде следует номинальное напряжение в вольтах. Если это не целое

число, то вместо запятой ставится буква V. Например, BZY85-C6V8 — это кремниевый стабилитрон специального назначения с регистрационным номером 85, напряжением стабилизации 6,8 В и допуском на напряжение ±5%.

В дополнительном коде для выпрямительных диодов указывается максимальная амплитуда обратного напряжения, для тиристоров — меньшее из значений максимального напряжения включения или максимальной амплитуды обратного напряжения. Например, BTX10-200 — это кремниевый управляемый выпрямитель (тиристор) специального назначения с регистрационным номером 10 и напряжением 200 В. В конце дополнительного обозначения может стоять буква R, обозначающая соединение анода с корпусом. Соединение катода с корпусом и симметричное исполнение выводов в коде не указываются.

Система Pro Electron широко применяется в ФРГ, Франции, Италии, ВНР, ПНР и других странах. Она заменила старую европейскую систему, по которой после начальной буквы О следовали буквы, указывающие основной класс приборов: А — диод; АР — фотодиод; AZ — стабилитрон; С — транзистор; СР — фототранзистор; RP — фотопроводящий элемент.

В основе новой системы обозначений приборов ПНР лежит система Pro Electron. Ее отличие состоит в том, что перед тремя цифрами для приборов широкого применения дополнительно ставится буква Р и перед двумя цифрами для приборов промышленного назначения — буквы YP. Вместо Y может стоять буква Z, X или W. Например BZXP21-B4V7 — стабилитрон промышленного назначения с номинальным значением напряжения стабилизации 4,7 В и допуском ±2%. Для новых приборов широкого применения принято после букв располагать цифры от 600 до 699, для приборов промышленного применения — от 1 до 99.

Первые буквы маркировки G, К полупроводниковых приборов ЧССР и G, S приборов ГДР обозначают тип исходного материала (германий и кремний соответственно), остальная часть кода соответствует системе Pro Electron.

По существующей в настоящее время в Японии системе стандартных обозначений (стандарт JIS-C-7012, принятый ассоциацией EIAJ — Electronic Industries Association of Japan) можно определить класс прибора (диод или транзистор), его назначение, тип проводимости. Вид полупроводникового материала в этой системе не отражается. Условное обозначение состоит из пяти элементов.

Первый элемент

Класс прибора	Условное обозначение
Фотодиоды, фототранзисторы	0
Диоды	1
Транзисторы	2
Четырехслойные приборы	3

Второй элемент, указывающий на то, что данный прибор является полупроводниковым, обозначается буквой S (Semiconductor).

Третий элемент

Подкласс приборов	Условное обозначение
Транзисторы p-n-p высокочастотные	A
Транзисторы p-n-p низкочастотные	B
Транзисторы n-p-n высокочастотные	C
Транзисторы n-p-n низкочастотные	D
Диоды Есаки	E
Тиристоры	F
Диоды Ганна	G
Однопереходные транзисторы	H
Полевые транзисторы с p-каналом	I
Полевые транзисторы с n-каналом	K
Симметричные тиристоры	M
Светоизлучающие диоды	Q
Выпрямительные диоды	R
Малосигнальные диоды	S
Лавинные диоды	T
Диоды с переменной емкостью, pin-диоды, диоды с накоплением заряда	V
Стабилитроны	Z

Примечание. У фототранзисторов и фотодиодов третий член маркировки отсутствует.

Четвертый элемент обозначает регистрационный номер и начинается с числа 11.

Пятый элемент отражает усовершенствование (А и В — первая и вторая модификации).

После маркировки могут быть дополнительные индексы (N, M, S), отражающие требования специальных стандартов.

Кроме вышеуказанных систем стандартных обозначений, изготовители приборов широко используют внутренние (внутрифирменные) обозначения. В этом случае за основу буквенного обозначения чаще всего берется принцип сокращенного названия фирмы, коды материала и применения (см. приложения 5, 6).

Фирма NEC (Япония) маркирует свои приборы следующим образом.

Подкласс приборов	Условное обозначение
Лавинно-пролетные диоды	AD
Диоды Ганна	GD
Смесительные германиевые диоды	GH
Фототранзисторы	PH
Фотоприемники (оптопары)	PS
Стабилитроны	RD
Малосигнальные диоды	SD
Инфракрасные диоды	SE
Светодиоды зеленого цвета свечения	SG

Окончание

Подкласс приборов	Условное обозначение
Точечно-контактные кремниевые диоды	SH
Арсенид-галлиевые диоды с барьером Шотки	SM
Светодиоды красного цвета свечения	SR
Варакторы	SV
Светодноды желтого цвета свечения	SY
Новые полупроводниковые приборы	V
Варисторы	VD

Следует отметить, что внутрифирменные обозначения достаточно многочисленны.

1.3. СИСТЕМЫ ЦВЕТНОГО КОДИРОВАНИЯ ДИОДОВ

Для маркировки малогабаритных полупроводниковых диодов вместо цифровых и буквенных обозначений часто используется цветное кодирование.

По системе Pro Electron (рис. 1) первым двум буквам соответствует первая широкая полоса (AA — черная, BA — красная), третьей — вторая широкая полоса (Z — белая, Y — серая, X — черная, W — синяя, V — зеленая, T — желтая, S — оранжевая). Узкие полосы соответствуют цифрам.

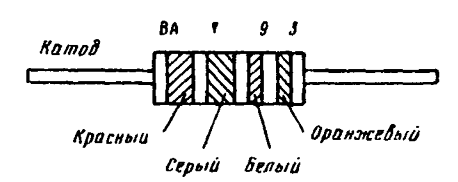


Рис. 1. Пример цветной маркировки по системе Pro Electron

Цифра	Цвет	Цифра	Цвет
0	Черный	5	Зеленый
1	Коричневый	6	Снний (голубой)
2	Красный	7	Фиолетовый
3	Оранжевый	8	Серый
4	Желтый	9	Белый

В отличие от системы Pro Electron, в системе JEDEC одна широкая полоса (рис. 2). При использовании цветного кода в обозначении диодов по системе JEDEC первая цифра и буква N опускаются. Следующий за буквой N типовой номер, состоящий из двух, трех или четырех цифр, обозначается цветными полосами по следующим правилам.

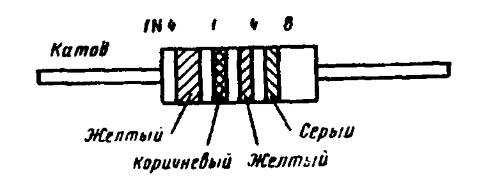


Рис. 2. Пример цветной маркнровкн по системе JEDEC

1. Номера, состоящие из двух цнфр, обозначаются одной (первой) черной полосой и двумя (второй и третьей) цветными, соответствующими цифрам. Если в обозначеиии имеется буква, то используется четвертая полоса.

2. Номера из трех цифр обозначаются тремя цветными полосами, соответствующимн цифрам. Четвертая полоса обозначает букву.

3. Номер, состоящий из четырех цифр, обозначается четырьмя цветными полосами и пятой черной. Если после цифр требуется обозначить букву, то используют пятую цветную полосу (вместо черной).

4. Для обозначения полярности цветные полосы либо смещаются ближе к катоду, либо первая от катода делается более широкой (двойной ширины).

5. Тнп полупроводннкового диода читается по цветным полоскам от катода.

В системе JEDEC цветное обозначение цифр такое же, как в системе Pro Electron.

1.4. УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ

Ниже приводятся графические обозначения полупроводниковых приборов, принятые за рубежом, а также в соответствии с ГОСТ 2.730—73.

Условное графическое обозначение	Наименование
	Выпрямительный диод
	Туннельный диод
	Обращенный диод
	Односторонний стабилитрон
	Двусторонний стабилитрон

Продолжение

Условное графическое обозначение	Наименование
	Варикап
	Двунаправленный диод
	Диодный тиристор
	Симметричный диодный тиристор
	Триодный тиристор, запираемый в обратном направлении, выключаемый, с управлением по аноду
	Триодный тиристор, запираемый в обратном направлении, с управлением по аноду
	Триодный тиристор, запираемый в обратном направлении, выключаемый, с управлением по катоду
	Триодный тиристор, запираемый в обратном направлении, с управлением по катоду
	Транзистор типа p-n-p
	Транзистор типа n-p-n
	Лавинный транзистор типа n-p-n
	Однопереходный транзистор с n-базой

Окончание

Условное графическое обозначение	Наименование
	Однопереходный транзистор с p-базой
	Транзистор двухэмиттерный типа p-n-p
	Полевой транзистор с каналом n-типа
	Полевой транзистор с каналом p-типа
	Полевой транзистор с изолированным затвором обогащенного типа с n-каналом
	Полевой транзистор с изолированным затвором обогащенного типа с p-каналом
	Полевой транзистор с изолированным затвором обедненного типа с n-каналом
	Полевой транзистор с изолированным затвором обогащенного типа с n-каналом и с внутренним соединением подложки и истока
	Полевой транзистор с изолированным затвором обедненного типа с p-каналом
	Полевой транзистор с двумя изолированными затворами обедненного типа с n-каналом и с выводом от подложки

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, РЕЖИМЫ РАБОТЫ И ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ

2.1. ОСОБЕННОСТИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ

Система и перечень параметров, включаемых в ТУ, характеризующие свойства полупроводниковых приборов, выбираются с учетом их физико-технологических особенностей и схемного назначения. В большинстве случаев необходимы сведения об их статических, динамических и предельных параметрах. Статические параметры характеризуют поведение приборов при постоянном токе, динамические — их частотно-временные свойства, предельные параметры определяют область устойчивой и надежной работы. Способность полупроводниковых приборов работать в широком диапазоне токов и напряжений, отсутствие четко выраженных границ типовых режимов и чувствительность к электрическим перегрузкам обусловливают соблюдение норм параметров, установленных ТУ на конкретный тип прибора. В технической документации на приборы невозможно предусмотреть все случаи их практического использования, а введение в ТУ дополнительного гарантированного параметра сопровождается усложнением технологического цикла и повышением стоимости приборов.

В справочники, стандарты или ТУ на полупроводниковые приборы включается необходимая для детального расчета схем информация о параметрах: нормы на значения параметров, режимы их измерений, вольт-амперные характеристики, зависимости параметров от режима и температуры, максимальные и максимально допустимые значения параметров, конструктивно-технологические особенности приборов, их основное назначение, специфические требования, методы измерения параметров, типовые схемы применения.

Постоянные (случайные) изменения технологических факторов оказывают существенное влияние на значения параметров изготавливаемых приборов. Поэтому значения параметров даже одного типа приборов являются случайными величинами, т. е. имеется отклонение от среднего (типового, номинального) уровня. Для некоторых параметров устанавливаются граничные (предельные) значения (нормы) и возможные отклонения (разброс). Нормы на разброс параметров устанавливаются на основе экспериментально-статистических данных при обеспечении надежной и устойчивой работы приборов в различных условиях и режимах применения, а также исходя из экономических соображений.

В зависимости от технологии и качества изготовления приборы имеют различные диапазоны разброса параметров. Наименьший разброс у планарных приборов, наибольший — у сплавных. Для одних параметров ($K_ш$, $I_{КБО}$, $C_к$, $r_б'C_к$, $U_{КЭ\,нас}$) предусматривается одностороннее ограничение (по минимуму или максимуму), для других ($h_{21э}$, $H_{21э}$, $U_{ст}$) — двустороннее.

Параметры полупроводниковых приборов зависят от режима работы (тока, напряжения, частоты сигнала, температуры) и изменяются во времени. Изменение параметров во времени обусловлено температурно-зависимыми процессами на поверхности и в объеме полупроводника.

Параметры диодов и транзисторов, определяемые геометрией конструкции (длиной, шириной, площадью или объемом отдельных областей): емкости переходов,

распределенное сопротивление базы, частотные характеристики — подвержены меньшим изменениям, чем параметры, зависящие от состояния поверхности. Состояние поверхности определяет значения и стабильность обратных токов, коэффициент усиления, пробивные напряжения.

В процессе старения ухудшаются электрические свойства приборов (увеличиваются обратные токи, уменьшаются коэффициент усиления и предельные напряжения переходов). Поэтому, если требуется долговременная стабильность свойств, приборы не должны подвергаться воздействию больших и длительных электрических нагрузок.

Значения параметров полупроводниковых приборов гарантируются для различных значений температуры (отрицательных и положительных). Зависимости параметров от температуры являются, как правило, нелинейными.

Необходимо отметить, что вследствие постоянного совершенствования конструкций и технологии изготовления приборов происходят изменения средних значений параметров. Некоторые образцы приборов имеют параметры лучше, чем приведенные в ТУ и справочниках.

В разных странах существуют региональные унифицированные стандарты на параметры и характеристики приборов, методики их измерений и контроля качества, которые могут существенно отличаться от международных стандартов.

2.2. МАКСИМАЛЬНЫЕ И МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Максимальные (предельные) параметры определяют режимы, при которых работа прибора недопустима, так как прибор может выйти из строя или могут возникнуть необратимые изменения его свойств.

Максимально допустимые (предельно допустимые) параметры — это параметры (мощность, напряжение, ток, температура), при которых гарантируется стабильная и надежная работа данного прибора. Они устанавливаются с запасом по отношению к максимальным. Необходимый запас выявляется в результате длительных испытаний на надежность с учетом погрешностей измерения, нестабильности в процессе испытаний, возможности случайных колебаний технологического процесса. Не рекомендуется использовать полупроводниковые приборы в совмещенных предельно допустимых режимах и при длительной работе даже в одном предельно допустимом режиме, так как снижается надежность их работы.

2.3. РАССЕИВАЕМАЯ МОЩНОСТЬ

Рассеиваемая мощность определяется физическими свойствами полупроводникового материала, геометрическими, конструктивно-технологическими и тепловыми характеристиками прибора. Мощность, рассеиваемая диодом, равна сумме мощностей, рассеиваемых при прохождении тока в прямом и обратном направлениях: $P_д = P_{пр} + P_{обр} \approx P_{пр}$ (величиной $P_{обр}$ во многих случаях можно пренебречь из-за ее малости). Мощность, рассеиваемая транзистором, состоит из мощностей, выделяемых на переходах коллектор — база и эмиттер — база: $P_{общ} = P_Э + P_К = I_Б U_{БЭ} + I_К U_{КЭ} \approx P_К$ (часто величиной $P_Э$ можно пренебречь, так как $P_Э \ll P_К$).

Различают максимально допустимую рассеиваемую мощность в статическом и импульсном режимах. В последнем случае она зависит от формы, длительности,

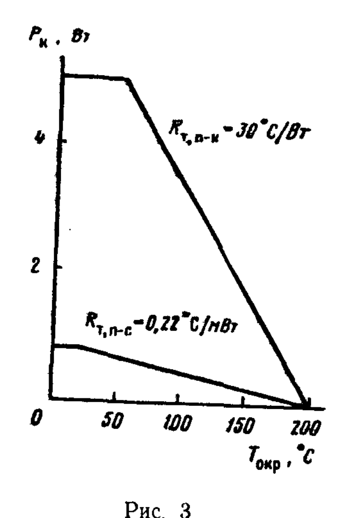


Рис. 3

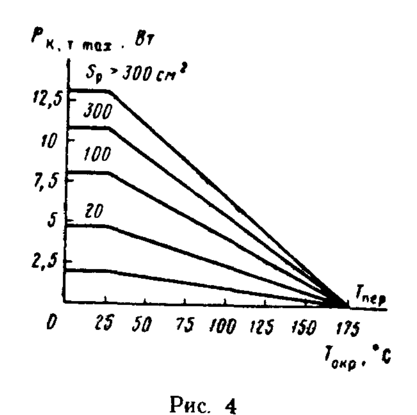


Рис. 4

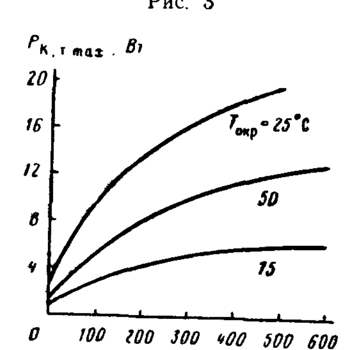


Рис. 5

Рис. 3. Зависимость рассеиваемой мощности от температуры

Рис. 4. Зависимость рассеиваемой мощности от температуры при различных значениях и площади радиатора $S_р$

Рис. 5. Зависимость мощности рассеяния от площади радиатора при различных значениях температуры

частоты и скважности импульсов. При тепловом равновесии рассеиваемая мощность расходуется на нагревание и влияет на температуру перехода при заданной температуре окружающей среды $T_{окр}$ или температуре корпуса $T_к$.

Максимальная мощность, рассеиваемая диодом или транзистором, ограничивается максимальной температурой перехода $T_п$, а также рядом специфических процессов, определяющих максимальные напряжения и токи. Зависимость между максимальной (максимально допустимой) мощностью рассеяния и максимальной температурой перехода для прибора без радиатора (теплоотвода) имеет вид $P_{K\ max}=(T_п-T_{окр})/R_{т,\ п-с}$, где $R_{т,\ п-с}$ — тепловое сопротивление переход – среда.

Для приборов, работающих с внешним теплоотводом, $P_{K,т\ max}=(T_п-T_к)R_{т,\ п-к}$, где $R_{т,\ п-к}$ — тепловое сопротивление переход — корпус. Максимальная (максимально допустимая) мощность при увеличении $T_{окр}$ или $T_к$ линейно уменьшается. Она рассчитывается в соответствии с указанными формулами или находится из типовых зависимостей, которые приводятся для конкретных приборов (рис. 3). Для мощных транзисторов значения $P_{K,\ т\ max}$ приводятся в справоч-

никах при условии идеального отвода тепла или для радиаторов различных размеров (рис. 4, 5). Максимально допустимая мощность, в отличие от максимальной, приводится с запасом, гарантирующим заданную надежность.

2.4. ПРОБИВНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ) И МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ

Максимальное напряжение, которое может выдерживать диод или транзистор, ограничивается явлением пробоя. Пробой p-n перехода выражается в резком увеличении обратного тока при достижении обратным напряжением определенного (критического) значения. Различают электрический и тепловой пробои. Механизм пробоя определяется физическими параметрами исходного материала, типом проводимости, мощностью прибора, конструктивно-технологическими факторами, внешними условиями и другими причинами.

Существуют два вида электрического пробоя: туннельный (зенеровский) и лавинный, связанные с увеличением напряженности электрического поля в p-n переходе. Туннельный и лавинный пробои различаются знаками температурного коэффициента напряжения (ТКН) — отрицательным для туннельного (он уменьшается с ростом температуры) и положительным для лавинного (он увеличивается с ростом температуры). Электрический пробой определяется характеристиками p-n перехода (шириной, объемными и поверхностными свойствами, удельным сопротивлением исходного материала). Оба вида электрического пробоя находят применение в стабилитронах: в области пробоя напряжение слабо зависит от тока, что и определяет стабилизацию напряжения.

Тепловой пробой возникает из-за потери устойчивости теплового режима работы и появления теплоэлектрической обратной связи. При плохих условиях теплопередачи от перехода происходит повышение его температуры (саморазогрев) и возможно разрушение прибора из-за перегрева (общего или локального). На вольт-амперной характеристике появляется участок с отрицательным дифференциальным сопротивлением. Вероятность возникновения теплового пробоя существенно зависит от теплового сопротивления прибора, внешних условий, схемы включения, элементов входной цепи, рабочего тока и напряжения на приборе. Чем выше $T_{п\ max}$ и ниже обратные токи и тепловые сопротивления, тем более устойчивы к тепловому пробою приборы. Теплового пробоя можно избежать, обеспечив тепловую стабильность режима работы прибора, т. е. хороший теплообмен. Напряжения теплового пробоя значительно больше напряжений лавинного и туннельного пробоев для кремниевых приборов.

Транзисторы и диоды характеризуются максимальными (пробивными) напряжениями переходов ($U_{КБО\ проб}$, $U_{ЭБО\ проб}$, $U_{обр}$). Кроме того, максимальное напряжение коллектор — эмиттер зависит от схемы, в которой применяется транзистор,— от условий во входной цепи (между эмиттером и базой), т. е. от значений сопротивлений $R_{бэ}$ и $R_э$ и напряжения смещения. Значения напряжения коллектор — эмиттер для произвольной схемы ($U_{КЭR\ проб}$, $U_{КЭК\ проб}$, $U_{КЭV\ проб}$) находятся в интервале между значениями напряжений $U_{КЭО\ проб}$ и $U_{КБО\ проб}$. Пробивное напряжение $U_{КЭО\ проб}$ является наименьшим из всех возможных пробивных напряжений коллектор — эмиттер и соответствует наихудшим условиям на входе, когда цепь базы отключена ($R_{бэ}=\infty$), т. е. $U_{КБО\ проб}>U_{КЭХ\ проб}>U_{КЭК\ проб}>U_{КЭR\ проб}>U_{КЭО\ проб}$ (рис. 6). Схемы измерения пробивных напряжений и об-

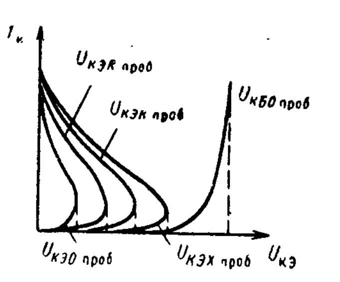


Рис. 6. Выходные вольт-амперные характеристики транзистора в области пробоя при различных условиях на входе

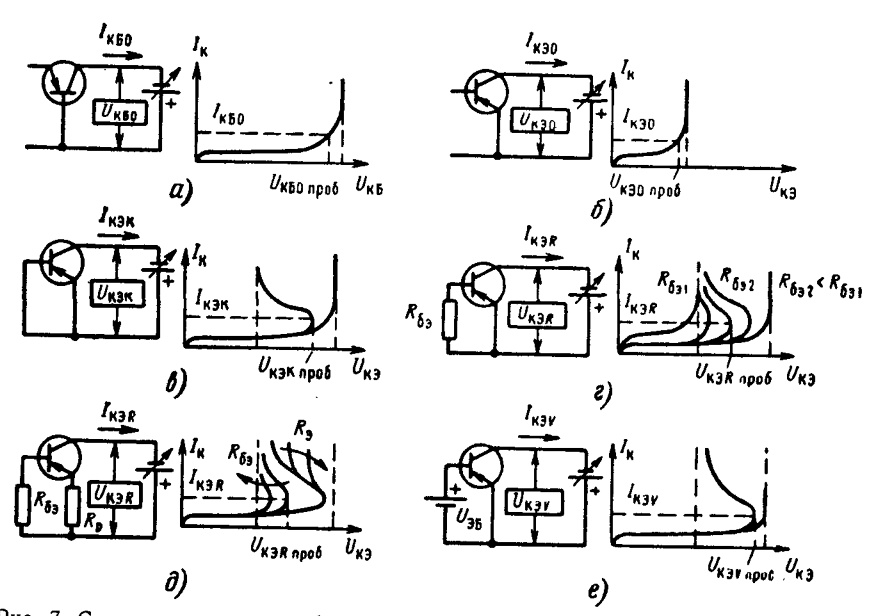


Рис. 7. Схемы измерения пробивных напряжений и обратных токов при различных условиях на входе

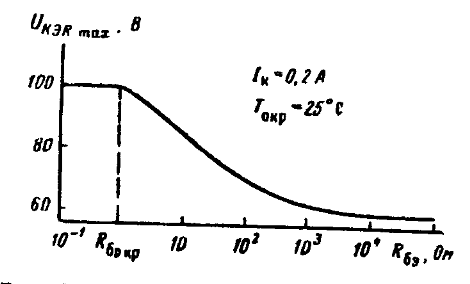


Рис. 8. Зависимость пробивного напряжения от сопротивления резистора в цепи базы

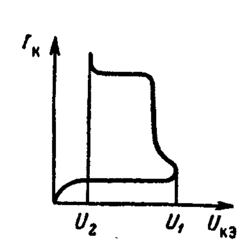


Рис. 9. Форма вольт-амперной характеристики в области второго пробоя (U_1 и U_2 — напряжения первого и второго пробоя)

ратных токов приведены на рис. 7, а — е. Для обеспечения стабильной и надежной работы транзисторов рабочее напряжение коллектор — эмиттер выбирают меньше $U_{КЭО\ проб}$. Изменение напряжения коллектор — эмиттер от сопротивления $R_{бэ}$ и $R_э$ характеризуется зависимостью $U_{КЭR\ проб}$ от этих сопротивлений. Имеется критическое сопротивление в цепи базы $R_{бэ\ кр}$, при котором начинается снижение допустимого рабочего напряжения (рис. 8). Чем больше $R_{бэ}$, тем сильнее зависимость $U_{КЭR\ проб}$ от температуры. Сопротивление $R_{бэ}$ существенно изменяет $U_{КЭR\ проб}$, если оно сравнимо или больше входного сопротивления транзистора. При включении сопротивления $R_э$ входное сопротивление увеличивается, поэтому возможно увеличение $R_{бэ}$ (см. рис. 7, д).

Напряжение $U_{КЭК\ проб}$ используется для расчета схем с трансформатором или резонансным контуром на входе; напряжение $U_{ЭБО\ проб}$ — для расчета напряжения запирания переключающих или усилительных схем при работе с отсечкой коллекторного тока; напряжение $U_{КБО\ проб}$ — для расчета режимов работы запертого транзистора и схем с общей базой.

Пробивные напряжения переходов устанавливаются при определенном значении тока (например, для маломощных транзисторов напряжение $U_{КБО\ проб}$ фиксируется при токах от 1 до 200 мкА). Пробивные напряжения снижаются, если повышается температура, т. е. приборы могут выйти из строя при напряжениях, безопасных при нормальной температуре.

Максимально допустимые напряжения устанавливаются по наименьшим из измеренных значений пробивных напряжений с некоторым запасом для обеспечения надежной работы приборов. Максимальные и максимально допустимые напряжения определяют верхнюю допустимую границу рабочего диапазона обратных напряжений диодов и транзисторов.

При некотором сочетании параметров (при больших напряжениях и токах, даже не превышающих предельных значений) у любого транзистора в активном режиме при прямом или обратном (в режиме отсечки) смещении на переходе эмиттер — база может возникнуть второй пробой (рис. 9). Поэтому изготовители приборов определяют области их безопасной работы, исключающие этот вид пробоя, сходного с тепловым. Кроме того, созданы транзисторы с повышенной устойчивостью ко второму пробою (например, транзисторы с эпитаксиальной базой, с балластными стабилизирующими резисторами в цепях эмиттеров). Существуют также схемные решения, уменьшающие вероятность возникновения второго пробоя. В большей степени второму пробою подвержены транзисторы, работающие с индуктивной нагрузкой в ключевом режиме (при запирании). Вследствие второго пробоя значительно сужается область безопасной работы мощных высокочастотных транзисторов. Даже при наличии запасов по предельным параметрам они могут выйти из строя при средней мощности, меньшей предельно допустимой. Часто в ТУ для прямого смещения приводятся значения тока, при которых происходит второй пробой.

2.5. МАКСИМАЛЬНЫЕ ТОКИ

Максимальный ток, протекающий через полупроводниковый прибор, определяется допустимой рассеиваемой мощностью, коэффициентом усиления, уменьшающимся при увеличении тока $I_К$ (например до значения $h_{21э} < 10$), критическим током, при котором происходит второй пробой, сопротивлением $r_{кэ\ нас}$ транзисто-

ра и постоянным прямым напряжением $U_{пр}$ диода. Поэтому для увеличения максимального тока стараются уменьшить $r_{кэ\ нас}$ и $U_{пр}$, увеличить рассеиваемую мощность (т. е. уменьшить тепловое сопротивление, увеличить допустимую температуру перехода), повысить устойчивость ко второму пробою, уменьшить снижение коэффициента усиления при увеличении тока $I_К$. Максимально допустимый ток устанавливается через максимальный с учетом коэффициента запаса.

Максимальный ток базы ограничивается сопротивлениями вывода и контактов базы. Ограничение максимального тока коллектора, как правило, наступает раньше, чем достигается максимальный ток базы.

Максимально допустимый ток через выпрямительный диод приходится выбирать с очень большим запасом по сравнению с максимальным (разрушающим) током. Дело в том, что при включении схемы выпрямителя через диоды за первые несколько периодов проходят большие импульсы тока, заряжающего конденсаторы фильтра. Например, при среднем выпрямленном токе 300...500 мА амплитуды импульсов тока могут достигать 3...5 А. При подборе аналогов следует иметь в виду, что некоторые зарубежные фирмы выбирают запасы по максимальному току, значительно меньше, чем это принято в СССР (соответственно даются и более узкие диапазоны температуры внешней среды или корпуса). Поэтому могут быть случаи, когда аналогичный по току отечественный выпрямительный диод имеет габаритные размеры много большие, чем зарубежный.

2.6. ТЕПЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

К тепловым параметрам приборов относятся минимальная $T_{п\ min}$ и максимальная $T_{п\ max}$ температуры перехода, тепловые сопротивления $R_т$, тепловые постоянные времени $\tau_т$ и теплоемкости $C_т$. Они определяют стабильность работы полупроводниковых приборов при изменении температуры, ограничивают максимальные мощности, токи и напряжения, допустимые диапазоны температур окружающей среды, при которых обеспечивается надежная работа. В частности, параметры $R_т$, $\tau_т$, $C_т$ позволяют определять нагрев транзистора или диода в рабочем режиме.

Как уже отмечалось, максимальная мощность полупроводниковых приборов в различных условиях эксплуатации ограничивается максимальной температурой перехода, при достижении которой либо резко ухудшаются их параметры, либо они выходят из строя из-за теплового пробоя переходов. При постоянных условиях окружающей среды $T_п$ является функцией электрической мощности $P=UI$, приложенной к прибору, и зависит от его структуры, теплофизических характеристик материалов (типа исходного материала, степени его легирования, состояния поверхности) и других технологических факторов. Кремниевые p-n переходы сохраняют свои свойства до температуры 150...200 °С, германиевые — до 70...120°С.

В процессе работы на p-n переходах выделяется основная мощность и происходит повышение температуры. Так как p-n переход нагревается до температуры, большей, чем температура корпуса и окружающей среды, то для полупроводниковых приборов устанавливается диапазон максимально допустимой окружающей температуры: для кремниевых приборов −60...+125 °С, для германиевых −60...+70° С. Связь между $T_п$ и $T_{окр}$ описывается формулой $T_п-T_{окр}=R_тP$, где $R_т$ показывает возрастание температуры на единицу рассеиваемой мощности.

Приводимые в справочниках значения $T_{п\ max}$ определяются экспериментально или рассчитываются и имеют запас по сравнению со значением температуры, при которой наступает разрушение прибора.

Измерять $T_п$ прямыми методами сложно, поэтому используются косвенные методы, при которых она оценивается по значению какого-либо термочувствительного параметра. Термочувствительными параметрами диодов являются обратный ток $I_{обр}$ и прямое напряжение $U_{пр}$, а транзисторов — обратные токи $I_{КБО}$, $I_{ЭБО}$, напряжения $U_{ЭБ}$, $U_{КБ}$, коэффициент передачи тока $h_{21э}$, входное сопротивление. Температуру рабочих областей полупроводниковых приборов измеряют и другими методами, например методом регистрации инфракрасного излучения, физическим (термопарой).

Теплообмен между переходом и окружающей средой принято характеризовать тепловым сопротивлением прибора — сопротивлением элементов конструкции распространению тепла от перехода к корпусу и теплоотводу, которое определяется конструкцией прибора, теплопроводностью ее элементов и системой охлаждения корпуса. Тепловое сопротивление переход — среда $R_{т,\ п-с}$ необходимо знать для расчета допустимой рассеиваемой мощности маломощных диодов и транзисторов, обычно работающих без теплоотвода, а тепловое сопротивление переход — корпус

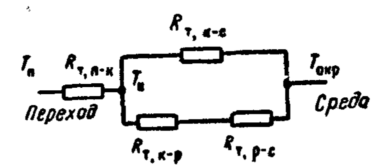


Рис. 10. Тепловая эквивалентная схема транзистора с теплоотводом ($R_{т,\ п-к}$, $R_{т,\ к-с}$, $R_{т,\ к-р}$, $R_{т,\ р-с}$ — тепловые сопротивления переход — корпус, корпус — среда, корпус — радиатор, и радиатор — среда соответственно)

$R_{т,\ п-к}$ — для расчета режима работы мощных приборов при наличии внешнего радиатора (рис. 10). Обычно $R_{т,\ п-с} \gg R_{т,\ п-к}$ (сопротивление $R_{т,\ п-к}$ остается постоянным только в случае работы при малых плотностях тока). Тепло от кристалла с переходами к корпусу или радиатору отводится за счет теплопроводности, а от корпуса в окружающее пространство — конвекцией и излучением.

Для охлаждения корпуса мощного прибора вместо радиатора может использоваться поток жидкости или газа. При применении радиатора нагрев полупроводникового прибора зависит от качества теплового контакта корпуса с радиатором, т. е. сопротивление корпус — среда $R_{т,\ к-с}$ зависит от типа радиатора, метода крепления, чистоты сопрягающихся поверхностей, усилия, с которым прижимается прибор (контактного давления). Для уменьшения контактного сопротивления применяются специальные смазки (например, кремнийорганические) и пасты, заполняющие пустоты между контактирующими поверхностями, а также прокладки из мягких, легко деформируемых металлов: свинца, индия, меди, алюминия.

Тепловые постоянные времени переход — корпус $\tau_{т,\ п-к}$ и корпус — среда $\tau_{т,\ к-с}$ используются для расчета теплового режима приборов в динамическом режиме и характеризуют скорость нарастания температуры отдельных участков объема полупроводникового прибора, когда температура перехода значительно изменяется за период действия импульсной мощности. Постоянная времени $\tau_{т,\ п-к}$ определяется по переходным тепловым характеристикам нагревания или остывания приборов и зависит от типа материала и конструкции приборов; $\tau_{т,\ к-с}$ зависит от способа отвода тепла от прибора. Постоянная времени переход — среда $\tau_{т,\ п-с}$ характеризует время установления теплового режима диодов и транзисторов без теплоотвода.

Значения теплоемкостей переход — корпус $C_{т,\ п-к}$ и корпус — среда $C_{т,\ к-с}$ необходимы при определении тепловых режимов в случае работы приборов при малых длительностях импульсов. Они определяются экспериментально.

Для приборов средней и большой мощностей, используемых с радиатором, обычно оговаривается предельная температура корпуса прибора.

Для зарубежных приборов часто указывается максимальная температура хранения T_{stg}, которая является предельной температурой перехода данного прибора. При бо́льших температурах даже в нерабочем состоянии могут происходить необратимые изменения свойств прибора. При высокой температуре активизируется действие примесей на поверхности кристалла, поэтому скорость деградации электрических параметров выше, чем при низких температурах.

2.7. КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕДАЧИ ТОКА

Коэффициент передачи $h_{21э}$ транзистора зависит от тока коллектора (эмиттера); с увеличением тока $I_К$ ($I_Э$) он сначала возрастает, достигает максимума, а затем уменьшается. В зависимости от технологии изготовления максимум кривой $h_{21э}=\varphi(I_К)$ может быть резко выраженным или размытым (рис. 11). Например, максимум этой кривой у меза-транзисторов достигается при токах, на 1—2 порядка больших, чем у сплавных. После прохождения максимума $h_{21э}$ уменьшается при-

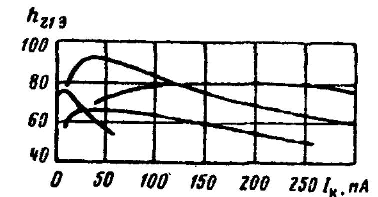


Рис. 11. Типовые зависимости коэффициента передачи от тока коллектора

близительно обратно пропорционально $I_К$. Такая неравномерность усиления в диапазоне токов является источником нелинейных искажений. В мощных транзисторах спад коэффициента передачи происходит более резко, чем в маломощных. Особенно резкий спад происходит у сплавных кремниевых p-n-p транзисторов (из-за физико-технологических причин). Поэтому не удалось создать такие транзисторы на большие рабочие токи.

У сплавных приборов $h_{21э}$ растет с увеличением напряжения на коллекторе $U_К$, у диффузионных эта зависимость слабо выражена (она наблюдается лишь при малых напряжениях на коллекторе). С ростом температуры $h_{21э}$ обычно увеличивается (рис. 12).

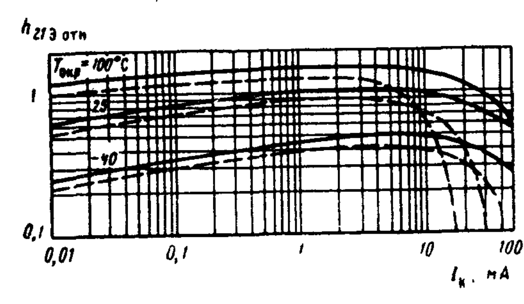


Рис. 12. Зависимость относительного коэффициента передачи от тока коллектора, при различных значениях температуры и напряжения (— — — $U_{КЭ}=1$ В, ——— $U_{КЭ}=10$ В)

2.8. ЕМКОСТИ ПЕРЕХОДОВ И ПОСТОЯННАЯ ВРЕМЕНИ КОЛЛЕКТОРА

Емкости p-n переходов влияют на частотные и импульсные характеристики полупроводниковых приборов. Обычный p-n переход подобен конденсатору, емкость которого меняется при изменении приложенного напряжения. Эта емкость состоит из двух компонентов, проявляющихся при работе диода в прямом и обратном направлениях,— барьерной и диффузионной емкостей. Барьерная (зарядная) емкость $C_б$ не зависит от тока через переход и является функцией частоты и обратного приложенного напряжения. Диффузионная емкость $C_д$ пропорциональна прямому току (даже при небольших прямых токах $C_д > C_б$) и также зависит от частоты. Емкость p-n перехода при прямом смещении диода равна сумме $C_д$ и $C_б$, при обратном — приблизительно емкости $C_б$, так как в этом случае емкость $C_д$ пренебрежимо мала.

Обычно в ТУ на прибор даются зависимости емкостей от напряжений, приложенных к переходам. На рис. 13 приведена зависимость $C_к(U_{КБ})$. С увеличением напряжения емкость нелинейно уменьшается. Емкость $C_к$ равна разности измерений выходной емкости $C_{22э}$ и паразитной емкости ножки корпуса.

Постоянная времени $\tau_к = r'_б C_к$, где $r'_б$ — сопротивление базы, характеризует внутреннюю обратную связь в транзисторе и определяет частотные и усилительные свойства, максимальную частоту генерации и коэффициент усиления по мощности на высокой частоте. Кроме того, чем меньше его значение, тем выше устойчивость к самовозбуждению транзистора в усилителе. Через параметры $\tau_к$ и $C_к$ можно определить сопротивление базы, необходимое для расчета схем.

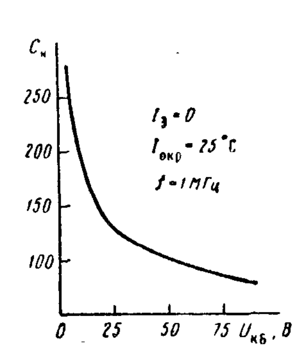


Рис. 13. Зависимость емкости коллектора от напряжения коллектор — база

2.9. ШУМЫ ТРАНЗИСТОРОВ

Собственные шумы транзисторов ограничивают чувствительность усилителей. Их источниками являются шумы: тепловые, дробовые эмиттерного и коллекторного переходов, избыточные, а также случайного перераспределения тока эмиттера между коллектором и базой.

Тепловые шумы транзистора практически определяются омическим сопротивлением базовой области. Дробовые шумы обусловлены флуктуациями носителей заряда через прибор (возникают при прохождении тока через эмиттерный и коллекторный переходы).

Избыточные шумы (фликкер-шумы)— специфические шумы, возникающие вследствие изменения состояния поверхности кристалла полупроводника во времени. Они пропорциональны протекающему току и проявляются на низких частотах: в диапазоне звуковых и инфранизких частот. Значения избыточных шумов могут сильно колебаться даже для транзисторов одного типа, так как зависят от технологических факторов. Избыточные шумы больше у n-p-n транзисторов, чем у p-n-p. Транзисторы с большими или нестабильными токами $I_{КБО}$ имеют повышенные избыточные шу-

мы. С ростом рабочей частоты доля избыточных шумов уменьшается и шумы транзисторов определяются в основном дробовыми и тепловыми составляющими.

Шумовые свойства транзистора обычно характеризуются коэффициентом шума, который определяется экспериментально или рассчитывается на основе анализа отдельных источников шума. Рассчитать точно коэффициент шума для области избыточных шумов невозможно, поэтому его определяют экспериментально.

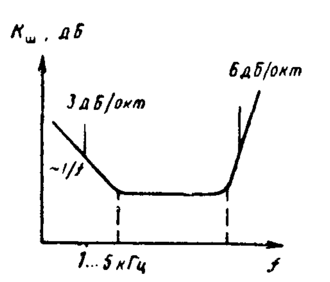


Рис. 14. Типовая зависимость коэффициента шума от частоты

Коэффициент шума — сложная функция многих переменных: полного сопротивления источника сигнала $R_г$, параметров режима, параметров транзисторов ($h_{21э}$, $I_{КБО}$, $C_э$, $f_{h21б}$, $r'_б$, $r_э$) и рабочей частоты $f_р$. Зависимость $K_ш$ от частоты имеет три характерных участка (рис. 14): низких частот ($K_ш$ уменьшается пропорционально $1/f$); средних частот ($K_ш$ не зависит от частоты) — область «белого» шума; высоких частот (при $f>f_{гр}$ усиление резко уменьшается и шумы возрастают, $K_ш$ зависит от $r'_б$ и отношения $(f_р/f_{h21б})^2$).

Эти участки обусловлены тем, что на различных частотах шумы генерируются различными источниками шумов. В области низких частот (0,1...5 кГц) коэффициент шума уменьшается примерно на 3 дБ на октаву, в области высоких частот увеличивается на 6 дБ на октаву, в области средних частот он минимален.

Следует отметить, что имеется взаимосвязь низкочастотных шумов и отказов приборов. Уровень низкочастотных шумов, пропорциональных $1/f$, дает информацию о структурных изменениях приборов и используется для распознавания разных дефектов в транзисторах, в частности трещин и нарушений целостности кристалла, наличия загрязнений поверхности, которые могут привести к отказам приборов. Методы неразрушающего контроля качества приборов по их шумам используются в технологическом цикле производства. Кроме того, существуют методы прогнозирования основных параметров надежности приборов по их низкочастотным шумам.

Минимальное значение $K_ш$ достигается при определенных значениях сопротивления источника сигнала $R_г$ и тока $I_К$ (рис. 15, 16). Увеличение $K_ш$ при росте $I_К$ происходит медленно при малых токах. При больших токах $K_ш$ растет почти пропорционально $I_К$. С ростом $U_К$ (в пределах 1...10 В) $K_ш$ почти не меняется, пока избыточные шумы малы по сравнению с дробовыми и тепловыми. В дальнейшем из-за увеличения избыточных шумов $K_ш$ возрастает. Таким образом, для того чтобы свести шумы к минимуму, выбирают оптимальный режим работы транзистора.

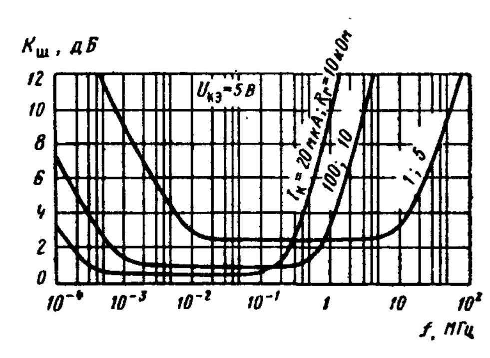


Рис. 15. Зависимость коэффициента шума от частоты при различных значениях тока коллектора и сопротивления источника сигнала

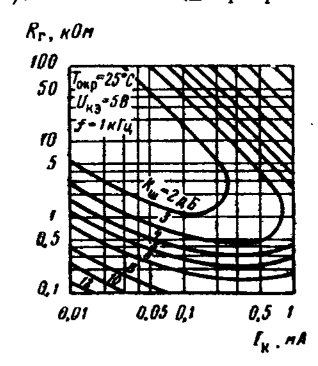


Рис. 16. Типовая зависимость коэффициента шума от сопротивления источника сигнала и тока коллектора

На средних и высоких частотах минимальный $K_ш$ будут иметь транзисторы с малыми $r'_б$ и $I_{КБО}$ и большими $h_{21э}$ и $f_{21б}$.

Измерения параметра $K_ш$ производятся обычно при стандартном сопротивлении $R_г$. Как правило, коэффициент шума увеличивается с ростом температуры.

2.10. ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ СХЕМЫ И ПАРАМЕТРЫ ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКА

Для анализа работы диода и транзистора в усилительном или генераторном режиме используются метод эквивалентных схем и метод четырехполюсника.

При первом методе основные расчетные соотношения схемы усилителя выражаются через параметры, отражающие физические процессы в транзисторе (диффузию, модуляцию ширины запирающего слоя), зарядные емкости, последовательные сопротивления и др., с учетом особенностей конструкции, паразитных емкостей и индуктивностей выводов в рабочем интервале частот. Для различных областей применения и диапазонов рабочих частот эти схемы различны. В зависимости от расположения пассивных элементов получаются Т- и П-образные эквивалентные схемы.

Эквивалентная схема диода, включающая сопротивление p-n перехода, емкости p-n перехода ($C_б$ и $C_д$), емкость корпуса, индуктивности выводов, сопротивления базы и выводов, видоизменяется при обратном и прямом смещениях.

Метод четырехполюсника позволяет рассчитывать усилитель с помощью матриц без составления эквивалентной схемы транзистора. При этом параметры четырехполюсника (четыре комплексных параметра), характеризующие свойства транзистора, определяются экспериментально. В отличие от параметров эквивалентной схемы, они зависят от схемы включения. Существуют три системы параметров, однозначно определяющие свойства транзисторов: Z-, h- и Y-параметры. Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки. Выбор той или иной системы параметров определяется удобством анализа и расчета каждой конкретной схемы.

При расчете низкочастотных схем наибольшее распространение получили Z- и h-параметры, высокочастотных схем — Y-параметры.

Для устранения нестабильности работы транзисторов в усилительном режиме, связанной с внутренней обратной связью, используются схемные методы нейтрализации и демпфирования входных и выходных проводимостей. С помощью внешних схемных элементов стараются уменьшить коэффициенты, характеризующие обратную связь (h_{12}, Y_{12}). У ряда современных транзисторов влияние обратной связи снижается технологическим способом.

Измерение параметра $Y_{11б}$ позволяет оценить сопротивление базы, которое, в свою очередь, определяет усилительные и частотные свойства транзисторов, а также высокочастотные шумы токораспределения (у транзисторов с малым сопротивлением $r'_б$ уровень шумов также мал). Вообще сопротивление $r'_б$ зависит от конст-

рукции и типа транзистора и лежит в диапазоне от нескольких единиц (у мощных приборов) до нескольких сотен Ом.

В качестве параметров, описывающих транзистор как четырехполюсник для СВЧ-диапазона, используются S-параметры: S_{11} и S_{12} — коэффициенты отражения соответственно от входа и выхода четырехполюсника при нагрузке на волновое сопротивление (входные и выходные сопротивления), S_{12} и S_{21} — коэффициенты обратной и прямой передач. Они применяются для расчета схем, работающих на частотах от 100 МГц до нескольких гигагерц (на этих частотах трудно осуществить условие короткого замыкания при измерении Y-параметров). Кроме того, S-параметры имеют ряд преимуществ с точки зрения обеспечения устойчивости в процессе измерения, но определяются только для конкретной рабочей точки и на фиксированной частоте.

Типовые (нормализованные) зависимости параметров четырехполюсника от режима и температуры иногда приводятся в справочниках или ТУ.

2.11. ЧАСТОТНЫЕ СВОЙСТВА ТРАНЗИСТОРОВ

Частотные свойства полупроводниковых приборов определяют области их применения.

Для эквивалентных схем и четырехполюсников существует ряд характеристических частот. Практическое значение имеют частоты, связанные с параметрами $h_{21б}$, $h_{21э}$ и $Y_{21э}$, а также частота генерации f_{max}, определяющая область частот, в которой транзистор, в принципе, может применяться как генератор колебаний (на этой частоте коэффициент усиления по мощности $K_{УP}=1$). Кроме того, f_{max} используется для оценки $K_{УP}$ на других частотах.

Модули коэффициентов передачи тока $h_{21б}$, $h_{21э}$ и крутизны $Y_{21э}$ уменьшаются с ростом частоты, поэтому вводятся характеристические частоты, на которых эти параметры снижаются в $\sqrt{2}$ раз (до 0,707) относительно их значения на низкой частоте (соответствующие предельные частоты $f_{h21б}$, $f_{h21э}$, $f_{Y21э}$). Усиление транзистора на частотах, превышающих $f_{h21э}$ и $f_{h21б}$, падает со скоростью 6 дБ на октаву, т. е. при рабочей частоте, в 2 раза превышающей $f_{h21э}$ и $f_{h21б}$, коэффициент усиления уменьшается в 2 раза.

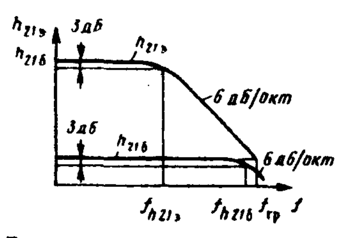


Рис. 17. Зависимости коэффициентов передачи тока от частоты

С ростом частоты входного сигнала коэффициент передачи плавно снижается и на некоторой частоте, называемой граничной ($f_{гр}=|h_{21э}|f_{изм}$, где $f_{изм}$ — частота измерения), модуль $h_{21э}$ достигает значения, равного единице, т. е. усиление по току отсутствует (рис. 17).

Частота f_{Y21} используется для расчета ограниченного ряда схем (генераторов и широкополосных усилителей) и связана с $f_{гр}$ формулой

$$f_{Y21э}=f_{гр}r_э/r'_б.$$

Частота f_{max} также связана с $f_{гр}$:

$$f_{max}=\sqrt{f_{гр}/8\pi r'_б C_к}.$$

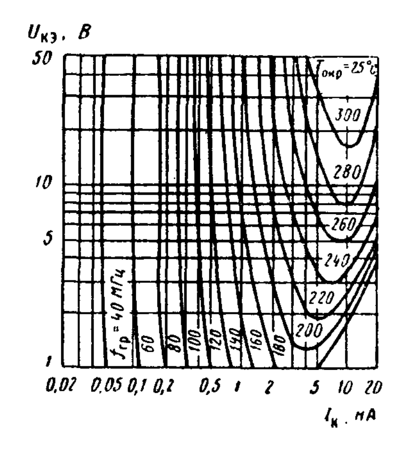


Рис. 18. Зависимость граничной частоты от тока коллектора

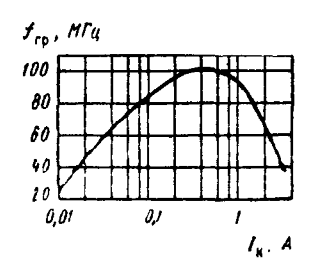


Рис. 19. Зависимость граничной частоты от режима работы ($T_{окр}=25$ °C)

Для характеристики транзисторов частота $f_{h21б}$ обычно используется на частотах до 20 МГц, а $f_{гр}$ — свыше 20 МГц.

Имеются формулы, связывающие частоты $f_{h21б}$, $f_{h21э}$ и $f_{гр}$. В частности, $f_{гр}=kf_{h21б}$, где $k=0{,}65...0{,}82$ для различных типов транзисторов (или $f_{h21б}=(1{,}2...1{,}6)f_{гр}$). Для бездрейфовых (сплавных) транзисторов обычно $k=0{,}82$, а предельная частота $f_{h21э}=(1-h_{21б})f_{h21б}$. Значения $f_{гр}$ зависят от положения рабочей точки (рис. 18) и температуры. Максимум зависимости $f_{гр}$ от тока коллектора (эмиттера) обычно почти совпадает с максимумом зависимости параметра $h_{21э}$ от тока (рис. 19). При больших токах предельная частота падает, при малых токах частотные свойства транзисторов также ухудшаются.

2.12. ОБРАТНЫЕ ТОКИ

Обратные токи и их зависимости от приложенных напряжений и температуры учитываются при расчете режима работы диодов и транзисторов.

Значение обратного тока через переход зависит от свойства материала, технологии изготовления (геометрии перехода, состояния поверхности), мощности прибора и рабочей температуры. Полный обратный ток p-n переходов $I_{обр}$ состоит из трех компонентов: теплового тока I_0, тока термогенерации $I_т$ и тока утечки $I_у$.

Тепловой ток зависит от физических свойств материала и обычно характеризуется температурой удвоения (приращением температуры, вызывающим удвоение теплового тока). У кремниевых диодов он значительно меньше, чем у германиевых, при одной и той же площади перехода. Ток I_0 экспоненциально зависит от температуры, причем у германиевых диодов он примерно удваивается при увеличении температуры на каждые 7...10 °С, у кремниевых — на каждые 8...12 °С.

Особенностью тока термогенерации является зависимость от напряжения. (Ширина перехода увеличивается с ростом напряжения, и ток $I_т$ возрастает.) Он пропорционален $\sqrt{U_{обр}}$, но увеличивается с ростом температуры слабее, чем ток I_0. Ток I_0 начинает превышать $I_т$ при температуре 100 °С. При комнатной температуре для германиевых диодов $I_т$ обычно мал и меньше I_0, но для кремниевых диодов, у которых $I_т$ является главным компонентом полного обратного тока, $I_т \gg I_0$ (на несколько порядков). Ток $I_т$ для германиевых приборов становится соизмеримым с током I_0 лишь при отрицательной температуре.

3 Заказ № 1141

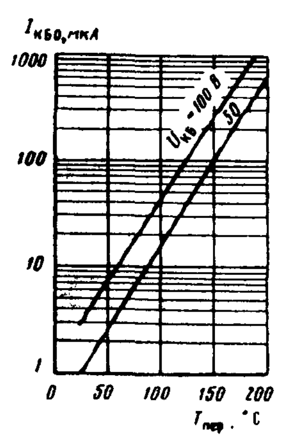


Рис. 20. Зависимость обратного тока коллектора от температуры

Ток утечки $I_у$ обусловлен проводимостью поверхности кристалла (характером ее обработки), связан с нарушением кристаллической решетки, наличием окисных пленок, шунтирующих переход, загрязнением поверхности и является основной причиной нестабильности $I_{обр}$ во времени. При повышении напряжения ток $I_у$ растет почти линейно и слабо зависит от температуры. Обычно у реальных кремниевых диодов $I_у > I_о + I_т$.

Небольшой наклон вольт-амперных характеристик диодов свидетельствует о том, что основная составляющая обратного тока — не зависящий от напряжения ток $I_б$. Если же характеристики имеют большой наклон, то основными составляющими являются токи $I_т$ и $I_у$. Большой ток $I_у$ у диодов нарушает указанный выше закон удвоения, т. е. увеличение $I_{обр}$ ослабляет его зависимость от температуры.

Транзисторы характеризуются обратными токами переходов эмиттер — база $I_{ЭБО}$ и коллектор — база $I_{КБО}$, а также обратным током между коллектором и эмиттером, значение которого, как и пробивное напряжение между коллектором и эмиттером (см. § 2.4), зависит от условий во входной цепи транзистора. На рис. 7 показаны направления обратных токов p-n-p транзистора. Следует отметить, что $I_{КБО} < I_{КЭS} < I_{КЭХ} < I_{КЭR} < I_{КЭО}$.

Обратный ток коллектора $I_{КБО}$ экспоненциально увеличивается с ростом температуры. Считается, что он изменяется приблизительно на 6...8% у германиевых приборов и на 8...10% у кремниевых при изменении температуры на 1 °С (рис. 20).

Для отечественных приборов обратные токи обычно определяются при максимальных обратных напряжениях. Большие обратные токи переходов свидетельствуют о недостаточно хорошем качестве приборов.

2.13. ОБЛАСТИ РАБОТЫ И ВОЛЬТ-АМПЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНЗИСТОРОВ

Для транзисторов принято различать четыре области работы (рис. 21): отсечки, активную (усиления), насыщения и лавинного пробоя (умножения), а также три схемы включения: с общим эмиттером (ОЭ), общей базой (ОБ) и общим коллектором (ОК). Транзисторы работают в прямом и инверсном включениях.

При прямом включении в области отсечки оба перехода (эмиттерный и коллекторный) смещены в обратном направлении и через них протекают очень малые токи $I_{КБО}$ и $I_{ЭБО}$. В активной области транзистор работает как усилительный элемент (эмиттерный переход смещен в прямом направлении, а коллекторный — в обратном). В области насыщения оба перехода смещены в прямом направлении, через транзистор протекает большой ток, а остаточное напряжение насыщения коллектор — эмиттер $U_{КЭ\,нас}$ характеризует его как переключатель в замкнутом состоянии. В области умножения коллекторный переход находится в состоянии лавинного (электрического) пробоя.

При инверсном включении, в отличие от прямого, эмиттер смещен в обратном направлении, а коллектор — в прямом. Транзистор работает в активной области, но

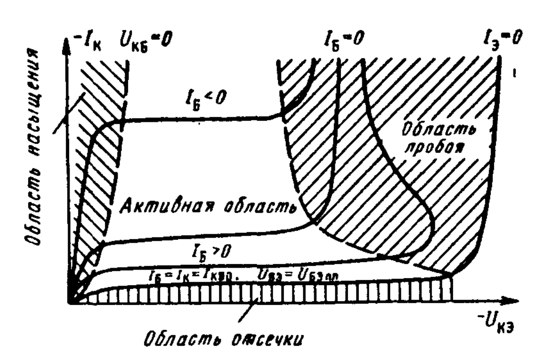


Рис. 21. Выходная вольт-амперная характеристика транзистора

его усилительные свойства хуже (например, $h_{21б\,inv}$=0,1...0,8). Дрейфовые (диффузионные) транзисторы редко используются в таком включении, так как из-за асимметрии конструкции (большого различия площадей эмиттера и коллектора) инверсное усиление мало́. Инверсный режим может иметь место во время переходных процессов в импульсных схемах.

Вольт-амперные характеристики, приводимые в справочниках, дают информацию о работе транзисторов во всех областях и режимах работы на большом и малом сигналах при различных допустимых сочетаниях токов и напряжений. По ним можно определить ряд основных параметров транзистора, выбрать оптимальное положение рабочей точки, рассчитать нелинейные искажения, цепи смещения и стабилизации режима. Для анализа режимов и расчета схем обычно широко используются два семейства статических характеристик: входных и выходных для схем с ОБ и ОЭ. При необходимости по ним можно построить переходные характеристики (прямые и обратные). По входным характеристикам определяются параметры $h_{11б}$ и $h_{11э}$, по выходным — $h_{22б}$, $Y_{22б}$, $h_{21э}$, $Y_{21э}$, $Y_{21б}$ (в зависимости от режима).

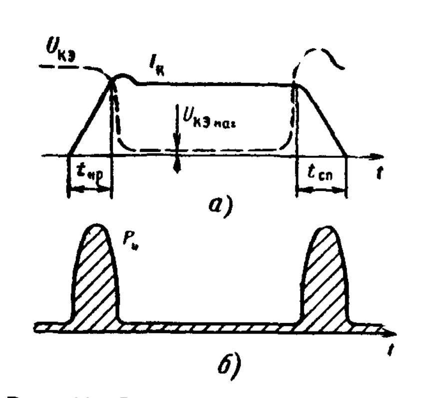
Наклон начального участка выходных характеристик определяет сопротивление $r_{КЭ\,нас}$. Кроме того, на выходных характеристиках обычно указывают область безопасной работы транзисторов.

2.14. ИМПУЛЬСНЫЙ И КЛЮЧЕВОЙ РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Рабочие токи, напряжения или мощности при работе в импульсном и ключевом режимах могут значительно превышать номинальное значение, установленное для режима постоянного тока.

Транзисторные ключи работают в насыщенном (режим переключения) или ненасыщенном режиме (в импульсных усилителях). В первом случае рабочая точка на семействе выходных характеристик циклически перемещается из области отсечки в область насыщения через активную область и обратно. Во втором случае рабочая точка проходит только через две области — отсечки и активную.

В режиме переключения (рис. 22, а) транзистор как ключевой элемент меняет свое состояние от закрытого (высокое напряжение и малый ток) до открытого (низкое напряжение и большой ток). Насыщенные ключи имеют меньшую мощность рассеяния $P_К$ во включенном состоянии и хорошую помехоустойчивость, но у



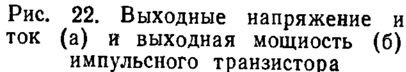


Рис. 22. Выходные напряжение и ток (а) и выходная мощность (б) импульсного транзистора

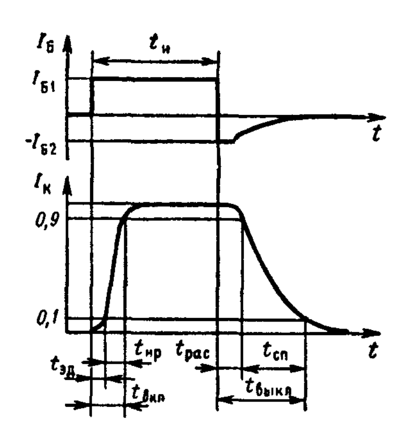


Рис. 23. Форма токов базы и коллектора импульсного транзистора

ных хуже быстродействие, так как переход из области насыщения происходит с задержкой, и больше мощность рассеяния на базе при больших степенях насыщения. Увеличение быстродействия транзисторов достигается уменьшением времени жизни неосновных носителей путем легирования активных и пассивных областей структуры атомами золота. Но для таких транзисторов велика вероятность возникновения лавинного пробоя. Поэтому для увеличения быстродействия часто параллельно переходу коллектор — база подключается диод Шотки, что предотвращает насыщение транзистора (отсутствуют режимы накопления и рассасывания зарядов). Такие транзисторы более устойчивы ко второму пробою в случае больших запирающих токов (например КТ635).

Для переключательных транзисторов в справочниках приводятся импульсные значения максимально допустимых параметров или графики, позволяющие определить импульсную рассеиваемую мощность $P_и$ в зависимости от соотношения длительности импульса $t_и$, скважности Q и частоты. Значения $P_и$ на фронте или срезе импульса могут превышать $P_{K\,max}$ (рис. 22, б). Ток $I_{K,\,и\,max}$ обычно определяется экспериментально для заданной длительности импульса и ограничивается $P_{K\,max}$. Формы входного и выходного импульсов тока представлены на рис. 23. Как видно, выходной импульс сдвинут относительно входного на $t_{зд}$, а фронт и срез имеют конечную длительность. Задержка фронта обусловлена зарядом входной емкости, равной сумме барьерных емкостей эмиттерного и коллекторного переходов.

Время переключения транзистора, т. е. его быстродействие, состоит из времен включения $t_{вкл}$ и выключения $t_{выкл}$. В свою очередь, время включения состоит из времен задержки $t_{зд}$ и нарастания $t_{нр}$, а время выключения — из времен задержки выключения $t_{рас}$ (времени рассасывания) и спада $t_{сп}$. Время переключения определяется как свойствами самого транзистора, так и выбранной схемой включения транзистора и параметрами управляющего сигнала. Оно является функцией частоты $f_{гр}$ и эмиттерного и коллекторного токов. Получить высокое быстродействие при большом токе трудно.

Для высокочастотных транзисторов (с $f_{гр}>100$ МГц) задержка включения определяется в основном емкостью $C_э$. Кремниевые транзисторы имеют бо́льшие значения $t_{зд}$, чем германиевые. Время задержки может быть уменьшено путем увеличения мощности включающего сигнала. Для времени нарастания влияние емкости $C_э$ незначительно, но играют роль $f_{гр}$ и входной ток. Как уже отмечалось, на длительности фронта и среза значительное влияние оказывает емкость $C_к$. Время $t_{сп}$ зависит от $I_К$ и от отношения $I_К/I_Б$.

Время рассасывания зависит от конкретной схемы включения и режима измерения. При больших степенях насыщения (или больших запирающих токах) и существенных отклонениях режима использования от указанного в справочнике время рассасывания может принимать значения, отличающиеся от номинального.

Параметры $t_{рас}$, $C_к$, $C_э$, $f_{гр}$, $h_{21э}$ дают возможность сравнивать переключательные свойства транзисторов при одинаковых режимах измерения.

Для зарубежных приборов, параметры $t_{вкл}$ и $t_{выкл}$ приводятся часто, для отечественных — реже, лишь для некоторых типов транзисторов, используемых при предельном быстродействии. Эти времена определяются для конкретной (типовой) электрической схемы, зависят от элементов внешних цепей (сопротивления нагрузки, сопротивления входной цепи, реактивных сопротивлений) и используются как справочные или рекламные сведения.

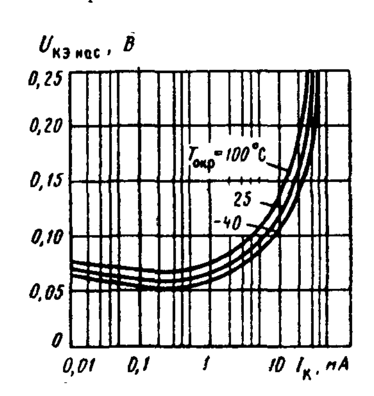


Рис. 24. Зависимость напряжения насыщения коллектор — эмиттер от тока коллектора при различных значениях температуры

Работа транзистора в режиме насыщения характеризуется также остаточным напряжением коллектор — эмиттер $U_{КЭ\,нас}$ или сопротивлением насыщения $r_{кэ\,нас}$. При сравнении транзисторов удобнее использовать параметр $r_{кэ\,нас}$, а не $U_{КЭ\,нас}$, так как он слабо зависит от тока. Напряжение $U_{КЭ\,нас}$ зависит от геометрических и физических параметров транзистора. Его уменьшают, выбирают определенную геометрию структуры, а также создавая конструкции с эпитаксиальными слоями. С увеличением степени насыщения (в 3...5 раз и выше) $U_{КЭ\,нас}$ почти не меняется. С ростом температуры оно несколько увеличивается (рис. 24). Большое сопротивление $r_{кэ\,нас}$ транзистора и диода увеличивает потери мощности в приборах и снижает КПД устройств, особенно при работе на больших токах.

Переключательные транзисторы (в отличие от усилительных) обычно имеют малые остаточные напряжения ($U_{КЭ\,нас}$, $U_{БЭ\,нас}$), времена переключения и большие пробивные напряжения $U_{КБО\,проб}$, $U_{ЭБО\,проб}$. Для этих транзисторов нет необходимости иметь большие $h_{21э}$. В общем случае мощность, выделяемая транзистором в ключевом режиме, состоит из мощностей, выделяющихся на коллекторном переходе в режиме насыщения ($P_{вкл}$), в режиме отсечки ($P_{выкл}$), в процессе перехода транзистора из одного режима в другой ($P_{пер}$), и управляющей мощности в цепи базы ($P_{упр}$). При небольших рабочих частотах (менее 1 кГц) основной составляющей, определяющей тепловые потери в транзисторе, является $P_{вкл}$. Мощностью $P_{пер}$ ограничивается предельная частота работы транзистора. Следует отметить, что для надежного отпирания транзистора необходимо подавать напряжение, превышающее плавающее напряжение $U_{ЭБ\,пл}$ — напряжение между выводами базы и эмиттера, обусловленное параметрами $I_{КБО}$, $r'_б$ и сопротивлением утечки.

2.15. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ

Современный уровень электрических параметров полупроводниковых приборов обусловливается технологией их изготовления, связанной с разработкой эффективных методов эпитаксиального выращивания, техникой изготовления фотошаблонов, проведением процессов фотолитографии и диффузии примесей, совершенствованием стабилизирующих и защитных покрытий кристаллов.

Использование той или иной технологии при создании приборов диктуется различными соображениями, связанными с техническими и экономическими показателями, а также надежностью.

Для изготовления переходов полупроводниковых приборов применяются следующие технологические методы: вытягивание из расплава, электрохимические, электроформовка, сплавление (вплавление), диффузия и ионное внедрение примесей. Первые три метода в настоящее время практически не применяются.

Метод сплавления применяется в основном при изготовлении низкочастотных маломощных и мощных германиевых транзисторов и кремниевых диодов. Сплавные транзисторы имеют невысокий частотный предел (примерно 10...15 МГц), достаточно высокие напряжения $U_{КБО\,проб}$ и $U_{ЭБО\,проб}$ (близкие по значениям), низкие напряжения насыщения, но большие емкости $C_к$ (из-за большой площади перехода коллектор — база) и большой разброс параметров вследствие плохой воспроизводимости процесса сплавления. Метод сплавления имеет простую технологию.

С помощью диффузионных методов на германии и кремнии получают транзисторы со структурами p-n-p и n-p-n. При двусторонней диффузии на двух поверхностях пластины полупроводника вводятся примеси и тем самым создаются области эмиттера и коллектора с проводимостью, противоположной проводимости исходной пластины (базовой области). По своим характеристикам такие транзисторы близки к сплавным, т. е. имеют большие рабочие токи, но малую частоту $f_{h21б}$. При двойной односторонней диффузии только через одну из поверхностей пластины проводится сначала диффузия примеси для создания базовой области (перехода коллектор — база), а затем диффузия примеси другого типа. При этом получается трехслойная транзисторная структура, где исходная пластина является телом коллектора. Транзисторы с двусторонней диффузией (с диффузионными эмиттером и коллектором) по сравнению с транзисторами с двойной односторонней диффузией (с диффузионной базой) имеют меньшие значения $U_{КЭ\,нас}$, меньший спад усиления, более высокую устойчивость ко второму пробою, но более низкую частоту $f_{h21б}$. Технология их изготовления более сложная (например, меза-планарная и планарная технологии). На германии с помощью двойной односторонней диффузии технологически легче получать p-n-p транзисторы, а на кремнии — n-p-n транзисторы.

Для изготовления транзисторных структур широко используются комбинированные методы: сплавление и диффузия или сочетание различных вариантов диффузии. В комбинации с методом сплавления были созданы диффузионно-сплавные и сплавно-диффузионные приборы. Например, базовая область — диффузионная, а коллектор и эмиттер — сплавные. Диффузионно-сплавные транзисторы имеют большое $U_{КЭ\,нас}$ и малые пробивные напряжения переходов $U_{КБО\,проб}$ и $U_{ЭБО\,проб}$ (несколько вольт), у них более высокая рабочая частота, чем у сплавных приборов. Транзисторы с большими рабочими токами (до десятков ампер) и частотой несколько десятков мегагерц получают методом сплавления — диффузии, так как этот метод позволяет создавать приборы, превосходящие сплавные по частоте.

В настоящее время наибольшие рабочие токи (кроме сплавных германиевых транзисторов) имеют кремниевые транзисторы, изготовленные с помощью двусторонней диффузии.

По технологии изготовления близкими к сплавно-диффузионным транзисторам являются конверсионные транзисторы.

Разновидностью сплавно-диффузионных и диффузионных транзисторов являются меза-транзисторы, имеющие структуру в виде выступа (т. е. эмиттерная и базовая области возвышаются над коллекторной и площадь перехода уменьшается за счет удаления боковых участков кристалла). Они предназначены для работы на частотах 500...1000 МГц и характеризуются малыми емкостями $C_к$ и $C_э$ и сопротивлением базы. Большинство мощных кремниевых транзисторов, изготовленных с помощью двойной односторонней диффузии, представляет собой меза-планарные приборы. Необходимо отметить, что, в отличие от метода сплавления, способы получения диффузионных структур применимы для групповой технологии.

Наряду с диффузионными методами, указанными выше, применяются методы тройной диффузии (преимущественно для изготовления меза- и планарных транзисторов), например для создания высоковольтных транзисторов.

Мощные приборы с двойной диффузией и охранным кольцом, расположенным по периметру коллекторного перехода (для снижения токов утечки и исключения поверхностного пробоя), обладают высокой линейностью $h_{21э}$ и малым $U_{КЭ\,нас}$. У приборов с тройной диффузией большая область безопасной работы, выше пробивные напряжения, но ниже усиление и $f_{гр}$.

Современные полупроводниковые приборы изготавливаются обычно по планарной технологии (у них переходы эмиттер — база и коллектор — база находятся в одной плоскости), являющейся модификацией диффузионной технологии. Электрические свойства биполярных и полевых транзисторов сильно зависят от свойств поверхности полупроводника и защитного слоя. Основные преимущества планарной технологии — обеспечение точных размеров переходов и их защита от воздействия внешней среды и загрязнений. В планарной структуре переходы находятся под защитным слоем двуокиси кремния, поэтому устраняются многие проблемы, связанные с поверхностными явлениями. В германиевых планарных транзисторах также применяются покрытия из двуокиси кремния. В качестве дополнительного пассивирующего (защитного) слоя в планарных приборах может использоваться нитрид кремния (например, у BC523), что увеличивает стабильность параметров транзисторов и позволяет им работать при более высоких температурах. Кроме указанных преимуществ планарные приборы имеют долговременную стабильность свойств, малые обратные токи, большое усиление при малых токах, хорошую воспроизводимость параметров. Планарная технология дает возможность изготавливать в едином технологическом процессе большое число структур.

Имеются планарные транзисторы (например, отечественные КТ104, КТ201, КТ203, КТ208, КТ209, КТ214, КТ501), которые позволяют по совокупности параметров заменить в схемах германиевые и кремниевые сплавные транзисторы.

Для улучшения параметров меза-планарных и планарных транзисторов используют методы встречной диффузии и эпитаксиального выращивания. С помощью эпитаксиальной технологии реализуется двуслойная структура коллектора: низкоомная исходная пластина и выращенный тонкий высокоомный слой. Для маломощных транзисторов эпитаксиальное выращивание практически полностью заменило встречную диффузию. Метод эпитаксиального выращивания считается более

перспективным, чем метод обратной эпитаксии (обращенного эпитаксиального наращивания) и метод встречной диффузии. Применение эпитаксиальных пленок улучшает три параметра диффузионных транзисторов: повышает пробивное напряжение коллекторного перехода $U_{КБ\,проб}$, уменьшает сопротивление тела коллектора $r_{КЭ\,нас}$ и емкость $C_к$. Кроме того, эпитаксиальные приборы имеют более слабую зависимость коэффициента усиления от тока эмиттера.

Для создания современных СВЧ-транзисторов используется технология ионного легирования или ионной имплантации (внедрения) примесей. Этот метод позволяет получить сопротивление базы, много меньшее, чем при диффузионном методе, и сверхтонкий базовый слой (глубина залегания всех переходов менее 1мкм), что повышает рабочую частоту транзисторов.

В отличие от метода высокотемпературной диффузии, имплантация ионов может осуществляться при низких температурах, что позволяет сохранить электрофизические свойства исходного материала и повысить процент выхода годных приборов. Процесс легирования можно автоматизировать, в результате чего повышаются воспроизводимость электрических параметров приборов, точность контроля распределения примесей и разрешающая способность. Помимо p-n переходов с помощью технологии ионного легирования на поверхности можно создавать изолирующие пленки (например, нитрида кремния).

Для СВЧ-приборов на арсениде галлия для получения очень тонких структур применяется метод молекулярно-лучевой эпитаксии.

Для получения больших мощностей на высоких частотах используются такие структуры, как гребенчатая, многоэмиттерная, матричная и др. Для малосигнальных СВЧ-транзисторов оптимальной является гребенчатая (полосковая) геометрия.

В современных мощных транзисторах имеются интегральные эмиттерные резисторы (диффузионные или тонкопленочные) для выравнивания распределения тока между отдельными участками эмиттерного перехода и уменьшения вероятности развития пробоя.

2.16. КОНСТРУКЦИИ КОРПУСОВ

Корпус прибора должен защищать кристалл от механических повреждений и воздействия внешних факторов, эффективно отводить тепло, обеспечивать электрическую изоляцию токопроводящих выводов и их надежное соединение с внешними электрическими цепями, а также простое и удобное крепление в аппаратуре.

При производстве полупроводниковых приборов используются типовые (базовые) унифицированные конструкции корпуса. Конструктивное оформление приборов обусловлено максимальными мощностью рассеяния и током, частотными свойствами, особенностями технологии изготовления и условиями эксплуатации.

Для сборки кристаллов применяются цельно- и металлостеклянные, металлические с проходным изолятором, металлокерамические, керамические с компаундной (пластмассовой) герметизацией и пластмассовые корпуса различных форм и размеров. Выпускаются также бескорпусные приборы.

Металлостеклянный корпус обычно состоит из ножки (фланца) и баллона (колпачка), герметично соединяемых друг с другом электроконтактной и холодной сваркой или пайкой. Наружные металлические детали корпуса в зависимости от типа прибора могут иметь металлическое (золочение, никелирование и др.) или

лакокрасочное покрытие. Наличие поверхности баллона (колпачка) цилиндрической формы допускает применение радиаторов, позволяющих увеличить рассеиваемую мощность приборов.

Выводы корпусов могут иметь одно- или двухстороннее расположение и находиться с той стороны, которой прибор прижимается к теплоотводу или шасси (направляться вниз), например в корпусах ТО-3; могут располагаться со стороны, противоположной контактирующей (обычно в мощных приборах), например в корпусах ТО-60, ТО-63, КТ-4, а также могут иметь радиальное расположение (обычно у ВЧ- и СВЧ-транзисторов).

Один из выводов прибора (от базы, эмиттера или коллектора) может быть электрически связан с корпусом или все выводы могут быть электрически изолированы от него. Для улучшения теплоотвода с одновременной электрической изоляцией кристалла от корпуса часто используется держатель из бериллиевой керамики, напаиваемый на фланец корпуса. Окись бериллия является хорошим изолятором и в то же время обладает высокой теплопроводностью.

Отвод тепла от кристалла зависит от теплофизических свойств материала корпуса. Так как у транзисторов отвод тепла обычно осуществляется через область коллектора, связанного электрически с корпусом, а работа прибора предпочтительнее в схеме с ОЭ, то корпус прибора изолируется от шасси с помощью прокладки (из слюды, окиси бериллия и др.). Имеются конструкции, где отвод тепла осуществляется через коллектор, электрически изолированный от корпуса, например корпус ТО-60. Иногда для улучшения отвода тепла в транзисторах малой и средней мощности внутренний объем корпуса заполняется теплоотводящим наполнителем. Фланцевые корпуса обеспечивают лучший отвод тепла, чем корпуса с монтажным винтом.

В различных странах проведены стандартизация и унификация конструкций корпусов полупроводниковых приборов. Это дает возможность, в частности, стандартизировать теплоотводы (радиаторы) для приборов. Габаритные и присоединительные размеры корпусов отечественных диодов и транзисторов стандартизированы и устанавливаются ГОСТ 18472—82. По габаритно-присоединительным размерам конструкции корпусов с учетом международной стандартизации должны отвечать рекомендациям МЭК № 191-2 и стандарту СТ СЭВ 1818—79. В нашей стране имеется ряд корпусов транзисторов и диодов, соответствующих этим документам:

металлостеклянный корпус типа КТ-1 с двумя, тремя (аналогичный зарубежный корпус типа ТО-18), четырьмя (ТО-72) или пятью выводами для транзисторов с рабочей частотой до 1,5 ГГц;

металлостеклянный корпус типа КТ-2 (ТО-5, ТО-39) для транзисторов малой и средней мощности (до 15 Вт);

металлокерамический корпус типа КТ-4 (ТО-60), имеющий три изолированных вывода, крепящий болт и предназначенный для мощных ВЧ- и СВЧ-транзисторов;

металлокерамические корпуса типов КТ-6, КТ-7 (ТО-61, ТО-63 соответственно) для транзисторов большой мощности (до 200 Вт) с двумя (для низкочастотных транзисторов) или тремя (для высокочастотных транзисторов) изолированными от корпуса выводами;

металлостеклянные корпуса типов КТ-8, КТ-9 (ТО-66, ТО-3 соответственно) для транзисторов большой мощности.

Корпуса диодов КД-2, КД-4, КД-6 соответствуют по габаритным размерам зарубежным корпусам DO-35, DO-6, SO-45.

Зарубежный корпус типа ТО-3 обычно используется для работы на частотах до 100...150 МГц, типа ТО-60 — до 500 МГц; для работы на более высоких частотах применяются специальные конструкции (коаксиальные корпуса, ТО-117 и др.).

На высоких частотах на электрические параметры приборов начинают влиять паразитные параметры корпуса: межэлектродные емкости, емкости электродов относительно корпуса и индуктивности выводов. Для работы на СВЧ (более 1 ГГц) индуктивность выводов должна быть менее 1 нГн.

В отличие от низкочастотных приборов, у высокочастотных выводы делаются короткими, толстыми, широкими и далеко расположенными друг от друга. Были разработаны коаксиальный корпус и различные модификации корпуса с полосковыми выводами (для сопряжения с полосковыми линиями). Например, у коаксиального корпуса индуктивность общего вывода 0,1 нГн, у керамического полоскового корпуса типа L-5 индуктивность эмиттерного вывода 0,275 нГн.

Для ВЧ- и СВЧ-транзисторов существуют два способа монтажа кристалла в корпус: для схем с ОЭ (эмиттер электрически связан с корпусом) и с ОБ. Наилучшие результаты работы усилительных транзисторов в полосковых корпусах получены в схеме с ОБ (класс С), так как при этом получаются высокие $К_{ур}$ и достигается лучшая стабильность усилителя. Транзисторы, включаемые по схеме с ОЭ, являются оптимальными для генераторов, так как паразитные параметры корпуса оказываются включенными в цепь обратной связи.

Бескорпусные приборы в виде кристаллов (пластин) с шариковыми, балочными, проволочными или ленточными выводами, на керамических держателях, в малогабаритных пластмассовых корпусах (SOT-23, SOT-89) применяются в составе гибридных интегральных микросхем. При этом осуществляется общая герметизация всей интегральной микросхемы для защиты приборов от влияния окружающей среды.

2.17. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПЛАСТМАССОЙ

Разработка полупроводниковых приборов в пластмассовом корпусе позволила снизить их стоимость и упростить технологию герметизации по сравнению с аналогичными по электрическим параметрам приборами в металлостеклянном корпусе. Это произошло за счет автоматизации операций монтажа, герметизации, сборки и классификации приборов, а также вследствие снижения некоторых требований к приборам (например, у приборов в пластмассовом корпусе более узкий рабочий диапазон температур). Использование пластмассовых корпусов — это также экономия керамики и металлов, в том числе дорогостоящих. Ряд конструкций корпусов создан лишь благодаря специфическим свойствам полимерных материалов.

Технологические процессы изготовления этих приборов не отличаются от аналогичных процессов изготовления приборов в обычном корпусе, только вместо ножки здесь используется центральный (обычно коллекторный) вывод и вместо металлического корпуса — заливка всей структуры полимерами.

Герметизация полимерами, применяемая как для маломощных, так и для мощных приборов, осуществляется либо в виде монолитной конструкции (герметизирующий материал контактирует с кристаллом), созданной путем погружения в жидкий полимер, заливкой в формах, литьем, опрессовкой или формовкой, либо в виде капсульной конструкции, при которой контакт кристалла с герметизирующим материалом отсутствует. Герметизация может быть односторонней (для мощных при-

боров) или двусторонней (для маломощных приборов). В качестве заливочных компаундов (полимеров) используются эпоксидная, полиэфирная или фенольная смола, кремнийорганические материалы с различными наполнителями.

Стабильность параметров и надежность приборов, герметизированных полимерами, связаны с различными серьезными проблемами и определяются изменениями, которые происходят на поверхности кристаллов. Эти изменения обусловлены наличием примесей в полимерном материале, проникновением влаги через выводы и полимер на поверхность кристалла, внутренними напряжениями, возникающими в герметизирующем слое, адгезией пластмассы с материалом выводов, наличием электролиза контактов при проникновении влаги. Состав материала корпуса и метод герметизации оказываются наиболее важными факторами, связанными с надежностью приборов. Дефекты пластмассового корпуса могут вызвать большие токи утечки, электрохимические процессы разрушения (металлизации и выводов), термомеханические разрушения (из-за различия коэффициентов расширения пластмассы и металлических выводов). Поэтому пластмасса должна иметь высокие электроизоляционные свойства (для снижения токов утечки), минимальные усадку и старение в течение длительного срока службы, быть влагонепроницаемой, термостойкой до температуры пайки и выше. Кроме того, она должна быть светонепроницаемой и пожаробезопасной (не должна самовоспламеняться).

Пластмассовые приборы имеют высокую механическую прочность, вибро- и ударопрочность. Однако пластмассовое покрытие недостаточно герметично, имеет плохой отвод тепла. В ряде случаев при использовании пластмассовых приборов в радиоэлектронной аппаратуре требуется дополнительная магнитная и электрическая экранировка их корпуса.

За рубежом для маломощных транзисторов наиболее часто используются пластмассовые корпуса типов RO-67 или SOT-54, ТО-92 (отечественный КТ-26), ТО-98, Х-55, для мощных транзисторов — типов ТО-220 или SOT-78 (КТ-28), ТО-202 или SOT-128, ТО-126 или SOT-32 (КТ-27). Для мощных приборов в качестве основания пластмассового корпуса и теплоотвода служит металлическая пластина (например, медная), на которую непосредственно монтируется кристалл прибора и запрессовывается пластмассой.

Следует отметить, что транзисторы в корпусах ТО-202 или SOT-128 по сравнению с аналогичными транзисторами в корпусах ТО-126 или SOT-32 имеют рассеиваемую мощность примерно на 20% больше за счет имеющегося металлического радиатора с площадью поверхности 250 мм^2, т. е. при эксплуатации в одинаковых режимах температура переходов у них будет примерно на 20% ниже, поэтому прогнозируемый срок их службы выше.

Существуют три способа монтажа приборов в аппаратуре: навесной, печатный и поверхностный. Для поверхностного монтажа применяются специальные малогабаритные пластмассовые корпуса (например, отечественные КТ-46, КТ-47, аналогичные зарубежным SOT-23, SOT-89, а также SOT-143, SOD-80), которые позволяют более эффективно использовать поверхность платы. Технология поверхностного монтажа (SMT — Surfoce mount technology) дает возможность при автоматизированном процессе сборки повысить плотность монтажа в 3 раза и уменьшить размеры плат, т. е. уменьшить массогабаритные показатели аппаратуры, исключить технологический процесс изготовления отверстий на печатных платах, сократить время монтажа по сравнению с монтажом на платах со сквозными отверстиями.

2.18. НАДЕЖНОСТЬ

Надежность полупроводниковых приборов существенно зависит от электрических и тепловых режимов работы, т. е. определяется реальными условиями их эксплуатации. Приборы работают надежно, если их рабочие токи, напряжения, мощности, температура перехода и температура окружающей среды не превышают максимально допустимых значений.

Надежность полупроводниковых приборов закладывается еще на этапе разработки и в дальнейшем обеспечивается на всех стадиях их изготовления. В производственных условиях надежность приборов зависит от конструкции, технологии изготовления (например, надежность планарных приборов выше надежности сплавных и сплавно-диффузионных) и методов контроля качества и надежности.

В ТУ на приборы определены условия, при которых гарантируется их надежная и устойчивая работа и предусмотрен комплекс мероприятий для обеспечения высокой надежности. При заводских испытаниях проводятся испытания приборов на безотказность и долговечность, позволяющие определить производственную надежность (для оговоренных в ТУ режимов, условий испытаний и критериев отказов), как правило, в условиях и режимах более тяжелых, чем условия эксплуатации, и с оценкой результатов испытаний по более жестким критериям. Количественные показатели надежности приборов в процессе работы в аппаратуре определяются эксплуатационной надежностью. Эксплуатационная надежность (в конкретных режимах, условиях и схемах применения) обычно выше производственной, т. е. интенсивность отказов приборов в аппаратуре меньше, чем при заводских испытаниях.

Разница между производственной и эксплуатационной надежностями более значительна, если приборы работают в облегченных электрических и эксплуатационных режимах по сравнению с максимально допустимыми (предусмотрены запасы по напряжению, току и мощности рассеяния) и если работа схемы (устройства) допускает большой диапазон изменения параметров используемых приборов. Не рекомендуется применять транзисторы при рабочих токах, соизмеримых с неуправляемыми обратными токами во всем диапазоне рабочих температур, а также в совмещенных предельных режимах.

Данные об эксплуатационной надежности накапливаются при эксплуатации аппаратуры и учитываются при ее доработке или усовершенствовании.

2.19. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНЗИСТОРОВ

Полупроводниковые приборы разрабатываются и совершенствуются в соответствии с перспективами и общими тенденциями развития радиоэлектронной аппаратуры, с учетом особенностей конкретных классов схем, в которых предполагается их использование. Выпускаемые полупроводниковые приборы исчисляются сотнями и тысячами наименований. Предназначенные для различных областей применения, они открывают возможности создания принципиально новых радиотехнических устройств, существенно расширяют и улучшают их функции и возможности.

По виду выполняемой функции (целевому назначению) транзисторы можно разделить на усилительные, переключательные и генераторные.

Общими для расчетов усилителей на транзисторах (постоянного тока, низкой частоты, промежуточной частоты, высокой частоты и др.) являются входное и выходное сопротивления каскада, соотношения, определяющие усиление, частотные свойства, режимы работы, температурная стабильность и прочие показатели.

В соответствии с назначением различают каскады предварительного усиления (напряжения, тока или мощности), предназначенные для получения максимального усиления (обычно по резисторной или трансформаторной схемам), и каскады усиления мощности, обеспечивающие на заданной нагрузке необходимую (выходную) мощность при минимальных искажениях и мощности потребления от источника питания. В многокаскадных усилителях с отрицательной обратной связью имеют место фазовые сдвиги между входными и выходными токами, поэтому для их устойчивой работы транзисторы выбирают исходя из условия $f_в \leqslant 0{,}3 f_{h21э}$ ($f_в$ — верхняя рабочая частота усилителя); при малой обратной связи $f_в \leqslant f_{h21э}$. Возможны два варианта усилителя с мощным выходным каскадом: бестрансформаторный (с выходной мощностью не более 5...10 Вт) и трансформаторный (на десятки и сотни ватт). При выходной мощности 0,1...1 Вт каскады выполняются однотактными с режимом работы в классе А; при больших значениях мощности — двухтактными с режимом работы в классах А, АВ или В.

В схемах с дополнительной симметрией, т. е. с использованием транзисторов со структурами p-n-p и n-p-n, приборы должны иметь одинаковые параметры и характеристики. Требуется подбор пар последовательно включенных транзисторов по параметрам $h_{21э}$ и $f_{h21э}$ с разбросом не более 10...15%. Для этой цели разработаны специальные (комплементарные) пары транзисторов, например отечественные транзисторы со структурами n-p-n и p-n-p соответственно: КТ502 и КТ503; КТ814 и КТ815; КТ816 и КТ817; КТ818 и КТ819.

В каскадах предварительного усиления напряжение $U_{КЭ}$ в рабочей точке мало (несколько вольт). Оно выбирается из соображений получения малого напряжения шумов или неискаженной формы сигнала на выходе.

В усилителях, имеющих хорошую температурную и режимную стабилизацию, замена транзистора на однотипный с более высоким значением $h_{21э}$ обычно не приводит к значительному увеличению тока коллектора в рабочей точке.

В транзисторных генераторах наиболее предпочтительными являются режимы классов В и С (реже АВ). При расчете транзисторного генератора с внешним возбуждением по заданным выходной мощности и верхней рабочей частоте выбирают тип транзистора и проверяют его пригодность по параметрам $P_К$, $f_{гр}$ и предельно допустимыми параметрами $U_{КБО\,max}$, $U_{ЭБО\,max}$, $I_{К\,max}$ для заданного угла отсечки коллекторного тока. Для расчета генераторов необходимо также знать $C_к$, $\tau_к$, f_{max}. Следует учитывать, что чем выше частота генерируемых колебаний, тем меньше коэффициент усиления по мощности $K_{уР}$. Для получения $K_{уР}=5...7$ дБ необходимо, чтобы частота $f_в$ была в 4...10 раз ниже $f_{h21б}$.

В каскадах усиления и генерации мощности $U_{КЭ}$ выбирается достаточно большим для получения максимального КПД и малых нелинейных искажений.

Транзисторы некоторых типов используются в специфических классах схем и характеризуются рядом особенностей режима и условий работы. Эти специализированные транзисторы образуют своеобразный класс приборов, например, транзисторы для схем с автоматической регулировкой усиления (АРУ), для усилителей промежуточной частоты, для работы в микроамперном диапазоне токов, для работы в ВЧ- и СВЧ-диапазонах, лавинные транзисторы, сдвоенные, составные, двухэмиттерные и т. п. Есть узлы, в которых требуются высоковольтные транзисторы. Кроме того, разработаны транзисторы универсального назначения. Оптимальное сочетание

параметров и характеристик, удовлетворяющих различным требованиям, дает возможность использовать их в радиоэлектронной аппаратуре вместо некоторых усилительных и переключательных транзисторов (например, транзистор КТ630).

Для схем с АРУ разработаны специальные транзисторы (германиевые и кремниевые), обладающие регулируемым усилением при увеличении рабочего тока (прямая АРУ). Уменьшение усиления таких транзисторов на высокой частоте происходит вследствие снижения $f_{гр}$ при увеличении тока эмиттера и уменьшения напряжения на коллекторе (например, КТ3128, ГТ328). В связи с этим наблюдается сильная зависимость $K_{уР}$ от тока. Обычно транзисторы имеют меньшую зависимость коэффициента усиления от электрического режима. Для зарубежных транзисторов, предназначенных для АРУ, часто указывается глубина регулировки усиления (отношение максимального коэффициента усиления к минимальному).

Жесткие требования к экономичности радиоэлектронной аппаратуры в ряде специальных применений способствовали созданию кремниевых транзисторов, функционирующих при малых токах (единицы и десятки микроампер), поскольку германиевые транзисторы вследствие большого обратного тока коллектора для этой цели непригодны. Такие приборы (например, транзисторы КТ3102, КТ3107) имеют малые токи $I_{КБО}$ и большие коэффициенты усиления. Однако при работе в микрорежиме у них ухудшаются частотные свойства, но несколько улучшаются шумовые характеристики. Кроме того, при малых токах обычно увеличивается зависимость параметров от температуры, снижается крутизна и затрудняется стабилизация режима.

Реализация большого коэффициента усиления по мощности в высокочастотных усилителях связана с уменьшением паразитной обратной связи, обусловленной проходной проводимостью транзистора Y_{12}. Разработаны транзисторы (например, КТ339АМ), у которых для снижения емкости обратной связи в транзисторную структуру введен интегральный экран (электростатический экран Фарадея), представляющий собой сочетание диффузионного экрана и дополнительного экранирующего диода. Применение интегрального экрана позволяет снизить емкость между коллекторным и базовым выводами в 2,5...4 раза (емкость $C_{12э}$ снижается до значения не более 0,3 пФ) и обеспечить большой коэффициент усиления $K_{уР}$ без применения схем нейтрализации.

Лавинные транзисторы предназначены для работы в режиме электрического пробоя коллекторного перехода. В зависимости от схемы включения они могут иметь управляемые S-образные (со стороны коллектора или эмиттера) и N-образные (со стороны базы) вольт-амперные характеристики. Использование обычных транзисторов в этом режиме принципиально возможно и встречается на практике, но при этом не обеспечиваются необходимые быстродействие, амплитуда импульсов, стабильность и надежность. Например, одной из причин, снижающих эффективность применения обычных высокочастотных транзисторов в лавинном режиме, является значительное снижение частоты $f_{гр}$ при увеличении коллекторного тока.

Лавинные транзисторы имеют следующие основные параметры: напряжение лавинного пробоя коллекторного перехода $U_{КБО\,проб}$, напряжение пробоя при отключенной базе $U_{КЭО\,проб}$, напряжение $U'_{КЭО\,проб}$ в максимуме вольт-амперной характеристики, зависящее от сопротивления $R_{бэ}$ и управляющего тока, максимальный ток разряда и время нарастания лавинного импульса. Область лавинного пробоя лежит между напряжениями $U_{КБО\,проб}$ и $U_{КЭО\,проб}$. Лавинные транзисторы применяются в релаксационных генераторах в ждущем или автоколебательном режиме.

С помощью лавинных транзисторов можно формировать амплитуды импульсов 10...15 В и выше на низкоомной нагрузке (50...70 Ом) и при малом времени нарастания фронта (менее 1 нс).

Отечественной промышленностью выпускаются лавинные транзисторы типов ГТ338 (А, В), КТ3122 за рубежом — лавинные транзисторы типов ASZ23, ECL1239, NS1110 — NS1116, PADT51, RT1110 — RT1116, SYL3013, 2N3033 — 2N3035, 2N5236, 2N5271, 2SA252, 2SA411.

Следует также отметить транзисторы, предназначенные для использования в инверсном включении (например, зарубежные транзисторы 2N2432, 2N2944 — 2N2946, 2N4138), которые имеют малое остаточное напряжение (менее 1 мВ) и применяются в модуляторах для стабильных усилителей постоянного тока, построенных по схеме модуляции — демодуляции, в схемах управления реверсивными двигателями, в логических схемах, амплитудных детекторах и других схемах. В некоторых схемах, например автомобильного зажигания и строчной развертки телевизоров, при запирании транзистор может переходить в режим инверсного включения при работе на комплексную нагрузку. Для транзистора КТ209 параметры инверсного включения нормируются, например отношение $h_{21э}/h_{21э\,inv} \geqslant 2$ $(\leqslant 12)$.

Разработаны специальные модуляторные транзисторы, в основу которых положены две транзисторные структуры. Это так называемые двухэмиттерные транзисторы, имеющие лучшие параметры инверсного включения (например, зарубежные транзисторы 3N74 — 3N79, 3N108 — 3N111). У отечественного транзистора КТ118 остаточное напряжение менее 0,2 мВ.

Для работы в выходных каскадах усилителя низких частот радиовещательных приемников, высококачественных магнитофонов, радиол, телевизоров разработаны германиевые и кремниевые транзисторы разного типа проводимости (например ГТ401, ГТ402, ГТ701, ГТ703). Они характеризуются слабой зависимостью коэффициента усиления от тока, высокой частотой $f_{h21э}$, низким напряжением $U_{КЭ\,нас}$, что позволяет улучшить акустические показатели устройств в широком диапазоне звуковых частот. В свою очередь, это дает возможность упрощать схемы усилителей, уменьшать число применяемых транзисторов, повышать надежность и снижать себестоимость устройств. Зависимость коэффициента передачи $h_{21э}$ от тока характеризуется коэффициентом линейности — отношением коэффициентов передачи при двух значениях тока эмиттера.

2.20. ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ

Различие между низкочастотными и высокочастотными транзисторами заключается в размерах активных областей и в значениях параметров структуры и паразитных параметров корпуса — для высокочастотных приборов они должны быть значительно меньшими.

К транзисторам, предназначенным для работы на высоких и сверхвысоких частотах, предъявляется ряд дополнительных требований. Они должны иметь малые емкости между электродами, создающие паразитную обратную связь, и малую индуктивность общего вывода. Кроме того, для получения максимального $K_{уР}$ они должны иметь высокую частоту $f_{гр}$ и малые $\tau_к$, $C_к$ и $U_{КЭ\,нас}$. При создании высо-

кочастотных приборов труднее получить высокую воспроизводимость и идентичность параметров у приборов одного технологического типа.

Высокочастотные транзисторы могут работать и как усилители, и как генераторы. Однако транзистор, оптимальный для усилителя мощности, не обязательно будет пригоден для генератора и, наоборот.

Высокочастотные мощные транзисторы характеризуются такими параметрами, как $P_{вых}$, $K_{уP}$, КПД, $I_{кр}$ (критический ток коллектора, при достижении которого происходит уменьшение $f_{гр}$ в $\sqrt{2}$ раз по отношению к максимальному значению,— определяет условную границу, при которой получают удовлетворительные частотные свойства транзистора). Факторы, определяющие усиление и ширину полосы транзисторных усилителей, могут быть найдены только в комбинации свойств транзистора и схемы, в которой он используется. Кроме того, параметр K_P зависит от условий определения входной и выходной мощностей, поэтому имеется несколько коэффициентов, характеризующих усиление транзистора. В качестве обобщенной характеристики усилительных свойств транзисторов используется U-функция (максимальный $K_{у,\,P}$ при обратной связи, нейтрализованной внешней схемой). Помимо указанных параметров они должны иметь хорошую устойчивость к рассогласованию нагрузки.

Для получения высокого КПД рабочая точка транзисторов должна находиться вблизи области насыщения. Высокочастотное напряжение насыщения (оно больше статического) определяет также выходную мощность на высокой частоте. Следует отметить, что использовать транзисторы с большими пробивными напряжениями для низковольтных устройств нецелесообразно, так как они имеют большие напряжения насыщения и низкие КПД.

Надежная работа мощных приборов при больших $P_{вых}$ обеспечивается лишь при пониженных значениях параметров электрического и теплового режимов. Обычно $P_{вых}$ указывается в справочниках для уровня, соответствующего надежной работе, и не превышает в режиме непрерывных колебаний 50% $P_{K\,max}$. На высоких частотах выходная мощность изменяется пропорционально $1/f^2$. Она монотонно увеличивается до определенных значений с ростом входной мощности и напряжения источника питания $U_{ип}$.

Высокочастотные транзисторы, используемые в качестве усилителя мощности, должны иметь пробивное напряжение коллекторного перехода в 2...3 раза больше $U_{ип}$. В схемах генераторов при расстройке коллекторной цепи пиковое значение напряжения на коллекторе может достигать (3...4) $U_{ип}$ и более, особенно на нижнем участке рабочего диапазона частот.

Обычно высокочастотные мощные транзисторы работают ненадежно в режимах короткого замыкания и холостого хода и могут отказывать при рассогласовании нагрузки на выходе. Например, транзистор 2N5178 обеспечивает мощность около 50 Вт на частоте 500 МГц лишь в тщательно настраиваемом узкополосном усилителе, и даже при слабом нарушении согласования возможен отказ.

Имеются высокочастотные транзисторы, которые могут работать при всех условиях рассогласования нагрузочного полного сопротивления. Так, транзисторы 2N5764 и 2N5765 могут работать в условиях сильного рассогласования, в отличие от типов 2N4430 и 2N4431. Разработаны также приборы для специальных областей применения, в которых требуются различные значения рабочего напряжения (6; 12; 13,5; 24; 28 В и др.), с различными уровнями широкополосности, с высокой линейностью и т. п.

Для передачи информации с помощью кабелей (например, в кабельных телевизионных системах) разработаны специальные широкополосные линейные транзисторы, работающие в классе А или АВ, при котором обеспечивается малый уровень искажений, вызываемых перекрестной модуляцией. Они имеют слабую зависимость коэффициента усиления от тока, малую емкость $C_к$ и применяются на частотах много меньших, чем максимальная рабочая частота. Для стабилизации температурного режима в корпусе транзистора монтируют схему температурной стабилизации с диодом — датчиком температуры. Нелинейность таких транзисторов характеризуется коэффициентом нелинейных (интермодуляционных) искажений. При сравнительной оценке линейности транзисторов могут использоваться зависимости $S_{21}(I_K)$ и $S_{21}(U_K)$.

Транзисторы для линейных широкополосных усилителей, работающих в режиме одной боковой полосы, характеризуются отдаваемой мощностью в пике огибающей (P_{PEP}).

Мощные высокочастотные транзисторы могут применяться в импульсном режиме, при этом выходная мощность может быть увеличена при повышении рабочих напряжений. Например, транзистор MSC 1330 имеет в непрерывном режиме выходную мощность 30 Вт на частоте 1,3 ГГц при $U_{ип}=28$ В, а в импульсном ($t_и=10$ мкс) при $U_{ип}=40$ В на той же частоте уже 70 Вт.

Современные мощные высокочастотные транзисторы имеют сложные геометрические и технологические структуры (полосковые, гребенчатые, многоэмиттерные, сетчатые, многоэлементные). В этих структурах возможно развитие второго пробоя, который чаще всего проявляется при работе или испытаниях транзисторов в статическом режиме (на постоянном токе) или режиме класса А.

Среди возможных причин отказа высокочастотных и сверхвысокочастотных усилительных транзисторов можно назвать возникновение генерации за счет паразитных реактивностей схемы, перегрузку при переходных процессах и действие статического электричества.

2.21. СОСТАВНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ

Составной транзистор фактически представляет собой соединение двух биполярных транзисторов по определенной схеме, имеющей три внешних вывода. Например, в составном транзисторе по схеме Дарлингтона (рис. 25, а, б) коллекторы соединены вместе, входом служит база транзистора VT1, а эмиттером — эмиттер транзистора VT2. Для обеспечения нормальных режимов работы управляющего VT1 и выходного VT2 транзисторов по постоянному току и напряжению транзистор VT2 делается более мощным. Такой составной транзистор функционально соответствует одному транзистору с высоким результирующим коэффициентом передачи тока, равным произведению коэффициентов передачи входящих в него одиночных транзисторов:

$$h_{21э об}=h_{21э1}+h_{21э2}+h_{21э1}h_{21э2}\approx h_{21э1}h_{21э2}.$$

Недостатком составных транзисторов является повышенное напряжение насыщения $U_{КЭ\,нас}=U_{КЭ\,нас1}+U_{БЭ2}$, а также относительно большой обратный ток.

Для увеличения стабильности работы эмиттерные переходы транзисторов VT1 и VT2 могут шунтироваться резисторами $R_{бэ1}$ и $R_{бэ2}$ (например, $R_{бэ1}=1...$ ...10 кОм, $R_{бэ2}=25...300$ Ом), предотвращающими возрастание токов утечки (осо-

4 Заказ № 1141

бению при высоких температурах), но и влияющими на общий коэффициент усиления (рис. 26, а, б):

$$h_{21эоб}=h_{21э1}R_{бэ1}/(R_{бэ1}+r_{вх1})+h_{21э2}R_{бэ2}/(R_{бэ2}+r_{вх2})+$$
$$+h_{21э1}h_{1э2}R_{бэ1}R_{бэ2}/[R_{бэ1}+r_{вх1})(R_{бэ2}+r_{вх2})],$$

где $r_{вх}$ — входное сопротивление транзистора. При этом

$$I_{кэо\ об}=I_{кэR1}(h_{21э2}R_{бэ1})/(R_{бэ2}+r_{вх2}).$$

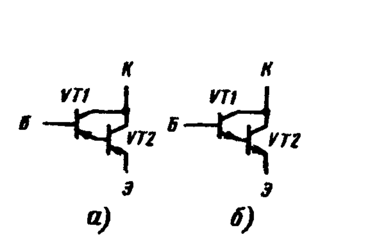


Рис. 25. Составные p-n-p (а) и n-p-n (б) транзисторы

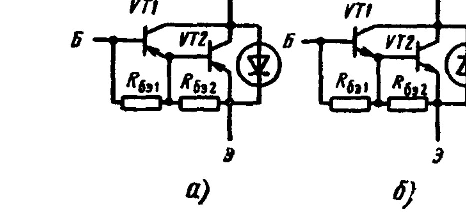


Рис. 26. Составные p-n-p (а) и n-p-n (б) транзисторы с резисторами $R_{б1}$ и $R_{б2}$

Внутренняя структура составных транзисторов варьируется в зависимости от области их применения. В ряде приборов могут отсутствовать резисторы $R_{б1}$ и $R_{б2}$ (например, у 2SB678, 2SB679, 2SB880, 2SD549, 2SD688, 2SD1190, 2SD1224), может быть только резистор $R_{б1}$ (например, у RCA9203, 2SD684, 2SD1088, 2SD1410, 2SD1861). Имеются приборы, в которых между коллектором и эмиттером выходного транзистора включается диод (например, у КТ825, 2N6050, 2N6285, TIP110), защищающий транзистор от инверсных (обратных) токов, возникающих в результате переходного процесса при работе на индуктивную нагрузку и при непредусмотренном изменении полярности напряжения питания (см. рис. 26). Но тогда они становятся не пригодными для использования в инверторных мостовых схемах. Для повышения стойкости ко второму пробою между коллектором и базой или между коллектором и эмиттером включается стабилитрон (например, у 2SD706, 2SD708, 2SD1208, 2SD1294).

Составные транзисторы применяются в стабилизаторах напряжения непрерывного и импульсного действия, электронных системах зажигания автомобилей (например, КТ848А), схемах управления двигателей, в различных усилительных и переключательных схемах.

Необходимо отметить, что большое усиление могут иметь и одиночные мощные и маломощные транзисторы со сверхбольшим коэффициентом усиления (так называемые Ultra-Beta и Super-Beta), например 2N5961 — 2N5963, 2SC1888, 2SC1983, 2SC2198, 2SC2315 — 2SC2317, 2SC2491, 2SD920, 2SD931, 2SD982, 2SD1052, 2SD1090, 2SD1353.

2.22. ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ ДИОДЫ

Выпрямительные диоды применяются в целях управления, коммутации, в ограничительных и развязывающих цепях, в источниках питания для преобразования (выпрямления) переменного напряжения в постоянное в однополупериодной, двухполупериодной, однофазной мостовой и многофазной схемах, в схемах умножения напряжения и преобразователях постоянного напряжения, где не предъявляются высокие требования к частотным и временным параметрам сигналов. Выпрямительные свойства диодов тем лучше, чем меньше обратный ток при заданном обратном напряжении и чем меньше падение напряжения при заданном прямом токе. Они характеризуются статическими ($U_{пр}$, $I_{обр}$), динамическими ($I_{пр\ ср}$, $U_{пр\ ср}$, $I_{обр\ ср}$, $U_{обр\ ср}$, $f_р$, $R_д$, $C_д$) и предельно допустимыми параметрами ($I_{пр\ ср\ max}$, $P_{д\ max}$, $U_{обр\ max}$, $U_{обр,\ и\ max}$, $T_{пер\ max}$, $I_{и\ max}$). Для выпрямительных диодов принципиальное значение имеет характер нагрузки (активная, емкостная или индуктивная), влияющей на форму и значение протекающего тока, т. е. определяющей режим работы диода.

При расчете выпрямителя обычно задаются значения выпрямленных напряжения $U_{вп}$ и тока $I_{вп}$, напряжения и частоты сети питания. Исходя из этого определяются, например, для распространенной мостовой схемы при работе на емкостную нагрузку среднее значение выпрямленного тока $I_{пр\ ср}=I_{вп}/2$, амплитудное значение тока $I_{и|max}\approx3{,}5\ I_{вп}$ (т. е. мгновенное значение прямого тока может значительно превышать среднее значение), значение обратного напряжения $U_{обр}\approx\approx1{,}5\ U_{вп}$, которые не должны превышать предельно допустимых значений. С повышением частоты приложенного напряжения, большей $f_р$, указанной в ТУ, выпрямляющие свойства диодов ухудшаются, значение $I_{вп}$ уменьшается (падает эквивалентное сопротивление p-n перехода), потери в диоде увеличиваются и он значительно нагревается. От значения $U_{пр}$ зависит рассеиваемая мощность и экономичность выпрямителя ($U_{пр}<1$ В для германия и $U_{пр}<1{,}5$ В для кремния). При постоянном $I_{пр}$ значение $U_{пр}$ с ростом температуры уменьшается (ТКН=1,2... ...3 мВ/°С), что учитывается при работе в широком диапазоне температур.

Предельно допустимыми параметрами выпрямительных диодов являются максимальный выпрямленный ток $I_{пр\ max}$, максимальное обратное напряжение $U_{обр\ max}$, максимальная и минимальная температура окружающей среды, максимально допустимая рассеиваемая мощность $P_{д\ max}$. Часто приводятся максимально допустимые значения импульсного прямого и выпрямленного токов, используемые при расчете переходных процессов выпрямителя, работающего на емкостную нагрузку.

В качестве выпрямительных диодов используются и диоды Шотки, имеющие структуру металл — полупроводник. По сравнению с p-n переходом у них отсутствует диффузия, связанная с инжекцией неосновных носителей, т. е. они работают только на основных носителях. Поэтому у диодов Шотки отсутствует емкость $C_д$, связанная с накоплением и рассасыванием неосновных носителей, а их быстродействие определяется только барьерной емкостью. Другой важной особенностью диодов Шотки является меньшее прямое падение напряжения (примерно на 0,2 Б). Прямая ветвь ВАХ у них подчиняется экспоненциальному закону в широком диапазоне токов, что позволяет их использовать как прецизионные логарифмирующие элементы.

2.23. СТАБИЛИТРОНЫ

Рабочий участок стабилитронов находится в области электрического пробоя p-n перехода, где напряжение стабилизации (пробоя) $U_{ст}$ остается практически постоянным при изменении тока стабилизации (пробоя) в достаточно широком диапазоне. Ток стабилизации $I_{ст}$ ограничивается внешним резистором, чтобы

рассеиваемая мощность не превышала предельно допустимого значения. В стабилитронах могут возникать два вида электрического пробоя: туннельный (эффект Зенера) — для диодов с $U_{ст}>5$ В и лавинный — для диодов с $U_{ст}>7$ В. В интервале 5...7 В возникает смешанный вид пробоя. Напряжение $U_{ст}$ зависит от тока $I_{ст}$ и от изменения температуры: с повышением температуры у диодов с $U_{ст}<5$ В оно уменьшается (температурный коэффициент напряжения стабилизации $\alpha_{U_{ст}}<<0$), у диодов с $U_{ст}>7$ В оно увеличивается ($\alpha_{U_{ст}}>0$). Стабилитроны кроме рабочего режима в обратном направлении могут включаться и в прямом направлении, т. е. работать как обычные p-n переходы.

Основными параметрами и характеристиками стабилитронов являются: номинальное напряжение стабилизации $U_{ст}$: стабильность величины $U_{ст}$ (разность двух напряжений $U_{ст}$ до и после испытаний, измеренных при одинаковых температуре и $I_{ст}$), $\Delta U_{ст}$; температурный коэффициент напряжения стабилизации $\alpha_{U_{ст}}$; номинальный ток стабилизации $I_{ст}$, при котором определяются классификационные параметры; минимальный ток стабилизации $I_{ст\,min}$ (при рабочих токах, меньших $I_{ст\,min}$, возрастает дифференциальное сопротивление и пробой становится неустойчивым); максимально допустимый ток стабилизации $I_{ст\,max}$, при котором гарантируется надежная работа (определяется максимально допустимой рассеиваемой мощностью); зависимость $U_{ст}$ от $I_{ст}$, определяющая сопротивление переменному и постоянному току; внешняя (показывающая закон изменения $U_{ст}$ при резком изменении температуры среды, что необходимо при осуществлении термокомпенсации) и внутренняя тепловые переходные характеристики; дрейф $U_{ст}$ во времени; предельно допустимые параметры.

Абсолютный температурный коэффициент напряжения стабилизации $\alpha_{U_{ст}a}= =dU_{ст}/dT\approx\Delta U_{ст}/\Delta T$, мВ/°С, при $I_{ст}=\text{const}$, а относительный $\alpha_{U_{ст}o}\approx \approx\Delta U_{ст}\cdot 100/(U_{ст}\cdot\Delta T)$, %/°С. Температурные изменения $U_{ст}$ могут быть уменьшены последовательным подключением к стабилитрону, работающему в обратном направлении, компенсирующего p-n перехода (одного или несколько) или другого стабилитрона в прямом направлении, а также последовательным подключением терморезисторов. Напряжение $U_{ст}$ при неизменных $I_{ст}$ и $T_{окр}$ меняется во времени незначительно. Следует отметить, что у стабилитронов с лавинным механизмом пробоя имеются собственные шумовые токи и напряжения.

Дифференциальное сопротивление $R_д$ — это отношение приращения падения напряжения на стабилитроне к вызвавшему его приращению тока при заданном $I_{ст}$, а статическое сопротивление $R_{ст}$ — отношение постоянного напряжения на стабилитроне к току через него.

Динамическое сопротивление переменному току примерно обратно пропорционально $I_{ст}$ в области малых токов и мало зависит от $I_{ст}$ в области больших токов, т. е. при работе стабилитрона в качестве источника опорного напряжения через него должен протекать ток более $I_{ст\,min}$.

Стабилитроны подразделяются на прецизионные (у которых в качестве классификационных параметров используются $\alpha_{U_{ст}}$, $\Delta U_{ст}$), и общего назначения. Они применяются в стабилизаторах и ограничителях напряжения, а также в качестве источников опорного (эталонного) напряжения (разброс $U_{ст}$ не должен превышать 0,1%).

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ

3.1. О ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ

Вопросы, связанные с взаимозаменяемостью отечественных и зарубежных полупроводниковых приборов, возникают при необходимости замены вышедшего из строя прибора в конкретной аппаратуре, а также при определении возможности воспроизведения интересующего устройства (схемы).

Полная аналогичность (эквивалентность) отечественных и зарубежных полупроводниковых приборов предполагает совпадение их функционального назначения, электрических параметров и характеристик, конструктивного оформления, габаритных и присоединительных размеров, массы, формы и расположения выводов, методов герметизации, электрической связи выводов с корпусом, надежности и стабильности. Однако полного совпадения получить практически невозможно, так как процесс создания полупроводниковых приборов — это технологический комплекс, характерный для каждой фирмы-изготовителя.

Принципы и методы определения наиболее вероятных значений и установления норм и допусков электрических параметров, принятые в разных странах, неодинаковы. Очевидно, что в ряде случаев нормы, устанавливаемые на параметры, могут значительно отличаться от их реальных значений.

Режимы, условия, методы проведения различных видов электрических, механических и климатических испытаний, нормы на параметры — критерии годности при испытаниях, методы измерений, от которых в общем зависят устанавливаемые параметры, многообразны, принципиально различны и не универсальны. Кроме того, значения параметров приборов зависят не только от режима работы и температуры, но и изменяются со временем (дрейф параметров во время работы и при хранении). В настоящее время существуют международные стандарты и рекомендации различных международных комиссий, способствующие регламентированию терминологии, технических требований, классификации, методов измерения и других свойств приборов. Однако в отдельных странах имеются свои особенности в стандартизации параметров и свойств приборов.

Эксплуатационные свойства транзисторов описываются большим числом параметров, поэтому можно считать, что практически полная тождественность отечественных и зарубежных транзисторов недостижима и не во всех случаях необходима. Целесообразнее говорить о частичной (неполной) или приближенной их эквивалентности. Подбор аналогов должен проводиться с учетом конкретной электрической схемы, а не только путем формального сравнения всех параметров приборов (показателей функционирования) в совпадающем или близком режимах измерений. При воспроизведении технических показателей схемы (узла, каскада) должны удовлетворяться прежде всего требования к выходным параметрам. Поэтому не все параметры транзисторов будут одинаково важными, а только те, по которым должна быть обеспечена взаимозаменяемость.

Таким образом, наличие конкретной схемы приводит к сокращению числа рассматриваемых параметров и упрощению решения задачи по подбору эквивалентных приборов за счет выявленных требований к выходным параметрам и определения реального режима работы приборов. При анализе комплекса выходных па-

раметров их условно можно разделить на основные (требуется наилучшее сочетание их значений) и второстепенные (значения могут меняться в достаточно широких пределах) параметры.

Взаимозаменяемость отечественных и зарубежных приборов зависит не только от их свойств, условий эксплуатации и режимов применения, но и от рационально разработанной схемы, учитывающей номинальный разброс параметров и не требующей специального подбора приборов. При замене зарубежного прибора отечественным, даже лучшим по параметрам, может потребоваться подстройка схемы, чтобы не ухудшилась работа каскада и не возникла паразитная генерация.

Подбор аналогов должен осуществляться сравнением электрических параметров (показателей функционирования) отечественных и зарубежных приборов из справочников, стандартов или технических условий на эти приборы, где указывается основное (целевое) назначение приборов, технология изготовления, структура (p-n-p или n-p-n), предельные (предельно допустимые) параметры, данные об электрических параметрах и их изменениях от режима и температуры, тип корпуса и другие сведения.

Следует отметить, что к зарубежной рекламной информации о новых приборах следует относиться критически, с достаточной долей осторожности, так как обычно рекламируемые параметры соответствуют единичным образцам приборов с максимально достигнутыми (рекордными) значениями. В процессе серийного производства значения этих параметров в среднем оказываются хуже рекламных.

Полупроводниковые приборы, изготавливаемые в едином технологическом процессе, иногда разделяются по каким-либо параметрам на группы и собираются в различных корпусах. Например, транзисторы BC107—BC109 имеют металлостеклянный корпус TO-18, приборы с таким же сочетанием параметров BC107P—BC109P, BC147—BC149, BC207—BC209, PBC107—PBC109 имеют соответственно корпуса X-55, MM-12, RO-110, TO-98. Многие приборы в металлостеклянном корпусе имеют эквиваленты в пластмассовом корпусе.

Некоторые фирмы выпускают свои приборы по лицензиям других фирм или стран, присваивают им новые номера, иногда меняя нормы на некоторые параметры.

Унификация и стандартизация отечественных полупроводниковых приборов и их корпусов позволила устранить излишнее многообразие типов приборов, выпускаемых нашей промышленностью.

Следует отметить, что взаимозаменяемость по присоединительным и габаритным размерам отечественных и зарубежных приборов, которая определяет возможность замены приборов при соблюдении условий сопряжения с панельками, теплоотводами, изоляционными прокладками, экранами, с отверстиями в шасси (плате), может не выполняться (в основном для приборов, не отвечающих по габаритным размерам требованиям МЭК).

3.2. БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ БИПОЛЯРНЫХ И ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРОВ

Буквенные обозначения параметров биполярных транзисторов, соответствующие публикациям МЭК 148, 148A, 148B и рекомендации по стандартизации СЭВ РС 3233—71, принятые за рубежом и стандартизированные ГОСТ 20003—74, приводятся ниже.

Буквенное обозначение параметра		Термин
отечественное	зарубежное	
$I_{КБО}$	I_{CBO}	Обратный ток коллекторного перехода при разомкнутом выводе эмиттера
$I_{ЭБО}$	I_{EBO}	Обратный ток эмиттерного перехода при разомкнутом выводе коллектора
$I_{КЭО}$	I_{CEO}	Обратный ток коллектор — эмиттер при разомкнутом выводе базы
$I_{КЭR}$	I_{CER}	Обратный ток коллектор — эмиттер при заданном сопротивлении в цепи база — эмиттер
$I_{КЭК}$	I_{CES}	Обратный ток коллектор — эмиттер при коротко замкнутых выводах базы и эмиттера
$I_{КЭV}$	I_{CEV}	Обратный ток коллектор — эмиттер при запирающем напряжении (смещении) в цепи база — эмиттер
$I_{КЭX}$	I_{CEX}	Обратный ток коллектор — эмиттер при заданных условиях цепи база — эмиттер
$I_{КР}$	—	Критический ток биполярного транзистора
$U_{КБО\ проб}$	$U_{(BR)CBO}$	Пробивное напряжение коллектор — база при разомкнутой цепи эмиттера
$U_{ЭБО\ проб}$	$U_{(BR)EBO}$	Пробивное напряжение эмиттер — база при разомкнутой цепи коллектора
$U_{КЭО\ проб}$	$U_{(BR)CEO}$	Пробивное напряжение коллектор — эмиттер при разомкнутой цепи базы ($R_{бэ}=\infty$)
$U_{КЭО\ гр}$	$U_{(L)CEO}$	Граничное напряжение коллектор — эмиттер при разомкнутой цепи базы и заданном токе эмиттера
$U_{КЭR\ проб}$	$U_{(BR)CER}$	Пробивное напряжение коллектор — эмиттер при заданном (конечном) сопротивлении в цепи база — эмиттер
$U_{КЭК\ проб}$	$U_{(BR)CES}$	Пробивное напряжение коллектор — эмиттер при коротко замкнутых выводах базы и эмиттера ($R_{бэ}=0$)
$U_{КЭV\ проб}$	$U_{(BR)CEV}$	Пробивное напряжение коллектор — эмиттер при запирающем напряжении в цепи база — эмиттер
$U_{КЭX\ проб}$	$U_{(BR)CEX}$	Пробивное напряжение коллектор — эмиттер при заданных условиях в цепи база — эмиттер
$U_{смк}$	U_{pt}	Напряжение смыкания
$U_{КЭ\ нас}$	$U_{CE\ sat}$	Напряжение насыщения коллектор — эмиттер
$U_{БЭ\ нас}$	$U_{BE\ sat}$	Напряжение насыщения база — эмиттер
$U_{ЭБ\ пл}$	$U_{EB\ fl}$	Плавающее напряжение эмиттер — база

Продолжение

Буквенное обозначение параметра		Термин
отечественное	зарубежное	
$U_{\text{КБ max}}$	$U_{CB\ max}$	Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор — база
$U_{\text{КЭ max}}$	$U_{CE\ max}$	Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор — эмиттер
$U_{\text{ЭБ max}}$	$U_{EB\ max}$	Максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер — база
$U_{\text{КЭ, и max}}$	$U_{CEM\ max}$	Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор — эмиттер
$U_{\text{КБ, и max}}$	$U_{CBM\ max}$	Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор — база
$U_{\text{ЭБ, и max}}$	$U_{EBM\ max}$	Максимально допустимое импульсное напряжение эмиттер — база
$P_{\text{К max}}$	$P_{C\ max}$	Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора
$P_{\text{К, ср max}}$	—	Максимально допустимая средняя рассеиваемая мощность коллектора
$P_{\text{и max}}$	$P_{M\ max}$	Максимально допустимая импульсная рассеиваемая мощность биполярного транзистора
P	P_{tot}	Постоянная рассеиваемая мощность биполярного транзистора
$P_{\text{ср}}$	P_{AV}	Средняя рассеиваемая мощность биполярного транзистора
$P_{\text{и}}$	P_{RM}	Импульсная рассеиваемая мощность биполярного транзистора
$P_{\text{К}}$	P_C	Постоянная рассеиваемая мощность коллектора
$P_{\text{вых}}$	P_{out}	Выходная мощность биполярного транзистора
$P_{\text{вх}}$	P_{in}	Входная мощность биполярного транзистора
$I_{\text{К max}}$	$I_{C\ max}$	Максимально допустимый постоянный ток коллектора
$I_{\text{Э max}}$	$I_{E\ max}$	Максимально допустимый постоянный ток эмиттера
$I_{\text{Б max}}$	$I_{B\ max}$	Максимально допустимый постоянный ток базы
$I_{\text{К, и max}}$	$I_{CM\ max}$	Максимально допустимый импульсный ток коллектора
$I_{\text{Э, и max}}$	$I_{EM\ max}$	Максимально допустимый импульсный ток эмиттера
$h_{11\text{э}}$, $h_{11\text{б}}$	h_{11e}, h_{11b} h_{ie}, h_{ib}	Входное сопротивление биполярного транзистора в режиме малого сигнала в схемах с общим эмиттером и общей базой соответственно.
$h_{21\text{э}}$, $h_{21\text{б}}$	h_{21e}, h_{21b} h_{fe}, h_{fb} β, α	Коэффициент передачи тока биполярного транзистора в режиме малого сигнала в схемах с общим эмиттером и общей базой соответственно

Продолжение

Буквенное обозначение параметра		Термин
отечественное	зарубежное	
$h_{12\text{э}}$, $h_{12\text{б}}$	h_{12e}, h_{12b} h_{re}, h_{rb}	Коэффициент обратной связи по напряжению биполярного транзистора в режиме малого сигнала в схемах с общим эмиттером и общей базой соответственно
$h_{22\text{э}}$, $h_{22\text{б}}$	h_{22e}, h_{22b} h_{oe}, h_{ob}	Выходная полная проводимость биполярного транзистора в режиме малого сигнала в схемах с общим эмиттером и общей базой соответственно
$\lvert h_{21\text{э}} \rvert$	$\lvert h_{21e} \rvert$	Модуль коэффициента передачи тока биполярного транзистора на высокой частоте
$h_{11\text{Э}}$	h_{11E} h_{IE}	Входное сопротивление биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером в режиме большого сигнала
$h_{21\text{Э}}$	h_{21E} h_{FE}	Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером
$Y_{11\text{э}}$, $Y_{11\text{б}}$	Y_{11e}, Y_{11b} Y_{ie}, Y_{ib}	Входная полная проводимость биполярного транзистора в режиме малого сигнала в схемах с общим эмиттером и общей базой соответственно
$Y_{12\text{э}}$, $Y_{12\text{б}}$	Y_{12e}, Y_{12b} Y_{re}, Y_{rb}	Полная проводимость обратной передачи биполярного транзистора в режиме малого сигнала в схемах с общим эмиттером и общей базой соответственно
$Y_{21\text{э}}$, $Y_{21\text{б}}$	Y_{21e}, Y_{21b} Y_{fe}, Y_{fb}	Полная проводимость прямой передачи биполярного транзистора в режиме малого сигнала в схемах с общим эмиттером и общей базой соответственно
$Y_{22\text{э}}$, $Y_{22\text{б}}$	Y_{22e}, Y_{22b} Y_{oe}, Y_{ob}	Выходная полная проводимость биполярного транзистора в режиме малого сигнала в схемах с общим эмиттером и общей базой соответственно
$Y_{21\text{Э}}$	Y_{21E}	Статическая крутизна прямой передачи в схеме с общим эмиттером
$C_{11\text{э}}$, $C_{11\text{б}}$	C_{11e}, C_{11b}	Входная емкость биполярного транзистора в схемах с общим эмиттером и общей базой соответственно
$C_{22\text{э}}$, $C_{22\text{б}}$	C_{22e}, C_{22b}	Выходная емкость биполярного транзистора в схемах с общим эмиттером и общей базой соответственно
$C_{\text{к}}$	C_c	Емкость коллекторного перехода
$C_{\text{э}}$	C_e	Емкость эмиттерного перехода
$r'_{\text{б}}$	r'_{bb} r'_b	Сопротивление базы биполярного транзистора
$\tau_{\text{к}}$, $r'_{\text{б}}C_{\text{к}}$	τ_c, $r'_{bb}C_c$	Постоянная времени цепи обратной связи коллекторной цепи

Продолжение

Буквенное обозначение параметра: отечественное	Буквенное обозначение параметра: зарубежное	Термин
$S_{11\text{э}}$, $S_{11\text{б}}$, $S_{11\text{к}}$	S_{11e}, S_{11b}, S_{11c} S_{1e}, S_{1b}, S_{1c}	Коэффициент отражения входной цепи биполярного транзистора в схемах с общим эмиттером, общей базой и общим коллектором
$S_{12\text{э}}$, $S_{12\text{б}}$, $S_{12\text{к}}$	S_{12e}, S_{12b}, S_{12c} S_{re}, S_{rb}, S_{rc}	Коэффициент обратной передачи напряжения биполярного транзистора в схемах с общим эмиттером, общей базой и общим коллектором
$S_{21\text{э}}$, $S_{21\text{б}}$, $S_{21\text{к}}$	S_{21e}, S_{21b}, S_{21c}	Коэффициент прямой передачи напряжения в схемах с общим эмиттером, общей базой и общим коллектором
$S_{22\text{э}}$, $S_{22\text{б}}$, $S_{22\text{к}}$	S_{22e}, S_{22b}, S_{22c} S_{oe}, S_{ob}, S_{oc}	Коэффициент отражения выходной цепи биполярного транзистора в схемах с общим эмиттером, общей базой и общим коллектором
$f_{h21\text{э}}$ $f_{h21\text{б}}$	f_{h21e}, f_{hfe} f_{h21b}, f_{hfb}	Предельная частота коэффициента передачи тока биполярного транзистора в схемах с общим эмиттером и общей базой
$f_{\text{гр}}$	f_T	Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером
—	f_{se}, f_{sb}, f_{sc}	Частота, при которой коэффициент прямой передачи напряжения равен единице: $\|S_{21e}\|=1$, $\|S_{21b}=1\|$, $\|S_{21c}==1\|$
f_{max}	f_{max}	Максимальная частота генерации биполярного транзистора
$K_{\text{ш}}$	F	Коэффициент шума биполярного транзистора
$t_{\text{зд}}$	t_d	Время задержки биполярного транзистора
$t_{\text{нр}}$	t_r	Время нарастания для биполярного транзистора
$t_{\text{рас}}$	t_s	Время рассасывания для биполярного транзистора
$t_{\text{сп}}$	t_f	Время спада для биполярного транзистора
$t_{\text{вкл}}$	t_{on}	Время включения биполярного транзистора
$t_{\text{выкл}}$	t_{off}	Время выключения биполярного транзистора
$r_{\text{кэ нас}}$	$r_{CE\ sat}$	Сопротивление насыщения
$K_{\text{у}P}$	G_P	Коэффициент усиления по мощности биполярного транзистора
—	G_A, G_a	Номинальный коэффициент передачи (усиления) по мощности биполярного транзистора

Окончание

Буквенное обозначение параметра: отечественное	Буквенное обозначение параметра: зарубежное	Термин
—	G_{pa}	Номинальный коэффициент усиления по мощности биполярного транзистора при согласованной нагрузке
—	$G_{pa\ max}$	Максимальный номинальный коэффициент усиления по мощности биполярного транзистора при одновременном согласовании входа и выхода
$T_{\text{к}}$	T_C, T_{case}, Θ_C, ϑ_C	Температура корпуса
$T_{\text{окр}}$	T_A, T_{amb}, Θ_A, ϑ_A	Температура окружающей среды
$T_{\text{п}}$	T_j, T_J	Температура перехода
—	T_{stg}	Температура хранения
$R_{\text{т, п—с}}$	R_{thja}	Тепловое сопротивление переход — окружающая среда
$R_{\text{т, п—к}}$	R_{thjc}	Тепловое сопротивление переход — корпус
$R_{\text{т, к—с}}$	R_{thca}	Тепловое сопротивление корпус — окружающая среда
$\tau_{\text{т, п—к}}$	τ_{thjc}	Тепловая постоянная времени переход — корпус
$\tau_{\text{т, п—с}}$	τ_{thja}	Тепловая постоянная времени переход — окружающая среда
$\tau_{\text{т, к—с}}$	τ_{thca}	Тепловая постоянная времени корпус — окружающая среда

Буквенные обозначения параметров полевых транзисторов, соответствующие публикации МЭК 747-8 и ГОСТ 19095—73, приведены ниже.

Буквенное обозначение параметра: отечественное	Буквенное обозначение параметра: зарубежное	Термин
I_C	I_D	Ток стока
$I_{C\ \text{ост}}$	I_{DSX}	Остаточный ток стока
$I_{C\ \text{нагр}}$	I_{DSR}	Ток стока при нагруженном затворе
$I_{C\ \text{нач}}$	I_{DSS}	Начальный ток стока
$I_{И}$	I_S	Ток истока
$I_{И\ \text{ост}}$	I_{SDX}	Остаточный ток истока
$I_{И\ \text{нач}}$	I_{SDS}	Начальный ток истока
$I_{З}$	I_G	Ток затвора

Продолжение

Буквенное обозначение параметра		Термин
отечественное	зарубежное	
$I_{з\ пр}$	I_{GF}	Прямой ток затвора
$I_{зсо}$	I_{GDO}	Обратный ток перехода затвор — сток
$I_{зио}$	I_{GSO}	Обратный ток перехода затвор — ясток
$I_{з\ ут}$	I_{GSS}	Ток утечки затвора
$I_{з\ отс}$	I_{GSX}	Ток отсечки затвора
$I_{п}$	I_{B}, I_{U}	Ток подложки
$U_{си}$	U_{DS}	Напряжение сток — исток
$U_{зи}$	U_{GS}	Напряжение затвор — исток
$U_{зи\ пор}$	U_{GST}, $U_{GS(th)}$, $U_{GS(TO)}$	Пороговое напряжение полевого транзистора
$U_{зи\ пр}$	U_{GSF}	Прямое напряжение затвор — исток
$U_{зи\ обр}$	U_{GSR}	Обратное напряжение затвор — исток
$U_{зс}$	U_{GD}	Напряжение затвор — сток
$U_{ип}$	U_{SB}, U_{SU}	Напряжение исток — подложка
$U_{сп}$	U_{DB}, U_{DU}	Напряжение сток — подложка
$U_{зп}$	U_{GB}, U_{GU}	Напряжение затвор — подложка
$U_{з1}-U_{з2}$	U_{G1-G2}	Напряжение затвор — затвор (для приборов с несколькими затворами)
$U_{з\ проб}$	$U_{(BR)GSS}$	Пробивное напряжение затвора
$U_{зи\ отс}$	$U_{GS(OFF)}$, $U_{GS(off)}$	Напряжение отсечки полевого транзистора
$P_{си}$	P_{DS}	Рассеиваемая мощность сток — исток

Продолжение

Буквенное обозначение параметра		Термин
отечественное	зарубежное	
$R_{си\ отк}$	$r_{DS(ON)}$, $r_{ds(on)}$, $r_{DS\ on}$	Сопротивление сток — исток в открытом состоянии
$R_{си\ зак}$	$r_{DS(OFF)}$, $r_{ds(off)}$, $r_{DS\ off}$	Сопротивление сток — исток в закрытом состоянии
$C_{зио}$	C_{gso}	Емкость затвор — исток
$C_{зсо}$	C_{gdo}	Емкость затвор — сток
$C_{сио}$	C_{dso}	Емкость сток — исток
$C_{11и}$	C_{iss}, C_{11ss}	Входная емкость полевого транзистора
$C_{22и}$	C_{oss}, C_{22ss}	Выходная емкость полевого транзистора
$g_{11и}$	g_{iss}, g_{11s}	Активная составляющая входной проводимости полевого транзистора
$g_{22и}$	g_{oss}, g_{22s}	Активная составляющая выходной проводимости полевого транзистора
$C_{12и}$	C_{rss}, C_{12ss}	Проходная емкость полевого траизистора
C_{22d}	C_{ods}, C_{22ds}	Выходная емкость полевого транзистора (затвор — сток по переменному току)
$y_{11и}$	y_{is}, y_{11s}	Полная входная проводимость полевого транзистора
$y_{12и}$	y_{rs}, y_{12s}	Полная проводимость обратной передачи полевого транзистора
$y_{21и}$	y_{fs}, y_{21s}	Полная проводимость прямой передачи полевого транзистора

Продолжение

Буквенное обозначение параметра		Термин
отечественное	зарубежное	
$y_{22и}$	y_{os}, y_{22s}	Полная выходная проводимость полевого транзистора
K_{yP}	G_P, G_p	Коэффициент усиления по мощности полевого транзистора
$f_{y21и}$	f_{yfs}	Частота отсечки полевого транзистора в схеме с общим истоком
S	g_{ms}	Крутизна характеристики полевого транзистора
$U_ш$	U_n	Шумовое напряжение
$K_ш$	F	Коэффициент шума полевого транзистора
—	α_{ID}	Температурный коэффициент тока стока
—	α_{rds}	Температурный коэффициент сопротивления сток — исток
$t_{зд\ вкл}$	$t_{d(on)}$	Время задержки включения полевого транзистора
$t_{зд\ выкл}$	$t_{d(off)}$	Время задержки выключения полевого транзистора
$t_{нр}$	t_r	Время нарастания для полевого транзистора
$t_{сп}$	t_f	Время спада для полевого транзистора
$t_{вкл}$	t_{on}	Время включения полевого транзистора
$t_{выкл}$	t_{off}	Время выключения полевого транзистора

Окончание

Буквенное обозначение параметра		Термин
отечественное	зарубежное	
Для сдвоенных полевых транзисторов		
$I_{З(ут)1} - I_{З(ут)2}$	$I_{GSS1} - I_{GSS2}$	Разность токов утечки затвора
$I_{С(нач)1}/I_{С(нач)2}$	I_{DSS1}/I_{DSS2}	Отношение токов стока при нулевом напряжении затвор — исток
$g_{22(и)1} - g_{22(и)2}$	$G_{22S1} - G_{22S2}$	Разность активных выходных проводимостей
$g_{21и1}/g_{21и2}$	g_{fs1}/g_{fs2}	Отношение активных проводимостей прямой передачи
$U_{ЗИ1} - U_{ЗИ2}$	$U_{GS1} - U_{GS2}$	Разность напряжений затвор — исток
$\Delta\|(U_{ЗИ1} - U_{ЗИ2})\|/\Delta T$	$\Delta\|(U_{GS1} - U_{GS2})\|/\Delta T$	Температурный уход разности напряжений затвор — исток

3.3. ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ И ИХ ЗАРУБЕЖНЫЕ АНАЛОГИ

При подборе аналогов к отечественным транзисторам учитывались основное назначение приборов, электрические параметры и характеристики, а также их конструктивно-технологические особенности.

Для отечественных транзисторов приводятся несколько приближенных зарубежных аналогов, отличающихся по электрическим параметрам не более, чем в два раза. В таблицах приняты следующие сокращения параметров и технологий изготовления транзисторов: С — сплавные, D — диффузионные, МД — микросплавные диффузионные, ТД — тройной диффузии, CD — сплавно-диффузионные, К — конверсионные, М — меза, П — планарные, ПЭ — планарно-эпитаксиальные, $t_{пк}$ — время переключения, Ge — германий, Si — кремний.

В таблицах для рассеиваемой мощности в скобках указана температура окружающей среды, а также рассеиваемая мощность транзистора с теплоотводом, для $U_{КЭR\ проб}$ — $R_{бэ}$, для $U_{КБО\ проб}$ — импульсное значение в вольтах. Значения параметров приводятся для температуры окружающей среды 25 °С.

Режимы измерений параметров $h_{21э}(U_К;\ I_К)$, $h_{21Э}(U_К;\ I_К)$, $I_{КБО}(U_К)$, $C_К(U_К)$, $K_ш(f_{изм})$ указаны в скобках.

Для параметров $f_{гр}$, $f_{h21э}$, $f_{h21б}$, $I_{КБО}$, $h_{21Э}$, $h_{21э}$, $C_К$, $r_{кэ\ нас}$, $K_ш$, $t_{рас}$, $t_{выкл}$, $r_бC_к$ приводятся знаки $\geqslant$ (больше) или $\leqslant$ (меньше). Если они отсутствуют, указывается типовое значение параметра.

В некоторых графах таблиц приводятся несколько параметров, отмеченных *, **, ***, которым соответствуют значения с теми же знаками.

Тип прибора	Материал, структура, технологии	$P_{K\,max}$, $P^*_{K,т\,max}$, $P^{**}_{K,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, мкА	$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$К_ш$, дБ, $r^*_б$, $r^{**}_{бэ\,нас}$, Ом	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
ГТ109А	Ge, p-n-p, C	30	≥1*	10 (18 имп)	—	20	≤5 (5 В)	20...50 (5 В; 1 мА)	≤30 (5 В)	—	—	≤10000	1
ГТ109В	Ge, p-n-p, C	30	≥1*	10 (18 имп)	—	20	≤5 (5 В)	35...80 (5 В; 1 мА)	≤30 (5 В)	—	—	≤10000	1
ГТ109В	Ge, p-n-p, C	30	≥1*	10 (18 имп)	—	20	≤5 (5 В)	60...130 (5 В; 1 мА)	≤30 (5 В)	—	—	≤10000	1
ГТ109Г	Ge, p-n-p, C	30	≥1*	10 (18 имп)	—	20	≤5 (5 В)	110...250 (5 В; 1 мА)	≤30 (5 В)	—	—	≤10000	1
ГТ109Д	Ge, p-n-p, C	30	≥3*	10 (18 имп)	—	20	≤2 (1,2 В)	20...70 (5 В; 1 мА)	≤40 (1,2 В)	—	—	≤10000	1
ГТ109Е	Ge, p-n-p, C	30	≥5*	10 (18 имп)	—	20	≤2 (1,2 В)	50...100 (5 В; 1 мА)	≤40 (1,2 В)	—	—	≤10000	1
ГТ109Ж	Ge, p-n-p, C	30	—	10 (18 имп)	—	20	≤1 (1,5 В)	≥100* (1,5 В)	—	—	—	≤10000	1
ГТ109И	Ge, p-n-p, C	30	≥1*	10 (18 имп)	—	20	≤5 (5 В)	20...80 (5 В; 1 мА)	≤30 (5 В)	—	≤12 (1 кГц)	≤10000	1
2N77	Ge, p-n-p, C	35	0,7*	25	—	15	10	55 (4 В; 0,7 мА)	40	—	—	—	TO-2
2N105	Ge, p-n-p, C	35	0,75*	25	—	15	5	55 (4 В; 0,7 мА)	17	—	—	—	TO-2
OC1044	Ge, p-n-p, C	83	≥7,5*	15	12	5 (10*)	≤10 (15 В)	45...225 (6 В; 1 мА)	14	—	≤250*	—	TO-1
OC1045	Ge, p-n-p, C	83	≥3*	15	12	5 (10*)	≤10 (15 В)	25...125 (5 В; 1 мА)	14	—	≤200*	—	TO-1
2SA49	Ge, p-n-p, C	60	9*	18	12	5	≤12 (18 В)	30...200 (6 В; 1 мА)	≤12,5 (6 В)	—	≤160*	—	TO-1
2SA52	Ge, p-n-p, C	60	7*	18	12	5	≤12 (18 В)	25...170 (6 В; 1 мА)	≤12,5 (6 В)	—	—	—	TO-1
2SA53	Ge, p-n-p, C	60	5*	18	12	5	≤12 (18 В)	20...130 (6 В; 1 мА)	≤12,5 (6 В)	—	—	—	TO-1
2SB90	Ge, p-n-p, C	40	1	18	12	50	≤14 (18 В)	150 (6 В; 1 мА)	12 (6 В)	—	10 (1 кГц)	—	TO-1
2SB97	Ge, p-n-p, C	40	—	18	12	50	≤14	70 (6 В; 1 мА)	12	—	7	—	TO-1
OC57	Ge, p-n-p, C	20	≥0,01	7	7	50	—	35 (0,5 В; 0,25 мА)	60	—	—	—	R-19
OC58	Ge, p-n-p, C	20	≥0,01	7	7	50	—	55 (0,5 В; 0,25 мА)	60	—	—	—	R-19
OC59	Ge, p-n-p, C	20	2,2*	7	7	5	3	80 (0,5 В; 0,25 мА)	60	—	—	—	R-19
OC60	Ge, p-n-p, C	20	—	7	7	5	1,5	75 (2 В; 3,8 мА)	—	—	—	—	R-19
2SB302	Ge, p-n-p, C	40	12*	10	5	2	6	80 (6 В; 1 мА)	10	—	—	—	TO-1
2SA255	Ge, p-n-p, C	55	5*	12	0,5	10	10	50 (6 В; 1 мА)	10	—	—	—	R-18
2SA254	Ge, p-n-p, C	55	10*	12	0,5	10	10	80 (6 В; 1 мА)	9,5	—	—	—	R-18
2N139	Ge, p-n-p, C	35	13*	16	0,5	15	10	48 (9 В; 1 мА)	9,5	—	—	—	TO-40
2N218	Ge, p-n-p, C	35	13*	16	0,5	15	10	48 (9 В; 1 мА)	18	—	—	—	TO-1
GC100	Ge, p-n-p, C	50	≥1	15	10	15	≤15 (6 В)	≥18 (6 В; 2 мА)	—	—	≤25 (1 кГц)	—	A-1
GC101	Ge, p-n-p, C	50	≥1	15	10	15	≤15 (6 В)	≥18 (6 В; 2 мА)	—	—	≤10 (1 кГц)	—	A-1
П27	Ge, p-n-p, C	30	≥1*	5* (0,5 к)	—	6	≤3 (5 В)	20...100 (5 В; 0,5 мА)	—	—	≤10 (1 кГц)	—	2
П27А	Ge, p-n-p, C	30	≥1*	5* (0,5 к)	—	6	≤3 (5 В)	20...170 (5 В; 0,5 мА)	—	—	≤5 (1 кГц)	—	2
П28	Ge, p-n-p, C	30	≥5*	5* (0,5 к)	—	6	≤3 (5 В)	20...200 (5 В; 0,5 мА)	—	—	≤5 (1 кГц)	—	2

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^*_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, мкА	$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$К_ш$, дБ, $r^*_б$, $r^{**}_{бэ\,нас}$, Ом	$τ_к$, $t^*_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
2N175	Ge, p-n-p, С	20	0,85*	10	10	2	12	65 (4 В; 0,5 мА)	36	—	—	—	TO-40
2N220	Ge, p-n-p, С	20	0,85*	10	10	2	12	65 (4 В; 0,5 мА)	36	—	≤6	—	TO-1
AC160	Ge, p-n-p, С	30	2*	10*	10	10	0,8 (12 В)	35...250 (4 В; 0,3 мА)	—	—	≤5	—	R-60
ГТ115А	Ge, p-n-p, С	50	≥1*	20	20	30	≤40 (20 В)	20...80 (1 В; 25 мА)	—	—	—	—	3а
ГТ115Б	Ge, p-n-p, С	50	≥1*	30	20	30	≤40 (30 В)	20...80 (1 В; 25 мА)	—	—	—	—	3а
ГТ115В	Ge, p-n-p, С	50	≥1*	20	20	30	≤40 (20 В)	60...150 (1 В; 25 мА)	—	—	—	—	3а
ГТ115Г	Ge, p-n-p, С	50	≥1*	30	20	30	≤40 (30 В)	60...150 (1 В; 25 мА)	—	—	—	—	3а
ГТ115Д	Ge, p-n-p, С	50	≥1*	20	20	30	≤40 (20 В)	125...250 (1 В; 25 мА)	—	—	—	—	3а
2N591	Ge, p-n-p, С	50	0,7*	32	—	20	7	70 (12 В; 2 мА)	—	—	—	—	TO-1
2SB39	Ge, p-n-p, С	50	0,85	10	10	2	10	65 (4 В; 0,5 мА)	40	—	8	—	TO-1
2N107	Ge, p-n-p, С	50	1*	12	—	10	10	19 (5 В; 1 мА)	40	—	—	—	R-31
AC107	Ge, p-n-p, С	80	2*	15	5	10	3	60 (5 В; 0,3 мА)	14	—	—	—	R-9
TG5	Ge, p-n-p, С	75	≥0,6*	30	10	10	—	25...80 (2 В; 3 мА)	—	≤10	—	—	TO-18
TG5E	Ge, p-n-p, С	75	≥0,6*	15	10	10	—	25...80 (2 В; 3 мА)	—	≤10	—	—	TO-18
2SB303	Ge, p-n-p, С	50	1	30	25	50	14 (20 В)	100 (6 В; 1 мА)	—	—	—	—	TO-1
2N506	Ge, p-n-p, С	50	≥0,6*	40	—	100	≤125	≥25 (0,5 В; 10 мА)	—	—	—	—	TO-22
2N535A	Ge, p-n-p, С	50	2*	20	20	20	10	100 (5 В; 1 мА)	—	—	—	—	TO-23
2N535B	Ge, p-n-p, С	50	2*	20	20	20	10	100 (5 В; 1 мА)	—	—	—	—	TO-23
2N536	Ge, p-n-p, С	50	2*	20	20	30	10	150 (1 В; 30 мА)	—	—	—	—	TO-23
AC122	Ge, p-n-p, С	60	1,2	30	12	50	15	90 (6 В; 2 мА)	—	—	—	—	R-60
2SB261	Ge, p-n-p, С	65	2,5	20	2,5	30	12	45 (6 В; 1 мА)	—	—	—	—	R-18
2SB262	Ge, p-n-p, С	65	3	20	2,5	30	12	90 (6 В; 1 мА)	—	—	—	—	R-18
ГТ124А	Ge, p-n-p, С	75	≥1*	25	10	100*	≤15 (15 В)	28...56 (0,5 В; 0,1 А)	—	≤0,5	—	—	13
ГТ124Б	Ge, p-n-p, С	75	≥1*	25	10	100*	≤15 (15 В)	45...90 (0,5 В; 0,1 А)	—	≤0,5	—	—	13
ГТ124В	Ge, p-n-p, С	75	≥1*	25	10	100*	≤15 (15 В)	71...162 (0,5 В; 0,1 А)	—	≤0,5	—	—	13
ГТ124Г	Ge, p-n-p, С	75	≥1*	25	10	100*	≤15 (15 В)	120...200 (0,5 В; 0,1 А)	—	≤0,5	—	—	13
2SA40	Ge, p-n-p, С	80	5*	25	12	50	5 (12 В)	65 (6 В; 1 мА)	10 (6 В)	—	≤220*	—	TO-1
2SA195	Ge, p-n-p, С	80	4*	15	12	15	12 (15 В)	30 (6 В; 1 мА)	10 (6 В)	—	75*	—	TO-1
2SA277	Ge, p-n-p, С	65	≥3,5*	18	12	40	7 (12 В)	80 (0,5 В; 100 мА)	—	—	—	—	TO-5
2SB12	Ge, p-n-p, С	50	0,8*	30	12	50	15 (30 В)	≥15 (6 В; 1 мА)	—	—	—	—	TO-1
2SB13	Ge, p-n-p, С	100	0,8*	30	12	50	15 (30 В)	≥30 (6 В; 1 мА)	—	—	—	—	TO-1
2SB44	Ge, p-n-p, С	80	≥0,5*	30	12	50	10 (12 В)	85 (6 В; 1 мА)	30 (6 В)	—	—	—	TO-1
2SB54	Ge, p-n-p, С	80	1*	25	12	50	14 (25 В)	80...300 (6 В; 1 мА)	35 (6 В)	—	10 (1 кГц)	—	TO-1
2SB110	Ge, p-n-p, С	100	1*	25	10	50	10 (6 В)	30 (6 В; 1 мА)	—	—	—	—	TO-1
2SB111	Ge, p-n-p, С	100	1*	25	10	50	10 (6 В)	45 (6 В; 1 мА)	—	—	—	—	TO-1
2SB112	Ge, p-n-p, С	100	1*	25	10	50	10 (6 В)	60 (6 В; 1 мА)	—	—	—	—	TO-1
2SB113	Ge, p-n-p, С	100	1*	25	10	50	10 (6 В)	80 (6 В; 1 мА)	—	—	—	—	TO-1
2SB114	Ge, p-n-p, С	100	1,5*	25	10	50	10 (6 В)	65 (1 В; 20 мА)	—	—	—	—	TO-18
2SB115	Ge, p-n-p, С	100	1,5*	25	10	50	10 (6 В)	85 (1 В; 20 мА)	—	—	—	—	TO-1
2SB116	Ge, p-n-p, С	100	1,5*	25	10	50	10 (6 В)	110 (1 В; 20 мА)	—	—	—	—	TO-1

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^{*}_{K,т\,max}$, $P^{**}_{K,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^{*}_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^{*}_{K,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, мкА	$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_{к}$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$К_{ш}$, дБ, $r^{*}_{б}$, $r^{**}_{бэ\,нас}$, Ом	$\tau_{к}$, пс, $t^{*}_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
2SB117	Ge, p-n-p, C	100	1,5*	25	10	50	10 (6 В)	140 (1 В; 20 мА)	—	—	—	—	TO-1
2SB135	Ge, p-n-p, C	100	0,8*	25	12	50	12 (25 В)	70 (6 В; 1 мА)	—	—	—	—	TO-1
ГТ125А	Ge, p-n-p, C	150	≥1*	35	20	300*	≤15 (15 В)	28...56* (5 В; 25 мА)	—	≤1	—	—	2
ГТ125Б	Ge, p-n-p, C	150	≥1*	35	20	300*	≤15 (15 В)	45...90* (5 В; 25 мА)	—	≤1	—	—	2
ГТ125В	Ge, p-n-p, C	150	≥1*	35	20	300*	≤15 (15 В)	71...140* (5 В; 25 мА)	—	≤1	—	—	2
ГТ125Г	Ge, p-n-p, C	150	≥1*	35	20	300*	≤15 (15 В)	120...200* (5 В; 25 мА)	—	≤1	—	—	2
ГТ125Д	Ge, p-n-p, C	150	≥1*	35	20	300*	≤15 (15 В)	≥28* (0,5 В; 100 мА)	—	≤1	—	—	2
ГТ125Е	Ge, p-n-p, C	150	≥1*	35	20	300*	≤15 (15 В)	45...90* (5 В; 25 мА)	—	≤1	—	—	2
ГТ125Ж	Ge, p-n-p, C	150	≥1*	35	20	300*	≤15 (15 В)	71...140* (5 В; 25 мА)	—	≤1	—	—	2
ГТ125И	Ge, p-n-p, C	150	≥1*	70	20	300*	≤15 (15 В)	28...56* (0,5 В; 100 мА)	—	≤1	—	—	2
ГТ125К	Ge, p-n-p, C	150	≥1*	70	20	300*	≤15 (15 В)	45...90* (0,5 В; 100 мА)	—	≤1	—	—	2
ГТ125Л	Ge, p-n-p, C	150	≥1*	70	20	300*	≤15 (15 В)	71...140* (0,5 В; 100 мА)	—	≤1	—	—	2
2SA65	Ge, p-n-p, C	150	6*	18	12	200	≤7 (12 В)	80* (0,5 В; 100 мА)	≤16 (6 В)	—	140*	—	TO-1
2SA173	Ge, p-n-p, C	125	4*	20	10	50	8 (20 В)	60* (1 В; 10 мА)	13 (6 В)	—	200*	—	TO-5
2SA174	Ge, p-n-p, C	175	4*	20	10	50	8 (20 В)	60* (1 В; 10 мА)	13 (6 В)	—	200*	—	—
2SA204	Ge, p-n-p, C	150	6*	30	20	200	6 (10 В)	60* (1 В; 10 мА)	15 (6 В)	—	130*	—	TO-5
2SA205	Ge, p-n-p, C	200	5*	30	20	200	6 (15 В)	40* (1 В; 10 мА)	15 (6 В)	—	110*	—	TO-5
2SA206	Ge, p-n-p, C	200	7*	30	20	200	6 (20 В)	55* (1 В; 10 мА)	15 (6 В)	—	120*	—	TO-5
2SA211	Ge, p-n-p, C	120	≥4*	18	10	100	10 (12 В)	≥30* (0,3 В; 100 мА)	≤20 (6 В)	—	≤150*	—	TO-5
2SA212	Ge, p-n-p, C	120	≥4*	25	12	100	5 (12 В)	≥30* (0,3 В; 100 мА)	≤20 (6 В)	—	≤150*	—	TO-5
2SA282	Ge, p-n-p, C	150	6*	18	12	200	7 (12 В)	80* (0,5 В; 100 мА)	—	—	—	—	TO-5
2SA391	Ge, p-n-p, C	150	7	18	12	200	6 (6 В)	70 (5 В; 1 мА)	10 (5 В)	—	150*	—	TO-5
2SA396	Ge, p-n-p, C	200	6	15	15	200	10 (12 В)	85 (5 В; 1 мА)	20 (5 В)	—	150*	—	TO-5
2SA414	Ge, p-n-p, C	150	7	30	20	200	3 (5 В)	40 (0,5 В; 100 мА)	9 (5 В)	—	—	—	TO-5
2SB15	Ge, p-n-p, C	100	0,8*	60	12	50	15 (60 В)	≥30 (6 В; 1 мА)	—	—	—	—	TO-1
2SB43	Ge, p-n-p, C	150	1*	25	12	50	10 (12 В)	70 (1 В; 50 мА)	35 (6 В)	—	—	—	TO-1
2SB48	Ge, p-n-p, C	140	2,5*	16	—	100	16 (16 В)	43 (1 В; 20 мА)	25 (6 В)	—	—	—	TO-5
2SB49	Ge, p-n-p, C	140	3*	16	—	100	16 (16 В)	83 (1 В; 20 мА)	25 (6 В)	—	—	—	TO-5
2SB55	Ge, p-n-p, C	150	1*	60	12	50	14 (25 В)	80 (1 В; 50 мА)	35 (6 В)	—	—	—	TO-1
2SB56	Ge, p-n-p, C	150	1*	25	12	50	14 (25 В)	80 (1 В; 50 мА)	35 (6 В)	—	—	—	TO-1
2SB75	Ge, p-n-p, C	150	2*	25	12	100	14 (30 В)	65 (1,5 В; 50 мА)	—	—	—	—	TO-1
МГТ108А	Ge, p-n-p, C	75	≥0,5*	10 (18 имп)	5	50	≤10 (5 В)	25...50 (5 В; 1 мА)	—	—	—	≤5000	4
МГТ108Б	Ge, p-n-p, C	75	≥1*	10 (18 имп)	5	50	≤10 (5 В)	35...80 (5 В; 1 мА)	—	—	—	≤5000	4
МГТ108В	Ge, p-n-p, C	75	≥1*	10 (18 имп)	5	50	≤10 (5 В)	60...130 (5 В; 1 мА)	—	—	—	≤5000	4
МГТ108Г	Ge, p-n-p, C	75	≥1*	10 (18 имп)	5	50	≤10 (5 В)	110...250 (5 В; 1 мА)	—	—	—	≤5000	4
МГТ108Д	Ge, p-n-p, C	75	≥1*	10 (18 имп)	5	50	≤10 (5 В)	30...120 (5 В; 1 мА)	—	—	≤6 (1 кГц)	≤5000	4

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^{*}_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^{*}_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K,\,max}$, $I^{*}_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, мкА	$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$К_ш$, дБ, $r^{*}_б$, $r^{**}_{бэ\,нас}$, Ом	$\tau_к$, $t^{*}_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
NKT11	Ge, p-n-p, C	75	≥1*	18	12	100	5	≥90 (4,5 В; 1 мА)	—	—	—	—	TO-1
AC150	Ge, p-n-p, C	60	≥1*	30	12	50	5,5 (30 В)	55...140 (6 В; 2 мА)	—	—	≤5	—	TO-18
NKT73	Ge, p-n-p, C	75	≥2,5*	15	10	10	5	≥40 (4,5 В; 1 мА)	11	—	—	—	TO-1
2SB443A	Ge, p-n-p, C	100	2,5	18	12	10	10 (18 В)	110 (6 В; 1 мА)	—	—	—	—	TO-1
2SB497	Ge, p-n-p, C	65	3	20	2,5	30	6	90 (6 В; 1 мА)	—	—	—	—	R-18
2SB335	Ge, p-n-p, C	83	1	20	10	60	10 (10 В)	70 (6 В; 1 мА)	—	—	—	—	R-18
2SB336	Ge, p-n-p, C	83	1	20	10	60	10	80 (1 В; 60 мА)	—	—	—	—	R-18
2SB400	Ge, p-n-p, C	100	1*	20	15	40	15	100 (6 В; 1 мА)	—	—	—	—	TO-1
2N206	Ge, p-n-p, C	75	0,78	30	12	50	10	47 (5 В; 1 мА)	35	—	—	—	TO-5
2N207	Ge, p-n-p, C	85	2	12	12	20	15	100 (5 В; 1 мА)	40	—	—	—	TO-5
2N130	Ge, p-n-p, C	85	0,7	25	12	10	12	24 (6 В; 1 мА)	40	—	—	—	TO-5
2SB57	Ge, p-n-p, C	100	1*	30	10	100	15	65 (6 В; 1 мА)	—	—	—	—	R-55
2N131	Ge, p-n-p, C	85	0,8	25	12	50	12	50 (6 В; 1 мА)	—	—	—	—	TO-5
2N131A	Ge, p-n-p, C	100	0,8	30*	12	100	15	45 (6 В; 1 мА)	—	—	—	—	OV-16
2N132	Ge, p-n-p, C	85	1	30*	12	100	15	90 (6 В; 1 мА)	—	—	—	—	TO-5
2N133	Ge, p-n-p, C	85	0,8	30*	12	100	15	50 (6 В; 1 мА)	—	—	—	—	TO-5
2N132A	Ge, p-n-p, C	100	1	24*	12	100	15	90 (6 В; 1 мА)	—	—	—	—	OV-16
2N265	Ge, p-n-p, C	75	1,5*	25	—	50	16	115 (5 В; 1 мА)	40	—	—	—	R-32
2N207A	Ge, p-n-p, C	85	2	12	12	20	15	100 (5 В; 1 мА)	40	—	—	—	TO-5
2N207B	Ge, p-n-p, C	85	2	12	12	20	10	100 (5 В; 1 мА)	40	—	—	—	TO-5
2SB443B	Ge, p-n-p, C	100	3,5*	18	12	10	10	190 (6 В; 1 мА)	—	—	—	—	TO-1
2SB444A	Ge, p-n-p, C	100	2,5*	18	12	10	7	120 (6 В; 1 мА)	—	—	—	—	TO-1
2SB444B	Ge, p-n-p, C	100	3,5*	18	12	10	7	190 (6 В; 2 мА)	40	—	—	—	TO-1
AC170	Ge, p-n-p, C	90	1,2*	32	10	100	10	125 (6 В; 2 мА)	21	—	—	—	R-60
AC171	Ge, p-n-p, C	90	1,2*	32	10	100	10	200 (6 В; 2 мА)	21	—	—	—	R-60
GC116	Ge, p-n-p, C	115	0,5	20	10	150	≤18 (15 В)	28...224 (6 В; 2 мА)	—	—	≤20 (1 кГц)	—	A-1
GC117	Ge, p-n-p, C	115	≥1,2*	20*	10	150	≤18 (15 В)	45...224 (6 В; 2 мА)	—	—	≤10 (1 кГц)	—	A-1
GC118	Ge, p-n-p, C	115	≥1,2*	25	10	150	≤18 (15 В)	45...224 (6 В; 2 мА)	—	—	≤5 (1 кГц)	—	A-1
TG2	Ge, p-n-p, C	75	≥0,6	15	10	10	≤15 (6 В)	20...80 (2 В; 3 мА)	—	≤15	—	—	TO-18
TG3A	Ge, p-n-p, C	75	≥1	15	10	10	≤15 (6 В)	75...130 (2 В; 3 мА)	—	≤8	—	—	TO-18
TG3F	Ge, p-n-p, C	75	≥2	15	10	10	≤10 (6 В)	80...250 (6 В; 1 мА)	—	≤7	—	—	TO-18
TG4	Ge, p-n-p, C	75	≥0,6	15	10	10	≤10 (6 В)	20...50 (2 В; 0,5 мА)	—	≤11	—	—	TO-18
2SB47	Ge, p-n-p, C	80	1	25	12	50	≤14 (25 В)	60...250 (1,5 В; 0,5 мА)	35 (6 В)	—	≤5 (1 кГц)	—	TO-1
МП39	Ge, p-n-p, C	150	≥0,5*	15* (10 к)	5	20 (150*)	≤15 (5 В)	≥12 (5 В; 1 мА)	≤50 (5 В)	—	—	—	2
МП39Б	Ge, p-n-p, C	150	≥0,5*	15* (10 к)	5	20 (150*)	≤15 (5 В)	20...60 (5 В; 1 мА)	≤50 (5 В)	—	≤12 (1 кГц)	—	2
МП40	Ge, p-n-p, C	150	≥1*	15* (10 к)	5	20 (150*)	≤15 (5 В)	20...40 (5 В; 1 мА)	≤50 (5 В)	—	—	—	2
МП40А	Ge, p-n-p, C	150	≥1*	30* (10 к)	5	20 (150*)	≤15 (5 В)	20...40 (5 В; 1 мА)	≤50 (5 В)	—	—	—	2
МП41	Ge, p-n-p, C	150	≥1*	15* (10 к)	5	20 (150*)	≤15 (5 В)	30...60 (5 В; 1 мА)	≤50 (5 В)	—	—	—	2

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K max}$, $P^*_{K, т max}$, $P^{**}_{K, и max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{KБO проб}$, $U^*_{KЭR проб}$, $U^{**}_{KЭO проб}$, В	$U_{ЭБO проб}$, В	$I_{K max}$, $I^*_{K, и max}$, мА	$I_{KБO}$, $I^*_{KЭR}$, мкА	$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{кэ нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r^*_б$, $r^{**}_{бэ нас}$, Ом	$\tau_к$, $t^*_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
МП41А	Ge, p-n-p, C	150	≥1*	15* (10 к)	5	20 (150*)	≤15 (5 В)	50...100 (5 В; 1 мА)	≤50 (5 В)	—	—	—	2
2N331	Ge, p-n-p, C	200	≥0,4	30	12	200	≤10 (30 В)	30...70 (6 В; 1 мА)	≤50 (6 В)	—	≤20 (1 кГц)	—	TO-5
OC70	Ge, p-n-p, C	125	0,45*	30	10	10	≤5	30 (2 В; 0,5 мА)	—	—	—	—	R-9
OC1070	Ge, p-n-p, C	125	0,015**	32	10	10 (50*)	≤12 (4,5 В)	20...40 (2 В; 0,5 мА)	—	—	≤15 (1 кГц)	—	TO-1
OC1071	Ge, p-n-p, C	125	0,01**	32	10	10 (50*)	≤12 (4,5 В)	30...75 (2 В; 4 мА)	—	—	≤15 (1 кГц)	—	TO-1
OC1072	Ge, p-n-p, C	125	0,35*	32	10	50 (125*)	≤10 (10 В)	45...120 (5,4 В; 10 мА)	—	—	≤15 (1 кГц)	—	TO-1
OC1075	Ge, p-n-p, C	125	0,1*	32	10	10 (50*)	≤12 (4,5 В)	65...130 (2 В; 3 мА)	—	—	≤15 (1 кГц)	—	TO-1
OC76	Ge, p-n-p, C	125	0,35	32	10	125	10	45 (5,4 В; 10 мА)	30	—	—	—	R-8
OC71	Ge, p-n-p, C	125	0,5*	30	10	10	≤5	47 (2 В; 3 мА)	30	—	—	—	R-9
2SB170	Ge, p-n-p, C	125	0,3*	30	6	10	12	30 (2 В; 0,5 мА)	—	—	—	—	TO-1
SFT351	Ge, p-n-p, C	200	≥0,6	32	20	150	≤15 (10 В)	20...44 (6 В; 1 мА)	40 (6 В)	—	≤8 (1 кГц)	—	TO-1
SFT352	Ge, p-n-p, C	200	≥0,8	32	20	150	≤15 (10 В)	40...66 (6 В; 1 мА)	40 (6 В)	—	≤8 (1 кГц)	—	TO-1
SFT353	Ge, p-n-p, C	200	≥1	32	20	150	≤15 (10 В)	60...250 (6 В; 2 мА)	40 (6 В)	—	≤8 (1 кГц)	—	TO-1
SFT306	Ge, p-n-p, C	150	≥1,5	18	12	100	≤10 (18 В)	15...70 (6 В; 1 мА)	≤150 (6 В)	—	6 (1 кГц)	—	TO-1
AC540	Ge, p-n-p, C	150	0,5	24	—	10 (50*)	≤20 (24 В)	30...70 (3 В; 2 мА)	—	—	≤10 (1 кГц)	—	TO-58
AC541	Ge, p-n-p, C	150	0,5	24	—	10 (50*)	≤20 (24 В)	50...100 (3 В; 2 мА)	—	—	≤10 (1 кГц)	—	TO-58
AC542	Ge, p-n-p, C	150	0,5	24	—	10 (50*)	≤20 (24 В)	80...200 (3 В; 2 мА)	—	—	≤10 (1 кГц)	—	TO-58
EFT306	Ge, p-n-p, C	150	2,5	15	9	100	≤15 (15 В)	15...70 (6 В; 1 мА)	30	—	—	—	TO-1
EFT307	Ge, p-n-p, C	150	5,7	15	9	100	≤15 (15 В)	25...120 (6 В; 1 мА)	30	—	—	—	TO-1
2N283	Ge, p-n-p, C	125	0,5*	32	30	10	4,5	40 (10 В; 0,5 мА)	—	—	—	—	R-8
OC75	Ge, p-n-p, C	125	0,75*	30	10	50	5	90 (2 В; 3 мА)	50	—	—	—	R-9
2SB171	Ge, p-n-p, C	125	0,5*	30	6	10	12	50 (2 В; 3 мА)	—	—	—	—	TO-1
2SB173	Ge, p-n-p, C	125	0,5*	20	6	10	12	50 (6 В; 1 мА)	—	—	—	—	TO-1
2SB175	Ge, p-n-p, C	125	0,6*	30	6	10	12	90 (2 В; 3 мА)	—	—	—	—	TO-1
2N368	Ge, p-n-p, C	150	≥0,4*	30	10	75	15	49 (5 В; 1 мА)	—	—	—	—	TO-5
2N237	Ge, p-n-p, C	150	0,5*	45	20	20	10	50 (6 В; 1 мА)	—	—	—	—	TO-22
2N405	Ge, p-n-p, C	150	0,65*	20	2,5	35	14	35 (6 В; 1 мА)	40	—	—	—	TO-40
2N406	Ge, p-n-p, C	150	0,65*	20	2,5	35	14	35 (6 В; 1 мА)	40	—	—	—	TO-1
2N104	Ge, p-n-p, C	150	0,7*	30	12	50	10	44 (6 В; 1 мА)	40	—	—	—	TO-40
2N215	Ge, p-n-p, C	150	0,7*	30	12	50	10	44 (6 В; 1 мА)	40	—	—	—	TO-1
2SB120	Ge, p-n-p, C	150	0,7*	32	2,5	20	6,5	70 (12 В; 2 мА)	—	—	—	—	TO-1
2SB32	Ge, p-n-p, C	150	0,8*	20	2,5	50	14	40 (6 В; 1 мА)	—	—	—	—	TO-1
2N45	Ge, p-n-p, C	150	1*	45	15	50	10	12 (5 В; 1 мА)	—	—	—	—	TO-29
2N45A	Ge, p-n-p, C	150	1*	45	5	10	15	15 (5 В; 1 мА)	40	—	—	—	TO-29
2N273	Ge, p-n-p, C	150	1*	20	10	100	10	20 (0,25 В; 50 мА)	40	—	—	—	TO-5
2SB33	Ge, p-n-p, C	150	1*	20	2,5	50	14	80 (6 В; 1 мА)	—	—	—	—	TO-1
2SB37	Ge, p-n-p, C	150	1*	30	12	50	14	80 (6 В; 1 мА)	45	—	—	—	TO-1
2SB60	Ge, p-n-p, C	150	1*	20	2,5	50	14	65 (6 В; 1 мА)	—	—	—	—	TO-1
2SB61	Ge, p-n-p, C	150	1*	30	12	50	10	85 (6 В; 1 мА)	40	—	—	—	TO-1
2N369	Ge, p-n-p, C	150	1,3*	30	10	50	—	95 (5 В; 1 мА)	—	—	—	—	OV-9
2N44A	Ge, p-n-p, C	155	1*	25**	—	50	8	31 (5 В; 1 мА)	40	—	—	—	R-32
2N2428	Ge, p-n-p, C	165	≥1,2*	32	10	30	10	120 (5 В; 2 мА)	—	—	—	—	TO-1

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^*_{K,т\,max}$, $P^{**}_{K,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{KБО\,проб}$, $U^*_{KЭR\,проб}$, $U^{**}_{KЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,и\,max}$, мА	$I_{KБО}$, $I^*_{KЭR}$, мкА	$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r^*_б$, $r^{**}_{бэ\,нас}$, Ом	$\tau_к$, $t^*_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
2SB439	Ge, p-n-p, C	150	2*	30	12	150	≤14 (12 В)	70...270 (6 В; 1 мА)	—	—	7 (1 кГц)	—	TO-1
2SB440	Ge, p-n-p, C	150	2*	30	12	150	≤14 (12 В)	70...270 (6 В; 1 мА)	—	—	5 (1 кГц)	—	TO-1
2N1413	Ge, p-n-p, C	200	≥0,8*	35	10	200	≤12 (30 В)	20...41 (5 В; 1 мА)	≤40 (5 В)	≤35	6 (1 кГц)	—	TO-5
2N1414	Ge, p-n-p, C	200	≥1*	35	10	200	≤12 (30 В)	30...64 (5 В; 1 мА)	≤40 (5 В)	≤37	6 (1 кГц)	—	TO-5
2N1415	Ge, p-n-p, C	200	≥1,3*	35	10	200	≤12 (30 В)	44...88 (5 В; 1 мА)	≤40 (5 В)	≤40	6 (1 кГц)	—	TO-5
МП20А	Ge, p-n-p, C	150	≥2*	30	30	300*	≤50 (30 В)	50...150 (5 В; 25 мА)	—	≤1	—	—	2
МП20Б	Ge, p-n-p, C	150	≥1,5*	30	30	300*	≤50 (30 В)	80...200 (5 В; 25 мА)	—	≤1	—	—	2
МП21В	Ge, p-n-p, C	150	≥1,5*	40	40	300*	≤50 (40 В)	20...100 (5 В; 25 мА)	—	≤1	—	—	2
МП21Г	Ge, p-n-p, C	150	≥1*	60	40	300*	≤50 (60 В)	20...80 (5 В; 25 мА)	—	≤1	—	—	2
МП21Д	Ge, p-n-p, C	150	≥1*	50	40	300*	≤50 (50 В)	60...200 (5 В; 25 мА)	—	≤1	—	—	2
МП21Е	Ge, p-n-p, C	150	≥0,7*	70	40	300*	≤50 (70 В)	30...150 (5 В; 25 мА)	—	≤1	—	—	2
2N59	Ge, p-n-p, C	180	1,8*	25	20	200	15 (20 В)	90* (100 мА)	40	—	—	—	TO-5
2N59A	Ge, p-n-p, C	180	1,8*	40	20	200	15 (20 В)	90* (100 мА)	40	—	—	—	TO-5
2N59B	Ge, p-n-p, C	180	1,8*	50	20	200	15 (20 В)	90* (100 мА)	40	—	—	—	TO-5
2N59C	Ge, p-n-p, C	180	1,8*	60	20	200	15 (20 В)	90* (100 мА)	40	—	—	—	TO-5
2N60	Ge, p-n-p, C	180	1,5*	25	20	200	15 (20 В)	65* (100 мА)	40	—	—	—	TO-5
2N60A	Ge, p-n-p, C	180	1,5*	40	20	200	15 (20 В)	65* (100 мА)	40	—	—	—	TO-5
2N60B	Ge, p-n-p, C	180	1,5*	50	20	200	15 (20 В)	65* (100 мА)	40	—	—	—	TO-5
2N60C	Ge, p-n-p, C	180	1,5*	60	20	200	15 (20 В)	65* (100 мА)	40	—	—	—	TO-5
2N61	Ge, p-n-p, C	180	1*	25	20	200	15 (20 В)	45* (100 мА)	40	—	—	—	TO-5
2N61A	Ge, p-n-p, C	180	1*	40	20	200	15 (20 В)	45* (100 мА)	40	—	—	—	TO-5
2N61B	Ge, p-n-p, C	180	1*	50	20	200	15 (20 В)	45* (100 мА)	40	—	—	—	TO-5
2N61C	Ge, p-n-p, C	180	1*	60	20	200	15 (20 В)	45* (100 мА)	40	—	—	—	TO-5
2N65	Ge, p-n-p, C	125	1	20	16	100	10	75 (5 В; 1 мА)	35	—	—	—	OV-4
2N109	Ge, p-n-p, C	165	1	35	12	150	14 (25 В)	65 (1 В; 50 мА)	60	—	—	—	TO-40
AC125	Ge, p-n-p, C	210 (500*)	≥1,3*	32	10	100	≤10 (10 В)	80...170 (5 В; 2 мА)	≤50 (5 В)	—	≤10	—	TO-1
EFT331	Ge, p-n-p, C	130 (45 °C)	1,3	32	12	250	≤15 (32 В)	17...45* (1 В; 100 мА)	32 (6 В)	≤3,5	—	—	TO-1
EFT332	Ge, p-n-p, C	130 (45 °C)	1,6	32	12	250	≤15 (32 В)	35...65* (1 В; 100 мА)	32 (6 В)	≤3,5	—	—	TO-1
EFT333	Ge, p-n-p, C	130 (45 °C)	2	32	12	250	≤15 (32 В)	55...200* (1 В; 100 мА)	32 (6 В)	≤3,5	—	—	TO-1
EFT341	Ge, p-n-p, C	130 (45 °C)	1,3	48	20	250	≤15 (48 В)	17...45* (1 В; 100 мА)	32 (6 В)	≤3,5	—	—	TO-1
EFT342	Ge, p-n-p, C	130 (45 °C)	1,6	48	20	250	≤15 (48 В)	35...65* (1 В; 100 мА)	32 (6 В)	≤3,5	—	—	TO-1
EFT343	Ge, p-n-p, C	130 (45 °C)	2	48	20	250	≤15 (48 В)	55...200* (1 В; 100 мА)	32 (6 В)	≤3,5	—	—	TO-1
GC507	Ge, p-n-p, C	125	≥0,3	32	10	125 (250*)	≤10 (6 В)	45...120* (6 В; 10 мА)	—	≤1,8	≤15 (1 кГц)	—	A-6
GC508	Ge, p-n-p, C	125	≥0,3	32	10	125 (250*)	≤10 (6 В)	65...220* (6 В; 10 мА)	—	≤1,8	—	—	A-6
GC509	Ge, p-n-p, C	125	≥0,3	60	10	125 (250*)	≤10 (6 В)	≥45* (6 В; 10 мА)	—	≤1,8	—	—	A-6

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^*_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, мкА	$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r^*_б$, $r^{**}_{бэ\,нас}$, Ом	$\tau_к$, $t^*_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
GC515	Ge, p-n-p, C	125	0,3*	32	10	125 (250*)	≤10 (6 В)	20...40 (6 В; 1 мА)	—	≤2,5	≤12 (1 кГц)	—	A-6
GC516	Ge, p-n-p, C	125	0,3*	32	10	125 (250*)	≤10 (6 В)	30...60 (6 В; 1 мА)	—	≤2,5	≤12 (1 кГц)	—	A-6
GC517	Ge, p-n-p, C	125	0,4*	32	10	125 (250*)	≤10 (6 В)	50...100 (6 В; 1 мА)	—	≤1,8	≤12 (1 кГц)	—	A-6
GC518	Ge, p-n-p, C	125	0,7*	32	10	125 (250*)	≤10 (6 В)	75...150 (6 В; 1 мА)	—	≤1,8	≤12 (1 кГц)	—	A-6
GC519	Ge, p-n-p, C	125	0,7*	32	10	125 (250*)	≤10 (6 В)	125...250 (6 В; 1 мА)	—	≤1,8	≤12 (1 кГц)	—	A-6
GCN55	Ge, p-n-p, C	125	0,3	32	10	125 (250*)	≤10 (6 В)	50...250* (6 В; 10 мА)	—	≤2	—	—	A-6
GCN56	Ge, p-n-p, C	125	0,3	60	10	125 (250*)	≤10 (6 В)	50...250* (1 В; 10 мА)	—	≤2	—	—	A-6
SFT223	Ge, p-n-p, C	225	3,2	30	15	250	15 (30 В)	60...160* (1 В; 100 мА)	25 (6 В)	≤3,5	—	—	TO-5
AC182	Ge, p-n-p, C	200	4	32	10	150	15	110 (6 В; 1 мА)	—	—	—	—	R-134
GFT251	Ge, p-n-p, C	225	1,3*	30	15	150	15	30 (6 В; 1 мА)	25 (6 В)	—	≤15 (1 кГц)	—	TO-5
SFT252	Ge, p-n-p, C	225	2*	30	15	150	15	50 (6 В; 1 мА)	25 (6 В)	—	≤15 (1 кГц)	—	TO-5
SFT253	Ge, p-n-p, C	225	3	30	15	150	15	80 (6 В; 1 мА)	25 (6 В)	—	≤15 (1 кГц)	—	TO-5
GC121	Ge, p-n-p, C	120	≥0,012**	20*	10	150	≤18 (15 В)	≥28* (0,5 В; 100 мА)	—	—	≤20 (1 кГц)	—	A-2
GC122	Ge, p-n-p, C	120	≥0,012**	33*	15	150	≤18 (15 В)	≥18* (0,5 В; 100 мА)	—	—	—	—	A-2
GC123	Ge, p-n-p, C	120	≥0,012**	70	15	150	≤18 (15 В)	≥18* (0,5 В; 100 мА)	—	—	—	—	A-2
TG50	Ge, p-n-p, C	175	0,5	30	10	150	≤20 (12 В)	20...120 (6 В; 10 мА)	—	≤1,5	—	—	TO-5
TG51	Ge, p-n-p, C	175	0,5	60	10	150	≤20 (12 В)	15...120* (0,7 В; 250 мА)	—	—	—	—	TO-5
TG52	Ge, p-n-p, C	175	0,5	30	10	150	≤20 (12 В)	15...120* (0,7 В; 250 мА)	—	—	—	—	TO-5
TG53	Ge, p-n-p, C	175	0,5	15	10	150	≤20 (12 В)	30...120 (6 В; 10 мА)	—	≤1,5	—	—	TO-5
TG55	Ge, p-n-p, C	175	0,5	30	10	150	≤20 (12 В)	30...120 (6 В; 10 мА)	—	—	—	—	TO-5
2N653	Ge, p-n-p, C	200	1,5*	30	25	250	≤15 (25 В)	30...70 (6 В; 1 мА)	10 (6 В)	—	10 (1 кГц)	—	TO-5
2N654	Ge, p-n-p, C	200	2*	30	25	250	≤15 (25 В)	50...125 (6 В; 1 мА)	10 (6 В)	—	10 (1 кГц)	—	TO-5
2N655	Ge, p-n-p, C	200	2,5*	30	25	250	≤15 (25 В)	100...250 (6 В; 1 мА)	10 (6 В)	—	10 (1 кГц)	—	TO-5
2N1175	Ge, p-n-p, C	200	≥1,5*	30	25	250	≤15 (25 В)	70...140* (1 В; 20 мА)	10 (6 В)	—	—	—	TO-5
2N1924	Ge, p-n-p, C	225	≥1*	60	25	500*	≤10 (45 В)	34...65* (1 В; 20 мА)	≤30 (5 В)	≤5,5	—	—	TO-5
2N1925	Ge, p-n-p, C	225	≥1,3*	60	25	500*	≤10 (45 В)	53...90* (1 В; 20 мА)	≤30 (5 В)	≤5,5	—	—	TO-5
2N1926	Ge, p-n-p, C	225	≥1,5*	60	25	500*	≤10 (45 В)	72...121* (1 В; 20 мА)	≤30 (5 В)	≤5,5	—	—	TO-5
AC121	Ge, p-n-p, C	300	1,5	20	10	300	≤25 (20 В)	30...250* (0,5 В; 100 мА)	≤40 (5 В)	≤3	—	—	TO-1
OC1074	Ge, p-n-p, C	125	1,5	20	6	300	≤20 (9 В)	60* (6 В; 5 мА)	—	≤2	≤30 (1 кГц)	—	TO-1
OC1077	Ge, p-n-p, C	125	≥0,35*	60	10	125 (250*)	≤10 (10 В)	≥45* (5,4 В; 10 мА)	—	≤3	—	—	TO-1
OC1079	Ge, p-n-p, C	125	≥0,008**	26*	6	300 (600*)	≤20 (12 В)	35...110* (6 В; 50 мА)	—	≤2	≤15 (1 кГц)	—	TO-1
SFT321	Ge, p-n-p, C	200	≥0,6	32	20	250	≤15 (10 В)	20...44* (1 В; 100 мА)	40 (6 В)	—	—	—	TO-1
SFT322	Ge, p-n-p, C	200	≥0,8	32	20	250	≤15 (10 В)	40...66* (1 В; 100 мА)	40 (6 В)	—	—	—	TO-1
SFT323	Ge, p-n-p, C	200	≥1	32	20	250	≤15 (10 В)	60...150 (1 В; 100 мА)	40 (6 В)	—	—	—	TO-1
T241	Ge, p-n-p, C	150	≥0,7	32	15	250	≤15 (32 В)	20...110* (1 В; 100 мА)	25 (6 В)	—	—	—	TO-1
T242	Ge, p-n-p, C	150	≥0,7	45	20	250	≤15 (45 В)	20...110* (1 В; 100 мА)	25 (6 В)	—	—	—	TO-1
T243	Ge, p-n-p, C	150	≥0,7	60	25	250	≤15 (60 В)	20...110 (1 В; 100 мА)	25 (6 В)	—	—	—	TO-1
2N1303	Ge, p-n-p, C	150	≥3	30	25	300*	—	≥10* (0,35 В; 200 мА)	—	—	—	—	TO-39
AC126	Ge, p-n-p, C	500*	≥1,7	32	10	100 (200*)	≤200 (32 В)	≥100 (5 В; 2 мА)	—	—	—	—	TO-1
AC132	Ge, p-n-p, C	500*	2	32	10	100 (200*)	≤200 (32 В)	135* (20 мА)	—	—	—	—	TO-1
EFT311	Ge, p-n-p, C	130	1,3	18	9	250	≤15 (18 В)	17...45* (1 В; 100 мА)	32 (6 В)	≤3,5	—	—	TO-1
		(45 °C)										—	TO-1
EFT312	Ge, p-n-p, C	130 (45 °C)	1,6	18	9	250	≤15 (18 В)	35...65* (1 В; 100 мА)	32 (6 В)	≤3,5	—	—	TO-1

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K max}$, $P^*_{K, т max}$, $P^{**}_{K, и max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО проб}$, $U^*_{КЭR проб}$, $U^{**}_{КЭО проб}$, В	$U_{ЭБО проб}$, В	$I_{K max}$, $I^*_{K, и max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, мкА	$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{кэ нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r^*_б$, $r^{**}_{бэ нас}$, Ом	$\tau_к$, $t^*_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
EFT313	Ge, p-n-p, C	130 (45 °C)	2	18	9	250	≤15 (18 В)	55...200* (1 В; 100 мА)	32 (6 В)	≤3,5	—	—	TO-1
EFT321	Ge, p-n-p, C	130 (45 °C)	—	24	12	250	≤15 (24 В)	17...45* (1 В; 100 мА)	32 (6 В)	—	—	—	TO-1
EFT322	Ge, p-n-p, C	130 (45 °C)	—	24	12	250	≤15 (24 В)	35...65* (1 В; 100 мА)	32 (6 В)	—	—	—	TO-1
EFT323	Ge, p-n-p, C	130 (45 °C)	—	24	12	250	≤15 (24 В)	55...200* (1 В; 100 мА)	32 (6 В)	—	—	—	TO-1
МП25	Ge, p-n-p, C	200	≥0,2*	40	40	300*	≤75 (40 В)	13...25 (20 В; 2,5 мА)	≤20 (20 В)	≤2,2	—	≤1500***	2
МП25А	Ge, p-n-p, C	200	≥0,2*	40	40	400*	≤75 (40 В)	30...80 (20 В; 2,5 мА)	≤20 (20 В)	≤2	—	≤1500***	2
МП25Б	Ge, p-n-p, C	200	≥0,5*	40	40	400*	≤75 (40 В)	13...25 (35 В; 1,5 мА)	≤20 (20 В)	≤1,8	—	≤1500***	2
МП26	Ge, p-n-p, C	200	≥0,2*	70	70	300*	≤75 (70 В)	20...50 (35 В; 1,5 мА)	≤15 (35 В)	≤2,2	—	≤1500***	2
МП26А	Ge, p-n-p, C	200	≥0,2*	70	70	400*	≤75 (70 В)	20...50 (35 В; 1,5 мА)	≤15 (35 В)	≤2	—	≤1500***	2
МП26Б	Ge, p-n-p, C	200	≥0,5*			400*	≤75 (70 В)	30...80 (35 В; 1,5 мА)	≤15 (35 В)	≤1,8	—	≤1500***	2
2N43	Ge, p-n-p, C	240	≥0,5*	45	5	300*	≤16 (45 В)	30 (5 В; 1 мА)	≤60 (5 В)	—	≤24 (1 кГц)	—	R-32
2N44	Ge, p-n-p, C	240	≥0,5*	45	5	300*	≤16 (45 В)	25 (5 В; 1 мА)	≤60 (5 В)	—	≤24 (1 кГц)	—	R-32
AC116	Ge, p-n-p, C	225 (45 °C)	0,015**	30	12	200	≤8 (6 В)	55...140 (6 В; 4 мА)	40	—	—	—	X-9
ACY24	Ge, p-n-p, C	530*	≥0,8	70	30	300	≤12 (25 В)	50* (5 В; 30 мА)	—	—	—	—	TO-18
OC77	Ge, p-n-p, C	125	≥0,35*	60	10	250	10	≥45 (5,4 В; 10 мА)	—	—	—	—	R-8
2SB172	Ge, p-n-p, C	125	1*	32	10	125	12	50* (1 В; 100 мА)	—	—	—	—	TO-1
2SB176	Ge, p-n-p, C	125	1,4*	32	10	125	12	100* (1 В; 100 мА)	—	—	—	—	TO-1
MA909	Ge, p-n-p, C	150	0,6*	75	35	200	50	≥20 (0,25 В; 5 мА)	—	—	—	—	TO-5
MA910	Ge, p-n-p, C	150	0,6*	90	45	200	50	≥20 (0,25 В; 5 мА)	—	—	—	—	TO-5
2SB136	Ge, p-n-p, C	150	0,8*	25	12	150	10	120* (1,5 В; 50 мА)	—	—	—	—	TO-1
2SB136A	Ge, p-n-p, C	150	0,8*	60	12	300	10	120* (1,5 В; 50 мА)	—	—	—	—	TO-1
2N186A	Ge, p-n-p, C	200	0,8*	25	5	200	16	24* (1 В; 100 мА)	40	—	—	—	R-32
2N189	Ge, p-n-p, C	200	0,8*	25	5	200	16	32 (5 В; 1 мА)	60	—	—	—	R-32
2N190	Ge, p-n-p, C	200	1*	25*	5	200	16	42 (5 В; 1 мА)	40	—	—	—	R-32
2N191	Ge, p-n-p, C	200	1,2*	25*	5	200	16	67 (5 В; 1 мА)	40	—	—	—	R-32
GC112	Ge, p-n-p, C	120	≥0,3	80	10	150	≤18 (15 В)	≥10 (6 В; 2 мА)	—	—	—	—	A-1
GS112	Ge, p-n-p, C	120	—	20	10	200	≤15 (15 В)	28...140* (0,5 В; 0,2 А)	—	≤1	≤25 (1 кГц)	900***	A-1
2SB263	Ge, p-n-p, C	200	1,5*	20	2,5	150	14 (12 В)	60 (6 В; 1 мА)	—	—	20	—	TO-1
2SB201	Ge, p-n-p, C	160	≥0,2*	35	12	140 (400*)	≤30 (12 В)	40...300* (1 В; 0,15 А)	—	≤1,3	—	1400***	TO-5
2SB200	Ge, p-n-p, C	210	0,5*	32	12	400*	≤40 (12 В)	30...150* (1 В; 0,15 А)	—	—	—	—	R-10
МП42	Ge, p-n-p, C	200	≥2*	15* (3 к)	—	150*	—	20...35* (1 В; 10 мА)	—	≤20	—	≤2000***	2
МП42А	Ge, p-n-p, C	200	≥1,5*	15* (3 к)	—	150*	—	30...50* (1 В; 10 мА)	—	≤20	—	≤1500***	2
МП42Б	Ge, p-n-p, C	200	≥1*	15* (3 к)	—	150*	—	45...100* (1 В; 10 мА)	—	≤20	—	≤1000***	2

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^*_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, мкА	$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r^*_б$, $r^{**}_{бэ\,нас}$, Ом	$\tau_к$, $t^*_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
ASY26	Ge, p-n-p, C	150	≥4	30	20	200 (300*)	≤7 (30 В)	≥30* (1 В; 10 мА)	≤16 (5 В)	≤10	—	≤1350*	TO-5
2N404	Ge, p-n-p, C	150	≥4*	25	12	150	≤5 (12 В)	≥40* (0,25 В; 20 мА)	≤20 (6 В)	≤13	—	≤500**	TO-5
MM404	Ge, p-n-p, C	150	≥4*	25	12	150	≤5 (12 В)	135 (6 В; 1 мА)	≤20 (6 В)	≤13	—	≤490***	TO-18
ASY70	Ge, p-n-p, C	250 (900*)	1,5	32	16	300	≤10 (10 В)	47 (0,5 В; 2 мА)	≤40 (5 В)	≤3	—	≤2500***	TO-1
OC1076	Ge, p-n-p, C	125	≥0,35*	32	10	125 (250*)	≤10 (10 В)	≥45* (5,4 В; 10 мА)	—	≤3	—	—	TO-1
ASX11	Ge, p-n-p, C	150	≥4,5*	30	18	250	≤10 (30 В)	35...80* (0,5 В; 10 мА)	—	≤32	—	≤260***	TO-5
ASX12	Ge, p-n-p, C	150	≥5,5*	21	12	250	≤10 (24 В)	50...120* (0,5 В; 10 мА)	—	≤30	—	≤220***	TO-5
AF266	Ge, p-n-p, C	125	4,5	18	—	100	≤3 (18 В)	50...150* (1,5 В; 10 мА)	≤18 (6 В)	—	—	—	TO-18
AT270	Ge, p-n-p, C	430*	4	40	—	250	≤20 (40 В)	25...130* (0,5 В; 10 мА)	≤20	—	—	—	TO-1
AT275	Ge, p-n-p, C	430*	4	25	—	250	≤20 (25 В)	25...130* (0,5 В; 10 мА)	≤20	—	—	—	TO-1
2N1353	Ge, p-n-p, C	200	3,5*	15	10	200	6	70* (1 В; 10 мА)	12	4	—	≤1580***	TO-5
2N1354	Ge, p-n-p, C	200	4,5*	30	20	200	6	70* (1 В; 10 мА)	12	4	—	≤1660***	TO-5
ASY31	Ge, p-n-p, C	125	≥4*	25	20	200	3	≥30* (20 мА)	16	—	—	—	R-9
2N123	Ge, p-n-p, C	150	8*	20	10	125	6	75* (1 В; 10 мА)	14	≤20	—	900*	R-32
2N581	Ge, p-n-p, C	150	8*	18	10	100	20	30* (0,3 В; 20 мА)	12	—	—	—	TO-5
2N1681	Ge, p-n-p, C	180	≥5*	30	20	200	25	75* (0,25 В; 10 мА)	≤20	10	—	950*	TO-5
GS109	Ge, p-n-p, C	100	—	20	10	50	≤15 (15 В)	28...140* (0,5 В; 50 мА)	10	—	≤25 (1 кГц)	≤1500***	A-1
GS111	Ge, p-n-p, C	100	—	20	10	50	≤15 (15 В)	28...140* (0,5 В; 50 мА)	10	—	—	≤1200***	A-1
ASY33	Ge, p-n-p, C	150	≥2	30	20	200	—	20...200* (1 В; 10 мА)	≤18 (5 В)	≤4	—	—	TO-5
ASY34	Ge, p-n-p, C	150	≥2	15	10	200	—	20...200* (1 В; 10 мА)	≤35 (5 В)	≤5	—	≤2700***	TO-5
ASY35	Ge, p-n-p, C	150	≥2	30	20	200	—	30...300* (1 В; 10 мА)	≤20 (5 В)	≤4	—	≤2500***	TO-5
2SB40	Ge, p-n-p, C	80	≥0,7*	40	12	100	≤10 (12 В)	43...200* (1 В; 0,1 А)	—	≤2,5	—	600*	TO-1
МП35	Ge, n-p-n, C	150	≥0,5*	15	—	20 (150*)	≤30 (5 В)	13...125 (5 В; 1 мА)	—	—	≤220*	—	2
МП36А	Ge, n-p-n, C	150	≥1*	15	—	20 (150*)	≤30 (5 В)	15...45 (5 В; 1 мА)	—	—	≤10 (1 кГц)	—	2
МП37	Ge, n-p-n, C	150	≥1*	15	—	20 (150*)	≤30 (5 В)	15...30 (5 В; 1 мА)	—	—	≤220*	—	2
МП37А	Ge, n-p-n, C	150	≥1*	30	—	20 (150*)	≤30 (5 В)	15...30 (5 В; 1 мА)	—	—	≤220*	—	2
МП37Б	Ge, n-p-n, C	150	≥1*	30	—	20 (150*)	≤30 (5 В)	25...50 (5 В; 1 мА)	—	—	≤220*	—	2
МП38	Ge, n-p-n, C	150	≥2*	15	—	20 (150*)	≤30 (5 В)	25...55 (5 В; 1 мА)	—	—	≤220*	—	2
МП38А	Ge, n-p-n, C	150	≥2*	15	—	20 (150*)	≤30 (5 В)	45...100 (5 В; 1 мА)	—	—	≤220*	—	2
2N193	Ge, n-p-n, C	150	3*	18	5	50	50	7,5 (6 В; 1 мА)	11	—	—	—	TO-22
2N444	Ge, n-p-n, C	100	≥0,5*	15	10	50	2	≥15 (4,5 В; 1 мА)	13	—	—	—	TO-5
2N444A	Ge, n-p-n, C	150	≥0,5*	15	10	50	4	15 (4,5 В; 1 мА)	—	—	—	—	TO-5
2N445	Ge, n-p-n, C	150	≥2*	15	10	50	2	35 (4,5 В; 1 мА)	13	—	—	—	TO-5
2N445A	Ge, n-p-n, C	150	≥2*	30	10	50	4	35 (5 В; 1 мА)	—	—	—	—	TO-5
2SD75	Ge, n-p-n, C	150	4*	25	12	100	14 (25 В)	40 (6 В; 1 мА)	42	—	≤15	—	TO-1
2SD75A	Ge, n-p-n, C	150	4*	45	12	100	10	40 (6 В; 1 мА)	42	—	≤20	—	TO-1
T321N	Ge, n-p-n, C	150	0,8*	32	12	150	≤15 (10 В)	20...44 (6 В; 1 мА)	45 (6 В)	—	—	—	TO-1
T322N	Ge, n-p-n, C	150	≥1*	32	12	150	≤15 (10 В)	32...85 (6 В; 1 мА)	45 (6 В)	—	—	—	TO-1
T323N	Ge, n-p-n, C	150	≥1,2*	32	12	150	≤15 (10 В)	55...200 (6 В; 1 мА)	45 (6 В)	—	—	—	TO-1
AC183	Ge, n-p-n, C	250	≥2*	32	20	150	≤20 (10 В)	50...250 (6 В; 2 мА)	80 (6 В)	—	≤10 (1 кГц)	—	TO-1A

Заказ № 1141

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^*_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, мкА	$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r^*_б$, $r^{**}_{бэ\,нас}$, Ом	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
GC525	Ge, n-p-n, C	130 (45 °C)	1,2	15	10	125 (250*)	≤12 (6 В)	20...150 (6 В; 1 мА)	—	≤2	≤10 (1 кГц)	—	A-6
GC526	Ge, n-p-n, C	130 (45 °C)	1,2	32	10	125 (250*)	≤12 (6 В)	20...150 (6 В; 1 мА)	—	≤2	≤10 (1 кГц)	—	A-6
GC527	Ge, n-p-n, C	130 (45 °C)	1,4	32	10	125 (250*)	≤12 (6 В)	50...150 (6 В; 1 мА)	—	≤2	≤6 (1 кГц)	—	A-6
101NU70	Ge, n-p-n, C	30	≥0,2*	10	—	100*	≤20 (5 В)	≥6 (5 В; 1 мА)	—	—	—	—	A-6
102NU70	Ge, n-p-n, C	50	≥0,5*	20	—	100*	≤15 (5 В)	12...20 (5 В; 1 мА)	—	—	—	—	A-6
103NU70	Ge, n-p-n, C	50	≥0,5*	20	2	100*	≤10 (5 В)	≥20 (5 В; 1 мА)	—	—	—	—	A-6
104NU70	Ge, n-p-n, C	50	≥0,5*	20	—	100*	≤10 (5 В)	≥20 (5 В; 1 мА)	—	—	≤15 (1 кГц)	—	A-6
105NU70	Ge, n-p-n, C	125	≥0,6*	32	10	10 (50*)	≤12 (4,5 В)	20...40 (2 В; 0,5 мА)	—	—	≤10 (1 кГц)	—	A-6
106NU70	Ge, n-p-n, C	125	≥0,8*	32	10	10 (50*)	≤12 (4,5 В)	30...75 (2 В; 3 мА)	—	—	≤10 (1 кГц)	—	A-6
107NU70	Ge, n-p-n, C	125	≥1*	32	10	10 (50*)	≤12 (4,5 В)	65...130 (2 В; 3 мА)	—	—	≤10 (1 кГц)	—	A-6
152NU70	Ge, n-p-n, C	50	≥2,5*	10	5	5 (10*)	≤10 (5 В)	20...100 (5 В; 0,5 мА)	≤26 (6 В)	—	≤10 (1 кГц)	—	A-6
153NU70	Ge, n-p-n, C	50	≥1*	10	5	5 (10*)	≤10 (5 В)	10...40 (5 В; 0,5 мА)	≤26 (6 В)	—	≤20 (1 кГц)	—	A-6
154NU70	Ge, n-p-n, C	50	≥2,5*	10	5	5 (10*)	≤10 (5 В)	20...100 (5 В; 0,5 мА)	≤26 (6 В)	—	≤20 (1 кГц)	—	A-6
155NU70	Ge, n-p-n, C	83	≥3*	15	8	10 (20*)	≤2 (2 В)	25...125 (6 В; 1 мА)	≤14 (6 В)	—	200*	—	A-6
2SD31	Ge, n-p-n, C	125	0,5	25	10	125	15	50* (1 В; 2 мА)	—	—	—	—	TO-1
2SD32	Ge, n-p-n, C	125	0,5	25	10	125	15	90* (1 В; 2 мА)	—	—	—	—	TO-1
2SD33	Ge, n-p-n, C	150	2*	20	2,5	50	14	60 (6 В; 1 мА)	—	—	—	—	TO-1
2SD37	Ge n-p-n, C	150	2*	30	12	50	14	60 (6 В; 1 мА)	30	—	—	—	TO-1
2SD195	Ge, n-p-n, C	150	2,5*	20	15	50	14	70* (1 В; 50 мА)	—	—	—	—	TO-1
2N94	Ge, n-p-n, C	150	2	20	5	100	50	50* (6 В; 1 мА)	100	—	—	—	TO-22
П29	Ge, p-n-p, C	30 (60 °C)	≥5*	10*	12	100*	≤4 (12 В)	20...50 (0,5 В; 20 мА)	≤20 (6 В)	10	—	≤6000	2
П29А	Ge, p-n-p, C	30 (60 °C)	≥5*	10*	12	100*	≤4 (12 В)	40...100 (0,5 В; 20 мА)	≤20 (6 В)	10	—	≤6000	2
П30	Ge, p-n-p, C	30 (60 °C)	≥10*	10*	12	100*	≤4 (12 В)	80...180 (0,5 В; 20 мА)	≤20 (6 В)	10	—	≤6000	2
OC41	Ge, p-n-p, C	83	4	16	12	50	—	35 (50 мА)	—	—	—	—	R-8
OC42	Ge, p-n-p, C	83	7	16	10	50	—	70* (50 мА)	—	—	—	—	R-8
AFY15	Ge, p-n-p, C	65	16	22	8	50	1 (6 В)	30...250 (6 В; 0,5 мА)	—	—	—	—	TO-18
AF260	Ge, p-n-p, C	75	5	15	—	10	≤3 (15 В)	25...150 (6 В; 1 мА)	≤14 (6 В)	—	—	—	TO-18
AF261	Ge, p-n-p, C	75	12	15	—	10	≤3 (15 В)	50...150 (6 В; 1 мА)	≤14 (6 В)	—	—	—	TO-18
2SA50	Ge, p-n-p, C	55	≥9*	18	12	24	≤3 (12 В)	30...150* (1 В; 24 мА)	—	≤8	—	100*	TO-1
КТ201А	Si, n-p-n, ПЭ	150 (90 °C)	≥10	20	20	20 (100*)	≤1 (20 В)	20...60 (1 В; 5 мА)	≤20 (5 В)	—	—	—	5
КТ201АМ	Si, n-p-n, ПЭ	150	≥10	20	20	20 (100*)	≤1 (20 В)	20...60 (1 В; 5 мА)	≤20 (5 В)	—	—	—	17
КТ201Б	Si, n-p-n, ПЭ	150	≥10	20	20	20 (100*)	≤1 (20 В)	30...90 (1 В; 5 мА)	≤20 (5 В)	—	—	—	5
КТ201БМ	Si, n-p-n, ПЭ	150	≥10	20	20	20 (100*)	≤1 (20 В)	30...90 (1 В; 5 мА)	≤20 (5 В)	—	—	—	17
КТ201В	Si, n-p-n, ПЭ	150	≥10	10	10	20 (100*)	≤1 (10 В)	30...90 (1 В; 5 мА)	≤20 (5 В)	—	—	—	5

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\ max}$, $P^{*}_{K,\ т\ max}$, $P^{**}_{K,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^{*}_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ проб}$, В	$I_{K\ max}$, $I^{*}_{K,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, мкА	$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_{к}$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{кэ\ нас}$, Ом	$К_{ш}$, дБ, $r^{*}_{б}$, $r^{**}_{бэ\ нас}$, Ом	$τ_{к}$, $t^{*}_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
КТ201ВМ	Si, n-p-n, ПЭ	150	⩾10	10	10	20 (100*)	⩽1 (10 В)	30...90 (1 В; 5 мА)	⩽20 (5 В)	—	—	—	17
КТ201Г	Si, n-p-n, ПЭ	150	⩾10	10	10	20 (100*)	⩽1 (10 В)	70...210 (1 В; 5 мА)	⩽20 (5 В)	—	—	—	5
КТ201ГМ	Si, n-p-n, ПЭ	150	⩾10	10	10	20 (100*)	⩽1 (10 В)	70...210 (1 В; 5 мА)	⩽20 (5 В)	—	—	—	17
КТ201Д	Si, n-p-n, ПЭ	150	⩾10	10	10	20 (100*)	⩽1 (10 В)	30...90 (1 В; 5 мА)	⩽20 (5 В)	—	⩽15 (1 кГц)	—	5
КТ201ДМ	Si, n-p-n, ПЭ	150	⩾10	10	10	20 (100*)	⩽1 (10 В)	30...90 (1 В; 5 мА)	⩽20 (5 В)	—	⩽15 (1 кГц)	—	17
2N2617	Si, n-p-n, С	250	⩾1	25	20	100	0,1	⩾25 (6 В; 1 мА)	80	—	—	—	R-8
2N2432	Si, n-p-n, ПЭ	300	⩾20	30	15	100	⩽0,01 (20 В)	⩾50* (5 В; 1 мА)	⩽12	⩽15	—	—	TO-18
2N2432A	Si, n-p-n, ПЭ	300	⩾20	45	18	100	⩽0,01 (40 В)	⩾50 (5 В; 1 мА)	⩽12	⩽15	—	—	TO-18
2N4138	Si, n-p-n, ПЭ	300	⩾20	30	15	100	⩽0,01 (20 В)	⩾50 (5 В; 1 мА)	⩽12	⩽15	—	—	TO-46
КТ104А	Si, p-n-p, ПЭ	150 (60 °С)	⩾5*	30**	10	50	⩽1 (30 В)	9...36 (5 В; 1 мА)	⩽50 (5 В)	⩽50	⩽120*	—	6
КТ104Б	Si, p-n-p, ПЭ	150 (60 °С)	⩾5*	15**	10	50	⩽1 (15 В)	20...80 (5 В; 1 мА)	⩽50 (5 В)	⩽50	⩽120*	—	6
КТ104В	Si, n-p-n, ПЭ	150 (60 °С)	⩾5*	15**	10	50	⩽1 (15 В)	40...160 (5 В; 1 мА)	⩽50 (5 В)	⩽50	⩽120*	—	6
КТ104Г	Si, p-n-p, ПЭ	150 (60 °С)	⩾5*	30**	10	50	⩽1 (30 В)	15...60 (5 В; 1 мА)	⩽50 (5 В)	⩽50	⩽120*	—	6
BSZ10	Si, p-n-p, С	250	⩾0,3*	25	20	50	⩽0,1 (10 В)	15...60 (6 В; 1 мА)	⩽80 (6 В)	⩽47	8 (1 кГц)	—	TO-18
BSZ11	Si, p-n-p, С	250	⩾1*	25	20	50	⩽0,1 (10 В)	25...60 (6 В; 1 мА)	⩽80 (6 В)	⩽47	6 (1 кГц)	—	TO-18
2N1024	Si, p-n-p, С	250	⩾1*	18	18	100	0,025	15 (6 В; 1 мА)	7	—	—	—	TO-5
2N1643	Si, p-n-p, С	250	0,7*	25	20	50	0,001	18 (6 В; 1 мА)	50	—	—	—	TO-5
OC200	Si, p-n-p, С	250	⩾0,45*	30	20	50 (100*)	0,5	15...60 (6 В; 1 мА)	—	⩽27,5	—	—	R-8
OC201	Si, p-n-p, С	250	⩾2	25	20	50 (100*)	0,5	20...80 (6 В; 1 мА)	—	⩽27,5	—	—	R-8
OC202	Si, p-n-p, С	250	⩾1,4	15	10	50 (100*)	0,5	40...120 (6 В; 1 мА)	—	⩽27,5	—	—	R-8
2N1220	Si, p-n-p, С	250	⩾2*	30	20	100	0,1	⩾9* (0,25 В; 5 мА)	⩽18	—	—	—	TO-5
2N1222	Si, p-n-p, С	250	⩾2*	30	10	100	0,1	⩾9 (6 В; 1 мА)	⩽18	—	—	—	TO-5
2N1223	Si, p-n-p, С	250	⩾2*	40	10	100	0,1	⩾6 (6 В; 1 мА)	⩽18	—	—	—	TO-5
2N1027	Si, p-n-p, С	250	⩾4	18	18	100	0,025	30 (6 В; 1 мА)	7	—	—	—	TO-5
2N1219	Si, p-n-p, С	250	⩾5*	30	20	100	0,1	⩾18* (0,25 В; 5 мА)	⩽15	—	—	—	TO-5
2N1221	Si, p-n-p, С	250	⩾5*	30	10	100	0,1	⩾18 (6 В; 1 мА)	⩽15	—	—	—	TO-5
2N1028	Si, p-n-p, С	250	6	18	12	100	0,025	⩾9 (6 В; 1 мА)	7	—	—	—	TO-5
КТ203А	Si, p-n-p, ПЭ	150 (75° С)	⩾5*	60	30	10 (50*)	⩽1 (60 В)	⩾9 (5 В; 1 мА)	⩽10 (5 В)	—	⩽300*	—	5
КТ203АМ	Si, p-n-p, ПЭ	150 (75° С)	⩾5*	60	30	10 (50*)	⩽1 (60 В)	⩾9 (5 В; 1 мА)	⩽10 (5 В)	—	⩽300*	—	17
КС203Б	Si, p-n-p, ПЭ	150 (75° С)	⩾5*	30	15	10 (50*)	⩽1 (30 В)	30...150 (5 В; 1 мА)	⩽10 (5 В)	⩽50	⩽300*	—	5

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^*_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, мкА	$h_{21э}$, $h^*_{21э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$К_ш$, дБ, $r^*_б$, $r^{**}_{бэ\,нас}$, Ом	$\tau_к$, $t^*_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
КТ203БМ	Si, p-n-p, ПЭ	150 (75° C)	≥5*	30	15	10 (50*)	≤1 (30 В)	30...150 (5 В; 1 мА)	≤10 (5 В)	≤50	≤300*	—	17
КТ203В	Si, p-n-p, ПЭ	150 (75° C)	≥5*	15	10	10 (50*)	≤1 (15 В)	30...200 (5 В; 1 мА)	≤10 (5 В)	≤25	≤300*	—	5
КТ203ВМ	Si, p-n-p, ПЭ	150 (75° C)	≥5*	15	10	10 (50*)	≤1 (15 В)	30...200 (5 В; 1 мА)	≤10 (5 В)	≤25	≤300*	—	17
BSZ12	Si, p-n-p, C	250	1*	60	30	50	≤0,1 (10 В)	≥10 (6 В; 1 мА)	≤80 (6 В)	≤47	8 (1 кГц)	—	TO-18
2N943	Si, p-n-p, C	250	≥1*	40	40	50	≤100 (40 В)	≥10 (6 В; 1 мА)	≤14 (6 В)	—	—	—	TO-18
2N944	Si, p-n-p, C	250	≥1*	40	40	50	≤100 (40 В)	≥10 (6 В; 1 мА)	≤14 (6 В)	—	—	—	TO-18
2N2274	Si, p-n-p, C	150	≥6	25	25	50	0,003 (10 В)	≥10 (0,5 В; 5 мА)	≤9	—	—	—	TO-18
2N2275	Si, p-n-p, C	150	≥6	25	25	50	0,003 (10 В)	≥10 (0,5 В; 5 мА)	≤9	—	—	—	TO-18
2N2276	Si, p-n-p, C	150	≥6	15	15	50	0,003 (10 В)	≥10 (0,5 В; 5 мА)	≤9	—	—	—	TO-18
2N2277	Si, p-n-p, C	150	≥6	15	15	50	0,003 (10 В)	≥10 (0,5 В; 5 мА)	≤9	—	—	—	TO-18
2N923	Si, p-n-p, C	150	≥0,8	40	40	50	50	21 (6 В; 1 мА)	≤20	—	—	—	TO-18
2N924	Si, p-n-p, C	150	≥0,8	40	40	50	50	47 (6 В; 1 мА)	≤20	—	—	—	TO-18
2N2372	Si, p-n-p, C	150	1	15	15	50	50	≥15 (4 В; 25 мА)	15	—	—	—	TO-18
2N2373	Si, p-n-p, C	150	1	15	15	50	50	≥20 (4 В; 25 мА)	15	—	—	—	TO-18
OC203	Si, p-n-p, C	250	≥0,3*	60	30	50 (100*)	1,5	10...60 (6 В; 1 мА)	—	≤2,75	—	—	R-8
КТ208А	Si, p-n-p, ПЭ	200 (60 °C)	≥5	20* (10 к)	10	300 (500*)	≤1 (20 В)	20...60* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	—	—	20
КТ208Б	Si, p-n-p, ПЭ	200 (60 °C)	≥5	15	10	300 (500*)	≤1 (20 В)	40...120* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	—	—	20
КТ208В	Si, p-n-p, ПЭ	200 (60 °C)	≥5	15	10	300 (500*)	≤1 (20 В)	80...240* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	≤4 (1 кГц)	—	20
КТ208Г	Si, p-n-p, ПЭ	200 (60 °C)	≥5	30* (10 к)	10	300 (500*)	≤1 (20 В)	20...60* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	—	—	20
КТ208Д	Si, p-n-p, ПЭ	200 (60 °C)	≥5	30	10	300 (500*)	≤1 (20 В)	40...120* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	—	—	20
КТ208Е	Si, p-n-p, ПЭ	200 (60 °C)	≥5	30	10	300 (500*)	≤1 (20 В)	80...240* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	≤4 (1 кГц)	—	20
КТ208Ж	Si, p-n-p, ПЭ	200 (60 °C)	≥5	45	20	300 (500*)	≤1 (20 В)	20...60* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	—	—	20
КТ208И	Si, p-n-p, ПЭ	200 (60 °C)	≥5	45	20	300 (500*)	≤1 (20 В)	40...120* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	—	—	20
КТ208К	Si, p-n-p, ПЭ	200 (60 °C)	≥5	45	20	300 (500*)	≤1 (20 В)	80...240* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	≤4 (1 кГц)	—	20
КТ208Л	Si, p-n-p, ПЭ	200 (60 °C)	≥5	60	20	300 (500*)	≤1 (20 В)	20...60* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	—	—	20
КТ208М	Si, p-n-p, ПЭ	200 (60 °C)	≥5	60	20	300 (500*)	≤1 (20 В)	40...120* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	—	—	20

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^*_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, мкА	$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r^*_б$, $r^{**}_{бэ\,нас}$, Ом	$\tau_к$, $t^*_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
BCY10	Si, p-n-p, C	300 (415*)	1,5	32	12	250 (500*)	≤0,02 (6 В)	≥12* (2 В; 30 мА)	90 (6 В)	≤4	≤20 (1 кГц)	—	R-8
BCY11	Si, p-n-p, C	300 (415*)	1,5	60	12	250 (500*)	≤0,02 (6 В)	≥12* (2 В; 30 мА)	90 (6 В)	≤4	≤20 (1 кГц)	—	R-8
BCY12	Si, p-n-p, C	300 (415*)	2	32	12	250 (500*)	≤0,02 (6 В)	40* (2 В; 30 мА)	90 (6 В)	≤4	≤20 (1 кГц)	—	R-8
SFT307	Si, p-n-p, C	150	≥4	18	12	100	≤10 (18 В)	25...120 (6 В; 1 мА)	≤11 (6 В)	—	6 (1 кГц)	—	TO-1
SFT308	Si, p-n-p, C	150	≥7	18	12	100	≤10 (18 В)	40...180 (6 В; 1 мА)	≤11 (6 В)	—	6 (1 кГц)	—	TO-1
EFT308	Si, p-n-p, C	150	10,3	15	9	100	≤15 (15 В)	40...160 (6 В; 1 мА)	≤12 (6 В)	—	—	—	TO-1
BCY90	Si, p-n-p, ПЭ	350	15	40	20	50 (100*)	≤0,002 (15 В)	10...35 (6 В; 1 мА)	4	≤10	4 (1 кГц)	—	TO-18
BCY91	Si, p-n-p, ПЭ	350	15	40	20	50 (100*)	≤0,002 (15 В)	25...60 (6 В; 1 мА)	4	≤10	4 (1 кГц)	—	TO-18
BCY92	Si, p-n-p, ПЭ	350	15	40	20	50 (100*)	≤0,002 (15 В)	40...100 (6 В; 1 мА)	4	≤10	4 (1 кГц)	200*	TO-18
BCY93	Si, p-n-p, ПЭ	350	15	70	30	50 (100*)	≤0,002 (15 В)	10...35 (6 В; 1 мА)	4	≤10	4 (1 кГц)	—	TO-18
BCY94	Si, p-n-p, ПЭ	350	15	70	30	50 (100*)	≤0,002 (15 В)	25...60 (6 В; 1 мА)	4	≤10	4 (1 кГц)	—	TO-18
BCY95	Si, p-n-p, ПЭ	350	15	70	30	50 (100*)	≤0,002 (15 В)	40...100 (6 В; 1 мА)	4	≤10	4 (1 кГц)	200*	TO-18
TCH98	Si, p-n-p, ПЭ	350	15	40	20	50 (100*)	≤0,002 (15 В)	≥80 (6 В; 1 мА)	4	≤10	4 (1 кГц)	200*	TO-18
TCH99	Si, p-n-p, ПЭ	350	15	70	30	50 (100*)	≤0,002 (15 В)	≥80 (6 В; 1 мА)	4	≤10	4 (1 кГц)	200*	TO-18
OC206	Si, p-n-p, C	300	≥0,85	32	12	250	0,5	≥16* (1 В; 150 мА)	—	≤2,75	—	—	R-8
OC204	Si, p-n-p, C	300	≥0,45	32	12	250	0,5	10...30* (1 В; 150 мА)	—	≤2,75	—	—	R-8
OC207	Si, p-n-p, C	300	≥0,45	50	12	250	0,5	12...70* (1 В; 150 мА)	—	≤2,75	—	—	R-8
OC205	Si, p-n-p, C	300	≥0,45	60	30	250	0,5	10...50* (1 В; 150 мА)	—	≤2,75	—	—	R-8
BCY30	Si, p-n-p, C	250	≥0,25	64	45	50 (150*)	≤0,05 (6 В)	10...35* (4,5 В; 20 мА)	≤60 (6 В)	≤27,5	≤20 (1 кГц)	—	TO-5
BCY31	Si, p-n-p, C	250	≥0,25	64	45	50 (150*)	≤0,05 (6 В)	15...60* (4,5 В; 20 мА)	≤60 (6 В)	≤27,5	≤20 (1 кГц)	—	TO-5
BCY32	Si, p-n-p, C	250	≥0,25	64	32	50 (150*)	≤0,05 (6 В)	20...70* (4,5 В; 20 мА)	≤60 (6 В)	≤27,5	≤20 (1 кГц)	—	TO-5
BCY33	Si, p-n-p, C	250	≥0,4	32	16	50 (150*)	≤0,05 (6 В)	10...35* (4,5 В; 20 мА)	≤60 (6 В)	≤27,5	≤20 (1 кГц)	—	TO-5
BCY34	Si, p-n-p, C	250	≥0,6	32	16	50 (150*)	≤0,05 (6 В)	15...60* (4,5 В; 20 мА)	≤60 (6 В)	≤27,5	≤20 (1 кГц)	—	TO-5
КТ209А	Si, p-n-p, ПЭ	200 (35°C)	≥5	15	10	300 (500*)	≤1* (15 В)	20...60* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	—	—	17
КТ209Б	Si, p-n-p, ПЭ	200 (35°C)	≥5	15	10	300 (500*)	≤1* (15 В)	40...120* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	—	—	17
КТ209В	Si, p-n-p, ПЭ	200 (35°C)	≥5	15	10	300 (500*)	≤1* (15 В)	80...240* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	≤5 (1 кГц)	—	17
КТ209Г	Si, p-n-p, ПЭ	200 (35°C)	≥5	30	10	300 (500*)	≤1* (30 В)	20...60* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	—	—	17
КТ209Д	Si, p-n-p, ПЭ	200 (35°C)	≥5	30	10	300 (500*)	≤1* (30 В)	40...120* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	—	—	17
КТ209Е	Si, p-n-p, ПЭ	200 (35°C)	≥5	30	10	300 (500*)	≤1* (30 В)	80...240* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	≤5 (1 кГц)	—	17
КТ209Ж	Si, p-n-p, ПЭ	200 (35°C)	≥5	45	20	300 (500*)	≤1* (45 В)	20...60* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	—	—	17
КТ209И	Si, p-n-p, ПЭ	200 (35°C)	≥5	45	20	300 (500*)	≤1* (45 В)	40...120* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	—	—	17

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^*_{K,т\,max}$, $P^{**}_{K,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, мкА	$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r^*_б$, $r^{**}_{бэ\,нас}$, Ом	$\tau_к$, $t^*_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
КТ209К	Si, p-n-p, ПЭ	200 (35°С)	≥5	45	20	300 (500*)	≤1* (45 В)	80...160* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	≤5 (1 кГц)	—	17
КТ209Л	Si, p-n-p, ПЭ	200 (35°С)	≥5	60	20	300 (500*)	≤1* (60 В)	20...60* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	—	—	17
КТ209М	Si, p-n-p, ПЭ	200 (35°С)	≥5	60	20	300 (500*)	≤1* (60 В)	40...120* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	—	—	17
MPS404	Si, p-n-p, ПЭ	310	≥4*	25	12	150	≤0,1 (10 В)	30...400* (0,15 В; 12 мА)	≤20 (6 В)	≤ 12	—	155*	ТО-92
MPS404A	Si, p-n-p, ПЭ	310	≥4*	40	25	150	0,1	30...400* (0,15 В; 12 мА)	≤20 (6 В)	≤ 12	—	155*	ТО-92
КТ501А	Si, p-n-p, ПЭ	350 (35°С)	≥5	15* (10 к)	10	300 (500*)	≤1* (15 В)	20...60* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	—	—	20
КТ501Б	Si, p-n-p, ПЭ	350 (35°С)	≥5	15* (10 к)	10	300 (500*)	≤1* (15 В)	40...120* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	—	—	20
КТ501В	Si, p-n-p, ПЭ	350 (35°С)	≥5	15* (10 к)	10	300 (500*)	≤1* (15 В)	80...240* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	≤4 (1 кГц)	—	20
КТ501Г	Si, p-n-p, ПЭ	350 (35°С)	≥5	30* (10 к)	10	300 (500*)	≤1* (30 В)	20...60* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	—	—	20
КТ501Д	Si, n-n-п, ПЭ	350 (35°С)	≥5	30* (10 к)	10	300 (500*)	≤1* (30 В)	40...120* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	—	—	20
КТ501Е	Si, p-n-p, ПЭ	350 (35°С)	≥5	30* (10 к)	10	300 (500*)	≤1* (30 В)	80...240* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	≤4 (1 кГц)	—	20
КТ501Ж	Si, p-n-p, ПЭ	350 (35°С)	≥5	45* (10 к)	20	300 (500*)	≤1* (45 В)	20...60* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	—	—	20
КТ501И	Si, p-n-p, ПЭ	350 (35°С)	≥5	45* (10 к)	20	300 (500*)	≤1* (45 В)	40...120* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	—	—	20
КТ501К	Si, p-n-p, ПЭ	350 (35°С)	≥5	45* (10 к)	20	300 (500*)	≤1* (45 В)	80...240* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	≤4 (1 кГц)	—	20
КТ501Л	Si, p-n-p, ПЭ	350 (35°С)	≥5	60* (10 к)	20	300 (500*)	≤1* (60 В)	20...60* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	—	—	20
КТ501М	Si, p-n-p, ПЭ	350 (35°С)	≥5	60* (10 к)	20	300 (500*)	≤1* (60 В)	40...120* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	—	—	20
BCY38	Si, p-n-p, ПЭ	410	≥0,45	32	12	250 (500*)	≤0,001 (6 В)	≥12* (1 В; 150 мА)	≤150 (6 В)	≤7	≤20 (1 кГц)	—	ТО-5
BCY39	Si, p-n-p, ПЭ	410	≥0,45	64	12	250 (500*)	≤0,001 (6 В)	≥12* (1 В; 150 мА)	≤150 (6 В)	≤7	≤20 (1 кГц)	—	ТО-5
BCY40	Si, p-n-p, ПЭ	410	≥0,85	32	12	250 (500*)	≤0,001 (6 В)	≥22* (1 В; 150 мА)	≤150 (6 В)	≤7	≤20 (1 кГц)	—	ТО-5
BCY54	Si, p-n-p, ПЭ	410	≥0,45	50	12	50 (500*)	≤0,001 (6 В)	22...100* (1 В; 150 мА)	≤150 (6 В)	≤7	≤20 (1 кГц)	—	ТО-5
SFT124	Si, p-n-p, С	350	≥0,6	24	12	500	≤20 (24 В)	20...40* (1 В; 250 мА)	—	—	—	—	R-13
SFT125	Si, p-n-p, С	350	≥0,8	24	12	500	≤20 (24 В)	40...150* (1 В; 250 мА)	—	—	—	—	R-13
SFT130	Si, p-n-p, С	550	≥0,6	24	12	500	≤20 (24 В)	20...44* (1 В; 250 мА)	—	≤1	—	—	R-13
SFT131	Si, p-n-p, С	550	≥0,8	24	12	500	≤20 (24 В)	40...150* (1 В; 250 мА)	—	≤1	—	—	R-13
SFT143	Si, p-n-p, С	350	≥0,6	45	25	500	≤20 (45 В)	20...44* (1 В; 250 мА)	—	≤1	5 (1 кГц)	—	R-13
SFT144	Si, p-n-p, С	350	≥0,8	45	25	500	≤20 (45 В)	40...80* (1 В; 250 мА)	—	≤1	5 (1 кГц)	—	R-13
SFT145	Si, p-n-p, С	550	≥0,6	45	25	500	≤20 (45 В)	20...44* (1 В; 250 мА)	—	≤1	5 (1 кГц)	—	R-13

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\ max}$, $P^{*}_{K,\ т\ max}$, $P^{**}_{K,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^{*}_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ проб}$, В	$I_{K\ max}$, $I^{*}_{K,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, мкА	$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{кэ\ нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r^{*}_б$, $r^{**}_{бэ\ нас}$, Ом	$\tau_к$, $t^{*}_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
SFT146	Si, p-n-p, С	550	≥0,8	45	25	500	20 (45 В)	40...80* (1 В; 250 мА)	—	≤1	5 (1 кГц)	—	R-13
BCY90B	Si, p-n-p, ПЭ	400	15	40	20	50 (150*)	≤0,002 (15 В)	10...35 (6 В; 1 мА)	4	≤10	4 (1 кГц)	—	TO-5
BCY91B	Si, p-n-p, ПЭ	400	15	40	20	50 (150*)	≤0,002 (15 В)	25...60 (6 В; 1 мА)	4	≤10	4 (1 кГц)	—	TO-5
BCY92B	Si, p-n-p, ПЭ	400	15	40	20	50 (150*)	≤0,002 (15 В)	40...100 (6 В; 1 мА)	4	≤10	4 (1 кГц)	200*	TO-5
BCY93B	Si, p-n-p, ПЭ	400	15	70	30	50 (150*)	≤0,002 (15 В)	10...35 (6 В; 1 мА)	4	≤10	4 (1 кГц)	—	TO-5
BCY94B	Si, p-n-p, ПЭ	400	15	70	30	50 (150*)	≤0,002 (15 В)	25...60 (6 В; 1 мА)	4	≤10	4 (1 кГц)	—	TO-6
BCY95B	Si, p-n-p, ПЭ	400	15	70	30	50 (150*)	≤0,002 (15 В)	40...100 (6 В; 1 мА)	4	≤10	4 (1 кГц)	200*	TO-5
TCH98B	Si, p-n-p, ПЭ	400	15	40	20	50 (150*)	≤0,002 (15 В)	≥80 (6 В; 1 мА)	4	≤10	4 (1 кГц)	200*	TO-5
TCH99B	Si, p-n-p, ПЭ	400	15	70	30	50 (150*)	≤0,002 (15 В)	≥80 (6 В; 1 мА)	4	≤10	4 (1 кГц)	200*	TO-5
КТ502А	Si, p-n-p, ПЭ	350	≥5 (≤50)	40	5	150 (300*)	≤1 (40 В)	40...120 (5 В; 10 мА)	≤50 (10 В)	≤60	≥320*	—	КТ-26
КТ502Б	Si, p-n-p, ПЭ	350	≥5 (≤50)	40	5	150 (300*)	≤1 (40 В)	80...240 (5 В; 10 мА)	≤50 (10 В)	≤60	≥320*	—	КТ-26
КТ502В	Si, p-n-p, ПЭ	350	≥5 (≤50)	60	5	150 (300*)	≤1 (60 В)	40...120 (5 В; 10 мА)	≤50 (10 В)	≤60	≥320*	—	КТ-26
КТ502Г	Si, p-n-p, ПЭ	350	≥5 (≤50)	60	5	150 (300*)	≤1 (60 В)	80...240 (5 В; 10 мА)	≤50 (10 В)	≤60	≥320*	—	КТ-26
КТ502Д	Si, p-n-p, ПЭ	350	≥5 (≤50)	80	5	150 (300*)	≤1 (80 В)	40...120 (5 В; 10 мА)	≤50 (10 В)	≤60	≥320*	—	КТ-26
КТ502Е	Si, p-n-p, ПЭ	350	≥5 (≤50)	90	5	150 (300*)	≤1 (90 В)	40...120 (5 В; 10 мА)	≤50 (10 В)	≤60	≥320*	—	КТ-26
BSS68	Si, p-n-p, ПЭ	500	≥50	110	6	100	—	≥30 (5 В; 10 мА)	≤5 (10 В)	≤10	≤36**	—	TO-92
KSA539R	Si, p-n-p, Э	400	—	60	5	200	≤0,1 (45 В)	40...80 (1 В; 50 мА)	—	≤3,3	≤8**	—	TO-92
KSA539O	Si, p-n-p, Э	400	—	60	5	200	≤0,1 (45 В)	70...140 (1 В; 50 мА)	—	≤3,3	≤8**	—	TO-92
KSA539Y	Si, p-n-p, Э	400	—	60	5	200	≤0,1 (45 В)	120...240 (1 В; 50 мА)	—	≤3,3	≤8**	—	TO-92
KSA545R	Si, p-n-p, Э	400	—	70	5	200	≤0,1 (45 В)	40...80 (1 В; 50 мА)	—	≤3,3	≤8**	—	TO-92
KSA545O	Si, p-n-p, Э	400	—	70	5	200	≤0,1 (45 В)	70...140 (1 В; 50 мА)	—	≤3,3	≤8**	—	TO-92
KSA545Y	Si, p-n-p, Э	400	—	70	5	200	≤0,1 (45 В)	120...240 (1 В; 50 мА)	—	≤3,3	≤8**	—	TO-92
КТ503А	Si, n-p-n, ПЭ	350	≥5 (≤50)	40	5	150 (300*)	≤1 (40 В)	40...120 (5 В; 10 мА)	≤50 (10 В)	≥60	≤580*	—	КТ-26
КТ503Б	Si, n-p-n, ПЭ	350	≥5 (≤50)	40	5	150 (300*)	≤1 (40 В)	80...240 (5 В; 10 мА)	≤50 (10 В)	≥60	≤580*	—	КТ-26
КТ503В	Si, n-p-n, ПЭ	350	≥5 (≤50)	60	5	150 (300*)	≤1 (60 В)	40...120 (5 В; 10 мА)	≤50 (10 В)	≥60	≤580*	—	КТ-26
КТ503Г	Si, n-p-n, ПЭ	350	≥5 (≤50)	60	5	150 (300*)	≤1 (60 В)	80...240 (5 В; 10 мА)	≤50 (10 В)	≥60	≤580*	—	КТ-26
КТ503Д	Si, n-p-n, ПЭ	350	≥5 (≤50)	80	5	150 (300*)	≤1 (80 В)	40...120 (5 В; 10 мА)	≤50 (10 В)	≥60	≤580*	—	КТ-26
КТ503Е	Si, n-p-n, ПЭ	350	≥5 (≤50)	100	5	150 (300*)	≤1 (100 В)	40...120 (5 В; 10 мА)	≤50 (10 В)	≥60	≤580*	—	КТ-26

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^*_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, мкА	$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r^*_б$, $r^{**}_{бэ\,нас}$, Ом	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
BSS38	Si, n-p-n, ПЭ	500	≥60	120	5	100 (250*)	≤0,2 (90 В)	80 (1 В; 10 мА)	≤4,5 (10 В)	≤60	≤300**	≤1*	ТО-92
MPS2711	Si, n-p-n, Э	310	—	18	5	100	≤0,5 (18 В)	30...90 (4,5 В; 2 мА)	≤4 (10 В)	—	—	—	ТО-92
MPS2712	Si, n-p-n, Э	310	—	18	5	100	≤0,5 (18 В)	75...225 (4,5 В; 2 мА)	≤4 (10 В)	—	—	—	ТО-92
KSC853R	Si, n-p-n, Э	400	—	70	5	200	≤0,1 (45 В)	40...80 (1 В; 50 мА)	—	≤2,6	≤7**	—	ТО-92
KSC853O	Si, n-p-n, Э	400	—	70	5	200	≤0,1 (45 В)	70...140 (1 В; 50 мА)	—	≤2,6	≤7**	—	ТО-92
KSC853Y	Si, n-p-n, Э	400	—	70	5	200	≤0,1 (45 В)	120...240 (1 В; 50 мА)	—	≤2,6	≤7**	—	ТО-92
KSD227O	Si, n-p-n, Э	400	—	30	5	300	≤0,1 (25 В)	70...140 (1 В; 50 мА)	—	≤1,3	—	—	ТО-92
KSD227Y	Si, n-p-n, Э	400	—	30	5	300	≤0,1 (25 В)	120...240 (1 В; 50 мА)	—	≤1,3	—	—	ТО-92
ГТ310А	Ge, p-n-p, CD	20 (35°C)	≥160	12	—	10	≤5 (5 В)	20...70* (5 В; 1 мА)	≤4 (5 В)	—	≤3 (1,6 МГц)	≤300	7
ГТ310Б	Ge, p-n-p, CD	20 (35°C)	≥160	12	—	10	≤5 (5 В)	60...180* (5 В; 1 мА)	≤4 (5 В)	—	≤3 (1,6 МГц)	≤300	7
ГТ310В	Ge, p-n-p, CD	20 (35°C)	≥120	12	—	10	≤5 (5 В)	20...70* (5 В; 1 мА)	≤5 (5 В)	—	≤4 (1,6 МГц)	≤300	7
ГТ310Г	Ge, p-n-p, CD	20 (35°C)	≥120	12	—	10	≤5 (5 В)	60...180* (5 В; 1 мА)	≤5 (5 В)	—	≤4 (1,6 МГц)	≤300	7
ГТ310Д	Ge, p-n-p, CD	20 (35°C)	≥80	12	—	10	≤5 (5 В)	20...70* (5 В; 1 мА)	≤5 (5 В)	—	≤4 (1,6 МГц)	≤500	7
ГТ310Е	Ge, p-n-p, CD	20 (35°C)	≥80	12	—	10	≤5 (5 В)	60...180* (5 В; 1 мА)	≤5 (5 В)	—	≤4 (1,6 МГц)	≤500	7
2N128	Ge, p-n-p, D	25	≥40	10	10	5	≤3 (3 В)	≥19 (3 В; 0,5 мА)	≤5	3,5	—	—	ТО-24
2SA107	Ge, p-n-p, D	35	20	6	1	10	10	40 (3 В; 1 мА)	—	—	—	—	ТО-44
2SA106	Ge, p-n-p, D	35	30	6	1	10	10	50 (3 В; 1 мА)	—	—	—	—	ТО-44
2SA105	Ge, p-n-p, D	35	75	6	1	10	10	50 (3 В; 1 мА)	—	—	—	—	ТО-44
2SA116	Ge, p-n-p, D	50	120*	30	1	20	10	70 (12 В; 1 мА)	2	—	—	—	ТО-44
2SA117	Ge, p-n-p, D	50	110*	30	1	20	10	75 (12 В; 1 мА)	2	—	—	—	ТО-44
2SA118	Ge, p-n-p, D	50	100*	30	1	20	10	75 (12 В; 1 мА)	2	—	—	—	ТО-44
2SA260	Ge, p-n-p, D	40	200	20	0,4	5	15	10 (6 В; 2 мА)	1,5	—	—	—	ТО-17
2N503	Ge, p-n-p, CD	25 (45°C)	≥168	20	0,5	50	100	45 (10 В; 2 мА)	≤2	—	—	≤120	ТО-9
ГТ322А	Ge, p-n-p, CD	50	≥80	25	0,25	10	≤4 (25 В)	30...100 (5 В; 1 мА)	≤1,8 (5 В)	—	≤4 (1,6 МГц)	≤50	8а
ГТ322Б	Ge, p-n-p, CD	50	≥80	25	0,25	10	≤4 (25 В)	50...120 (5 В; 1 мА)	≤1,8 (5 В)	—	≤4 (1,6 МГц)	≤100	8а
ГТ322В	Ge, p-n-p, CD	50	≥80	25	0,25	10	≤4 (25 В)	20...120 (5 В; 1 мА)	≤2,5 (5 В)	—	≤4 (1,6 МГц)	≤200	8а
2SA338	Ge, p-n-p, D	50	20	20	0,5	5	16	30 (6 В; 1 мА)	2,5	—	—	—	R-18
2SA321	Ge, p-n-p, D	50	25	20	0,5	10	12	40 (6 В; 1 мА)	3	—	—	—	ТО-44
2SA322	Ge, p-n-p, D	50	30	20	0,5	10	12	40 (6 В; 1 мА)	3	—	—	—	ТО-44
2SA339	Ge, p-n-p, D	50	30	20	0,5	5	16	60 (6 В; 1 мА)	2,5	—	—	—	R-18

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^*_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, мкА	$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$К_ш$, дБ, $r^*_б$, $r^{**}_{бэ\,нас}$, Ом	$τ_к$, пс, $t^*_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
2SA219	Ge, p-n-p, D	50	40	20	0,5	10	12	50 (6 В; 1 мА)	2,5	—	—	—	TO-44
2SA221	Ge, p-n-p, D	50	50	20	0,5	10	12	75 (6 В; 1 мА)	2,5	—	—	—	TO-44
2SA223	Ge, p-n-p, D	50	64	20	0,5	10	12	50 (6 В; 1 мА)	2,5	—	—	—	TO-44
2SA259	Ge, p-n-p, D	55	30	20	0,5	10	10	45 (6 В; 1 мА)	2,2	—	—	—	R-18
2SA258	Ge, p-n-p, D	55	40	20	0,5	10	10	45 (6 В; 1 мА)	2,2	—	—	—	R-18
2SA257	Ge, p-n-p, D	55	50	20	0,5	10	10	45 (6 В; 1 мА)	2,2	—	—	—	R-18
2SA256	Ge, p-n-p, D	55	60	20	0,5	10	10	75 (6 В; 1 мА)	≤3	—	—	—	R-18
2SA101	Ge, p-n-p, D	60	15	40	0,5	10	16	30 (6 В; 1 мА)	4	—	—	—	TO-1
2SA102	Ge, p-n-p, D	60	25	40	0,5	10	16	40 (6 В; 1 мА)	4	—	—	—	TO-1
2SA103	Ge, p-n-p, D	60	35	40	0,5	10	16	50 (6 В; 1 мА)	4	—	—	—	TO-72
2SA104	Ge, p-n-p, D	60	50	40	0,5	10	16	100 (6 В; 1 мА)	4	—	—	—	TO-1
2SA340	Ge, p-n-p, D	63	70	20	0,5	10	13	100 (6 В; 1 мА)	1,5	—	—	—	TO-72
2SA341	Ge, p-n-p, CD	63	70	20	0,5	10	13	100 (6 В; 1 мА)	1,5	—	—	—	TO-72
2SA342	Ge, p-n-p, CD	63	100	20	0,5	10	13	100 (6 В; 1 мА)	1,5	—	—	—	TO-72
2N990	Ge, p-n-p, CD	67	≥44	20	1	10	8	40 (6 В; 1 мА)	≤4	—	—	—	TO-72
2N991	Ge, p-n-p, CD	67	≥44	20	1	10	8	40 (6 В; 1 мА)	≤4	—	—	—	TO-72
2N993	Ge, p-n-p, CD	67	≥44	20	1	10	8	40 (6 В; 1 мА)	≤2,5	—	—	—	TO-72
AF271	Ge, p-n-p, CD	55	30	20	0,5	10	≤10 (20 В)	20 (6 В; 1 мА)	≤3,5 (6 В)	—	—	—	TO-18
AF272	Ge, p-n-p, CD	55	35	20	0,5	10	≤10 (20 В)	40 (6 В; 1 мА)	≤3,5 (6 В)	—	—	—	TO-18
AF275	Ge, p-n-p, CD	55	35	20	0,5	10	≤10 (20 В)	20...300 (6 В; 1 мА)	≤3,5 (6 В)	—	—	—	TO-18
OC169	Ge, p-n-p, CD	50 (45°C)	30	20	0,4	10	≤13 (6 В)	20...300 (6 В; 1 мА)	—	—	≤8 (450 кГц)	—	TO-7
GF514	Ge, p-n-p, CD	60	75	32	0,5	10	≤8 (6 В)	140 (6 В; 1 мА)	≤5 (6 В)	—	8,5 (100 кГц)	≤24	TO-72
GF515	Ge, p-n-p, CD	60	45	32	0,5	10	≤8 (6 В)	140 (6 В; 1 мА)	≤5 (6 В)	—	2 (1 МГц)	≤24	TO-72
GF516	Ge, p-n-p, CD	60	45	32	0,5	10	≤8 (6 В)	140 (6 В; 1 мА)	≤5 (6 В)	—	2 (1 МГц)	≤60	TO-72
GF517	Ge, p-n-p, CD	60	50	20	0,5	10	≤13 (6 В)	100 (6 В; 1 мА)	≤5 (6 В)	—	2 (1 МГц)	≤100	TO-72
GFY50	Ge, p-n-p, CD	50	≥30	20	1	10	≤16 (6 В)	20...420 (6 В; 1 мА)	≤5 (6 В)	—	≤8 (1 МГц)	—	TO-7
2N987	Ge, p-n-p, CD	86	100	40	1	10	8	100 (6 В; 1 мА)	14	—	—	—	R-38
AF426	Ge, p-n-p, CD	50	≥40	20	1	10	—	30...300 (6 В; 1 мА)	4 (6 В)	—	3 (0,5 МГц)	—	TO-18

Заказ № 1141

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\ max}$, $P^{*}_{K,\ т\ max}$, $P^{**}_{K,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^{*}_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ проб}$, В	$I_{K\ max}$, $I^{*}_{K,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, мкА	$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{кэ\ нас}$, Ом	$К_ш$, дБ, $r^{*}_б$, $r^{**}_{бэ\ нас}$, Ом	$\tau_к$, пс, $t^{*}_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
AF427	Ge, p-n-p, CD	50	⩾40	20	1	10	—	30...300 (6 В; 1 мА)	4,5 (6 В)	—	3 (0,5 МГц)	—	ТО-18
AF428	Ge, p-n-p, CD	50	⩾40	20	1	10	—	30...300 (6 В; 1 мА)	⩽8 (6 В)	—	3 (0,5 МГц)	—	ТО-18
AF429	Ge, p-n-p, CD	50	⩾30	20	1	10	—	30...300 (6 В; 1 мА)	⩽10 (6 В)	—	3 (0,5 МГц)	—	ТО-18
AF430	Ge, p-n-p, CD	50	⩾30	15	1	10	—	20...300 (6 В; 1 мА)	⩽12 (6 В)	—	3 (0,5 МГц)	—	ТО-18
2SA72	Ge, p-n-p, CD	55	40*	18	0,5	5	⩽12 (18 В)	⩾20 (6 В; 1 мА)	1,9 (6 В)	—	40*	—	ТО-44
2SA73	Ge, p-n-p, CD	55	35*	18	0,5	5	⩽12 (18 В)	⩾20 (6 В; 1 мА)	2 (4,5 В)	—	—	—	ТО-44
2SA92	Ge, p-n-p, CD	55	50*	18	0,5	5	⩽12 (18 В)	70 (4,5 В; 1 мА)	2 (4,5 В)	—	—	—	ТО-44
2SA93	Ge, p-n-p, CD	55	45*	18	0,5	5	⩽12 (18 В)	49 (4,5 В; 1 мА)	2 (4,5 В)	—	—	—	ТО-44
2SA58	Ge, p-n-p, CD	55	75*	18	0,5	5	⩽12 (18 В)	80 (9 В; 1 мА)	1,9 (6 В)	—	—	—	ТО-44
2SA60	Ge, p-n-p, CD	55	55*	18	0,5	5	⩽12 (18 В)	70 (6 В; 1 мА)	1,9 (6 В)	—	—	—	ТО-44
2SA236	Ge, p-n-p, CD	55	35*	18	0,5	5	⩽12 (18 В)	50 (6 В; 1 мА)	⩽2,5 (6 В)	—	—	—	ТО-44
2SA237	Ge, p-n-p, CD	55	35*	18	0,5	5	⩽12 (18 В)	50 (6 В; 1 мА)	⩽3,5 (6 В)	—	—	—	ТО-44
2SA285	Ge, p-n-p, D	50	⩾25*	18	0,5	5	⩽15 (18 В)	18...300 (6 В; 1 мА)	2 (6 В)	—	—	—	ТО-44
2SA286	Ge, p-n-p, D	50	⩾30*	18	0,5	5	⩽15 (18 В)	44...146 (6 В; 1 мА)	2 (6 В)	—	—	—	ТО-44
2SA287	Ge, p-n-p, D	50	60	18	0,5	5	⩽15 (18 В)	44...146 (6 В; 1 мА)	2 (6 В)	—	—	—	ТО-44
П417	Ge, p-n-p, DC	50	⩾200***	8**	0,7	10	⩽3 (10 В)	24...100 (5 В; 5 мА)	⩽5 (5 В)	—	—	⩽400	9
П417А	Ge, p-n-p, DC	50	⩾200***	8**	0,7	10	⩽3 (10 В)	65...200 (5 В; 5 мА)	⩽5 (5 В)	—	—	⩽400	9
П417Б	Ge, p-n-p, DC	50	⩾200***	8**	0,7	10	⩽3 (10 В)	75...250 (5 В; 5 мА)	⩽6 (6 В)	—	—	⩽400	9
2N1726	Ge, p-n-p, M	60	⩾100***	20	1	50	10	⩾50 (6 В; 1 мА)	⩽2,5	—	—	⩽100	ТО-9
2N1727	Ge, p-n-p, M	60	⩾100***	20	0,5	50	10	⩾20 (6 В; 1 мА)	⩽2,5	—	—	—	ТО-9
2N1728	Ge, p-n-p, M	60	⩾100***	20	0,5	50	10	⩾40 (6 В; 1 мА)	⩽2,5	—	—	—	ТО-9
2N1864	Ge, p-n-p, M	60	⩾50***	20	0,5	50	10	⩾10 (6 В; 1 мА)	⩽2,5	—	—	⩽100	ТО-9
2N1746	Ge, p-n-p, M	60	⩾100***	20	0,5	50	10	60 (6 В; 1 мА)	⩽3	—	—	⩽100	ТО-9
2N1747	Ge, p-n-p, M	60	⩾180***	20	0,5	50	10	60 (6 В; 1 мА)	⩽3	—	—	—	ТО-9
2N1752	Ge, p-n-p, MD	60	⩾50***	12	0,5	50	10	⩾30 (6 В; 1 мА)	⩽3	—	—	—	ТО-9
2N1785	Ge, p-n-p, M	45	⩾50***	10	1	50	10	⩾40 (6 В; 1 мА)	⩽3	—	—	⩽100	ТО-9

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^{*}_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^{*}_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^{*}_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, мкА	$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_{к}$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$К_{ш}$, дБ, $r^{*}_{б}$, $r^{**}_{бэ\,нас}$, Ом	$\tau_{к}$, пс, $t^{*}_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
2N1786	Ge, p-n-p, M	45	≥50***	10	0,5	50	10	≥15 (6 В; 1 мА)	≤3	—	—	≤100	TO-9
2N1787	Ge, p-n-p, M	45	≥50***	15	0,5	50	10	≥25 (6 В; 1 мА)	≤3	—	—	≤100	TO-9
2N1865	Ge, p-n-p, M	60	≥180***	20	0,5	50	10	70 (6 В; 1 мА)	≤3	—	—	—	TO-9
ГТ309А	Ge, p-n-p, CD	75	≥120	10* (10 к)	1,5	10	≤5 (5 В)	20...70 (5 В; 1 мА)	≤7,5 (5 В)	—	—	≤500	13
ГТ309Б	Ge, p-n-p, CD	75	≥120	10* (10 к)	1,5	10	≤5 (5 В)	60...180 (5 В; 1 мА)	≤7,5 (5 В)	—	≤6 (1,6 МГц)	≤500	13
ГТ309В	Ge, p-n-p, CD	75	≥80	10* (10 к)	1,5	10	≤5 (5 В)	20...70 (5 В; 1 мА)	≤7,5 (5 В)	—	≤6 (1,6 МГц)	≤1000	13
ГТ309Г	Ge, p-n-p, CD	75	≥80	10* (10 к)	1,5	10	≤5 (5 В)	60...180 (5 В; 1 мА)	≤7,5 (5 В)	—	—	≤1000	13
ГТ309Д	Ge, p-n-p, CD	75	≥80	10* (10 к)	1,5	10	≤5 (5 В)	20...70 (5 В; 1 мА)	≤7,5 (5 В)	—	—	≤1000	13
ГТ309Е	Ge, p-n-p, CD	75	≥80	10* (10 к)	1,5	10	≤5 (5 В)	60...180 (5 В; 1 мА)	≤7,5 (5 В)	—	—	≤1000	13
AF178	Ge, p-n-p, CD	75	180	25	0,5	10	50	≥20 (12 В; 1 мА)	≤7,5	—	—	—	TO-12
2SA234	Ge, p-n-p, M	80	120*	20	0,5	10	≤15 (20 В)	30...135 (6 В; 1 мА)	≤3 (6 В)	—	—	—	TO-44
2SA235	Ge, p-n-p, M	80	135*	20	0,5	10	≤15 (20 В)	30...135 (6 В; 1 мА)	≤3 (6 В)	—	—	—	TO-44
OC170	Ge, p-n-p, CD	80	75	20	0,5	10	8	150 (6 В; 1 мА)	5	—	—	—	TO-7
OC171	Ge, p-n-p, CD	80	75	20	0,5	10	8	150 (6 В; 1 мА)	2,5	—	—	—	TO-7
2SA272	Ge, p-n-p, D	80	20	9	0,5	10	10	45 (6 В; 1 мА)	3	—	—	—	TO-1
2SA269	Ge, p-n-p, D	80	30	20	0,5	10	10	45 (6 В; 1 мА)	2,2	—	—	—	TO-1
2SA271	Ge, p-n-p, D	80	30	9	0,5	10	10	60 (6 В; 1 мА)	3	—	—	—	TO-1
2SA268	Ge, p-n-p, D	80	40	20	0,5	10	10	45 (6 В; 1 мА)	2,2	—	—	—	TO-1
2SA267	Ge, p-n-p, D	80	50	20	0,5	10	10	60 (6 В; 1 мА)	2,2	—	—	—	TO-1
2SA270	Ge, p-n-p, D	80	50	9	0,5	10	10	75 (6 В; 1 мА)	3	—	—	—	TO-1
2SA266	Ge, p-n-p, D	80	60	20	0,5	10	10	75 (6 В; 1 мА)	2,2	—	—	—	TO-1
2SA400	Ge, p-n-p, D	80	70	20	0,5	10	10	70 (6 В; 1 мА)	2,3	—	—	—	TO-1
AFZ11	Ge, p-n-p, CD	83	140	20	0,5	10	50	70 (6 В; 1 мА)	2	—	—	—	TO-72
2SA343	Ge, p-n-p, CD	83	150*	20	0,4	5	12	100 (6 В; 1 мА)	1,5	—	—	—	TO-7
GF126	Ge, p-n-p, CD	83	≥40	25	0,5	10	≤7,5 (6 В)	—	—	—	—	—	A-3
GF128	Ge, p-n-p, CD	83	≥100	25	0,5	10	≤7,5 (6 В)	—	—	—	—	—	A-3
GF130	Ge, p-n-p, CD	83	≥27,5	25	0,5	10	≤7,5 (6 В)	—	—	—	—	—	A-3

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^*_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, мкА	$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$К_ш$, дБ, $r^*_б$, $r^{**}_{бэ\,нас}$, Ом	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
2SA69	Ge, p-n-p, CD	100	70	20	0,5	10	13	150 (6 В; 1 мА)	4	—	—	—	TO-7
2SA70	Ge, p-n-p, CD	100	70	20	0,5	10	13	150 (6 В; 1 мА)	3,5	—	—	—	TO-7
2SA71	Ge, p-n-p, CD	100	100	20	0,5	10	13	150 (6 В; 1 мА)	2,5	—	—	—	TO-7
ГТ305А	Ge, p-n-p, D	75	⩾140	15	1,5	40 (100*)	—	25...80* (1 В; 10 мА)	⩽7 (5 В)	⩽50	—	⩽500 ⩽3000*	13
ГТ305Б	Ge, p-n-p, D	75	⩾160	15	1,5	40 (100*)	—	60...180* (1 В; 10 мА)	⩽7 (5 В)	⩽50	—	⩽500	13
ГТ305В	Ge, p-n-p, D	75	⩾160	15	1,5	40 (100*)	⩽4 (15 В)	40...120* (5 В; 5 мА)	⩽5,5 (5 В)	—	⩽6 (1,6 МГц)	⩽300	13
AFY13	Ge, p-n-p, D	60 (45°C)	50	25	0,7	50	2,5 (6 В)	125* (6 В; 1 мА)	—	—	7	—	TO-18
AFY29	Ge, p-n-p, D	60 (45°C)	35	25	0,7	50	3 (6 В)	83* (6 В; 1 мА)	—	—	—	—	TO-18
2N2199	Ge, p-n-p, D	75	⩾120	15	0,5	100	5	⩾20 (10 В; 3 мА)	⩽2,8	—	—	—	TO-9
2N2200	Ge, p-n-p, D	75	⩾120	15	0,5	100	5	⩾70 (10 В; 3 мА)	⩽2,8	—	—	—	TO-9
2SA246	Ge, p-n-p, M	100	155	30	0,5	30	30 (30 В)	70 (6 В; 5 мА)	2,5	—	—	—	TO-44
2N2273	Ge, p-n-p, M	100	⩾200	25	1	100	⩽100	⩾20* (10 В; 1 мА)	3,5	—	—	—	TO-18
2N1499B	Ge, p-n-p, CD	75	⩾150	30	2	100	3	⩾40* (0,3 В; 10 мА)	⩽3	⩽15	—	120*	TO-9
2N501	Ge, p-n-p, MD	60	120	15	2	50	⩽100	30* (1 В; 10 мА)	5	⩽20	—	—	TO-1
2N1499A	Ge, p-n-p, MD	60	100	20	0,5	100	25	50* (0,5 В; 40 мА)	1,5	⩽25	—	—	TO-9
2N499A	Ge, p-n-p, MD	60	120	30	0,5	50	5	20...80 (9 В; 1 мА)	⩽2,5	—	—	⩽250	TO-1
2N1748	Ge, p-n-p, M	60	132	25	1	50	10	70 (6 В; 1 мА)	1,3	—	—	—	TO-9
2N1745	Ge, p-n-p, MD	60	200	20	0,5	50	10	60* (6 В; 1 мА)	1,5	—	—	—	TO-9
2N979	Ge, p-n-p, MD	60	⩾100	20	2	100	⩽3	⩾30* (0,3 В; 10 мА)	⩽3	⩽20	—	—	TO-18
2N980	Ge, p-n-p, MD	60	100	20	2	100	⩽5	⩾30* (0,3 В; 10 мА)	⩽3	⩽20	—	—	TO-18
2N1500	Ge, p-n-p, MD	60	175	15	2	50	⩽5	⩾20* (0,5 В; 10 мА)	⩽3	⩽20	—	—	TO-9
2N1754	Ge, p-n-p, MD	50	150	13	2	50	⩽5	⩾20* (0,5 В; 10 мА)	⩽3	⩽20	—	—	TO-9
П422	Ge, p-n-p, CD	100	⩾50	10* (1 к)	—	20	⩽5 (5 В)	24...100 (5 В; 1 мА)	⩽10 (5 В)	—	⩽10 (1,6 МГц)	⩽1000	10
П423	Ge, p-n-p, CD	100	⩾100	10* (1 к)	—	20	⩽5 (5 В)	24...100 (5 В; 1 мА)	⩽10 (5 В)	—	⩽10 (1,6 МГц)	⩽500	10
2SA109	Ge, p-n-p, D	80	30*	20	—	10	20	60 (9 В; 1 мА)	1,7	—	—	—	TO-44
2SA110	Ge, p-n-p, D	80	30*	20	—	10	20	60 (9 В; 1 мА)	1,7	—	—	—	TO-44
2SA111	Ge, p-n-p, D	80	20*	20	—	10	20	40 (9 В; 1 мА)	1,7	—	—	—	TO-44

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^{*}_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^{*}_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^{*}_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, мкА	$h_{21э}$, $h_{21Э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$K_ш$ дБ, $r^{*}_б$, $r^{**}_{бэ\,нас}$, Ом	$\tau_к$, пс, $t^{*}_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
2SA112	Ge, p-n-p, D	80	20*	20	—	10	20	45 (9 В; 1 мА)	1,7	—	—	—	TO-44
2SA354	Ge, p-n-p, D	80	30	25	0,5	10	10	70 (9 В; 1 мА)	2,5	—	—	—	TO-1
2SA355	Ge, p-n-p, D	80	30	25	0,5	10	10	90 (9 В 1 мА)	2,5	—	—	—	TO-1
2N1524	Ge, p-n-p, D	80	33	24	0,5	10	16	⩾17 (6 В; 1 мА)	3,6	—	—	—	TO-1
2N1526	Ge, p-n-p, D	80	33	24	0,5	10	16	⩾27 (5,7 В; 1 мА)	—	—	—	—	TO-1
2SA350	Ge, p-n-p, D	80	45*	20	0,5	10	⩽5 (12 В)	50...200 (9 В; 1 мА)	3,2	—	—	—	TO-1
2SA351	Ge, p-n-p, D	80	45*	20	0,5	10	10	70 (9 В; 1 мА)	3,2	—	—	—	TO-1
2SA352	Ge, p-n-p, D	80	45*	20	0,5	10	10	75 (9 В; 1 мА)	3,2	—	—	—	TO-1
2SA108	Ge, p-n-p, D	80	45	20	0,5	10	20	70 (9 В; 1 мА)	1,7	—	—	—	TO-44
SFT316	Ge, p-n-p, D	120	70	20	0,5	10	15	120 (6 В; 1 мА)	1,8	—	—	—	TO-44
SFT354	Ge, p-n-p, D	120	87	20	0,5	10	15	120 (6 В; 1 мА)	1,8	—	—	—	TO-44
SFT357	Ge, p-n-p, D	120	85	20	0,5	10	15	120 (6 В; 1 мА)	1,8	—	—	—	TO-44
SFT163	Ge, p-n-p, D	120	⩾120	15	0,5	10	15	⩾70 (12 В; 5 мА)	3	—	—	—	TO-44
SFT358	Ge, p-n-p, D	120	110	20	0,5	10	15	120 (6 В; 1 мА)	1,8	—	—	—	TO-44
П416	Ge, p-n-p, D	100 (360*)	⩾40	12* (1 к)	3	25 (120*)	⩽3 (10 В)	20...80 (5 В; 5 мА)	⩽8 (5 В)	⩽40	—	⩽500 ⩽1000*	10
П416А	Ge, p-n-p, D	100 (360*)	⩾60	12* (1 к)	3	25 (120*)	⩽3 (10 В)	60...120 (5 В; 5 мА)	⩽8 (5 В)	⩽40	—	⩽500 ⩽1000*	10
П416Б	Ge, p-n-p, D	100 (360*)	⩾80	12* (1 к)	3	25 (120*)	⩽3 (10 В)	90...250 (5 В; 5 мА)	⩽8 (5 В)	⩽40	—	⩽500 ⩽1000*	10
2N602	Ge, p-n-p, D	120	20	20	1	10	8	⩾20 (1 В; 0,5 мА)	4	—	—	—	TO-5
2N603	Ge, p-n-p, D	120	40	30	1	10	8	⩾30 (1 В; 0,5 мА)	3	—	—	—	TO-5
2N604	Ge, p-n-p, D	120	60	30	2	10	8	⩾40 (1 В; 0,5 мА)	3	—	—	—	TO-5
2SA279	Ge, p-n-p, CD	120	80	30	0,5	30	6	100 (2 В; 10 мА)	3,5	—	—	—	TO-7
SFT319	Ge, p-n-p, CD	150	20	20	0,5	10	15	50 (9 В; 1 мА)	2,5	—	—	—	TO-1
SFT320	Ge, p-n-p, CD	150	35	20	0,5	10	15	80 (9 В; 1 мА)	2,5	—	—	—	TO-1
П401	Ge, p-n-p, CD	100	⩾30	10* (1 к)	1	20	⩽10 (5 В)	16...300 (5 В; 5 мА)	⩽15 (5 В)	—	—	⩽3500	10
П402	Ge, p-n-p, CD	100	⩾50	10* (1 к)	1	20	⩽5 (5 В)	16...250 (5 В; 5 мА)	⩽10 (5 В)	—	—	⩽1000	10
П403	Ge, p-n-p, CD	100	⩾100	10* (1 к)	1	20	⩽5 (5 В)	30...100 (5 В; 5 мА)	⩽10 (5 В)	—	—	⩽500	10
П403А	Ge, p-n-p, CD	100	⩾80	10* (1 к)	1	20	⩽5 (5 В)	16...200 (5 В; 5 мА)	⩽10 (5 В)	—	—	⩽500	10
T358H	Ge, p-n-p, D	120	⩾85	32	1	10	⩽15 (15 В)	60...350 (6 В; 1 мА)	⩽30 (6 В)	—	—	—	TO-1
EFT317	Ge, p-n-p, CD	150	40	20	0,5	10	⩽20 (15 В)	35...220 (9 В; 1 мА)	2,5 (9 В)	—	—	—	TO-1

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\ max}$, $P^*_{K,\ т\ max}$, $P^{**}_{K,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^*_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ проб}$, В	$I_{K\ max}$, $I^*_{K,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, мкА	$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{кэ\ нас}$, Ом	$К_ш$, дБ, $r^*_б$, $r^{**}_{бэ\ нас}$, Ом	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
EFT319	Ge, p-n-p, CD	150	35	20	0,5	10	≤20 (15 В)	20...500 (9 В; 1 мА)	2,5 (9 В)	—	—	—	ТО-1
EFT320	Ge, p-n-p, CD	150	35	20	0,5	10	≤20 (15 В)	35...220 (9 В; 1 мА)	2,5 (9 В)	—	—	—	ТО-1
T316H	Ge, p-n-p, D	120	≥50	32	1	10	≤15 (5 В)	40...350 (6 В; 1 мА)	≤5 (6 В)	—	—	—	ТО-1
T354H	Ge, p-n-p, D	120	≥60	32	1	10	≤15 (5 В)	40...350 (6 В; 1 мА)	≤5 (6 В)	—	—	—	ТО-1
T317	Ge, p-n-p, D	150	≥25	20	0,5	10	≤15 (5 В)	35...200 (6 В; 1 мА)	≤5 (6 В)	—	—	—	ТО-1
T319	Ge, p-n-p, D	150	≥15	20	0,5	10	≤15 (5 В)	20...350 (6 В; 1 мА)	≤5 (6 В)	—	—	—	ТО-1
T320	Ge, p-n-p, D	150	≥20	20	0,5	10	≤15 (5 В)	35...200 (6 В; 1 мА)	≤5 (6 В)	—	—	—	ТО-1
T357H	Ge, p-n-p, D	120	≥70	20	0,5	10	≤15 (5 В)	60...350 (6 В; 1 мА)	≤5 (6 В)	—	—	—	ТО-1
2N2089	Ge, p-n-p, CD	100	≥44	20	1	11	≤8 (15 В)	≥40 (6 В; 1 мА)	≤4 (6 В)	—	—	—	ТО-7
ГТ308А	Ge, p-n-p, CD	150 (360**)	≥90	20	3	50 (120*)	≤2 (5 В)	20...75* (1 В; 10 мА)	≤8 (5 В)	≤30	—	≤400 ≤1000*	10
ГТ308Б	Ge, p-n-p, CD	150 (360**)	≥120	20	3	50 (120*)	≤2 (5 В)	50...120* (1 В; 10 мА)	≤8 (5 В)	≤24	—	≤400 ≤1000*	10
ГТ308В	Ge, p-n-p, CD	150 (360**)	≥120	20	3	50 (120*)	≤2 (5 В)	80...200* (1 В; 10 мА)	≤8 (5 В)	≤24	≤8 (1,6 МГц)	≤500 ≤1000*	10
2N1854	Ge, p-n-p, D	150	≥40	18	2	100	4,2	≥40 (0,5 В; 2 мА)	≤12	—	—	—	ТО-5
2N794	Ge, p-n-p, M	150	≥25	13	1	100	≤3 (6 В)	≥30* (0,3 В; 10 мА)	≤12 (6 В)	—	—	140*	ТО-18
2N795	Ge, p-n-p, M	150	≥35	13	4	100	≤3 (6 В)	≥30* (0,3 В; 10 мА)	≤12 (6 В)	—	—	120*	ТО-18
2N796	Ge, p-n-p, M	150	≥50	13	4	100	≤3 (6 В)	≥50* (0,3 В; 10 мА)	≤12 (6 В)	—	—	80*	ТО-18
2N1300	Ge, p-n-p, M	150	≥25	13	1	100	≤3 (6 В)	≥30* (0,3 В; 10 мА)	≤12 (6 В)	—	—	140*	ТО-5
2N1301	Ge, p-n-p, M	150	≥35	13	4	100	≤3 (6 В)	≥30* (0,3 В; 10 мА)	≤12 (6 В)	—	—	120*	ТО-5
2N1683	Ge, p-n-p, M	150	≥50	13	4	100	≤3 (6 В)	≥50* (0,3 В; 10 мА)	≤12 (6 В)	—	—	≤440*	ТО-5
2N2048	Ge, p-n-p, CD	150	≥150	20	2	100	5	≥50* (0,5 В; 10 мА)	≤3	≤4	—	—	ТО-9
2N2048A	Ge, p-n-p, CD	150	≥150	30	2,5	100	3	≥40* (0,5 В; 50 мА)	≤3	≤4	—	120	ТО-9
2N2400	Ge, p-n-p, CD	150	150	12	1	100	3	≥30* (0,5 В; 10 мА)	≤4	≤22	—	—	ТО-18
2SA412	Ge, p-n-p, M	150	≥25	13	1	100	≤3 (6 В)	≥30* (3 В; 10 мА)	≤12	—	—	60*	ТО-1
ГТ321А	Ge, p-n-p, K	160 (20** Вт)	≥60	40**	4	200 (2 А*)	≤500 (60 В)	20...60* (3 В; 0,5 А)	≤80 (10 В)	≤3,5	—	≤600 ≤1000*	10
ГТ321Б	Ge, p-n-p, K	160 (20** Вт)	≥60	40**	4	200 (2 А*)	≤500 (60 В)	40...120* (3 В; 0,5 А)	≤80 (10 В)	≤3,5	—	≤600 ≤1000*	10
ГТ321В	Ge, p-n-p, K	160 (20** Вт)	≥60	40**	4	200 (2 А*)	≤500 (60 В)	80...200* (3 В; 0,5 А)	≤80 (10 В)	≤3,5	—	≤600 ≤1000*	10
ГТ321Г	Ge, p-n-p, K	160 (20** Вт)	≥60	30**	2,5	200 (2 А*)	≤500 (45 В)	20...60* (3 В; 0,5 А)	≤80 (10 В)	≤3,5	—	≤600 ≤1000*	10

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\ max}$, $P^*_{K,\ т\ max}$, $P^{**}_{K,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^*_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ проб}$, В	$I_{K\ max}$, $I^*_{K\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, мкА	$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{кэ\ нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r^*_б$, $r^{**}_{бэ\ нас}$, Ом	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, t^{**}_{max}, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
ГТ321Д	Ge, p-n-p, К	160 (20** Вт)	⩾60	30**	2,5	200 (2 А*)	⩽500 (45 В)	40...120* (3 В; 0,5 А)	⩽80 (10 В)	⩽3,5	—	⩽600 ⩽1000*	10
ГТ321Е	Ge, p-n-p, К	160 (20** Вт)	⩾60	30**	2,5	200 (2 А*)	⩽500 (45 В)	80...200* (3 В; 0,5 А)	⩽80 (10 В)	⩽3,5	—	⩽600 ⩽1000*	10
2N1204	Ge, p-n-p, М	200	⩾110	20	4	500	7	⩽15* (1,5 В; 0,4 А)	8	⩽2,5	—	—	ТО-39
2N1204А	Ge, p-n-p, М	200	⩾110	20	4	500	7	⩾25* (0,5 В; 0,2 А)	8	⩽2	—	—	ТО-39
2N1494	Ge, p-n-p, CD	400	⩾110	20	4	500	7	⩽15* (1,5 В; 0,4 А)	8	⩽2	—	—	ТО-31
2N1494А	Ge, p-n-p, CD	400	⩾110	20	4	500	7	⩾25* (0,5 В; 0,2 А)	8	⩽2	—	—	ТО-31
2SA78	Ge, p-n-p, CD	125	⩾25*	40	2	400	⩽8 (2 В)	30...150* (1 В; 0,4 А)	—	6	—	85*	ТО-44
2N1384	Ge, p-n-p, CD	240	35*	30	1	500	50	50* (0,5 В; 0,2 А)	—	—	—	⩽250*	ТО-11
ГТ320А	Ge, p-n-p, D	200	⩾80	20	3	150 (300*)	⩽10 (20 В)	20...80* (1 В; 10 мА)	⩽8 (5 В)	⩽8,5	—	⩽500 ⩽400*	10
ГТ320Б	Ge, p-n-p, D	200	⩾120	20	3	150 (300*)	⩽10 (20 В)	50...160* (1 В; 10 мА)	⩽8 (5 В)	⩽8,5	—	⩽500 ⩽500*	10
ГТ320В	Ge, p-n-p, D	200	⩾160	20	3	150 (300*)	⩽10 (20 В)	80...250* (1 В; 10 мА)	⩽8 (5 В)	⩽8,5	—	⩽600 ⩽600*	10
2N711	Ge, p-n-p, М	150	⩾150	12	1	50	⩽100 (12 В)	⩾20* (0,5 В; 10 мА)	⩽6 (5 В)	⩽50	—	⩽120*	ТО-18
2N711А	Ge, p-n-p, М	150	⩾110	15	1,5	100	⩽100 (14 В)	25...150* (0,5 В; 10 мА)	⩽6 (5 В)	⩽11	—	⩽100*	ТО-18
2N711В	Ge, p-n-p, М	150	⩾120	18	2	100	⩽20 (15 В)	30...150* (0,5 В; 10 мА)	⩽5 (10 В)	⩽9	—	⩽200*	ТО-18
2N705	Ge, p-n-p, М	150	300	15	3,5	50	⩽3 (5 В)	⩾25* (0,3 В; 10 мА)	⩽5 (10 В)	⩽30	—	⩽100*	ТО-18
2N710	Ge, p-n-p, М	150	300	15	2	50	⩽3 (5 В)	⩾25 (0,5 В; 10 мА)	⩽5 (10 В)	⩽50	—	⩽100*	ТО-18
2N3883	Ge, p-n-p, D	300	⩾100	25	3	250	⩽100 (25 В)	⩾30* (1 В; 0,2 А)	⩽8 (10 В)	⩽2,5	—	⩽70*	ТО-5
2N2635	Ge, p-n-p, М	150	⩾150	30	2,5	100	⩽5 (20 В)	⩾30* (0,5 В; 10 мА)	⩽5 (5 В)	⩽8	—	⩽185*	ТО-18
ГТ313А	Ge, p-n-p, CD	100	⩾300	15	0,7	30	⩽5 (12 В)	20...250 (5 В; 5 мА)	⩽2,5 (5 В)	⩽4,6	—	⩽75	11
ГТ313Б	Ge, p-n-p, CD	100	⩾450	15	0,7	30	⩽5 (12 В)	20...250 (5 В; 5 мА)	⩽2,5 (5 В)	⩽4,6	—	⩽40	11
ГТ313В	Ge, p-n-p, CD	100	⩾350	15	0,7	30	⩽5 (12 В)	30...170 (5 В; 5 мА)	⩽2,5 (5 В)	⩽4,6	—	⩽75	11
2N502А	Ge, p-n-p, CD	75	⩾150	30	0,5	50	⩽5 (10 В)	⩾15* (10 В; 2 мА)	⩽1,6 (10 В)	—	⩽7 (200 МГц)	⩽50	ТО-9
2N502В	Ge, p-n-p, CD	75	⩾150	30	0,5	50	⩽5 (10 В)	20...80* (10 В; 2 мА)	⩽1,6 (10 В)	—	⩽7 (200 МГц)	⩽50	ТО-9
2N1742	Ge, p-n-p, CD	60	⩾150	20	0,5	50	⩽10 (10 В)	⩾10* (10 В; 2 мА)	1,5	—	⩽5,5 (200 МГц)	—	ТО-9

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^*_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, мкА	$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$К_ш$, дБ, $r^*_б$, $r^{**}_{бэ\,нас}$, Ом	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
2N1743	Ge, p-n-p, CD	60	⩾150	20	0,5	50	⩽10 (10 В)	⩾10* (10 В; 2 мА)	1,5	—	⩽12 (200 МГц)	—	ТО-9
AFY11	Ge, p-n-p, М	185 (560*)	⩾200	30	1	70	⩽18 (15 В)	⩾25 (6 В; 2 мА)	⩽2,8 (10 В)	—	6 (200 МГц)	⩽40	ТО-5
GF501	Ge, p-n-p, М	300	⩾300	24	0,5	100	⩽18 (15 В)	⩾10* (9 В; 10 мА)	2,1 (9 В)	—	—	⩽56	ТО-18
GF502	Ge, p-n-p, М	300	⩾300	24	0,5	100	⩽18 (15 В)	⩾10* (9 В; 10 мА)	⩽3,5 (9 В)	—	—	⩽70	ТО-18
GF503	Ge, p-n-p, М	300	⩾300	24	0,5	100	⩽18 (15 В)	⩾10* (9 В; 10 мА)	⩽3,5 (9 В)	—	—	⩽50	ТО-18
GF504	Ge, p-n-p, М	300	⩾300	28	0,5	100	⩽18 (15 В)	⩾10* (9 В; 10 мА)	⩽3,5 (9 В)	—	—	⩽70	ТО-18
2N700	Ge, p-n-p, М	75	⩾500	25	0,2	50	⩽2 (6 В)	⩾4 (6 В; 2 мА)	⩽1,5 (6 В)	—	⩽10 (70 МГц)	—	ТО-72
2N741	Ge, p-n-p, М	150	⩾360	15	1	100	3	⩾10 (6 В; 5 мА)	6	—	7 (30 МГц)	—	ТО-18
2N741A	Ge, p-n-p, М	150	⩾300	20	1	100	3	⩾10 (6 В; 5 мА)	6	—	7 (30 МГц)	—	ТО-18
2SA440	Ge, p-n-p, М	60	350	20	0,4	5	⩽20 (20 В)	80 (6 В; 3 мА)	1,7 (6 В)	—	—	40	R-146
2SA229	Ge, p-n-p, М	75	400	20	0,2	5	⩽10 (12 В)	10 (6 В; 2 мА)	⩽1,5 (6 В)	—	—	⩽150	ТО-17
2SA230	Ge, p-n-p, М	75	400	20	0,2	5	⩽10 (12 В)	10 (6 В; 2 мА)	⩽1,5 (6 В)	—	—	⩽150	ТО-17
ГТ328А	Ge, p-n-p, ПЭ	50 (55°C)	⩾400	15* (5 к)	0,25	10	⩽10 (15 В)	20...200* (5 В; 3 мА)	⩽1,5 (5 В)	—	⩽7 (180 МГц)	⩽5	8а
ГТ328Б	Ge, p-n-p, ПЭ	50 (55°C)	⩾300	15* (5 к)	0,25	10	⩽10 (15 В)	40...200* (5 В; 3 мА)	⩽1,5 (5 В)	—	⩽7 (180 МГц)	⩽10	8а
ГТ328В	Ge, p-n-p, ПЭ	50 (55°C)	⩾300	15* (5 к)	0,25	10	⩽10 (15 В)	10...70* (5 В; 3 мА)	⩽1,5 (5 В)	—	⩽7 (180 МГц)	⩽10	8а
2N3127	Ge, p-n-p, М	100	⩾400	25	0,75	50	⩽3 (10 В)	20...100* (10 В; 3 мА)	⩽1,2 (10 В)	⩽60	⩽5 (200 МГц)	⩽12	ТО-72
2N3279	Ge, p-n-p, М	100	⩾400	30	1	50	⩽5 (10 В)	10...70* (10 В; 3 мА)	⩽1 (10 В)	⩽60	⩽3,5 (200 МГц)	⩽10	ТО-72
2N3280	Ge, p-n-p, М	100	⩾400	30	1	50	⩽5 (10 В)	10...70* (10 В; 3 мА)	⩽1,2 (10 В)	⩽60	⩽3,5 (200 МГц)	⩽10	ТО-72
2N3281	Ge, p-n-p, М	100	⩾300	30	0,5	50	⩽5 (10 В)	10...100* (10 В; 3 мА)	⩽1,2 (10 В)	⩽60	⩽5 (200 МГц)	⩽15	R-96
2N3282	Ge, p-n-p, М	100	⩾300	30	0,5	50	⩽5 (10 В)	10...100* (10 В; 3 мА)	⩽1,2 (10 В)	⩽60	⩽5 (200 МГц)	⩽15	R-96
AF106	Ge, p-n-p, М	60	220	25	0,3	10	⩽10 (12 В)	70* (6 В; 2 мА)	—	—	⩽7,5 (200 МГц)	6	ТО-72
AF106A	Ge, p-n-p, М	60	220	25	0,3	10	⩽10 (12 В)	⩾10 (12 В; 1 мА)	—	—	5,5 (200 МГц)	—	ТО-72
AF109R	Ge, p-n-p, М	60	⩾140	20	0,3	10	⩽8 (20 В)	55* (6 В; 2 мА)	—	—	⩽4,8 (200 МГц)	—	ТО-72
AFY12	Ge, p-n-p, М	60 (45°C)	230	25	0,5	10	⩽3 (12 В)	⩾30 (12 В; 1 мА)	—	—	⩽7 (200 МГц)	5	ТО-72
AF200	Ge, p-n-p, М	80 (55°C)	⩾100	25	0,3	10	⩽10 (12 В)	⩾30* (10 В; 3 мА)	—	—	—	6	ТО-72
AF201	Ge, p-n-p, М	80 (55°C)	⩾100	25	0,3	10	⩽10 (12 В)	⩾20* (10 В; 3 мА)	—	—	—	6	ТО-72
AF202	Ge, p-n-p, М	80 (55°C)	⩾100	25	0,3	30	⩽10 (12 В)	⩾20* (10 В; 3 мА)	—	—	—	6	ТО-72
AF253	Ge, p-n-p, П	90 (45°C)	550	20	0,3	10	⩽5 (12 В)	⩾10* (12 В; 2 мА)	—	—	4	—	ММ-12
AF256	Ge, p-n-p, П	90 (45°C)	⩾170	25	0,3	10	0,5 (12 В)	28* (12 В; 1 мА)	—	—	5,5	—	ММ-12
GF505	Ge, p-n-p, М	60 (45°C)	⩾170	24	0,3	10	⩽10 (12 В)	⩾25 (12 В; 1 мА)	⩽0,8 (12 В)	—	⩽7,5 (200 МГц)	⩽15	ТО-72

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^*_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, мкА	$h_{21э}$, $h_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r^*_б$, $r^{**}_{бэ\,нас}$, Ом	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
GF506	Ge, p-n-p, M	60 (45°C)	⩾170	24	0,3	10	⩽10 (12 В)	⩾10 (12 В; 1 мА)	⩽0,8 (12 В)	—	⩽7,5 (200 МГц)	⩽15	TO-72
2N3283	Ge, p-n-p, M	100	⩾250	25	0,5	50	⩽10 (10 В)	10...200* (10 В; 4 мА)	⩽1,5 (10 В)	—	⩾5 (200 МГц)	⩽25	TO-72
2N3284	Ge, p-n-p, M	100	⩾250	25	0,5	50	⩽10 (10 В)	10...200* (10 В; 3 мА)	⩽1,5 (10 В)	—	⩽6 (200 МГц)	⩽25	TO-72
2N3286	Ge, p-n-p, M	100	⩾250	25	0,5	50	⩽10 (10 В)	10...200* (10 В; 3 мА)	⩽1,5 (10 В)	—	5 (200 МГц)	⩽25	TO-72
ГТ346А	Ge, p-n-p, ПЭ	50 (55°C)	⩾700	20	0,3	10	⩽10 (20 В)	10...150 (10 В; 2 мА)	⩽1,3 (5 В)	—	⩽6 (800 МГц)	⩽3	8а
ГТ346Б	Ge, p-n-p, ПЭ	50 (55°C)	⩾550	20	0,3	10	⩽10 (20 В)	10...150 (10 В; 2 мА)	⩽1,3 (5 В)	—	⩽8 (800 МГц)	⩽5,5	8а
ГТ346В	Ge, p-n-p, ПЭ	50 (55°C)	⩾550	20	0,3	10	⩽10 (20 В)	15...150 (10 В; 2 мА)	⩽1,3 (5 В)	—	⩽7 (200 МГц)	⩽6	8а
AF139	Ge, p-n-p, M	60 (45°C)	550	20	0,3	10	⩽8 (20 В)	⩾10* (12 В; 1,5 мА)	⩽1,5 ((12 В)	—	⩽8,2 (800 МГц)	⩽8	TO-72
AF239	Ge, p-n-p, M	60 (45°C)	⩾600	20	0,3	15	⩽8 (20 В)	⩾15* (12 В; 1,5 мА)	—	—	⩽6 (800 МГц)	⩽5	TO-72
AF239S	Ge, p-n-p, M	60 (45°C)	780	20	0,3	15	⩽8* (20 В)	⩾10* (10 В; 2 мА)	—	—	⩽5 (800 МГц)	—	TO-72
AF240	Ge, p-n-p, M	60 (45°C)	500	20*	0,3	10	⩽8* (20 В)	⩾10* (10 В; 2 мА)	—	—	6,5 (800 МГц)	—	TO-72
AF251	Ge, p-n-p, П	90 (45°C)	750	20	0,3	10	⩽5 (12 В)	30 (12 В; 2 мА)	0,38*	—	4,8	—	MM-12
AF252	Ge, p-n-p, П	90 (45°C)	650	20	0,3	10	⩽5 (12 В)	⩾10 (12 В; 2 мА)	0,38*	—	5,2	—	MM-12
2SA422	Ge, p-n-p, M	50	⩾500	20	0,4	5	⩽30 (20 В)	25 (12 В; 2 мА)	⩽1,2	—	—	2,2	TO-17
GF507	Ge, p-n-p, M	60 (45°C)	⩾250	20	0,3	10	⩽8 (20 В)	⩾11* (12 В; 1,5 мА)	0,4 (12 В)	—	⩽9 (800 МГц)	⩽5	TO-72
GF145	Ge, p-n-p, M	60	650	20	0,3	10	⩽8 (20 В)	—	—	—	⩽9 (800 МГц)	15	A-4
GF147	Ge, p-n-p, M	60	650	20	0,3	10	⩽8 (20 В)	⩾10* (10 В; 2 мА)	1,2 (10 В)	—	⩽6 (800 МГц)	15	A-4
2N3399	Ge, p-n-p, M	80	⩾400	20	0,5	10	8	⩾10* (12 В; 1,5 мА)	⩽2	—	—	—	TO-72
ГТ376А	Ge, p-n-p, ПЭ	35 (85°C)	⩾1020	7**	0,25	10	⩽5 (7 В)	10...150* (5 В; 2 мА)	⩽1,2 (5 В)	—	⩽3,5 (180 МГц)	⩽15	8а
2N2415	Ge, p-n-p, ПЭ	75	⩾500	10**	0,3	20	⩽5 (10 В)	10...200* (6 В; 2 мА)	⩽2 (6 В)	—	⩽3 (200 МГц)	⩽8	TO-72
2N2416	Ge, p-n-p, ПЭ	75	⩾400	10**	0,3	20	⩽5 (10 В)	8...200* (6 В; 2 мА)	⩽2 (6 В)	—	⩽4 (200 МГц)	⩽10	TO-72
2N3267	Ge, p-n-p, ПЭ	75	⩾900	15	0,2	20	5	15 (6 В; 3 мА)	⩽1,7	—	—	—	TO-72
2N700A	Ge, p-n-p, M	75	⩾1000	25	0,2	50	⩽2 (6 В)	4...50 (6 В; 2 мА)	⩽1,4 (6 В)	—	⩽10 (70 МГц)	—	TO-17
2N2360	Ge, p-n-p, MD	60	1600	20	0,5	—	⩽10	33* (10 В; 2 мА)	—	—	⩽5,5 (200 МГц)	—	TO-12
2N2361	Ge, p-n-p, MD	60	1600	20	0,5	—	⩽10	33* (10 В; 2 мА)	—	—	⩽12 (200 МГц)	—	TO-12

Заказ № 1141

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^*_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, мкА	$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r^*_б$, $r^{**}_{бэ\,нас}$, Ом	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
ГТ311Е	Ge, n-p-n, П	150	≥250	12 (20 имп)	2	50	≤5 (12 В)	20...80* (3 В; 15 мА)	≤2,5 (5 В)	≤20	—	≤75; 50*	11
ГТ311Ж	Ge, n-p-n, П	150	≥300	12 (20 имп)	2	50	≤5 (12 В)	50...200* (3 В; 15 мА)	≤2,5 (5 В)	≤20	—	≤100; 50*	11
ГТ311И	Ge, n-p-n, П	150	≥450	10	1,5	50	≤5 (10 В)	100...300* (3 В; 15 мА)	≤2,5 (5 В)	≤20	—	≤100; 50*	11
2N797	Ge, n-p-n, М	150	≥600	20	4	150	≤1 (10 В)	40...75* (0,25 В; 10 мА)	≤4 (5 В)	≤14	—	80**	ТО-18
2N2482	Ge, n-p-n, М	150	≥600	20	3	100	≤5	≥15* (6 В; 2 мА)	≤4,5	—	—	—	ТО-18
2N955	Ge, n-p-n, М	150	≥500	12	2	100	≤5	≥30* (0,5 В; 30 мА)	≤8	—	—	—	ТО-18
2N955A	Ge, n-p-n, М	150	≥500	12	2	150	≤5	≥30* (0,5 В; 30 мА)	≤6	—	—	—	ТО-18
2N1585	Ge, n-p-n, М	300	400	25	2	100	≤100 (25 В)	20 (10 В; 10 мА)	1,8	—	—	—	ТО-5
ГТ330Д [1]	Ge, n-p-n, П	50 (45°C)	≥500	10 (20 имп)	1,5	20	≤5 (10 В)	30...400* (5 В; 5 мА)	≤3 (5 В)	≤15	≤8 (400 МГц)	≤30; 50*	12
ГТ330Ж [1]	Ge, n-p-n, П	50 (45°C)	≥1000	10 (20 имп)	1,5	20	≤5 (10 В)	30...400* (5 В; 5 мА)	≤3 (5 В)	≤15	—	≤50; 50*	12
ГТ330И [1]	Ge, n-p-n, П	50 (45°C)	≥500	10 (20 имп)	1,5	20	≤5 (10 В)	10...400* (5 В; 5 мА)	≤3 (5 В)	≤15	≤8 (400 МГц)	≤30; 50*	12
AF279	Ge, p-n-p, М	60	780	20*	0,3	10	≤15 (20 В)	45* (5 В; 5 мА)	0,42 (10 В)	—	≤5 (800 МГц)	—	ТО-50
AF280	Ge, p-n-p, М	60	500	20*	0,3	10	≤15 (20 В)	≥10* (10 В; 2 мА)	0,42 (10 В)	—	7 (800 МГц)	—	ТО-50
ГТ329А [1]	Ge, n-p-n, П	50 (40°C)	≥1200	10	0,5	20	≤5 (10 В)	15...300* (5 В; 5 мА)	≤2 (5 В)	—	≤4 (400 МГц)	≤15	12
ГТ329Б [1]	Ge, n-p-n, П	50 (40°C)	≥1680	10	0,5	20	≤5 (10 В)	15...300* (5 В; 5 мА)	≤3 (5 В)	—	≤6 (400 МГц)	≤30	12
ГТ329В [1]	Ge, n-p-n, П	50 (40°C)	≥990	10	1	20	≤5 (10 В)	15...300* (5 В; 5 мА)	≤3 (5 В)	—	≤6 (400 МГц)	≤20	12
2N5043	Ge, p-n-p, ПЭ	30 (100°C)	≥1500	15	0,7	30	≤6 (10 В)	15...150* (5 В; 3 мА)	≤1 (5 В)	—	≤2,5 (400 МГц)	—	ТО-72
2N5044	Ge, p-n-p, ПЭ	30 (100°C)	≥1000	15	0,7	30	≤6 (10 В)	15...150* (5 В; 3 мА)	≤1 (5 В)	—	≤3,5 (400 МГц)	—	ТО-72
ГТ341А [1]	Ge, n-p-n, П	35 (60°C)	≥1500	10	0,3	10	≤5 (10 В)	15...300* (5 В; 5 мА)	≤1 (5 В)	—	≤4,5 (1 ГГц)	≤10	12
ГТ341Б [1]	Ge, n-p-n, П	35 (60°C)	≥1980	10	0,3	10	≤5 (10 В)	15...300* (5 В; 5 мА)	≤1 (5 В)	—	≤5,5 (1 ГГц)	≤10	12
ГТ341В [1]	Ge, n-p-n, П	35 (60°C)	≥1500	10	0,5	10	≤5 (10 В)	15...300* (5 В; 5 мА)	≤1 (5 В)	—	≤5,5 (1 ГГц)	≤10	12

[1] Для создания аппаратуры рекомендуются аналогичные транзисторы другого типа проводимости (p-n-p).

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^{*}_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^{*}_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^{*}_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, мкА	$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r^{*}_б$, $r^{**}_{бэ\,нас}$, Ом	$\tau_к$, пс, $t^{*}_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
TIX3024	Ge, p-n-p, M	75	≥1500	15	0,3	50	≤6 (10 В)	25...250* (5 В; 3 мА)	≤3 (5 В)	—	≤5 (1 ГГц)	≤3	U-26
TIXM101	Ge, p-n-p, ПЭ	75	≥1500	15	0,3	50	≤6 (10 В)	70 (5 В; 2 мА)	≤3	—	≤2,6 (200 МГц)	—	TO-72
TIXM104	Ge, p-n-p, ПЭ	40	≥1400	15	0,3	20	—	—	≤1	—	5,5 (1,5 ГГц)	—	X-60
2N2999	Ge, p-n-p, M	75	≥1400	15	0,2	20	≤100 (15 В)	100* (6 В; 3 мА)	1,7	—	≤7 (1 ГГц)	—	TO-72
ГТ362А [1]	Ge, n-p-n, П	40	≥2400	5 (55°C)	0,2	10	≤5 (5 В)	10...200* (3 В; 5 мА)	≤1 (5 В)	—	≤4,5 (2,25 ГГц)	≤10	12
ГТ362Б [1]	Ge, n-p-n, П	40	≥2400	5 (55°C)	0,2	10	≤5 (5 В)	10...250* (3 В; 5 мА)	≤1 (5 В)	—	≤5,5 (2,25 ГГц)	≤20	12
TIXM103	Ge, p-n-p, ПЭ	40	≥1800	15	0,3	20	—	—	1	—	≤7 (3 ГГц)	—	X-60
П307	Si, n-p-n, П	250	≥20	80*	3	30 (120*)	≤20 (80 В)	16...50* (20 В; 10 мА)	—	≤150	—	—	2
П307А	Si, n-p-n, П	250	≥20	80*	3	30 (120*)	≤20 (80 В)	30...90* (20 В; 10 мА)	—	≤200	—	—	2
П307Б	Si, n-p-n, П	250	≥20	80*	3	15 (120*)	≤20 (80 В)	50...150* (20 В; 10 мА)	—	≤330	—	—	2
П307В	Si, n-p-n, П	250	≥20	60*	3	30 (120*)	≤20 (60 В)	50...150* (20 В; 10 мА)	—	≤250	—	—	2
П307Г	Si, n-p-n, П	250	≥20	80*	3	15 (120*)	≤20 (80 В)	16...50* (20 В; 10 мА)	—	≤250	—	—	2
П308	Si, n-p-n, П	250	≥20	120*	3	30 (120*)	≤20 (120 В)	30...90* (20 В; 10 мА)	—	≤330	—	—	2
П309	Si, n-p-n, П	250	≥20	120*	3	30 (120*)	≤20 (120 В)	16...50* (20 В; 10 мА)	—	≤200	—	—	2
2N754	Si, n-p-n, П	300	≥30	60	3	50	≤1 (60 В)	20...80* (10 В; 5 мА)	≤10 (10 В)	≤80	—	—	TO-18
2N755	Si, n-p-n, П	300	≥30	100	3	50	≤1 (100 В)	20...80* (10 В; 5 мА)	≤10 (10 В)	≤80	—	—	TO-18
2SC727	Si, n-p-n, D	350	20	100	3	100	≤1 (30 В)	90* (4 В; 10 мА)	10 (6 В)	10	—	—	TO-18
BFY80	Si, n-p-n, D	260 (45°C)	≥50	100	7	50 (200*)	≤0,1 (75 В)	≥30 (10 В; 2 мА)	—	—	—	—	TO-18
BC285	Si, n-p-n, D	360	80	120	5	100	0,1	≥30 (30 В; 5 мА)	4	—	—	—	TO-18
BSX21	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥60	120	5	100 (250*)	≤0,2 (90 В)	82* (1 В; 10 мА)	≤4,5 (10 В)	≤175	—	—	TO-18
2N1566	Si, n-p-n, D	600	≥60	80	5	50	≤1	≥80 (5 В; 5 мА)	≤10	—	—	—	TO-5
2N560	Si, n-p-n, D	500	50	60	8	100	0,1	≥20* (5 В; 0,1 А)	≤8	—	—	—	TO-29
2N734	Si, n-p-n, П	500	≥30	80	5	50	1	20...50 (5 В; 10 мА)	≥10 (5 В)	≤100	—	—	TO-18
2N735	Si, n-p-n, П	500	≥30	80	5	50	—	40...100 (5 В; 10 мА)	≥10 (5 В)	≤100	—	—	TO-18
2N738	Si, n-p-n, П	500	≥30	125	5	50	—	20...50 (5 В; 10 мА)	≥10 (5 В)	≤100	—	—	TO-18
2N739	Si, n-p-n, П	500	≥60	125	5	50	—	40...100 (5 В; 10 мА)	≥10 (5 В)	≤100	—	—	TO-5
2Т3531	Si, n-p-n, П	250	≥100	115**	5	30	≤0,1	30...80	≤4	—	—	—	TO-5
2Т3532	Si, n-p-n, П	250	≥100	90**	5	30	≤0,1	30...80	≤4	—	—	—	TO-5
2N1572	Si, n-p-n, D	600	≥12	125	5	50	≤1	≥20 (5 В; 5 мА)	≤10	—	—	—	TO-5
2N1573	Si, n-p-n, D	600	≥30	125	5	50	≤1	≥40 (5 В; 5 мА)	≤10	—	—	—	TO-5
2N1574	Si, n-p-n, D	600	≥30	125	5	50	≤1	≥80 (5 В; 5 мА)	≤10	—	—	—	TO-5
BSY79	Si, n-p-n, ПЭ	300	100	120	5	30	≤0,05 (90 В)	≥30 (1 В; 1 мА)	4 (10 В)	≤250	≤500*	—	TO-18

[1] Для создания аппаратуры рекомендуются аналогичные транзисторы другого типа проводимости (p-n-p).

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^*_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{**}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, мкА	$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r^*_б$, $r^{**}_{бэ\,нас}$, Ом	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
КТ301Г	Si, n-p-n, П	150 (60°C)	≥30	30	3	10	≤10 (20 В)	10...32 (10 В; 3 мА)	≤10 (10 В)	≤300	—	≤2000	36
КТ301Д	Si, n-p-n, П	150 (60°C)	≥30	30	3	10	≤10 (20 В)	20...60 (10 В; 3 мА)	≤10 (10 В)	≤300	—	≤2000	36
КТ301Е	Si, n-p-n, П	150 (60°C)	≥30	30	3	10	≤10 (30 В)	40...120 (10 В; 3 мА)	≤10 (10 В)	≤300	—	≤2000	36
КТ301Ж	Si, n-p-n, П	150 (60°C)	≥30	20	3	10	≤10 (20 В)	80...300 (10 В; 3 мА)	≤10 (10 В)	≤300	—	≤2000	36
2N1390	Si, n-p-n, П	300	30	20	2	50	0,8	≥15 (5 В; 10 мА)	7	—	—	—	TO-5
2N1387	Si, n-p-n, П	300	50	30	3	50	0,1	30 (5 В; 10 мА)	4	—	—	—	TO-5
2N842	Si, n-p-n, М	300	≥30*	45	2	50	≤1 (45 В)	20...55* (5 В; 10 мА)	≤10 (10 В)	≤120	—	10*	TO-18
2N843	Si, n-p-n, М	300	≥30*	45	2	50	≤1 (45 В)	45...150* (5 В; 10 мА)	≤10 (10 В)	≤120	—	10*	TO-18
BC101	Si, n-p-n, П	300	≥30	40	7	40	≤0,02 (40 В)	30...120* (1,5 В; 10 мА)	≤8 (5 В)	≤60	—	—	TO-18
КТ358А	Si, n-p-n, ПЭ	100 (50°C)	≥80	15	4	30 (60*)	≤10 (15 В)	10...100* (5,5 В; 20 мА)	≤5 (10 В)	≤40	—	≤500	17
КТ358Б	Si, n-p-n, ПЭ	100 (50°C)	≥120	30	4	30 (60*)	≤10 (30 В)	25...100* (5,5 В; 20 мА)	≤5 (10 В)	≤40	—	≤500	17
КТ358В	Si, n-p-n, ПЭ	100 (50°C)	≥120	15	4	30 (60*)	≤10 (15 В)	50...280* (5,5 В; 20 мА)	≤5 (10 В)	≤40	—	≤500	17
2SC401	Si, n-p-n, ПЭ	100	170	50	5	100	0,2	90 (3 В; 1 мА)	2,5	—	—	—	U-37
2SC403	Si, n-p-n, ПЭ	100	170	50	3	100	0,2	60 (3 В; 1 мА)	2,2	—	—	—	U-37
2SC404	Si, n-p-n, ПЭ	100	170	50	3	50	0,2	90 (3 В; 1 мА)	2,2	—	—	—	U-37
2SC829	Si, n-p-n, ПЭ	150	≥150	30	5	30	10	40...500 (10 В; 1 мА)	1,3	—	≤60*	—	TO-92
2N3709	Si, n-p-n, П	250	≥100	30	6	30	≤0,1 (20 В)	45...165 (5 В; 1 мА)	—	≤100	—	—	TO-92
2N3710	Si, n-p-n, П	250	≥100	30	6	30	≤0,1 (20 В)	90...330 (5 В; 1 мА)	—	≤100	—	—	TO-92
КТ312А	Si, n-p-n, ПЭ	225	≥80	20	4	30 (60*)	≤10 (20 В)	10...100* (2 В; 20 мА)	≤5 (10 В)	≤40	—	≤500	15а
КТ312Б	Si, n-p-n, ПЭ	225	≥120	35	4	30 (60*)	≤10 (35 В)	25...100* (2 В; 20 мА)	≤5 (10 В)	≤40	—	≤500	15а
КТ312В	Si, n-p-n, ПЭ	225	≥120	20	4	30 (60*)	≤10 (20 В)	50...280* (2 В; 20 мА)	≤5 (10 В)	≤40	—	≤500	15а
2N702	Si, n-p-n, М	300	≥70	25	5	50	≤0,5 (10 В)	20...60* (5 В; 10 мА)	≤6 (5 В)	≤50	—	—	TO-18
2N703	Si, n-p-n, М	300	≥70	25	5	50	≤0,5 (10 В)	40..100* (5 В; 10 мА)	≤6 (5 В)	≤50	—	—	TO-5
2SC33	Si, n-p-n, ПЭ	150	≥125	45	3	50	≤0,1 (20 В)	25...125* (10 В; 5 мА)	≤6 (10 В)	—	—	—	TO-5
2SC281	Si, n-p-n, М	200	≥100	30	5	100	≤0,1 (20 В)	60...320* (6 В; 10 мА)	≤10	—	—	—	TO-1
2SC105	Si, n-p-n, ПЭ	250	≥100	30	5	80	≤0,005 (15 В)	60* (1 В; 10 мА)	≤6 (10 В)	—	—	—	TO-18
2N780	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥60	45	5	50	0,01	≥35 (5 В; 0,5 мА)	≤4	—	—	—	TO-18
BCY42	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥100	40	5	100	0,025	≥45* (5 В; 1 мА)	≤6	—	—	—	TO-18
BCY43	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥100	40	5	100	0,025	≥75* (5 В; 1 мА)	≤6	—	—	—	TO-18
BSY73	Si, n-p-n, ПЭ	300	145	25	5	100	≤0,1 (20 В)	≥35* (1 В; 1 мА)	≤6 (10 В)	≤5	—	—	TO-18
2SC282	Si, n-p-n, М	350	≥100	30	5	100	≤0,1 (20 В)	60...320* (6 В; 10 мА)	10	—	—	600*	TO-1
2N728	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥100	15	3	20	≤5 (15 В)	20...200* (6 В; 10 мА)	≤12 (10 В)	≤70	—	—	TO-18

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^{*}_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^{*}_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^{*}_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, мкА	$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$К_ш$, дБ, $r^{*}_{б}$, $r^{**}_{бэ\,нас}$, Ом	$\tau_к$, пс, $t^{*}_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
2N729	Si, n-p-n, ПЭ	300	⩾100	30	3	20	⩽5 (30 В)	20...200* (6 В; 10 мА)	⩽12 (10 В)	⩽70	—	—	ТО-18
BF240	Si, n-p-n, ПЭ	300	⩾90	15	4	100	⩽0,5 (15 В)	⩾35* (4,5 В; 2 мА)	⩽4 (10 В)	⩽100	—	—	ТО-18
КТ315А	Si, n-p-n, ПЭ	150 (250*)	⩾250	25	6	100	⩽0,5 (10 В)	30...120* (10 В; 1 мА)	⩽7 (10 В)	⩽20	⩽40*	⩽300	16
КТ315Б	Si, n-p-n, ПЭ	150 (250*)	⩾250	20	6	100	⩽0,5 (10 В)	50...350* (10 В; 1 мА)	⩽7 (10 В)	⩽20	⩽40*	⩽500	16
КТ315В	Si, n-p-n, ПЭ	150 (250*)	⩾250	40	6	100	⩽0,5 (10 В)	30...120* (10 В; 1 мА)	⩽7 (10 В)	⩽20	⩽40*	⩽500	16
КТ315Г	Si, n-p-n, ПЭ	150 (250*)	⩾250	35	6	100	⩽0,5 (10 В)	50...350* (10В; 1 мА)	⩽7 (10 В)	⩽20	⩽40*	⩽500	16
КТ315Д	Si, n-p-n, ПЭ	150 (250*)	⩾250	40* (10 к)	6	100	⩽0,6 (10 В)	20...90* (10 В; 1 мА)	⩽7 (10 В)	⩽30	⩽40*	⩽1000	16
КТ315Е	Si, n-p-n, ПЭ	150 (250*)	⩾250	35* (10 к)	6	100	⩽0,6 (10 В)	50...350* (10В; 1 мА)	⩽7 (10 В)	⩽30	⩽40*	⩽1000	16
КТ315Ж	Si, n-p-n, ПЭ	100	⩾250	20* (0 к)	6	50	⩽0,6 (10 В)	30...250* (10 В; 1 мА)	⩽10 (10 В)	⩽25	—	⩽800 ⩽250*	16
КТ315И	Si, n-p-n, ПЭ	100	⩾250	60* (0 к)	6	50	⩽0,6 (10 В)	⩾30* (10 В; 1 мА)	⩽10 (10 В)	⩽45	—	950	16
КТ315К	Si, n-p-n, ПЭ	150	⩾250	20	6	100	⩽0,5 (10 В)	50...350* (10В; 1 мА)	⩽7 (10 В)	⩽20	—	⩽500	16
2SC641	Si, n-p-n, ПЭ	100	⩾200	40	5	100	0,25	35...200* (1 В; 10 мА)	6	—	—	⩽30*	ММ-12
2SC633	Si, n-p-n, ПЭ	180	140	25	6	100	0,2	90* (3 В; 1 мА)	4,5	—	—	—	U-37
2SC634	Si, n-p-n, ПЭ	180	140	40	6	100	0,2	90* (3 В; 1 мА)	4,5	—	—	—	U-37
2N2711	Si, n-p-n, П	200	120	18	5	100	⩽0,5 (18 В)	30...90* (4,5 В; 2 мА)	⩽12 (10 В)	⩽20	2,8 (10 кГц)	—	R-67
2N2712	Si, n-p-n, П	200	120	18	5	100	⩽0,5 (18 В)	75...225* (4,5 В; 2 мА)	⩽12 (10 В)	⩽20	2,8 (10 кГц)	—	R-67
2N3397	Si, n-p-n, ПЭ	200	120	25	5	100	0,1	55...500* (4,5 В; 2 мА)	⩽10	⩽20	—	—	ТО-98
BFP719	Si, n-p-n, ПЭ	150	⩾250	15**	5	100	—	20...90* (10 В; 1 мА)	⩽7 (10 В)	—	—	⩽300	ММ-10
BFP720	Si, n-p-n, ПЭ	150	⩾250	15**	5	100	—	50...350* (10 В; 1 мА)	⩽7 (10 В)	—	—	⩽500	ММ-10
BFP721	Si, n-p-n, ПЭ	150	⩾250	30**	5	100	—	20...90* (10 В; 1 мА)	⩽7 (10 В)	—	—	⩽500	ММ-10
BFP722	Si, n-p-n, ПЭ	150	⩾250	25**	5	100	—	50...350* (10В; 1 мА)	⩽7 (10 В)	—	—	⩽500	ММ-10
КТ339А	Si, n-p-n, ПЭ	260 (55°С)	⩾300	40	4	25	⩽1 (40 В)	⩾25* (10 В; 7 мА)	⩽2 (5 В)	—	—	⩽25	86
КТ339АМ	Si, n-p-n, ПЭ	260 (55°С)	⩾300	40	4	25	⩽1 (40 В)	⩾25* (10 В; 7 мА)	⩽2 (5 В)	—	—	⩽25	176
КТ339Б	Si, n-p-n, ПЭ	260 (55°С)	⩾250	25	4	25	⩽1 (40 В)	⩾15* (10 В; 7 мА)	⩽2 (5 В)	—	—	⩽25	86
КТ339В	Si, n-p-n, ПЭ	260 (55°С)	⩾450	40	4	25	⩽1 (40 В)	⩾25* (10 В; 7 мА)	⩽2 (5 В)	—	—	⩽50	86
КТ339Г	Si, n-p-n, ПЭ	260 (55°С)	⩾250	40	4	25	⩽1 (40 В)	⩾40* (10 В; 7 мА)	⩽2 (5 В)	—	—	⩽100	86
КТ339Д	Si, n-p-n, ПЭ	260 (55°С)	⩾250	40	4	25	⩽1 (40 В)	⩾15* (10 В; 7 мА)	⩽2 (5 В)	—	—	⩽150	86

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^*_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, мкА	$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$К_ш$, дБ, $r^*_б$, $r^{**}_{бэ\,нас}$, Ом	$\tau_к$, пс, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
BF173	Si, n-p-n, ПЭ	260 (45°C)	⩾350	40	4	25	—	⩾38* (10 В; 7 мА)	0,23*	—	—	—	ТО-72
BF199	Si, n-p-n, ПЭ	500	500	40	4	25	⩽0,1 (40 В)	⩾40* (10 В; 7 мА)	0,33*	—	—	—	ТО-92
KF173	Si, n-p-n, ПЭ	260	⩾400	40	4	25	⩽0,1 (30 В)	—	⩽0,35*	—	—	—	ТО-72
BF306	Si, n-p-n, ПЭ	250	500	40	4	25	—	⩾37* (10 В; 7 мА)	⩽0,35*	—	—	—	ТО-72
BF330	Si, n-p-n, ПЭ	250	500	40	4	25	—	⩾37* (10 В; 7 мА)	⩽0,3*	—	—	—	SOT-25
BF208	Si, n-p-n, ПЭ	200	⩾350	40	4	25	⩽0,1 (20 В)	⩾40* (10 В; 7 мА)	⩽0,3*	—	—	⩽10	ТО-72
BF197	Si, n-p-n, ПЭ	320	550	40	4	25	⩽0,1 (20 В)	87* (10 В; 7 мА)	0,32*	—	—	—	ММ-10
BF223	Si, n-p-n, ПЭ	330	⩾375	35	4	40	⩽0,05 (20 В)	79* (10 В; 15 мА)	0,3*	—	—	—	ММ-10
BF311	Si, n-p-n, ПЭ	320	⩾375	35	4	40	⩽0,05 (20 В)	79* (10 В; 15 мА)	0,3*	—	—	—	ТО-92
BFJ70	Si, n-p-n, ПЭ	175	⩾550	40	3,5	25	0,045 (20 В)	—	0,27*	—	—	—	ТО-72
BF273	Si, n-p-n, ПЭ	260 (45°C)	550	40	4	25	—	⩾35	0,23*	—	—	—	ТО-72
MPSH-37	Si, n-p-n, ПЭ	310	⩾300	40**	5	100	⩽0,5 (35 В)	⩾25* (10 В; 5 мА)	⩽0,7*	⩽50	—	—	ТО-92
2SC563	Si, n-p-n, ПЭ	145	⩾360	40	4	25	—	⩾38 (10 В; 7 мА)	0,23*		—	—	ТО-72
КТ375А	Si, n-p-n, ПЭ	200 (400**)	⩾250	60	5	100 (200*)	⩽1 (60 В)	10...100* (2 В; 20 мА)	⩽5 (10 В)	⩽40	—	⩽300	17а
КТ375Б	Si, n-p-n, ПЭ	200 (400**)	⩾250	30	5	100 (200*)	⩽1 (30 В)	50...280* (2 В; 20 мА)	⩽5 (10 В)	⩽40	—	⩽300	17а
BC170A	Si, n-p-n, ПЭ	200	100	20**	5	100	⩽0,1 (15 В)	⩾30* (1 В; 30 мА)	⩽4 (10 В)	⩽14	⩽10 (1 кГц)	—	Х-64
BC170B	Si, n-p-n, ПЭ	200	100	20**	5	100	⩽0,1 (15 В)	⩾60* (1 В; 30 мА)	⩽4 (10 В)	⩽14	⩽10 (1 кГц)	—	Х-64
2N3903	Si, n-p-n, ПЭ	310	⩾250	60	6	200	⩽10 (60 В)	50...150* (1 В; 10 мА)	⩽4,5 (5 В)	⩽20	⩽6 (1 кГц)	⩽175*	ТО-92
2N3904	Si, n-p-n, ПЭ	310	⩾300	60	6	200	⩽10 (60 В)	100...300* (1 В; 10 мА)	⩽4,5 (5 В)	⩽20	⩽5 (1 кГц)	⩽200*	ТО-92
2N5219	Si, n-p-n, ПЭ	310	⩾150	20	3	100	⩽10	⩾35 (10 В; 2 мА)	⩽4 (10 В)	⩽70	—	—	ТО-92
2N5223	Si, n-p-n, ПЭ	310	⩾150	25	3	100	⩽0,1 (10 В)	50...800 (10 В; 2 мА)	⩽4 (10 В)	⩽70	—	—	ТО-92
MPS706A	Si, n-p-n, ПЭ	310	⩾200	25	5	100	⩽0,5 (15 В)	20...60* (1 В; 10 мА)	⩽6 (10 В)	⩽60	50*	—	ТО-92
2SC370	Si, n-p-n, ПЭ	200	⩾80	30	4	100	⩽0,5 (18 В)	25...50* (12 В; 2 мА)	⩽3,5 (10 В)	—	50*	—	R-67
2SC371	Si, n-p-n, ПЭ	200	⩾80	30	4	100	⩽0,5 (18 В)	40...140 (12 В; 2 мА)	⩽3,5 (10 В)	—	50*	—	R-67
2SC372	Si, n-p-n, ПЭ	200	⩾80	30	4	100	⩽0,5 (18 В)	40...240 (12 В; 2 мА)	⩽3,5 (10 В)	—	50*	—	R-67
BSW88A	Si, n-p-n, ПЭ	300 (45°C)	⩾200	35	5	100	⩽0,05 (25 В)	100...300 (1 В; 10 мА)	—	—	—	⩽800**	Х-73
BSX80	Si, n-p-n, ПЭ	230	⩾200	35	5	200	⩽0,05 (20 В)	80* (1 В; 10 мА)	—	—	—	⩽80**	ММ-11
BSX81A	Si, n-p-n, ПЭ	300	⩾200	35	5	100	⩽0,05 (25 В)	100...300* (1 В; 10 мА)	⩽6	—	—	⩽800**	ММ-11
SF215C	Si, n-p-n, П	200	⩾100	20	5	100	⩽0,1 (20 В)	56...140 (6 В; 2 мА)	⩽4,3 (10 В)	—	8 (100 МГц)	85	А-5
SF215D	Si, n-p-n, П	200	⩾100	20	5	100	⩽0,1 (20 В)	112...280 (6 В; 2 мА)	⩽4,3 (10 В)	—	8 (100 МГц)	85	А-5
SF215E	Si, n-p-n, П	200	⩾100	20	5	100	⩽0,1 (20 В)	224...560 (6 В; 2 мА)	⩽4,3 (10 В)	—	8 (100 МГц)	85	А-5
SF216C	Si, n-p-n, П	200	⩾100	40	5	100	⩽0,1 (20 В)	56...140 (6 В, 2 мА)	⩽4,3 (10 В)	—	8 (100 МГц)	85	А-5
SF216D	Si, n-p-n, П	200	⩾100	40	5	100	⩽0,1 (20 В)	112...280 (6 В; 2 мА)	⩽4,3 (10 В)	—	8 (100 МГц)	85	А-5
SF216E	Si, n-p-n, П	200	100	40	5	100	⩽0,1 (20 В)	224...560 (6 В; 2 мА)	⩽4,3 (10 В)	—	8 (100 МГц)	85	А-5
SS216	Si, n-p-n, ПЭ	200	350	20	5	100 (200*)	⩽0,1 (20 В)	18...280* (0,5 В; 30 мА)	2,6 (10 В)	⩽15	—	280**	А-5
SS218	Si, n-p-n, ПЭ	200	350	20	5	100 (200*)	⩽0,1 (20 В)	18...280* (0,5 В; 30 мА)	2,6 (10 В)	⩽15	—	⩽60**	А-5
SS219	Si, n-p-n, ПЭ	200	⩾100	20	5	100 (200*)	⩽0,1 (20 В)	18...280* (0,5 В; 30 мА)	—	⩽15	—	⩽30**	А-5

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^{*}_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^{*}_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^{*}_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, мкА	$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$К_ш$, дБ, $r^{*}_б$, $r^{**}_{бэ\,нас}$, Ом	$τ_к$, пс, $t^{*}_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
2SC712	Si, n-p-n, ПЭ	200	150	30	4	100	≤1	35...500* (6 В; 10 мА)	2,5	—	—	—	TO-92
2N3605	Si, n-p-n, ПЭ	200	300	18	5	200	0,5	≥30* (1 В; 10 мА)	≤6	25	—	≤20*	R-67
2N3606	Si, n-p-n, ПЭ	200	300	18	5	200	0,5	≥30* (1 В; 10 мА)	≤6	25	—	≤35*	R-67
2N3607	Si, n-p-n, ПЭ	200	300	18	5	200	0,5	≥30* (1 В; 10 мА)	≤6	25	—	≤45*	R-67
2SC620	Si, n-p-n, ПЭ	250	200	50	5	200	≤1	35...300* (6 В; 10 мА)	7	—	—	100	TO-92
КТ350А	Si, p-n-p, ПЭ	300 (30°C)	≥100	20	5	600*	≤1 (10 В)	20...200* (1 В; 0,5 А)	≤70 (5 В)	≤2	—	—	17а
2N978	Si, p-n-p, ПЭ	330	≥40	30	5	600	≤5 (10 В)	15...60* (10 В; 0,15 А)	≤45 (10 В)	≤10	—	—	TO-18
MPS6562	Si, p-n-p, ПЭ	500	≥60	25	4	600	0,1 (20 В)	50...200* (1 В; 0,5 А)	≤30 (10 В)	≤1	—	—	TO-92
MPS6563	Si, p-n-p, ПЭ	500	≥60	20	4	600	0,1 (20 В)	50...200* (1 В; 0,35 А)	≤30 (10 В)	≤1,3	—	—	TO-92
2N5226	Si, p-n-p, ПЭ	625	≥50	25	4	500	≤0,3 (15 В)	30...600* (10 В; 0,05 А)	≤20 (5 В)	≤8	—	—	TO-92
2SA673	Si, p-n-p, Э	400	≥40	35	4	500	≤0,5 (20 В)	60...320* (3 В; 10 мА)	—	≤4	—	—	TO-92
КТ351А	Si, p-n-p, ПЭ	300 (30°C)	≥200	15* (10 к)	5	400*	≤1 (10 В)	20...80* (1 В; 0,3 А)	≤20 (5 В)	≤1,5	—	—	17а
КТ351Б	Si, p-n-p, ПЭ	300 (30°C)	≥200	15* (10 к)	5	400*	≤1 (10 В)	50...200* (1 В; 0,3 А)	≤20 (5 В)	≤2,25	—	—	17а
2N2696	Si, p-n-p, ПЭ	360	≥100	25	4	500	≤0,025 (10 В)	≥20* (2 В; 0,3 А)	≤20 (10 В)	≤5	—	≤170**	TO-18
BC192	Si, p-n-p, ПЭ	400	≥100	25	5	500	≤0,1 (20 В)	60...180* (5 В; 50 мА)	≤12 (10 В)	≤5	—	—	TO-92
BSV49A	Si, p-n-p, ПЭ	400	200	30	5	500	0,025	80* (25 В; 0,15 А)	8	—	—	—	TO-18
2N3121	Si, p-n-p, ПЭ	360	≥130	45	4	500	0,01	≥15* (2 В; 0,3 А)	≤10	≤5	—	≤100**	TO-18
2N5221	Si, p-n-p, ПЭ	310	≥100	15	3	500	≤0,1 (10 В)	30...60* (10 В; 50 мА)	≤15 (5 В)	≤3,3	—	—	TO-92
BFW89	Si, p-n-p, П	300	≥100	40	5	500	0,5	80...320* (0,15 А)	18	≤2,6	—	≤250*	MM-10
BFW90	Si, p-n-p, П	300	≥100	40	5	500	0,5	40...120* (0,15 А)	18	≤2,6	—	≤250*	MM-10
BFW91	Si, p-n-p, П	300	≥100	20	5	500	0,5	≥40* (0,15 А)	18	≤2,6	—	≤250*	MM-10
BSJ36	Si, p-n-p, ПЭ	360	≥100	40	5	500	≤0,015 (25 В)	85* (10 В; 0,15 А)	≤8 (10 В)	≤3,3	≤25 (1 кГц)	100**	TO-18
BC226	Si, p-n-p, ПЭ	300	≥200	30	4	600	≤0,1 (20 В)	90* (1 В; 0,15 А)	≤5 (10 В)	≤3,3	—	—	TO-18
BC226A	Si, p-n-p, ПЭ	300	200	40	5	600	≤0,05 (20 В)	90* (1 В; 0,15 А)	≤5 (10 В)	≤3,3	—	—	TO-18
BC216	Si, p-n-p, ПЭ	300	200	30	4	600	≤0,1 (20 В)	≥20* (1 В; 0,15 А)	≤5 (10 В)	≤3,3	—	—	TO-18
BC216A	Si, p-n-p, ПЭ	300	200	40	5	600	≤0,05 (20 В)	≥20* (1 В; 0,15 А)	≤5 (10 В)	≤3,3	—	—	TO-18
MPS3638	Si, p-n-p, ПЭ	310	≥100	25	4	500	≤0,1 (25 В)	≥20* (2 В; 0,3 А)	≤20 (10 В)	≤3,3	—	≤140*	TO-92
MPS3638A	Si, p-n-p, ПЭ	310	≥150	25	4	500	≤0,1 (25 В)	≥20* (2 В; 0,3 А)	≤10 (10 В)	≤3,3	—	≤140*	TO-92
2N5354	Si, p-n-p, ПЭ	260 (55°C)	250	25	4	300 (700*)	≤0,1 (25 В)	20* (5 В; 0,3 А)	≤8 (5 В)	≤3,3	—	—	TO-98
2N5365	Si, p-n-p, ПЭ	360	250	40	4	300 (500*)	≤0,1 (40 В)	≥20* (5 В; 0,3 А)	≤8 (10 В)	≤3,3	—	—	TO-98
2N5366	Si, p-n-p, ПЭ	360	250	40	4	300 (500*)	≤0,1 (40 В)	≥40* (5 В; 0,3 А)	≤8 (10 В)	≤3,3	—	—	TO-98
2SA467	Si, p-n-p, ПЭ	300	≥100	40	5	400	≤0,1 (20 В)	40...240* (1 В; 0,1 А)	≤15 (10 В)	≤2,5	—	—	R-67
КТ352А	Si, p-n-p, ПЭ	300 (30°C)	≥200	20	5	200*	≤1 (10 В)	25...120* (1 В; 0,2 А)	≤15 (5 В)	≤3	—	—	17а
КТ352Б	Si, p-n-p, ПЭ	300 (30°C)	≥200	20	5	200*	≤1 (10 В)	70...300* (1 В; 0,2 А)	≤15 (5 В)	≤3	—	≤150*	17а

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^*_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, мкА	$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r^*_б$, $r^{**}_{бэ\,нас}$, Ом	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
2N869	Si, p-n-p, ПЭ	360	⩾100	25	5	100	⩽0,1 (15 В)	20...120* (5 В; 10 мА)	⩽9 (10 В)	⩽100	—	—	ТО-18
2N995	Si, p-n-p, ПЭ	360	⩾100	20	4	120	⩽0,05 (15 В)	⩾50* (1 В; 50 мА)	⩽10 (10 В)	⩽10	—	—	ТО-18
2N996	Si, p-n-p, ПЭ	360	⩾100	15	4	200	⩽10 (15 В)	⩾35* (1 В; 20 мА)	⩽10 (10 В)	⩽5	—	—	ТО-18
2N2411	Si, p-n-p, ПЭ	300	200	25	5	100	0,01* (25 В)	20...60* (0,5 В; 10 мА)	⩽5 (5 В)	⩽5	—	—	ТО-18
2N2412	Si, p-n-p, ПЭ	300	200	25	5	100	0,01* (25 В)	40...120* (0,5 В; 10 мА)	⩽5 (5 В)	⩽5	—	—	ТО-18
2SA500	Si, p-n-p, ПЭ	250	⩾100	30	5	100	⩽0,5 (15 В)	30...200* (1 В; 10 мА)	⩽7 (10 В)	⩽40	—	250*	ТО-18
BCY72	Si, p-n-p, ПЭ	350	⩾200	25	5	200*	⩽0,5 (25 В)	⩾50* (1 В; 50 мА)	⩽6 (10 В)	⩽10	⩽6 (1 кГц)	⩽350*	ТО-18
2SA741H	Si, p-n-p, ПЭ	300	⩾100	20	4	100	⩽0,2 (16 В)	30...120* (0,5 В; 30 мА)	—	—	⩽33**	⩽120*	ТО-18
2N3248	Si, p-n-p, ПЭ	360	⩾250	15	5	200	⩽0,05 (10 В)	⩾25* (1 В; 0,1 А)	⩽8	⩽4	—	⩽60*	ТО-18
2SA559	Si, p-n-p, ПЭ	350	⩾100	20	5	200	⩽0,5 (10 В)	50* (1 В; 10 мА)	—	⩽3	—	90*	ТО-18
BC355	Si, p-n-p, П	310	⩾200	30	4	200	—	63...370* (15 В; 10 мА)	⩽4,5 (5 В)	⩽60	—	—	ТО-92
BC355A	Si, p-n-p, П	310	⩾200	30	4	200	—	63...150* (15 В; 10 мА)	⩽4,5 (5 В)	⩽60	—	—	ТО-92
КТ345А	Si, p-n-p, ПЭ	300 (600**)	⩾350	20* (10 к)	5	200 (300*)	⩽0,5 (20 В)	⩾20* (1 В; 100 мА)	⩽15 (5 В)	⩽3	—	⩽70*	17а
КТ345Б	Si, p-n-p, ПЭ	300 (600**)	⩾350	20* (10 к)	5	200 (300*)	⩽0,5 (20 В)	⩾50* (1 В; 100 мА)	⩽15 (5 В)	⩽3	—	⩽70*	17а
КТ345В	Si, p-n-p, ПЭ	300 (600**)	⩾350	20* (10 к)	5	200 (300*)	⩽0,5 (20 В)	⩾70* (1 В; 100 мА)	⩽15 (5 В)	⩽3	—	⩽70*	17а
2N3702	Si, p-n-p, ПЭ	300	⩾100	40	5	200(600*)	⩽0,1 (20 В)	60...300* (5 В; 50 мА)	⩽12 (10 В)	⩽5	—	⩽290**	ТО-92
2N5447	Si, p-n-p, ПЭ	300	⩾100	40	5	200	⩽0,1 (20 В)	60...300* (5 В; 50 мА)	⩽12 (10 В)	⩽5	—	—	Х-55
2SA568	Si, p-n-p, ПЭ	200	120	35	4	300	1	35...300* (2 В; 0,15 А)	10	—	—	—	ТО-92
2SA781K	Si, p-n-p, Э	200	550	20	4	200	⩽0,2 (16 В)	20...200* (0,5 В; 30 мА)	—	⩽17	⩽33**	⩽120*	ТО-92
BC513	Si, p-n-p, ПЭ	300	⩾200	30	5	200	0,15	⩾80 (5 В; 2 мА)	5	—	—	—	Х-55
2N3249	Si, p-n-p, ПЭ	360	⩾300	15	5	200	⩽0,05 (10 В)	⩾35* (1 В; 0,1 А)	⩽8	⩽4,5	—	⩽60*	ТО-18
КТ361А	Si, p-n-p, ПЭ	150 (35°С)	⩾250	25	4	50	⩽1 (10 В)	20...90* (10 В; 1 мА)	⩽9 (10 В)	⩽20	⩽40*	⩽500	16
КТ361Б	Si, p-n-p, ПЭ	150 (35°С)	⩾250	20	4	50	⩽1 (10 В)	50...350* (10 В; 1 мА)	⩽9 (10 В)	⩽20	⩽40*	⩽500	16
КТ361В	Si, p-n-p, ПЭ	150 (35°С)	⩾250	40	4	50	⩽1 (10 В)	40...160* (10 В; 1 мА)	⩽7 (10 В)	⩽20	⩽40*	⩽1000	16
КТ361Г	Si, p-n-p, ПЭ	150 (35°С)	⩾250	35	4	50	⩽1 (10 В)	50...350* (10 В; 1 мА)	⩽7 (10 В)	⩽20	⩽40*	⩽500	16
КТ361Д	Si, p-n-p, ПЭ	150 (35°С)	⩾250	40	4	50	⩽1 (10 В)	20...90* (10 В; 1 мА)	⩽7 (10 В)	⩽50	—	⩽250	16
КТ361Е	Si, p-n-p, ПЭ	150 (35°С)	⩾250	35	4	50	⩽1 (10 В)	50...350* (10 В; 1 мА)	⩽7 (10 В)	⩽50	—	⩽1000	16
КТ361Ж	Si, p-n-p, ПЭ	150	⩾250	10	4	50	⩽1 (10 В)	50...350* (10 В; 1 мА)	⩽9 (10 В)	⩽50	—	⩽100	16
КТ361И	Si, p-n-p, ПЭ	150	⩾250	15	4	50	⩽1 (10 В)	⩾250 (10 В; 1 мА)	⩽9 (10 В)	⩽50	—	⩽1000	16
КТ361К	Si, p-n-p, ПЭ	150	⩾250	60	4	50	⩽1 (10 В)	50...350* (10 В; 1 мА)	⩽7 (10 В)	⩽50	—	⩽500	16
BC250A	Si, p-n-p, ПЭ	300	180	20	5	100	⩽0,1 (15 В)	35...100* (10 В; 1 мА)	⩽3 (10 В)	⩽14	—	—	ТО-92
BC250B	Si, p-n-p, ПЭ	300	180	20	5	100	⩽0,1 (15 В)	80...250* (10 В; 1 мА)	⩽3 (10 В)	⩽14	—	—	ТО-92

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^{*}_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^{*}_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^{*}_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, мкА	$h_{21э}$, $h_{21Э}$	$C_{к}$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$К_{ш}$, дБ, $r^{*}_{б}$, $r^{**}_{бэ\,нас}$, Ом	$\tau_{к}$, пс, $t^{*}_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
2N3905	Si, p-n-p, ПЭ	310	≥200	40	5	200	≤10 (40 В)	50...150* (10 В; 1 мА)	≤4,5 (5 В)	≤25	≤5 (1 кГц)	≤200*	TO-92
2N3906	Si, p-n-p, ПЭ	310	≥250	40	5	200	≤10 (40 В)	100...300 (10 В; 1 мА)	≤4,5 (5 В)	≤25	≤4 (1 кГц)	≤225*	TO-92
BSW20	Si, p-n-p, ПЭ	300	≥150	35	5	100	≤0,02 (25 В)	50...300* (1 В; 10 мА)	≤7 (10 В)	≤18	—	≤800**	TO-92
2SA555	Si, p-n-p, ПЭ	200	200	50	5	200	≤1 (10 В)	80* (1 В; 10 мА)	5,5 (6 В)	—	—	—	X-20
2SA556	Si, p-n-p, ПЭ	200	200	35	5	200	≤1 (10 В)	80* (1 В; 10 мА)	5,5 (6 В)	—	—	—	X-20
BCW62A	Si, p-n-p, ПЭ	225	≥200	60	5	200	≤0,015 (30 В)	100...300 (5 В; 2 мА)	≤5(10 В)	≤6	≤10 (1 кГц)	—	U-94
BCW63A	Si, p-n-p, ПЭ	225	≥200	45	5	200	≤0,015 (30 В)	100...300 (5 В; 2 мА)	≤5(10 В)	≤6	≤10 (1 кГц)	—	U-94
BCW57	Si, p-n-p, П	200 (50°C)	150	50	6	200	10	≥125 (5 В; 2 мА)	—	≤75	—	—	MM-13
BCW58	Si, p-n-p, П	200 (50°C)	150	30	5	200	10	≥125 (5 В; 2 мА)	—	≤75	—	—	MM-13
BC157	Si, p-n-p, П	250	150	30	5	200	0,05	75...260 (5 В; 2 мА)	—	7,5	—	—	MM-10
BC557	Si, p-n-p, П	300	150	50	5	200	≤0,015 (30 В)	75...475 (5 В; 2 мА)	≤4,5 (10 В)	7,5	≤10 (1 кГц)	—	TO-92
2N4125	Si, p-n-p, ПЭ	310	≥200	30	4	200	≤0,05 (20 В)	50...150* (1 В; 2 мА)	≤4,5 (5 В)	≤8	≤5 (1 кГц)	140*	TO-92
КТ340А	Si, n-p-n, ПЭ	150 (85°C)	≥300	15	5	50	≤1 (15 В)	100...300* (1 В; 10 мА)	≤3 (5 В)	≤20	—	≤45; ≤10*	5
КТ340Б	Si, n-p-n, ПЭ	150 (85°C)	≥300	20	5	50	≤1 (20 В)	≥100* (1 В; 10 мА)	≤3,7 (5 В)	≤25	—	≤40; ≤15*	5
КТ340В	Si, n-p-n, ПЭ	150 (85°C)	≥300	15	5	50 (200*)	≤1 (15 В)	≥35* (2 В; 0,2 А)	≤3,7 (5 В)	≤2	—	≤85; ≤15*	5
КТ340Г	Si, n-p-n, ПЭ	150 (85°C)	≥300	15	5	75 (500*)	≤1 (15 В)	≥16* (2 В; 0,5 А)	≤3,7 (5 В)	≤1,2	—	≤85; ≤15*	5
КТ340Д	Si, n-p-n, ПЭ	150 (85°C)	≥300	15	5	50	≤1 (15 В)	≥40* (2 В; 0,2 А)	≤6 (5 В)	≤30	—	≤150; ≤75*	5
BSX38A	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥200	35	5	100	≤0,02 (25 В)	100...300* (1 В; 10 мА)	≤5 (10 В)	≤20	—	≤800**	TO-18
BSY38	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥200	20	5	100 (200*)	≤0,1 (20 В)	15...45* (1 В; 0,1 А)	≤5 (5 В)	≤25	—	≤16*	TO-18
BSY39	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥200	20	5	100 (200*)	≤0,1 (20 В)	200* (0,5 В; 50 мА)	≤5 (5 В)	≤25	—	≤45**	TO-18
2N743	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥300	20	5	200*	≤1* (20 В)	≥10* (1 В; 0,1 А)	≤5 (5 В)	≤10	—	≤14*	TO-18
2N744	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥300	20	5	200*	≤1* (20 В)	≥20* (1 В; 0,1 А)	≤5 (5 В)	≤10	—	≤18*	TO-18
BSY26	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥200	20	6	100 (200*)	0,025	20...60* (1 В; 10 мА)	≤6	≤35	—	≤130**	TO-18
BSY27	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥200	20	6	100 (200*)	0,025	40...120* (1 В; 10 мА)	≤6	≤35	—	≤130**	TO-18
BSY95	Si, n-p-n, ПЭ	150	≥200	20	5	100 (200*)	0,05	50...200* (10 мА)	≤6 (9 В)	≤35	—	≤50*	TO-18
BSY95A	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥200	20	5	100 (200*)	0,05 (16 В)	50...200* (10 мА)	≤6 (9 В)	≤35	—	≤50*	TO-18
2N834	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥350	40	5	200*	≤0,5 (20 В)	≥25* (1 В; 10 мА)	≤4 (10 В)	≤25	—	≤25*	TO-18
2N835	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥300	25	3	200*	≤0,5 (20 В)	40...120* (1 В; 10 мА)	≤4 (10 В)	≤30	—	≤35*	TO-18
2N2242	Si, n-p-n, ПЭ	360	≥250	20*	5	225	≤0,1 (20 В)	20...60* (1 В; 10 мА)	≤6	≤20	—	—	TO-18
2N706A	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥200	25	5	200	≤0,5 (5 В)	20...60* (1 В; 10 мА)	≤5 (5 В)	≤60	—	≤25*	TO-18
2N753	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥200	25	5	50	≤0,5 (15 В)	40...120* (1 В; 10 мА)	≤5 (5 В)	≤60	—	≤35*	TO-18
BSX53A	Si, n-p-n, ПЭ	130 (45°C)	≥200	35	5	100	≤0,013 (25 В)	100...300 (1 В; 10 мА)	≤5 (10 В)	≤20	—	≤800**	TO-18
SS106	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥200	25	5	200	≤0,05 (15 В)	18...560 (1 В; 10 мА)	5 (10 В)	≤50	—	≤75**	TO-18
SS108	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥300	40	5	200	≤0,05 (20 В)	18...560 (1 В; 10 мА)	5 (10 В)	≤50	—	≤75**	TO-18

Заказ № 1141

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\ max}$, $P^*_{K,\ т\ max}$, $P^{**}_{K,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^*_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ проб}$, В	$I_{K\ max}$, $I^*_{K\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, мкА	$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{кэ\ нас}$, Ом	$К_ш$, дБ, $r^*_б$, $r^{**}_{бэ\ нас}$, Ом	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
SS109	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥200	20	5	200	≤0,05 (15 В)	18...560 (1 В; 10 мА)	5 (10 В)	≤5	—	≤75**	ТО-18
2SC67	Si, n-p-n, ПЭ	360	≥200	40	5	200	≤0,1 (15 В)	≥30* (1 В; 10 мА)	4,5 (10 В)	≤25	—	≤20*	ТО-18
2SC68	Si, n-p-n, ПЭ	360	≥300	40	5	200	≤0,1 (15 В)	30...200* (1 В; 10 мА)	3,5 (10 В)	≤25	—	≤20*	ТО-18
2N784A	Si, n-p-n, ПЭ	360	≥300	40	5	200	≤0,025 (25 В)	25...150* (1 В; 10 мА)	≤3,5 (10 В)	≤19	—	≤15*	ТО-18
2N919	Si, n-p-n, ПЭ	360	≥200	25	5	200	—	20...60* (1 В; 10 мА)	≤7 (5 В)	≤20	—	≤25*	ТО-18
2N920	Si, n-p-n, ПЭ	360	≥200	25	5	200	—	40...120* (1 В; 10 мА)	≤7 (5 В)	≤20	—	≤25*	ТО-18
BSYP62	Si, n-p-n, ПЭ	360	≥200	25	5	200	—	≥20* (1 В; 10 мА)	≤6 (10 В)	≤60	—	≤75**	ТО-18
BSYP63	Si, n-p-n, ПЭ	360	≥300	40	5	200	—	30...120* (1 В; 10 мА)	≤6 (10 В)	≤40	—	≤75**	ТО-18
BSXP87	Si, n-p-n, ПЭ	360	≥300	40	5	200	—	30...120* (1 В; 10 мА)	≤6 (10 В)	≤3,5	—	≤40**	ТО-18
2N708	Si, n-p-n, ПЭ	360	≥300	40	5	200	≤0,025 (25 В)	30...120* (1 В; 10 мА)	≤6 (10 В)	≤40	—	≤25*	ТО-18
BSJ63	Si, n-p-n, ПЭ	360	≥300	40	5	—	≤0,025 (20 В)	≥30* (1 В; 10 мА)	≤6 (10 В)	≤40	—	≤70**	ТО-18
BC218	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥200	30	4	—	≤0,1 (20 В)	≥50* (5 В; 10 мА)	≤4 (10 В)	≤100	—	—	ТО-18
BC218A	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥200	45	5	—	≤0,05 (30 В)	≥50* (5 В; 10 мА)	≤4 (10 В)	≤100	—	—	ТО-18
BSX51	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥150	25	5	200	≤0,5 (25 В)	75...225* (4,5 В; 2 мА)	≤8 (5 В)	≤6	—	≤200*	ТО-18
BSX52	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥150	25	5	200	≤0,5 (25 В)	180...540* (4,5 В; 2 мА)	≤8 (5 В)	≤6	—	≤200*	ТО-18
BFX44	Si, n-p-n, ПЭ	360	≥300	40	4	125 (250*)	≤0,1 (20 В)	≥20* (1 В; 0,1 А)	≤4 (5 В)	≤6	—	≤40; ≤30*	ТО-18
КТ306А	Si, n-p-n, ПЭ	150 (90°С)	≥300	15	4	30 (50*)	≤0,5 (15 В)	20...60* (1 В; 10 мА)	≤5 (5 В)	≤30	—	≤30*	15б
КТ306АМ	Si, n-p-n, ПЭ	150 (90°С)	≥300	15	4	30 (50*)	≤0,5 (15 В)	20...60* (1 В; 10 мА)	≤5 (5 В)	≤30	—	≤30*	17а
КТ306Б	Si, n-p-n, ПЭ	150 (90°С)	≥500	15	4	30 (50*)	≤0,5 (15 В)	40...120* (1 В; 10 мА)	≤5 (5 В)	≤30	—	≤30*	15б
КТ306БМ	Si, n-p-n, ПЭ	150 (90°С)	≥500	15	4	30 (50*)	≤0,5 (15 В)	40...120* (1 В; 10 мА)	≤5 (5 В)	≤30	—	≤30*	17а
КТ306В	Si, n-p-n, ПЭ	150 (90°С)	≥300	15	4	30 (50*)	≤0,5 (15 В)	20...100* (1 В; 10 мА)	≤5 (5 В)	—	≤30*	≤500	15б
КТ306ВМ	Si, n-p-n, ПЭ	150 (90°С)	≥300	15	4	30 (50*)	≤0,5 (15 В)	20...100* (1 В; 10 мА)	≤5 (5 В)	—	≤30*	≤500	17а
КТ306Г	Si, n-p-n, ПЭ	150 (90°С)	≥500	15	4	30 (50*)	≤0,5 (15 В)	40...200* (1 В; 10 мА)	≤5 (5 В)	—	≤30*	≤500	15б
КТ306ГМ	Si, n-p-n, ПЭ	150 (90°С)	≥500	15	4	30 (50*)	≤0,5 (15 В)	40...200* (1 В; 10 мА)	≤5 (5 В)	—	≤30*	≤500	17а
КТ306Д	Si, n-p-n, ПЭ	150 (90°С)	≥200	15	4	30 (50*)	≤0,5 (15 В)	30...150* (1 В; 10 мА)	≤5 (5 В)	—	≤30*	≤300	15б
КТ306ДМ	Si, n-p-n, ПЭ	150 (90°С)	≥200	15	4	30 (50*)	≤0,5 (15 В)	30...150* (1 В; 10 мА)	≤5 (5 В)	—	≤30*	≤300	17а
BSX66	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥200	80	5	100	0,01	≥40* (10 мА)	≤5	—	—	≤100*	ТО-18
BSX67	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥200	30	5	100	0,01	≥60* (10 мА)	≤5	—	—	≤100*	ТО-18
MPS834	Si, n-p-n, Э	310	≥350	30*	5	200*	≤0,5 (20 В)	≥20* (1 В; 10 мА)	≤4 (10 В)	≤25	≤90**	≤25	ТО-92
MPS2713	Si, n-p-n, Э	310	250	18	5	200*	≤0,5 (18 В)	30...90* (4,5 В; 2 мА)	2,5 (10 В)	≤6	≤26**	12*	ТО-92
MPS2714	Si, n-p-n, Э	310	250	18	5	200*	≤0,5 (18 В)	75...225* (4,5 В; 2 мА)	2,5 (10 В)	≤6	≤26**	12*	ТО-92

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^*_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, мкА	$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r^*_б$, $r^{**}_{бэ\,нас}$, Ом	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
2SC170	Si, n-p-n, ПЭ	110	250	25	3	50	≤0,5	60* (6 В; 10 мА)	5	—	—	—	ТО-18
2SC171	Si, n-p-n, ПЭ	200	250	25	3	50	≤0,5 (20 В)	60* (6 В; 10 мА)	5 (6 В)	≤20	—	—	ТО-18
2SC172	Si, n-p-n, ПЭ	300	350	25	3	50	≤0,1 (20 В)	60* (6 В; 10 мА)	5 (6 В)	≤20	—	—	ТО-18
2SC400	Si, n-p-n, ПЭ	250	300	30	5	100	≤0,5 (15 В)	30* (10 В; 10 мА)	≤6 (10 В)	≤50	—	200*	ТО-18
2SC601	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥500	40	5	100	0,1	40* (1 В; 10 мА)	≤4	≤25	—	≤13*	ТО-18
КТ316А	Si, n-p-n, ПЭ	150 (90°C)	≥600	10* (3 к)	4	50	≤0,5 (10 В)	20...60* (1 В; 10 мА)	≤3 (5 В)	≤40	—	≤10*	5а
КТ316АМ	Si, n-p-n, ПЭ	150 (90°C)	≥600	10* (3 к)	4	50	≤0,5 (10 В)	20...60* (1 В; 10 мА)	≤3 (5 В)	≤40	—	≤10*	17а
КТ316Б	Si, n-p-n, ПЭ	150 (90°C)	≥800	10* (3 к)	4	50	≤0,5 (10 В)	40...120* (1 В; 10 мА)	≤3 (5 В)	≤40	—	≤10*	5а
КТ316БМ	Si, n-p-n, ПЭ	150 (90°C)	≥800	10* (3 к)	4	50	≤0,5 (10 В)	40...120* (1 В; 10 мА)	≤3 (5 В)	≤40	—	≤10*	17а
КТ316В	Si, n-p-n, ПЭ	150 (90°C)	≥800	10* (3 к)	4	50	≤0,5 (10 В)	40...120* (1 В; 10 мА)	≤3 (5 В)	≤40	—	≤15*	5а
КТ316ВМ	Si, n-p-n, ПЭ	150 (90°C)	≥800	10* (3 к)	4	50	≤0,5 (10 В)	40...120* (1 В; 10 мА)	≤3 (5 В)	≤40	—	≤15*	17а
КТ316Г	Si, n-p-n, ПЭ	150 (90°C)	≥600	10* (3 к)	4	50	≤0,5 (10 В)	20...100* (1 В; 10 мА)	≤3 (5 В)	≤40	—	≤150	5а
КТ316ГМ	Si, n-p-n, ПЭ	150 (90°C)	≥600	10* (3 к)	4	50	≤0,5 (10 В)	20...100* (1 В; 10 мА)	≤3 (5 В)	≤40	—	≤150	17а
КТ316Д	Si, n-p-n, ПЭ	150 (90°C)	≥800	10* (3 к)	4	50	≤0,5 (10 В)	60...300* (1 В; 10 мА)	≤3 (5 В)	≤40	—	≤150	5а
КТ316ДМ	Si, n-p-n, ПЭ	150 (90°C)	≥800	10* (3 к)	4	50	≤0,5 (10 В)	60...300* (1 В; 10 мА)	≤3 (5 В)	≤40	—	≤150	17а
2N3010	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥600	11	4	50	≤10 (15 В)	25...125* (0,4 В; 10 мА)	≤3 (5 В)	≤25	—	≤6*	ТО-18
2N709	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥600	15	4	200	≤0,05 (5 В)	20...120* (0,5 В; 10 мА)	≤3 (5 В)	≤100	—	≤6*	ТО-18
2N2475	Si, n-p-n, П	300	≥600	15	5	90	≤0,05 (5 В)	30...150* (0,35 В; 10 мА)	≤3 (5 В)	≤25	—	≤6*	R-64
ZT2475	Si, n-p-n, П	300	≥600	15	5	90	≤0,05 (5 В)	40...150* (0,4 В; 20 мА)	≤2 (5 В)	≤20	—	≤6*	R-64
2N2784	Si, n-p-n, ПЭ	300	1000	15	4	—	0,005 (5 В)	40...120* (0,5 В; 10 мА)	≤3	87	—	≤5*	ТО-18
2SC40	Si, n-p-n, М	250	750	25	3	50	0,1	50 (6 В; 1 мА)	2,3	—	—	—	ТО-18
2N709A	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥800	15	4	200	≤0,05 (5 В)	30...90* (0,5 В; 10 мА)	≤3 (5 В)	≤100	—	≤6*	ТО-18
MM1748	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥600	15	4	100	≤0,05 (5 В)	20...120* (0,5 В; 10 мА)	≤3 (5 В)	≤100	—	≤6*	ТО-52
КТ342А	Si, n-p-n, ПЭ	250	≥250	35	5	50 (300*)	≤0,05 (25 В)	100...250* (5 В; 1 мА)	≤8 (5 В)	≤10	—	≤200	5
КТ342АМ	Si, n-p-n, ПЭ	250	≥250	35	5	50 (300*)	≤0,05 (25 В)	100...250* (5 В; 1 мА)	≤8 (5 В)	≤10	—	≤200	17а
КТ342Б	Si, n-p-n, ПЭ	250	≥300	30	5	50 (300*)	≤0,05 (20 В)	200...500* (5 В; 1 мА)	≤8 (5 В)	≤10	—	≤300	5
КТ342БМ	Si, n-p-n, ПЭ	250	≥300	30	5	50 (300*)	≤0,05 (20 В)	200...500* (5 В; 1 мА)	≤8 (5 В)	≤10	—	≤300	17а
КТ342В	Si, n-p-n, ПЭ	250	≥300	25	5	50 (300*)	≤0,05 (10 В)	400...1000* (5 В; 1 мА)	≤8 (5 В)	≤10	—	≤700	5
КТ342ВМ	Si, n-p-n, ПЭ	250	≥300	25	5	50 (300*)	≤0,05 (10 В)	400...1000* (5 В; 1 мА)	≤8 (5 В)	≤10	—	≤700	17а

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^*_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, мкА	$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r^*_б$, $r^{**}_{бэ\,нас}$, Ом	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
2N929	Si, n-p-n, П	300	≥50	45	5	30 (60*)	≤0,01 (45 В)	60* (5 В; 0,5 мА)	≤8 (5 В)	≤100	≤4 (1 кГц)	—	TO-18
2N930	Si, n-p-n, П	300	≥50	45	5	30 (60*)	≤0,01 (45 В)	150* (5 В; 0,5 мА)	≤8 (5 В)	≤100	≤3 (1 кГц)	—	TO-18
BC107A	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥150	50	6	100 (200*)	≤0,015* (50В)	120...220* (5 В; 2 мА)	≤6 (10 В)	≤20	≤10 (1 кГц)	—	TO-18
BC107B	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥150	50	6	100 (200*)	≤0,015* (50В)	180...460* (5 В; 2 мА)	≤6 (10 В)	≤20	≤10 (1 кГц)	—	TO-18
BC108A	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥150	30	5	100 (200*)	≤0,015 (30 В)	120...220* (5 В; 2 мА)	≤6 (10 В)	≤20	≤10 (1 кГц)	—	TO-18
BC108B	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥150	30	5	100 (200*)	≤0,015 (30 В)	180...460* (5 В; 2 мА)	≤6 (10 В)	≤20	≤10 (1 кГц)	—	TO-18
BC108C	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥150	30	5	100 (200*)	≤0,015 (30 В)	380...800* (5 В; 2 мА)	≤6 (10 В)	≤20	≤10 (1 кГц)	—	TO-18
BC109B	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥150	30	5	50	≤0,015 (30 В)	180...460* (5 В; 2 мА)	≤6 (10 В)	≤20	≤4 (1 кГц)	—	TO-18
BC109C	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥150	30	5	50	≤0,015 (30 В)	380...800* (5 В; 2 мА)	≤6 (10 В)	≤20	≤4 (1 кГц)	—	TO-18
2N915	Si, n-p-n, ПЭ	360	≥250	70	5	200	≤0,01 (60 В)	50...200* (5 В; 10 мА)	≤3,5 (10 В)	≤100	—	—	TO-18
2N916	Si, n-p-n, ПЭ	360	≥300	45	5	100	≤0,01 (30 В)	50...200* (5 В; 10 мА)	≤6 (5 В)	≤50	—	≤300	TO-18
BCY58A	Si, n-p-n, ПЭ	300	300	32*	7	200	≤0,01 (32 В)	125...250* (5 В; 2 мА)	≤6 (10 В)	≤6	≤6 (1 кГц)	≤800**	TO-18
BCY58B	Si, n-p-n, ПЭ	300	300	32*	7	200	≤0,01 (32 В)	175...350* (5 В; 2 мА)	≤6 (10 В)	≤6	—	—	TO-18
BCY58C	Si, n-p-n, ПЭ	300	300	32*	7	200	≤0,01 (32 В)	250...500* (5 В; 2 мА)	≤6 (10 В)	≤6	—	—	TO-18
BCY58D	Si, n-p-n, ПЭ	300	300	32*	7	200	≤0,01 (32 В)	350...700* (5 В; 2 мА)	≤6 (10 В)	≤6	—	—	TO-18
KC507	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥150	45	5	100 (200*)	≤0,015 (45 В)	125...500 (5 В; 2 мА)	≤4,5 (10 В)	25	≤10 (1 кГц)	—	TO-18
KC508	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥150	20	5	100 (200*)	≤0,015 (20 В)	125...500 (5 В; 2 мА)	≤4,5 (10 В)	25	≤10 (1 кГц)	—	TO-18
KC509	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥150	20	5	100 (200*)	≤0,015 (20 В)	240...900 (5 В; 2 мА)	≤4,5 (10 В)	25	≤4 (1 кГц)	—	TO-18
SF136D	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥300	20	5	200	≤0,1 (20 В)	112...280* (1 В; 10 мА)	≤5 (10 В)	≤30	7,8 (1 кГц)	≤300	TO-18
SF136E	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥300	20	5	200	≤0,1 (20 В)	224...560* (1 В; 10 мА)	≤5 (10 В)	≤30	7,8 (1 кГц)	≤300	TO-18
SF136F	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥300	20	5	200	≤0,1 (20 В)	450...1120* (1 В; 10 мА)	≤5 (10 В)	≤30	7,8 (1 кГц)	≤300	TO-18
SF137D	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥300	40	5	200	≤0,1 (40 В)	112...280* (1 В; 10 мА)	≤5 (10 В)	≤30	6,8 (1 кГц)	≤130	TO-18
SF137E	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥300	40	5	200	≤0,1 (40 В)	224...560* (1 В; 10 мА)	≤5 (10 В)	≤30	6,8 (1 кГц)	≤130	TO-18
SF137F	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥300	40	5	200	≤0,1 (40 В)	450...1120* (1 В; 10 мА)	≤5 (10 В)	≤30	6,8 (1 кГц)	≤130	TO-18
BFJ93	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥30	50	5	100	≤0,01 (45 В)	150...600 (5 В; 1 мА)	6 (5 В)	≤14	≤4 (1 кГц)	—	TO-18
BC234	Si, n-p-n, П	300	≥200	30	4	—	≤0,1 (20 В)	90...180* (5 В; 10 мА)	≤4 (10 В)	≤100	—	—	TO-18
BC234A	Si, n-p-n, П	300	≥200	45	5	—	≤0,05 (30 В)	90...180* (5 В; 10 мА)	≤4 (10 В)	≤100	—	—	TO-18
BC235	Si, n-p-n, П	300	≥200	30	4	—	≤0,1 (20 В)	150...400* (5 В; 10 мА)	≤4 (10 В)	≤100	—	—	TO-18
BC235A	Si, n-p-n, П	300	≥200	45	5	—	≤0,05 (30 В)	150...400* (5 В; 10 мА)	≤4 (10 В)	≤100	—	—	TO-18
BCY69	Si, n-p-n, П	300	≥150	20	5	100	≤0,015 (20 В)	450* (5 В; 2 мА)	≤8 (5 В)	≤25	≤5 (1 кГц)	—	TO-18
BSX79A	Si, n-p-n, ПЭ	345 (45°C)	≥200	50	5	100 (200*)	≤0,01 (25 В)	100...300 (1 В; 10 мА)	≤5 (10 В)	≤6	—	≤800*	TO-18
BSX79B	Si, n-p-n, ПЭ	345 (45°C)	≥200	50	5	100 (200*)	≤0,01 (25 В)	250...750 (1 В; 10 мА)	≤5 (10 В)	≤6	—	≤800*	TO-18
КТ3102А	Si, n-p-n, ПЭ	250	≥150	50	5	100 (200*)	≤0,05 (50 В)	100...200 (5 В; 2 мА)	≤6 (5 В)	—	≤10 (1 кГц)	≤100	17а
КТ3102Б	Si, n-p-n, ПЭ	250	≥150	50	5	100 (200*)	≤0,05 (50 В)	200...500 (5 В; 2 мА)	≤6 (5 В)	—	≤10 (1 кГц)	≤100	17а
КТ3102В	Si, n-p-n, ПЭ	250	≥150	30	5	100 (200*)	≤0,015 (30 В)	200...500 (5 В; 2 мА)	≤6 (5 В)	—	≤10 (1 кГц)	≤100	17а
КТ3102Г	Si, n-p-n, ПЭ	250	≥300	20	5	100 (200*)	≤0,015 (20 В)	400...1000 (5 В; 2 мА)	≤6 (5 В)	—	≤10 (1 кГц)	≤100	17а
КТ3102Д	Si, n-p-n, ПЭ	250	≥150	30	5	100 (200*)	≤0,015 (30 В)	200...500 (5 В; 2 мА)	≤6 (5 В)	—	≤4 (1 кГц)	≤100	17а
КТ3102Е	Si, n-p-n, ПЭ	250	≥300	20	5	100 (200*)	≤0,015 (20 В)	400...1000 (5 В; 2 мА)	≤6 (5 В)	—	≤4 (1 кГц)	≤100	17а
BC182A	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥150	60	6	200	≤0,015 (50 В)	120...220 (5 В; 2 мА)	≤5 (10 В)	≤25	≤10 (1 кГц)	—	TO-92
BC182B	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥150	60	6	200	≤0,015 (50 В)	180...460 (5 В; 2 мА)	≤5 (10 В)	≤25	≤10 (1 кГц)	—	TO-92

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^*_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭК}$, мкА	$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$К_ш$, дБ, $r^*_б$, $r^{**}_{бэ\,нас}$, Ом	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
BC182C	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥150	60	6	200	≤0,015 (50 В)	380...800 (5 В; 2 мА)	≤5 (10 В)	≤25	≤10 (1 кГц)	—	TO-92
BC183A	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥150	45	6	200	≤0,015 (30 В)	120...220 (5 В; 2 мА)	≤5 (10 В)	≤25	≤10 (1 кГц)	—	TO-92
BC183B	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥150	45	6	200	≤0,015 (30 В)	180...460 (5 В; 2 мА)	≤5 (10 В)	≤25	≤10 (1 кГц)	—	TO-92
BC183C	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥150	45	6	200	≤0,015 (30 В)	380...800 (5 В; 2 мА)	≤5 (10 В)	≤25	≤10 (1 кГц)	—	TO-92
BC237A	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥150	50*	6	100 (200*)	≤0,015 (50 В)	120...220 (5 В; 2 мА)	≤4,5 (10 В)	≤6	≤10 (1 кГц)	—	TO-92
BC237B	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥150	50*	6	100 (200*)	≤0,015 (50 В)	180...460 (5 В; 2 мА)	≤4,5 (10 В)	≤6	≤10 (1 кГц)	—	TO-92
BC238A	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥150	30*	5	100 (200*)	≤0,015 (30 В)	120...220 (5 В; 2 мА)	≤4,5 (10 В)	≤6	≤10 (1 кГц)	—	TO-92
BC238B	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥150	30	5	100 (200*)	≤0,015 (30 В)	180...460 (5 В; 2 мА)	≤4,5 (10 В)	≤6	≤10 (1 кГц)	—	TO-92
BC238C	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥150	30	5	100 (200*)	≤0,015 (30 В)	380...800 (5 В; 2 мА)	≤4,5 (10 В)	≤6	≤10 (1 кГц)	—	TO-92
BC239B	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥150	20*	5	50	≤0,015 (30 В)	180...460 (5 В; 2 мА)	≤4,5 (10 В)	≤6	≤4 (1 кГц)	—	TO-92
BC239C	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥150	20*	5	50	≤0,015 (30 В)	380...800 (5 В; 2 мА)	≤4,5 (10 В)	≤6	≤4 (1 кГц)	—	TO-92
BC107AP	Si, n-p-n, ПЭ	300	300	50	6	200	≤0,1 (20 В)	125...260 (5 В; 2 мА)	≤4,5 (10 В)	≤25	≤10 (1 кГц)	—	X-55
BC107BP	Si, n-p-n, ПЭ	300	300	50	6	200	≤0,1 (20 В)	240...500 (5 В; 2 мА)	≤4,5 (10 В)	≤25	≤10 (1 кГц)	—	X-55
BC108AP	Si, n-p-n, ПЭ	300	300	30	5	200	≤0,1 (20 В)	125...260 (5 В; 2 мА)	≤4,5 (10 В)	≤25	≤10 (1 кГц)	—	X-55
BC108BP	Si, n-p-n, ПЭ	300	300	30	5	200	≤0,1 (20 В)	240...500 (5 В; 2 мА)	≤4,5 (10 В)	≤25	≤10 (1 кГц)	—	X-55
BC108CP	Si, n-p-n, ПЭ	300	300	30	5	200	≤0,1 (20 В)	450...900 (5 В; 2 мА)	≤4,5 (10 В)	≤25	≤10 (1 кГц)	—	X-55
BC109BP	Si, n-p-n, ПЭ	300	300	30	5	200	≤0,1 (20 В)	240...500 (5 В; 2 мА)	≤4,5 (10 В)	≤25	≤4 (1 кГц)	—	X-55
BC109CP	Si, n-p-n, ПЭ	300	300	30	5	200	≤0,1 (20 В)	450...900 (5 В; 2 мА)	≤4,5 (10 В)	≤25	≤4 (1 кГц)	—	X-55
BC184A	Si, n-p-n, ПЭ	300	280	45	6	200	≤0,015 (30 В)	240...500 (5 В; 2 мА)	≤5 (10 В)	≤25	≤4 (1 кГц)	—	X-55
BC184B	Si, n-p-n, ПЭ	300	280	45	6	200	≤0,015 (30 В)	450...900 (5 В; 2 мА)	≤5 (10 В)	≤25	≤4 (1 кГц)	—	X-55
BC382B	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥150	50	6	100	≤0,015 (30 В)	240...500 (5 В; 2 мА)	≤5 (10 В)	≤6	≤6 (10 кГц)	—	X-55
BC382C	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥150	50	6	100	≤0,015 (30 В)	450...900 (5 В; 2 мА)	≤5 (10 В)	≤6	≤6 (10 кГц)	—	X-55
BC383B	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥150	45	6	100	≤0,015 (30 В)	240...500 (5 В; 2 мА)	≤5 (10 В)	≤6	≤6 (10 кГц)	—	X-55
BC383C	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥150	45	6	100	≤0,015 (30 В)	450...900 (5 В; 2 мА)	≤5 (10 В)	≤6	≤6 (10 кГц)	—	X-55
BC384B	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥150	45	6	100	≤0,015 (30 В)	240...500 (5 В; 2 мА)	≤5 (10 В)	≤6	≤4 (10 кГц)	—	X-55
BC384C	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥150	45	6	100	≤0,015 (30 В)	450...900 (5 В; 2 мА)	≤5 (10 В)	≤6	≤4 (10 кГц)	—	X-55
2SC1000GTM	Si, n-p-n, ПЭ	400	80	60	5	150	≤0,1 (60 В)	200...700 (6 В; 2 мА)	≤10 (6 В)	≤6	≤10 (1 кГц)	—	TO-92
2SC1815	Si, n-p-n, Э	400	≥80	60	5	150	≤0,1 (60 В)	70...700 (6 В; 2 мА)	≤3 (10 В)	≤2,5	≤10 (1 кГц)	—	TO-92
BCY59-VII	Si, n-p-n, ПЭ	440	≥125	45*	7	200	≤0,01* (45 В)	120...220 (5 В; 2 мА)	≤6 (10 В)	≤7	≤6 (1 кГц)	≤800**	TO-18
BCY59-VIII	Si, n-p-n, ПЭ	440	≥125	45*	7	200	≤0,01* (45 В)	180...310 (5 В; 2 мА)	≤6 (10 В)	≤7	≤6 (1 кГц)	≤800**	TO-18
BCY59-IX	Si, n-p-n, ПЭ	440	≥125	45*	7	200	≤0,01* (45 В)	250...460 (5 В; 2 мА)	≤6 (10 В)	≤7	≤6 (1 кГц)	≤800**	TO-18
BCY59-X	Si, n-p-n, ПЭ	440	≥125	45*	7	200	≤0,01* (45 В)	380...630 (5 В; 2 мА)	≤6 (10 В)	≤7	≤6 (1 кГц)	≤800**	TO-18
2N4123	Si, n-p-n, ПЭ	350	≥250	40	5	200	≤0,05 (20 В)	50...200 (10 В; 2 мА)	≤4 (5 В)	≤6	≤5 (1 кГц)	—	TO-92
2N4124	Si, n-p-n, ПЭ	350	≥300	30	5	200	≤0,05 (20 В)	120...480 (10 В; 2 мА)	≤4 (5 В)	≤6	≤6 (1 кГц)	—	TO-92
2N3711	Si, n-p-n, П	250	80	30	6	30	≤0,1 (20 В)	180...660 (5 В; 1 мА)	—	≤100	—	—	TO-92
2SC828	Si, n-p-n, ПЭ	250	220	30	5	50 (100*)	≤1 (10 В)	65...700 (5 В; 2 мА)	5	≤3,2	≤6 (1 кГц)	—	TO-92
2SC828A	Si, n-p-n, ПЭ	250	220	45	5	50 (100*)	≤1 (10 В)	65...700 (5 В; 2 мА)	5	≤3,2	≤6 (1 кГц)	—	TO-92
BCY56	Si, n-p-n, ПЭ	300	250	45	5	100 (200*)	≤0,1 (20 В)	100...450 (5 В; 2 мА)	4,5 (5 В)	—	≤5 (1 кГц)	—	TO-18
BCY57	Si, n-p-n, ПЭ	300	350	25	5	100 (200*)	≤0,1 (20 В)	200...800 (5 В; 2 мА)	4,5 (5 В)	—	≤5 (1 кГц)	—	TO-18
BC451	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥150	50	5	100	≤0,1 (30 В)	200...800 (5 В; 2 мА)	≤4,5 (10 В)	≤25	≤10 (1 кГц)	—	TO-92
BC452	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥150	30	5	100	≤0,1 (30 В)	200...800 (5 В; 2 мА)	≤4,5 (10 В)	≤25	≤10 (1 кГц)	—	TO-92
BC453	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥150	30	5	100	≤0,1 (30 В)	200...800 (5 В; 2 мА)	≤4,5 (10 В)	≤25	≤4 (15,7 кГц)	—	TO-92
2SC538	Si, n-p-n, ПЭ	300	180	25	5	100*	≤0,1 (10 В)	90...700 (5 В; 2 мА)	—	≤3,2	—	—	TO-92
2SC538A	Si, n-p-n, ПЭ	300	180	45	5	100*	≤0,1 (10 В)	90...700 (5 В; 2 мА)	—	≤3,2	—	—	TO-92

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^*_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, мкА	$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$К_ш$, дБ, $r^*_б$, $r^{**}_{бэ\,нас}$, Ом	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
2SC900	Si, n-p-n, Э	250	100	40	5	100	≤0,05 (40 В)	225...1000 (3 В; 0,5 мА)	3,5 (6 В)	≤3	—	—	TO-92
2SC923	Si, n-p-n, Э	250	100	30	5	30	≤0,05 (25 В)	150...1000 (3 В; 0,5 мА)	—	≤15	—	—	TO-92
2SC945	Si, n-p-n, Э	250	250	50	5	100	≤0,1 (40 В)	40...600 (6 В; 1 мА)	4,5 (6 В)	≤17	≤4 (1 кГц)	—	TO-92
2N5209	Si, n-p-n, ПЭ	310	80	50	4,5	50	≤0,05 (35 В)	150...600 (5 В; 1 мА)	≤4 (5 В)	≤70	≤4 (1 кГц)	—	TO-92
2N5210	Si, n-p-n, ПЭ	310	80	50	4,5	50	≤0,05 (35 В)	250...900 (5 В; 1 мА)	≤4 (5 В)	≤70	≤3 (1 кГц)	—	TO-92
SF131E	Si, n-p-n, П	300	≥200	20	5	50	≤0,1 (20 В)	224...560* (1 В; 10 мА)	≤5 (10 В)	≤50	≤7 (1 кГц)	≤300	A-4
SF131F	Si, n-p-n, П	300	≥200	20	5	50	≤0,1 (20 В)	450...1120* (1 В; 10 мА)	≤5 (10 В)	≤50	≤7 (1 кГц)	≤300	A-4
SF132F	Si, n-p-n, П	300	≥200	40	5	50	≤0,1 (40 В)	450...1120* (1 В; 10 мА)	≤5 (10 В)	≤50	≤7 (1 кГц)	≤300	A-4
SF132E	Si, n-p-n, П	300	≥200	40	5	50	≤0,1 (40 В)	224...560* (1 В; 10 мА)	≤5 (10 В)	≤50	≤7 (1 кГц)	≤300	A-4
BC547A	Si, n-p-n, П	300	300	50	6	100 (200*)	≤0,015 (30 В)	110...220* (5 В; 2 мА)	—	≤6	≤10 (1 кГц)	—	TO-92
BC547B	Si, n-p-n, П	300	300	50	6	100 (200*)	≤0,015 (30 В)	200...450* (5 В; 2 мА)	—	≤6	≤10 (1 кГц)	—	TO-92
BC547C	Si, n-p-n, П	300	300	50	6	100 (200*)	≤0,015 (30 В)	420...800* (5 В; 2 мА)	—	≤7,7	≤10 (1 кГц)	—	TO-92
BC548A	Si, n-p-n, П	300	300	30	5	100 (200*)	≤0,015 (30 В)	110...220* (5 В; 2 мА)	—	≤6	≤10 (1 кГц)	—	TO-92
B7548B	Si, n-p-n, П	300	300	30	5	100 (200*)	≤0,015 (30 В)	200...450* (5 В; 2 мА)	—	≤6	≤10 (1 кГц)	—	TO-92
BC548C	Si, n-p-n, П	300	300	30	5	100 (200*)	≤0,015 (30 В)	420...800* (5 В; 2 мА)	—	≤6	≤10 (1 кГц)	—	TO-92
BC549A	Si, n-p-n, П	300	300	30	5	100 (200*)	≤0,015 (30 В)	110...220* (5 В; 2 мА)	—	≤6	≤4 (1 кГц)	—	TO-92
BC549B	Si, n-p-n, П	300	300	30	5	100 (200*)	≤0,015 (30 В)	200...450* (5 В; 2 мА)	—	≤6	≤4 (1 кГц)	—	TO-92
BC549C	Si, n-p-n, П	300	300	30	5	100 (200*)	≤0,015 (30 В)	420...800* (5 В; 2 мА)	—	≤6	≤4 (1 кГц)	—	TO-92
BCY65-VII	Si, n-p-n, ПЭ	345	≥125	60	7	100	≤0,01 (60 В)	120...220 (5 В; 2 мА)	≤6 (5 В)	≤35	≤6 (1 кГц)	—	TO-18
BCY65-VIII	Si, n-p-n, ПЭ	345	≥125	60	7	100	≤0,01 (60 В)	180...310 (5 В; 2 мА)	≤6 (5 В)	≤35	≤6 (1 кГц)	—	TO-18
BCY65-IX	Si, n-p-n, ПЭ	345	≥125	60	7	100	≤0,01 (60 В)	250...460 (5 В; 2 мА)	≤6 (5 В)	≤35	≤6 (1 кГц)	—	TO-18
2N2483	Si, n-p-n, ПЭ	360	≥60	60	6	50	≤0,01 (45 В)	≥175 (5 В; 2 мА)	≤6 (5 В)	—	≤4 (1 кГц)	—	TO-18
2N2484	Si, n-p-n, ПЭ	360	≥60	60	6	50	≤0,01 (45 В)	≥250 (5 В; 1 мА)	≤6 (5 В)	—	≤3 (1 кГц)	—	TO-18
BC317	Si, n-p-n, П	625	≥100	50	6	150 (300*)	≤0,03 (20 В)	125...260 (5 В; 2 мА)	≤4 (10 В)	≤20	≤6 (1 кГц)	—	TO-92
BC318	Si, n-p-n, П	625	≥100	45	5	150 (300*)	≤0,03 (20 В)	240...500 (5 В; 2 мА)	≤4 (10 В)	≤20	≤6 (1 кГц)	—	TO-92
BC319	Si, n-p-n, П	625	≥100	30	5	150 (300*)	≤0,03 (20 В)	450...900 (5 В; 2 мА)	≤4 (10 В)	≤20	≤4 (1 кГц)	—	TO-92
BC521	Si, n-p-n, ПЭ	625	≥100	45	8	50	≤0,002 (30 В)	380...1550 (5 В; 1 мА)	≤3 (10 В)	≤20	≤6 (1 кГц)	—	TO-92
BC521C	Si, n-p-n, ПЭ	625	≥100	45	8	50	≤0,002 (30 В)	380...800 (5 В; 2 мА)	≤3 (10 В)	≤20	≤6 (1 кГц)	—	TO-92
MPS6571	Si, n-p-n, ПЭ	625	≥50	20	3	50	≤0,05 (20 В)	250...1000 (5 В; 0,1 мА)	≤4,5 (5 В)	≤50	—	—	TO-92
MPSA09	Si, n-p-n, ПЭ	625	≥30	50	3	100	≤100 (50 В)	100...600 (5 В; 0,1 мА)	≤5 (5 В)	≤90	—	—	TO-92
PN2484	Si, n-p-n, ПЭ	360	≥60	60	6	50	≤0,01 (45 В)	≥250* (5 В; 1 мА)	≤6 (5 В)	≤350	≤3 (1 кГц)	—	TO-92
2N4123	Si, n-p-n, ПЭ	625	≥250	40	5	200	≤0,05 (20 В)	50...200 (10 В; 2 мА)	≤4 (5 В)	≤6	≤6 (1 кГц)	—	TO-92
2N4124	Si, n-p-n, ПЭ	625	≥300	30	5	200	≤0,05 (20 В)	120...480 (10 В; 2 мА)	≤4 (5 В)	≤6	≤5 (1 кГц)	—	TO-92
MPS3707	Si, n-p-n, Э	310	≥100	30	6	30	≤0,1 (20 В)	100...400* (5 В; 0,1 мА)	—	≤100	≤5 (15,7 кГц)	—	TO-92
MPS3708	Si, n-p-n, Э	310	≥100	30	6	30	≤0,1 (20 В)	45...660* (5 В; 1 мА)	—	≤100	≤5 (15,7 кГц)	—	TO-92
MPS3709	Si, n-p-n, Э	310	≥100	30	6	30	≤0,1 (20 В)	45...165* (5 В; 1 мА)	—	≤100	≤5 (15,7 кГц)	—	TO-92
MPS3710	Si, n-p-n, Э	310	≥100	30	6	30	≤0,1 (20 В)	90...450* (5 В; 1 мА)	—	≤100	≤5 (15,7 кГц)	—	TO-92
MPS3711	Si, n-p-n, Э	310	≥100	30	6	30	≤0,1 (20 В)	180...800* (5 В; 1 мА)	—	≤100	≤5 (15,7 кГц)	—	TO-92
2SC454B	Si, n-p-n, Э	200	230	30	5	100	≤0,5 (18 В)	100...200 (12 В; 2 мА)	≤3,5 (10 В)	≤20	≤25 (1 кГц)	—	TO-92
2SC454C	Si, n-p-n, Э	200	230	30	5	100	≤0,5 (18 В)	160...320 (12 В; 2 мА)	≤3,5 (10 В)	≤20	≤25 (1 кГц)	—	TO-92
2SC454D	Si, n-p-n, Э	200	230	30	5	100	≤0,5 (18 В)	250...500 (12 В; 2 мА)	≤3,5 (10 В)	≤20	≤25 (1 кГц)	—	TO-92
2SC458	Si, n-p-n, Э	200	230	30	5	100	≤0,5 (18 В)	100...500 (12 В; 2 мА)	≤3,5 (10 В)	≤20	≤10 (1 кГц)	—	TO-92
2SC458LGB	Si, n-p-n, Э	200	230	30	5	100	≤0,5 (18 В)	100...200 (12 В; 2 мА)	≤3,5 (10 В)	≤20	≤5 (1 кГц)	—	TO-92
2SC458LGC	Si, n-p-n, Э	200	230	30	5	100	≤0,5 (18 В)	160...320 (12 В; 2 мА)	≤3,5 (10 В)	≤20	≤5 (1 кГц)	—	TO-92

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^{*}_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^{*}_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^{*}_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, мкА	$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r^{*}_б$, $r^{**}_{бэ\,нас}$, Ом	$\tau_к$, пс, $t^{*}_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
2SC458LGD	Si, n-p-n, Э	200	230	30	5	100	≤0,5 (18 В)	250...500 (12 В; 2 мА)	≤3,5 (10 В)	≤20	≤5 (1 кГц)	—	TO-92
2SC458KB	Si, n-p-n, Э	200	≥100	30	5	100	≤0,5 (18 В)	100...200 (1 В; 10 мА)	≤4 (10 В)	≤40	≤100**	260*	TO-92
2SC458KC	Si, n-p-n, Э	200	≥100	30	5	100	≤0,5 (18 В)	160...320 (1 В; 10 мА)	≤4 (10 В)	≤40	≤100**	260*	TO-92
2SC458KD	Si, n-p-n, Э	200	≥100	30	5	100	≤0,5 (18 В)	250...500 (1 В; 10 мА)	≤4 (10 В)	≤40	≤100**	260*	TO-92
MPS6512	Si, n-p-n, Э	350	250	40	4	100	≤0,05 (30 В)	50...100 (10 В; 2 мА)	≤3,5 (10 В)	≤10	2 (1 кГц)	—	TO-92
MPS6513	Si, n-p-n, Э	350	250	40	4	100	≤0,05 (30 В)	90...180 (10 В; 2 мА)	≤3,5 (10 В)	≤10	2 (1 кГц)	—	TO-92
MPS6514	Si, n-p-n, Э	350	390	40	4	100	≤0,05 (30 В)	150...300 (10 В; 2 мА)	≤3,5 (10 В)	≤10	2 (1 кГц)	—	TO-92
MPS6515	Si, n-p-n, Э	350	390	40	4	100	≤0,05 (30 В)	250...500 (10 В; 2 мА)	≤3,5 (10 В)	≤10	2 (1 кГц)	—	TO-92
КТ3107А	Si, p-n-p, ПЭ	300	≥200	50	5	100 (200*)	≤0,1 (20 В)	70...140 (5 В; 2 мА)	≤7 (10 В)	≤20	≤10 (1 кГц)	—	17а
КТ3107Б	Si, p-n-p, ПЭ	300	≥200	50	5	100 (200*)	≤0,1 (20 В)	120...220 (5 В; 2 мА)	≤7 (10 В)	≤20	≤10 (1 кГц)	—	17а
КТ3107В	Si, p-n-p, ПЭ	300	≥200	30	5	100 (200*)	≤0,1 (20 В)	70...140 (5 В; 2 мА)	≤7 (10 В)	≤20	≤10 (1 кГц)	—	17а
КТ3107Г	Si, p-n-p, ПЭ	300	≥200	30	5	100 (200*)	≤0,1 (20 В)	120...220 (5 В; 2 мА)	≤7 (10 В)	≤20	≤10 (1 кГц)	—	17а
КТ3107Д	Si, p-n-p, ПЭ	300	≥200	30	5	100 (200*)	≤0,1 (20 В)	180...460 (5 В; 2 мА)	≤7 (10 В)	≤20	≤10 (1 кГц)	—	17а
КТ3107Е	Si, p-n-p, ПЭ	300	≥200	25	5	100 (200*)	≤0,1 (20 В)	120...220 (5 В; 2 мА)	≤7 (10 В)	≤20	≤4 (1 кГц)	—	17а
КТ3107Ж	Si, p-n-p, ПЭ	300	≥200	25	5	100 (200*)	≤0,1 (20 В)	180...460 (5 В; 2 мА)	≤7 (10 В)	≤20	≤4 (1 кГц)	—	17а
КТ3107И	Si, p-n-p, ПЭ	300	≥200	50	5	100 (200*)	≤0,1 (20 В)	180...460 (5 В; 2 мА)	≤7 (10 В)	≤20	≤10 (1 кГц)	—	17а
КТ3107К	Si, p-n-p, ПЭ	300	≥200	30	5	100 (200*)	≤0,1 (20 В)	380...800 (5 В; 2 мА)	≤7 (10 В)	≤20	≤10 (1 кГц)	—	17а
КТ3107Л	Si, p-n-p, ПЭ	300	≥200	25	5	100 (200*)	≤0,1 (20 В)	380...800 (5 В; 2 мА)	≤7 (10 В)	≤20	≤4 (1 кГц)	—	17а
BC212A	Si, p-n-p, ПЭ	300	≥200	60	5	200	≤0,015 (30 В)	120...220 (5 В; 2 мА)	≤6 (10 В)	≤6	≤10 (1 кГц)	—	TO-92
BC212B	Si, p-n-p, ПЭ	300	≥200	60	5	200	≤0,015 (30 В)	180...460 (5 В; 2 мА)	≤6 (10 В)	≤6	≤10 (1 кГц)	—	TO-92
BC212C	Si, p-n-p, ПЭ	300	≥200	60	5	200	≤0,015 (30 В)	380...800 (5 В; 2 мА)	≤6 (10 В)	≤6	≤10 (1 кГц)	—	TO-92
BC213A	Si, p-n-p, ПЭ	300	≥200	45	5	200	≤0,015 (30 В)	120...220 (5 В; 2 мА)	≤6 (10 В)	≤6	≤10 (1 кГц)	—	TO-92
BC213B	Si, p-n-p, ПЭ	300	≥200	45	5	200	≤0,015 (30 В)	180...460 (5 В; 2 мА)	≤6 (10 В)	≤6	≤10 (1 кГц)	—	TO-92
BC213C	Si, p-n-p, ПЭ	300	≥200	45	5	200	≤0,015 (30 В)	380...800 (5 В; 2 мА)	≤6 (10 В)	≤6	≤10 (1 кГц)	—	TO-92
BC307A	Si, p-n-p, ПЭ	300	200	50*	5	100 (200*)	≤0,015* (50В)	120...220 (5 В; 2 мА)	≤6 (10 В)	≤20	≤10 (1 кГц)	—	TO-92
BC307B	Si, p-n-p, ПЭ	300	200	50*	5	100 (200*)	≤0,015* (50В)	180...460 (5 В; 2 мА)	≤6 (10 В)	≤20	≤10 (1 кГц)	—	TO-92
BC308A	Si, p-n-p, ПЭ	300	200	30*	5	100 (200*)	≤0,015* (30В)	120...220 (5 В; 2 мА)	≤6 (10 В)	≤20	≤10 (1 кГц)	—	TO-92
BC308B	Si, p-n-p, ПЭ	300	200	30*	5	100 (200*)	≤0,015* (30В)	180...460 (5 В; 2 мА)	≤6 (10 В)	≤20	≤10 (1 кГц)	—	TO-92
BC308C	Si, p-n-p, ПЭ	300	200	30*	5	100 (200*)	≤0,015* (30В)	380...800 (5 В; 2 мА)	≤6 (10 В)	≤20	≤10 (1 кГц)	—	TO-92
BC309B	Si, p-n-p, ПЭ	300	200	25*	5	50	≤0,015* (25В)	180...460 (5 В; 2 мА)	≤6 (10 В)	≤20	≤4 (1 кГц)	—	TO-92
BC309C	Si, p-n-p, ПЭ	300	200	25*	5	50	≤0,015* (25В)	380...800 (5 В; 2 мА)	≤6 (10 В)	≤20	≤4 (1 кГц)	—	TO-92
BC177AP	Si, p-n-p, ПЭ	300	350	50	6	200	≤0,1 (20 В)	75...150 (5 В; 2 мА)	≤4 (10 В)	≤30	≤10 (1 кГц)	—	X-55
BC177VIP	Si, p-n-p, ПЭ	300	350	50	6	200	≤0,1 (20 В)	125...260 (5 В; 2 мА)	≤4 (10 В)	≤30	≤10 (1 кГц)	—	X-55
BCY70	Si, p-n-p, ПЭ	310	≥200	50	5	200*	≤0,5 (50 В)	≥45 (1 В; 1 мА)	≤6 (10 В)	≤2,5	≤6 (1 кГц)	≤350	TO-18
BCY71	Si, p-n-p, ПЭ	310	≥200	45	5	200*	≤0,05 (40 В)	100...600 (1 В; 10 мА)	≤6 (10 В)	≤2,5	≤2 (1 кГц)	—	TO-18
BCY72	Si, p-n-p, ПЭ	310	≥200	25	5	200*	≤0,05 (20 В)	≥40 (1 В; 1 мА)	≤6 (10 В)	≤2,5	≤6 (1 кГц)	≤350	TO-18
BCY78	Si, p-n-p, ПЭ	400	180	32	5	200	≤0,01* (32 В)	120...630 (5 В; 2 мА)	≤7 (10 В)	≤4	≤6 (1 кГц)	≤800**	TO-18
BCY79	Si, p-n-p, ПЭ	400	180	45	5	200	≤0,01* (45 В)	120...430 (5 В; 2 мА)	≤7 (10 В)	≤4	≤6 (1 кГц)	≤800**	TO-18
BFX65	Si, p-n-p, ПЭ	360	≥40	45	6	50	≤10 (45 В)	≥100 (5 В; 1 мА)	≤6,5 (5 В)	≤25	≤3 (1 кГц)	—	TO-18
BC178AP	Si, p-n-p, ПЭ	300	350	30	5	200	≤0,1 (20 В)	125...260 (5 В; 2 мА)	4 (10 В)	≤30	≤10 (1 кГц)	—	X-55
BC178BP	Si, p-n-p, ПЭ	300	350	30	5	200	≤0,1 (20 В)	240...500 (5 В; 2 мА)	4 (10 В)	≤30	≤10 (1 кГц)	—	X-55
BC178VIP	Si, p-n-p, ПЭ	300	350	30	5	200	≤0,1 (20 В)	75...150 (5 В; 2 мА)	4 (10 В)	≤30	≤10 (1 кГц)	—	X-55

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^*_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, мкА	$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$К_ш$, дБ, $r^*_б$, $r^{**}_{бэ\,нас}$, Ом	$τ_к$, $t^*_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
BC179AP	Si, p-n-p, ПЭ	300	350	30	5	200	⩽0,1 (20 В)	125...260 (5 В; 2 мА)	4 (10 В)	⩽30	⩽4 (1 кГц)	—	X-55
BC179BP	Si, p-n-p, ПЭ	300	350	30	5	200	⩽0,1 (20 В)	240...500 (5 В; 2 мА)	4 (10 В)	⩽30	⩽4 (1 кГц)	—	X-55
BC454A	Si, p-n-p, ПЭ	300	⩾150	50	5	100	⩽0,1 (30 В)	125...250 (6 В; 2 мА)	⩽6 (10 В)	⩽25	⩽10 (1 кГц)	—	ТО-92
BC454B	Si, p-n-p, Э	300	⩾150	50	5	100	⩽0,1 (30 В)	220...470 (6 В; 2 мА)	⩽6 (10 В)	⩽25	⩽10 (1 кГц)	—	ТО-92
BC454C	Si, p-n-p, Э	300	⩾150	50	5	100	⩽0,1 (30 В)	420...800 (6 В; 2 мА)	⩽6 (10 В)	⩽25	⩽10 (1 кГц)	—	ТО-92
BC455A	Si, p-n-p, Э	300	⩾150	30	5	100	⩽0,1 (30 В)	125...250 (6 В; 2 мА)	⩽6 (10 В)	⩽25	⩽10 (1 кГц)	—	ТО-92
BC455B	Si, p-n-p, Э	300	⩾150	30	5	100	⩽0,1 (30 В)	220...470 (6 В; 2 мА)	⩽6 (10 В)	⩽25	⩽10 (1 кГц)	—	ТО-92
BC455C	Si, p-n-p, Э	300	⩾150	30	5	100	⩽0,1 (30 В)	420...800 (6 В; 2 мА)	⩽6 (10 В)	⩽25	⩽10 (1 кГц)	—	ТО-92
BC456A	Si, p-n-p, Э	300	⩾150	30	5	100	⩽0,1 (30 В)	125...250 (6 В; 2 мА)	⩽6 (10 В)	⩽25	⩽4 (15,7 кГц)	—	ТО-92
BC456B	Si, p-n-p, Э	300	⩾150	30	5	100	⩽0,1 (30 В)	220...470 (6 В; 2 мА)	⩽6 (10 В)	⩽25	⩽4 (15,7 кГц)	—	ТО-92
BC456C	Si, p-n-p, Э	300	⩾150	30	5	100	⩽0,1 (30 В)	420...800 (6 В; 2 мА)	⩽6 (10 В)	⩽25	⩽4 (15,7 кГц)	—	ТО-92
BC320A	Si, p-n-p, ПЭ	310	⩾100	50	6	150	⩽0,03	110...220* (5 В; 2 мА)	⩽4 (10 В)	⩽5	⩽6 (1 кГц)	—	ТО-92
BC320B	Si, p-n-p, ПЭ	310	⩾100	50	6	150	⩽0,03	200...450* (5 В; 2 мА)	⩽4 (10 В)	⩽5	⩽6 (1 кГц)	—	ТО-92
BC321A	Si, p-n-p, ПЭ	310	⩾100	40	5	150	⩽0,03	110...220* (5 В; 2 мА)	⩽4 (10 В)	⩽5	⩽6 (1 кГц)	—	ТО-92
BC321B	Si, p-n-p, ПЭ	310	⩾100	40	5	150	⩽0,03	200...450* (5 В; 2 мА)	⩽4 (10 В)	⩽5	⩽6 (1 кГц)	—	ТО-92
BC321C	Si, p-n-p, ПЭ	310	⩾100	40	5	150	⩽0,03	400...800* (5 В; 2 мА)	⩽4 (10 В)	⩽5	⩽6 (1 кГц)	—	ТО-92
BC557A	Si, p-n-p, ПЭ	500	150	50	5	100 (200*)	⩽0,015 (30 В)	125...250 (5 В; 2 мА)	⩽4,5 (10 В)	⩽30	⩽10 (1 кГц)	—	ТО-92
BC557B	Si, p-n-p, ПЭ	500	150	50	5	100 (200*)	⩽0,015 (30 В)	220...475 (5 В; 2 мА)	⩽4,5 (10 В)	⩽30	⩽10 (1 кГц)	—	ТО-92
BC558	Si, p-n-p, ПЭ	500	150	30	5	100 (200*)	⩽0,015 (30 В)	75...475 (5 В; 2 мА)	⩽4,5 (10 В)	⩽30	⩽10 (1 кГц)	—	ТО-92
BC558A	Si, p-n-p, ПЭ	500	150	30	5	100 (200*)	⩽0,015 (30 В)	125...250 (5 В; 2 мА)	⩽4,5 (10 В)	⩽30	⩽10 (1 кГц)	—	ТО-92
BC558B	Si, p-n-p, ПЭ	500	150	30	5	100 (200*)	⩽0,015 (30 В)	220...475 (5 В; 2 мА)	⩽4,5 (10 В)	⩽30	⩽10 (1 кГц)	—	ТО-92
BC559	Si, p-n-p, ПЭ	500	150	30	5	100 (200*)	⩽0,015 (30 В)	125...475 (5 В; 2 мА)	⩽4,5 (10 В)	⩽30	⩽4 (1 кГц)	—	ТО-92
2SA564	Si, p-n-p, ПЭ	250	80	25	5	100*	⩽1 (10 В)	65...700 (5 В; 2 мА)	—	⩽3,2	6 (1 кГц)	—	ТО-92
2SA564A	Si, p-n-p, ПЭ	250	80	45	5	100*	⩽1 (10 В)	65...700 (5 В; 2 мА)	—	⩽3,2	6 (1 кГц)	—	ТО-92
2SA640	Si, p-n-p, Э	250	100	50	5	50	⩽0,05 (50 В)	225...1000 (3 В; 0,5 мА)	6,5 (10 В)	⩽17	—	—	ТО-92
2SA641	Si, p-n-p, Э	250	100	50	5	50	⩽0,05 (50 В)	225...1000 (3 В; 0,5 мА)	6,5 (10 В)	⩽17	—	—	ТО-92
2SA733	Si, p-n-p, Э	250	180	50	5	100	⩽0,1 (40 В)	40...600 (6 В; 0,1 мА)	8 (10 В)	⩽17	—	—	ТО-92
2SA750	Si, p-n-p, Э	250	100	50	5	50	⩽0,05 (50 В)	225...1000 (3 В; 0,5 мА)	6,5 (10 В)	⩽17	—	—	ТО-92
2SA1015	Si, p-n-p, Э	400	⩾80	50	5	150	⩽0,1 (50 В)	70...240 (6 В; 2 мА)	⩽7 (10 В)	⩽3	⩽10 (1 кГц)	—	ТО-92
2SA999	Si, p-n-p, ПЭ	300	200	50	6	200	⩽1 (50 В)	90...500 (6 В; 1 мА)	7	—	—	—	ТО-92
2SA999L	Si, p-n-p, ПЭ	300	200	50	6	200	⩽1 (50 В)	150...500 (6 В; 1 мА)	7	—	—	—	ТО-92
BC322B	Si, p-n-p, ПЭ	310	⩾100	30	5	150	⩽0,03	200...450* (5 В; 2 мА)	⩽4 (10 В)	⩽5	⩽4 (1 кГц)	—	ТО-92
BC322C	Si, p-n-p, ПЭ	310	⩾100	30	5	150	⩽0,03	400...800* (5 В; 2 мА)	⩽4 (10 В)	⩽5	⩽4 (1 кГц)	—	ТО-92
2N3964	Si, p-n-p, П	360	⩾50	45	6	200	⩽0,01 (40 В)	250...600* (5 В; 1 мА)	⩽6 (5 В)	⩽25	⩽2 (1 кГц)	—	ТО-18
BC526A	Si, p-n-p, ПЭ	625	⩾100	60	6	200	⩽0,015 (30 В)	100...300 (5 В; 2 мА)	⩽5 (10 В)	⩽6	—	—	ТО-92
BC526B	Si, p-n-p, ПЭ	625	⩾100	60	6	200	⩽0,015 (30 В)	200...400 (5 В; 2 мА)	⩽5 (10 В)	⩽6	⩽4 (1 кГц)	—	ТО-92
BC526C	Si, p-n-p, ПЭ	625	⩾100	60	6	200	⩽0,015 (30 В)	350...600 (5 В; 2 мА)	⩽5 (10 В)	⩽6	⩽4 (1 кГц)	—	ТО-92
2N4126	Si, p-n-p, ПЭ	625	⩾200	25	4	200	⩽0,05 (20 В)	120...360 (1 В; 2 мА)	⩽4,5 (5 В)	⩽8	⩽4 (1 кГц)	—	ТО-92
2SA844C	Si, p-n-p, Э	300	200	55	5	100	⩽0,1 (18 В)	160...320 (12 В; 2 мА)	2 (10 В)	⩽50	—	—	ТО-92
2SA844D	Si, p-n-p, Э	300	200	55	5	100	⩽0,1 (18 В)	250...500 (12 В; 2 мА)	2 (10 В)	⩽50	—	—	ТО-92
2SA1029B	Si, p-n-p, Э	200	⩾200	30	5	100	⩽0,5 (18 В)	100...200 (12 В; 2 мА)	⩽4 (10 В)	⩽20	—	—	ТО-92
2SA1029C	Si, p-n-p, Э	200	⩾200	30	5	100	⩽0,5 (18 В)	160...320 (12 В; 2 мА)	⩽4 (10 В)	⩽20	—	—	ТО-92
2SA1029D	Si, p-n-p, Э	200	⩾200	30	5	100	⩽0,5 (18 В)	250...500 (12 В; 2 мА)	⩽4 (10 В)	⩽20	—	—	ТО-92
2SA1030B	Si, p-n-p, Э	200	⩾200	55	5	100	⩽0,5 (18 В)	100...200 (12 В; 2 мА)	⩽4 (10 В)	⩽20	—	—	ТО-92

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^{*}_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^{*}_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^{*}_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, мкА	$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r^{*}_б$, $r^{**}_{бэ\,нас}$, Ом	$\tau_к$, пс, $t^{*}_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
2SA1030C	Si, p-n-p, Э	200	⩾200	55	5	100	⩽0,5 (18 В)	160...320 (12 В; 2 мА)	⩽4 (10 В)	⩽20	—	—	TO-92
2SA1031B	Si, p-n-p, Э	200	⩾200	30	5	100	⩽0,5 (18 В)	100...200 (12 В; 2 мА)	⩽4 (10 В)	⩽20	—	—	TO-92
2SA1031C	Si, p-n-p, Э	200	⩾200	30	5	100	⩽0,5 (18 В)	160...320 (12 В; 2 мА)	⩽4 (10 В)	⩽20	⩽5 (120 Гц)	—	TO-92
2SA1031D	Si, p-n-p, Э	200	⩾200	30	5	100	⩽0,5 (18 В)	250...500 (12 В; 2 мА)	⩽4 (10 В)	⩽20	⩽5 (120 Гц)	—	TO-92
2SA1033B	Si, p-n-p, Э	310	⩾200	30	5	100	⩽0,5 (18 В)	100...200 (12 В; 2 мА)	⩽4 (10 В)	⩽20	—	—	TO-92
2SA1033C	Si, p-n-p, Э	310	⩾200	30	5	100	⩽0,5 (18 В)	160...320 (12 В; 2 мА)	⩽4 (10 В)	⩽20	—	—	TO-92
2SA1033D	Si, p-n-p, Э	310	⩾200	30	5	100	⩽0,5 (18 В)	250...500 (12 В; 2 мА)	⩽4 (10 В)	⩽20	—	—	TO-92
MPS3702	Si, p-n-p, Э	310	100	40	5	200	⩽0,1 (20 В)	60...300 (5 В; 50 мА)	⩽12 (10 В)	⩽5	⩽20**	—	TO-92
MPS3703	Si, p-n-p, Э	310	100	50	5	200	⩽0,1 (20 В)	30...150 (5 В; 50 мА)	⩽12 (10 В)	⩽5	⩽20**	—	TO-92
MPS6516	Si, p-n-p, Э	350	200	40	4	100	⩽0,05 (30 В)	50...100 (10 В; 2 мА)	⩽4 (10 В)	⩽10	2 (1 кГц)	—	TO-92
MPS6517	Si, p-n-p, Э	350	200	40	4	100	⩽0,05 (30 В)	90...180 (10 В; 2 мА)	⩽4 (10 В)	⩽10	2 (1 кГц)	—	TO-92
MPS6518	Si, p-n-p, Э	350	340	40	4	100	⩽0,05 (30 В)	150...300 (10 В; 2 мА)	⩽4 (10 В)	⩽10	2 (1 кГц)	—	TO-92
MPS6519	Si, p-n-p, Э	350	340	25	4	100	⩽0,05 (20 В)	250...500 (10 В; 2 мА)	⩽4 (10 В)	⩽10	2 (1 кГц)	—	TO-92
КТ373А	Si, n-p-n, ПЭ	150 (55°C)	⩾350	30* (10 к)	5	50 (200*)	⩽0,05 (25 В)	100...250* (5 В; 1 мА)	⩽8 (5 В)	⩽10	—	⩽200	14
КТ373Б	Si, n-p-n, ПЭ	150 (55°C)	⩾300	25* (10 к)	5	50 (200*)	⩽0,05 (20 В)	200...600* (5 В; 1 мА)	⩽8 (5 В)	⩽10	—	⩽300	14
КТ373В	Si, n-p-n, ПЭ	150 (55°C)	⩾300	10* (10 к)	5	50 (200*)	⩽0,05 (20 В)	500...1000* (5 В; 1 мА)	⩽8 (5 В)	⩽10	—	⩽700	14
КТ373Г	Si, n-p-n, ПЭ	150 (55°C)	⩾250	60* (10 к)	5	50 (200*)	⩽0,05 (20 В)	50...125* (5 В; 1 мА)	⩽8 (5 В)	⩽20	—	⩽200	14
PBC107A	Si, n-p-n, ПЭ	200	⩾150	45	5	100	⩽0,1 (45 В)	125...260 (5 В; 2 мА)	⩽6 (10 В)	—	⩽6 (1 кГц)	—	TO-98
PBC107B	Si, n-p-n, ПЭ	200	⩾150	45	5	100	⩽0,1 (45 В)	240...500 (5 В; 2 мА)	⩽6 (10 В)	—	⩽6 (1 кГц)	—	TO-98
PBC108A	Si, n-p-n, ПЭ	200	⩾150	20	5	100	⩽0,1 (20 В)	125...260 (5 В; 2 мА)	⩽6 (10 В)	—	⩽6 (1 кГц)	—	TO-98
PBC108B	Si, n-p-n, ПЭ	200	⩾150	20	5	100	⩽0,1 (20 В)	240...500 (5 В; 2 мА)	⩽6 (10 В)	—	⩽6 (1 кГц)	—	TO-98
PBC108C	Si, n-p-n, ПЭ	200	⩾150	20	5	100	⩽0,1 (20 В)	450...900 (5 В; 2 мА)	⩽6 (10 В)	—	⩽6 (1 кГц)	—	TO-98
PBC109B	Si, n-p-n, ПЭ	200	⩾150	20	5	100	⩽0,1 (20 В)	240...500 (5 В; 2 мА)	⩽6 (10 В)	—	⩽4 (1 кГц)	—	TO-98
PBC109C	Si, n-p-n, ПЭ	200	⩾150	20	5	100	⩽0,1 (20 В)	450...900 (5 В; 2 мА)	⩽6 (10 В)	—	⩽4 (1 кГц)	—	TO-98
BC167A	Si, n-p-n, ПЭ	300	⩾150	50	6	100 (200*)	0,002 (20 В)	110...220* (5 В; 2 мА)	⩽4,5 (10 В)	⩽20	⩽10 (1 кГц)	—	TO-92
BC167B	Si, n-p-n, ПЭ	300	⩾150	50	6	100 (200*)	0,002 (20 В)	200...450* (5 В; 2 мА)	⩽4,5 (10 В)	⩽20	⩽10 (1 кГц)	—	TO-92
BC168A	Si, n-p-n, ПЭ	300	⩾150	20**	5	100 (200*)	0,002 (20 В)	110...220* (5 В; 2 мА)	⩽4,5 (10 В)	⩽20	⩽10 (1 кГц)	—	TO-92
BC168B	Si, n-p-n, ПЭ	300	⩾150	20**	5	100 (200*)	0,002 (20 В)	200...450* (5 В; 2 мА)	⩽4,5 (10 В)	⩽20	⩽10 (1 кГц)	—	TO-92
BC168C	Si, n-p-n, ПЭ	300	⩾150	20**	5	100 (200*)	0,002 (20 В)	420...800* (6 В; 2 мА)	⩽4,5 (10 В)	⩽20	⩽10 (1 кГц)	—	TO-92
BC169B	Si, n-p-n, ПЭ	300	⩾150	20**	5	50	0,002 (20 В)	200...450* (5 В; 2 мА)	⩽4,5 (10 В)	⩽20	⩽4 (1 кГц)	—	TO-92
BC169C	Si, n-p-n, ПЭ	300	⩾150	20**	5	50	0,002 (20 В)	420...800* (6 В; 2 мА)	⩽4,5 (10 В)	⩽20	⩽4 (1 кГц)	—	TO-92
BC171A	Si, n-p-n, ПЭ	300	⩾150	45**	6	100 (200*)	⩽0,015 (45 В)	170* (5 В; 2 мА)	⩽6 (10 В)	⩽20	⩽10 (1 кГц)	—	TO-92
BC171B	Si, n-p-n, ПЭ	300	⩾150	45**	6	100 (200*)	⩽0,015 (45 В)	290* (5 В; 2 мА)	⩽6 (10 В)	⩽20	⩽10 (1 кГц)	—	TO-92
BC172A	Si, n-p-n, ПЭ	300	⩾150	25**	5	100 (200*)	⩽0,015 (20 В)	170* (5 В; 2 мА)	⩽6 (10 В)	⩽20	⩽10 (1 кГц)	—	TO-92
BC172B	Si, n-p-n, ПЭ	300	⩾150	25**	5	100 (200*)	⩽0,015 (20 В)	290* (5 В; 2 мА)	⩽6 (10 В)	⩽20	⩽10 (1 кГц)	—	TO-92
BC172C	Si, n-p-n, ПЭ	300	⩾150	25**	5	100 (200*)	⩽0,015 (20 В)	500* (5 В; 2 мА)	⩽6 (10 В)	⩽20	⩽10 (1 кГц)	—	TO-92
BC173B	Si, n-p-n, ПЭ	300	⩾150	25**	5	100 (200*)	⩽0,015 (20 В)	290* (5 В; 2 мА)	⩽6 (10 В)	⩽20	⩽4 (1 кГц)	—	TO-92
BC173C	Si, n-p-n, ПЭ	300	⩾150	25**	5	100 (200*)	⩽0,015 (20 В)	500* (5 В; 2 мА)	⩽6 (10 В)	⩽20	⩽4 (1 кГц)	—	TO-92

Заказ № 1141

Продолжение

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^*_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, мкА	$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r^*_б$, $r^{**}_{бэ\,нас}$, Ом	$\tau_к$, $t^*_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
BCP627A	Si, n-p-n, ПЭ	220	≥150	45	5	50	—	100...220 (5 В; 2 мА)	≤6 (10 В)	—	10 (1 кГц)	—	TO-92
BCP627B	Si, n-p-n, ПЭ	220	≥150	45	5	50	—	200...400 (5 В; 2 мА)	≤6 (10 В)	—	10 (1 кГц)	—	TO-92
BCP627C	Si, n-p-n, ПЭ	220	≥150	45	5	50	—	450...900 (5 В; 2 мА)	≤6 (10 В)	—	10 (1 кГц)	—	TO-92
BCP628A	Si, n-p-n, ПЭ	220	≥150	20	5	50	—	100...220 (5 В; 2 мА)	≤6 (10 В)	—	10 (1 кГц)	—	TO-92
BCP628B	Si, n-p-n, ПЭ	220	≥150	20	5	50	—	200...400 (5 В; 2 мА)	≤6 (10 В)	—	10 (1 кГц)	—	TO-92
BCP628C	Si, n-p-n, ПЭ	220	≥150	20	5	50	—	450...900 (5 В; 2 мА)	≤6 (10 В)	—	10 (1 кГц)	—	TO-92
2N3390	Si, n-p-n, П	360	120	25	5	100	≤0,1 (25 В)	400...800* (4,5 В; 2 мА)	≤10 (10 В)	—	—	—	TO-98
2N3391	Si, n-p-n, П	360	120	25	5	100	≤0,1 (25 В)	250...500* (4,5 В; 2 мА)	≤10 (10 В)	—	—	—	TO-98
2N3392	Si, n-p-n, П	360	120	25	5	100	≤0,1 (25 В)	150...300* (4,5 В; 2 мА)	≤10 (10 В)	—	—	—	TO-98
2N3393	Si, n-p-n, П	360	120	25	5	100	≤0,1 (25 В)	90...180* (4,5 В; 2 мА)	≤10 (10 В)	—	—	—	TO-98
2N3394	Si, n-p-n, П	360	120	25	5	100	≤0,1 (25 В)	55...110* (4,5 В; 2 мА)	≤10 (10 В)	—	—	—	TO-98
SC206D	Si, n-p-n, П	200	≥300	20	5	100	≤0,1 (20 В)	112...280 (6 В; 2 мА)	—	—	≤25 (1 кГц)	—	A-5
SC206E	Si, n-p-n, П	200	≥300	20	5	100	≤0,1 (20 В)	224...560 (6 В; 2 мА)	—	—	≤25 (1 кГц)	—	A-5
SC206F	Si, n-p-n, П	200	≥300	20	5	100	≤0,1 (20 В)	450...1120 (6 В; 2 мА)	—	—	≤25 (1 кГц)	—	A-5
SC207D	Si, n-p-n, П	200	≥300	20	5	100	≤0,1 (20 В)	112...280 (6 В; 2 мА)	—	—	≤8 (1 кГц)	—	A-5
SC207E	Si, n-p-n, П	200	≥300	20	5	100	≤0,1 (20 В)	224...560 (6 В; 2 мА)	—	—	≤8 (1 кГц)	—	A-5
SC207F	Si, n-p-n, П	200	≥300	20	5	100	≤0,1 (20 В)	450...1120 (6 В; 2 мА)	—	—	≤8 (1 кГц)	—	A-5
BCW47	Si, n-p-n, ПЭ	150 (50°C)	300	50	6	100 (200*)	≤0,1 (20 В)	110...450* (5 В; 2 мА)	2,5 (10 В)	≤25	—	—	MM-13
BCW48	Si, n-p-n, ПЭ	150 (50°C)	300	30	5	100 (200*)	≤0,1 (20 В)	110...800* (5 В; 2 мА)	2,5 (10 В)	≤25	—	—	MM-13
BCW49	Si, n-p-n, ПЭ	150 (50°C)	300	30	5	100 (200*)	≤0,1 (20 В)	200...800* (5 В; 2 мА)	2,5 (10 В)	≤25		—	MM-13
BC147A	Si, n-p-n, ПЭ	220 (55°C)	≥150	50*	6	100 (200*)	≤0,015* (50В)	120...220* (5 В; 2 мА)	≤4,5 (10 В)	≤10	≤10 (1 кГц)	—	MM-10
BC148A	Si, n-p-n, ПЭ	220 (50°C)	≥150	30*	5	100 (200*)	≤0,015* (30В)	120...220* (5 В; 2 мА)	≤4,5 (10 В)	≤10	≤10 (1 кГц)	—	MM-10
BC147B	Si, n-p-n, ПЭ	220 (55°C)	≥150	50*	6	100 (200*)	≤0,015* (50В)	180...460* (5 В; 2 мА)	≤4,5 (10 В)	≤10	≤10 (1 кГц)	—	MM-10
BC148B	Si, n-p-n, ПЭ	220 (55°C)	≥150	30*	5	100 (200*)	≤0,015* (30В)	180...460* (5 В; 2 мА)	≤4,5 (10 В)	≤10	≤10 (1 кГц)	—	MM-10
BC149B	Si, n-p-n, ПЭ	220 (55°C)	≥150	30*	5	50	≤0,015* (30В)	180...460* (5 В; 2 мА)	≤4,5 (10 В)	≤10	≤4 (1 кГц)	—	MM-10
BC148C	Si, n-p-n, ПЭ	220 (50°C)	≥150	30*	5	100 (200*)	≤0,015* (30В)	380...800* (5 В; 2 мА)	≤4,5 (10 В)	≤10	≤10 (1 кГц)	—	MM-10
BC149C	Si, n-p-n, ПЭ	220 (50°C)	≥150	30*	5	50	≤0,015* (50В)	380...800* (5 В; 2 мА)	≤4,5 (10 В)	≤10	≤4 (1 кГц)	—	MM-10
BC146-01	Si, n-p-n, ПЭ	50 (45°C)	150	20**	5	50	—	80...200 (5 В; 0,2 мА)	—	—	2 (1 кГц)	—	SOT-42
BC146-02	Si, n-p-n, ПЭ	50 (45°C)	150	20**	5	50	—	140...350 (5 В; 0,2 мА)	—	—	1,5 (1 кГц)	—	SOT-42
BC146-03	Si, n-p-n, ПЭ	50 (45°C)	150	20**	5	50	—	280...550 (5 В; 0,2 мА)	—	—	2 (1 кГц)	—	SOT-42

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^{*}_{K,т\,max}$, $P^{**}_{K,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^{*}_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^{*}_{K,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, мкА	$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_{к}$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$K_{ш}$, дБ, $r^{*}_{б}$, $r^{**}_{бэ\,нас}$, Ом	$\tau_{к}$, пс, $t^{*}_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
КС147	Si, n-p-n, ПЭ	200	⩾150	45	5	100 (200*)	⩽0,015 (45 В)	125...500 (5 В; 2 мА)	⩽4,5 (10 В)	⩽25	⩽10 (1 кГц)	—	ММ-10
КС148	Si, n-p-n, ПЭ	200	⩾150	20	5	100 (200*)	⩽0,015 (20 В)	125...500 (5 В; 2 мА)	⩽4,5 (10 В)	⩽25	⩽10 (1 кГц)	—	ММ-10
КС149	Si, n-p-n, ПЭ	200	⩾150	20	5	100 (200*)	⩽0,015 (20 В)	240...900 (5 В; 2 мА)	⩽4,5 (10 В)	⩽25	⩽4 (1 кГц)	—	ММ-10
КТ313А	Si, p-n-p, ПЭ	300 (1000*)	⩾200	60	5	350 (700*)	⩽0,5 (50 В)	30...120 (10 В; 1 мА)	⩽12 (10 В)	⩽3,3	—	⩽120*	5
КТ313Б	Si, p-n-p, ПЭ	300 (1000*)	⩾200	60	5	350 (700*)	⩽0,5 (50 В)	80...300 (10 В; 1 мА)	⩽12 (10 В)	⩽3,3	—	⩽120*	5
2N2906	Si, p-n-p, ПЭ	400	⩾200	60	5	600	0,02 (50 В)	⩾25 (10 В; 1 мА)	⩽8 (10 В)	⩽2,6	—	⩽80*	ТО-18
2N2906A	Si, p-n-p, ПЭ	400	⩾200	60	5	600	0,01 (50 В)	⩾40 (10 В; 1 мА)	⩽8 (10 В)	⩽2,6	—	⩽80*	ТО-18
2N2907	Si, p-n-p, ПЭ	400	⩾200	60	5	600	0,02 (50 В)	⩾50 (10 В; 1 мА)	⩽8 (10 В)	⩽2,6	—	⩽80*	ТО-18
2N2907A	Si, p-n-p, ПЭ	400	⩾200	60	5	600	0,01 (50 В)	⩾100 (10 В; 1 мА)	⩽8 (10 В)	⩽2,6	—	⩽80*	ТО-18
2N3250	Si, p-n-p, ПЭ	360	⩾250	50	5	200	0,02 (40 В)	⩾45 (1 В; 1 мА)	⩽6 (10 В)	⩽10	⩽250*	⩽175*	ТО-18
2N3250A	Si, p-n-p, ПЭ	360	⩾250	60	5	200	0,02 (40 В)	⩾45 (1 В; 1 мА)	⩽6 (10 В)	⩽10	⩽250*	⩽175*	ТО-18
2SA530	Si, p-n-p, Э	200	⩾200	50	5	100	1 (20 В)	35...200 (1 В; 10 мА)	⩽8 (10 В)	⩽12,5	80*	⩽160*	ТО-18
2SA603	Si, p-n-p, ПЭ	300	⩾150	60	8	200	0,5 (40 В)	80...240 (1 В; 10 мА)	⩽7 (10 В)	⩽7	—	—	ТО-18
2SA1090	Si, p-n-p, Э	300	⩾150	60	8	200	0,1 (60 В)	70...400 (1 В; 10 мА)	⩽7 (10 В)	⩽3	30*	400*	ТО-18
2SA718	Si, p-n-p, Э	300	⩾150	60	8	200	0,1 (40 В)	80...240 (1 В; 10 мА)	⩽7 (10 В)	⩽7	—	—	ТО-18
2SA876H	Si, p-n-p, Э	350 (1000*)	⩾200	70	5	500	0,5 (50 В)	80...240 (1 В; 10 мА)	⩽20 (10 В)	⩽2,6	6,6	⩽250*	ТО-18
КТ3117А	Si, n-p-n, ПЭ	300 (800)	200	60	4	400 (800)	10 (60 В)	40...200 (5 В; 0,2 А)	⩽10 (10 В)	⩽1,2	—	⩽80*	5
2N914	Si, n-p-n, ПЭ	360	⩾300	40	5	150 (500*)	⩽0,025 (20 В)	⩾10 (5 В; 0,5 А)	⩽6 (10 В)	⩽3,5	—	⩽40*	ТО-18
2N2020	Si, n-p-n, ПЭ	360	⩾250	60	5	800	⩽0,01 (50 В)	20...60* (10 В; 0,15 А)	⩽8 (10 В)	⩽2,6	—	190*	ТО-18
2N2221	Si, n-p-n, ПЭ	500	⩾250	60	5	800	⩽0,01 (50 В)	40...120* (10 В; 0,15 А)	⩽8 (10 В)	⩽3	—	190*	ТО-18
2N2221A	Si, n-p-n, ПЭ	500	⩾250	75	6	800	⩽0,01 (60 В)	40...120* (10 В; 0,15 А)	⩽8 (10 В)	⩽2	—	⩽150; ⩽225*	ТО-18
BSW61	Si, n-p-n, ПЭ	500	⩾250	60	5	800	—	⩾40* (10 В; 0,15 А)	—	—	—	—	ТО-18
BSW62	Si, n-p-n, ПЭ	500	⩾250	60	5	800	—	⩾40* (10 В; 0,15 А)	—	—	—	—	ТО-18
BFX94	Si, n-p-n, ПЭ	500	⩾250	60	5	800	0,01	40...120* (10 В; 0,15 А)	⩽8 (10 В)	⩽3,2	—	—	ТО-18
BSX97	Si, n-p-n, ПЭ	400	⩾200	40	5	500	—	⩾40* (10 В; 0,15 А)	⩽8 (10 В)	⩽3	⩽4**	—	ТО-18
BSX75	Si, n-p-n, ПЭ	430 (45°С)	⩾100	40	5	800	⩽0,1 (30В)	40...250* (10 В; 0,15 А)	⩽10 (10 В)	⩽2,2	—	150*	ТО-18
2N3301	Si, n-p-n, ПЭ	360	⩾250	60	5	500	⩽10 (60 В)	40...120* (10 В; 0,15 А)	⩽8 (10 В)	⩽1,2	—	⩽150**	ТО-18
2N3302	Si, n-p-n, ПЭ	360	⩾250	60	5	500	⩽10 (60 В)	100...300* (10 В; 0,15 А)	⩽8 (10 В)	⩽1,2	—	⩽150**	ТО-18
2N2539	Si, n-p-n, ПЭ	500	⩾250	60	5	800	⩽0,25 (40 В)	50...150* (10 В; 0,15 А)	⩽8 (10 В)	⩽3	—	⩽20*	ТО-18
2N2222	Si, n-p-n, ПЭ	500	⩾250	60	5	800	⩽0,01 (50 В)	100...300* (10 В; 0,15 А)	⩽8 (10 В)	⩽2,6	—	—	ТО-18
КТ357Б	Si, p-n-p, ПЭ	100 (50°С)	⩾300	6*	3,5	40 (80*)	⩽5 (6 В)	20...100* (0,5 В; 10 мА)	⩽7 (5 В)	⩽30	—	⩽150*	14
КТ357А	Si, p-n-p, ПЭ	100 (50°С)	⩾300	6*	3,5	40 (80*)	⩽5 (6 В)	60...300* (0,5 В; 10 мА)	⩽7 (5 В)	⩽30	—	⩽250*	14

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^*_{K,т\,max}$, $P^{**}_{K,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, мкА	$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r^*_б$, $r^{**}_{бэ\,нас}$, Ом	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
КТ357В	Si, p-n-p, ПЭ	100 (50°С)	≥300	20*	3,5	40 (80*)	≤5 (20 В)	20...100* (0,5 В; 10 мА)	≤7 (5 В)	≤30	—	≤150*	14
КТ357Г	Si, p-n-p, ПЭ	100 (50°С)	≥300	20*	3,5	40 (80*)	≤5 (20 В)	60...300* (0,5 В; 10 мА)	≤7 (5 В)	≤30	—	≤250*	14
2N5228	Si, p-n-p, ПЭ	310	≥300	5	3	50	≤0,1 (4 В)	≥30* (0,3 В; 10 мА)	≤5 (5 В)	≤40	—	≤90*	ТО-92
MPS3639	Si, p-n-p, ПЭ	200	≥300	6	4	80	≤100 (6 В)	30...120* (0,3 В; 10 мА)	≤3,5 (5 В)	≤16	—	20*	ТО-92
2SA495G	Si, p-n-p, ПЭ	200	≥100	35	5	100	≤0,5 (15 В)	40...400* (1 В; 10 мА)	≤7 (10 В)	≤40	—	300*	R-67
2SA495	Si, p-n-p, ПЭ	200	≥100	35	5	100	≤0,5 (15 В)	40...240* (1 В; 10 мА)	≤7 (10 В)	≤50	—	—	R-67
2SA628	Si, p-n-p, ПЭ	150	100	30	4	100	1	55...500* (6 В; 1 мА)	3,5	30	—	60	ТО-92
												100*	—
КТ343А	Si, p-n-p, ПЭ	150 (75°С)	≥300	17* (10 к)	4	50 (150*)	≤1 (10 В)	≥30* (0,3 В; 10 мА)	≤6 (5 В)	≤30	—	≤10*	5
КТ343Б	Si, p-n-p, ПЭ	150 (75°С)	≥300	17* (10 к)	4	50 (150*)	≤1 (10 В)	≥50* (0,3 В; 10 мА)	≤6 (5 В)	≤30	—	≤20*	5
КТ343В	Si, p-n-p, ПЭ	150 (75°С)	≥300	9* (10 к)	4	50 (150*)	≤1 (7 В)	≥30* (0,3 В; 10 мА)	≤6 (5 В)	≤30	—	≤10*	5
BSW19	Si, p-n-p, ПЭ	300	≥150	35	5	100	0,02 (25 В)	40...300* (1 В; 10 мА)	≤7 (10 В)	≤18	—	≤800**	ТО-18
2T3841	Si, p-n-p, ПЭ	300	≥300	15	4	200	0,005	30...250	≤6	—	—	—	ТО-18
BSY40	Si, p-n-p, ПЭ	300	210	25	5	100 (140*)	≤0,01 (25 В)	25...60* (0,5 В; 10 мА)	—	≤20	—	≤90*	ТО-18
BSY41	Si, p-n-p, ПЭ	300	230	25	5	100 (140*)	≤0,01 (25 В)	50...200* (0,5 В; 10 мА)	—	≤20	—	≤90*	ТО-18
2N3545	Si, p-n-p, ПЭ	360	≥250	20	5	200	≤0,01 (10 В)	40...120* (1 В; 10 мА)	≤8	≤20	—	≤40*	ТО-18
BCW21	Si, p-n-p, ПЭ	300	≥150	25	5	200	0,5	75...225* (4,5 В; 2 мА)	≤8 (5 В)	≤10	—	—	ТО-18
КТ349А	Si, p-n-p, ПЭ	200 (35°С)	≥300	15* (10 к)	4	50 (100*)	≤1 (10 В)	20...80* (1 В; 10 мА)	≤6 (5 В)	≤30	—	—	5; 17а
КТ349Б	Si, p-n-p, ПЭ	200 (35°С)	≥300	15* (10 к)	4	50 (100*)	≤1 (10 В)	40...160* (1 В; 10 мА)	≤6 (5 В)	≤30	—	—	5; 17а
КТ349А	Si, p-n-p, ПЭ	200 (35°С)	≥300	15* (10 к)	4	50 (100*)	≤1 (10 В)	120...300* (1 В; 10 мА)	≤6 (5 В)	≤30	—	—	5; 17а
BC178A	Si, p-n-p, ПЭ	300	150	25**	5	100	≤0,1 (20 В)	125...260 (5 В; 2 мА)	4 (10 В)	≤30	≤10 (1 кГц)	—	ТО-18
2N726	Si, p-n-p, ПЭ	300	≥140	25	5	50	≤1 (25 В)	15...45* (1 В; 10 мА)	≤5 (5 В)	≤60	—	—	ТО-18
2N727	Si, p-n-p, ПЭ	300	≥140	25	5	50	≤1 (25 В)	30...120* (1 В; 10 мА)	≤5 (5 В)	≤60	—	—	ТО-18
2SA494G	Si, p-n-p, ПЭ	200	≥100	35	5	80	≤0,1 (15 В)	70...400 (6 В; 0,1 мА)	≤7 (10 В)	≤40	—	—	R-67
BC158A	Si, p-n-p, ПЭ	230 (45°С)	150	30	5	100	0,002 (20 В)	125...260 (5 В; 2 мА)	4,5	—	—	—	ММ-10
КТ347А	Si, p-n-p, ПЭ	150 (75°С)	≥500	15* (10 к)	4	50 (110*)	≤1 (15 В)	30...400* (0,3 В; 10 мА)	≤6 (5 В)	≤30	—	≤25*	5
КТ347Б	Si, p-n-p, ПЭ	150 (75°С)	≥500	9* (10 к)	4	50 (110*)	≤1 (9 В)	30...400* (0,3 В; 10 мА)	≤6 (5 В)	≤30	—	≤25*	5

Продолжение

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^*_{K,т\,max}$, $P^{**}_{K,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, мкА	$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r^*_б$, $r^{**}_{бэ\,нас}$, Ом	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
КТ347В	Si, p-n-p, ПЭ	150 (75°С)	≥500	6* (10 к)	4	50 (110*)	≤1 (6 В)	50...400* (0,3 В; 10 мА)	≤6 (5 В)	≤30	—	≤40*	5
2N2894	Si, p-n-p, ПЭ	360	≥400	12	4	200	≤0,08 (6 В)	≥30* (0,3 В; 10 мА)	≤6 (5 В)	≤15	—	≤90**	TO-18
2N869A	Si, p-n-p, ПЭ	360	≥400	25	5	200	≤10 (25 В)	≥30* (0,3 В; 10 мА)	≤5 (5 В)	≤15	—	≤80**	TO-18
2N3012	Si, p-n-p, ПЭ	360	≥400	12	4	200	≤10 (12 В)	≥25* (0,3 В; 10 мА)	≤6 (5 В)	≤15	—	≤75**	TO-18
2N3209	Si, p-n-p, ПЭ	360	≥400	20	4	200	≤0,08* (10 В)	≥25* (0,3 В; 10 мА)	≤5 (5 В)	≤15	—	≤90**	TO-18
KSY81	Si, p-n-p, ПЭ	360	≥400	12	4	200	≤10 (12 В)	≥30* (0,3 В; 10 мА)	≤6 (5 В)	≤7	—	≤90**	TO-18
2N5056	Si, p-n-p, ПЭ	360	≥600	15	4,5	100	≤0,05* (10 В)	≥20* (0,3 В; 10 мА)	4,5	≤13	—	≤30*	TO-18
2N3576	Si, p-n-p, ПЭ	360	≥400	20	5	200	≤0,01* (15 В)	40...120* (0,5 В; 10 мА)	≤4,5	≤15	—	≤30*	TO-18
MPS3640	Si, p-n-p, ПЭ	310	≥500	12	4	80	≤0,1 (12 В)	30...120* (0,3 В; 10 мА)	≤3,5 (5 В)	≤20	—	≤20*	TO-92
КТ337А	Si, p-n-p, ПЭ	150 (60°С)	≥500	6* (10 к)	4	30	≤1 (6 В)	≥30* (0,3 В; 10 мА)	≤6 (5 В)	≤20	—	≤25*	5; 17а
КТ337Б	Si, p-n-p, ПЭ	150 (60°С)	≥600	6* (10 к)	4	30	≤1 (6 В)	≥50* (0,3 В; 10 мА)	≤6 (5 В)	≤20	—	≤28*	5; 17а
КТ337В	Si, p-n-p, ПЭ	150 (60°С)	≥600	6* (10 к)	4	30	≤1 (6 В)	≥70* (0,3 В; 10 мА)	≤6 (5 В)	≤20	—	≤28*	5; 17а
2N3304	Si, p-n-p, ПЭ	300	≥500	6	4	200	≤0,01 (3 В)	30...120* (0,3 В; 10 мА)	≤3,5 (5 В)	≤16	—	≤30*	TO-18
2N4207	Si, p-n-p, ПЭ	300	≥650	6	4,5	50	≤0,01* (3 В)	≥50* (0,3 В; 10 мА)	≤3	≤15	—	≤15*	TO-18
2N4208	Si, p-n-p, ПЭ	300	≥700	12	4,5	50	≤0,01* (6 В)	≥30* (0,3 В; 10 мА)	3	≤15	—	≤20*	TO-18
2N3451	Si, p-n-p, ПЭ	300	≥500	6	4	200	≤0,01* (3 В)	30...120* (0,3 В; 10 мА)	≤5,5	≤16	—	≤60*	TO-18
КТ326АМ	Si, p-n-p, ПЭ	200 (30°С)	≥250	15* (100 к)	5	50	≤0,5 (20 В)	20...70* (2 В; 10 мА)	≤5 (5 В)	≤30	—	≤450	17а
КТ326БМ	Si, p-n-p, ПЭ	200 (30°С)	≥400	15* (100 к)	5	50	≤0,5 (20 В)	45...160 (2 В; 10 мА)	≤5 (5 В)	≤30	—	≤450	17а
BFY19	Si, p-n-p, П	300	≥400	30	3	100	10	110 (9 В; 10 мА)	4	—	—	—	TO-18
2SA522	Si, p-n-p, ПЭ	250	≥100	25	5	100	≤0,1 (15 В)	35...200* (10 В; 10 мА)	7 (10 В)	—	—	—	TO-18
BFX12	Si, p-n-p, ПЭ	300	≥150	20	5	100 (140*)	0,01	20...60* (0,35 В; 10 мА)	8	≤25	—	—	TO-18
BFX13	Si, p-n-p, ПЭ	300	≥150	20	5	100 (140*)	0,01	50...250* (0,35 В; 10 мА)	6	≤25	—	—	TO-18
2N4034	Si, p-n-p, ПЭ	360	≥400	40	5	100	0,015*	≥50* (10 В; 1 мА)	4	≤180	—	≤140*	TO-18
КТ368А	Si, n-p-n, ПЭ	225 (65°С)	≥900	15	4	30 (60*)	≤0,5 (15 В)	50...300* (5 В; 10 мА)	≤1,7 (5 В)	—	≤3,3 (60 МГц)	≤15	8а
КТ368Б	Si, n-p-n, ПЭ	225 (65°С)	≥900	15	4	30 (60*)	≤0,5 (15 В)	50...300* (5 В; 10 мА)	≤1,7 (5 В)	—	—	≤15	8а
BFS62	Si, n-p-n, ПЭ	200 (45°С)	≥580	40	4	25	≤0,1 (20 В)	35...90 (10 В; 7 мА)	≤0,33* (10 В)	—	≤4 (200 МГц)	—	TO-72
2N918	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥600	30	3	50	≤0,01 (15 В)	≥20 (1 В; 3 мА)	≤1,7 (10 В)	≤40	≤6 (60 МГц)	≤15	TO-72
2N3600	Si, n-p-n, ПЭ	300	≥850	30	3	50	≤0,01 (15 В)	20...150 (1 В; 3 мА)	≤1 (10 В)	≤40	≤3 (60 МГц)	≤15	TO-72

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^*_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, мкА	$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r^*_б$, $r^{**}_{бэ\,нас}$, Ом	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
BFX73	Si, n-p-n, ПЭ	200	⩾600	30	3	50	⩽0,01	⩾20* (1 В; 3 мА)	⩽1,7 (10 В)	⩽40	⩽6 (60 МГц)	—	TO-72
2N917	Si, n-p-n, ПЭ	200	⩾500	30	3	50	⩽0,001 (15 В)	20...200 (1 В; 3 мА)	⩽1,7 (10 В)	⩽3,3	⩽6 (60 МГц)	⩽75	TO-72
2SC390	Si, n-p-n, ПЭ	150	⩾600	30	3	20	⩽0,1 (10 В)	40...200 (10 В; 2 мА)	⩽1,5 (10 В)	⩽60	⩽3 (60 МГц)	⩽6	TO-72
BFY78	Si, n-p-n, ПЭ	300	⩾500	25	3	50	⩽0,02	⩾20* (1 В; 3 мА)	⩽2,8	⩽40	⩽6 (60 МГц)	—	TO-72
2SC583	Si, n-p-n, ПЭ	200	⩾1000	30	2,5	25 (50*)	—	25...150* (1 В; 2 мА)	⩽1,5 (10 В)	—	—	—	TO-72
КТ325А	Si, n-p-n, ПЭ	225 (85°C)	⩾800	15* (3 к)	4	30 (60*)	⩽0,5 (15 В)	30...90* (5 В; 10 мА)	⩽2,5 (5 В)	—	—	⩽125	19
КТ325АМ	Si, n-p-n, ПЭ	225 (85°C)	⩾800	15* (3 к)	4	30 (60*)	⩽0,5 (15 В)	30...90* (5 В; 10 мА)	⩽2,5 (5 В)	—	—	⩽125	17а
КТ325Б	Si, n-p-n, ПЭ	225 (85°C)	⩾800	15* (3 к)	4	30 (60*)	⩽0,5 (15 В)	70...210* (5 В; 10 мА)	⩽2,5 (5 В)	—	—	⩽125	19
КТ325БМ	Si, n-p-n, ПЭ	225 (85°C)	⩾800	15* (3 к)	4	30 (60*)	⩽0,5 (15 В)	70...210* (5 В; 10 мА)	⩽2,5 (5 В)	—	—	⩽125	17а
КТ325В	Si, n-p-n, ПЭ	225 (85°C)	⩾1000	15* (3 к)	4	30 (60*)	⩽0,5 (15 В)	160...400* (5 В; 10 мА)	⩽2,5 (5 В)	—	—	⩽125	19
КТ325ВМ	Si, n-p-n, ПЭ	225 (85°C)	⩾1000	15* (3 к)	4	30 (60*)	⩽0,5 (15 В)	160...400* (5 В; 10 мА)	⩽2,5 (5 В)	—	—	⩽125	17а
2N2615	Si, n-p-n, П	300	⩾800	30	3	—	—	20* (1 В; 3 мА)	⩽2,8	—	—	—	TO-18
2N2616	Si, n-p-n, П	300	⩾900	30	3	50	—	50* (1 В; 3 мА)	2,4	—	—	—	TO-18
2SC809	Si, n-p-n, ПЭ	200	1200	25	3	20	⩽0,1 (12 В)	90 (6 В; 2 мА)	1,4 (6 В)	—	—	—	TO-72
2SC618	Si, n-p-n, ПЭ	150	800	25	4	25	⩽0,1 (12 В)	50 (6 В; 2 мА)	1,3 (6 В)	—	⩽6 (70 МГц)	—	TO-72
2SC618A	Si, n-p-n, ПЭ	150	800	25	4	25	⩽0,1 (12 В)	50 (6 В; 2 мА)	1,3 (6 В)	—	⩽3,5 (70 МГц)	—	TO-72
2N2708	Si, n-p-n, ПЭ	200	⩾700	20**	3	50	⩽0,01 (15 В)	30...200* (2 В; 2 мА)	⩽1 (15 В)	—	⩽6 (60 МГц)	⩽33	TO-72
2SC612	Si, n-p-n, ПЭ	180	⩾1000	35	2	20	⩽1 (10 В)	40...160 (10 В; 2 мА)	⩽1,5 (10 В)	—	⩽5 (70 МГц)	—	TO-72
2SC253	Si, n-p-n, ПЭ	200	⩾600	30	3	30	⩽1 (15 В)	20...120 (6 В; 5 мА)	1,5 (6 В)	—	⩽6 (7 МГц)	—	TO-72
КТ363А	Si, p-n-p, ПЭ	150 (45°C)	⩾1000	15* (1 к)	4,5	30 (50*)	⩽0,5 (15 В)	20...120* (5 В; 5 мА)	⩽2 (5 В)	⩽35	—	⩽50, ⩽10*	5
КТ363АМ	Si, p-n-p, ПЭ	150 (45°C)	⩾1000	15* (1 к)	4,5	30 (50*)	⩽0,5 (15 В)	20...120* (5 В; 5 мА)	⩽2 (5 В)	⩽35	—	⩽50, ⩽10*	17а
КТ363Б	Si, p-n-p, ПЭ	150 (45°C)	⩾1500	12* (1 к)	4,5	30 (50*)	⩽0,5 (15 В)	40...120* (5 В; 5 мА)	⩽2 (5 В)	⩽35	—	⩽75, ⩽5*	5
КТ363БМ	Si, p-n-p, ПЭ	150 (45°C)	⩾1500	12* (1 к)	4,5	30 (50*)	⩽0,5 (15 В)	40...120* (5 В; 5 мА)	⩽2 (5 В)	⩽35	—	⩽75, ⩽5*	17а
2N4260	Si, p-n-p, ПЭ	200	⩾1200	15	4,5	30	⩽10 (15 В)	30...150* (1 В; 10 мА)	⩽2,5 (4 В)	⩽35	—	⩽35	TO-72
2N4261	Si, p-n-p, ПЭ	200	⩾1500	15	4,5	30	⩽10 (15 В)	30...150* (1 В; 10 мА)	⩽2,5 (4 В)	⩽35	—	⩽60	TO-72
MPSL07	Si, p-n-p, ПЭ	310	⩾1000	6	4,5	80	0,01	⩾30* (3 В; 10 мА)	1,9	15	—	⩽40**	TO-92
MPSL08	Si, p-n-p, ПЭ	310	⩾1200	12	4,5	80	0,01	⩾30* (3 В; 10 мА)	1,9	15	—	⩽40**	TO-92
2N3546	Si, p-n-p, ПЭ	360	⩾700	15	4,5	100	⩽0,10 (10 В)	30...120* (1 В; 10 мА)	⩽6 (10 В)	⩽15	—	⩽20**	TO-18
2N4209	Si, p-n-p, ПЭ	300	⩾850	15	4,5	50	⩽100 (15 В)	50...120* (0,3 В; 10 мА)	⩽3 (5 В)	⩽18	⩽30**	⩽20**	TO-18
2N5771	Si, p-n-p, ПЭ	625	⩾850	15	4,5	50	⩽0,01 (8 В)	50...120* (0,3 В; 10 мА)	⩽3 (5 В)	⩽18	⩽30**	⩽20**	TO-92

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^*_{K,т\,max}$, $P^{**}_{K,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, мкА	$h_{21э}$, $h^*_{21э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$К_ш$, дБ, $r^*_б$, $r^{**}_{бэ\,нас}$, Ом	$\tau_к$, $t^*_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
КТ355А	Si, n-p-n, ПЭ	225 (85°С)	≥1500	15* (3 к)	4	30 (60*)	≤0,5 (15 В)	80...300* (5 В; 10 мА)	≤2 (5 В)	—	≤5,5 (60 МГц) ≤10*	≤60	21
2N5851	Si, n-p-n, ПЭ	500	≥800	30	4,5	100	≤1 (15 В)	≥40* (1 В; 10 мА)	≤1,5 (4 В)	≤20	2,5 (200 МГц)	≤20	TO-72
2N5852	Si, n-p-n, ПЭ	500	≥1100	30	4,5	100	≤1 (15 В)	≥40* (1 В; 10 мА)	≤1,5 (4 В)	≤20	2,5 (200 МГц)	≤20	TO-72
2SC1044	Si, n-p-n, ПЭ	250	1000	45	3	30	≤0,1 (30 В)	40...200* (6 В; 6 мА)	0,6 (6 В)	—	≤4 (200 МГц)	—	TO-72
2N5842	Si, n-p-n, ПЭ	350	≥1700	20	3	100	0,02	≥25* (4 В; 25 мА)	1,5	—	—	≤40	TO-72
BFX89	Si, n-p-n, ПЭ	200	1200	15*	2,5	25 (50*)	≤0,01 (15 В)	20...125 (1 В; 25 мА)	≤1,7 (10 В)	—	≤4 (200 МГц)	—	TO-72
BFY66	Si, n-p-n, ПЭ	175 (45°С)	≥600	30	3	100	≤0,01 (15 В)	≥20 (1 В; 3 мА)	—	—	≤6 (60 МГц)	—	TO-18
2Т3674	Si, n-p-n, ПЭ	150	≥1000	25	5	25	≤0,01	≥20	≤1,5	—	≤5	—	TO-72
КТ372А	Si, n-p-n, ПЭ	50 (100°С)	≥2400	15* (10 к)	3	10	≤0,5 (15 В)	≥10* (5 В; 10 мА)	≤1 (5 В)	—	≤3,5 (1 ГГц)	—	22
КТ372Б	Si, n-p-n, ПЭ	50 (100°С)	≥3000	15* (10 к)	3	10	≤0,5 (15 В)	≥10* (5 В; 10 мА)	≤1 (5 В)	—	≤5,5 (1 ГГц)	—	22
КТ372В	Si, n-p-n, ПЭ	50 (100°С)	≥2400	15* (10 к)	3	10	≤0,5 (15 В)	≥10* (5 В; 10 мА)	≤1 (5 В)	—	≤5,5 (1 ГГц)	—	22
BFR34	Si, n-p-n, ПЭ	200	4500	20	3,5	30	≤0,05 (10 В)	≥25* (6 В; 10 мА)	0,75 (10 В)	—	2,5 (800 МГц)	—	TO-50
BFR34A	Si, n-p-n, ПЭ	200	3300	20	3,5	30	≤0,05 (10 В)	≥25* (6 В; 10 мА)	0,75 (10 В)	—	3 (800 МГц)	—	TO-50
2SC1090	Si, n-p-n, ПЭ	300	3000	20	3	50	≤0,5 (10 В)	30...300* (5 В; 10 мА)	0,9 (5 В)	—	≤4,5 (1000МГц)	—	U-78
2N5652	Si, n-p-n, ПЭ	250	3000	20	3	30	≤0,1 (10 В)	30...300* (10 В; 10 мА)	0,6 (10 В)	—	≤2,5 (500 МГц)	—	TO-72

ТРАНЗИСТОРЫ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^*_{K,т\,max}$, $P^{**}_{K,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, мкА	$h_{21э}$, $h^*_{21э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$К_ш$, дБ, $r^*_б$, $r^{**}_{бэ\,нас}$, Ом	$\tau_к$, $t^*_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
КТ3129А9	Si, p-n-p, ПЭ	75 (100**)	≥200	50	5	100 (200*)	≤1 (50 В)	30...120 (5 В; 2 мА)	≤10 (10 В)	≤20	≤130**	—	КТ-46
КТ3129Б9	Si, p-n-p, ПЭ	75 (100**)	≥200	50	5	100 (200*)	≤1 (50 В)	80...250 (5 В; 2 мА)	≤10 (10 В)	≤20	≤130**	—	КТ-46

Продолжение

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^*_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, мкА	$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r^*_б$, $r^{**}_{бэ\,нас}$, Ом	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
КТ3129В9	Si, p-n-p, ПЭ	75 (100**)	≥200	30	5	100 (200*)	≤1 (30 В)	80...250 (5 В; 2 мА)	≤10 (10 В)	≤20	≤130**	—	КТ-46
КТ3129Г9	Si, p-n-p, ПЭ	75 (100**)	≥200	30	5	100 (200*)	≤1 (30 В)	200...500 (5 В; 2 мА)	≤10 (10 В)	≤20	≤130**	—	КТ-46
КТ3129Д9	Si, p-n-p, ПЭ	75 (100**)	≥200	20	5	100 (200*)	≤1 (20 В)	200...500 (5 В; 2 мА)	≤10 (10 В)	≤20	≤130**	—	КТ-46
BCF29	Si, p-n-p, ПЭ	200	150	30	5	100 (200*)	≤0,1 (20 В)	120...260 (5 В; 2 мА)	≤7 (10 В)	≤30	≤4 (1 кГц)	—	ТО-236
BCF30	Si, p-n-p, ПЭ	200	150	30	5	100 (200*)	≤0,1 (20 В)	215...500 (5 В; 2 мА)	≤7 (10 В)	≤30	≤4 (1 кГц)	—	ТО-236
BCF70	Si, p-n-p, ПЭ	200	150	50	5	100 (200*)	≤0,1 (20 В)	215...500 (5 В; 2 мА)	≤7 (10 В)	≤30	≤4 (1 кГц)	—	ТО-236
BCW29	Si, p-n-p, ПЭ	200	150	30	5	100 (200*)	≤0,1 (20 В)	120...260 (5 В; 2 мА)	≤7 (10 В)	≤30	≤10 (1 кГц)	—	ТО-236
BCW30	Si, p-n-p, ПЭ	200	150	30	5	100 (200*)	≤0,1 (20 В)	215...500 (5 В; 2 мА)	≤7 (10 В)	≤30	≤10 (1 кГц)	—	ТО-236
BCW61A	Si, p-n-p, ПЭ	150	≥180	32	5	100	≤0,02* (32 В)	125...250 (5 В; 2 мА)	≤6 (10 В)	≤25	≤6 (1 кГц)	≤800**	SOT-23
BCW61B	Si, p-n-p, ПЭ	150	≥180	32	5	100	≤0,02* (32 В)	175...350 (5 В; 2 мА)	≤6 (10 В)	≤25	≤6 (1 кГц)	≤800**	SOT-23
BCW61C	Si, p-n-p, ПЭ	150	≥180	32	5	100	≤0,02* (32 В)	250...500 (5 В; 2 мА)	≤6 (10 В)	≤25	≤6 (1 кГц)	≤800**	SOT-23
BCW69	Si, p-n-p, ПЭ	200	150	50	5	100 (200*)	≤0,1 (20 В)	120...260 (5 В; 2 мА)	≤7 (10 В)	≤30	≤10 (1 кГц)	—	ТО-236
BCW70	Si, p-n-p, ПЭ	200	150	50	5	100 (200*)	≤0,1 (20 В)	215...500 (5 В; 2 мА)	≤7 (10 В)	≤30	≤10 (1 кГц)	—	ТО-236
BCW89	Si, p-n-p, ПЭ	200	150	60	5	100 (200*)	≤0,1 (20 В)	120...260 (5 В; 2 мА)	≤7 (10 В)	≤30	≤10 (1 кГц)	—	ТО-236
BCX71G	Si, p-n-p, ПЭ	150	≥180	45	5	100	≤0,02* (32 В)	125...250 (5 В; 2 мА)	≤6 (10 В)	≤25	≤6 (1 кГц)	≤800**	SOT-23
BCX71H	Si, p-n-p, ПЭ	150	≥180	45	5	100	≤0,02* (32 В)	175...350 (5 В; 2 мА)	≤6 (10 В)	≤25	≤6 (1 кГц)	≤800**	SOT-23
BCX71J	Si, p-n-p, ПЭ	150	≥180	45	5	100	≤0,02* (32 В)	250...500 (5 В; 2 мА)	≤6 (10 В)	≤25	≤6 (1 кГц)	≤800**	SOT-23
2SA811C5	Si, p-n-p, ПЭ	150	100	50	5	50	≤0,05 (50 В)	135...270 (0,3 В; 0,5 мА)	6,2	≤10	—	—	SOT-23
2SA811C6	Si, p-n-p, ПЭ	150	100	50	5	50	≤0,05 (50 В)	200...400 (0,3 В; 0,5 мА)	6,2	≤10	—	—	SOT-23
2SA812M4	Si, p-n-p, ПЭ	200	180	60	5	100	≤0,1 (60 В)	90...180 (6 В; 1 мА)	4,2	≤3	—	—	SOT-23
2SA812M5	Si, p-n-p, ПЭ	200	180	60	5	100	≤0,1 (60 В)	135...270 (6 В; 1 мА)	4,2	≤3	—	—	SOT-23
2SA1052B	Si, p-n-p, Э	150	—	30	5	100	≤0,5 (20 В)	100...200 (12 В; 2 мА)	—	≤20	—	—	ТО-236
2SA1052C	Si, p-n-p, Э	150	—	30	5	100	≤0,5 (20 В)	160...320 (12 В; 2 мА)	—	≤20	—	—	ТО-236
2SA1052D	Si, p-n-p, Э	150	—	30	5	100	≤0,5 (20 В)	250...500 (12 В; 2 мА)	—	≤20	—	—	ТО-236
2SB709	Si, p-n-p, ПЭ	200	80	25	5	100	≤1 (10 В)	90...650 (10 В; 1 мА)	2,7 (10 В)	≤5	—	—	SOT-23
2SB709A	Si, p-n-p, ПЭ	200	80	45	5	100	≤1 (10 В)	90...650 (10 В; 1 мА)	2,7 (10 В)	≤5	—	—	SOT-23
КТ3130А9	Si, n-p-n, ПЭ	100	≥150	50	5	100	≤0,1 (50 В)	100...250 (5 В; 2 мА)	≤12 (5 В)	—	≤10 (1 кГц)	—	КТ-46
КТ3130Б9	Si, n-p-n, ПЭ	100	≥150	50	5	100	≤0,1 (50 В)	200...500 (5 В; 2 мА)	≤12 (5 В)	—	≤10 (1 кГц)	—	КТ-46
КТ3130В9	Si, n-p-n, ПЭ	100	≥150	30	5	100	≤0,1 (30 В)	200...500 (5 В; 2 мА)	≤12 (5 В)	—	≤10 (1 кГц)	—	КТ-46
КТ3130Г9	Si, n-p-n, ПЭ	100	≥300	20	5	100	≤0,1 (20 В)	400...1000 (5 В; 2 мА)	≤12 (5 В)	—	≤10 (1 кГц)	—	КТ-46
КТ3130Д9	Si, n-p-n, ПЭ	100	≥150	30	5	100	≤0,1 (30 В)	200...500 (5 В; 2 мА)	≤12 (5 В)	—	≤10 (1 кГц)	—	КТ-46
КТ3130Е9	Si, n-p-n, ПЭ	100	≥300	20	5	100	≤0,1 (20 В)	400...1000 (5 В; 2 мА)	≤12 (5 В)	—	≤4 (1 кГц)	—	КТ-46
КТ3130Ж9	Si, n-p-n, ПЭ	100	≥150	30	5	100	≤0,1 (20 В)	100...500 (5 В; 2 мА)	≤12 (5 В)	—	≤4 (1 кГц)	—	КТ-46
BCF32	Si, n-p-n, ПЭ	200	300	30	5	100 (200*)	≤0,1 (20 В)	200...450 (5 В; 2 мА)	≤4 (10 В)	≤25	≤4 (1 кГц)	—	ТО-236
BCF33	Si, n-p-n, ПЭ	200	300	30	5	100 (200*)	≤0,1 (20 В)	420...800 (5 В; 2 мА)	≤4 (10 В)	≤25	≤4 (1 кГц)	—	ТО-236
BCF81	Si, n-p-n, ПЭ	200	300	50	5	100 (200*)	≤0,1 (20 В)	420...800 (5 В; 2 мА)	≤4 (10 В)	≤25	≤4 (1 кГц)	—	ТО-236
BCW31	Si, n-p-n, ПЭ	200	300	30	5	100 (200*)	≤0,1 (20 В)	110...220 (5 В; 2 мА)	≤4 (10 В)	≤25	≤10 (1 кГц)	—	ТО-236
BCW32	Si, n-p-n, ПЭ	200	300	30	5	100 (200*)	≤0,1 (20 В)	200...450 (5 В; 2 мА)	≤4 (10 В)	≤25	≤10 (1 кГц)	—	ТО-236

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^*_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, мкА	$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r^*_б$, $r^{**}_{бэ\,нас}$, Ом	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{f\,max}$, нс	Корпус
BCW33	Si, n-p-n, ПЭ	200	300	30	5	100 (200*)	≤0,1 (20 В)	420...800 (5 В; 2 мА)	≤4 (10 В)	≤25	≤10 (1 кГц)	—	TO-236
BCW60A	Si, n-p-n, ПЭ	150	≥125	32	5	100	≤0,02* (32 В)	125...250 (5 В; 2 мА)	≤4,5 (10 В)	≤35	≤6 (1 кГц)	≤800**	SOT-23
BCW60B	Si, n-p-n, ПЭ	150	≥125	32	5	100	≤0,02* (32 В)	175...350 (5 В; 2 мА)	≤4,5 (10 В)	≤35	≤6 (1 кГц)	≤800**	SOT-23
BCW60C	Si, n-p-n, ПЭ	150	≥125	32	5	100	≤0,02* (32 В)	250...500 (5 В; 2 мА)	≤4,5 (10 В)	≤35	≤6 (1 кГц)	≤800**	SOT-23
BCW60D	Si, n-p-n, ПЭ	150	≥125	32	5	100	≤0,02* (32 В)	350...700 (5 В; 2 мА)	≤4,5 (10 В)	≤35	≤6 (1 кГц)	≤800**	SOT-23
BCW71	Si, n-p-n, ПЭ	200	300	50	5	100 (200*)	≤0,1 (20 В)	110...220 (5 В; 2 мА)	≤4 (10 В)	≤25	≤10 (1 кГц)	—	TO-236
BCW72	Si, n-p-n, ПЭ	200	300	50	5	100 (200*)	≤0,1 (20 В)	200...450 (5 В; 2 мА)	≤4 (10 В)	≤25	≤10 (1 кГц)	—	TO-236
BCW81	Si, n-p-n, ПЭ	200	300	50	5	100 (200*)	≤0,1 (20 В)	420...800 (5 В; 2 мА)	≤4 (10 В)	≤25	≤10 (1 кГц)	—	TO-236
BCV71	Si, n-p-n, ПЭ	200	300	60	5	100 (200*)	≤0,1 (20 В)	110...220 (5 В; 2 мА)	≤4 (10 В)	≤25	≤10 (1 кГц)	—	TO-236
BCV72	Si, n-p-n, ПЭ	200	300	60	5	100 (200*)	≤0,1 (20 В)	200...450 (5 В; 2 мА)	≤4 (10 В)	≤25	≤10 (1 кГц)	—	TO-236
BCX70G	Si, n-p-n, ПЭ	150	≥125	45	5	100	≤0,02* (32 В)	125...250 (5 В; 2 мА)	≤4,5 (10 В)	≤35	≤6 (1 кГц)	≤800**	SOT-23
BCX70H	Si, n-p-n, ПЭ	150	≥125	45	5	100	≤0,02* (32 В)	175...350 (5 В; 2 мА)	≤4,5 (10 В)	≤35	≤6 (1 кГц)	≤800**	SOT-23
BCX70J	Si, n-p-n, ПЭ	150	≥125	45	5	100	≤0,02* (32 В)	250...500 (5 В; 2 мА)	≤4,5 (10 В)	≤35	≤6 (1 кГц)	≤800**	SOT-23
BCX70K	Si, n-p-n, ПЭ	150	≥125	45	5	100	≤0,02* (32 В)	350...700 (5 В; 2 мА)	≤4,5 (10 В)	≤35	≤6 (1 кГц)	≤800**	SOT-23
2SC1622D6	Si, n-p-n, ПЭ	150	100	40	5	100	≤0,05 (40 В)	200...400 (3 В; 0,5 мА)	3,2	≤3	—	—	SOT-23
2SC1622D7	Si, n-p-n, ПЭ	150	100	40	5	100	≤0,05 (40 В)	300...600 (3 В; 0,5 мА)	3,2	≤3	—	—	SOT-23
2SC1623	Si, n-p-n, ПЭ	200	250	60	5	100	≤0,1 (60 В)	90...180 (6 В; 1 мА)	3	≤3	—	—	SOT-23
2SC2404	Si, n-p-n, ПЭ	100	650	30	5	50	≤0,1 (10 В)	260...1040 (5 В; 2 мА)	≤1* (6 В)	—	—	—	SOT-23
2SC2405	Si, n-p-n, ПЭ	100	—	35	5	50	≤0,1 (10 В)	260...1040 (5 В; 2 мА)	≤1* (6 В)	—	—	—	SOT-23
2SD601	Si, n-p-n, ПЭ	200	150	30	7	100	≤1 (10 В)	90...650 (10 В; 2 мА)	3,5 (10 В)	≤5	—	—	SOT-23
2SD601A	Si, n-p-n, ПЭ	200	150	60	7	100	≤1 (10 В)	90...650 (10 В; 2 мА)	3,5 (10 В)	≤5	—	—	SOT-23

МАЛОШУМЯЩИЕ СВЧ-ТРАНЗИСТОРЫ

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, мВт	$f_{гр}$, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, мкА	$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$K_р$, дБ	$K_ш$, дБ	$\tau_к$, пс, $r^*_б$, Ом	Корпус
KT371A	Si, n-p-n, ПЭ	100 (65 °C)	≥3000	10	3	20 (40*)	≤0,5 (10 В)	30...240 (1 В; 10 мА)	≤1,2 (5 В)	≥9 (400 МГц)	≤5 (400 МГц)	≤15; ≤10*	KT-14
BFR90	Si, n-p-n, ПЭ	180 (60°C)	≥3000	20	2	25	≤0,05 (10 В)	≥40 (10 В; 14 мА)	0,5 (10 В)	19,5 (500 МГц)	2,4 (500 МГц)	—	SOT-37

11 Заказ № 1141

Продолжение

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, мВт	$f_{гр}$, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, мкА	$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$K_р$, дБ	$K_ш$, дБ	$\tau_к$, пс, $r^*_б$, Ом	Корпус
КТ382А	Si, n-p-n, ПЭ	100 (65 °С)	⩾1800	15	3	20 (40*)	⩽0,5 (15 В)	40...330 (1 В; 5 мА)	⩽2 (5 В)	⩾9 (400 МГц)	⩽3 (400 МГц)	⩽15	КТ-14
КТ382Б	Si, n-p-n, ПЭ	100 (65 °С)	⩾1800	15	3	20 (40*)	⩽0,5 (15 В)	40...330 (1 В; 5 мА)	⩽2 (5 В)	⩾5 (400 МГц)	⩽4,5 (400 МГц)	⩽10	КТ-4
BFW92	Si, n-p-n, ПЭ	190 (73 °С)	1600	25 (имп)	2,5	25 (50*)	⩽0,05 (10 В)	20...150 (1 В; 5 мА)	0,7 (10 В)	11 (800 МГц)	4 (500 МГц)	—	SOT-37
MMT2857	Si, n-p-n, ПЭ	225	⩾1000	30	3	40	⩽0,05 (15 В)	⩾30 (1 В; 3 мА)	⩽1 (10 В)	18 (450 МГц)	3,8 (450 МГц)	8	Micro-T
MMT8015	Si, n-p-n, ПЭ	200	⩾1000	15	3	15	⩽0,01 (6 В)	25...300 (6 В; 1 мА)	⩽1 (6 В)	⩾6 (1 ГГц)	⩽4 (1 ГГц)	4	Micro-T
КТ399А	Si, n-p-n, ПЭ	150 (55 °С)	⩾1800	15**	3	30 (60*)	⩽0,5 (15 В)	⩾40* (1 В; 5 мА)	⩽1,7 (5 В)	⩾11,5 (400 МГц)	⩽2 (400 МГц)	⩽8	КТ-1
КТ399АМ	Si, n-p-n, ПЭ	150 (55 °С)	⩾1800	15**	3	30 (60*)	⩽0,5 (15 В)	⩾40* (1 В; 5 мА)	⩽1,7 (5 В)	⩾11,5 (400 МГц)	⩽2 (400 МГц)	⩽8	КТ-26
2SC1260	Si, n-p-n, ПЭ	250	⩾1500	45	4	30	⩽0,1 (30 В)	40...200 (6 В; 6 мА)	⩽0,7 (6 В)	13 (0,5 ГГц)	3 (0,5 ГГц)	—	ТО-72
BFW30	Si, n-p-n, ПЭ	250	1600	20	2,5	50 (100*)	⩽0,05 (10 В)	⩾25 (5 В; 5 мА)	⩽1,5 (5 В)	7 (0,8 ГГц)	⩽5 (0,5 ГГц)	—	ТО-72
BFY90	Si, n-p-n, ПЭ	200	⩾1300	30	2,5	25 (50*)	⩽0,01 (15 В)	25...150 (1 В; 2 мА)	⩽1,5 (10 В)	8 (0,8 ГГц)	⩽5 (0,5 ГГц)	—	ТО-72
2N2857	Si, n-p-n, ПЭ	200	⩾1000	30	2,5	40	⩽0,01 (15 В)	30...150 (1 В; 3 мА)	⩽1 (10 В)	⩾12,5 (450 МГц)	⩽4,5 (450 МГц)	⩽15	ТО-72
2N3570	Si, n-p-n, ПЭ	200	⩾1500	30	3	50	⩽0,01 (6 В)	20...150 (6 В; 5 мА)	⩽0,75 (6 В)	—	⩽7 (1 ГГц)	⩽8	ТО-72
2N3571	Si, n-p-n, ПЭ	200	⩾1200	25	3	50	⩽0,01 (6 В)	20...200 (6 В; 5 мА)	⩽0,85 (6 В)	—	⩽4 (450 МГц)	⩽10	ТО-72
2N3572	Si, n-p-n, ПЭ	200	⩾1000	25	3	50	⩽0,01 (6 В)	20...300 (6 В; 5 мА)	⩽0,85 (6 В)	—	⩽6 (450 МГц)	⩽13	ТО-72
2N3839	Si, n-p-n, ПЭ	200	⩾1000	30	2,5	40	⩽0,01	⩾30 (1 В; 3 мА)	—	⩾12,5 (45 МГц)	⩽3,4 (450 МГц)	—	ТО-72

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, мВт	$f_{гр}$, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, мкА	$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$K_р$, дБ	$K_ш$, дБ	$\tau_к$, пс, $r^*_б$, Ом	Корпус
2N3880	Si, n-p-n	200	1200	30	2,5	—	⩽0,05	30...200 (6 В; 3 мА)	—	⩾14 (450 МГц)	⩽3,5 (450 МГц)	—	ТО-72
2N5031	Si, n-p-n	200	⩾1000	15	3	20	⩽0,01 (6 В)	25...300 (6 В; 1 мА)	⩽1,5 (6 В)	⩾14 (450 МГц)	⩽2,5 (450 МГц)	5	ТО-72
2N5032	Si, n-p-n	200	⩾1000	15	3	20	⩽0,01 (6 В)	25...300 (6 В; 1 мА)	⩽1,5 (6 В)	⩾14 (450 МГц)	⩽3 (450 МГц)	5	ТО-72
2N5179	Si, n-p-n	200	⩾900	20	2,5	50	⩽0,02 (15 В)	25...250 (1 В; 3 мА)	⩽1 (10 В)	⩾15 (200 МГц)	⩽4,5 (200 МГц)	⩽14	ТО-72
2N6304	Si, n-p-n	200	⩾1400	30	3,5	50	⩽0,01 (5 В)	25...250 (5 В; 2 мА)	⩽1 (10 В)	⩾15 (450 МГц)	⩽4,5 (450 МГц)	⩽12	ТО-72
2N6305	Si, n-p-n	200	⩾1200	30	3,5	50	⩽0,01 (5 В)	25...250 (5 В; 2 мА)	⩽1 (10 В)	⩾12 (450 МГц)	⩽5,5 (450 МГц)	⩽15	ТО-72
MM8006	Si, n-p-n	200	⩾1000	15	3	20	⩽0,01 (6 В)	⩾25 (6 В; 1 мА)	⩽1,5 (6 В)	⩾14 (450 МГц)	⩽3,8 (450 МГц)	5	ТО-72
MM8007	Si, n-p-n	200	⩾1000	15	3	20	⩽0,01 (6 В)	⩾25 (6 В; 1 мА)	⩽1,5 (6 В)	⩾12 (450 МГц)	⩽5 (450 МГц)	5	ТО-72
SD1300	Si, n-p-n	200	⩾1500	30	3,5	50	⩽0,1 (15 В)	30...300 (10 В; 10 мА)	⩽1,8 (10 В)	20 (200 МГц)	⩽5 (450 МГц)	—	ТО-72
SD1301	Si, n-p-n	200	⩾1500	30	3,5	50	⩽0,1 (15 В)	30...300 (10 В; 10 мА)	⩽1 (10 В)	20 (200 МГц)	⩽5 (450 МГц)	—	ТО-72
КТ3109А	Si, p-n-p, ПЭ	170 (40 °C)	⩾800	30	3	50	⩽0,1 (20 В)	⩾15 (10 В; 10 мА)	⩽1 (10 В)	⩾10 (0,8 ГГц)	⩽6 (800 МГц)	⩽6	КТ-14
КТ3109Б	Si, p-n-p, ПЭ	170 (40 °C)	⩾800	25	3	50	⩽0,1 (20 В)	⩾15 (10 В; 10 мА)	⩽1 (10 В)	—	⩽7 (800 МГц)	⩽10	КТ-14
КТ3109В	Si, p-n-p, ПЭ	170 (40 °C)	⩾800	25	3	50	⩽0,1 (20 В)	⩾15 (10 В; 10 мА)	⩽1 (10 В)	—	⩽8 (800 МГц)	⩽10	КТ-14
BF970	Si, p-n-p, ПЭ	160 (55 °C)	900	40	3	30	⩽0,1 (20 В)	⩾25 (10 В; 3 мА)	0,475 (5 В)	⩾13 (0,8 ГГц)	⩽8 (800 МГц)	—	SOT-37
BF979	Si, p-n-p, ПЭ	140 (55 °C)	1000	20	3	30*	⩽0,1 (15 В)	⩾20 (10 В; 10 мА)	0,65* (10 В)	—	⩽6 (800 МГц)	—	SOT-37
BF680	Si, p-n-p, ПЭ	160 (55 °C)	750	30	3	50	⩽0,1 (20 В)	⩾25 (10 В; 3 мА)	0,5 (10 В)	⩾10 (0,8 ГГц)	⩽6 (800 МГц)	—	ТО-50
КТ3120А	Si, p-n-p, ПЭ	100	⩾1800	15	3	20 (40*)	0,5 (15 В)	⩾40 (1 В; 5 мА)	⩽2 (5 В)	⩾10 (400 МГц)	⩽2 (400 МГц)	⩽8	КТ-14
BF480	Si, p-n-p, ПЭ	200 (60 °C)	2000	20	2	20 (30*)	—	—	—	15 (200 МГц)	2,9 (200 МГц)	—	SOT-37

ТРАНЗИСТОРЫ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ НИЗКОЙ, СРЕДНЕЙ И ВЫСОКОЙ ЧАСТОТ

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^*_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K,\,и\,max}$, Вт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, мкА	$h_{21э}$, $h^*_{21э}$	$C_к$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$К_ш$, дБ, $τ^*_к$, пс, $r^{**}_{бэ\,нас}$, $h^{***}_{11б}$, Ом	$t_{рас}$, $t^*_{выкл}$, $t^{**}_{пк}$, нс	Корпус
ГТ402Д	Ge, p-n-p, С	0,3; 0,6	⩾1*	25* (0,2 к)	—	500	⩽25 (10 В)	30...80 (1 В; 3 мА)	—	⩽5	—	—	23; 27
ГТ402Е	Ge, p-n-p, С	0,3; 0,6	⩾1*	25* (0,2 к)	—	500	⩽25 (10 В)	60...150 (1 В; 3 мА)	—	⩽5	—	—	23; 27
ГТ402Ж	Ge, p-n-p, С	0,3; 0,6	⩾1*	40* (0,2 к)	—	500	⩽25 (10 В)	30...80 (1 В; 3 мА)	—	⩽5	—	—	23; 27
ГТ402И	Ge, p-n-p, С	0,3; 0,6	⩾1*	40* (0,2 к)	—	500	⩽25 (10 В)	60...150 (1 В; 3 мА)	—	⩽5	—	—	23; 27
AC128	Ge, p-n-p, C	1*	⩾1	32	10	1000	⩽10 (10 В)	55...175 (50 мА)	100 (5 В)	—	—	—	TO-1
AC188	Ge, p-n-p, C	1*	⩾1	25	10	1000	⩽200 (25 В)	⩾70 (10 В; 5 мА)	⩽110 (5 В)	—	—	—	TO-1
AC152	Ge, p-n-p, C	0,3 (0,9*)	1,5	32	10	500	⩽25 (32 В)	114* (0,5 В; 2 мА)	⩽40 (5 В)	⩽8	—	—	TO-1
ACY33	Ge, p-n-p, C	0,3 (1,1*)	⩾1	32	10	1000	⩽10 (10 В)	97 (50 мА)	⩽100 (5 В)	⩽10	—	—	TO-1
AC117	Ge, p-n-p, C	1,1	0,01**	32	10	1000	⩽6 (6 В)	60...400 (2 В; 150 мА)	—	—	—	—	X-9
AC138	Ge, p-n-p, C	2,2	1,5*	32	10	1200	⩽15 (10 В)	30...250 (6 В; 5 мА)	—	—	—	—	TO-1
AC124	Ge, p-n-p, C	1*	0,011**	45	10	1000	⩽8 (45 В)	60...170 (2 В; 150 мА)	—	—	—	—	TO-1
AC184	Ge, p-n-p, C	0,27	2,5	45	10	500 (1000*)	⩽10 (10 В)	50...250 (1 В; 300 мА)	40 (6 В)	—	—	—	R-134
AC139	Ge, p-n-p, C	0,22	1,5*	32	10	1000	⩽14 (12 В)	40...160 (0,4 А)	—	—	—	—	TO-1
AC142	Ge, p-n-p, C	0,22	1,5*	32	10	1200	⩽14 (12 В)	40...160 (0,4 А)	—	—	—	—	TO-1
SFT325	Ge, p-n-p, C	0,2	2	32	12	500	⩽25	150* (6 В; 5 мА)	—	—	—	—	X-47
GC500	Ge, p-n-p, C	0,55	⩾0,5	24	10	300 (600*)	⩽16 (6 В)	50 (300 мА)	—	⩽0,8	⩽15 (1 кГц)	—	A-6
GC501	Ge, p-n-p, C	0,55	⩾1	24	10	300 (600*)	⩽16 (6 В)	95 (300 мА)	—	⩽0,8	⩽15 (1 кГц)	—	A-6
GC502	Ge, p-n-p, C	0,55	⩾1	32	20	300 (600*)	⩽16 (6 В)	95 (300 мА)	—	⩽0,8	15 (1 кГц)	—	A-6
ГТ405А[1]	Ge, p-n-p, С	0,6	⩾1*	25* (0,2 к)	—	500	⩽25 (10 В)	30...80 (1 В; 3 мА)	—	—	—	—	24
ГТ405Б[1]	Ge, p-n-p, С	0,6	⩾1*	25* (0,2 к)	—	500	⩽25 (10 В)	60...150 (1 В; 3 мА)	—	—	—	—	24
ГТ405В[1]	Ge, p-n-p, С	0,6	⩾1*	40* (0,2 к)	—	500	⩽25 (10 В)	30...80 (1 В; 3 мА)	—	—	—	—	24
ГТ405Г[1]	Ge, p-n-p, С	0,6	⩾1*	40* (0,2 к)	—	500	⩽25 (10 В)	60...150 (1 В; 3 мА)	—	—	—	—	24
ГТ403А	Ge, p-n-p, С	4*	⩾0,008**	45	20	1250	⩽50 (45 В)	20...60 (5 В; 0,1 А)	—	⩽1	—	—	25
ГТ403Б	Ge, p-n-p, С	4*	⩾0,008**	45	20	1250	⩽50 (45 В)	50...150 (5 В; 0,1 А)	—	⩽1	—	—	25
ГТ403В	Ge, p-n-p, С	5*	⩾0,008**	60	20	1250	⩽50 (60 В)	20...60 (5 В; 0,1 А)	—	⩽1	—	—	25

[1] Германиевые транзисторы в пластмассовом корпусе с таким сочетанием параметров не выпускаются. Зарубежные приборы, рекомендуемые для замены, такие же, как для транзисторов типа ГТ402.

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^*_{K,т\,max}$, $P^{**}_{K,и\,max}$, Вт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, мкА	$h_{21э}$, $h^*_{21э}$	$C_к$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $\tau^*_к$, пс, $r^{**}_{бэ\,нас}$, $h^{***}_{11б}$, Ом	$t_{рас}$, $t^*_{выкл}$, $t^{**}_{пк}$, нс	Корпус
ГТ403Г	Ge, p-n-p, C	4*	⩾0,006**	60	20	1250	⩽50 (60 В)	50...150 (5 В; 0,1 А)	—	⩽1	—	—	25
ГТ403Д	Ge, p-n-p, C	4*	⩾0,006**	60	30	1250	⩽50 (60 В)	50...150 (5 В; 0,1 А)	—	⩽1	—	—	25
ГТ403Е	Ge, p-n-p, C	5*	⩾0,008**	60	20	1250	⩽50 (60 В)	⩾30 (0,45 А)	—	⩽1	—	—	25
ГТ403Ж	Ge, p-n-p, C	4*	⩾0,008**	80	20	1250	⩽50 (80 В)	20...60 (5 В; 0,1 А)	—	⩽1	—	—	25
ГТ403И	Ge, p-n-p, C	4*	⩾0,008**	80	20	1250	⩽50 (80 В)	⩾30 (0,45 А)	—	⩽1	—	—	25
ГТ403Ю	Ge, p-n-p, C	4*	⩾0,008**	45	20	1250	⩽50 (45 В)	30...60 (5 В; 0,1 А)	—	⩽1	—	—	25
ГТ406А	Ge, p-n-p, C	0,6 (4*)	⩾0,006**	25	20	1250	⩽50 (25 В)	50...150 (5 В; 0,1 А)	—	⩽1	—	—	25
ASY76	Ge, p-n-p, C	0,5	⩾0,5	40	10	500 (1000*)	⩽40 (40 В)	⩾45 (6 В; 10 мА)	⩽60 (5 В)	⩽1	⩽15 (1 кГц)	—	ТО-5
ASY77	Ge, p-n-p, C	0,5	⩾0,5	60	10	500 (1000*)	⩽40 (60 В)	⩾45 (6 В; 10 мА)	⩽60 (5 В)	⩽1	⩽15 (1 кГц)	—	ТО-5
ASY80	Ge, p-n-p, C	0,5	⩾0,7	40	20	500 (1000*)	⩽40 (40 В)	⩾50 (0,3 А)	⩽60 (5 В)	⩽1	⩽15 (1 кГц)	—	ТО-5
AD164	Ge, p-n-p, C	6* (45°С)	0,011**	25	20	500 (1000*)	⩽30 (25 В)	80...320 (1 В; 0,5 А)	—	—	—	—	MD-11
AD152	Ge, p-n-p, C	6*	0,011**	45	12	1000	⩽30 (45 В)	40...160 (1 В; 0,5 А)	—	—	—	—	MD-11
AD155	Ge, p-n-p, C	6*	0,011**	25	12	1000	⩽30 (45 В)	65...320 (1 В; 0,5 А)	—	—	—	—	MD-11
AD169	Ge, p-n-p, C	6*	0,011**	45	12	1000	⩽30 (45 В)	40...160 (1 В; 0,5 А)	—	—	—	—	MD-11
GC510K	Ge, p-n-p, C	1*	⩾0,01**	32	10	1000 (2000*)	⩽10 (10 В)	60...175 (0,3 А)	85 (6 В)	⩽0,6	—	—	А-7
GC512K	Ge, p-n-p, C	1*	⩾0,01**	25	10	1000 (2000*)	⩽15 (10 В)	⩾25 (0,3А)	85 (6 В)	⩽0,6	—	—	А-7
2NU72	Ge, p-n-p, C	4*	⩾0,1	24	8	1500	⩽35 (6 В)	⩾10 (1,5 А)	—	⩽0,2	—	—	SOT-9
3NU72	Ge, p-n-p, C	4*	⩾0,1	32	10	1500	⩽35 (6 В)	⩾10 (1,5 А)	—	⩽0,2	—	—	SOT-9
4NU72	Ge, p-n-p, C	4*	⩾0,1	48	15	1500	⩽35 (6 В)	⩾10 (1,5 А)	—	⩽0,2	—	—	SOT-9
5NU72	Ge, p-n-p, C	4*	⩾0,1	60	20	1500	⩽35 (6 В)	⩾10 (1,5 А)	—	⩽0,2	—	—	SOT-9
ADP665	Ge, p-n-p, C	3,2*	⩾0,1	30	10	1500	—	20...120 (6 В; 0,1 А)	—	—	—	—	ТО-66
ADP666	Ge, p-n-p, C	3,2*	⩾0,1	60	10	1500	—	20...120 (6 В; 0,1 А)	—	—	—	—	ТО-66
ГТ404А	Ge, n-p-n, C	0,6; 0,3	⩾1*	25* (0,2 к)	—	500	⩽25 (10 В)	30...80 (1 В; 3 мА)	—	⩽6	—	—	23; 27
ГТ404Б	Ge, n-p-n, C	0,6; 0,3	⩾1*	25* (0,2 к)	—	500	⩽25 (10 В)	60...150 (1 В; 3 мА)	—	⩽6	—	—	23; 27
ГТ404В	Ge, n-p-n, C	0,6; 0,3	⩾1*	40* (0,2 к)	—	500	⩽25 (10 В)	30...80 (1 В; 3 мА)	—	⩽6	—	—	23; 27
ГТ404Г	Ge, n-p-n, C	0,6; 0,3	⩾1*	40* (0,2 к)	—	500	⩽25 (10 В)	60...150 (1 В; 3 мА)	—	⩽6	—	—	23; 27
ГТ404Д	Ge, n-p-n, C	0,6; 0,3	⩾1*	25* (0,2 к)	—	500	⩽25 (10 В)	30...80 (1 В; 3 мА)	—	⩽6	—	—	23; 27
ГТ404Е	Ge, n-p-n, C	0,6; 0,3	⩾1*	25* (0,2 к)	—	500	⩽25 (10 В)	60...150 (1 В; 3 мА)	—	⩽6	—	—	23; 27

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^*_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K,\,и\,max}$, Вт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, мкА	$h_{21Э}$, $h^*_{21э}$	$C_к$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$К_ш$, дБ, $\tau^*_к$, пс, $r^{**}_{бэ\,нас}$, $h^{***}_{11б}$, Ом	$t_{рас}$, $t^*_{выкл}$, $t^{**}_{пк}$, нс	Корпус
ГТ404Ж	Ge, n-p-n, С	0,6; 0,3	≥1*	40* (0,2 к)	—	500	≤25 (10 В)	30...80 (1 В; 3 мА)	—	≤6	—	—	23; 27
ГТ404И	Ge, n-p-n, С	0,6; 0,3	≥1*	40* (0,2 к)	—	500	≤25 (10 В)	60...150 (1 В; 3 мА)	—	≤6	—	—	23; 27
АС127	Ge, n-p-n, С	0,24 (0,34*)	≥1,5	32	10	500	≤15 (10 В)	100 (20 мА)	70 (5 В)	—	≤10 (1 кГц)	—	ТО-1
АС187	Ge, n-p-n, С	1	≥1*	25	10	1000	≤100 (25 В)	≥70 (10 В; 5 мА)	≤180 (5 В)	—	—	—	ТО-1
АС176	Ge, n-p-n, С	1	≥1*	32	10	1000	≤500 (32 В)	35 (50 мА)	≤100 (5 В)	≤5,5	—	—	ТО-1
АС181	Ge, n-p-n, С	0,3	≥2*	32	20	1000	≤20 (10 В)	50...250 (1 В; 0,6 А)	80 (5 В)	0,3	≤10 (1 кГц)	—	R-134
АС141	Ge, n-p-n, С	0,22 (0,72*)	3*	32	10	1200	≤14 (10 В)	40...160 (0,4 А)	—	—	—	—	ТО-1
АС141В	Ge, n-p-n, С	0,22 (0,72*)	3*	25	10	1200	≤14 (10 В)	30...250 (6 В; 1 мА)	—	—	—	—	ТО-1
SFT377	Ge, n-p-n, С	0,25	≥1	16**	10	600	10	50 (1 В; 0,3 А)	—	—	—	—	ТО-1
2SD127	Ge, n-p-n, С	0,25	≥1	23	12	500	20	82 (1 В; 20 мА)	—	—	—	—	ТО-1
2SD127A	Ge, n-p-n, С	0,25	≥1	23	12	500	20	≥46 (1 В; 0,5 А)	—	—	—	—	ТО-1
2SD128	Ge, n-p-n, С	0,25	≥1	32	12	500	20	82 (1 В; 20 мА)	—	—	—	—	ТО-1
2SD128A	Ge, n-p-n, С	0,25	≥1	32	12	500	20	≥46 (1 В; 0,5 А)	—	—	—	—	ТО-1
2SD72	Ge, n-p-n, С	0,72	0,75	25	6	600	50	80 (1 В; 0,2 А)	—	—	—	—	ТО-1
GD607	Ge, n-p-n, С	4*	≥1	32	10	1 А (2* А)	≤35 (10 В)	30...180 (50 мА)	—	—	—	—	SOT-9
GD608	Ge, n-p-n, С	4*	≥1	25	10	1 А (2* А)	≤35 (10 В)	100...500 (50 мА)	—	—	—	—	SOT-9
GD609	Ge, n-p-n, С	4*	≥1	20	10	1 А (2* А)	≤35 (10 В)	30...500 (50 мА)	—	—	—	—	SOT-9
АС185	Ge, n-p-n, С	0,27 (1,25*)	≥2	32	20	500 (1000*)	≤20 (10 В)	50...250 (1 В; 0,3 А)	80 (6 В)	—	—	—	ТО-11
П605	Ge, p-n-p, К	3*	—	45	1	1500	≤2000 (45 В)	20...60 (3 В; 0,5 А)	≤130 (20 В)	≤40	≤500*	≤3000	26
П605А	Ge, p-n-p, К	3*	—	45	0,5	1500	≤2000 (45 В)	40...120 (3 В; 0,5 А)	≤130 (20 В)	≤40	≤500*	≤4000	26
П606	Ge, p-n-p, К	1,25*	≥30	35	1	1500	≤2000 (35 В)	20...60 (3 В; 0,5 А)	≤130 (20 В)	≤40	≤500*	≤3000	26
П606А	Ge, p-n-p, К	1,25*	≥30	35	0,5	1500	≤2000 (35 В)	40...120 (3 В; 0,5 А)	≤130 (20 В)	≤40	≤500*	≤4000	26
2SA416	Ge, p-n-p, СД	6*	≥60	70	1,5	700	600	40...100 (10 В; 0,5 А)	—	—	—	600	ТО-3
П607	Ge, p-n-p, К	1,5* (40°C)	≥60	30	1,5	300 (600*)	≤300 (30 В)	20...80 (3 В; 0,25 А)	≤50 (10 В)	≤10	≤500*	≤3000	26
П607А	Ge, p-n-p, К	1,5* (40°C)	≥60	30	1,5	300 (600*)	≤300 (30 В)	60...200 (3 В; 0,25 А)	≤50 (10 В)	≤10	≤500*	≤3000	26
П608	Ge, p-n-p, К	1,5* (40°C)	≥90	30	1,5	300 (600*)	≤300 (30 В)	40...120 (3 В; 0,25 А)	≤50 (10 В)	≤10	≤500*	≤3000	26

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^*_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K,\,и\,max}$, Вт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, мкА	$h_{21Э}$, $h^*_{21э}$	$C_к$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$К_ш$, дБ, $\tau^*_к$, пс, $r^{**}_{бэ\,нас}$, Ом, $h^{***}_{11б}$	$t_{рас}$, $t^*_{выкл}$, $t^{**}_{пк}$, нс	Корпус
П608А	Ge, p-n-p, К	1,5* (40°C)	⩾90	30	1,5	300 (600*)	⩽300 (30 В)	80...240 (3 В; 0,25 А)	⩽50 (10 В)	⩽10	⩽500*	⩽3000	26
П609	Ge, p-n-p, К	1,5* (40°C)	⩾120	30	1,5	300 (600*)	⩽300 (30 В)	40...120 (3 В; 0,25 А)	⩽50 (10 В)	⩽10	⩽500*	⩽3000	26
П609А	Ge, p-n-p, К	1,5* (40°C)	⩾120	30	1,5	300 (600*)	⩽300 (30 В)	80...240 (3 В; 0,25 А)	⩽50 (10 В)	⩽10	⩽500*	⩽3000	26
AUY10	Ge, p-n-p, СД	4,5*	120	70	2	700	⩽2000	⩾40 (10 В; 0,6 А)	—	—	—	—	ТО-3
2SA374	Ge, p-n-p, СД	1,5*	⩾150	34	0,5	300	12	100 (2 В; 0,15 А)	13	—	—	—	ТО-5
КТ601А	Si, n-p-n, П	0,25 (0,5*)	⩾40	100* (10 к)	3	30	⩽50 (50 В)	⩾16 (20 В; 10 мА)	⩽15 (20 В)	—	⩽600*	—	27
КТ601АМ	Si, n-p-n, П	0,5	⩾40	100* (10 к)	3	30	⩽300* (100 В)	⩾16 (20 В; 10 мА)	⩽15 (20 В)	—	⩽600*	—	31
2SC64	Si, n-p-n, М	0,6	⩾20	130	3	50	1,5	20 (20 В; 5 мА)	10	—	—	—	ТО-5
2N1051	Si, n-p-n, Д	0,5*	⩾60	60	8	100	—	⩾30 (5 В; 5 мА)	⩽7	—	—	—	ТО-5
2N1564	Si, n-p-n, Д	0,6*	⩾60	80	5	50	—	⩾20 (5 В; 5 мА)	⩽10	—	—	—	ТО-5
2N735А	Si, n-p-n, ПЭ	0,5*	⩾60	80	6	50	⩽0,005 (50 В)	30...100 (5 В; 5 мА)	⩽10 (5 В)	⩽100	—	—	ТО-18
2N844	Si, n-p-n, М	0,3	⩾50	60	3	50	1	80* (10 В; 1 мА)	⩽6	—	—	—	ТО-18
2N845	Si, n-p-n, М	0,3	⩾50	100	3	50	⩽1	80* (10 В; 1 мА)	⩽6	—	—	—	ТО-18
2N1565	Si, n-p-n, Д	0,6	⩾60	80	5	50	1	⩾40 (5 В; 5 мА)	⩽10	—	—	—	ТО-5
КТ630А	Si, n-p-n, П	0,8	⩾50	120	7	1000 (2000*)	⩽1 (90 В)	40...120 (10В; 0,15 А)	⩽15 (10 В)	⩽2	⩾5***	⩽500*	19
КТ630Б	Si, n-p-n, П	0,8	⩾50	120	7	1000 (2000*)	⩽1 (90 В)	80...240 (10 В; 0,15 А)	⩽15 (10 В)	⩽2	⩾5***	⩽500*	19
КТ630В	Si, n-p-n, П	0,8	⩾50	150	7	1000 (2000*)	⩽1 (90 В)	40...120 (10 В; 0,15 А)	⩽15 (10 В)	⩽2	⩾5***	⩽500*	19
КТ630Г	Si, n-p-n, П	0,8	⩾50	100	5	1000 (2000*)	⩽1 (40 В)	40...120 (10 В; 0,15 А)	⩽15 (10 В)	⩽2	⩾5***	⩽500*	19
КТ630Д	Si, n-p-n, П	0,8	⩾50	60	5	1000 (2000*)	⩽1 (40 В)	80...240 (10 В; 0,15 А)	⩽15 (10 В)	⩽2	⩾5***	⩽500*	19
КТ630Е	Si, n-p-n, П	0,8	⩾50	60	5	1000 (2000*)	⩽1 (40 В)	160...480 (10 В; 0,15 А)	⩽15 (10 В)	⩽2	⩾5***	⩽500*	19
2N656	Si, n-p-n	1 (4*)	⩾40	60	8	600	⩽10 (30 В)	30...90 (10 В; 0,2 А)	—	⩽20	⩽25**	—	ТО-5
2N657	Si, n-p-n	1 (4*)	⩾40	100	8	600	⩽10 (30 В)	30...90 (10 В; 0,2 А)	—	⩽20	⩽25**	—	ТО-5
2N1613	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	⩾60	75	7	1000	⩽0,01 (60 В)	40...120 (10В; 0,15 А)	⩽25 (10 В)	⩽10	⩾24***	—	ТО-5
2N1711	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	⩾70	75	7	1000	⩽0,01 (60 В)	100...300 (10 В; 0,15 А)	⩽25 (10 В)	⩽10	⩾24***	—	ТО-5
2N1893	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	⩾50	120	7	1000	⩽0,01 (90 В)	40...120 (10 В; 0,15 А)	⩽15 (10 В)	⩽24	⩾20***	—	ТО-5
2N2243	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	⩾50	120	7	1000	⩽0,01 (60 В)	40...120 (10 В; 0,15 А)	⩽15 (10 В)	⩽2,3	—	—	ТО-5

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^*_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K,\,и\,max}$, Вт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, мкА	$h_{21э}$, $h^*_{21э}$	$C_к$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $\tau^*_к$, пс, $r^{**}_{бэ\,нас}$, $h^{***}_{11б}$, Ом	$t_{рас}$, $t^*_{выкл}$, $t^{**}_{пк}$, нс	Корпус
2N2243A	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	≥50	120	7	1000	≤0,01 (60 В)	40...120 (10 В; 0,15 А)	≤15 (10 В)	≤1,6	—	—	ТО-5
2N2987	Si, n-p-n, ТДП	1 (15*)	≥30	95	7	1000 (1500*)	≤0,1** (50 В)	25...75 (5 В; 0,2 А)	≤50 (10 В)	≤6	—	2600*	ТО-5
2N2988	Si, n-p-n, ТДП	1 (15*)	≥30	155	7	1000 (1500*)	≤0,1** (90 В)	25...75 (5 В; 0,2 А)	≤50 (10 В)	≤6	—	2600*	ТО-5
2N2989	Si, n-p-n, ТДП	1 (15*)	≥30	95	7	1000 (1500*)	≤0,1** (50 В)	60...120 (5 В; 0,2 А)	≤50 (10 В)	≤6	—	2600*	ТО-5
2N2990	Si, n-p-n, ТДП	1 (15*)	≥30	155	7	1000 (1500*)	≤0,1** (90 В)	60...120 (5 В; 0,2 А)	≤50 (10 В)	≤6	—	2600*	ТО-5
2N497	Si, n-p-n, Д	0,8 (4*)	≥30	60	8	600	≤10 (30 В)	12...36 (10 В; 0,2 А)	—	≤25	—	—	ТО-5
2N498	Si, n-p-n, Д	0,8 (4*)	≥30	100	8	600	≤10 (30 В)	12...36 (10 В; 0,2 А)	—	≤25	—	—	ТО-5
2N3053	Si, n-p-n, ПЭ	1	≥100	60	5	700	≤100 (60 В)	50...250 (10 В; 0,15 А)	≤15 (10 В)	≤9	—	—	ТО-5
2N3107	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	≥70	100	7	1000	≤0,01 (60 В)	100...300 (1 В; 0,15 А)	≤20 (10 В)	≤1,6	—	≤1000*	ТО-5
2N3108	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	≥70	100	7	1000	≤0,01 (60 В)	40...120 (1 В; 0,15 А)	≤20 (10 В)	≤1,6	—	≤600*	ТО-5
2N3109	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	≥60	80	7	1000	≤0,01 (60 В)	100...300 (1 В; 0,15 А)	≤25 (10 В)	≤1,6	—	≤1000*	ТО-5
2N3110	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	≥60	80	7	1000	≤0,01 (60 В)	40...120 (1 В; 0,15 А)	≤25 (10 В)	≤1,6	—	≤600*	ТО-5
2N697	Si, n-p-n, П	0,6	≥50	60	5	500	≤1 (30 В)	40...120 (1 В; 0,15 А)	≤35 (10 В)	≤10	≥20***	—	ТО-39
2N699	Si, n-p-n, П	0,6	≥50	120	5	1000	≤0,05 (60 В)	40...120 (1 В; 0,15 А)	≤50 (10 В)	≤33	≥20***	—	ТО-39
2N2270	Si, n-p-n, П	1	≥60	60	7	1000	≤0,05 (60 В)	50...200 (10 В; 0,15 А)	≤15 (10 В)	≤6	—	—	ТО-39
2N2102	Si, n-p-n, П	1	≥60	120	7	1000	≤0,002 (60 В)	40...120 (10 В; 0,15 А)	≤15 (10 В)	≤3,3	≥24***	—	ТО-39
2N2102A	Si, n-p-n, П	1	≥60	120	7	1000	≤0,002 (60 В)	40...120 (10 В; 0,15 А)	≤15 (10 В)	≤2	—	—	ТО-39
2N2405	Si, n-p-n, П	1	≥50	120	7	1000	≤0,01 (90 В)	60...200 (10 В; 0,15 А)	≤15 (10 В)	≤7	≥24***	—	ТО-39
BC140	Si, n-p-n, ПЭ	1	≥50	80	7	1000	≤0,1* (60 В)	40...250 (1 В; 0,1 А)	≤25 (10 В)	≤14	—	—	ТО-39
BC141	Si, n-p-n, ПЭ	1	≥60	100	7	1000	≤0,1* (60 В)	40...250 (1 В; 0,1 А)	≤25 (10 В)	≤14	—	≤850*	ТО-39
BC300	Si, n-p-n, П	0,85	120	120	7	1000	—	40...240 (10 В; 0,15А)	≤10 (10 В)	≤3,3	—	—	ТО-5
2N696	Si, n-p-n, Д	0,6	≥40	60	5	500	≤1 (30 В)	20...60 (10 В; 0,15 А)	≤35 (10 В)	≤10	—	—	ТО-5
2N698	Si, n-p-n, П	0,8	≥40	120	7	500	0,005 (75 В)	20...60 (10 В; 0,15 А)	≤15 (10 В)	≤9	≥20***	—	ТО-39
2N1420	Si, n-p-n, Д	0,6	≥50	60	5	1000	≤1 (30 В)	100...300 (10 В; 0,15 А)	≤35 (10 В)	≤10	≥24***	—	ТО-39
2N1507	Si, n-p-n, П	0,6	≥50	60	5	1000	≤1 (30 В)	100...300 (10 В; 0,15 А)	≤35 (10 В)	≤10	—	—	ТО-5
2N1889	Si, n-p-n, П	0,8	≥50	100	7	500	≤0,01 (75 В)	40...120 (10 В; 0,15 А)	≤10 (10 В)	≤3,3	—	—	ТО-39
2N1890	Si, n-p-n, П	0,8	≥60	100	7	500	≤0,01 (75 В)	100...300 (10 В; 0,15 А)	≤10 (10 В)	≤3,3	—	—	ТО-39
2N2192	Si, n-p-n, П	0,8	≥50	60	5	1000	≤0,01 (30 В)	100...300 (10 В; 0,15 А)	≤20 (10 В)	≤2,3	—	≤150	ТО-39
2N2192A	Si, n-p-n, П	0,8	≥50	60	5	1000	≤0,01 (30 В)	100...300 (10 В; 0,15 А)	≤20 (10 В)	≤1,6	—	≤150	ТО-39
2N2193	Si, n-p-n, П	0,8	≥50	80	8	1000	≤0,01 (60 В)	40...120 (10 В; 0,15 А)	≤20 (10 В)	≤2,3	—	≤150	ТО-39
2N2193A	Si, n-p-n, П	0,8	≥50	80	8	1000	≤0,01 (60 В)	40...120 (10 В; 0,15 А)	≤20 (10 В)	≤1,6	—	≤150	ТО-39
2N2194	Si, n-p-n, П	0,8	≥50	60	5	1000	≤0,01 (30 В)	20...60 (10 В; 0,15 А)	≤20 (10 В)	≤2,3	—	≤150	ТО-39
2N2194A	Si, n-p-n, П	0,8	≥50	60	5	1000	≤0,01 (30 В)	20...60 (10 В; 0,15 А)	≤20 (10 В)	≤1,6	—	≤150	ТО-39
2SC497	Si, n-p-n, Э	0,6	50	100	5	800	≤1 (30 В)	40...240 (2 В; 0,2 А)	15 (10 В)	≤4	—	—	ТО-39
2SC498	Si, n-p-n, Э	0,6	50	80	5	800	≤1 (30 В)	40...240 (2 В; 0,2 А)	15 (10 В)	≤4	—	—	ТО-39
2SC503	Si, n-p-n, Э	0,8 (6*)	≥50	100	5	600	≤0,5 (80 В)	30...300 (2 В; 0,15 А)	≤30 (10 В)	≤3,3	≤25***	450	ТО-39

Продолжение

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^*_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K,\,и\,max}$, Вт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, мкА	$h_{21Э}$, $h^*_{21э}$	$C_к$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$К_ш$, дБ, $\tau^*_к$, пс, $r^{**}_{бэ\,нас}$, $h^{***}_{11б}$, Ом	$t_{рас}$, $t^*_{выкл}$, $t^{**}_{пк}$, нс	Корпус
2SC504	Si, n-p-n, Э	0,8	⩾50	80	5	600	⩽0,5 (60 В)	30...300 (2 В; 0,15 А)	⩽30 (10 В)	⩽3,3	⩽25***	450	ТО-39
2SC510	Si, n-p-n, ТД	0,8 (8*)	⩾20	140	5	1500	⩽1 (30 В)	30...150 (2 В; 0,2 А)	⩽40 (10 В)	⩽3	—	3000	ТО-39
2SC512	Si, n-p-n, ТД	0,8	⩾20	100	5	1500	⩽1 (30 В)	30...150 (2 В; 0,2 А)	⩽40 (10 В)	⩽3	—	3000	ТО-39
BFY50	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	⩾60	80	6	1000	⩽0,5 (80 В)	⩾30 (10 В; 0,15 А)	⩽12 (10 В)	⩽1,3	⩽2**	300	ТО-39
BFY51	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	⩾50	60	6	1000	⩽0,5 (60 В)	⩾40 (10 В; 0,15 А)	⩽12 (10 В)	⩽2,3	⩽2**	300	ТО-39
BFY52	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	⩾50	40	6	1000	⩽0,5 (40 В)	⩾60 (10 В; 0,15 А)	⩽12 (10 В)	⩽2,3	⩽2**	300	ТО-39
BFY53	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	⩾50	40	6	1000	—	⩾30 (10 В; 0,15 А)	— —	⩽2,3	—	—	ТО-39
BFY55	Si, n-p-n, ПЭ	0,8 (4*)	⩾60	80	7	1000	⩽0,01 (50 В)	40...120 (10 В; 0,15 А)	⩽12 (10 В)	⩽1,3	⩽800*	—	ТО-39
BFY56	Si, n-p-n, ПЭ	0,8 (5*)	⩾40	80	7	1000	⩽0,05 (50 В)	30...150 (1 В; 0,15 А)	⩽25 (10 В)	⩽1,2	—	⩽625*	ТО-5
BFY56A	Si, n-p-n, ПЭ	0,8 (5*)	⩾60	85*	7	1000	⩽0,02* (50 В)	40...120 (10 В; 0,15 А)	⩽25 (10 В)	⩽1	⩽1,6**	⩽800*	ТО-39
BFY56B	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	⩾50	80	7	1000	⩽0,05 (50 В)	50...300 (1 В; 0,15 А)	⩽25 (10 В)	⩽1	—	—	ТО-39
BSY51	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	100	60	5	500	⩽0,1 (30 В)	40...120 (10 В; 0,15 А)	⩽10 (10 В)	⩽2,4	6 (1 кГц)	—	ТО-39
BSY52	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	130	60	5	500	⩽0,1 (30 В)	100...300 (10 В; 0,15 А)	⩽10 (10 В)	⩽2,4	6 (1 кГц)	—	ТО-39
BSY53	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	100	75	7	750	⩽0,01 (60 В)	40...120 (10 В; 0,15 А)	⩽10 (10 В)	⩽2,4	6 (1 кГц)	—	ТО-39
BSY54	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	145	75	7	750	⩽0,01 (60 В)	100...300 (10 В; 0,15 А)	⩽10 (10 В)	⩽2,4	⩽8 (1 кГц)	—	ТО-39
BSY55	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	100	120	7	500	⩽0,01 (90 В)	40...120 (10 В; 0,15 А)	⩽10 (10 В)	⩽2,4	6 (1 кГц)	—	ТО-39
BSY56	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	145	120	7	500	⩽0,01 (90 В)	100...300 (10 В; 0,15 А)	⩽10 (10 В)	⩽2,4	6 (1 кГц)	—	ТО-39
BSY56A	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	50	80	7	1000	—	40...200 (1 В; 0,15 А)	⩽25 (10 В)	⩽1,2	—	—	ТО-39
2N2297	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	60	80	7	1000	⩽0,01 (60 В)	40...120 (10 В; 0,15 А)	⩽12 (10 В)	⩽1,3	⩽800*	—	ТО-5
2N2868	Si, n-p-n, П	0,8	⩾50	60	7	1000	⩽0,01	40...120 (10 В; 0,15 А)	⩽20	⩽1,6	—	—	ТО-39
BFY34	Si, n-p-n, П	0,8 (2,6*)	⩾60	75	7	500	⩽0,01 (60 В)	40...120 (10 В; 0,15 А)	⩽25 (10 В)	⩽10	—	—	ТО-39
BFY46	Si, n-p-n, П	2,6*	⩾70	75	7	500	⩽0,01 (60 В)	100...300 (10 В; 0,15 А)	⩽25 (10 В)	⩽10	—	—	ТО-39
2N5681	Si, n-p-n, ПЭ	1	⩾30	100	4	1000	⩽1 (100 В)	40...150 (2 В; 0,25 А)	⩽50 (20 В)	⩽2	—	—	ТО-39
2N5682	Si, n-p-n, ПЭ	1	⩾30	120	4	1000	⩽1 (120 В)	40...150 (2 В; 0,25 А)	⩽50 (20 В)	⩽2	—	—	ТО-39
2N2195	Si, n-p-n, ПЭ	0,6	⩾50	45	5	1000	⩽0,1	⩾20 (10 В; 0,15 А)	⩽20	—	—	—	ТО-5
2N3019	Si, n-p-n, ПЭ	0,8 (5*)	⩾100	140	7	1000	⩽0,01 (90 В)	100...300 (10 В; 0,15 А)	⩽12 (10 В)	⩽1,3	—	—	ТО-39
2N3020	Si, n-p-n, ПЭ	0,8 (5*)	⩾80	140	7	1000	⩽0,01 (90 В)	40...120 (10 В; 0,15 А)	⩽12 (10 В)	⩽1	—	—	ТО-39
2SC959S	Si, n-p-n, Э	0,7	50	120	5	700	⩽3 (80 В)	40...200 (5 В; 0,2 А)	—	⩽4	—	—	ТО-39
2SC1008	Si, n-p-n, Э	0,8	75	80	8	700	⩽0,1 (60 В)	80...240 (2 В; 0,05 А)	17 (10 В)	⩽1,4	—	—	ТО-39
2SC1008A	Si, n-p-n, Э	0,8	70	100	8	700	⩽0,1 (60 В)	80...240 (2 В; 0,05 А)	15 (10 В)	⩽1,4	—	—	ТО-39
2SC306	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	⩾75	50	5	500	⩽0,1	85 (10 В; 0,15 А)	10	⩽4,7	—	300	ТО-5
2SC307	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	⩾100	80	5	500	⩽0,01	85 (10 В; 0,15 А)	10	⩽4,7	—	300	ТО-5
2SC308	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	⩾45	100	5	500	—	65 (10 В; 0,15 А)	—	—	—	—	ТО-5
2SC309	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	⩾60	120	5	500	0,1	65 (10 В; 0,15 А)	10	⩽10	—	200	ТО-5
2SC310	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	⩾60	140	5	500	0,01	65 (10 В; 0,15 А)	10	⩽10	—	200	ТО-5
2SC481	Si, n-p-n, ПЭ	0,6	⩾100	60	5	1000	—	35 (2 В; 0,15 А)	—	—	—	—	ТО-39

12 Заказ № 1141

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^{*}_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K,\,и\,max}$, Вт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^{*}_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^{*}_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, мкА	$h_{21Э}$, $h^{*}_{21э}$	$C_к$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$К_ш$, дБ, $\tau^{*}_{к}$, пс, $r^{**}_{бэ\,нас}$, $h^{***}_{11б}$, Ом	$t_{рас}$, $t^{*}_{выкл}$, $t^{**}_{пк}$, нс	Корпус
BFY67	Si, n-p-n, П	0,8 (3*)	≥60	75	7	500 (1000*)	≤100 (75 В)	40...120 (10 В; 0,15 А)	≤25 (10 В)	≤10	≤9*	—	TO-39
BFY68	Si, n-p-n, П	0,8 (3*)	≥70	75	7	500 (1000*)	≤100 (75 В)	100...300 (10 В; 0,15 А)	≤25 (10 В)	≤10	≤9**	—	TO-39
BFY67A	Si, n-p-n, П	0,8	≥60	60	5	500 (1000*)	≤0,075 (30 В)	≥40 (10 В; 0,15 А)	—	≤10	≤9**	—	TO-39
BFY67C	Si, n-p-n, П	0,8	≥60	50	5	500 (1000*)	≤0,02 (25 В)	≥30 (10 В; 0,15 А)	—	≤10	≤9**	—	TO-39
BFY68A	Si, n-p-n, П	0,8	≥60	60	5	500 (1000*)	≤0,075 (30 В)	≥100 (10 В; 0,15 А)	—	≤10	≤9**	—	TO-39
BSW65	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	80	80	6	1000 (2000*)	≤100 (80 В)	≥40 (5 В; 0,1 А)	≤35 (10 В)	≤1	≤1,2**	1000*	TO-39
BSW66	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	80	100	6	1000 (2000*)	≤100 (100 В)	≥40 (5 В; 0,1 А)	≤35 (10 В)	≤1	≤1,2**	1000*	TO-39
BSW67	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	80	120	6	1000 (2000*)	≤100 (120 В)	≥40 (5 В; 0,1 А)	≤35 (10 В)	≤1	≤1,2**	1000*	TO-39
BSW68	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	80	150	6	1000 (2000*)	≤100 (150 В)	≥40 (5 В; 0,1 А)	≤35 (10 В)	≤1	≤1,2**	1000*	TO-39
BSX45	Si, n-p-n, ПЭ	1	≥50	80	7	1000	≤100* (80 В)	40...100 (1 В; 0,1 А)	≤25 (10 В)	≤1	3,5 (1 кГц)	≤850*	TO-39
BSX46	Si, n-p-n, ПЭ	1	≥50	100	7	1000	≤100* (100 В)	63...160 (1 В; 0,1 А)	≤20 (10 В)	≤1	3,5 (1 кГц)	≤850*	TO-39
BSX47	Si, n-p-n, ПЭ	1	≥50	120	7	1000	≤100* (120 В)	100...250 (1 В; 0,1 А)	≤15 (10 В)	≤1	3,5 (1 кГц)	≤850*	TO-39
SF128A	Si, n-p-n, ПЭ	0,6	≥60	100	7	500 (1000*)	≤0,1 (100 В)	18...35 (2 В; 50 мА)	—	≤3,3	4,5 (1 кГц)	—	TO-5
SF128B	Si, n-p-n, ПЭ	0,6	≥60	100	7	500 (1000*)	≤0,1 (100 В)	28...71 (2 В; 50 мА)	—	≤3,3	4,5 (1 кГц)	—	TO-5
SF128C	Si, n-p-n, ПЭ	0,6	≥60	100	7	500 (1000*)	≤0,1 (100 В)	56...140 (2 В; 50 мА)	—	≤3,3	4,5 (1 кГц)	—	TO-5
SF128D	Si, n-p-n, ПЭ	0,6	≥60	100	7	500 (1000*)	≤0,1 (100 В)	112...280 (2 В; 50 мА)	—	≤3,3	4,5 (1 кГц)	—	TO-5
SF129A	Si, n-p-n, ПЭ	0,6	≥60	120	7	500 (1000*)	≤0,1 (100 В)	18...35 (2 В; 50 мА)	—	≤3,3	—	—	TO-5
SF129B	Si, n-p-n, ПЭ	0,6	≥60	120	7	500 (1000*)	≤0,1 (100 В)	28...71 (2 В; 50 мА)	—	≤3,3	—	—	TO-5
SF129C	Si, n-p-n, ПЭ	0,6	≥60	120	7	500 (1000*)	≤0,1 (100 В)	56...140 (2 В; 50 мА)	—	≤3,3	—	—	TO-5
SF129D	Si, n-p-n, ПЭ	0,6	≥60	120	7	500 (1000*)	≤0,1 (100 В)	112...280 (2 В; 50 мА)	—	≤3,3	—	—	TO-5
BSS42	Si, n-p-n, ПЭ	1 (5*)	100	120	6	1500	≤0,1 (100 В)	50...70 (5 В; 0,1 А)	≤20 (10 В)	≤0,8	≤1,2**	700*	TO-39
BSW39-6	Si, n-p-n, ПЭ	0,79 (4,4*)	≥50	100	7	1000	≤0,03 (60 В)	40...100 (1 В; 0,1 А)	≤20 (10 В)	≤0,75	≤2**	300*	TO-39
BSW39-10	Si, n-p-n, ПЭ	0,79 (4,4*)	≥50	100	7	1000	≤0,03 (60 В)	63...160 (1 В; 0,1 А)	≤20 (10 В)	≤0,75	≤2**	300*	TO-39

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^*_{K,т\,max}$, $P^{**}_{K,и\,max}$, Вт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, мкА	$h_{21Э}$, $h^*_{21э}$	$C_к$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$К_ш$, дБ, $\tau^*_к$, пс, $r^{**}_{бэ\,нас}$, $h^{***}_{11б}$, Ом	$t_{рас}$, $t^*_{выкл}$, $t^{**}_{пк}$, нс	Корпус
BSW39-16	Si, n-p-n, ПЭ	0,79 (4,4*)	⩾50	100	7	1000	⩽0,03 (60 В)	100...250 (1 В; 0,1 А)	⩽20 (10 В)	⩽0,75	⩽2**	300*	ТО-39
BSX45-6	Si, n-p-n, ПЭ	1 (5*)	⩾50	80*	7	1000	⩽0,03* (60 В)	40...100 (1 В; 0,1 А)	⩽25 (10 В)	⩽1	3,5 (1 кГц)	⩽850*	ТО-39
BSX45-10	Si, n-p-n, ПЭ	1 (5*)	⩾50	80*	7	1000	⩽0,03* (60 В)	63...160 (1 В; 0,1 А)	⩽25 (10 В)	⩽1	3,5 (1 кГц)	⩽850*	ТО-39
BSX45-16	Si, n-p-n, ПЭ	1 (5*)	⩾50	80*	7	1000	⩽0,03* (60 В)	100...250 (1 В; 0,1 А)	⩽25 (10 В)	⩽1	3,5 (1 кГц)	⩽850*	ТО-39
BSX46-6	Si, n-p-n, ПЭ	1 (5*)	⩾50	100*	7	1000	⩽0,03* (60 В)	40...100 (1 В; 0,1 А)	⩽25 (10 В)	⩽1	3,5 (1 кГц)	⩽850*	ТО-39
BSX46-10	Si, n-p-n, ПЭ	1 (5*)	⩾50	100*	7	1000	⩽0,03* (60 В)	63...160 (1 В; 0,1 А)	⩽25 (10 В)	⩽1	3,5 (1 кГц)	⩽850*	ТО-39
BSX46-16	Si, n-p-n, ПЭ	1 (5*)	⩾50	100*	7	1000	⩽0,03* (60 В)	100...250 (1 В; 0,1 А)	⩽25 (10 В)	⩽1	3,5 (1 кГц)	⩽850*	ТО-39
BSX72	Si, n-p-n, ПЭ	0,7 (3,1*)	⩾100	40	5	1000 (1500*)	⩽0,1 (30 В)	40...250 (10 В; 0,15 А)	⩽10 (10 В)	⩽2,2	⩽4**	150*	ТО-39
2SC108A	Si, n-p-n, Э	0,8	⩾100	90	5	800	⩽0,5 (80 В)	40...240 (2 В; 0,2 А)	⩽15 (10 В)	⩽2	⩽5**	⩽80	ТО-39
BC119	Si, n-p-n, ПЭ	0,8 (3,5*)	⩾40	60	5	1000	⩽0,05 (40 В)	40...120 (1 В; 0,15 А)	⩽25 (10 В)	⩽2,3	⩽2**	—	ТО-5
BC142	Si, n-p-n, ПЭ	0,8 (5*)	⩾40	80	5	1000	⩽0,05 (40 В)	⩾20 (10 В; 0,2 А)	25	⩽2	—	—	ТО-5
BC286	Si, n-p-n, ПЭ	0,8 (4*)	100	70	5	1000	⩽0,02 (30 В)	120 (2 В; 0,1 А)	12 (10 В)	⩽1	—	—	ТО-5
BFX84	Si, n-p-n, ПЭ	0,8 (2,86*)	⩾50	100	6	1000	⩽0,5 (100 В)	⩾30 (10 В; 0,15 А)	⩽12 (10 В)	⩽2	⩽3**	300	ТО-39
BFX85	Si, n-p-n, ПЭ	0,8 (2,86*)	⩾50	100	6	1000	⩽0,5 (100 В)	⩾70 (10 В; 0,15 А)	⩽12 (10 В)	⩽2	⩽3**	300	ТО-39
BFX86	Si, n-p-n, ПЭ	0,8 (2,86*)	⩾50	40	6	1000	⩽0,5 (40 В)	⩾70 (10 В; 0,15 А)	⩽12 (10 В)	⩽2	⩽3**	300	ТО-39
BSW66A	Si, n-p-n, ПЭ	0,8 (5*)	130	100	6	1000 (2000*)	⩽100 (100 В)	⩾40 (5 В; 0,1 А)	⩽20 (10 В)	⩽1	⩽1,4**	900*	ТО-39
BSW67A	Si, n-p-n, ПЭ	0,8 (5*)	130	120	6	1000 (2000*)	⩽100 (100 В)	⩾40 (5 В; 0,1 А)	⩽20 (10 В)	⩽1	⩽1,4**	900*	ТО-39
BSW68A	Si, n-p-n, ПЭ	0,8 (5*)	130	150	6	1000 (2000*)	⩽100 (100 В)	⩾40 (5 В; 0,1 А)	⩽20 (10 В)	⩽1	⩽1,4**	900*	ТО-39
BSX47-6	Si, n-p-n, ПЭ	6,25*	⩾50	120*	7	1000	⩽0,03* (80 В)	40...100 (1 В; 0,1 А)	⩽15 (10 В)	⩽1	3,5 (0,2 кГц)	⩽850*	ТО-39
BSX47-10	Si, n-p-n, ПЭ	6,25*	⩾50	120*	7	1000	⩽0,03* (80 В)	63...160 (1 В; 0,1 А)	⩽15 (10 В)	⩽1	3,5 (0,2 кГц)	⩽850*	ТО-39
КТ605А	Si, n-p-n, П	0,4 (100°С)	⩾40	300	5	100 (200*)	⩽50* (250 В)	10...40 (40 В; 20 мА)	⩽7 (40 В)	⩽400	⩽250*	—	28
КТ605АМ	Si, n-p-n, П	0,4 (100°С)	⩾40	300	5	100 (200*)	⩽20* (250 В)	10...40 (40 В; 20 мА)	⩽7 (40 В)	⩽400	⩽250*	—	18
КТ605Б	Si, n-p-n, П	0,4 (100°С)	⩾40	300	5	100 (200*)	⩽50* (250 В)	30...120 (40 В; 20 мА)	⩽7 (40 В)	⩽400	⩽250*	—	28

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^{*}_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K,\,и\,max}$, Вт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, f^{**}_{21h}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^{*}_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^{*}_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, мкА	$h_{21э}$, $h^{*}_{21э}$	$C_к$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$К_ш$, дБ, $\tau^{*}_{к}$, пс, $r^{**}_{бэ\,нас}$, $h^{***}_{11б}$, Ом	$t_{рас}$, $t^{*}_{выкл}$, $t^{**}_{пк}$, нс	Корпус
КТ605БМ	Si, n-p-n, П	0,4 (100°С)	≥40	300	5	100 (200*)	≤20* (250 В)	30...120 (40 В; 20 мА)	≤7 (40 В)	≤400	≤250*	—	18
2SC1056	Si, n-p-n, П	0,475	≥75	260	5	100	≤1	≥20 (10 В; 10 мА)	≤10	—	—	—	ТО-5
BC100	Si, n-p-n, П	0,59	10	350	7	150	0,06	40 (20 В; 10 мА)	—	≤160	—	≤500	ТО-5
BF471	Si, n-p-n, ПЭ	1,8* (114°С)	≥60	300	5	50 (100*)	≤0,01 (200 В)	≥50 (20 В; 25 мА)	—	≤800	—	—	ТО-126
КТ618А	Si, n-p-n, П	0,5	≥40	300	5	100	≤50* (250 В)	≥30 (40 В; 1 мА)	≤7 (40 В)	—	—	—	19
2SC505	Si, n-p-n, П	0,6	≥20	300	3	100	2 (100 В)	30...150 (5 В; 50 мА)	≤15 (50 В)	≤20	—	—	ТО-39
2SC788	Si, n-p-n, П	0,8	≥60	250	5	50	≤0,1	100 (5 В; 10 мА)	4	—	—	—	ТО-5
MJ420	Si, n-p-n, П	0,8 (2,5*)	≥15	275	6	100 (500*)	≤100 (275 В)	≥15 (20 В; 1 мА)	≤12 (20 В)	≤170	—	—	ТО-5
BF179C	Si, n-p-n, П	0,7	≥60	250	5	50	≤1 мА (260 В)	≥20 (15 В; 20 мА)	≤3,5* (20 В)	≤75	—	≤100	ТО-39
BFP179C	Si, n-p-n, П	0,6	≥75	250	5	50	—	≥20 (15 В; 20 мА)	≤3,5* (20 В)	—	—	—	ТО-39
КТ603А	Si, n-p-n, ПЭ	0,5 (50°С)	≥200	30* (1 к)	3	300 (600*)	≤10 (30 В)	10...80 (2 В; 0,15 А)	≤15 (10 В)	≤7	≤400*	≤100*	28
КТ603Б	Si, n-p-n, ПЭ	0,5 (50°С)	≥200	30* (1 к)	3	300 (600*)	≤10 (30 В)	≥60 (2 В; 0,15 А)	≤15 (10 В)	≤7	≤400*	≤100*	28
КТ603В	Si, n-p-n, ПЭ	0,5 (50°С)	≥200	15* (1 к)	3	300 (600*)	≤5 (15 В)	10...80 (2 В; 0,15 А)	≤15 (10 В)	≤7	≤400*	≤100*	28
КТ603Г	Si, n-p-n, ПЭ	0,5 (50°С)	≥200	15* (1 к)	3	300 (600*)	≤5 (15 В)	≥60 (2 В; 0,15 А)	≤15 (10 В)	≤7	≤400*	≤100*	28
КТ603Д	Si, n-p-n, ПЭ	0,5 (50°С)	≥200	10* (1 к)	3	300 (600*)	≤1 (10 В)	20...80 (2 В; 0,15 А)	≤15 (10 В)	≤7	≤400*	≤100*	28
КТ603Е	Si, n-p-n, ПЭ	0,5 (50°С)	≥200	10* (1 к)	3	300 (600*)	≤1 (10 В)	60...200 (2 В; 0,15 А)	≤15 (10 В)	≤7	≤400*	≤100*	28
КТ603И	Si, n-p-n, ПЭ	0,5 (50°С)	≥200	30* (1 к)	3	300 (600*)	≤10 (30 В)	≥20 (2 В; 0,35 А)	≤15 (10 В)	≤3,4	≤400*	≤100*	28
BSW36	Si, n-p-n, П	0,8	≥150	32	4	500	—	≥50 (1 В; 0,05 А)	≤15 (10 В)	≤4	—	150*	ТО-5
2N2237	Si, n-p-n, ПЭ	0,6	≥100	40	6	500	0,05	40...125 (1 В; 0,1 А)	≤35	≤2,5	—	600*	ТО-5
2SC151H	Si, n-p-n, Э	0,75	≥80	40	5	100	≤1 (20 В)	20...120 (6 В; 10 мА)	≤10 (6 В)	≤20	≤40**	150	ТО-39
2SC796	Si, n-p-n, ПЭ	0,5	230	40	2	500	5	50* (20 В; 15 мА)	5	—	—	—	ТО-5
КТ616А	Si, n-p-n, ПЭ	0,3	≥200	20*	4	400 (600*)	≤15 (10 В)	≥40 (1 В; 0,5 А)	≤15 (10 В)	≤1,2	—	≤50	5
КТ616Б	Si, n-p-n, ПЭ	0,3	≥200	20*	4	400 (600*)	≤15 (10 В)	≥25 (1 В; 0,5 А)	≤15 (10 В)	≤1,2	—	≤15	5
BSW41	Si, n-p-n, ПЭ	0,325 (1*)	≥250	30	5	300 (500*)	≤0,5 (30 В)	≥15 (1 В; 0,5 А)	≤8 (10 В)	≤1,4	—	≤110*	ТО-18

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^*_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{и,\,и\,max}$, Вт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, мкА	$h_{21э}$, $h^*_{21э}$	$C_к$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $\tau^*_к$, пс, $r^{**}_{бэ\,нас}$, Ом, $h^{***}_{11б}$	$t_{рас}$, $t^*_{выкл}$, $t^{**}_{пк}$, нс	Корпус
BSX89	Si, n-p-n, ПЭ	0,3	≥200	25	5	500	≤0,5 (15 В)	≥20 (10 В; 10 мА)	2,5 (10 В)	≤60	—	≤75**	TO-18
2SC395A	Si, n-p-n, ПЭ	0,25	≥200	20	5	400	≤0,1, (20 В)	20...300 (1 В; 10 мА)	≤6 (10 В)	≤25	—	≤50	TO-18
2N3210	Si, n-p-n, ПЭ	0,36	≥300	40	5	500	≤0,01 (20 В)	30...120 (1 В; 10 мА)	≤6 (10 В)	≤3,75	—	≤20	TO-18
BSY17	Si, n-p-n, ПЭ	0,35	≥280	20	5	200	≤1 (20 В)	≥10 (1 В; 0,1 А)	≤5 (5 В)	≤28	—	≤14	TO-18
BSY18	Si, n-p-n, ПЭ	0,35	≥280	20	5	200	≤1 (20 В)	≥20 (1 В; 0,1 А)	≤5 (5 В)	≤28	—	≤18	TO-18
BSY62	Si, n-p-n, ПЭ	0,35	≥280	25	5	200	≤0,5 (15 В)	30...300 (1 В; 10 мА)	≤5 (5 В)	≤60	—	≤25	TO-18
2SC131	Si, n-p-n, ПЭ	0,35	≥175	40	5	300	0,05 (10 В)	60 (1 В; 10 мА)	≤4	≤7	—	≤20	TO-18
2SC132	Si, n-p-n, ПЭ	0,35	≥175	20	5	300	0,05 (10 В)	60 (1 В; 10 мА)	≤4	≤7	—	20	TO-18
2SC133	Si, n-p-n, ПЭ	0,35	≥175	20	5	300	0,05 (10 В)	60 (1 В; 10 мА)	≤4	≤7	—	20	TO-18
2SC134	Si, n-p-n, ПЭ	0,35	≥175	40	5	300	≤0,02 (10 В)	60 (1 В; 10 мА)	≤4	≤3	—	100	TO-18
2SC135	Si, n-p-n, ПЭ	0,35	≥175	20	5	300	≤0,02 (10 В)	60 (1 В; 10 мА)	≤4	≤3	—	100	TO-18
2SC137	Si, n-p-n, ПЭ	0,35	≥175	25	5	300	≤0,05 (10 В)	50 (1 В; 10 мА)	≤4	≤7	—	20	TO-18
KSY21	Si, n-p-n, ПЭ	0,36	≥300	40	5	500	≤1 (40 В)	≥10 (1 В; 0,5 А)	≤6 (10 В)	≤3,5	—	20	TO-18
KSY62	Si, n-p-n, ПЭ	0,35	≥200	25	5	200	≤0,5 (15 В)	20...300 (1 В; 10 мА)	≤5 (5 В)	≤60	—	≤25	TO-18
KSY63	Si, n-p-n, ПЭ	0,35	≥300	40	5	200 (500*)	0,025 (20 В)	30...120 (1 В; 10 мА)	≤6 (5 В)	≤25	—	≤25	TO-18
KT617A	Si, n-p-n, ПЭ	0,5	≥150	30	4	400 (600*)	≤5 (30 В)	≥30 (2 В; 0,4 А)	≤15 (10 В)	≤7	≤120*	—	19
KF507	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	≥50	40	5	500	≤0,5 (30 В)	≥20 (10 В; 0,5 А)	≤25 (10 В)	≤10	6 (2 мГц)	—	TO-5
SF21	Si, n-p-n, ПЭ	0,6	≥60	20	5	500	≤1 (20 В)	—	—	≤20	—	—	TO-5
SF22	Si, n-p-n, ПЭ	0,6	≥60	33	5	500	≤0,1 (33 В)	—	—	≤20	—	—	TO-5
SF126A	Si, n-p-n, ПЭ	0,6	≥60	33	5	500 (1000*)	≤0,1 (33 В)	18...35 (2 В; 50 мА)	—	≤3,3	≤550*	1300	TO-5
SF126B	Si, n-p-n, ПЭ	0,6	≥60	33	5	500 (1000*)	≤0,1 (33 В)	28...71 (2 В; 50 мА)	≤20 (10 В)	≤3,3	≤550*	1300	TO-5
SF126C	Si, n-p-n, ПЭ	0,6	≥60	33	5	500 (1000*)	≤0,1 (33 В)	56...140 (2 В; 50 мА)	—	≤3,3	≤550*	1300	TO-5
2SC482	Si, n-p-n, ПЭ	0,6	≥50	40	5	600	1	≥30 (2 В; 0,15 А)	15	—	—	—	TO-5
2N2236	Si, n-p-n, П	0,6	≥50	40	5	500	0,05	≥15 (1 В; 0,1 А)	≤35	—	—	—	TO-5
SF121A	Si, n-p-n, П	0,6	≥60	20	5	100 (300*)	≤1 (20 В)	18...35 (2 В; 50 мА)	≤26 (10 В)	≤20	5,5 (1 кГц)	2200	TO-5
SF121B	Si, n-p-n, П	0,6	≥60	20	5	100 (300*)	≤1 (20 В)	28...71 (2 В; 50 мА)	≤26 (10 В)	≤20	5,5 (1 кГц)	2200	TO-5
SF122A	Si, n-p-n, П	0,6	≥60	33	5	100 (300*)	≤1 (30 В)	18...35 (2 В; 50 мА)	≤26 (10 В)	≤20	5,5 (1 кГц)	2200	TO-5
SF122B	Si, n-p-n, П	0,6	≥60	33	5	100 (300*)	≤1 (30 В)	28...71 (2 В; 50 мА)	≤26 (10 В)	≤20	5,5 (1 кГц)	2200	TO-5
2N1838	Si, n-p-n, П	0,6	≥90	45	5	500	≤1,5 (30 В)	40...150 (10 В; 0,1 А)	≤27 (10 В)	≤14	—	170	TO-5
2N1839	Si, n-p-n, П	0,6	≥90	45	4,5	500	≤1,5 (30 В)	≥12 (10 В; 0,1 А)	≤27 (10 В)	≤14	—	78	TO-5
2N1840	Si, n-p-n, П	0,6	≥90	25	5	500	≤1,5 (30 В)	≥10 (10 В; 0,15 А)	≤27 (10 В)	≤9	—	—	TO-5
2SC188	Si, n-p-n, П	0,6	150	40	3	500	1	50 (6 В; 50 мА)	9	—	—	—	TO-5
SS125	Si, n-p-n, П	0,6	≥30	30	5	600	≤0,025 (20 В)	—	—	≤15	—	<100	TO-5

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^*_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K,\,и\,max}$, Вт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, мкА	$h_{21Э}$, $h^*_{21э}$	$C_к$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $\tau^*_к$, пс, $r^{**}_{бэ\,нас}$, $h^{***}_{11б}$, Ом	$t_{рас}$, $t^*_{выкл}$, $t^{**}_{пк}$, нс	Корпус
КТ608А	Si, n-p-n, ПЭ	0,5	⩾200	60	4	400 (800*)	⩽10 (60 В)	20...80 (5 В; 0,2 А)	⩽15 (10 В)	⩽2,5	—	⩽120	28
КТ608Б	Si, n-p-n, ПЭ	0,5	⩾200	60	4	400 (800*)	⩽10 (60 В)	40...160 (5 В; 0,2 А)	⩽15 (10 В)	⩽2,5	—	⩽120	28
BSY58	Si, n-p-n, ПЭ	0,8 (2,6*)	⩾250	50	5	600	0,12	⩾17 (1 В; 1 А)	⩽6 (10 В)	⩽3	—	⩽110*	ТО-39
SSY20	Si, n-p-n, ПЭ	0,7	—	60	5	600	⩽0,2 (50 В)	18...71 (1,3 В; 0,5 А)	15 (10 В)	⩽2	—	—	ТО-5
2N2224	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	⩾160	65	5	500	⩽0,01 (50 В)	40...120 (1 В; 0,1 А)	⩽8 (10 В)	⩽2,6	—	—	ТО-5
2N2958	Si, n-p-n, ПЭ	0,6	⩾250	60	5	600	⩽10 (60 В)	40...120 (10 В; 0,15 А)	⩽8 (10 В)	⩽3,3	—	⩽300	ТО-5
2N3299	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	⩾250	60	5	500	⩽10 (60 В)	40...120 (10 В; 0,15 А)	⩽6 (10 В)	⩽3	—	⩽150*	ТО-5
BSY34	Si, n-p-n, ПЭ	0,8 (2,6*)	⩾250	60	5	600	⩽0,07 (50 В)	⩾25 (1 В; 0,1 А)	⩽6 (10 В)	⩽1,7	—	⩽95*	ТО-39
2N1958	Si, n-p-n, ПЭ	0,6 (2*)	⩾100	60	5	500	⩽0,5 (30 В)	⩾20 (10 В; 0,15 А)	⩽18 (10 В)	⩽3	—	⩽25	ТО-5
2N1959	Si, n-p-n, ПЭ	0,6 (2*)	⩾100	60	5	500	⩽0,5 (30 В)	40...120 (10 В; 0,15 А)	⩽18 (10 В)	⩽3	—	⩽25	ТО-5
2N3724	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	⩾300	50	6	500	⩽1,7 (40 В)	60...150 (1 В; 0,1 А)	⩽8 (10 В)	⩽2	—	⩽60*	ТО-39
2N3722	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	⩾300	80	6	500	⩽0,5* (40 В)	40...150 (1 В; 0,1 А)	⩽10 (10 В)	⩽2,5	—	⩽85	ТО-5
2SC594	Si, n-p-n, ПЭ	0,75	⩾100	60	5	200	⩽0,1 (45 В)	⩾20 (3 В; 0,2 А)	⩽5 (10 В)	⩽3	⩽10**	250	ТО-39
2N4046	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	⩾250	50	6	500 (1000*)	⩽10 (50 В)	40...150 (1 В; 0,1 А)	⩽12 (10 В)	⩽2	⩽8,6**	⩽60*	ТО-5
KSY34	Si, n-p-n, ПЭ	0,8 (2,6*)	⩾250	60	5	600	⩽0,07 (50 В)	⩾25 (1 В; 0,1 А)	⩽6 (10 В)	⩽2	—	⩽95*	ТО-5
КТ604А	Si, n-p-n, П	0,8 (3*)	⩾40	300	5	200	⩽50 (250 В)	10...40 (40 В; 20 мА)	⩽7 (40 В)	⩽400	—	—	30а
КТ604АМ	Si, n-p-n, П	0,8 (3*)	⩾40	250* (1 к)	5	200	⩽20* (250 В)	10...40 (40 В; 20 мА)	⩽7 (40 В)	⩽400	—	—	31
КТ604Б	Si, n-p-n, П	0,8 (3*)	⩾40	250* (1 к)	5	200	⩽50 (250 В)	30...120 (40 В; 20 мА)	⩽7 (40 В)	⩽400	—	—	30а
КТ604БМ	Si, n-p-n, П	0,8 (3*)	⩾40	300	5	200	⩽20* (250 В)	30...120 (40 В; 20 мА)	⩽7 (40 В)	⩽400	—	—	31
BF258	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	90	250	5	100	⩽0,05 (200 В)	⩾25 (10 В; 30 мА)	5,5 (30 В)	⩽33	—	—	ТО-39
BF259	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	90	200	5	100	⩽0,05 (250 В)	⩾25 (10 В; 30 мА)	5,5 (30 В)	⩽33	—	—	ТО-39
BF337	Si, n-p-n, П	3*	⩾80	250	5	100 (200*)	⩽100** (200 В)	⩾20 (10 В; 30 мА)	3,5*	—	⩽100*	—	ТО-39
BF338	Si, n-p-n, П	3*	⩾80	250	5	100 (200*)	⩾100** (250 В)	⩾20 (10 В; 30 мА)	3,5*	—	⩽100*	—	ТО-39
2N3742	Si, n-p-n, ПЭ	1 (5*)	⩾30	300	7	50	⩽0,2 (200 В)	20...200 (10 В; 30 мА)	⩽6 (10 В)	⩽100	—	—	ТО-5
2N4926	Si, n-p-n, П	1 (5*)	⩾30	200	7	50	⩽0,1 (100 В)	20...200 (10 В; 30 мА)	⩽6 (20 В)	⩽100	—	—	ТО-39

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^*_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K,\,и\,max}$, Вт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, мкА	$h_{21Э}$, $h^*_{21э}$	$С_к$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$К_ш$, дБ, $τ^*_к$, пс, $r^{**}_{бэ\,нас}$, $h^{***}_{11б}$, Ом	$t_{рас}$, $t^*_{выкл}$, $t^{**}_{пк}$, нс	Корпус
2N4927	Si, n-p-n, П	1 (5*)	⩾30	200	7	50	⩽0,1 (150 В)	20...200 (10 В; 30 мА)	⩽6 (20 В)	⩽100	—	—	TO-39
2SC2611	Si, n-p-n, П	1	80	300	5	100	—	30...200 (20 В; 20 мА)	—	⩽75	—	—	TO-126
BD115	Si, n-p-n, П	0,875 (5*)	80	245	5	150 (200*)	—	⩾22 (100 В; 50 мА)	—	⩽90	⩽100*	—	TO-5
КТ611А	Si, n-p-n, ПЭ	0,8 (3*)	60	200	3	100	⩽200 (180 В)	10...40 (40 В; 20 мА)	⩽5 (40 В)	⩽400	⩽200*	—	30а
КТ611АМ	Si, n-p-n, ПЭ	0,8 (3*)	60	200	4	100	⩽100 (180 В)	10...40 (40 В; 20 мА)	⩽5 (40 В)	⩽400	⩽200*	—	18
КТ611Б	Si, n-p-n, ПЭ	0,8 (3*)	60	200	3	100	⩽200 (180 В)	30...120 (40 В; 20 мА)	⩽5 (40 В)	⩽400	⩽200*	—	30а
КТ611БМ	Si, n-p-n, ПЭ	0,8 (3*)	60	200	4	100	⩽100 (180 В)	30...120 (40 В; 20 мА)	⩽5 (40 В)	⩽400	⩽200*	—	18
КТ611В	Si, n-p-n, ПЭ	0,8 (3*)	60	180	3	100	⩽100 (150 В)	10...40 (40 В; 20 мА)	⩽5 (40 В)	⩽400	⩽200*	—	30а
КТ611Г	Si, n-p-n, ПЭ	0,8 (3*)	60	180	3	100	⩽100 (150 В)	30...120 (40 В; 20 мА)	⩽5 (40 В)	⩽400	⩽200*	—	30а
BF257	Si, n-p-n, П	0,6 (5*)	90	160	5	100 (200*)	⩽0,05 (100 В)	⩾25 (10 В; 30 мА)	5,5 (30 В)	⩽33	⩽200*	—	TO-39
BF179B	Si, n-p-n, П	0,6 (65°С)	120	220	5	50	—	⩾20 (15 В; 20 мА)	—	—	⩽100*	—	TO-5
BF336	Si, n-p-n, П	3*	80	185	5	100 (200*)	—	⩾20 (10 В; 30 мА)	—	—	⩽100*	—	TO-5
2N3114	Si, n-p-n, ПЭ	0,8 (5*)	40	150	5	200	⩽0,01 (100 В)	30...120 (10 В; 30 мА)	⩽9 (20 В)	⩽20	—	—	TO-5
2N3712	Si, n-p-n, ПЭ	1 (5*)	40	150	5	200	⩽0,1 (75 В)	30...150 (10 В; 30 мА)	⩽9 (20 В)	⩽40	100*	—	TO-5
2N4924	Si, n-p-n, П	1 (5*)	100	100	5	200	⩽0,1 (50 В)	⩾35 (10 В; 10 мА)	⩽10 (20 В)	⩽25	—	—	TO-39
2N4925	Si, n-p-n, П	1 (5*)	100	150	5	200	⩽0,1 (75 В)	⩾35 (10 В; 10 мА)	⩽10 (20 В)	⩽25	—	—	TO-39
BF111	Si, n-p-n, П	3*	100	200*	5	80	⩽0,2* (160 В)	⩾20 (20 В; 60 мА)	—	330	⩽100*	—	TO-39
BF178	Si, n-p-n, П	3*	100	160	5	50	⩽0,2* (160 В)	⩾20 (20 В; 30 мА)	—	50	⩽100*	—	TO-39
BFY45	Si, n-p-n, П	0,8 (2,5*)	130	140*	5	30	⩽0,1* (140 В)	⩾40 (10 В; 10 мА)	⩽3,5 (10 В)	—	—	—	TO-39
BFY65	Si, n-p-n, П	0,56 (1,3*)	50	100	7	100 (200*)	⩽0,1 (75 В)	⩾30 (2 В; 15 мА)	⩽8 (10 В)	⩽450	—	—	TO-39
BF114	Si, n-p-n, П	0,59 (45°С)	100	160	5	50	⩽50 (100 В)	⩾25 (10 В; 30 мА)	—	—	—	—	TO-5
KF504	Si, n-p-n, П	0,7 (2,5*)	90	170	5	50	⩽0,1 (140 В)	70 (10 В; 10 мА)	⩽3,5 (10 В)	⩽70	⩽150*	—	TO-5
BF305	Si, n-p-n, П	0,8	100	160	5	50	—	⩾30 (10 В; 15 мА)	3,5*	—	—	—	TO-39

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^*_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K,\,и\,max}$, Вт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, мкА	$h_{21Э}$, $h^*_{21э}$	$C_к$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$К_ш$, дБ, $\tau^*_к$, пс, $r^{**}_{бэ\,нас}$, $h^{***}_{11б}$, Ом	$t_{рас}$, $t^*_{выкл}$, $t^{**}_{пк}$, нс	Корпус
BFP177	Si, n-p-n, П	0,6	≥75	100	5	50	—	≥20 (10 В; 15 мА)	3,5*	—	—	—	TO-39
BFP178	Si, n-p-n, П	0,6	≥75	160	5	50	—	≥20 (20 В; 30 мА)	3,5*	—	—	—	TO-39
BFP179A	Si, n-p-n, П	0,6	≥75	160	5	50	—	≥20 (20 В; 20 мА)	3,5*	—	—	—	TO-39
BFP179B	Si, n-p-n, П	0,6	≥75	220	5	50	—	≥20 (15 В; 20 мА)	3,5*	—	—	—	TO-39
BF186	Si, n-p-n, П	2,75*	≥120	165	5	60	—	≥20 (20 В; 40 мА)	—	≤500	30	—	TO-1
BFJ98	Si, n-p-n, П	0,8 (3*)	≥40	150	6	100	≤0,01 (100 В)	90 (10 В; 10 мА)	—	≤40	—	—	TO-5
BF291	Si, n-p-n, П	0,8 (3*)	≥40	150	6	100	≤0,01 (100 В)	90 (10 В; 10 мА)	≤3,5 (20 В)	12	—	—	TO-5
BFW45	Si, n-p-n, П	0,8	≥80	165	5	50 (100*)	—	20...120 (20 В; 50 мА)	4	—	30*	—	TO-39
SF150B	Si, n-p-n, П	0,68 (3,75*)	≥80	160	5	50	≤0,1 (140 В)	28...71 (10 В; 5 мА)	≤8,5 (10 В)	≤166	≤30*	—	TO-5
SF150C	Si, n-p-n, П	0,68 (3,75*)	≥80	160	5	50	≤0,1 (140 В)	56...140 (10 В; 5 мА)	≤8,5 (10 В)	≤166	≤30*	—	TO-5
BF137	Si, n-p-n, ПЭ	0,68	95	160	5	100	0,01	≥25 (10 В; 30 мА)	2	—	—	—	TO-39
2SC65	Si, n-p-n, М	0,6	110	150	2	50	≤10 (150 В)	30 (20 В; 5 мА)	≤10	—	—	—	TO-5
2SC66	Si, n-p-n, М	0,6	110	150	2	50	≤10 (150 В)	55 (20 В; 5 мА)	≤10	—	—	—	TO-5
BF140A	Si, n-p-n, П	0,8 (2,5*)	≥40	150	3	40	≤1 (100 В)	≥15 (10 В; 10 мА)	≤3 (50 В)	25	≤150*	—	TO-5
2SC506	Si, n-p-n, П	0,6	≥20	200	3	100	≤2 (100 В)	30...150 (5 В; 50 мА)	≤15 (50 В)	≤20	—	—	TO-39
2SC507	Si, n-p-n, П	0,75	≥100	170	5	100	≤0,5 (100 В)	40...240 (5 В; 10 мА)	≤40 (20 В)	≤80	≤120**	1000	TO-39
2SD668A	Si, n-p-n, Э	1	140	180	5	50	≤10	60...320 (5 В; 10 мА)	3,5	≤66	—	—	TO-126
2SD668	Si, n-p-n, Э	1	140	120**	5	50	≤10	60...320 (5 В; 10 мА)	3,5	≤66	—	—	TO-126
MM3001	Si, n-p-n, ПЭ	1 (5*)	150	150	5	200	1 (75 В)	20 (10 В; 10 мА)	7 (20 В)	—	—	—	TO-39
КТ644А	Si, p-n-p, ПЭ	1 (12,5*)	≥200	60	5	600 (1000*)	≤0,1 (50 В)	40...120 (10 В; 0,15 А)	≤8 (10 В)	≤2,7	—	≤180	18
КТ644Б	Si, p-n-p, ПЭ	1 (12,5*)	≥200	60	5	600 (1000*)	≤0,1 (50 В)	100...300 (10 В; 0,15 А)	≤8 (10 В)	≤2,7	—	≤180	18
КТ644В	Si, p-n-p, ПЭ	1 (12,5*)	≥200	40**	5	600 (1000*)	≤0,1 (50 В)	40...120 (10 В; 0,15 А)	≤8 (10 В)	≤2,7	—	≤180	18
КТ644Г	Si, p-n-p, ПЭ	1 (12,5*)	≥200	40**	5	600 (1000*)	≤0,1 (50 В)	100...300 (10 В; 0,15 А)	≤8 (10 В)	≤2,7	—	≤180	18
BC527-6	Si, p-n-p, ПЭ	0,625	≥100	60	6	1000	≤0,1 (40 В)	40...100 (1 В; 0,1 А)	≤15 (10 В)	≤1,4	≤8**	—	TO-92
BC527-10	Si, p-n-p, ПЭ	0,625	≥100	60	6	1000	≤0,1 (40 В)	63...160 (1 В; 0,1 А)	≤15 (10 В)	≤1,4	≤8**	—	TO-92
BD386	Si, p-n-p, П	10*	≥250	60	5	1000	—	80...300 (1 В; 50 мА)	—	≤2	—	—	TO-202
КТ639А	Si, p-n-p, ПЭ	1 (12,5*)	≥80	45	5	1500 (2000*)	≤0,1 (30 В)	40...100 (2 В; 0,15 А)	≤50 (10 В)	≤1	—	≤200	18
КТ639Б	Si, p-n-p, ПЭ	1 (12,5*)	≥80	45	5	1500 (2000*)	≤0,1 (30 В)	63...160 (2 В; 0,15 А)	≤50 (10 В)	≤1	—	≤200	18

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^*_{K,т\,max}$, $P^{**}_{K,и\,max}$, Вт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, мкА	$h_{21Э}$, $h^*_{21э}$	$C_к$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$К_ш$, дБ, $\tau^*_к$, пс, $r^{**}_{бэ\,нас}$, Ом, $h^{***}_{11б}$	$t_{рас}$, $t^*_{выкл}$, $t^{**}_{пк}$, нс	Корпус
КТ639В	Si, p-n-p, ПЭ	1 (12,5*)	⩾80	45	5	1500 (2000*)	⩽0,1 (30 В)	100...250 (2 В; 0,15 А)	⩽50 (10 В)	⩽1	—	⩽200	18
КТ639Г	Si, p-n-p, ПЭ	1 (1,25*)	⩾80	60	5	1500 (2000*)	⩽0,1 (30 В)	40...100 (2 В; 0,15 А)	⩽50 (10 В)	⩽1	—	⩽200	18
КТ639Д	Si, p-n-p, ПЭ	1 (12,5*)	⩾80	60	5	1500 (2000*)	⩽0,1 (30 В)	63...160 (2 В; 0,15 А)	⩽50 (10 В)	⩽1	—	⩽200	18
2SA715B	Si, p-n-p, Э	0,75 (10*)	160	35	5	2500 (3000*)	⩽20 (35 В)	60...120 (2 В; 0,5 А)	—	⩽0,5	—	—	TO-126
2SA715C	Si, p-n-p, Э	0,75 (10*)	160	35	5	2500 (3000*)	⩽20 (35 В)	100...200 (2 В; 0,5 А)	—	⩽0,5	—	—	TO-126
2SA715D	Si, p-n-p, Э	0,75 (10*)	160	35	5	2500 (3000*)	⩽20 (35 В)	160...320 (2 В; 0,5 А)	—	⩽0,5	—	—	TO-126
2SA738B	Si, p-n-p, Э	0,75 (10*)	160	25	5	2500 (3000*)	⩽20 (25 В)	60...120 (2 В; 0,5 А)	—	⩽0,5	—	—	TO-126
2SA738C	Si, p-n-p, Э	0,75 (10*)	160	25	5	2500 (3000*)	⩽20 (25 В)	100...200 (2 В; 0,5 А)	—	⩽0,5	—	—	TO-126
2SA738D	Si, p-n-p, Э	0,75 (10*)	160	25	5	2500 (3000*)	⩽20 (25 В)	160...320 (2 В; 0,5 А)	—	⩽0,5	—	—	TO-126
2SA743	Si, p-n-p, Э	0,75 (8*)	120	50	4	1000	⩽20* (50 В)	60...200 (4 В; 50 мА)	—	⩽1,5	—	—	TO-126
2SA743A	Si, p-n-p, Э	0,75 (8*)	120	80	4	1000	⩽20* (80 В)	60...200 (4 В; 50 мА)	—	⩽1,5	—	—	TO-126
2SA779K	Si, p-n-p, ПЭ	1,25 (10*)	110	35	5	1500 (3000*)	⩽20 (30 В)	60...200 (2 В; 0,5 А)	—	⩽0,5	⩽0,64**	450	TO-202AA
2SA780AK	Si, p-n-p, Э	1,25 (10*)	110	80	4	1000	⩽20* (80 В)	60...200 (4 В; 50 мА)	—	⩽1,5	1,18**	900	TO-202AA
MPS-U51	Si, p-n-p, ПЭ	8*	50	40	5	2000	⩽0,1 (30 В)	60 (1 В; 0,1 А)	30 (10 В)	0,7	—	—	X-81
MPS-U51A	Si, p-n-p, ПЭ	8*	50	50	5	2000	⩽0,1 (40 В)	60 (1 В; 0,1 А)	30 (10 В)	0,7	—	—	X-81
MPS-U55	Si, p-n-p, ПЭ	1	50	60	4	2000	⩽0,1 (40 В)	50 (1 В; 0,25 А)	15 (10 В)	2	—	—	X-81
MPS-U56	Si, p-n-p, ПЭ	1	50	80	4	2000	⩽0,1 (60 В)	50 (1 В; 0,25 А)	15 (10 В)	2	—	—	X-81
2SA962A	Si, p-n-p, ПЭ	1,5	⩾50	60	5	1500	⩽0,001 (50 В)	70...240 (2 В; 0,15 А)	30 (10 В)	⩽1	—	—	TO-202
BD227	Si, p-n-p, ПЭ	12,5*	50	45	5	1500 (3000*)	⩽0,1 (30 В)	40...250 (2 В; 0,15 А)		⩽0,8		—	TO-126
BD229	Si, p-n-p, ПЭ	12,5* 2	50 75	60	5	1500 (3000*)	⩽0,1 (30 В)	40...160 (2 В; 0,15 А)		⩽0,8		—	TO-126
BD826	Si, p-n-p, ПЭ	(8*)		45	5	1000 (3000*)	⩽0,1 (30 В)	40...250 (2 В; 0,15 А)		⩽1		—	SOT-128
BD828	Si, p-n-p, ПЭ	2 (8*)	75	60	5	1000 (1500*)	⩽0,1 (30 В)	40...250 (2 В; 0,15 А)		⩽1		—	SOT-128
BD840	Si, p-n-p, ПЭ	2 (10*)	50	45	5	1500 (3000*)	⩽0,1 (30 В)	40...250 (2 В; 0,15 А)		⩽0,8		—	SOT-128
BD842	Si, p-n-p, ПЭ	2 (10*)	50	60	5	1500 (3000*)	⩽0,1 (30 В)	40...250 (2 В; 0,15 А)		⩽0,8		—	SOT-128

13 Заказ № 1141

Продолжение

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^*_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K,\,и\,max}$, Вт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{ЭБО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, мкА	$h_{21Э}$, $h^*_{21э}$	$C_к$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $\tau^*_к$, пс, $r^{**}_{бэ\,нас}$, $h^{***}_{11б}$, Ом	$t_{рас}$, $t^*_{выкл}$, $t^{**}_{пк}$, нс	Корпус
2SA496	Si, p-n-p, Э	1	≥50	40	5	1000	≤1 (30 В)	40...240 (2 В; 0,05 А)	20 (10 В)	≤1,6	—	—	TO-126
2SA505	Si, p-n-p, Э	1	≥50	60	5	1000	≤1 (30 В)	40...240 (2 В; 0,05 А)	20 (10 В)	≤1,6	—	—	TO-126
BSV15-6	Si, p-n-p, ПЭ	0,85	≥50	40**	5	1000	≤0,1* (40 В)	40...100 (1 В; 0,1 А)	≤30 (10 В)	≤2	≤2,8**	≤500	TO-39
BSV15-10	Si, p-n-p, ПЭ	0,85	≥50	40**	5	1000	≤0,1* (40 В)	63...160 (1 В; 0,1 А)	≤30 (10 В)	≤2	≤2,8**	≤500	TO-39
BSV15-16	Si, p-n-p, ПЭ	0,85	≥50	40**	5	1000	≤0,1* (40 В)	100...250 (1 В; 0,1 А)	≤30 (10 В)	≤2	≤2,8**	≤500	TO-39
BSV16	Si, p-n-p, ПЭ	0,85	≥50	60**	5	1000	≤0,1* (60 В)	40...250 (1 В; 0,1 А)	≤30 (10 В)	≤2	≤2,8**	≤500	TO-39
КТ645А	Si, n-p-n, ПЭ	0,5 (1**)	≥200	60	4	300 (600*)	≤10 (60 В)	20...200 (2 В; 0,15 А)	≤5 (10 В)	≤3,3	≤120*	≤50	17
MPS706	Si, n-p-n, ПЭ	0,625 (1*)	≥200	25	3	200	≤10 (25 В)	≥20 (1 В; 10 мА)	≤6 (10 В)	≤60	≤90**	≤75*	TO-92
MPS3705	Si, n-p-n, ПЭ	0,31	≥100	50	5	600*	≤0,1 (20 В)	50...150 (2 В; 0,15 А)	≤12 (10 В)	≤8	—	—	TO-92
MPS6530	Si, n-p-n, ПЭ	0,21 (60°С)	≥200	60	5	600*	≤0,05 (40 В)	40...120 (1 В; 0,1 А)	≤5 (10 В)	≤5	≤10**	—	TO-92
MPS6532	Si, n-p-n, ПЭ	0,21 (60°С)	≥200	50	5	600*	≤0,1 (30 В)	≥30 (1 В; 0,1 А)	≤5 (10 В)	≤5	≤12**	—	TO-92
2N4400	Si, n-p-n, ПЭ	0,625	≥200	60	6	600*	≤0,1* (35 В)	50...150 (1 В; 0,15 А)	≤6,5 (5 В)	≤2,6	≤6**	≤225	TO-92
2SC366G	Si, n-p-n, Э	0,4	≥100	60	5	400	≤0,1 (40 В)	70...240 (1 В; 0,1 А)	≤15 (10 В)	≤2,5	50***	250	TO-92
2SC367G	Si, n-p-n, Э	0,4	≥100	40	5	400	≤0,1 (40 В)	70...240 (1 В; 0,1 А)	≤15 (10 В)	≤2,5	—	250	TO-92
2SC752GTM	Si, n-p-n, Э	0,4	≥200	40	5	200	≤0,1 (40 В)	40...240 (1 В; 0,01 А)	≤6 (10 В)	≤15	—	≤30	TO-92
2SC815	Si, n-p-n, Э	0,25	200	60	5	200	≤0,1 (45 В)	50...232 (1 В; 0,05 А)	5,5 (10 В)	≤3,3	—	—	TO-92
2N5845	Si, n-p-n, ПЭ	0,625	≥200	50	6	600	≤0,5 (40 В)	50...200 (1 В; 0,1 А)	≤9 (10 В)	≤2,5	≤8,5**	≤40	TO-92
2SC1317NC	Si, n-p-n, ПЭ	0,625	≥200	30	5	500	≤0,1 (20 В)	60...160 (10 В; 0,15 А)	≤15 (10 В)	≤2	—	—	TO-92
MPS6565	Si, n-p-n, ПЭ	0,625	≥200	60	4	200	≤0,1 (30 В)	40...160 (10 В; 10 мА)	≤3,5 (10 В)	≤40	—	—	TO-92
MPS6566	Si, n-p-n, ПЭ	0,625	≥200	60	4	200	≤0,1 (30 В)	100...400 (10 В; 10 мА)	≤3,5 (10 В)	≤40	—	—	TO-92
КТ646А	Si, n-p-n, ПЭ	1 (2,5*)	≥200	60	4 (5)	1000 (1200*)	≤10 (60 В)	40...200 (5 В; 0,2 А)	≤10 (10 В)	≤1,7	≤120*	≤60	18
BD825	Si, n-p-n, ПЭ	2 (8*)	250	45	5	1000 (1500*)	≤0,1 (30 В)	40...250 (2 В, 0,15 А)	—	≤1	—	—	SOT-28
BD827	Si, n-p-n, ПЭ	2 (8*)	250	60	5	1000 (1500*)	≤0,1 (30 В)	40...250 (2 В; 0,15 А)	—	≤1	—	—	SOT-28
2SC1846	Si, n-p-n, ПЭ	1,2 (5*)	250	45	5	1500*	≤0,1 (20 В)	60...340 (10 В; 0,5 А)	—	≤1	—	—	TO-126
2SC2036	Si, n-p-n	1	150	80	5	1000	≤100* (80 В)	≥100 (2 В; 0,15 А)	12 (10 В)	≤1,4	—	—	TO-126
2SC3419	Si, n-p-n, Э	1,2 (5*)	≥50	40	5	800	≤1 (40 В)	70...240 (2 В; 50 мА)	10 (10 В)	≤1,6	—	—	TO-126
КТ928А	Si, n-p-n, ПЭ	0,5 (3,6**)	≥250	60	5	800 (1200*)	≤5 (60 В)	20...100 (5 В; 150 мА)	≤12 (10 В)	≤3,3	≤100*	≤250	19
КТ928Б	Si, n-p-n, ПЭ	0,5 (3,6**)	≥250	60	5	800 (1200*)	≤5 (60 В)	50...200 (5 В; 150 мА)	≤12 (10 В)	≤3,3	≤100*	≤250	19

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^*_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K,\,и\,max}$, Вт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭО\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, мкА	$h_{21Э}$, $h^*_{21э}$	$C_к$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $\tau^*_к$, пс, $r^{**}_{бэ\,нас}$, $h^{***}_{11б}$, Ом	$t_{рас}$, $t^*_{выкл}$, $t^{**}_{пк}$, нс	Корпус
2N2218	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	≥250	60	5	800	≤0,01 (50 В)	40...120 (10 В; 150 мА)	≤8 (10 В)	≤2,6	—	—	ТО-5
2N2218A	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	≥250	75	7	800	≤0,1 (60 В)	40...120 (10 В; 150 мА)	≤8 (10 В)	≤2	≤150*	≤225	ТО-5
2N2219	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	≥250	60	5	800	≤0,01 (50 В)	100...300 (10 В; 150 мА)	≤8 (10 В)	≤2,6	—	190	ТО-5
2N2219A	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	≥250	75	7	800	≤0,01 (60 В)	100...300 (10 В; 150 мА)	≤8 (10 В)	≤2	≤150*	≤225	ТО-5
2N4960	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	≥250	60	6,5	1000	≤0,01 (50 В)	100...300 (10 В; 150 мА)	≤15 (10 В)	≤3,4	—	≤1000*	ТО-5
2N2217	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	≥250	60	5	800	≤0,01 (50 В)	20...60 (10 В; 150 мА)	≤8 (10 В)	≤2,6	—	190	ТО-5
2N2537	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	≥250	60	5	800	≤0,25 (40 В)	50...150 (10 В; 150 мА)	≤8 (10 В)	≤3	—	≤20	ТО-5
2N2538	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	≥250	60	5	800	≤0,25 (40 В)	100...300 (10 В; 0,15 А)	≤8 (10 В)	≤3	—	≤20	ТО-5
2N3015	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	≥250	60	5	500	≤0,2 (30 В)	30...120 (10 В; 150 мА)	≤8 (10 В)	≤2,6	—	≤60*	ТО-5
BSW51	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	≥250	60	5	800	—	≥40 (10 В; 0,15 А)	—	—	—	—	ТО-39
BSW52	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	≥250	60	5	800	—	≥40 (10 В; 0,15 А)	—	—	—	—	ТО-39
BSS27	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	300	70	5	1000	≤10 (70 В)	≥30 (1 В; 0,15 А)	7 (10 В)	≤0,8	≤0,66**	≤250*	ТО-39
BSS28	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	300	50	5	1000	≤10 (50 В)	≥40 (1 В; 0,15 А	7 (10 В)	≤0,8	≤0,66**	≤250*	ТО-39
BSS29	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	300	50	5	1000	≤10 (50 В)	≥25 (1 В; 0,15 А)	7 (10 В)	≤1	≤0,66**	≤250*	ТО-39
BSX32	Si, n-p-n, ПЭ	0,8 (3,5*)	≥300	65	6	1000	≤4 (50 В)	60...150 (1 В; 0,1 А)	≤10 (10 В)	≤1	≤2**	≤60*	ТО-5
BSW27	Si, n-p-n, ПЭ	1 (3*)	≥200	60	4	1000	≤0,5 (20 В)	20...60 (2 В; 0,10 А)	≤10 (10 В)	≤3,5	—	≤85*	ТО-39
BSX59	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	≥250	70	5	1000*	≤0,5 (40 В)	≥25 (1 В; 0,5 А)	≤10 (10 В)	≤2,6	≥1,8**	60*	ТО-5
2SC109A	Si, n-p-n, Э	0,8	≥100	70	5	800	≤0,5 (40 В)	40...240 (2 В; 200 мА)	≤15 (10 В)	≤2		≤80	ТО-39
BSX60	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	≥250	70	6	1000*	≤0,5 (40 В)	≥25 (1 В; 0,5 А)	≤10 (10 В)	≤2,6	≥1,8**	70*	ТО-5
BSX61	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	≥250	70	5	1000*	≤0,5 (40 В)	≥25 (1 В; 0,5 А)	≤10 (10 В)	≤2,6	≥1,8**	100*	ТО-5
2N2410	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	≥200	60	5	800	≤0,3 (30 В)	30...120 (10 В; 0,15 А)	≤11 (10 В)	≤3	—	≤40	ТО-5
BSXP59	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	≥250	70	5	1000*	—	≥25 (1 В; 0,5 А)	≤15 (10 В)	≤2	—	≤60*	ТО-39
BSXP60	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	≥250	70	5	1000*	—	≥25 (1 В; 0,5 А)	≤10 (10 В)	≤2	—	≤70*	ТО-39
BSXP61	Si, n-p-n, ПЭ	0,8	≥250	70	5	1000*	—	≥25 (1 В; 0,5 А)	≤10 (10 В)	≤4	—	≤100*	ТО-39
КТ940А	Si, n-p-n, П	1,2 (10*)	≥90	300*	5	100 (300*)	≤0,05 (250 В)	≥25 (10 В; 30 мА)	≤4,2 (30 В)	≤33	—	—	18
КТ940Б	Si, n-p-n, П	1,2 (10*)	≥90	250*	5	100 (300*)	≤0,05 (200 В)	≥25 (10 В; 30 мА)	≤4,2 (30 В)	≤33	—	—	18
КТ940В	Si, n-p-n, П	1,2 (10*)	≥90	160*	5	100 (300*)	≤0,05 (100 В)	≥25 (10 В; 30 мА)	≤4,2 (30 В)	≤33	—	—	18
BF457	Si, n-p-n, П	1,2 (10*)	90	160	5	100 (300*)	≤0,05 (100 В)	≥25 (10 В; 30 мА)	5,5 (30 В)	≤33	—	—	ТО-126
BF458	Si, n-p-n, П	1,2 (10*)	90	270	5	100 (300*)	≤0,05 (200 В)	≥25 (10 В; 30 мА)	5,5 (30 В)	≤33	—	—	ТО-126
BF459	Si, n-p-n, П	1,2 (10*)	90	300	5	100 (300*)	≤0,05 (250 В)	≥25 (10 В; 30 мА)	5,5 (30 В)	≤33	—	—	ТО-126
BF469	Si, n-p-n, ПЭ	2* (110°C)	≥60	250	5	20 (100*)	≤0,01 (200 В)	≥50 (20 В; 25 мА)	≤1,8 (30 В)	≤33	≤90*	—	ТО-126
BF470	Si, n-p-n, ПЭ	2* (110°C)	≥60	300	5	30 (100*)	≤0,01 (200 В)	≥50 (20 В; 25 мА)	≤1,8 (30 В)	≤33	≤90*	—	ТО-126

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^*_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K,\,и\,max}$, Вт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, мкА	$h_{21Э}$, $h^*_{21э}$	$C_к$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $\tau^*_к$, пс, $r^{**}_{бэ\,нас}$; $h^{***}_{11б}$, Ом	$t_{рас}$, $t^*_{выкл}$, $t^{**}_{пк}$, нс	Корпус
BF419	Si, n-p-n, П	0,8 (6*)	≥60	300	5	100 (300*)	≤0,05 (250 В)	45 (10 В; 20 мА)	≤4,5 (30 В)	≤55	—	500	ТО-126
BF297	Si, n-p-n, ПЭ	0,625	95	160	5	100	≤0,05 (100 В)	30...150 (10 В; 30 мА)	≤5,5 (30 В)	≤33	—	—	Х-55
BF298	Si, n-p-n, ПЭ	0,625	95	250	5	100	≤0,05 (200 В)	30...150 (10 В; 30 мА)	≤5,5 (30 В)	≤33	—	—	Х-55
BF299	Si, n-p-n, ПЭ	0,625	95	300	5	100	≤0,05 (250 В)	30...150 (10 В; 30 мА)	≤5,5 (30 В)	≤33	—	—	Х-55
BF615	Si, n-p-n, ПЭ	2 (10*)	70	250	5	20 (300*)	≤0,05 (200 В)	≥25 (15 В; 5 мА)	≤3 (30 В)	≤100	—	—	ТО-202
BF617	Si, n-p-n, ПЭ	2 (10*)	70	300	5	20 (300*)	0,05 (250 В)	≥30 (15 В; 25 мА)	≤3 (30 В)	≤40	—	—	ТО-202
2SC1566	Si, n-p-n, Д	1	≥80	250	5	150*	—	≥30 (20 В; 40 мА)	—	≤40	—	—	ТО-202
2SC1550	Si, n-p-n, Д	10*	≥70	250	6,5	100	≤100 (250 В)	≥30 (10 В; 30 мА)	—	≤40	—	—	ТО-126
2SC1569	Si, n-p-n, ТД	1,5 (12,5*)	≥40	300	5	150	≤1 (100 В)	≥40 (10 В; 50 мА)	≤6,5 (50 В)	≤10	—	—	ТО-220
2N3440S	Si, n-p-n, ПЭ	1 (10*)	≥15	300	7	1000*	≤0,02 (250 В)	40...160 (10 В; 20 мА)	15 (30 В)	≤10	≤26**	—	ТО-39
2SC2231	Si, n-p-n, Д	1,5 (12*)	≥50	160**	5	200	≤0,1 (200 В)	100...320 (10 В; 50 мА)	≤10 (10 В)	≤5	—	—	ТО-202
2SC2231A	Si, n-p-n, Д	1,5 (12*)	≥50	180**	5	200	≤0,1 (200 В)	100...320 (10 В; 50 мА)	≤10 (10 В)	≤5	—	—	ТО-202
2SC2242	Si, n-p-n, Д	1,5 (25*)	≥20	300	5	150	≤1 (240 В)	40...170 (10 В; 50 мА)	≤12 (50 В)	≤30	—	—	ТО-220
2SC2456	Si, n-p-n, П	1,2 (10*)	≥50	300	7	100	≤1 (240 В)	40...170 (10 В; 50 мА)	≤5 (50 В)	≤10	≤12**	—	ТО-126
2SC3424	Si, n-p-n, Д	1,5	≥60	250	5	20 (100*)	≤1 (200 В)	≥50 (20 В; 25 мА)	≤2* (30 В)	≤150	—	—	—
2SC2068	Si, n-p-n, ТД	1,5	≥75	300	5	50	≤1 (240 В)	30...200 (10 В; 20 мА)	≤4 (20 В)	≤100	—	—	ТО-202
2SC3423	Si, n-p-n, Э	1,2 (5*)	200	150	5	50	≤0,1 (150 В)	80...240 (5 В; 10 мА)	1,8 (10 В)	≤100	—	—	—
2SC2258	Si, n-p-n, Д	1	100	250	7	100	0,1 (150 В)	≥40 (20 В; 40 мА)	—	≤24	—	—	ТО-126
2SC3335	Si, n-p-n, П	1,2 (5*)	≥60	250	5	50 (100*)	≤1 (200 В)	50 (20 В; 25 мА)	≤2* (30 В)	≤150	—	—	ТО-126
КТ602А	Si, n-p-n, П	0,85 (2,8*)	150	120 (160 имп)	5	75 (500*)	≤70 (120 В)	20...80 (10 В; 10 мА)	≤4 (50 В)	≤60	≤300*	—	30а
КТ602АМ	Si, n-p-n, П	0,85 (2,8*)	150	120 (160 имп)	5	75 (500*)	≤70 (120 В)	20...80 (10 В; 10 мА)	≤4 (50 В)	≤60	≤300*	—	18
КТ602Б	Si, n-p-n, П	0,85 (2,8*)	≥150	120 (160 имп)	5	75 (500*)	≤70 (120 В)	≥50 (10 В; 10 мА)	≤4 (50 В)	≤60	≤300*	—	30а
КТ602БМ	Si, n-p-n, П	0,85 (2,8*)	≥150	120 (160 имп)	5	75 (500*)	≤70 (120 В)	≥50 (10 В; 10 мА)	≤4 (50 В)	≤60	≤300*	—	18
КТ602В	Si, n-p-n, П	0,85 (2,8*)	≥150	80	5	75 (500*)	≤70 (80 В)	15...80 (10 В; 10 мА)	≤4 (50 В)	≤60	≤300*	—	30а

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^*_{K,т\,max}$, $P^{**}_{K,и\,max}$, Вт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, мкА	$h_{21Э}$, $h^*_{21э}$	$C_к$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $\tau^*_к$, пс, $r^{**}_{бэ\,нас}$, $h^{***}_{11б}$, Ом	$t_{рас}$, $t^*_{выкл}$, $t^{**}_{пк}$, нс	Корпус
КТ602Г	Si, n-p-n, П	0,85 (2,8*)	⩾150	80	5	75 (500*)	⩽70 (80 В)	⩾50 (10 В; 10 мА)	⩽4 (50 В)	⩽60	⩽300*	—	30а
BF177	Si, n-p-n, П	0,6 (65°С)	120	100	5	50	⩽0,2* (100 В)	⩾20 (10 В; 15 мА)	—	66	⩽100*	—	TO-39
KF503	Si, n-p-n, ПЭ	0,7 (2,5*)	⩾90	100	5	50	⩽0,5 (50 В)	80 (10 В; 30 мА)	⩽3,5 (10 В)	15	150*	—	TO-5
SF123A	Si, n-p-n, П	0,6	⩾60	66	5	100 (300*)	⩽1 (66 В)	18...35 (2 В; 50 мА)	⩽26 (10 В)	⩽20	520*	2200	TO-5
SF123B	Si, n-p-n, П	0,6	⩾60	66	5	100 (300*)	⩽1 (66 В)	28...71 (2 В; 50 мА)	⩽26 (10 В)	⩽20	520*	2200	TO-5
SF123C	Si, n-p-n, П	0,6	⩾60	66	5	100 (300*)	⩽1 (66 В)	56...140 (2 В; 50 мА)	⩽26 (10 В)	⩽20	520*	2200	TO-5
BFJ57	Si, n-p-n, П	0,8 (3*)	⩾40	125	5	—	⩽100 (125 В)	90 (10 В; 10 мА)	⩽12 (20 В)	⩽40	—	—	TO-5
SFT187	Si, n-p-n, П	0,8 (2,5*)	⩾70	135	3	—	—	⩾25 (10 В; 30 мА)	⩽3 (50 В)	⩽10	—	—	TO-5
2N1566A	Si, n-p-n, П	0,6 (1,2*)	⩾100	80	5	100	⩽0,5 (40 В)	60...200 (5 В; 5 мА)	⩽6 (5 В)	⩽60	—	—	TO-5
MM3000	Si, n-p-n, ПЭ	1 (5*)	⩾150	100	5	200	⩽1 (50 В)	⩾20 (10 В; 10 мА)	⩽7 (20 В)	—	—	—	TO-39
2SC249	Si, n-p-n, П	0,5	170	70	5	70	⩽1 (30 В)	60 (6 В; 2,5 мА)	2,7 (6 В)	—	—	—	TO-39
2SC247	Si, n-p-n, П	0,6	150	100	3	100	⩽1 (30 В)	60 (6 В; 2 мА)	3 (6 В)	—	—	—	TO-39
КТ626А	Si, p-n-p, ПЭ	6,5* (60°С)	⩾75	45	4	500 (1500*)	⩽0,01 (30 В)	40...260 (2 В; 0,15 А)	⩽150 (10 В)	⩽2	⩽500*	—	18
КТ626Б	Si, p-n-p, ПЭ	6,5* (60°С)	⩾75	60	4	500 (1500*)	⩽0,15 (30 В)	30...100 (2 В; 0,15 А)	⩽150 (10 В)	⩽2	⩽500*	—	18
КТ626В	Si, p-n-p, ПЭ	6,5* (60°С)	⩾45	80	4	500 (1500*)	⩽1 (80 В)	15...45 (2 В; 0,15 А)	⩽150 (10 В)	⩽10	⩽500*	—	18
BD136	Si, p-n-p, ПЭ	8*	75	45	5	1000 (1500*)	⩽0,1 (30 В)	40...250 (2 В; 0,15 А)	⩽150 (10 В)	⩽1	—	—	TO-126
BD138	Si, p-n-p, ПЭ	8*	75	60	5	1000 (1500*)	⩽0,1 (30 В)	40...160 (2 В; 0,15 А)	—	⩽1	—	—	TO-126
BD140	Si, p-n-p, ПЭ	8*	75	100	5	1000 (1500*)	⩽0,1 (30 В)	40...160 (2 В; 0,15 А)	—	⩽1	—	—	TO-126
D41D1	Si, p-n-p, ПЭ	6,25*	150	45*	5	1000 (1500*)	⩽0,1 (45 В)	50...150 (2 В; 0,1 А)	10 (10 В)	⩽1	—	75	X-51
D41D4	Si, p-n-p, ПЭ	6,25*	150	60*	5	1000 (1500*)	⩽0,1 (60 В)	50...150 (2 В; 0,1 А)	10 (10 В)	⩽1	—	75	X-51
D41D7	Si, p-n-p, ПЭ	6,25*	⩾75	75*	5	1000 (1500*)	⩽0,1 (75 В)	50...150 (2 В; 0,1 А)	10 (10 В)	⩽2	—	75	X-51
2SA1356	Si, p-n-p, Э	1,2 (5*)	⩾50	40	5	800	⩽1 (40 В)	70...240 (2 В; 0,05 А)	20 (10 В)	⩽1,6	⩽2,6**	—	SOT-82

ТРАНЗИСТОРЫ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ НИЗКОЙ, СРЕДНЕЙ И ВЫСОКОЙ ЧАСТОТ

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K,т\,max}$, $P^*_{K,и\,max}$, Вт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,и\,max}$, А	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мА	$h_{21Э}$	$C_к$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$r_{бэ\,нас}$, Ом, $\tau^*_к$, пс	$t_{рас}$, $t^*_{выкл}$, $t^{**}_{сп}$, мкс	Корпус
П201Э	Ge, p-n-p, С	10	≥0,1*	45	—	1,5	≤0,4 (20 В)	≥20 (10 В; 0,2 А)	—	≤1,25	—	—	32
П201АЭ	Ge, p-n-p, С	10	≥0,2*	45	—	1,5 (2*)	≤0,4 (20 В)	≥40 (10 В; 0,2 А)	—	≤1,25	—	—	32
П202Э	Ge, p-n-p, С	10	≥0,1*	70	—	2 (2,5*)	≤0,4 (30 В)	≥20 (10 В; 0,2 А)	—	≤1,25	—	—	32
П203Э	Ge, p-n-p, С	10	≥0,2*	70	—	2 (2,5*)	≤0,4 (30 В)	—	—	≤1,25	—	—	32
2SB481	Ge, p-n-p, С	6	0,015**	32	10	1	—	30...110 (1 А)	—	—	—	—	MD-9
2SB130	Ge, p-n-p, С	6	0,7	32	10	1,5	0,1	20 (1 В; 1,5 А)	—	—	—	—	MD-11
2SB180A	Ge, p-n-p, С	12	0,013**	40	12	0,5	≤0,5 (30 В)	70 (1,5 В; 0,5 А)	—	—	—	—	TO-8
2SB181A	Ge, p-n-p, С	12	0,013**	60	12	0,5	≤0,2 (30 В)	70 (1,5 В; 0,5 А)	—	—	—	—	TO-8
GD617	Ge, p-n-p, С	4 (60°C)	1	32	10	1	≤0,025 (10 В)	40...230 (0,5 А)	—	≤0,6	—	—	SOT-9
GD618	Ge, p-n-p, С	4 (60°C)	1	40	10	1	≤0,025 (10 В)	100...300 (0,5 А)	—	≤0,6	—	—	SOT-9
GD619	Ge, p-n-p, С	4 (60°C)	1	50	10	1	≤0,025 (10 В)	40...360 (0,5 А)	—	≤0,6	—	—	SOT-9
OC30	Ge, p-n-p, С	4	≥0,15	32	10	1,4	0,035 (6 В)	18...110 (6 В; 0,1 А)	—	≤1	—	—	MD-11
2SB367	Ge, p-n-p, С	6,6	0,5*	30	12	1,5	≤0,07 (12 В)	50...80 (1,5 В; 0,5 А)	—	—	—	—	TO-66
2SB368	Ge, p-n-p, С	6,6	0,5*	45	12	1,5	≤0,07 (12 В)	50...80 (1,5 В; 0,5 А)	—	—	—	—	TO-66
2SB473	Ge, p-n-p, С	4,3	0,01**	32	6	1	0,015	40...180 (0,5 А)	—	—	—	—	MD-9
2SB456	Ge, p-n-p, С	13	—	80	30	1	≤0,1 (80 В)	80 (1 В; 0,3 А)	—	0,2	—	—	TO-8
2SB466	Ge, p-n-p, С	12	0,013**	40	12	0,5	≤0,5 (30 В)	70 (1,5 В; 0,5 А)	—	—	—	—	MD-10
2SB467	Ge, p-n-p, С	12	0,013**	60	12	0,5	≤0,2 (30 В)	70 (1,5 В; 0,5 А)	—	—	—	—	MD-10
2SB448	Ge, p-n-p, С	13	≥0,01**	32	10	1	≤1	30...110 (1 А)	—	—	—	—	MD-11
ADP670	Ge, p-n-p, С	10	≥0,1	30	10	1,5	—	30...200 (6 В; 0,3 А)	—	—	—	—	TO-3
ADP671	Ge, p-n-p, С	10	≥0,1	20	10	1,5	—	30...200 (6 В; 0,3 А)	—	—	—	—	TO-3
ADP672	Ge, p-n-p, С	10	≥0,1	60	10	1,5	—	30...200 (6 В; 0,3 А)	—	—	—	—	TO-3
П213	Ge, p-n-p, С	11,5 (45°C)	≥0,2	45	15	5	≤0,15 (45 В)	20...50 (5 В; 1 А)	—	≤0,16	—	—	33
П213А	Ge, p-n-p, С	10	≥0,2	45	10	5	≤1 (45 В)	≥20 (5 В; 0,2 А)	—	—	—	—	33
П213Б	Ge, p-n-p, С	10	≥0,2	45	10	5	≤1 (45 В)	≥40 (5 В; 0,2 А)	—	≤1,25	—	—	33
П214	Ge, p-n-p, С	10	≥0,2	60	15	5	≤0,3 (60 В)	20...60 (5 В; 0,2 А)	—	≤0,3	—	—	33
П214А	Ge, p-n-p, С	10	≥0,2	60	15	5	≤0,3 (60 В)	50...150 (5 В; 0,2 А)	—	≤0,3	—	—	33
П214Б	Ge, p-n-p, С	11,5	≥0,2	60	15	5	≤0,15 (45 В)	20...150 (5 В; 0,2 А)	—	≤0,3	—	—	33
П214В	Ge, p-n-p, С	10	≥0,2	60	10	5	≤1,5 (60 В)	≥20 (5 В; 0,2 А)	—	≤1,25	—	—	33
П214Г	Ge, p-n-p, С	10	≥0,2	60	10	5	≤1,5 (60 В)	—	—	≤1,25	—	—	33
П215	Ge, p-n-p, С	10	≥0,2	80	15	5	≤0,3 (80 В)	20...150 (5 В; 0,2 А)	—	≤0,3	—	—	33
2N2835	Ge, p-n-p, С	16	0,6	32	10	1	—	≥30 (1 А)	—	≤10	—	—	MD-17
AUY18	Ge, p-n-p, С	11 (45°C)	0,3	64	20	8	≤1* (64 В)	75 (0,5 В; 0,5 А)	—	≤0,04	—	—	TO-8
AD1202	Ge, p-n-p, С	8,1	0,2	45	10	1,5 (3*)	≤0,1 (14 В)	35 (7 В; 0,3 А)	—	≤0,25	—	—	TO-3
AD1203	Ge, p-n-p, С	8,1	0,2	60	10	1,5 (3*)	≤0,1 (14 В)	35 (7 В; 0,3 А)	—	≤0,25	—	—	TO-3
2N2659	Ge, p-n-p, С	15	≥0,28	50	20	3	0,125	30...90 (0,5 В; 0,5 А)	—	≤0,4	—	—	R-122

Тип прибора	Материал; структура; технология	$P_{K,т\,max}$, $P^*_{K,и\,max}$, Вт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,и\,max}$, А	$I_{КЭО}$, $I^*_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мА	$h_{21Э}$	$C_к$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$r_{бэ\,нас}$, Ом, $\tau^*_к$, пс	$t_{рас}$, $t^*_{выкл}$, $t^{**}_{сп}$, мкс	Корпус
2N2660	Ge, p-n-p, C	15	⩾0,28	70	20	3	0,125	30...90 (0,5 В; 0,5 А)	—	⩽0,4	—	—	R-122
2N2661	Ge, p-n-p, C	15	⩾0,28	90	20	3	0,125	30...90 (0,5 В; 0,5 А)	—	⩽0,4	—	—	R-122
2N2665	Ge, p-n-p, C	15	⩾0,3	50	20	3	0,125	50...150 (0,5 В; 0,5 А)	—	⩽0,4	—	—	R-122
2N2666	Ge, p-n-p, C	15	⩾0,3	70	20	3	0,125	50...150 (0,5 В; 0,5 А)	—	⩽0,4	—	—	R-122
2N2667	Ge, p-n-p, C	15	⩾0,3	90	20	3	0,125	50...150 (0,5 В; 0,5 А)	—	⩽0,4	—	—	R-122
AD139	Ge, p-n-p, C	11	0,01**	32	10	3,5	⩽0,025 (0,5 В)	30...110 (0,5 В; 1 А)	—	—	—	—	MD-11
AD263	Ge, p-n-p, C	10	0,45	60	10	4	⩽0,1 (0,5 В)	20 (5 В; 1,5 А)	—	—	—	—	SOT-9
AD262	Ge, p-n-p, C	10 (60°C)	0,45	35	10	4	⩽0,1 (0,5 В)	30 (2 В; 1,5 А)	—	0,2	—	—	SOT-9
AD431	Ge, p-n-p, C	6	—	32	—	2 (3*)	⩽0,3 (32 В)	30...150 (1 В; 2 А)	—	⩽0,27	—	—	TO-3
AD436	Ge, p-n-p, C	6	—	40	—	3 (3,5*)	⩽0,3 (40 В)	15...60 (1 В; 2 А)	—	⩽0,2	—	—	TO-3
AD438	Ge, p-n-p, C	6	—	60	—	3 (3,5*)	⩽0,3 (60 В)	15...40 (1 В; 2 А)	—	⩽0,2	—	—	TO-3
AD439	Ge, p-n-p, C	6	—	80	—	3 (3,5*)	⩽0,3 (80 В)	15...50 (1 В; 2 А)	—	⩽0,2	—	—	TO-3
AD457	Ge, p-n-p, C	7	—	60	—	5	⩽0,3 (60 В)	20...60 (1,5 В; 2 А)	—	⩽0,2	—	—	TO-3
AD465	Ge, p-n-p, C	7	—	40	—	6	⩽0,3 (40 В)	20...90 (1,5 В; 2 А)	—	⩽0,16	—	—	TO-3
AD467	Ge, p-n-p, C	7	—	60	—	6	⩽0,3 (40 В)	20...50 (1,5 В; 2 А)	—	⩽0,16	—	—	TO-3
AD469	Ge, p-n-p, C	7	—	80	—	6	⩽0,3 (80 В)	20...60 (1,5 В; 2 А)	—	⩽0,16	—	—	TO-3
5NU73	Ge, p-n-p, C	12,5	⩾0,15	60	20	3,5	⩽0,1 (6 В)	⩾10 (1 А)	—	⩽0,13	—	—	TO-3
6NU73	Ge, p-n-p, C	12,5	⩾0,15	70	25	3,5	⩽0,1 (6 В)	⩾10 (1 А)	—	⩽0,13	—	—	TO-3
7NU73	Ge, p-n-p, C	12,5	⩾0,15	80	30	3,5	⩽0,1 (6 В)	⩾10 (1 А)	—	⩽0,13	—	—	TO-3
GD160	Ge, p-n-p, C	5,3	⩾0,25	20	10	3	⩽0,05 (6 В)	⩾15 (1,5 А)	—	⩽0,2	—	—	SOT-9
GD170	Ge, p-n-p, C	5,3	⩾0,25	33	10	3	⩽0,05 (6 В)	⩾15 (1,5 А)	—	⩽0,2	—	—	SOT-9
GD175	Ge, p-n-p, C	5,3	⩾0,25	50	10	3	⩽0,05 (6 В)	⩾15 (1,5 А)	—	⩽0,2	—	—	SOT-9
GD180	Ge, p-n-p, C	5,3	⩾0,25	66	10	3	⩽0,05 (6 В)	⩾15 (1,5 А)	—	⩽0,2	—	—	SOT-9
GD240	Ge, p-n-p, C	10 (45°C)	⩾0,35	30	10	3	⩽2,5 (30 В)	20...80 (2 В; 2 А)	—	0,08	—	—	SOT-9
GD241	Ge, p-n-p, C	10 (45°C)	⩾0,35	40	10	3	⩽2,5 (40 В)	20...80 (2 В; 2 А)	—	0,08	—	⩽8	SOT-9
GD242	Ge, p-n-p, C	10 (45°C)	⩾0,35	50	10	3	⩽2,5 (50 В)	20...80 (2 В; 2 А)	—	0,08	—	⩽10	SOT-9
GD243	Ge, p-n-p, C	10 (45°C)	⩾0,3	65	10	3	⩽2,5 (65 В)	20...80 (2 В; 2 А)	—	0,08	—	⩽10	SOT-9
GD244	Ge, p-n-p, C	10 (45°C)	⩾0,3	75	10	3	⩽2,5 (75 В)	20...80 (2 В; 2 А)	—	0,08	—	⩽14	SOT-9
ГТ703А	Ge, p-n-p, C	15 (40°C)	⩾0,010**	20* (0,05 к)	10	3,5	⩽0,5 (20 В)	30...70 (1 В; 50 мА)	—	⩽0,2	—	—	34
ГТ703Б	Ge, p-n-p, C	15 (40°C)	⩾0,010**	20* (0,05 к)	10	3,5	⩽0,5 (20 В)	50...100 (1 В; 50 мА)	—	⩽0,2	—	—	34
ГТ703В	Ge, p-n-p, C	15 (40°C)	⩾0,010**	30* (0,05 к)	10	3,5	⩽0,5 (30 В)	30...70 (1 В; 50 мА)	—	⩽0,2	—	—	34
ГТ703Г	Ge, p-n-p, C	15 (40°C)	⩾0,010**	30* (0,05 к)	10	3,5	⩽0,5 (30 В)	50...100 (1 В; 50 мА)	—	⩽0,2	—	—	34
ГТ703Д	Ge, p-n-p, C	15 (40°C)	⩾0,010**	40* (0,05 к)	10	3,5	⩽0,5 (30 В)	20...45 (1 В; 50 мА)	—	⩽0,2	—	—	34

Тип прибора	Материал структура, технология	$P_{K, т\ max}$, $P^*_{K, и\ max}$, Вт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^*_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ проб}$, В	$I_{K\ max}$; $I^*_{K, и\ max}$, А	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мА	$h_{21Э}$	$C_к$, пФ	$r_{кэ\ нас}$, Ом	$r_{бэ\ нас}$, Ом, $\tau^*_к$, пс	$t_{рас}$, $t^*_{выкл}$, $t^{**}_{сп}$, мкс	Корпус
AD148	Ge, p-n-p, C	13,5	0,012**	32	10	3,5	0,12 (10 В)	51 (1 В; 50 мА)	—	≤0,2	—	—	MD-23
AD149	Ge, p-n-p, C	27,5	≥0,007**	50	20	3,5	≤1* (32 В)	50 (1 В; 50 мА)	—	0,2	—	—	TO-3
AD150	Ge, p-n-p, C	27,5	0,012**	32	10	3,5	≤1* (32 В)	82 (1 В; 50 мА)	—	≤0,2	—	—	TO-3
AD162	Ge, p-n-p, C	6	1,5	32	10	3	≤0,2 (32 В)	74...300 (1 В; 50 мА)	—	—	—	—	MD-17
ADY27	Ge, p-n-p, C	27,5 (45°C)	0,012**	32	10	3,5	≤0,5* (32 В)	50 (1 В; 50 мА)	—	≤0,2	—	—	TO-3
OC26	Ge, p-n-p, C	22,5 (45°C)	≥0,003**	40	10	3,5	≤0,1 (0,5 В)	20...75 (14 В; 30 мА)	—	≤0,25	—	—	TO-3
OC1016	Ge, p-n-p, C	13,75	≥0,003**	32	10	1,5 (3*)	≤0,1 (14 В)	40 (14 В; 30 мА)	—	≤0,25	—	—	TO-3
SFT212	Ge, p-n-p, C	30	≥0,2	30	10	3	≤1 (30 В)	20...150 (2 В; 2 А)	—	≤0,13	—	—	TO-3
SFT213	Ge, p-n-p, C	30	≥0,2	40	20	3	≤1 (40 В)	20...150 (2 В; 2 А)	—	≤0,13	—	—	TO-3
AD301	Ge, p-n-p, C	30	≥0,2	30	10	3	≤1 (30 В)	20...150 (2 В; 2 А)	—	≤0,4	—	—	TO-3
OC27	Ge, p-n-p, C	12,5	≥0,15	32	10	3,5	≤0,1 (6 В)	60...180 (6 В; 0,1 А)	—	≤0,13	—	—	TO-3
2NU73	Ge, p-n-p, C	12,5	≥0,15	24	8	3,5	≤0,1 (6 В)	≥10 (3 А)	—	≤0,13	—	—	TO-3
3NU73	Ge, p-n-p, C	12,5	≥0,15	32	10	3,5	≤0,1 (6 В)	≥10 (3 А)	—	≤0,13	—	—	TO-3
4NU73	Ge, p-n-p, C	12,5	≥0,15	48	15	3,5	≤0,1 (6 В)	≥10 (3 А)	—	≤0,13	—	—	TO-3
2N2836	Ge, p-n-p, C	30	0,5	55	20	3,5	≤2,5 (55 В)	30...100 (1 А)	—	≤0,13	—	—	TO-3
П216	Ge, p-n-p, C	30	≥0,2*	40	15	7,5	≤0,5 (40 В)	≥18 (0,75 В; 4 А)	—	≤0,2	—	—	33
П216А	Ge, p-n-p, C	30	≥0,2*	40	15	7,5	≤0,5 (40 В)	20...80 (0,75 В; 4 А)	—	≤0,2	—	—	33
П216Б	Ge, p-n-p, C	24	≥0,2*	35	15	7,5	≤1,5 (35 В)	≥10 (3 В; 2 А)	—	≤0,25	—	—	33
П216В	Ge, p-n-p, C	24	≥0,2*	35	15	7,5	≤2 (35 В)	≥30 (3 В; 2 А)	—	≤0,25	—	—	33
П216Г	Ge, p-n-p, C	24	≥0,2*	50	15	7,5	≤2,5 (50 В)	≥5 (3 В; 2 А)	—	—	—	—	33
П216Д	Ge, p-n-p, C	24	≥0,2*	50	15	7,5	≤2 (50 В)	15...30 (3 В; 2 А)	—	≤0,25	—	—	33
П217	Ge, p-n-p, C	30	≥0,2*	60	15	7,5	≤0,5 (60 В)	≥16 (0,75 В; 4 А)	—	≤0,5	—	—	33
П217А	Ge, p-n-p, C	30	≥0,2*	60	15	7,5	≤0,5 (60 В)	20...60 (5 В; 1 А)	—	≤0,5	—	—	33
П217Б	Ge, p-n-p, C	30	≥0,2*	60	15	7,5	≤0,5 (60 В)	≥20 (5 В; 1 А)	—	≤0,5	—	—	33
П217В	Ge, p-n-p, C	24	≥0,2*	60	15	7,5	≤3 (60 В)	15...30 (3 В; 2 А)	—	≤0,25	—	—	33
П217Г	Ge, p-n-p, C	24	≥0,2*	60	15	7,5	≤3 (60 В)	15...40 (3 В; 2 А)	—	≤0,5	—	—	33
ASZ15	Ge, p-n-p, C	30 (45°C)	0,2	100	40	8	≤3 (100 В)	20...55 (1 В; 1 А)	190 (5 В)	≤0,04	—	10	TO-3
ASZ16	Ge, p-n-p, C	30 (45°C)	0,25	60	20	8	≤3 (60 В)	45...130 (1 В; 1 А)	190 (5 В)	≤0,04	—	10	TO-3
ASZ17	Ge, p-n-p, C	30 (45°C)	0,22	60	20	8	≤3 (60 В)	25...75 (1 В; 1 А)	190 (5 В)	≤0,04	—	10	TO-3
ASZ18	Ge, p-n-p, C	30 (45°C)	0,22	100	40	8	≤3 (100 В)	30...110 (1 В; 1 А)	190 (5 В)	≤0,04	—	10	TO-3
2N178	Ge, p-n-p, C	40	0,005**	30	20	3	≤3 (30 В)	15...45 (0,2 В; 0,5 А)	—	0,2	—	—	TO-3
2N554	Ge, p-n-p, C	40	0,005**	15	15	3	≤10 (15 В)	50 (2 В; 0,5 А)	—	0,2	—	—	TO-3
2N555	Ge, p-n-p, C	40	0,005**	30	15	3	≤20 (30 В)	50 (2 В; 0,5 А)	—	0,2	—	—	TO-3
AD130	Ge, p-n-p, C	30	0,35	32	10	3	≤15 (32 В)	20...100 (1 В; 1 А)	≤200 (6 В)	≤0,33	—	≤15	TO-3
AD131	Ge, p-n-p, C	30	0,35	64	20	3	≤15 (64 В)	20...100 (1 В; 1 А)	≤200 (6 В)	≤0,33	—	≤15	TO-3
AD132	Ge, p-n-p, C	30	0,35	80	20	3	≤15 (80 В)	20...100 (1 В; 1 А)	≤200 (6 В)	≤0,33	—	≤15	TO-3

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K,\,т\,max}$, $P^{*}_{K,\,и\,max}$, Вт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^{*}_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^{*}_{K,\,и\,max}$, А	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, мА	$h_{21Э}$	$C_к$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$r_{бэ\,нас}$, Ом, $\tau^{*}_{к}$, пс	$t_{рас}$, $t^{*}_{выкл}$, $t^{**}_{сп}$, мкс	Корпус
AD163	Ge, p-n-p, C	30	0,35	100	20	3	≤15 (100 В)	≥10 (1 В; 1 А)	≤200 (6 В)	≤0,33	—	≤15	ТО-3
AUY19	Ge, p-n-p, C	30 (45°C)	0,35	64	20	3	≤0,5* (64 В)	17 (1 В; 3 А)	≤200 (6 В)	≤0,33	—	≤15	ТО-3
AUY20	Ge, p-n-p, C	30 (45°C)	0,35	80	20	3	≤0,5* (80 В)	17 (1 В; 3 А)	≤200 (6 В)	≤0,33	—	≤15	ТО-3
ASZ1015	Ge, p-n-p, C	22,5	0,25*	80	40	6	≤0,1 (0,5 В)	20...55 (1 В; 1 А)	160 (12 В)	≤0,17	—	≤15	ТО-3
ASZ1016	Ge, p-n-p, C	22,5	0,25*	60	20	6	≤0,1 (0,5 В)	45...130 (1 В; 1 А)	160 (12 В)	≤0,17	—	≤15	ТО-3
ASZ1017	Ge, p-n-p, C	22,5	0,25*	60	20	6	≤0,1 (0,5 В)	25...75 (1 В; 1 А)	160 (12 В)	≤0,17	—	≤15	ТО-3
ASZ1018	Ge, p-n-p, C	22,5	0,25*	80	40	6	≤0,1 (0,5 В)	30...110 (1 В; 1 А)	160 (12 В)	≤0,17	—	≤15	ТО-3
AD138	Ge, p-n-p, C	30	0,005**	40	10	8	≤0,1 (45 В)	42 (1,5 В; 5 А)	—	—	—	—	ТО-3
AUY28	Ge, p-n-p, C	30	0,25	90	25	6	≤0,05 (6 В)	33 (1,5 В; 5 А)	—	≤0,04	—	≤15*	ТО-3
AD302	Ge, p-n-p, C	45	≥0,2	40	20	3	≤1 (40 В)	20...150 (2 В; 2 А)	—	≤0,07	—	—	ТО-3
AD303	Ge, p-n-p, C	45	≥0,2	60	30	3	≤1 (60 В)	20...150 (2 В; 2 А)	—	≤0,07	—	—	ТО-3
SFT214	Ge, p-n-p, C	45	≥0,2	60	30	3	≤1 (60 В)	20...150 (2 В; 2 А)	—	≤0,13	—	—	ТО-3
SFT238	Ge, p-n-p, C	45	≥0,25	40	20	6	≤1 (40 В)	20...80 (2 В; 5 А)	—	≤0,07	—	—	ТО-3
SFT239	Ge, p-n-p, C	45	≥0,25	60	30	6	≤1 (60 В)	20...80 (2 В; 5 А)	—	≤0,07	—	—	ТО-3
SFT240	Ge, p-n-p, C	45	≥0,25	80	40	6	≤1 (80 В)	20...80 (2 В; 5 А)	—	≤0,07	—	—	ТО-3
SFT250	Ge, p-n-p, C	45	≥0,2	80	40	3	≤1 (80 В)	20...150 (2 В; 2 А)	—	≤0,13	—	—	ТО-3
AD304	Ge, p-n-p, C	45	≥0,2	80	40	3	≤1 (80 В)	20...150 (2 В; 2 А)	—	≤0,07	—	—	ТО-3
AD312	Ge, p-n-p, C	45	≥0,25	40	20	6	≤1 (40 В)	20...80 (2 В; 5 А)	—	≤0,07	—	—	ТО-3
AD313	Ge, p-n-p, C	45	≥0,25	60	30	6	≤1 (60 В)	20...80 (2 В; 5 А)	—	≤0,07	—	—	ТО-3
AD314	Ge, p-n-p, C	45	≥0,25	80	40	6	≤1 (80 В)	20...80 (2 В; 5 А)	—	≤0,07	—	—	ТО-3
AD542	Ge, p-n-p, C	20	—	80	—	8 (10*)	≤4 (80 В)	≥10 (3 В; 10 А)	—	≤0,1	—	—	ТО-3
EFT212	Ge, p-n-p, C	30	≥0,2	30	7,5	3	≤1 (30 В)	20...150 (2 В; 2 А)	—	—	—	—	ТО-3
EFT213	Ge, p-n-p, C	30	≥0,2	40	20	3	≤1 (40 В)	20...150 (2 В; 2 А)	≤220 (5 В)	≤0,13	—	—	ТО-3
EFT214	Ge, p-n-p, C	30	≥0,2	60	30	3	≤1 (60 В)	20...150 (2 В; 2 А)	≤220 (5 В)	≤0,13	—	—	ТО-3
EFT250	Ge, p-n-p, C	30	—	80	40	3	≤1 (80 В)	20...150 (2 В; 2 А)	≤220 (5 В)	≤0,13	—	—	ТО-3
OC25	Ge, p-n-p, C	22,5 (45°C)	0,25	40	10	4	—	15...80 (1 А)	—	—	—	—	ТО-3
П210Б	Ge, p-n-p, C	45	≥0,1*	65	25	12	≤15 (45 В)	≥10 (2 В; 5 А)	—	—	—	—	35
П210В	Ge, p-n-p, C	45	≥0,1*	45	25	12	≤15 (35 В)	≥10 (2 В; 5 А)	—	—	—	—	35
AUY21	Ge, p-n-p, C	36 (45°C)	0,3	65	20	10	≤1 (65 В)	≥12,5 (0,5 В; 5 А)	—	≤0,04	—	≤15	ТО-41
AUY22	Ge, p-n-p, C	36 (45°C)	0,3	80	20	8	≤1 (80 В)	≥12,5 (0,5 В; 5 А)	—	≤0,045	—	≤15	ТО-41
2N456	Ge, p-n-p, C	50	—	40	20	5	2	10...30 (1,5 В; 5 А)	—	≤0,2	—	—	ТО-3
2N457	Ge, p-n-p, C	50	—	60	20	5	2	10...30 (1,5 В; 5 А)	—	≤0,2	—	—	ТО-3
2N458	Ge, p-n-p, C	50	0,1	80	20	5	2	10...30 (1,5 В; 5 А)	—	≤0,2	—	—	ТО-3
AD142	Ge, p-n-p, C	30 (55°C)	0,45	80	10	10	—	30...170 (2 В; 1 А)	—	—	—	—	ТО-3
AD143	Ge, p-n-p, C	30 (55°C)	0,45	40	10	10	—	30...170 (2 В; 1 А)	—	—	—	—	ТО-3

14 Заказ № 1141

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K,\,т\,max}$, $P^*_{K,\,и\,max}$, Вт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,\,и\,max}$, А	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мА	$h_{21Э}$	$C_к$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$r_{бэ\,нас}$, Ом, $\tau^*_к$, пс	$t_{рас}$, $t^*_{выкл}$, $t^{**}_{сп}$, мкс	Корпус
AD145	Ge, p-n-p, C	30 (55°C)	0,2	20	10	10	≤0,16 (0,5 В)	30 (2 В; 1 А)	—	—	—	—	ТО-3
AUY21A	Ge, p-n-p, C	36	0,3	65	20	10	≤1 (65 В)	12,5...60 (0,5 В; 5 А)	—	—	—	—	ТО-3
AUY22A	Ge, p-n-p, C	36	0,3	80	20	10	≤1 (80 В)	12,5...60 (0,5 В; 5 А)	—	—	—	—	ТО-3
AD325	Ge, p-n-p, C	45	0,4	100	40	10	≤3 (100 В)	20...150 (2 В; 2 А)	—	≤0,07	—	—	ТО-3
AD545	Ge, p-n-p, C	20	—	60	—	15	≤4 (60 В)	≥10 (3 В; 15 А)	—	≤0,07	—	—	ТО-3
6NU74	Ge, p-n-p, C	50	≥0,15	90	15	15	≤1 (6 В)	20...60 (10 А)	—	≤0,1	—	—	ТО-3
7NU74	Ge, p-n-p, C	50	≥0,15	90	15	15	≤1 (6 В)	50...150 (10 А)	—	≤0,1	—	—	ТО-3
OC28	Ge, p-n-p, C	30 (45°C)	0,25	80	40	8 (10*)	—	20...55 (1 А)	—	—	—	—	ТО-3
OC35	Ge, p-n-p, C	30 (45°C)	0,25	60	20	8 (10*)	—	25...75 (1 А)	—	—	—	—	ТО-3
ГТ701А	Ge, p-n-p, C	50	≥0,05**	55* (140 имп)	15	12	≤6 (60 В)	≥10 (2 В; 6 А)	—	—	—	—	35
2N2137A	Ge, p-n-p, C	70	≥0,012**	30	15	—	≤2 (30 В)	15...22 (2 В; 2 А)	—	≤0,25	—	—	ТО-3
2N2142A	Ge, p-n-p, C	70	≥0,012**	30	15	—	≤2 (30 В)	25...33 (2 В; 2 А)	—	≤0,25	—	—	ТО-3
2N2138A	Ge, p-n-p, C	70	≥0,012**	45	25	—	≤2 (45 В)	15...22 (2 В; 2 А)	—	≤0,25	—	—	ТО-3
2N2143A	Ge, p-n-p, C	70	≥0,012**	45	25	—	≤2 (45 В)	25...33 (2 В; 2 А)	—	≤0,25	—	—	ТО-3
2N3611	Ge, p-n-p, C	77	≥0,3	40	20	7 (15*)	≤5 (40 В)	≥20 (2 В; 7 А)	—	≤0,05	—	—	ТО-3
2U3613	Ge, p-n-p, C	77	≥0,3	40	20	7 (15*)	—	≥30 (2 В; 7 А)	—	≤0,05	—	—	ТО-3
2N5887	Ge, p-n-p, C	57	≥0,25	20	20	7	≤1 (15 В)	≥10 (2 В; 3 А)	—	≤0,06	—	—	ТО-66
2N5888	Ge, p-n-p, C	57	≥0,25	30	20	7	≤1 (25 В)	≥10 (2 В; 3 А)	—	≤0,06	—	—	ТО-66
2N5889	Ge, p-n-p, C	57	≥0,25	30	20	7	≤1 (25 В)	≥15 (2 В; 3 А)	—	≤0,06	—	—	ТО-66
2N5890	Ge, p-n-p, C	57	≥0,25	45	20	7	≤1 (35 В)	≥15 (2 В; 3 А)	—	≤0,06	—	—	ТО-66
2N5891	Ge, p-n-p, C	57	≥0,25	60	20	7	≤1 (45 В)	≥15 (2 В; 3 А)	—	≤0,06	—	—	ТО-66
2NU74	Ge, p-n-p, C	50	≥0,15	50	10	15	≤1 (6 В)	20...60 (10 А)	—	≤0,1	—	—	ТО-3
3NU74	Ge, p-n-p, C	50	≥0,15	50	10	15	≤1 (6 В)	50...130 (10 А)	—	≤0,1	—	—	ТО-3
4NU74	Ge, p-n-p, C	50	≥0,15	60	15	15	≤1 (6 В)	20...60 (10 А)	—	≤0,1	—	—	ТО-3
5NU74	Ge, p-n-p, C	50	≥0,15	60	15	15	≤1 (6 В)	50...130 (10 А)	—	≤0,1	—	—	ТО-3
ГТ705А	Ge, n-p-n, C	15 (40°C)	≥0,01**	20* (0,05 к)	10	3,5	≤0,5 (20 В)	30...70 (1 В; 50 мА)	—	≤0,6	—	—	34
ГТ705Б	Ge, n-p-n, C	15 (40°C)	≥0,01**	20* (0,05 к)	10	3,5	≤0,5 (20 В)	50...100 (1 В; 50 мА)	—	≤0,6	—	—	34
ГТ705В	Ge, n-p-n, C	15 (40°C)	≥0,01**	30* (0,05 к)	10	3,5	≤0,5 (30 В)	30...70 (1 В; 50 мА)	—	≤0,6	—	—	34
ГТ705Г	Ge, n-p-n, C	15 (40°C)	≥0,01**	30* (0,05 к)	10	3,5	≤0,5 (30 В)	50...100 (1 В; 50 мА)	—	≤0,6	—	—	34
ГТ705Д	Ge, n-p-n, C	15 (40°C)	≥0,01**	20* (0,05 к)	10	3,5	≤0,5 (20 В)	90...250 (1 В; 50 мА)	—	≤0,6	—	—	34

Тип прибора	Материал, структура; технология	$P_{К,т\,max}$, $P^*_{К,и\,max}$, Вт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{К\,max}$, $I^*_{К,и\,max}$, А	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мА	$h_{21Э}$	$C_к$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$r_{бэ\,нас}$, Ом, $\tau^*_к$, пс	$t_{рас}$, $t^*_{выкл}$, $t^{**}_{сп}$, мкс	Корпус
AD161	Ge, n-p-n, С	4 (75°С)	≥0,02**	32	10	1 (3,5*)	≤0,5 (32 В)	74...300 (1 В; 50 мА)	150 (5 В)	≤0,6	—	—	MD 17
2N1218	Ge, n-p-n, С	20	≥0,007**	45	15	3	0,1	30...120 (1,5 В; 1 А)	—	≤0,1	—	—	ТО-3
2N1292	Ge, n-p-n, С	25	—	35	15	3	—	30 (2 В; 0,5 А)	—	≤0,1	—	—	ТО-3
2N1321	Ge, n-p-n, С	25	—	35	15	3	—	30 (2 В; 0,5 А)	—	≤0,1	—	—	ТО-10
2N1329	Ge, n-p-n, С	25	—	35	15	3	—	30 (2 В; 0,5 А)	—	≤0,1	—	—	ТО-13
2N4077	Ge, n-p-n, С	7,5	≥1	32	10	1	0,25	75...300 (0,5 А)	—	≤0,6	—	—	MD-6
2N326	Ge, n-p-n, С	7	≥0,15	35	—	2	0,3	15...60 (1 В; 1 А)	—	≤1,2	—	—	ТО-3
ГТ905А	Ge, p-n-p, СД	6 (30°С)	≥60	75	0,4	3 (7*)	≤2 (75 В)	35...100 (70 В; 3 А)	≤200 (30 В)	≤0,17	≤300*	≤4	36
ГТ905Б	Ge, p-n-p, СД	6 (30°С)	≥60	60	0,4	3 (7*)	≤2 (60 В)	35...100 (70 В; 3 А)	≤200 (30 В)	≤0,17	≤300*	≤4	36
2N2147	Ge, p-n-p, СД	12,5	≥3	75	1,5	5	≤1 (40 В)	75 (2 В; 4 А)	—	≤0,12	—	—	ТО-3
2N2148	Ge, p-n-p, СД	12,5	≥2	60	1,5	5	≤1 (40 В)	40 (2 В; 4 А)	—	≤0,15	—	—	ТО-3
2N3732	Ge, p-n-p, Д	3 (55°С)	≥1	100	0,5	3	0,2	35...500 (4 В; 0,7 А)	—	≤0,35	—	—	ТО-3
ГТ810А	Ge, p-n-p, ДС	15 (27,5°С)	≥15	200 (250 имп)	1,4	10	≤20 (200 В)	≥15 (10 В; 5 А)	—	≤0,07	—	≤5	33
AU107	Ge, p-n-p, ДС	30 (30°С)	2	200	2	10	≤5 (200 В)	≥10 (1,3 В; 6 А)	≤250 (5 В)	≤2,5	—	—	ТО-3
2N3730	Ge, p-n-p, Д	10 (55°С)	≥1	200	0,5	10	0,2	10...200 (4 В; 50 мА)	—	≤0,88	—	—	ТО-3
2SB468	Ge, p-n-p, Д	10	—	200	1,5	10	—	14...130 (1,5 В; 4 А)	—	—	—	$t_{нр}$≤2,5	ТО-3
AU103	Ge, p-n-p, ДС	10	15	155	4	10	≤10 (155 В)	≥15 (1 В; 10 А)	—	≤0,07	—	≤3	ТО-3
AU104	Ge, p-n-p, ДС	15	15	185	4	12	≤10 (185 В)	≥14 (1 В; 12 А)	—	≤0,07	—	≤3	ТО-3
AU113	Ge, p-n-p, Д	5 (55°С)	≥1	250	3	10	≤1,8 (200 В)	15...80 (1,3 В; 6 А)	—	≤0,06	—	—	ТО-3
ГТ806А	Ge, p-n-p, ДС	30	≥10*	75	1,5	15	—	10...100 (10 А)	—	≤0,04	—	—	37
ГТ806Б	Ge, p-n-p, ДС	30	≥10*	100	1,5	15	—	10...100 (10 А)	—	≤0,04	—	—	37
ГТ806В	Ge, p-n-p, ДС	30	≥10*	120	1,5	15	—	10...100 (10 А)	—	≤0,04	—	—	37
ГТ806Г	Ge, p-n-p, ДС	30	≥10*	50	1,5	15	—	10...100 (10 А)	—	≤0,04	—	—	37

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K,\,т\,max}$, $P^*_{K,\,и\,max}$, Вт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,\,и\,max}$, А	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мА	$h_{21Э}$	$C_к$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$r_{бэ\,нас}$, Ом, $\tau^*_к$, пс	$t_{рас}$, $t^*_{выкл}$, $t^{**}_{сп}$, мкс	Корпус
ГТ806Д	Ge, p-n-p, ДС	30	⩾10*	140	1,5	15	—	10...100 (10 А)	—	⩽0,04	—	—	37
AU108	Ge, p-n-p, ДС	30 (30°C)	2	100	2	10	⩽5 (100 В)	⩾10 (1,3 В; 6 А)	250 (5 В)	⩽2,5	—	—	ТО-3
AL100	Ge, p-n-p, ДС	30 (55°C)	4	130	2	10	⩽1 (40 В)	40...250 (2 В; 1 А)	—	⩽0,1	—	—	ТО-3
AL102	Ge, p-n-p, ДС	30 (55°C)	4	130	2	6	⩽1 (40 В)	40...250 (2 В; 1 А)	—	⩽0,1	—	—	ТО-3
AL103	Ge, p-n-p, ДС	30 (55°C)	3	100	1,5	6	⩽1 (40 В)	40...250 (2 В; 1 А)	—	—	—	—	ТО-3
2SB361	Ge, p-n-p, Д	40	⩾5*	80	1	7	⩽0,3 (40 В)	50...135 (2 В; 1 А)	—	—	—	—	ТО-3
2SB362	Ge, p-n-p, Д	40	⩾5*	100	1	7	⩽0,3 (40 В)	50...110 (2 В; 5 А)	—	—	—	—	ТО-3
AU110	Ge, p-n-p, ДС	30	2	160	2	10	⩽1 (40 В)	20...90 (2 В; 5 А)	—	⩽0,1	—	—	ТО-3
AUY38	Ge, p-n-p, Д	30 (55°C)	2,5	130	2	10	⩽3 (130 В)	30...190 (1 В; 5 А)	—	⩽0,04	—	—	ТО-3
AUY35	Ge, p-n-p, Д	15	2,5	70	2	10	⩽0,1 (0,5 В)	35...260 (1 В; 5 А)	—	⩽0,045	—	—	ТО-8
KT801A	Si, n-p-n, СД	5 (55°C)	⩾10	80* (0,1 к)	2,5	2	⩽10* (80 В)	15...50 (5 В; 1 А)	—	⩽2	—	—	306
KT801Б	Si, n-p-n, СД	5 (55°C)	⩾10	60* (0,1 к)	2,5	2	⩽10* (60 В)	30...150 (5 В; 1 А)	—	⩽2	—	—	306
2N4237	Si, n-p-n, Д	6	⩾1	50	6	1 (3*)	⩽0,1 (50 В)	⩾15 (1 В; 1 А)	⩽100 (10 В)	⩽0,6	—	0,35	ТО-5
2N4238	Si, n-p-n, Д	6	⩾1	80	6	1 (3*)	⩽0,1 (80 В)	⩾15 (1 В; 1 А)	⩽100 (10 В)	⩽0,6	—	0,35	ТО-5
2N4239	Si, n-p-n, Д	6	⩾1	100	6	1 (3*)	⩽0,1 (100 В)	⩾15 (1 В; 1 А)	⩽100 (10 В)	⩽0,6	—	0,35	ТО-5
BSX62	Si, n-p-n, ПЭ	5	⩾30	60*	5	3	⩽0,1 (60 В)	⩾25 (5 В; 2 А)	⩽70 (10 В)	⩽0,4	—	1,5	ТО-39
BSX63	Si, n-p-n, ПЭ	5	⩾30	80*	5	3	⩽0,1 (60 В)	⩾25 (5 В; 2 А)	⩽70 (10 В)	⩽0,4	—	—	ТО-39
KU601	Si, n-p-n, М	10	⩾9	60	3	2	⩽0,3 (60 В)	⩾20 (6 В; 0,2 А)	250 (12 В)	⩽1,4	—	—	ТО-3
KU602	Si, n-p-n, М	10	⩾9	120	3	2	⩽0,3 (120 В)	⩾20 (6 В; 0,2 А)	250 (12 В)	⩽1,4	—	—	ТО-3
KU611	Si, n-p-n, М	10	⩾9	60	3	2	⩽0,3 (60 В)	⩾20 (6 В; 0,2 А)	250 (12 В)	⩽1,4	—	—	SOT-9
KU612	Si, n-p-n, М	10	⩾9	120	3	2	⩽0,3 (120 В)	⩾20 (6 В; 0,2 А)	250 (12 В)	⩽1,4	—	—	SOT-9
2N1700	Si, n-p-n, Д	5	1,2	60	6	0,75	⩽0,075 (30 В)	20...80 (4 В; 0,1 А)	150 (40 В)	⩽10	—	—	ТО-5
2N2890	Si, n-p-n, ПЭ	5	⩾30	100	5	2	⩽0,1 (60 В)	⩾30 (2 В; 1 А)	—	⩽0,37	—	—	ТО-5
2N2891	Si, n-p-n, ПЭ	5	⩾30	100	5	2	⩽0,1 (60 В)	⩾50 (2 В; 1 А)	—	⩽0,37	—	—	ТО-5
П701	Si, n-p-n, ДС	10 (50°)	⩾20*	40* (0,1 к)	2 (80°C)	0,5	⩽0,1 (40 В)	10...40 (10 В; 0,5 А)	—	⩽14	—	—	38
П701А	Si, n-p-n, ДС	10 (50°C)	⩾20*	60* (0,1 к)	2	0,5	⩽0,1 (60 В)	15...60 (10 В; 0,2 А)	—	⩽14	—	—	38
П701Б	Si, n-p-n, ДС	10 (50°C)	⩾20*	35* (0,1 к)	2	0,5	⩽0,1 (35 В)	30...100 (10 В; 0,2 А)	—	⩽14	—	—	38

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{К, т\ max}$, $P^*_{К, и\ max}$, Вт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^*_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ проб}$, В	$I_{К\ max}$, $I^*_{К, и\ max}$, А	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мА	$h_{21Э}$	$C_к$, пФ	$r_{кэ\ нас}$, Ом	$r_{бэ\ нас}$, Ом, $\tau^*_к$, пс	$t_{рас}$, $t^*_{выкл}$, $t^{**}_{сп}$, мкс	Корпус
2N1714	Si, n-p-n, Д	10 (100°C)	≥16	90	6	0,75	≤0,05 (90 В)	20...60 (5 В; 0,2 А)	≤50 (10 В)	≤10	—	—	ТО-5
2N1716	Si, n-p-n, Д	10 (100°C)	≥16	90	6	0,75	≤0,05 (90 В)	40...120 (5 В; 0,2 А)	≤50 (10 В)	≤10	—	—	ТО-5
2SC525	Si, n-p-n, П	10	≥20	70	5	1,5	≤0,001 (30 В)	30...150 (2 В; 0,2 А)	≤50 (10 В)	≤3	—	3	MD-29
2SC893	Si, n-p-n, М	12	20	100	6	0,5	≤0,001 (30 В)	50...370 (4 В; 50 мА)	—	≤2	—	—	MD-29
КТ807А	Si, n-p-n, МП	10 (70°C)	≥5	100	4	0,5 (1,5*)	≤5* (100 В)	15...45 (5 В; 0,5 А)	—	≤2	—	—	39
КТ807Б	Si, n-p-n, МП	10 (70°C)	≥5	100	4	0,5 (1,5*)	≤5* (100 В)	30...100 (5 В; 0,5 А)	—	≤2	—	—	39
MPS-U01	Si, n-p-n, ПЭ	8	≥50	40	5	2	≤0,1 мкА (40 В)	≥50 (1 В; 1 А)	≤20 (10 В)	≤0,5	—	—	X-81
MPS-U01A	Si, n-p-n, ПЭ	8	≥50	50	5	2	≤0,1 мкА (40 В)	≥50 (1 В; 1 А)	≤20 (10 В)	≤0,5	—	—	X-81
MPS-U05	Si, n-p-n, ПЭ	10	≥50	60	4	2	≤0,1 мкА (40 В)	55 (1 В; 0,5 А)	≤12 (10 В)	≤1,6	—	—	X-81
MPS-U06	Si, n-p-n, ПЭ	10	≥50	80	4	2	≤0,1 мкА (60 В)	55 (1 В; 0,5 А)	≤12 (10 В)	≤1,6	—	—	X-81
MPS-U07	Si, n-p-n, ПЭ	10	≥50	100	4	2	≤0,1 мкА (80 В)	30 (1 В; 0,5 А)	≤12 (10 В)	≤1,6	—	—	X-81
КТ704А	Si, n-p-n, МП	15 (50°C)	≥3	500* (1000 имп)	4	2,5 (4*)	≤5* (1000 В)	10...100 (15 В; 1 А)	≤50 (20 В)	≤2,5	—	—	40
КТ704Б	Si, n-p-n, МП	15 (50°C)	≥3	400* (700 имп)	4	2,5 (4*)	≤5* (700 В)	10...100 (15 В; 1 А)	≤50 (20 В)	≤2,5	—	—	40
КТ704В	Si, n-p-n, МП	15 (50°C)	≥3	400* (500 имп)	4	2,5 (4*)	≤5* (500 В)	≥10 (15 В; 1 А)	≤50 (20 В)	≤2,5	—	—	40
BDY93	Si, n-p-n, Д	30 (50°C)	8	350** (750 имп)	6	3 (6*)	≤0,5* (750 В)	15...60 (5 В; 1 А)	85 (10 В)	≤1	—	≤3	ТО-3
BDY94	Si, n-p-n, Д	30 (50°C)	8	300** (750 имп)	6	3 (6*)	≤0,5* (750 В)	25...80 (5 В; 1 А)	85 (10 В)	≤1	—	≤3,5	ТО-3
BDY95	Si, n-p-n, Д	30 (50°C)	8	250** (600 имп)	6	3 (6*)	≤0,5* (600 В)	25...80 (5 В; 1 А)	85 (10 В)	≤1	—	≤3,5	ТО-3
BU126	Si, n-p-n, Д	30 (50°C)	8	300** (750 имп)	6	3 (6*)	≤0,5* (750 В)	15...60 (5 В; 1 А)	85 (10 В)	≤4	—	1,2	ТО-3
BU132	Si, n-p-n, Д	15 (97°C)	8	600** (800 имп)	5	1 (2*)	≤0,25* (800 В)	25...80 (10 В; 0,25 А)	—	≤20	—	—	ТО-3
BU133	Si, n-p-n, Д	30 (50°C)	8	250** (750 имп)	6	3 (6*)	≤0,5* (750 В)	15...80 (5 В; 1 А)	85 (10 В)	≤4	—	2	ТО-3
2N3585	Si, n-p-n, ТДМ	35	≥10	500	6	2 (5*)	≤1* (450 В)	8...80 (2 В; 1 А)	—	≤0,75	≤1,4	≤4	ТО-66
2N4240	Si, n-p-n, ТДМ	35	≥10	500	6	2 (5*)	≤2* (450 В)	10...100 (2 В; 0,75 А)	—	≤1,3	≤1,4	≤6	ТО-66
2N3583	Si, n-p-n, ТДМ	35	≥10	250	6	1 (5*)	≤1** (225 В)	≥10 (10 В; 1 А)	—	≤5	≤1,4	—	ТО-66

Тии прибора	Материал, структура, технология	$P_{К,т\,max}$, $P^*_{К,и\,max}$, Вт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{К\,max}$, $I^*_{К,и\,max}$, А	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мА	$h_{21Э}$	$C_к$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$r_{бэ\,нас}$, Ом, $\tau^*_к$, пс	$t_{рас}$, $t^*_{выкл}$, $t^{**}_{сп}$, мкс	Корпус
КТ805А	Si, n-p-n, МП	30 (50°C)	⩾20	60* (160 имп)	5	5 (8*)	⩽15* (60 В)	⩾15 (10 В; 2 А)	—	⩽0,5	—	—	37
КТ805АМ	Si, n-p-n, МП	30 (50°C)	⩾20	60* (160 имп)	5	5 (8*)	⩽15* (60 В)	⩾15 (10 В; 2 А)	—	⩽0,5	—	—	18
КТ805Б	Si, n-p-n, МП	30 (50°C)	⩾20	60* (135 имп)	5	5 (8*)	⩽15* (60 В)	⩾15 (10 В; 2 А)	—	⩽1	—	—	37
КТ805БМ	Si, n-p-n, МП	30 (50°C)	⩾20	60* (135 имп)	5	5 (8*)	⩽15* (60 В)	⩾15 (10 В; 2 А)	—	⩽1	—	—	18
КТ805ВМ	Si, n-p-n, МП	30 (50°C)	⩾20	60* (135 имп)	5	5 (8*)	⩽15* (60 В)	⩾15 (10 В; 2 А)	—	⩽1,25	—	—	18
2N3054	Si, n-p-n, Д	25	⩾0,8	90	7	4	⩽0,1* (60 В)	25...100 (4 В; 0,25 А)	—	⩽2	—	—	TO-66
2N3766	Si, n-p-n, Д	20	⩾10	80	6	4	⩽0,1 (80 В)	⩾20 (10 В; 1 А)	⩽50 (10 В)	⩽2,5	—	—	TO-66
2N3767	Si, n-p-n, Д	20	⩾10	100	6	4	⩽0,1 (100 В)	⩾20 (10 В; 1 А)	—	⩽2,5	—	—	TO-66
2N6260	Si, n-p-n, Д	29	⩾0,8	50	5	3	⩽1** (30 В)	20...100 (4 В; 1,5 А)	—	⩽1	—	—	TO-66
BD109	Si, n-p-n, ПЭ	18,5	⩾30	60	5	3	⩽0,1 (60 В)	40 (5 В; 2 А)	⩽70 (10 В)	⩽0,375	—	⩽1,5*	MD-6
BD148	Si, n-p-n, Д	31 (45°C)	1	60	7	4	⩽2* (60 В)	⩾15 (1,5 В; 2 А)	—	⩽0,65	—	—	MD-17
BD149	Si, n-p-n, Д	31 (45°C)	1	80	7	4	⩽2* (60 В)	⩾15 (1,5 В; 2 А)	—	⩽0,65	—	—	MD-17
BDY12	Si, n-p-n, ПЭ	26 (45°C)	⩾30	60	5	3	⩽0,1 (60 В)	⩾25 (5 В; 2 А)	⩽70 (10 В)	⩽0,4	—	⩽1,5*	MD-17
BDY13	Si, n-p-n, ПЭ	26 (45°C)	⩾30	80	5	3	⩽0,1 (80 В)	⩾25 (5 В; 2 А)	⩽70 (10 В)	⩽0,4	—	—	MD-17
BDY78	Si, n-p-n, М	25	⩾8	90	7	4	⩽1 (90 В)	25...100 (4 В; 0,5 А)	—	⩽1	—	—	TO-66
BDY60	Si, n-p-n, ПЭ	15 (100°C)	100	60 (120 имп)	5	5 (10*)	⩽0,01 (100 В)	⩾40 (2 В; 1 А)	⩽80 (10 В)	⩽0,14	⩽0,34	0,35*	TO-3
BDY61	Si, n-p-n, ПЭ	15 (100°C)	100	60 (100 имп)	5	5 (10*)	⩽0,01 (80 В)	⩾38 (2 В; 1 А)	⩽80 (10 В)	⩽0,14	⩽0,34	0,35*	TO-3
2SC2562	Si, n-p-n, Э	2,5	120	60	5	5	⩽0,001 (50 В)	⩾30 (1 В; 3 А)	⩽80 (10 В)	⩽0,14	⩽0,4	1	TO-220
2SC3422	Si, n-p-n, Э	10	100	40	5	3	⩽0,0001 (40 В)	⩾25 (2 В; 2,5 А)	35 (10 В)	⩽0,4	—	—	SOT-82
П702	Si, n-p-n, МП	40 (50°C)	⩾4	60*	3	2	⩽5 (70 В)	⩾25 (10 В; 1,1 А)	—	⩽2,5	—	—	37
П702А	Si, n-p-n, МП	40 (50°C)	⩾4	60*	3	2	⩽5 (70 В)	⩾10 (10 В; 1,1 А)	—	⩽4	—	—	37
2N4231	Si, n-p-n, Д	35	⩾4	50	5	3 (5*)	⩽0,05	25...100 (2 В; 1,5 А)	⩽200 (10 В)	⩽0,46	—	0,45	TO-66
2N4232	Si, n-p-n, Д	35	⩾4	70	5	3 (5*)	⩽0,05	25...100 (2 В; 1,5 А)	⩽200 (10 В)	⩽0,46	—	0,45	TO-66
2N4233	Si, n-p-n, Д	35	⩾4	90	5	3 (5*)	⩽0,05	25...100 (2 В; 1,5 А)	⩽200 (10 В)	⩽0,46	—	0,45	TO-66
2N4910	Si, n-p-n, Д	25	⩾3	40	5	1 (4*)	⩽0,1	⩾10 (1 В; 1 А)	⩽100 (10 В)	⩽0,6	—	0,35	TO-66
2N4911	Si, n-p-n, Д	25	⩾3	60	5	1 (4*)	⩽0,1	⩾10 (1 В; 1 А)	⩽100 (10 В)	⩽0,6	—	—	TO-66
2N4912	Si, n-p-n, Д	25	⩾3	80	5	1 (4*)	⩽0,1	⩾10 (1 В; 1 А)	⩽100 (10 В)	⩽0,6	—	—	TO-66

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K,\,т\,max}$, $P^*_{K,\,и\,max}$, Вт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,\,и\,max}$, А	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мА	$h_{21Э}$	$C_к$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$r_{бэ\,нас}$, Ом, $\tau^*_к$, пс	$t_{рас}$, $t^*_{выкл}$, $t^{**}_{сп}$, мкс	Корпус
BUY43	Si, n-p-n, Д	31 (45°C)	1	40**	7	4	⩽1* (50 В)	⩾25 (1,5 В; 0,5 А)	—	⩽0,55	—	—	MD-17
BUY46	Si, n-p-n, Д	31 (45°C)	0,8	55**	7	4	⩽1 (30 В)	⩾40 (1,5 В; 0,5 А)	—	⩽2	—	—	MD-17
2N1701	Si, n-p-n, Д	25	1*	60	6	1	⩽0,1 (30 В)	20...80 (4 В; 0,3 А)	175 (40 В)	⩽5	—	—	TO-8
2SD146	Si, n-p-n, Д	20	1,4*	40	5	1	⩽0,02 (30 В)	30...150 (4 В; 0,5 А)	—	⩽6	—	—	MD-10
2SD147	Si, n-p-n, Д	20	1,4*	60	5	1	⩽0,02 (30 В)	20...150 (4 В; 0,5 А)	—	⩽6	—	—	MD-10
2SD148	Si, n-p-n, Д	20	1,2*	70	5	2	⩽0,02 (30 В)	35 (4 В; 2 А)	—	⩽0,5	—	2,5	MD-10
КТ814А	Si, p-n-p, ПЭ	10	⩾3	40* (0,1 к)	5	1,5 (3*)	⩽0,5 (40 В)	⩾40 (20 В; 0,15 А)	⩽60 (5 В)	⩽1,2	⩽3500*	—	18
КТ814Б	Si, p-n-p, ПЭ	10	⩾3	50* (0,1 к)	5	1,5 (3*)	⩽0,5 (40 В)	⩾40 (2 В; 0,15 А)	⩽60 (5 В)	⩽1,2	⩽3500*	—	18
КТ814В	Si, p-n-p, ПЭ	10	⩾3	70* (0,1 к)	5	1,5 (3*)	⩽0,5 (40 В)	⩾40 (2 В; 0,15 А)	⩽60 (5 В)	⩽1,2	⩽3500*	—	18
КТ814Г	Si, p-n-p, ПЭ	10	⩾3	100* (0,1 к)	5	1,5 (3*)	⩽0,5 (40 В)	⩾30 (2 В; 0,15 А)	⩽60 (5 В)	⩽1,2	⩽3500*	—	18
BD166	Si, p-n-p, ПЭ	20	⩾3	45	5	1,5 (3*)	⩽0,1 (45 В)	⩾40 (2 В; 0,15 А)	—	⩽1	—	—	TO-126
BD168	Si, p-n-p, ПЭ	20	⩾3	60	5	1,5 (3*)	⩽0,1 (60 В)	⩾40 (2 В; 0,15 А)	—	⩽1	—	—	TO-126
BD170	Si, p-n-p, ПЭ	20	⩾3	80	5	1,5 (3*)	⩽0,1 (80 В)	⩾40 (2 В; 0,15 А)	—	⩽1	—	—	TO-126
BD814	Si, p-n-p, Э	12,5	⩾3	45	5	2 (6*)	⩽0,1 (45 В)	⩾25 (2 В; 1 А)	—	⩽0,6	—	0,7	SOT-128
BD816	Si, p-n-p, Э	12,5	⩾3	60	5	2 (6*)	⩽0,1 (60 В)	⩾25 (2 В; 1 А)	—	⩽0,6	—	0,7	SOT-128
BD818	Si, p-n-p, Э	12,5	⩾3	100	5	2 (6*)	⩽0,1 (100 В)	⩾25 (2 В; 1 А)	—	⩽0,6	—	0,7	SOT-128
TIP30	Si, p-n-p, ДМ	30	⩾3	40	5	1 (3*)	⩽0,2* (40 В)	⩾40 (4 В; 0,2 А)	—	⩽0,7	—	—	TO-220
TIP30A	Si, p-n-p, ДМ	30	⩾3	60	5	1 (3*)	⩽0,2* (60 В)	⩾40 (4 В; 0,2 А)	—	⩽0,7	—	—	TO-220
TIP30B	Si, p-n-p, ДМ	30	⩾3	80	5	1 (3*)	⩽0,2* (80 В)	⩾40 (4 В; 0,2 А)	—	⩽0,7	—	—	TO-220
TIP30C	Si, p-n-p, ДМ	30	⩾3	100	5	1 (3*)	⩽0,2* (100 В)	⩾40 (4 В; 0,2 А)	—	⩽0,7	—	—	TO-220
TIP62	Si, p-n-p, ДМ	15	⩾3	40	5	0,5 (1,5*)	⩽0,2* (40 В)	15...100 (4 В; 0,5 А)	—	⩽1,4	—	1*	TO-220
TIP62A	Si, p-n-p, ДМ	15	⩾3	60	5	0,5 (1,5*)	⩽0,2* (60 В)	15...100 (4 В; 0,5 А)	—	⩽1,4	—	1*	TO-220
TIP62B	Si, p-n-p, ДМ	15	⩾3	80	5	0,5 (1,5*)	⩽0,2* (80 В)	15...100 (4 В; 0,5 А)	—	⩽1,4	—	1*	TO-220
TIP62C	Si, p-n-p, ДМ	15	⩾3	100	5	0,5 (1,5*)	⩽0,2* (100 В)	15...100 (4 В; 0,5 А)	—	⩽1,4	—	1*	TO-220
2SA815	Si, p-n-p	15	⩾10	100	5	1	⩽0,001 (50 В)	70...240 (5 В; 0,15 А)	30 (10 В)	⩽1	⩽2**	—	TO-220
КТ815А	Si, n-p-n, МПЭ	10	⩾3	40* (0,1 к)	5	1,5 (3*)	⩽0,5 (40 В)	⩾40 (2 В; 0,15 А)	⩽60 (5 В)	⩽1,2	⩽5000*	—	18

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K, т\ max}$, $P^*_{K, и\ max}$, Вт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^*_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ проб}$, В	$I_{K\ max}$, $I^*_{K, и\ max}$, А	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мА	$h_{21Э}$	$C_к$, пФ	$r_{кэ\ нас}$, Ом	$r_{бэ\ нас}$, Ом, $\tau^*_к$, пс	$t_{рас}$, $t^*_{выкл}$, $t^{**}_{сп}$, мкс	Корпус
КТ815Б	Si, n-p-n, МПЭ	10	⩾3	50* (0,1 к)	5	1,5 (3*)	⩽0,5 (40 В)	⩾40 (2 В; 0,15 А)	⩽60 (5 В)	⩽1,2	⩽5000*	—	18
КТ815В	Si, n-p-n, МПЭ	10	⩾3	70* (0,1 к)	5	1,5 (3*)	⩽0,5 (40 В)	⩾40 (2 В; 0,15 А)	⩽60 (5 В)	⩽1,2	⩽5000*	—	18
КТ815Г	Si, n-p-n, МПЭ	10	⩾3	100* (0,1 к)	5	1,5 (3*)	⩽0,5 (40 В)	⩾40 (2 В; 0,15 А)	⩽60 (5 В)	⩽1,2	⩽5000*	—	18
BD165	Si, n-p-n, ПЭ	20	⩾3	45	5	1,5 (3*)	⩽0,1 (45 В)	⩾40 (2 В; 0,15 А)	—	⩽1	—	—	TO-126
BD167	Si, n-p-n, ПЭ	20	⩾3	60	5	1,5 (3*)	⩽0,1 (60 В)	⩾40 (2 В; 0,15 А)	—	⩽1	—	—	TO-126
BD169	Si, n-p-n, ПЭ	20	⩾3	80	5	1,5 (3*)	⩽0,1 (80 В)	⩾40 (2 В; 0,15 А)	—	⩽1	—	—	TO-126
BD813	Si, n-p-n, Э	12,5	⩾3	45	5	2 (6*)	⩽0,1 (45 В)	⩾25 (2 В; 1 А)	—	⩽0,6	—	—	SOT-128
BD815	Si, n-p-n, Э	12,5	⩾3	60	5	2 (6*)	⩽0,1 (60 В)	⩾25 (2 В; 1 А)	—	⩽0,6	—	—	SOT-128
BD817	Si, n-p-n, Э	12,5	⩾3	80	5	2 (6*)	⩽0,1 (80 В)	⩾25 (2 В; 1 А)	—	⩽0,6	—	—	SOT-128
TIP29	Si, n-p-n, ДМ	30	⩾3	40	5	1 (3*)	⩽0,2* (40 В)	⩾40 (4 В; 0,2 А)	—	⩽0,7	—	—	TO-220
TIP29A	Si, n-p-n, ДМ	30	⩾3	60	5	1 (3*)	⩽0,2* (60 В)	⩾40 (4 В; 0,2 А)	—	⩽0,7	—	—	TO-220
TIP29B	Si, n-p-n, ДМ	30	⩾3	80	5	1 (3*)	⩽0,2* (80 В)	⩾40 (4 В; 0,2 А)	—	⩽0,7	—	—	TO-220
TIP29C	Si, n-p-n, ДМ	30	⩾3	100	5	1 (3*)	⩽0,2* (100 В)	⩾40 (4 В; 0,2 А)	—	⩽0,7	—	—	TO-220
TIP61	Si, n-p-n, ДМ	15	⩾3	40	5	0,5 (1,5*)	⩽0,2* (40 В)	15...100 (4 В; 0,5 А)	—	⩽1,4	—	0,7*	TO-220
TIP61A	Si, n-p-n, ДМ	15	⩾3	60	5	0,5 (1,5*)	⩽0,2* (60 В)	15...100 (4 В; 0,5 А)	—	⩽1,4	—	0,7*	TO-220
TIP61B	Si, n-p-n, ДМ	15	⩾3	80	5	0,5 (1,5*)	⩽0,2* (80 В)	15...100 (4 В; 0,5 А)	—	⩽1,4	—	0,7*	TO-220
TIP61C	Si, n-p-n, ДМ	15	⩾3	100	5	0,5 (1,5*)	⩽0,2* (100 В)	15...100 (4 В; 0,5 А)	—	⩽1,4	—	0,7*	TO-220
КТ816А	Si, p-n-p, МПЭ	25	⩾3	40* (1 к)	5	3 (6*)	⩽0,1 (25 В)	⩾25 (2 В; 1 А)	⩽60 (10 В)	⩽0,6	—	—	18
КТ816Б	Si, p-n-p, МПЭ	25	⩾3	45* (1 к)	5	3 (6*)	⩽0,1 (45 В)	⩾25 (2 В; 1 А)	⩽60 (10 В)	⩽0,6	—	—	18
КТ816В	Si, p-n-p, МПЭ	25	⩾3	60* (1 к)	5	3 (6*)	⩽0,1 (60 В)	⩾25 (2 В; 1 А)	⩽60 (10 В)	⩽0,6	—	—	18
КТ816Г	Si, p-n-p, МПЭ	25	⩾3	100* (1 к)	5	3 (6*)	⩽0,1 (100 В)	⩾25 (2 В; 1 А)	⩽60 (10 В)	⩽0,6	—	—	18
2SB1017	Si, p-n-p, Д	25	9	80	5	4	⩽0,03 (80 В)	40...240 (5 В; 0,5 А)	130 (10 В)	⩽0,57	—	—	—
2SB996	Si, p-n-p, Д	30	9	80	5	4	⩽0,03 (80 В)	40...240 (5 В; 0,5 А)	130 (10 В)	⩽0,57	—	—	—
2SB596	Si, p-n-p, ДМ	30	⩾3	80	5	4	⩽0,03 (80 В)	40...240 (5 В; 0,5 А)	130 (10 В)	⩽0,57	⩽0,3	—	TO-220

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K,\text{т max}}$, $P^*_{K,\text{и max}}$, Вт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\max}$, $I^*_{K,\text{и max}}$, А	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мА	$h_{21Э}$	$C_к$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$r_{бэ\,нас}$, Ом, $\tau^*_к$, пс	$t_{рас}$, $t^*_{выкл}$, $t^{**}_{сп}$, мкс	Корпус
2SB595	Si, p-n-p, ДМ	40	5	100	5	5	≤0,1 (100 В)	40...240 (5 В; 1 А)	270 (10 В)	≤0,5	≤0,37	—	TO-220
2SA490	Si, p-n-p, ЭМ	25	≥3	50	5	3	≤0,01 (30 В)	40...240 (2 В; 0,5 А)	150 (10 В)	≤0,6	≤0,9	—	TO-220
2SA670	Si, p-n-p, ТД	25	≥15	50	4	3	≤0,1 (20 В)	35...200 (4 В; 1 А)	—	≤0,6	—	—	TO-220AA
2SA671	Si, p-n-p, ТД	25	≥15	50	4	3	≤0,1 (20 В)	35...200 (4 В; 1 А)	—	≤0,6	—	—	TO-220AB
BD434	Si, p-n-p, Э	36	≥3	22	5	4 (7*)	≤0,1 (22 В)	≥50 (1 В; 2 А)	—	≤0,25	—	—	TO-126
BD436	Si, p-n-p, Э	36	≥3	32	5	4 (7*)	≤0,1 (32 В)	≥50 (1 В; 2 А)	—	≤0,25	—	—	TO-126
BD438	Si, p-n-p, Э	36	≥3	45	5	4 (7*)	≤0,1 (45 В)	≥40 (1 В; 2 А)	—	≤0,3	—	—	TO-126
BD440	Si, p-n-p, Э	36	≥3	60	5	4 (7*)	≤0,1 (60 В)	≥25 (1 В; 2 А)	—	≤0,4	—	—	TO-126
BD442	Si, p-n-p, Э	36	≥3	80	5	4 (7*)	≤0,1 (80 В)	≥15 (1 В; 2 А)	—	≤0,4	—	—	TO-126
BD612	Si, p-n-p, Э	15	≥3	22	5	4 (7*)	≤0,1 (22 В)	≥50 (1 В; 2 А)	—	≤0,25	—	—	TO-202
BD614	Si, p-n-p, Э	15	≥3	32	5	4 (7*)	≤0,1 (32 В)	≥50 (1 В; 2 А)	—	≤0,25	—	—	TO-202
BD616	Si, p-n-p, Э	15	≥3	45	5	4 (7*)	≤0,1 (45 В)	≥40 (1 В; 2 А)	—	≤0,3	—	—	TO-202
BD618	Si, p-n-p, Э	15	≥3	60	5	4 (7*)	≤0,1 (60 В)	≥25 (1 В; 2 А)	—	≤0,4	—	—	TO-202
BD620	Si, p-n-p, Э	15	≥3	80	5	4 (7*)	≤0,1 (80 В)	≥15 (1 В; 2 А)	—	≤0,4	—	—	TO-202
BD934	Si, p-n-p, Э	30	≥3	45	5	3 (7*)	≤0,1 (45 В)	≥25 (2 В; 1 А)	—	≤0,6	—	0,7*	TO-220
BD936	Si, p-n-p, Э	30	≥3	60	5	3 (7*)	≤0,1 (60 В)	≥25 (2 В; 1 А)	—	≤0,6	—	0,7*	TO-220
BD938	Si, p-n-p, Э	30	≥3	100	5	3 (7*)	≤0,1 (100 В)	≥25 (2 В; 1 А)	—	≤0,6	—	0,7*	TO-220
BD234	Si, p-n-p, Э	25	≥3	45	5	2 (6*)	≤0,1 (45 В)	≥25 (2 В; 1 А)	—	≤0,6	—	0,7*	TO-126
BD236	Si, p-n-p, Э	25	≥3	60	5	2 (6*)	≤0,1 (60 В)	≥25 (2 В; 1 А)	—	≤0,6	—	0,7*	TO-126
BD238	Si, p-n-p, Э	25	≥3	100	5	2 (6*)	≤0,1 (100 В)	≥25 (2 В; 1 А)	—	≤0,6	—	0,7*	TO-126
BD176	Si, p-n-p, Э	30	≥3	45	5	3 (6*)	≤0,1 (45 В)	≥15 (2 В; 1 А)	—	≤0,8	—	—	TO-126
BD178	Si, p-n-p, Э	30	≥3	60	5	3 (6*)	≤0,1 (60 В)	≥15 (2 В; 1 А)	—	≤0,8	—	—	TO-126
BD180	Si, p-n-p, Э	30	≥3	80	5	3 (6*)	≤0,1 (80 В)	≥15 (2 В; 1 А)	—	≤0,8	—	—	TO-126
BD240	Si, p-n-p, Э	30	≥3	55	5	4	≤0,2* (45 В)	≥15 (4 В; 1 А)	—	≤0,7	—	—	TO-220
BD240A	Si, p-n-p, Э	30	≥3	70	5	4	≤0,2* (60 В)	≥15 (4 В; 1 А)	—	≤0,7	—	—	TO-220
BD240B	Si, p-n-p, Э	30	≥3	90	5	4	≤0,2* (80 В)	≥15 (4 В; 1 А)	—	≤0,7	—	—	TO-220
TIP32	Si, p-n-p, ДМ	40	≥3	40	5	3 (5*)	≤0,2* (40 В)	≥25 (4 В; 1 А)	—	≤0,4	—	—	TO-220
TIP32A	Si, p-n-p, ДМ	40	≥3	60	5	3 (5*)	≤0,2* (60 В)	≥25 (4 В; 1 А)	—	≤0,4	—	—	TO-220
TIP32B	Si, p-n-p, ДМ	40	≥3	80	5	3 (5*)	≤0,2* (80 В)	≥25 (4 В; 1 А)	—	≤0,4	—	—	TO-220
TIP32C	Si, p-n-p, ДМ	40	≥3	100	5	3 (5*)	≤0,2* (100 В)	≥25 (4 В; 1 А)	—	≤0,4	—	—	TO-220
2SA768	Si, p-n-p	30	10	60	6	4	≤1 (60 В)	≥40 (4 В; 1 А)	—	≤0,5	—	0,4	TO-220
2SA769	Si, p-n-p	30	10	80	6	4	≤1 (80 В)	≥40 (4 В; 1 А)	—	≤0,5	—	0,4	TO-220
2N5193	Si, p-n-p, ЭБ	40	≥2	40	5	4 (7*)	≤0,1 (40 В)	25...100 (2 В; 1,5 А)	150 (5 В)	≤0,3	≤0,8	0,8	TO-126
2N5194	Si, p-n-p, ЭБ	40	≥2	60	5	4 (7*)	≤0,1 (60 В)	25...100 (2 В; 1,5 А)	150 (5 В)	≤0,3	≤0,8	0,8	TO-126
2N5195	Si, p-n-p, ЭБ	40	≥2	80	5	4 (7*)	≤0,1 (80 В)	20...80 (2 В; 1,5 А)	150 (5 В)	≤0,3	≤0,8	0,8	TO-126
КТ817А	Si, n-p-n, МПЭ	25	≥3	40*	5	3 (6*)	≤0,1 (25 В)	≥25 (2 В; 1 А)	≤60 (10 В)	≤0,6	—	—	18

15 Заказ № 1141

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K,\,т\,max}$, $P^*_{K,\,и\,max}$, Вт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,\,и\,max}$, А	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мА	$h_{21Э}$	$C_к$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$r_{бэ\,нас}$, Ом, $\tau^*_к$, пс	$t_{рас}$, $t^*_{выкл}$, $t^{**}_{сп}$, мкс	Корпус
КТ817Б	Si, n-p-n, МПЭ	25	≥3	45*	5	3 (6*)	≤0,1 (45 В)	≥25 (2 В; 1 А)	≤60 (10 В)	≤0,6	—	—	18
КТ817В	Si, n-p-n, МПЭ	25	≥3	60*	5	3 (6*)	≤0,1 (60 В)	≥25 (2 В; 1 А)	≤60 (10 В)	≤0,6	—	—	18
КТ817Г	Si, n-p-n, МПЭ	25	≥3	100*	5	3 (6*)	≤0,1 (100 В)	≥25 (2 В; 1 А)	≤60 (10 В)	≤0,6	—	—	18
BD220	Si, n-p-n, ДМ	36	≥0,8	80	7	4	≤0,5* (50 В)	30...120 (4 В; 0,5 А)	—	≤2	—	≤15*	TO-220
BD221	Si, n-p-n, ДМ	36	≥0,8	60	5	4	≤10* (50 В)	30...120 (4 В; 0,1 А)	—	≤1	—	≤15*	TO-220
BD222	Si, n-p-n, ДМ	36	≥0,8	80	5	4	≤0,5* (50 В)	20...80 (4 В; 1,5 А)	—	≤0,66	—	≤15*	TO-220
BD433	Si, n-p-n, Э	36	≥3	22	5	4 (7*)	≤0,1 (22 В)	≥50 (1 В; 2 А)	—	≤0,25	—	—	TO-126
BD435	Si, n-p-n, Э	36	≥3	32	5	4 (7*)	≤0,1 (32 В)	≥50 (1 В; 2 А)	—	≤0,25	—	—	TO-126
BD437	Si, n-p-n, Э	36	≥3	45	5	4 (7*)	≤0,1 (45 В)	≥40 (1 В; 2 А)	—	≤0,3	—	—	TO-126
BD439	Si, n-p-n, Э	36	≥3	60	5	4 (7*)	≤0,1 (60 В)	≥25 (1 В; 2 А)	—	≤0,4	—	—	TO-126
BD441	Si, n-p-n, Э	36	≥3	80	5	4 (7*)	≤0,1 (80 В)	≥15 (1 В; 2 А)	—	≤0,4	—	—	TO-126
BD611	Si, n-p-n, Э	15	≥3	22	5	4 (7*)	≤0,1 (22 В)	≥50 (1 В; 2 А)	—	≤0,25	—	—	TO-202
BD613	Si, n-p-n, Э	15	≥3	32	5	4 (7*)	≤0,1 (32 В)	≥50 (1 В; 2 А)	—	≤0,25	—	—	TO-202
BD615	Si, n-p-n, Э	15	≥3	45	5	4 (7*)	≤0,1 (45 В)	≥40 (1 В; 2 А)	—	≤0,3	—	—	TO-202
BD617	Si, n-p-n, Э	15	≥3	60	5	4 (7*)	≤0,1 (60 В)	≥25 (1 В; 2 А)	—	≤0,4	—	—	TO-202
BD619	Si, n-p-n, Э	15	≥3	80	5	4 (7*)	≤0,1 (80 В)	≥15 (1 В; 2 А)	—	≤0,4	—	—	TO-202
BD933	Si, n-p-n, Э	30	≥3	45	5	3 (7*)	≤0,1 (45 В)	≥25 (2 В; 1 А)	—	≤0,6	—	1*	TO-220
BD935	Si, n-p-n, Э	30	≥3	60	5	3 (7*)	≤0,1 (60 В)	≥25 (2 В; 1 А)	—	≤0,6	—	1*	TO-220
BD937	Si, n-p-n, Э	30	≥3	100	5	3 (7*)	≤0,1 (100 В)	≥25 (2 В; 1 А)	—	≤0,6	—	1*	TO-220
2SD1406	Si, n-p-n, Д	25	3	60	7	3	≤0,1 (60 В)	≥20 (5 В; 3 А)	70 (10 В)	≤0,33	—	1,5	—
2SD1408	Si, n-p-n, Д	25	8	80	5	4	≤0,03 (80 В)	≥15 (5 В; 3 А)	90 (10 В)	≤0,5	—	—	—
BD233	Si, n-p-n, Э	25	≥3	45	5	2 (6*)	≤0,1 (45 В)	≥25 (2 В; 1 А)	—	≤0,6	—	1,1*	TO-126
BD235	Si, n-p-n, Э	25	≥3	60	5	2 (6*)	≤0,1 (60 В)	≥25 (2 В; 1 А)	—	≤0,6	—	1,1*	TO-126
BD237	Si, n-p-n, Э	25	≥3	100	5	2 (6*)	≤0,1 (100 В)	≥25 (2 В; 1 А)	—	≤0,6	—	1,1*	TO-126
BD175	Si, n-p-n, Э	30	≥3	45	5	3 (6*)	≤0,1 (45 В)	≥15 (2 В; 1 А)	—	≤0,8	—	—	TO-126
BD177	Si, n-p-n, Э	30	≥3	60	5	3 (6*)	≤0,1 (60 В)	≥15 (2 В; 1 А)	—	≤0,8	—	—	TO-126
BD179	Si, n-p-n, Э	30	≥3	80	5	3 (6*)	≤0,1 (80 В)	≥15 (2 В; 1 А)	—	≤0,8	—	—	TO-126
BD239	Si, n-p-n, Э	30	≥3	55	5	4	≤0,2* (45 В)	≥15 (4 В; 1 А)	—	≤0,7	—	—	TO-220
BD239A	Si, n-p-n, Э	30	≥3	70	5	4	≤0,2* (60 В)	≥15 (4 В; 1 А)	—	≤0,7	—	—	TO-220
BD239B	Si, n-p-n, Э	30	≥3	90	5	4	≤0,2* (80 В)	≥15 (4 В; 1 А)	—	≤0,7	—	—	TO-220
2N5190	Si, n-p-n, ЭБ	40	≥2	40	5	4 (7*)	≤0,1 (40 В)	25...100 (2 В; 1,5 А)	100 (3 В)	≤0,35	≤0,8	1	TO-126
2N5191	Si, n-p-n, ЭБ	40	≥2	60	5	4 (7*)	≤0,1 (60 В)	25...100 (2 В; 1,5 А)	100 (3 В)	≤0,35	≤0,8	1	TO-126
2N5192	Si, n-p-n, ЭБ	40	≥2	80	5	4 (7*)	≤0,1 (80 В)	20...80 (2 В; 1,5 А)	100 (3 В)	≤0,35	≤0,8	1	TO-126
2SD1354	Si, n-p-n, Д	30	3	60	7	3	≤0,1 (60 В)	≥20 (5 В; 3 А)	70 (10 В)	≤0,33	—	1,5	—
2SD1356	Si, n-p-n, Д	30	8	80	5	4	≤0,03 (80 В)	≥15 (5 В; 3 А)	90 (10 В)	≤0,5	—	—	—
TIP31	Si, n-p-n, ДМ	40	≥3	40	5	3 (5*)	≤0,2* (40 В)	≥25 (4 В; 1 А)	—	≤0,4	—	—	TO-220

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{К,т\,max}$, $P^*_{К,и\,max}$, Вт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{К\,max}$, $I^*_{К,и\,max}$, А	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мА	$h_{21Э}$	$C_к$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$r_{бэ\,нас}$, Ом, $\tau^*_к$, пс	$t_{рас}$, $t^*_{выкл}$, $t^{**}_{сп}$, мкс	Корпус
TIP31A	Si, n-p-n, ДМ	40	⩾3	60	5	3 (5*)	⩽0,2* (60 В)	⩾25 (4 В; 1 А)	—	⩽0,4	—	—	TO-220
TIP31B	Si, n-p-n, ДМ	40	⩾3	80	5	3 (5*)	⩽0,2* (80 В)	⩾25 (4 В; 1 А)	—	⩽0,4	—	—	TO-220
TIP31C	Si, n-p-n, ДМ	40	⩾3	100	5	3 (5*)	⩽0,2* (100 В)	⩾25 (4 В; 1 А)	—	⩽0,4	—	—	TO-220
2SC790	Si, n-p-n, ТД	25	⩾3	50	5	3	⩽0,01 (30 В)	40...240 (2 В; 0,5 А)	85 (10 В)	⩽0,7	—	—	TO-220
2SD234	Si, n-p-n, ТД	25	⩾3	60	10	3	⩽0,1 (40 В)	40...240 (5 В; 0,5 А)	90 (10 В)	⩽0,4	⩽0,5	—	TO-220
2SD235	Si, n-p-n, ТД	25	⩾3	50	10	3	⩽0,1 (20 В)	40...240 (5 В; 0,5 А)	90 (10 В)	⩽0,4	—	—	TO-220
2SD526	Si, n-p-n, ТД	30	⩾3	80	5	4	⩽0,03 (80 В)	40...240 (5 В; 0,5 А)	90 (10 В)	⩽0,5	—	—	TO-220
2SD880	Si, n-p-n, ТД	30	⩾3	60	7	3	⩽0,1 (60 В)	60...300 (5 В; 0,5 А)	70 (10 В)	⩽0,3	—	1,5	TO-220
2SC1826	Si, n-p-n	30	10	80	6	4	⩽1 (80 В)	⩾40 (4 В; 1 А)	—	⩽0,5	—	1,85	TO-220
2SC1827	Si, n-p-n	30	10	100	6	4	⩽1 (100 В)	⩾40 (4 В; 1 А)	—	⩽0,5	—	1,85	TO-220
2N6121	Si, n-p-n	40	⩾2,5	45	5	4	⩽0,1 (45 В)	25...100 (2 В; 1,5 А)	100 (3 В)	⩽0,4	⩽0,8	1	TO-220
2N6122	Si, n-p-n	40	⩾2,5	60	5	4	⩽0,1 (60 В)	25...100 (2 В; 1,5 А)	100 (3 В)	⩽0,4	⩽0,8	1	TO-220
2N6123	Si, n-p-n	40	⩾2,5	80	5	4	⩽0,1 (80 В)	20...80 (2 В; 1,5 А)	100 (3 В)	⩽0,4	⩽0,8	1	TO-220
КТ818А	Si, p-n-p, МПЭ	60	⩾3	40* (0,1 к)	5	10 (15*)	⩽1 (40 В)	⩾15 (5 В; 5 А)	—	⩽0,27	—	—	КТ-28
КТ818Б	Si, p-n-p, МПЭ	60	⩾3	50* (0,1 к)	5	10 (15*)	⩽1 (40 В)	⩾20 (5 В; 5 А)	—	⩽0,27	—	—	КТ-28
КТ818В	Si, p-n-p, МПЭ	60	⩾3	70* (0,1 к)	5	10 (15*)	⩽1 (40 В)	⩾15 (5 В; 5 А)	—	⩽0,27	—	—	КТ-28
КТ818Г	Si, p-n-p, МПЭ	60	⩾3	90* (0,1 к)	5	10 (15*)	⩽1 (40 В)	⩾12 (5 В; 5 А)	—	⩽0,27	—	—	КТ-28
КТ818АМ	Si, p-n-p, МПЭ	100	⩾3	40* (0,1 к)	5	15 (20*)	⩽1 (40 В)	⩾15 (5 В; 5 А)	—	⩽0,27	—	—	КТ-9
КТ818БМ	Si, p-n-p, МПЭ	100	⩾3	50* (0,1 к)	5	15 (20*)	⩽1 (40 В)	⩾20 (5 В; 5 А)	—	⩽0,27	—	—	КТ-9
КТ818ВМ	Si, p-n-p, МПЭ	100	⩾3	70* (0,1 к)	5	15 (20*)	⩽1 (40 В)	⩾15 (5 В; 5 А)	—	⩽0,27	—	—	КТ-9
КТ818ГМ	Si, p-n-p, МПЭ	100	⩾3	90* (0,1 к)	5	15 (20*)	⩽1 (40 В)	⩾12 (5 В; 5 А)	—	⩽0,27	—	—	КТ-9
BD202	Si, p-n-p, Э	60	⩾3	60	5	8 (12*)	⩽1 (40 В)	⩾30 (2 В; 3 А)	—	⩽0,33	—	—	TO-220
BD204	Si, p-n-p, Э	60	⩾3	60	5	8 (12*)	⩽1 (40 В)	⩾30 (2 В; 2 А)	—	⩽0,33	—	—	TO-220
BDX78	Si, p-n-p, Э	60	⩾3	80	5	8 (12*)	⩽1 (40 В)	⩾30 (2 В; 2 А)	—	⩽0,33	—	—	TO-220
BD292	Si, p-n-p, Э	60	⩾3	45	5	6 (10*)	⩽1 (40 В)	⩾30 (2 В; 3 А)	—	⩽0,33	—	—	SOT-82
BD294	Si, p-n-p, Э	60	⩾3	60	5	6 (10*)	⩽1 (40 В)	⩾30 (2 В; 3 А)	—	⩽0,33	—	—	SOT-82

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K,\,т\,max}$, $P^*_{K,\,и\,max}$, Вт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,\,и\,max}$, А	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мА	$h_{21Э}$	$C_к$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$r_{бэ\,нас}$, Ом, $t^*_к$, пс	$t_{рас}$, $t^*_{выкл}$, $t^{**}_{сп}$, мкс	Корпус
BD296	Si, p-n-p, Э	60	⩾3	80	5	6 (10*)	⩽1 (40 В)	⩾30 (2 В; 3 А)	—	⩽0,33	—	—	SOT-82
BDT92	Si, p-n-p, Э	90	⩾4	60	7	10 (20*)	⩽0,1 (60 В)	20...200 (4 В; 4 А)	—	⩽0,3	—	—	TO-220
BDT94	Si, p-n-p, Э	90	⩾4	80	7	10 (20*)	⩽0,1 (80 В)	20...200 (4 В; 4 А)	—	⩽0,3	—	—	TO-220
BDT96	Si, p-n-p, Э	90	⩾4	100	7	10 (20*)	⩽0,1 (100 В)	20...200 (4 В; 4 А)	—	⩽0,3	—	—	TO-220
BDV92	Si, p-n-p, Э	90	⩾4	60	5	10 (20*)	⩽0,1 (60 В)	⩾20 (4 В; 4 А)	—	⩽0,3	—	1,5*	SOT-93
BDV94	Si, p-n-p, Э	90	⩾4	80	5	10 (20*)	⩽0,1 (80 В)	⩾20 (4 В; 4 А)	—	⩽0,3	—	1,5*	SOT-93
BDV96	Si, p-n-p, Э	90	⩾4	100	5	10 (20*)	⩽0,1 (100 В)	⩾20 (4 В; 4 А)	—	⩽0,3	—	1,5*	SOT-99
BDX92	Si, p-n-p, Э	90	⩾4	60	5	8 (12*)	⩽0,1 (60 В)	⩾10 (2 В; 5 А)	—	⩽0,2	—	2*	TO-3
BDX94	Si, p-n-p, Э	90	⩾4	80	5	8 (12*)	⩽0,1 (80 В)	⩾10 (2 В; 5 А)	—	⩽0,2	—	2*	TO-3
BDX96	Si, p-n-p, Э	90	⩾4	100	5	8 (12*)	⩽0,1 (100 В)	⩾10 (2 В; 5 А)	—	⩽0,2	—	2*	TO-3
2N6246	Si, p-n-p, Э	125	⩾5	70	5	15	⩽0,2 (55 В)	20...100 (4 В; 7 А)	—	⩽0,18	—	—	TO-3
2N6247	Si, p-n-p, Э	125	⩾5	90	5	15	⩽0,2 (75 В)	20...100 (4 В; 6 А)	—	⩽0,2	—	—	TO-3
2N6248	Si, p-n-p, Э	125	⩾5	110	5	10	⩽0,2 (95 В)	20...100 (4 В; 5 А)	—	⩽0,26	—	—	TO-3
2N6469	Si, p-n-p, Э	125	⩾5	50	5	15	⩽0,2 (35 В)	20...150 (4 В; 5 А)	—	⩽0,23	—	—	TO-3
BD950	Si, p-n-p, Э	40	⩾3	60	5	5 (8*)	⩽0,1 (60 В)	⩾20 (4 В; 2 А)	—	⩽0,5	—	0,4*	TO-220
BD952	Si, p-n-p, Э	40	⩾3	80	5	5 (8*)	⩽0,1 (80 В)	⩾20 (4 В; 2 А)	—	⩽0,5	—	0,4*	TO-220
BD954	Si, p-n-p, Э	40	⩾3	100	5	5 (8*)	⩽0,1 (100 В)	⩾20 (4 В; 2 А)	—	⩽0,5	—	0,4*	TO-220
BD534	Si, p-n-p, ЭБ	50	⩾3	45	5	8	⩽0,1 (45 В)	⩾25 (2 В; 2 А)	—	⩽0,4	⩽0,75	—	TO-220
BD536	Si, p-n-p, ЭБ	50	⩾3	60	5	8	⩽0,1 (60 В)	⩾25 (2 В; 2 А)	—	⩽0,4	⩽0,75	—	TO-220
BD538	Si, p-n-p, ЭБ	50	⩾3	80	5	8	⩽0,1 (80 В)	⩾15 (2 В; 2 А)	—	⩽0,4	⩽0,75	—	TO-220
BD664	Si, p-n-p, ЭБ	75	⩾3	45	5	10	⩽0,1 (45 В)	15...150 (2 В; 3 А)	—	⩽0,33	⩽0,37	4	TO-220
BD706	Si, p-n-p, ЭБ	75	⩾3	45	5	12	⩽0,1 (45 В)	20...150 (4 В; 4 А)	—	⩽0,25	⩽0,37	—	TO-220
BD708	Si, p-n-p, ЭБ	75	⩾3	60	5	12	⩽0,1 (60 В)	15...150 (4 В; 4 А)	—	⩽0,25	⩽0,37	—	TO-220
BD710	Si, p-n-p, ЭБ	75	⩾3	80	5	12	⩽0,1 (80 В)	15...150 (4 В; 4 А)	—	⩽0,25	⩽0,37	—	TO-220
BD712	Si, p-n-p, ЭБ	75	⩾3	100	5	12	⩽0,1 (100 В)	15...150 (4 В; 4 А)	—	⩽0,25	⩽0,37	—	TO-220
BDW22	Si, p-n-p, ЭБ	90	⩾3	45	5	10 (15*)	⩽0,1* (45 В)	15...150 (4 В; 4 А)	—	⩽0,25	⩽0,37	—	TO-3
BDW22A	Si, p-n-p, ЭБ	90	⩾3	60	5	10 (15*)	⩽0,1* (60 В)	15...150 (4 В; 4 А)	—	⩽0,25	⩽0,37	—	TO-3
BDW22B	Si, p-n-p, ЭБ	90	⩾3	80	5	10 (15*)	⩽0,1* (80 В)	15...150 (4 В; 4 А)	—	⩽0,25	⩽0,37	—	TO-3
BDW22C	Si, p-n-p, ЭБ	90	⩾3	100	5	10 (15*)	⩽0,1* (100 В)	15...150 (4 В; 4 А)	—	⩽0,25	⩽0,37	—	TO-3
BDW52	Si, p-n-p, ЭБ	125	⩾3	45	5	15 (20*)	⩽0,5 (45 В)	20...150 (4 В; 5 А)	250 (10 В)	⩽0,3	⩽0,3	0,3	TO-3
BDW52A	Si, p-n-p, ЭБ	125	⩾3	60	5	15 (20*)	⩽0,5 (60 В)	20...150 (4 В; 5 А)	250 (10 В)	⩽0,3	⩽0,3	0,3	TO-3

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K,т\ max}$, $P^*_{K,и\ max}$, Вт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^*_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ проб}$, В	$I_{K\ max}$, $I^*_{K,и\ max}$, А	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мА	$h_{21Э}$	$C_к$, пФ	$r_{кэ\ нас}$, Ом	$r_{бэ\ нас}$, Ом, $\tau^*_к$, пс	$t_{рас}$, $t^*_{выкл}$, $t^{**}_{сп}$, мкс	Корпус
BDW52B	Si, p-n-p, ЭБ	125	≥3	80	5	15 (20*)	≤0,5 (80 В)	20...150 (4 В; 5 А)	250 (10 В)	≤0,3	≤0,3	0,3	ТО-3
BDW52C	Si, p-n-p, ЭБ	125	≥3	100	5	15 (20*)	≤0,5 (100 В)	20...150 (4 В; 5 А)	250 (10 В)	≤0,3	≤0,3	0,3	ТО-3
BDX18	Si, p-n-p, ЭБ	117	≥4	100	7	15	≤5** (90 В)	20...70 (4 В; 4 А)	—	≤0,27	≤0,45	—	ТО-3
2N6107	Si, p-n-p, ЭБ	40	≥10	80	5	7	≤0,1* (80 В)	30...150 (4 В; 4 А)	≤250 (10 В)	≤0,5	≤0,75	—	ТО-220
2N6109	Si, p-n-p, ЭБ	40	≥10	60	5	7	≤0,1* (60 В)	30...150 (4 В; 2,5 А)	≤250 (10 В)	≤0,4	≤0,6	—	ТО-220
2N6111	Si, n-p-n, ЭБ	40	≥10	40	5	7	≤0,1* (40 В)	30...150 (4 В; 3 А)	≤250 (10 В)	≤0,33	≤0,5	—	ТО-220
2SB754	Si, n-p-n, ЭБ	60	10	50	5	7	≤0,01 (50 В)	≥30 (1 В; 4 А)	300 (10 В)	≤0,1	≤0,3	—	ТО-220
2SB1016	Si, p-n-p, Д	30	5	100	5	5	≤0,1 (100 В)	≥20 (5 В; 4 А)	270 (10 В)	≤0,5	—	—	ТО-220
2SB1018	Si, p-n-p, Д	30	10	100	5	7	≤0,005 (100 В)	≥30 (1 В; 4 А)	250 (10 В)	≤0,12	≤0,35	—	ТО-220
2SB1019	Si, p-n-p, Д	30	10	70	5	7	≤0,03 (70 В)	≥30 (1 В; 4 А)	250 (10 В)	≤0,1	≤0,3	2,5	ТО-220
2SB553	Si, p-n-p, Э	40	10	70	5	7	≤0,03 (70 В)	≥30 (1 В; 4 А)	250 (10 В)	≤0,1	≤0,3	2,5	ТО-220
2N6132	Si, p-n-p, Э	50	≥2,5	40	5	7	≤0,5 (40 В)	20...100 (4 В; 2,5 А)	—	≤0,2	—	—	ТО-220
2N6133	Si, p-n-p, Э	50	≥2,5	60	5	7	≤0,5 (60 В)	20...100 (4 В; 2,5 А)	—	≤0,2	—	—	ТО-220
2N6134	Si, p-n-p, Э	50	≥2,5	80	5	7	≤0,5 (80 В)	20...100 (4 В; 2,5 А)	—	≤0,24	—	—	ТО-220
2SB558	Si, p-n-p, ТД	60	7	100	6	7	≤0,1 (50 В)	≥15 (5 В; 5 А)	220 (10 В)	≤0,5	—	—	ТО-3
КТ819А	Si, n-p-n, МПЭ	60	≥3	40* (0,1 к)	5	10 (15*)	≤1 (40 В)	≥15 (5 В; 5 А)	—	≤0,4	—	—	КТ-28
КТ819Б	Si, n-p-n, МПЭ	60	≥3	50* (0,1 к)	5	10 (15*)	≤1 (40 В)	≥20 (5 В; 5 А)	—	≤0,4	—	—	КТ-28
КТ819В	Si, n-p-n, МПЭ	60	≥3	70* (0,1 к)	5	10 (15*)	≤1 (40 В)	≥15 (5 В; 5 А)	—	≤0,4	—	—	КТ-28
КТ819Г	Si, n-p-n, МПЭ	60	≥3	100* (0,1 к)	5	10 (15*)	≤1 (40 В)	≥12 (5 В; 5 А)	—	≤0,4	—	—	КТ-28
КТ819АМ	Si, n-p-n, МПЭ	100	≥3	40* (0,1 к)	5	15 (20*)	≤1 (40 В)	≥15 (5 В; 5 А)	—	≤0,4	—	—	КТ-9
КТ819БМ	Si, n-p-n, МПЭ	100	≥3	50* (0,1 к)	5	15 (20*)	≤1 (40 В)	≥20 (5 В; 5 А)	—	≤0,4	—	—	КТ-9
КТ818ВМ	Si, n-p-n, МПЭ	100	≥3	70* (0,1 к)	5	15 (20*)	≤1 (40 В)	≥15 (5 В; 5 А)	—	≤0,4	—	—	КТ-9
КТ819ГМ	Si, n-p-n, МПЭ	100	≥3	100* (0,1 к)	5	15 (20*)	≤1 (40 В)	≥12 (5 В; 5 А)	—	≤0,4	—	—	КТ-9
BD201	Si, n-p-n, Э	60	≥3	60	5	8 (12*)	≤1 (40 В)	≥30 (2 В; 3 А)	—	≤0,33	—	—	ТО-220
BD203	Si, n-p-n, Э	60	≥3	60	5	8 (12*)	≤1 (40 В)	≥30 (2 В; 2 А)	—	≤0,33	—	—	ТО-220
BDX77	Si, n-p-n, Э	60	≥3	100	5	8 (12*)	≤1 (40 В)	≥30 (2 В; 2 А)	—	≤0,33	—	—	ТО-220
BD181	Si, n-p-n, Д	117	≥0,015**	45*	7	15*	—	20...70 (4 В; 3 А)	—	—	—	—	ТО-3
BD182	Si, n-p-n, Д	117	≥0,015**	60*	7	15*	—	20...70 (4 В; 4 А)	—	—	—	—	ТО-3
BD183	Si, n-p-n, Д	117	≥0,015**	80*	7	15*	—	20...70 (4 В; 4 А)	—	—	—		
2N3055	Si, n-p-n, М	115	≥0,8	100	7	15	≤5* (100 В)	20...70 (4 В; 4 А)	—	≤0,275	—	2,7	ТО-3

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{К,\,т\,max}$, $P^*_{К,\,и\,max}$, Вт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{К\,max}$, $I^*_{К,\,и\,max}$, А	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мА	$h_{21Э}$	$C_к$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$r_{бэ\,нас}$, Ом, $\tau^*_к$, пс	$t_{рас}$, $t^*_{выкл}$, $t^{**}_{сп}$, мкс	Корпус
2N3055E	Si, n-p-n, ЭБ	115	≥2,5	100	7	15	≤1* (100 В)	20...70 (4 В; 4 А)	—	≤0,3	≤0,37	—	TO-3
NJE3055	Si, n-p-n, ЭБ	70	≥2	70	5	10	≤1 (70 В)	20...70 (4 В; 4 А)	—	≤0,275	—	—	TO-220
BD291	Si, n-p-n, Э	60	≥3	45	5	6 (10*)	≤1 (40 В)	≥30 (2 В; 3 А)	—	≤0,33	—	—	SOT-82
BD293	Si, n-p-n, Э	60	≥3	60	5	6 (10*)	≤1 (40 В)	≥30 (2 В; 3 А)	—	≤0,33	—	—	SOT-82
BD142	Si, n-p-n, МД	117	≥0,8	50	7	15	≤2 (40 В)	12...160 (4 В; 4 А)	—	≤0,27	—	—	TO-3
BD533	Si, n-p-n, ЭБ	50	≥3	45	5	8	≤0,1 (45 В)	≥25 (2 В; 2 А)	—	≤0,4	—	—	TO-220
BD535	Si, n-p-n, ЭБ	50	≥3	60	5	8	≤0,1 (60 В)	≥25 (2 В; 2 А)	—	≤0,4	—	—	TO-220
BD537	Si, n-p-n, ЭБ	50	≥3	80	5	8	≤0,1 (80 В)	≥15 (2 В; 2 А)	—	≤0,4	—	—	TO-220
BD663	Si, n-p-n, ЭБ	75	≥3	45	5	10	≤0,1* (45 В)	15...150 (2 В; 3 А)	—	≤0,33	≤0,37	—	TO-220
BD705	Si, n-p-n, ЭБ	75	≥3	45	5	12	≤0,1 (45 В)	20...150 (4 В; 4 А)	—	≤0,25	≤0,37	—	TO-220
BD707	Si, n-p-n, ЭБ	75	≥3	60	5	12	≤0,1 (60 В)	15...150 (4 В; 4 А)	—	≤0,25	≤0,37	—	TO-220
BD709	Si, n-p-n, ЭБ	75	≥3	80	5	12	≤0,1 (80 В)	15...150 (4 В; 4 А)	—	≤0,25	≤0,37	—	TO-220
BD711	Si, n-p-n, ЭБ	75	≥3	100	5	12	≤0,1 (100 В)	15...150 (4 В; 4 А)	—	≤0,25	≤0,37	—	TO-220
BDW21	Si, n-p-n, ЭБ	90	≥3	45	5	10 (15*)	≤0,1* (45 В)	15...150 (4 В; 4 А)	—	≤0,25	≤0,37	—	TO-3
BDW21A	Si, n-p-n, ЭБ	90	≥3	60	5	10 (15*)	≤0,1 (60 В)	15...150 (4 В; 4 А)	—	≤0,25	≤0,37	—	TO-3
BDW21B	Si, n-p-n, ЭБ	90	≥3	80	5	10 (15*)	≤0,1 (80 В)	15...150 (4 В; 4 А)	—	≤0,25	≤0,37	—	TO-3
BDW21C	Si, n-p-n, ЭБ	90	≥3	100	5	10 (15*)	≤0,1 (100 В)	15...150 (4 В; 4 А)	—	≤0,25	≤0,37	—	TO-3
BDW51	Si, n-p-n, ЭБ	125	≥3	45	5	15 (20*)	≤0,5 (45 В)	20...150 (4 В; 5 А)	150 (10 В)	≤0,3	≤0,25	0,3	TO-3
BDW51A	Si, p-n-p, ЭБ	125	≥3	60	5	15 (20*)	≤0,5 (60 В)	20...150 (4 В; 5 А)	150 (10 В)	≤0,3	≤0,25	—	TO-3
BDW51B	Si, p-n-p, ЭБ	125	≥3	80	5	15 (20*)	≤0,5 (80 В)	20...150 (4 В; 5 А)	150 (10 В)	≤0,3	≤0,25	—	TO-3
BDW51C	Si, n-p-n, ЭБ	125	≥3	100	5	15 (20*)	≤0,5 (100 В)	20...150 (4 В; 5 А)	150 (10 В)	≤0,3	≤0,25	—	TO-3
BDX10	Si, n-p-n, Д	115	≥0,8	100	7	15	≤5* (100 В)	20...70 (4 В; 4 А)	—	≤0,25	≤0,37	—	TO-3
BDX10C	Si, n-p-n, Д	115	≥0,8	80	7	15	≤5* (80 В)	≥12 (4 В; 4 А)	—	≤0,25	≤0,37	—	TO-3
BDX13	Si, n-p-n, Д	117	≥0,8	50	5	15	≤2 (40 В)	15...60 (4 В; 8 А)	—	≤0,18	≤0,27	—	TO-3
BDX71	Si, n-p-n, Д	75	≥0,015**	70	8	10	≤2* (65 В)	20...80 (4 В; 4 А)	—	≤0,25	≤0,42	—	TO-220
BDX73	Si, n-p-n, Д	75	≥0,015**	80	8	10	≤2* (75 В)	20...80 (4 В; 4 А)	—	≤0,25	≤0,42	—	TO-220
2SD716	Si, n-p-n, ДМ	60	12	100	5	6	≤0,1 (100 В)	55...160 (5 В; 1 А)	100 (10 В)	≤0,5	—	—	
2SD843	Si, n-p-n	40	10	100	5	7	≤0,005 (100 В)	≥30 (1 В; 4 А)	250 (10 В)	≤0,13	≤0,35	2,5	TO-3
BD953	Si, n-p-n, Э	40	≥3	100	5	5 (8)	≤0,1 (100 В)	≥20 (4 В; 2 А)	—	≤0,5	—	1,5*	TO-220
2N5490	Si, n-p-n, Д	50	≥0,8	60	5	7	≤2* (40 В)	20...100 (4 В; 2 А)	—	≤0,455	—	≤15	TO-220
2N6253	Si, n-p-n, Д	115	≥0,8	55	5	15	≤2** (55 В)	20...70 (4 В; 3 А)	—	≤0,33	—	—	TO-3
2N5492	Si, n-p-n, Д	50	≥0,8	75	5	7	≤0,5* (55 В)	20...100 (4 В; 2,5 А)	—	≤0,455	—	—	TO-220
2N6371	Si, n-p-n, Д	117	≥0,8	50	5	15	≤2** (45 В)	15...60 (4 В; 8 А)	—	≤1,9	—	—	TO-3
2N5494	Si, n-p-n, Д	50	≥0,8	60	5	7	≤0,5* (40 В)	20...100 (4 В; 3 А)	—	≤0,455	—	—	TO-220

Продолжение

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K,\,т\,max}$, $P^*_{K,\,и\,max}$, Вт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,\,и\,max}$, А	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мА	$h_{21Э}$	$C_к$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$r_{бэ\,нас}$, Ом, $\tau^*_к$, пс	$t_{рас}$, $t^*_{выкл}$, $t^{**}_{сп}$, мкс	Корпус
2N5496	Si, n-p-n, Д	50	⩾0,8	90	5	7	⩽0,5* (70 В)	20...100 (4 В; 3,5 А)	—	⩽0,285	—	—	TO-220
2N6099	Si, n-p-n, Д	75	⩾0,8	70	8	10	—	20...80 (4 В; 4 А)	—	—	—	—	TO-220
2N6101	Si, n-p-n, Д	75	⩾0,8	80	8	10	—	20...80 (4 В; 5 А)	—	—	—	—	TO-220
2N6288	Si, n-p-n, Э	40	⩾4	40	5	7	⩽0,1* (35 В)	30...150 (4 В; 3 А)	⩽250 (10 В)	⩽0,33	—	—	TO-220
2N6289	Si, n-p-n, Э	40	⩾4	40	5	7	⩽0,1* (35 В)	30...150 (4 В; 3 А)	⩽250 (10 В)	⩽0,33	—	—	TO-220
2N6290	Si, n-p-n, Э	40	⩾4	60	5	7	⩽0,1* (55 В)	30...150 (4 В; 2,5 А)	⩽250 (10 В)	⩽0,5	—	—	TO-220
2N6291	Si, n-p-n, Э	40	⩾4	60	5	7	⩽0,1* (55 В)	30...150 (4 В; 2,5 А)	⩽250 (10 В)	⩽0,5	—	—	TO-220
2N6292	Si, n-p-n, Э	40	⩾4	80	5	7	⩽0,1* (75 В)	30...150 (4 В; 2 А)	⩽250 (10 В)	⩽0,5	—	—	TO-220
2N6293	Si, n-p-n, Э	40	⩾4	80	5	7	⩽0,1* (75 В)	30...150 (4 В; 2 А)	⩽250 (10 В)	⩽0,5	—	—	TO-220
2N6470	Si, n-p-n, Э	125	⩾5	50	5	15	⩽0,5* (35 В)	20...150 (4 В; 5 А)	—	⩽0,26	—	—	TO-3
2N6471	Si, n-p-n, Э	125	⩾5	70	5	15	⩽0,5* (55 В)	20...150 (4 В; 5 А)	—	⩽0,26	—	—	TO-3
2N6472	Si, n-p-n, Э	125	⩾5	90	5	15	⩽0,5* (75 В)	20...150 (4 В; 5 А)	—	⩽0,26	—	—	TO-3
2N6129	Si, n-p-n, Д	50	⩾2,5	40	5	7	⩽0,5 (40 В)	20...100 (4 В; 2,5 А)	—	⩽0,2	—	—	TO-220
2N6130	Si, n-p-n, Д	50	⩾2,5	60	5	7	⩽0,5 (60 В)	20...100 (4 В; 2,5 А)	—	⩽0,2	—	—	TO-220
2N6131	Si, n-p-n, Д	50	⩾2,5	80	5	7	⩽0,5 (80 В)	20...100 (4 В; 2,5 А)	—	⩽0,24	—	—	TO-220
TIP41	Si, n-p-n, ДМ	65	⩾3	40	5	6 (10*)	⩽0,4* (40 В)	15...75 (4 В; 3 А)	—	⩽0,25	—	—	TO-220
TIP41A	Si, n-p-n, ДМ	65	⩾3	60	5	6 (10*)	⩽0,4* (60 В)	15...75 (4 В; 3 А)	—	⩽0,25	—	—	TO-220
TIP41B	Si, n-p-n, ДМ	65	⩾3	80	5	6 (10*)	⩽0,4* (80 В)	15...75 (4 В; 3 А)	—	⩽0,25	—	—	TO-220
TIP41C	Si, n-p-n, ДМ	65	⩾3	100	5	6 (10*)	⩽0,4* (100 В)	15...75 (4 В; 3 А)	—	⩽0,25	—	—	TO-220
BDY20	Si, n-p-n, Э	115	1	100	7	15	⩽5 (100 В)	20...70 (4 В; 4 А)	250 (20 В)	⩽0,3	—	2	TO-3
BDY38	Si, n-p-n, Э	115	1	50	7	6 (8*)	⩽1 (50 В)	⩾30 (4 В; 2 А)	250 (20 Б)	⩽0,25	—	—	TO-3
BDY73	Si, n-p-n, Э	117	⩾0,8	100	7	15	⩽5** (100 В)	50...150 (4 В; 4 А)	—	⩽0,37	—	—	TO-3
BD295	Si, n-p-n, Э	60	⩾3	80	5	6 (10*)	⩽1 (40 В)	⩾30 (2 В; 3 А)	—	⩽0,33	—	—	SOT-82
BDT91	Si, n-p-n, Э	90	⩾4	60	7	10 (20*)	⩽0,1 (60 В)	20...200 (4 В; 4 А)	—	⩽0,3	—	—	TO-220
BDT93	Si, n-p-n, Э	90	⩾4	80	7	10 (20*)	⩽0,1 (80 В)	20...200 (4 В; 4 А)	—	⩽0,3	—	—	TO-220
BDT95	Si, n-p-n, Э	90	⩾4	100	7	10 (20*)	⩽0,1 (100 В)	20...200 (4 В; 4 А)	—	⩽0,3	—	—	TO-220
BDV91	Si, n-p-n, Э	90	⩾4	60	5	10 (20*)	⩽0,1 (60 В)	⩾20 (4 В; 4 А)	—	⩽0,3	—	1,5*	SOT-93
BDV93	Si, n-p-n, Э	90	⩾4	80	5	10 (20*)	⩽0,1 (80 В)	⩾20 (4 В; 4 А)	—	⩽0,3	—	1,5*	SOT-93
BDV95	Si, n-p-n, Э	90	⩾4	100	5	10 (20*)	⩽0,1 (100 В)	⩾20 (4 В; 4 А)	—	⩽0,3	—	1,5*	SOT-93
BDX91	Si, n-p-n, Э	90	⩾4	60	5	8 (12*)	⩽0,1 (60 В)	⩾10 (2 В; 5 А)	—	⩽0,2	—	2*	TO-3
BDX93	Si, n-p-n, Э	90	⩾4	80	5	8 (12*)	⩽0,1 (80 В)	⩾10 (2 В; 5 А)	—	⩽0,2	—	2*	TO-3

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K, т\ max}$, $P^*_{K, и\ max}$, Вт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, МГц	$U_{ЭБО\ проб}$, $U^*_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ проб}$, В	$I_{K\ max}$, $I^*_{K, и\ max}$, А	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мА	$h_{21Э}$	$C_к$, пФ	$r_{кэ\ нас}$, Ом	$r_{бэ\ нас}$, Ом, $\tau^*_к$, пс	$t_{рас}$, $t^*_{выкл}$, $t^{**}_{сп}$, мкс	Корпус
BDX95	Si, n-p-n, Э	90	≥4	100	5	8 (12*)	≤0,1 (100 В)	≥10 (2 В; 5 А)	—	≤0,2	—	2*	ТО-3
BD949	Si, n-p-n, Э	40	≥3	60	5	5 (8*)	≤0,1 (60 В)	≥20 (4 В; 2 А)	—	≤0,5	—	1,5*	ТО-220
BD951	Si, n-p-n, Э	40	≥3	80	5	5 (8*)	≤0,1 (80 В)	≥20 (4 В; 2 А)	—	≤0,5	—	1,5*	ТО-220
КТ933А	Si, p-n-p, ПЭ	5 (50°С)	≥75	80	4,5	0,5	≤0,5 (80 В)	≥15 (3 В; 0,4 А)	≤70 (20 В)	≤3,75	—	—	19
КТ933Б	Si, p-n-p, ПЭ	5 (50°С)	≥75	60	4,5	0,5	≤0,5 (60 В)	≥30 (3 В; 0,4 А)	≤70 (20 В)	≤3,75	—	—	19
BFX30	Si, p-n-p, ПЭ	3,5	≥100	65	5	0,6	≤0,5 (65 В)	≥10 (0,4 В; 0,15 А)	≤12 (10 В)	—	≤9	≤0,25	ТО-39
2N4030	Si, p-n-p, ПЭ	4	≥100	60	5	1	≤0,05 (50 В)	≥25 (5 В; 0,5 А)	≤20 (10 В)	—	—	≤0,35	ТО-5
2N4031	Si, p-n-p, ПЭ	4	≥100	80	5	1	≤0,05 (60 В)	≥25 (5 В; 0,5 А)	≤20 (10 В)	—	—	≤0,35	ТО-5
2N4036	Si, p-n-p, ПЭ	7	≥60	90	7	1	≤0,1 (90 В)	≥20 (10 В; 0,5 А)	≤30 (10 В)	≤4	—	≤0,6	ТО-39
2N4037	Si, p-n-p, ПЭ	7	≥60	60	7	1	≤0,25 (90 В)	≥15 (10 В; 1 А)	≤30 (10 В)	≤9	—	≤0,6	ТО-39
2N4314	Si, p-n-p, ПЭ	7	≥60	90	7	1	≤0,25 (90 В)	≥15 (10 В; 1 А)	≤30 (10 В)	≤9	—	≤0,6	ТО-39
BC160-6	Si, p-n-p, ПЭ	5	≥50	40	5	1	≤0,1* (40 В)	40...100 (1 В; 0,1 А)	≤30 (10 В)	≤14	—	—	ТО-39
BC161-6	Si, p-n-p, ПЭ	5	≥50	60	5	1	≤0,1* (40 В)	40...100 (1 В; 0,1 А)	≤30 (10 В)	≤14	—	—	ТО-39
2SA537	Si, p-n-p, Э	5	≥100	60	5	0,7	≤0,001 (30 В)	30...160 (4 В; 50 мА)	≤35 (10 В)	≤3,3	≤7	≤0,35*	ТО-39
2SA504	Si, p-n-p, Э	6	≥50	80	5	0,6	≤0,005 (60 В)	30...300 (2 В; 0,15 А)	≤30 (10 В)	≤3,3	—	0,45	ТО-39
BC139	Si, p-n-p, ПЭ	3	100	40	5	0,5	≤0,05 (30 В)	≥40 (10 В; 0,1 А)	10	≤2,6	≤2	—	ТО-5
BC143	Si, p-n-p, ПЭ	4	100	60	5	1	≤0,05 (30 В)	≥20 (1 В; 0,3 А)	20	≤1	—	—	ТО-5
BFX29	Si, p-n-p, ПЭ	3,5	≥100	60	5	0,6	≤0,5 (60 В)	≥40 (10 В; 0,15 А)	≤12 (10 В)	≤2,6	≤9	≤0,15*	ТО-39
BFX87	Si, p-n-p, ПЭ	4	≥100	50	4	0,6	≤0,5 (50 В)	≥25 (10 В; 0,5 А)	≤12 (10 В)	≤2,6	≤9	≤0,15*	ТО-39
BFX88	Si, p-n-p, ПЭ	4	≥100	40	4	0,6	≤0,5 (40 В)	≥25 (10 В; 0,5 А)	≤12 (10 В)	≤2,6	≤9	≤0,15*	ТО-39
КТ838А	Si, n-p-n, МП	12,5 (90°С)	≥3	1500 (имп)	5...7	5 (7,5*)	≤1* (1500 В)	4 (5 В; 3,5 А)	≤170 (10 В)	≤1,1	—	≤10; ≤1,5**	КТ-9
BU205	Si, n-p-n, Д	10 (90°С)	7,5	1500 (имп)	5...7	2,5 (3*)	≤1* (1500 В)	≥2 (5 В; 2А)	≤80 (10 В)	≤3,75	—	0,75**	ТО-3
BU204	Si, n-p-n, Д	10 (90°С)	7,5	1300 (имп)	5	2,5 (3*)	≤1* (1300 В)	≥2 (5 В; 2А)	≤80 (10 В)	≤3,75	—	0,75**	ТО-3
BU207	Si, n-p-n, Д	12,5 (95°С)	7	1300 (имп)	5	5 (7,5*)	≤1* (1300 В)	≥2 (5 В; 2А)	≤125 (10 В)	≤1,1	—	10	ТО-3
BU208	Si, n-p-n, Д	12,5 (95°С)	≥1	1500 (имп)	5...7	5 (7,5*)	≤1* (1500 В)	≥2,25 (5 В; 4,5 А)	≤125 (10 В)	≤1,1	—	10	ТО-3
BU207A	Si, n-p-n, Д	12,5 (95°С)	7	1500 (имп)	—	5 (7,5*)	≤1* (1500 В)	≥2,25 (5 В; 4,5 А)	≤125 (10 В)	≤1,1	—	10	ТО-3
КТ835А	Si, p-n-p, МПЭ	25	≥1	30	4	3	≤0,1 (30 В)	≥25 (1 В; 1 А)	≤800 (10 В)	≤0,35	≤1,3	—	КТ-28
КТ835Б	Si, p-n-p, МПЭ	25	≥1	45	4	7,5	≤0,15 (45 В)	10...100 (5 В; 2 А)	≤800 (10 В)	≤0,8	≤1,5	—	КТ-28

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K,т\,max}$, $P^*_{K,т\,max}$, Вт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,и\,max}$, А	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мА	$h_{21Э}$	$C_к$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$r_{бэ\,нас}$, Ом, $\tau^*_к$, пс	$t_{рас}$, $t^*_{выкл}$, $t^{**}_{сп}$, мкс	Корпус
2SB834	Si, p-n-p, П	30	9	60	7	3	≤0,1 (60 В)	≥20 (5 В; 3 А)	150 (10 В)	≤0,33	≤2**	—	TO-220
2SB906	Si, p-n-p, Э	20	9	60	7	3	≤0,1 (60 В)	≥20 (5 В; 3 А)	150 (10 В)	≤0,57	≤3**	—	TO-220
2N6011	Si, p-n-p, Э	40	≥10	40	5	7	≤0,1 (35 В)	30...150 (4 В; 3 А)	≤250 (10 В)	≤0,33	—	—	TO-220
КТ837А	Si, p-n-p, ЭД	30	≥1	80	15	7,5	≤0,15 (80 В)	10...40 (5 В; 2 А)	—	≤0,8	—	—	КТ-28
КТ837Б	Si, p-n-p, ЭД	30	≥1	80	15	7,5	≤0,15 (80 В)	20...80 (5 В; 2 А)	—	≤0,8	—	—	КТ-28
КТ837В	Si, p-n-p, ЭД	30	≥1	80	15	7,5	≤0,15 (80 В)	50...150 (5 В; 2 А)	—	≤0,8	—	—	КТ-28
КТ837Г	Si, p-n-p, ЭД	30	≥1	60	15	7,5	≤0,15 (60 В)	10...40 (5 В; 2 А)	—	≤0,3	—	—	КТ-28
КТ837Д	Si, p-n-p, ЭД	30	≥1	60	15	7,5	≤0,15 (60 В)	20...80 (5 В; 2 А)	—	≤0,3	—	—	КТ-28
КТ837Е	Si, p-n-p, ЭД	30	≥1	60	15	7,5	≤0,15 (60 В)	50...150 (5 В; 2 А)	—	≤0,3	—	—	КТ-28
КТ837Ж	Si, p-n-p, ЭД	30	≥1	45	15	7,5	≤0,15 (45 В)	10...40 (5 В; 2 А)	—	≤0,25	—	—	КТ-28
КТ837И	Si, p-n-p, ЭД	30	≥1	45	15	7,5	≤0,15 (45 В)	20...80 (5 В; 2 А)	—	≤0,25	—	—	КТ-28
КТ837К	Si, p-n-p, ЭД	30	≥1	45	15	7,5	≤0,15 (45 В)	50...150 (5 В; 2 А)	—	≤0,25	—	—	КТ-28
КТ837Л	Si, p-n-p, ЭД	30	≥1	80	5	7,5	≤0,15 (80 В)	10...40 (5 В; 2 А)	—	≤0,8	—	—	КТ-28
КТ837М	Si, p-n-p, ЭД	30	≥1	80	5	7,5	≤0,15 (80 В)	20...80 (5 В; 2 А)	—	≤0,8	—	—	КТ-28
КТ837Н	Si, p-n-p, ЭД	30	≥1	80	5	7,5	≤0,15 (80 В)	50...150 (5 В; 2 А)	—	≤0,8	—	—	КТ-28
КТ837П	Si, p-n-p, ЭД	30	≥1	60	5	7,5	≤0,15 (60 В)	10...40 (5 В; 2 А)	—	≤0,3	—	—	КТ-28
КТ837Р	Si, p-n-p, ЭД	30	≥1	60	5	7,5	≤0,15 (60 В)	20...80 (5 В; 2 А)	—	≤0,3	—	—	КТ-28
КТ837С	Si, p-n-p, ЭД	30	≥1	60	5	7,5	≤0,15 (60 В)	50...150 (5 В; 2 А)	—	≤0,3	—	—	КТ-28
КТ837Т	Si, p-n-p, ЭД	30	≥1	45	5	7,5	≤0,15 (45 В)	10...40 (5 В; 2 А)	—	≤0,25	—	—	КТ-28
КТ837У	Si, p-n-p, ЭД	30	≥1	45	5	7,5	≤0,15 (45 В)	20...80 (5 В; 2 А)	—	≤0,25	—	—	КТ-28
КТ837Ф	Si, p-n-p, ЭД	30	≥1	45	5	7,5	≤0,15 (45 В)	50...150 (5 В; 2 А)	—	≤0,25	—	—	КТ-28
BD944	Si, p-n-p, Э	40	≥3	22	5	5 (8*)	≤0,1 (22 В)	≥50 (1 В; 2 А)	—	≤0,25	—	—	TO-220
BD946	Si, p-n-p, Э	40	≥3	32	5	5 (8*)	≤0,1 (32 В)	≥50 (1 В; 2 А)	—	≤0,25	—	—	TO-220
BD948	Si, p-n-p, Э	40	≥3	45	5	5 (8*)	≤0,1 (45 В)	≥40 (1 В; 2 А)	—	≤0,35	—	—	TO-220
2N6124	Si, p-n-p, Д	40	≥2,5	45	5	4	≤0,1 (45 В)	25...100 (2 В; 1,5 А)	—	≤0,4	—	—	TO-220
2N6125	Si, p-n-p, Д	40	≥2,5	60	5	4	≤0,1 (60 В)	25...100 (2 В; 1,5 А)	—	≤0,4	—	—	TO-220
2N6126	Si, p-n-p, Д	40	≥2,5	80	5	4	≤0,1 (80 В)	20...80 (2 В; 1,5 А)	—	≤0,4	—	—	TO-220
BD223	Si, p-n-p, Д	36	≥0,8	70	7	4	≤0,5* (50 В)	30...120 (4 В; 0,5 А)	—	≤2	—	≤15*	TO-220
BD224	Si, p-n-p, Д	36	≥0,8	40	7	4	≤10* (50 В)	30...120 (4 В; 1 А)	—	≤1	—	≤15*	TO-220
BD225	Si, p-n-p, Д	36	≥0,8	60	7	4	≤0,5 (50 В)	20...80 (4 В; 1,5 А)	—	≤0,66	—	≤15*	TO-220
2SB434	Si, p-n-p, ТД	25	10	50	5	3	≤0,01 (30 В)	15...60 (5 В; 2,5 А)	150 (10 В)	≤0,4	≤1,8**	—	TO-220
2SB434G	Si, p-n-p, ТД	25	3	60	5	3	≤0,01 (40 В)	20...90 (5 В; 1 А)	150 (10 В)	≤0,4	≤0,5**	—	TO-220
2SB435	Si, p-n-p, ТД	25	10	40	5	3	≤0,01 (30 В)	≥15 (1 В; 2,5 А)	150 (10 В)	≤1	≤1,8**	—	TO-220
2SB435G	Si, p-n-p, ТД	25	3	50	5	3	≤0,01 (40 В)	≥20 (1 В; 1 А)	150 (10 В)	≤1	≤1,5**	—	TO-220
КТ840А	Si, n-p-n, П	60	≥8	400* (900 имп)	5	6 (8*)	≤3 (900 В)	10...60 (5 В; 0,6 А)	—	≤0,75	≤0,4	≤0,6**; ≤3,5	КТ-9
КТ840Б	Si, n-p-n, П	60	≥8	350* (750 имп)	5	6 (8*)	≤3 (750 В)	≥10 (5 В; 0,6 А)	—	≤0,75	≤0,4	≤0,6**; ≤3,5	КТ-9
BU326	Si, n-p-n, П	60 (50°С)	6	(800 имп)	5	6 (8*)	≤1 (800** В)	30 (5 В; 0,6 А)	—	≤0,75	—	≤3,5	TO-3

16 Заказ № 1141

Тип прибора	Материал, структура, технология,	$P_{K,т\,max}$, $P^*_{K,и\,max}$, Вт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,и\,max}$, А	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мА	$h_{21Э}$	$С_к$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$r_{бэ\,нас}$, Ом, $\tau^*_к$, пс	$t_{рас}$, $t^*_{выкл}$, $t^{**}_{сп}$, мкс	Корпус
BU326A	Si, n-p-n, П	60 (50°C)	6	900 (имп)	5	6(8*)	⩽1** (900 В)	30 (5 В; 0,6 А)	—	⩽0,75	—	⩽3,5	ТО-3
BU606	Si, p-n-p, ПЭ	90	⩾10	400	6	7 (10*)	⩽5* (400 В)	35 (5 В; 0,6 А)	—	⩽0,2	⩽0,24	⩽0,75*	ТО-3
BU607	Si, n-p-n, ПЭ	90	⩾10	330	6	7 (10*)	⩽5* (330 В)	35 (5 В; 0,6 А)	—	⩽0,2	⩽0,24	⩽0,75*	ТО-3
BU608	Si, n-p-n, ПЭ	90	⩾10	400	6	7 (10*)	⩽5* (400 В)	35 (5 В; 0,6 А)	—	⩽0,17	⩽0,25	⩽0,4*	ТО-3
BUY18S	Si, n-p-n, ПЭ	50	30	400	6	7 (10*)	⩽0,01 (200 В)	⩾20 (5 В; 1 А)	55 (50 В)	⩽0,15	⩽0,27	⩽1*	ТО-3
2N5838	Si, n-p-n, Э	100	⩾5	275	6	3 (5*)	⩽2** (200 В)	⩾20 (5 В; 0,5 А)	⩽150 (10 В)	⩽0,33	⩽0,66	⩽3	ТО-3
2N5839	Si, n-p-n, Э	100	⩾5	300	6	3 (5*)	⩽2** (250 В)	⩾20 (5 В; 0,5 А)	⩽150 (10 В)	⩽0,75	⩽0,66	⩽3,75	ТО-3
2N5840	Si, n-p-n, Э	100	⩾5	375	6	3 (5*)	⩽2** (250 В)	⩾20 (5 В; 0,5 А)	⩽150 (10 В)	⩽0,75	⩽0,66	⩽3	ТО-3
КТ932А	Si, p-n-p, ПЭ	20 (50°C)	⩾30	80	4,5	2	⩽1,5* (80 В)	⩾15 (3 В; 1,5 А)	⩽200 (20 В)	⩽1	—	—	КТ-9
КТ932Б	Si, p-n-p, ПЭ	20 (50°C)	⩾50	60	4,5	2	⩽1,5* (60 В)	⩾30 (3 В; 1,5 А)	⩽200 (20 В)	⩽1	—	—	КТ-9
КТ932В	Si, p-n-p, ПЭ	20 (50°C)	⩾30	40	4,5	2	⩽1,5* (40 В)	⩾40 (3 В; 1,5 А)	⩽200 (20 В)	⩽1	—	—	КТ-9
BD132	Si, p-n-p, ПЭ	15 (60°C)	⩾60	45	4	3 (6*)	⩽0,005 (50 В)	⩾20 (1 В; 2 А)	⩽60 (5 В)	⩽0,35	⩽0,75	—	ТО-126
2N3740	Si, p-n-p, ДМ	25	⩾3	60	7	1	⩽0,1 (60 В)	⩾10 (1 В; 1 А)	⩽100 (10 В)	⩽0,6	—	—	ТО-66
2N3741	Si, p-n-p, ДМ	25	⩾3	80	7	1	⩽0,1 (80 В)	⩾10 (1 В; 1 А)	⩽100 (10 В)	⩽0,6	—	—	ТО-66
2D4898	Si, p-n-p, ДМ	25	⩾3	40	5	1	⩽0,1 (40 В)	⩾10 (1 В; 1 А)	⩽100 (10 В)	⩽0,6	⩽1,3	—	ТО-66
2N4899	Si, p-n-p, ДМ	25	⩾3	60	5	1	⩽0,1 (60 В)	⩾10 (1 В; 1 А)	⩽100 (10 В)	⩽0,6	⩽1,3	—	ТО-66
2N4900	Si, p-n-p, ДМ	25	⩾3	80	5	1	⩽0,1 (80 В)	⩾10 (1 В; 1 А)	⩽100 (10 В)	⩽0,6	⩽1,3	—	ТО-66
2N6180	Si, p-n-p, ТД	25	⩾50	100	7	2	⩽0,0005 (80 В)	⩾10 (2 В; 1 А)	⩽40 (10 В)	⩽1,4	⩽2,4	⩽1**	ТО-126
2N6181	Si, p-n-p, ТД	25	⩾50	75	5	2	⩽0,0005 (60 В)	40...250 (2 В; 0,5 А)	⩽40 (10 В)	⩽2,4	⩽3	⩽1**	ТО-126
2SA755A	Si, p-n-p, ТД	25	50	50	4	2	⩽0,1 (20 В)	35...70 (4 В; 1 А)	—	⩽0,9	—	—	ТО-220
2SA755B	Si, p-n-p, ТД	20	50	50	4	2	⩽0,1 (20 В)	60...120 (4 В; 1 А)	—	⩽0,9	—	—	ТО-220
2SB551H	Si, p-n-p, ТД	25	⩾15	50	4	3	⩽0,1 (20 В)	35...200 (4 В; 1 А)	—	⩽0,6	—	—	ТО-66
КТ943А	Si, n-p-n, МП	25	⩾30	45	5	2 (6*)	⩽0,1 (45 В)	40...220 (2 В; 0,15 А)	—	⩽0,6	—	—	18
КТ943Б	Si, n-p-n, МП	25	⩾30	60	5	2 (6*)	⩽0,1 (60 В)	40...160 (2 В; 0,15 А)	—	⩽0,6	—	—	18
КТ943В	Si, n-p-n, МП	25	⩾30	100	5	2 (6*)	⩽0,1 (100 В)	40...120 (2 В; 0,15 А)	—	⩽0,6	—	—	18
КТ943Г	Si, n-p-n, МП	25	⩾30	100	5	2 (6*)	⩽1 (100 В)	20...60 (2 В; 0,15 А)	—	⩽1,2	—	—	18
КТ943Д	Si, n-p-n, МП	25	⩾30	100	5	2 (6*)	⩽1 (100 В)	30...100 (2 В; 0,15 А)	—	⩽1,2	—	—	18

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{К,\,т\,max}$, $P^*_{К,\,и\,max}$, Вт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{К\,max}$, $I^*_{К,\,и\,max}$, А	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мА	$h_{21Э}$	$C_к$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$r_{бэ\,нас}$, Ом, $\tau^*_к$, пс	$t_{рас}$, $t^*_{выкл}$, $t^{**}_{сп}$, мкс	Корпус
BDY34	Si, n-p-n, ПЭ	21 (45°C)	≥80	45	5,5	3	≤0,1 (40 В)	30...300 (2 В; 0,2 А)	≤70 (10 В)	0,45	≤0,65*	≤1**	ТО-126
BD131	Si, n-p-n, ПЭ	15	≥60	70	6	3 (6*)	≤0,005 (50 В)	≥40 (12 В; 0,5 А)	≤60 (5 В)	≤0,8	—	—	ТО-126
BD226	Si, n-p-n, ПЭ	12	≥60	45	5	1,5	0,1	40...250 (2 В; 0,15 А)	—	≤0,8	—	—	ТО-126
BD228	Si, n-p-n, ПЭ	12	≥60	50	5	1,5	—	40...160 (2 В; 0,15 А)	—	≤0,8	—	—	ТО-126
BD230	Si, n-p-n, ПЭ	12	≥60	100	5	1,5	—	40...160 (2 В; 0,15 А)	—	≤0,8	—	—	ТО-126
BD375	Si, n-p-n, ПЭ	25	≥50	50	5	2	0,1	≥20 (4 В; 1 А)	—	≤1	—	—	ТО-126
BD377	Si, n-p-n, ПЭ	25	≥50	75	5	2	—	≥20 (4 В; 1 А)	—	≤1	—	≤0,05**	ТО-126
BD379	Si, n-p-n, ПЭ	25	≥50	100	5	2	—	≥30 (4 В; 0,5 А)	—	≤1	—	≤0,05**	ТО-126
BD135-6	Si, n-p-n, ПЭ	12,5	≥50	45	5	1,5 (2*)	≤0,1 (30 В)	40...100 (2 В; 0,15 А)	—	≤1	—	≤0,05**	ТО-126
BD137-6	Si, n-p-n, ПЭ	12,5	≥50	60	5	1,5 (2*)	≤0,1 (30 В)	40...100 (2 В; 0,15 А)	—	≤1	—	—	ТО-126
BD139-6	Si, n-p-n, ПЭ	12,5	≥50	100*	5	1,5 (2*)	≤0,1 (30 В)	40...100 (2 В; 0,15 А)	—	≤1	—	—	ТО-126
2SC1173	Si, n-p-n, Э	10	100	30	5	3	≤0,001 (20 В)	70...240 (2 В; 0,5 А)	35 (10 В)	≤0,4	—	—	ТО-220
2SC1624	Si, n-p-n, П	15	≥10	120	5	1	≤0,001 (50 В)	70...240 (5 В; 0,15 А)	20 (10 В)	≤1	—	—	ТО-220
2SC1625	Si, n-p-n, П	15	≥10	100	5	1	≤0,01 (50 В)	70...240 (5 В; 0,15 А)	20 (10 В)	≤1	—	—	ТО-220
2SC2794	Si, n-p-n	25	40	60	5	2	≤0,001 (60 В)	40...240 (2 В; 0,15 А)	45 (10 В)	≤0,6	—	—	ТО-126
2N6178	Si, n-p-n, ТД	25	≥50	100	7	2	≤1** (60 В)	30...130 (2 В; 0,5 А)	≤20 (10 В)	≤1	≤2,4	≤0,8*	Пластм.
2N6179	Si, n-p-n, ТД	25	≥50	75	5	2	≤0,0005 (60 В)	40...250 (2 В; 0,5 А)	≤20 (10 В)	≤1,6	≤3	≤0,8*	Пластм.
КТ809А	Si, n-p-n, МП	40 (50°C)	≥5,1	400* (0,01 к)	4	3 (5*)	≤3 (400 В)	15...100 (5 В; 2 А)	≤150 (20 В)	≤0,75	—	≤4	37
2N3584	Si, n-p-n, Д	35	≥10	375	6	2 (5*)	≤1** (340 В)	25...100 (10 В; 1 А)	≤120 (10 В)	≤0,75	—	4	ТО-66
2N3738	Si, n-p-n, Д	20	≥10	250	6	3	≤0,1 (250 В)	≥25 (10 В; 0,25 А)	≤20 (100 В)	≤10	—	—	ТО-66
2N3739	Si, n-p-n, Д	20	≥10	325	6	3	≤0,1 (325 В)	≥25 (10 В; 0,25 А)	≤20 (100 В)	≤10	—	—	ТО-66
BLY49	Si, n-p-n, Д	40	≥15	250	8	3 (5*)	≤0,05 (40 В)	30...100 (10 В; 1 А)	≤200 (20 В)	≤0,75	—	≤1,55	ТО-3
BLY49A	Si, n-p-n, Д	40	≥15	250	8	3 (5*)	≤0,05 (40 В)	30...100 (10 В; 1 А)	≤200 (20 В)	≤0,75	—	≤1,55	ТО-66
BLY50	Si, n-p-n, Д	40	≥15	250	8	3 (5*)	≤0,05 (40 В)	60...200 (10 В; 1 А)	≤200 (20 В)	≤0,75	—	≤1,55	ТО-3
BLY50A	Si, n-p-n, Д	40	≥15	250	8	3 (5*)	≤0,05 (40 В)	60...200 (10 В; 1 А)	≤200 (20 В)	≤0,75	—	≤1,55	ТО-66
BU120	Si, n-p-n, М	50 (75°C)	10	400	6	4 (6*)	—	≥10 (10 В; 2 А)	—	≤0,7	—	—	ТО-3
BD216	Si, n-p-n, Д	21,5 (75°C)	≥10	300	6	1	—	40...15 0 (10 В; 0,1 А)	—	≤0,7	—	—	MD-17
BU129	Si, n-p-n, Д	25	10	400	10	5	—	≥20 (1,5 В; 1,5А)	—	≤0,6	—	≤2	ТО-3
BD253	Si, n-p-n, Д	50	≥15	350	8	3 (6*)	≤2 (350 В)	≥15 (4 В; 1 А)	—	≤1,2	—	—	ТО-3
2SC825	Si, n-p-n, Д	30	15	300	6	2	≤0,02 (10 В)	75 (10 В; 0,5 А)	—	≤0,8	—	—	ТО-66
2SC779	Si, n-p-n, М	25	≥10	300	6	2	≤0,1 (200 В)	30...200 (10 В; 0,1 А)	≤80 (10 В)	≤2	—	≤4	ТО-66
2SC1504	Si, n-p-n, Д	40	10	400	6	2	≤1 (400 В)	≥20 (4 В; 1 А)	—	≤1	—	9	ТО-3
КТ808А	Si, n-p-n, МП	50 (50°C)	≥7,2	120* (250 имп)	4	10	≤3* (120 В)	10...50 (3 В; 6 А)	≤500 (10 В)	—	—	≤2	37

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K, т\ max}$, $P^*_{K, и\ max}$, Вт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^*_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ проб}$, В	$I_{K\ max}$, $I^*_{K,\ и\ max}$, А	$I_{КЭО}$, $I^*_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мА	$h_{21Э}$	$C_к$, пФ	$r_{кэ\ нас}$, Ом	$r_{бэ\ нас}$, Ом, $\tau^*_к$, пс	$t_{рас}$, $t^*_{выкл}$, $t^{**}_{сп}$, мкс	Корпус
КТ808АМ	Si, n-p-n, МП	50 (50°C)	≥7	120* (250 имп)	4	10	≤3* (120 В)	10...50 (3 В; 6 А)	≤500 (10 В)	—	—	≤2	КТ-9
КТ808БМ	Si, n-p-n, МП	50 (50°C)	≥7	100* (160 имп)	4	10	≤3* (100 В)	10...50 (3 В; 6 А)	≤500 (10 В)	—	—	≤2	КТ-9
КТ808ВМ	Si, n-p-n, МП	50 (50°C)	≥7	80* (135 имп)	4	10	≤60 (150 В)	10...50 (3 В; 6 А)	≤500 (10 В)	—	—	≤2	КТ-9
КТ808ГМ	Si, n-p-n, МП	50 (50°C)	≥7	70* (80 имп)	4	10	≤3* (70 В)	10...50 (3 В; 6 А)	≤500 (10 В)	—	—	≤2	КТ-9
2N4913	Si, n-p-n, Д	87,5	≥4	40	5	5 (15*)	≤1** (40 В)	≥7 (2 В; 5 А)	50 (40 В)	≤0,3	—	1,2*	ТО-3
2N4914	Si, n-p-n, Д	875	≥4	60	5	5 (15*)	≤1** (60 В)	≥7 (2 В; 5 А)	50 (40 В)	≤0,3	—	1,2*	ТО-3
2N4915	Si, n-p-n, Д	87,5	≥4	80	5	5 (15*)	≤1** (80 В)	≥7 (2 В; 5 А)	50 (40 В)	≤0,3	—	1,2*	ТО-3
BLY47	Si, n-p-n, М	40	≥15	100	8	3 (5*)	≤0,05 (40 В)	30...100 (10 В; 1 А)	≤200 (20 В)	≤0,75	—	≤1,55	ТО-3
BLY47A	Si, n-p-n, М	40	≥15	100	8	3 (5*)	≤0,05 (40 В)	30...100 (10 В; 1 А)	≤200 (20 В)	≤0,75	—	≤1,55	ТО-66
BLY48	Si, n-p-n, М	40	≥15	100	8	3 (5*)	≤0,05 (40 В)	60...200 (10 В; 1 А)	≤200 (20 В)	≤0,75	—	≤1,55	ТО-3
BLY48A	Si, n-p-n, М	40	≥15	100	8	3 (5*)	≤0,05 (40 В)	60...200 (10 В; 1 А)	≤200 (20 В)	≤0,75	—	≤1,55	ТО-66
2N5427	Si, n-p-n, Д	40	≥30	80	6	7	≤0,01 (80 В)	≥20 (2 В; 5 А)	≤250 (10 В)	≤0,35	—	≤2	ТО-66
2N5429	Si, n-p-n, Д	40	≥30	100	6	7	≤0,01 (100 В)	≥20 (2 В; 5 А)	≤250 (10 В)	≤0,35	—	≤2	ТО-66
BUY55	Si, n-p-n, Д	60 (75°C)	≥10	150	6	10 (15*)	≤1 (150 В)	≥8 (1,5 В; 7 А)	≤200 (10 В)	≤0,2	—	1,2	ТО-3
2SD201	Si, n-p-n, Д	50	≥4	90	6	6	≤0,05 (40 В)	≥20 (4 В; 3 А)	—	≤0,5	—	2,4	ТО-3
2SD202	Si, n-p-n, Д	50	≥4	110	6	6	≤0,03 (40 В)	≥20 (4 В; 3 А)	—	≤0,5	—	2,4	ТО-3
2SD203	Si, n-p-n, Д	50	≥4	130	6	6	≤0,03 (40 В)	≥20 (4 В; 3 А)	—	≤0,5	—	2,4	ТО-3
2SC1113	Si, n-p-n, МЭ	40	10	120	6	6	≤1 (120 В)	≥30 (4 В; 5 А)	—	≤0,3	—	3,4	ТО-66
2SC1144	Si, n-p-n	50	10	80	6	6	≤1 (80 В)	≥30 (4 В; 1 А)	—	≤0,5	—	3,4	ТО-66
2SC1145	Si, n-p-n	50	10	100	6	6	≤1 (100 В)	≥30 (4 В; 1 А)	—	≤0,5	—	3,4	ТО-66
2SD867	Si, n-p-n	100	1,5	130	7	10	≤0,1 (130 В)	≥20 (5 В; 5 А)	200 (10В)	≤0,3	≤0,5	4	ТО-3
KU606	Si, n-p-n, М	50 (80°C)	12	120	5	8	≤1 (50 В)	≥5 (10 В; 0,5 А)	≤750 (10 В)	≤0,35	—	$t_{вр}$ ≤1,5	ТО-3
KD602	Si, n-p-n, Д	35	≥0,5	110	5	10	—	15...50 (10 В; 0,5 А)	—	—	—	—	ТО-3
BDY24	Si, n-p-n, Д	87,5	≥10	100	10	6	—	15...180 (4 В; 2 А)	—	≤0,3	—	—	ТО-3
2SC1618	Si, n-p-n, ДМ	50	10	80	6	6	≤1 (80 В)	≥20 (4 В; 3 А)	—	≤0,5	—	3,4	ТО-3
2SC1619	Si, n-p-n, ДМ	50	10	100	6	6	≤1 (100 В)	≥20 (4 В; 3 А)	—	≤0,5	—	3,4	ТО-3
2SC1619A	Si, n-p-n, ДМ	50	10	120	6	6	≤1 (120 В)	≥20 (4 В; 3 А)	—	≤0,5	—	3,4	ТО-3
BDY71	Si, n-p-n, Д	29	≥0,8	90	7	4	≤1** (90 В)	80...200 (4 В; 0,5 А)	—	≤2	—	—	ТО-66
2N6372	Si, n-p-n, Э	40	≥4	50	5	6	≤0,1* (35 В)	20...100 (4 В; 3 А)	—	≤0,33	—	—	ТО-66
2N6373	Si, n-p-n, Э	40	≥4	70	5	6	≤0,1* (55 В)	≥5 (4 В; 6 А)	—	≤0,33	—	—	ТО-66
2N6374	Si, n-p-n, Э	40	≥4	90	5	6	≤0,1* (75 В)	≥5 (4 В; 6 А)	—	≤0,33	—	—	ТО-66

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K, т\ max}$, $P^*_{K, и\ max}$, Вт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^*_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ проб}$, В	$I_{K\ max}$, $I^*_{K, и\ max}$, А	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мА	$h_{21Э}$	$C_к$, пФ	$r_{кэ\ нас}$, Ом	$r_{бэ\ нас}$, Ом, $\tau^*_к$, пс	$t_{рас}$, $t^*_{выкл}$, $t^{**}_{сп}$, мкс	Корпус
КТ802А	Si, n-p-n, МП	50	≥10; ≥20	150; 180	3; 5	5	≤60 (150 В)	≥15 (10 В; 2 А)	—	≤1	—	—	37
2N5050	Si, n-p-n, Д	40	≥10	125	6	2	≤0,5* (125 В)	≥5 (5 В; 2 А)	≤250 (10 В)	≤2,5	—	≤3,5	ТО-66
2N5051	Si, n-p-n, Д	40	≥10	150	6	2	≤0,5* (150 В)	≥5 (5 В; 2 А)	≤250 (10 В)	≤2,5	—	≤3,5	ТО-66
2N5052	Si, n-p-n, Д	40	≥10	200	6	2	≤0,5* (200 В)	≥5 (5 В; 2 А)	≤250 (10 В)	≤2,5	—	≤3,5	ТО-66
2N6263	Si, n-p-n, Д	20	≥0,8	140	7	3	≤5** (100 В)	20...100 (4 В; 0,5 А)	—	≤2,4	—	—	ТО-66
2N6264	Si, n-p-n, Д	50	≥0,8	170	7	3	≤1** (130 В)	20...60 (2 В; 1 А)	—	≤0,5	—	—	ТО-66
BDX25	Si, n-p-n, П	34 (45°C)	30	130	5	5 (10*)	≤0,1 (130 В)	≥20 (2 В; 3 А)	70 (10 В)	≤0,5	—	—	MD-17
BUYP52	Si, n-p-n, П	50	≥10	120	5	5	—	≥10 (5 В; 0,5 А)	—	≤0,7	—	—	ТО-3
BUYP53	Si, n-p-n, П	50	≥10	80	5	5	—	≥20 (5 В; 0,5 А)	—	≤0,7	—	—	ТО-3
BDY72	Si, n-p-n, МП	25	≥0,8	150	7	3	≤1* (130 В)	60...180 (4 В; 0,5 А)	—	≤2	—	—	ТО-66
2SC41	Si, n-p-n, М	50	≥10*	150	6	5	≤60 (150 В)	12...92 (10 В; 1 А)	≤350 (20 В)	2	—	—	ТО-3
2SC42	Si, n-p-n, М	50	≥8*	150	6	5	≤60 (150 В)	4...185 (10 В; 1 А)	≤350 (20 В)	2	—	—	ТО-3
2SC43	Si, n-p-n, М	50	≥8*	100	6	5	≤60 (100 В)	4...185 (10 В; 1 А)	≤350 (20 В)	2	—	—	ТО-3
BU123	Si, n-p-n, Д	50	10	180	8	5	—	25...250 (5 В; 1 А)	—	≤0,7	—	—	ТО-3
2SC508	Si, n-p-n, Д	20	25	180	5	4	≤0,12 (50 В)	≥20 (5 В; 4 А)	—	≤0,5	—	—	ТО-66
2SC519A	Si, n-p-n, Д	50	≥5	130	5	7	≤1 (50 В)	≥30 (5 В; 1 А)	≤250 (50 В)	≤0,4	—	3	ТО-3
2SC520A	Si, n-p-n, Д	50	≥5	100	5	7	≤1 (50 В)	≥30 (5 В; 1 А)	≤250 (50 В)	≤0,4	—	3	ТО-3
2SC1111	Si, n-p-n, Д	50	10	140	6	6	≤1 (140 В)	≥30 (4 В; 3 А)	—	≤0,5	—	2,8	ТО-3
2SC1112	Si, n-p-n, Д	50	10	160	6	6	≤1 (160 В)	≥30 (4 В; 3 А)	—	≤0,5	—	2,8	ТО-3
2SD877	Si, n-p-n	25	3	110	7	3	≤0,1 (110 В)	≥20 (5 В; 2,5 А)	85 (10 В)	≤0,33	≤0,5	5	ТО-66
2N3441	Si, n-p-n, Д	25	1	160	7	3 (4*)	≤0,1 (140 В)	20...80 (4 В; 0,5 А)	—	2	—	—	ТО-66
БDY79	Si, n-p-n, М	25	≥8	150	7	4	≤1 (150 В)	25...100 (4 В; 0,5 А)	—	≤1	—	—	ТО-66
КТ803А	Si, n-p-n, П	60 (50°C)	≥20	60* (0,1 к)	4	10	≤5* (70 В)	10...70 (10 В; 5 А)	≤250 (20 В)	≤0,5	—	≤0,19*	37
2N3054A	Si, n-p-n, Д	75	≥3	60	7	4 (10*)	≤0,5* (30 В)	≥5 (4 В; 3 А)	60 (10 В)	≤2	—	≤0,3	ТО-66
2N5067	Si, n-p-n, Д	87,5	≥4	40	5	5	≤1 (40 В)	≥7 (2 В; 5 А)	60 (20 В)	≤0,3	—	0,25	ТО-3
2N5068	Si, n-p-n, Д	87,5	≥4	60	5	5	≤1 (60 В)	≥7 (2 В; 5 А)	60 (20 В)	≤0,3	—	0,25	ТО-3
2N5069	Si, n-p-n, Д	87,5	≥4	80	5	5	≤1 (80 В)	≥7 (2 В; 5 А)	60 (20 В)	≤0,3	—	0,25	ТО-3
KD601	Si, n-p-n, ПЭ	35 (45°C)	≥10	40	5	10	≤10** (24 В)	—	—	≤0,24	—	—	ТО-3
2N1702	Si, n-p-n, Д	75	1	60	6	5	≤0,2 (30 В)	15...60 (4 В; 0,8 А)	≤200 (40 В)	≤4	—	—	MD-6
BDY23	Si, n-p-n, П	87,5	≥10	60	10	6	—	15...180 (4 В; 2 А)	—	≤0,5	—	—	ТО-3
MJ480	Si, n-p-n, Д	87,5	≥4	40	5	4 (7*)	≤1 (40 В)	≥10 (2 В; 3 А)	≤200 (10 В)	≤0,4	—	—	ТО-3
MJ481	Si, n-p-n, Д	87,5	≥4	60	5	4 (7*)	≤1 (60 В)	≥10 (2 В; 3 А)	≤200 (10 В)	≤0,4	—	—	ТО-3
2SC44	Si, n-p-n, М	50	≥8*	50	6	5	≤60 (50 В)	4...185 (10 В; 1 А)	≤350 (20 В)	—	—	—	ТО-3
2SC793	Si, n-p-n, Д	60	9	80	5	7	≤1 (30 В)	30...200 (5 В; 1 А)	—	≤0,46	—	—	ТО-3
2SC521A	Si, n-p-n, Д	50	≥5	70	5	7	≤1 (50 В)	≥30 (5 В; 1 А)	≤250 (50 В)	≤0,4	—	3	ТО-3
2SC493	Si, n-p-n, М	50	10	80	5	5	10	20...200 (5 В; 1 А)	—	≤0,5	—	—	ТО-3
BUYP54	Si, n-p-n, П	50	≥10	40	5	5	—	≥20 (5 В; 0,5 А)	—	≤0,7	—	—	ТО-3

Тип прибора	Материал, структура технология	$P_{K,\tau\,max}$, $P^*_{K,и\,max}$, Вт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,и\,max}$, А	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мА	$h_{21Э}$	$C_к$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$r_{бэ\,нас}$, Ом, $\tau^*_к$, пс	$t_{рас}$, $t^*_{выкл}$, $t^{**}_{сп}$, мкс	Корпус
КТ908А	Si, n-p-n, МП	50 (50°C)	⩾30	100* (0,01 к)	5	10	⩽25* (100 В)	8...60 (2 В; 10 А)	⩽400 (25 В)	⩽0,15	—	—	37
КТ908Б	Si, n-p-n, МП	50 (50°C)	⩾30	60* (0,25 к)	5	10	⩽50* (60 В)	⩾20 (4 В; 4 А)	⩽400 (30 В)	⩽0,25	—	—	37
BDY92	Si, n-p-n, П	40 (75°C)	⩾40	80	6	10 (15*)	⩽3** (80 В)	30...120 (5 А)	—	⩽0,1	—	1,3	TO-3
2N4301	Si, n-p-n, ПЭ	50 (100°C)	⩾30	100	8	10 (20*)	⩽0,01* (90 В)	⩾15 (4 В; 10 А)	—	⩽0,1	—	1,5*	TO-61
2N5313	Si, n-p-n, П	50 (100°C)	⩾30	80	6	10	—	30...90 (5 В; 10 А)	⩽500	⩽0,15	—	—	TO-61
2N5315	Si, n-p-n, П	50 (100°C)	⩾30	100	6	10	—	30...90 (5 В; 10 А)	⩽500	⩽0,15	—	—	TO-61
2D5317	Si, n-p-n, П	50 (100°C)	⩾30	80	6	10	—	30...90 (5 В; 5 А)	⩽500	⩽0,15	—	—	TO-61
2N5319	Si, n-p-n, П			100	6	10	—	30...90 (5 В; 5 А)	⩽500	⩽0,15	—	—	TO-61
2SD47	Si, n-p-n, М	50	20	100	6	5	15	12...184 (10 В; 1 А)	—	0,6	—	—	TO-3
SDT3207	Si, n-p-n, ПЭ	50	⩾30	80	6	10	—	30...90 (5 В; 5 А)	—	—	—	—	TO-61
SDT3208	Si, n-p-n, ПЭ	50	⩾30	100	6	10	—	30...90 (5 В; 5 А)	—	—	—	—	TO-61
SDT7012	Si, n-p-n, П	50	⩾15	80	5	10	—	20...60 (5 В; 5 А)	—	—	—	—	TO-61
SDT7013	Si, n-p-n, П	50	⩾15	100	5	10	—	20...60 (5 В; 5 А)	—	—	—	—	TO-61
2N2811	Si, n-p-n, П	70	⩾15	80	8	10	0,1	20...60 (5 В; 5 А)	⩽350	⩽0,15	—	—	MT-29
2N2813	Si, n-p-n, П	70	⩾15	100	8	10	0,1	20...60 (5 В; 5 А)	⩽350	⩽0,15	—	—	MT-29
BUX77	Si, n-p-n, ПЭ	40	⩾15	100	6	5	⩽2* (100 В)	⩾30 (5 В; 5 А)	—	⩽0,2	⩽0,26	⩽0,5	TO-66
2N3878	Si, n-p-n, Э	35	⩾60	120	7	7 (10*)	⩽4** (100 В)	⩾20 (5 В; 4 А)	⩽175 (10 В)	⩽0,5	—	—	TO-66
2N3879	Si, n-p-n, Э	35	⩾60	75**	7	7 (10*)	⩽5** (40 В)	20...80 (5 В; 4 А)	⩽175 (10 В)	⩽0,3	—	⩽0,8	TO-66
2N5202	Si, n-p-n, Э	35	⩾60	120	7	4 (5*)	⩽5** (40 В)	10...100 (1,2 В; 4 А)	⩽175 (10 В)	⩽0,3	—	⩽0,8	TO-66
КТ812А	Si, n-p-n, МП	50 (50°C)	⩾3	400* (0,01 к)	7	8 (12*)	⩽5* (700 В)	⩾4 (2,5 В; 8 А)	—	⩽0,3	⩽0,3	—	КТ-9
КТ812Б	Si, n-p-n, МП	50 (50°C)	⩾3	300* (0,01 к)	7	8 (12*)	⩽5* (500 В)	⩾4 (2,5 В; 8 А)	—	⩽0,3	⩽0,3	—	КТ-9
КТ812В	Si, n-p-n, МП	50 (50°C)	⩾3	200* (0,01 к)	7	8 (12*)	⩽5* (300 В)	⩾10 (5 В; 5 А)	—	⩽0,3	⩽0,3	—	КТ-9
2N5239	Si, n-p-n, Э	100	⩾5	300	6	5	⩽4** (300 В)	⩾5 (10 В; 4,5 А)	⩽150 (10 В)	⩽1,5	—	—	TO-3
2N5240	Si, n-p-n, Э	100	⩾5	375	6	5	⩽2** (375 В)	⩾5 (10 В; 4,5 А)	—	⩽1,5	—	—	TO-3
2N6077	Si, n-p-n, Э	45	⩾1	300	6	7	⩽5** (250 В)	⩾12 (1 В; 1,2 А)	⩽150 (10 В)	⩽0,33	—	—	TO-66
2N6078	Si, n-p-n, Э	45	⩾1	275	6	7	⩽0,05* (250 В)	⩾12 (1 В; 1,2 А)	—	⩽0,6	—	—	TO-66
2N6079	Si, n-p-n, Э	45	⩾1	375	9	7	⩽0,5 (450 В)	⩾12 (1 В; 1,2 А)	—	⩽0,75	—	—	TO-66
BU106	Si, n-p-n, Э	75	⩾3	325	8	7 (10*)	⩽1,5** (325 В)	⩾8 (5 В; 4 А)	⩽150 (10 В)	⩽1,25	—	⩽3	TO-3
2SC1576	Si, n-p-n, ТД	100	10	450	6	8	⩽0,1 (450 В)	30...150 (5 В; 1 А)	—	⩽3	—	3	TO-3
2SC1617	Si, n-p-n, ТД	50	10	300	5	7	⩽1 (250 В)	⩾15 (5 В; 7 А)	—	⩽0,24	—	—	TO-3

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K,т\ max}$, $P^*_{K,и\ max}$, Вт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^*_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ проб}$, В	$I_{K\ max}$, $I^*_{K,и\ max}$, А	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мА	$h_{21Э}$	$C_к$, пФ	$r_{кэ\ нас}$, Ом	$r_{бэ\ нас}$, Ом, $\tau^*_к$, пс	$t_{рас}$, $t^*_{выкл}$, $t^{**}_{сп}$, мкс	Корпус
2SC2137	Si, n-p-n, ТДМ	80	6	500	6	7	⩽0,1 (400 В)	10...40 (5 В; 3 А)	—	⩽0,5	—	⩽2	TO-3
2SC2138	Si, n-p-n, ТДМ	80	6	400	6	7	⩽0,1	10...40 (5 В; 3 А)	—	—	—	—	TO-3
KU605	Si, n-p-n, M	50 (80°C)	12	200	5	10	⩽1 (50 В)	⩾5 (10 В; 5 А)	⩽750 (10 В)	⩽0,2	—	⩽1	TO-3
KU607	Si, n-p-n, M	70	⩾9	210	5	10	⩽1 (150 В)	⩾10 (1,7 В; 5 А)	500 (10 В)	⩽0,3	—	⩽1	TO-3
KUY12	Si, n-p-n, Д	70	⩾9	210	5	10	⩽1 (150 В)	⩾10 (1,7 В; 8 А)	—	⩽0,2	—	⩽1	TO-3
BDY25	Si, n-p-n, Д	87,5	⩾10	200	10	6	—	15...180 (4 В; 2 А)	—	⩽0,3	—	—	TO-3
2SC1114	Si, n-p-n, Д	100	10	300	6	4	⩽1 (300 В)	⩾20 (5 В; 1 А)	—	⩽0,75	—	3,2	TO-3
2SC1454	Si, n-p-n, Д	50	10	300	6	4	1 (300 В)	⩾20 (5 В; 1 А)	—	⩽0,75	—	3,2	TO-3
BU409	Si, n-p-n, ПЭ	60 (50 °C)	⩾10	250	6	7	⩽5 (250 В)	⩾7,5 (1 В; 3 А)	—	⩽0,33	⩽0,42	—	TO-220
KT828A	Si, n-p-n, МП	50 (50°C)	⩾4	800* (0,01)	5	5 (7,5*)	⩽5 (1400 В)	⩾2,25 (5 В; 4,5 А)	—	⩽0,66	—	⩽10; ⩽1,2**	KT-9
KT828Б	Si, n-p-n, МП	60 (75°C)	20	600* (0,01 к)	5	5 (7,5*)	⩽5 (1200 В)	⩾2,25 (5 В; 4,5 А)	—	⩽0,66	—	⩽10; ⩽1,2**	KT-9
BUX97	Si, n-p-n, ПЭ	60 (75°C)	20	350** (750*)	7	6 (8*)	⩽1* (750 В)	10...70 (5 В; 1 А)	—	⩽0,75	⩽0,45	2	TO-3
BUX97A	Si, n-p-n, ПЭ	60 (75°C)	20	400** (800*)	7	6 (8*)	⩽1* (800 В)	10...70 (5 В; 1 А)	—	⩽0,75	⩽0,45	2	TO-3
BUX97B	Si, n-p-n, ПЭ			450** (800*)	7	6 (8*)	⩽1* (800 В)	10...70 (5 В; 1 А)	—	⩽0,75	⩽0,45	2	TO-3
BUX82	Si, n-p-n, П	60 (50°C)	6	(800* имп)	10	6 (8*)	⩽1* (800 В)	30 (5 В; 0,6 А)	—	⩽0,75	—	⩽3,5	TO-3
BUX83	Si, n-p-n, П	60 (50°C)	6	(1000* имп)	10	6 (8*)	⩽1** (1000 В)	30 (5 В; 0,6 А)	—	⩽0,75	—	⩽3,5	TO-3
2SC2121	Si, n-p-n, ТДМ	50	8	750	6	3 (6*)	⩽0,5** (750 В)	15...60 (5 В; 1 А)	85 (10 В)	⩽1,25	—	1,2	TO-3
2SD640	Si, n-p-n, ТДМ	100	3	600	5	7	⩽0,1 (500 В)	25...140 (5 В; 3 А)	70 (50 В)	⩽0,3	—	0,6**	TO-3
2SC1828	Si, n-p-n, Д	40	7	800	6	1 (3*)	⩽0,1 (800 В)	⩾30 (10 В; 0,2 А)	—	⩽10	—	7,2	TO-66
2SC2790	Si, n-p-n, Д	80	—	850	7	2	⩽0,1 (800 В)	⩾17 (5 В; 0,5 А)	—	⩽2	⩽3	⩽4; ⩽1**	TO-3
2SC2790A	Si, n-p-n, Д	80	—	850	7	2	⩽0,1 (800 В)	⩾10 (5 В; 0,5 А)	—	⩽2	⩽3	⩽2,5; ⩽1**	TO-3
2SC2791	Si, n-p-n, Д	100	—	900	7	5 (7*)	⩽0,1 (800 В)	⩾10 (5 В; 3 А)	—	⩽0,33	⩽5	⩽3,5	TO-3
KT839A	Si, n-p-n, МП	50	⩾5	1500	5	10	⩽1 (1500 В)	⩾5 (10 В; 4 А)	⩽240 (10 В)	⩽0,375	—	⩽10; ⩽1,5**	KT-9
BU108	Si, n-p-n, ТД	56	7,5	1500* (0,1 к)	5	5 (10*)	⩽1* (1500 В)	4 (5 В; 4 А)	125 (10 В)	⩽1,1	—	⩽1**	TO-3

Продолжение

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K,т\,max}$, $P^*_{K,и\,max}$, Вт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,и\,max}$, А	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мА	$h_{21Э}$	$C_к$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$r_{бэ\,нас}$, Ом, $\tau^*_к$, пс	$t_{рас}$, $t^*_{выкл}$, $t^{**}_{сп}$, мкс	Корпус
MJ3480	Si, n-p-n, ТД	56	7,5	1300* (0,1 к)	7	5 (10*)	⩽1* (1300 В)	4 (5 В; 4 А)	125 (10 В)	⩽1,1	—	⩽1**	ТО-3
2SC1172	Si, n-p-n, ТД	50	3	1500	5	6	⩽0,01 (500 В)	⩾10 (10 В; 2 А)	155 (10 В)	⩽1,25	—	⩽1**	ТО-3
2SC1172A	Si, n-p-n, ТД	50	2	1500	5	6	⩽0,01 (500 В)	⩾10 (10 В; 2 А)	165 (10 В)	⩽1	—	⩽1**	ТО-3
2SC1172B	Si, n-p-n, ТД	50	3	1500	5	7	⩽0,01 (500 В)	⩾10 (10 В; 2 А)	160 (10 В)	⩽0,8	—	⩽1**	ТО-3
2SC1894	Si, n-p-n, МТД	50	3	1500	5	6	⩽0,01 (500 В)	⩾8 (10 В; 2 А)	155 (10 В)	⩽1,25	—	⩽1**	ТО-3
2SC1895	Si, n-p-n, МТД	50	2	1500	5	6	⩽0,01 (500 В)	8...30 (10 В; 2 А)	165 (10 В)	⩽1	—	⩽1**	ТО-3
2SC1896	Si, n-p-n, МТД	50	2	1500	5	7	⩽0,01 (500 В)	8...40 (10 В; 2 А)	165 (10 В)	⩽0,8	—	⩽1**	ТО-3
2SD822	Si, n-p-n, ТД	50	3	1500	5	7	⩽0,01 (500 В)	⩾8 (5 В; 1 А)	165 (10 В)	⩽0,8	⩽0,25	⩽1**	ТО-3
2SD821	Si, n-p-n, ТД	50	3	1500	5	6	⩽0,01 (500 В)	⩾8 (5 В; 1 А)	165 (10 В)	⩽1	⩽0,3	⩽1**	ТО-3
2SD820	Si, n-p-n, ТД	50	3	1500	5	5	⩽0,01 (500 В)	⩾8 (5 В; 1 А)	165 (10 В)	⩽1,25	⩽0,37	⩽1**	ТО-3
2SD1279	Si, n-p-n, ДМ	50	3	1400	5	10	⩽0,01 (500 В)	⩾8 (5 В; 2 А)	165 (10 В)	⩽0,6	⩽2	⩽1**	ТО-3
КТ945А	Si, n-p-n, Э	50 (50°C)	⩾51	150* (0,01 к)	5	15 (25*)	⩽25 (150 В)	⩾10 (7 В; 15 А)	⩽200 (30 В)	0,17	⩽0,2	⩽1,1	КТ-9
BDY90	Si, n-p-n, Д	40 (75°C)	70	120	6	10 (15*)	⩽3** (120 В)	⩾20 (5 В; 10 А)	—	0,15	—	⩽1,3	ТО-3
BDY91	Si, n-p-n, Д	40 (75°C)	70	100	6	10 (15*)	⩽3** (100 В)	⩾20 (5 В; 10 А)	—	0,15	—	⩽1,3	ТО-3
2SC1440	Si, n-p-n, Д	100	10	150	6	15	⩽1 (150 В)	⩾12 (4 В; 5 А)	—	0,15	—	⩽2	ТО-3
2SD675A	Si, n-p-n, Д	100	25	140	5	12	⩽1	35...200 (5 В; 1 А)	—	0,4	—	—	ТО-3
2SC2431	Si, n-p-n, ПЭ	100	80	120	5	15	0,05	⩾7 (5 В; 15 А)	—	0,21	—	0,7	ТО-3

СОСТАВНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K,т\,max}$, $P^*_{K,и\,max}$, Вт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,и\,max}$, А	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мА	$h_{21Э}$	$C_к$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$r_{бэ\,нас}$, Ом, $\tau^*_к$, пс	$t_{рас}$, $t^*_{выкл}$, $t^{**}_{сп}$, мкс	Корпус
КТ825Г	Si, p-n-p, МП	125	⩾4	90	5	20 (30*)	⩽1* (90 В)	⩾750 (10 В; 10 А)	⩽700 (10 В)	⩽0,4	—	⩽4,5*	КТ-9
КТ825Д	Si, p-n-p, МП	125	⩾4	60	5	20 (30*)	⩽1* (60 В)	⩾750 (10 В; 10 А)	⩽700 (10 В)	⩽0,4	—	⩽4,5*	КТ-9
КТ825Е	Si, p-n-p, МП	125	⩾4	30	5	20 (30*)	⩽1* (30 В)	⩾750 (10 В; 10 А)	⩽700 (10 В)	⩽0,4	—	⩽4,5*	КТ-9

Продолжение

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{К, и\,max}$, $P^{*}_{К, и\,max}$, Вт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$ МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^{*}_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{К\,max}$, $I_{К, и\,max}$ А	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$; мА	$h_{21Э}$	$C_{к}$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$r_{бэ\,нас}$, Ом, $\tau^{*}_{к}$, пс	$t_{рас}$, $t^{*}_{выкл}$, $t^{**}_{сп}$, мкс	Корпус
BDX62	Si, p-n-p, ЭБ	90	7	60	5	8 (12*)	≤0,2 (60 В)	≥750 (3 В; 8 А)	—	≤0,66	—	—	TO-3
BDX62A	Si, p-n-p, ЭБ	90	7	80	5	8 (12*)	≤0,2 (80 В)	≥750 (3 В; 8 А)	—	≤0,66	—	—	TO-3
BDX62B	Si, p-n-p, ЭБ	90	7	100	5	8 (12*)	≤0,2 (100 В)	≥750 (3 В; 8 А)	—	≤0,66	—	—	TO-3
BDX64	Si, p-n-p, ЭБ	117	7	60	5	12 (16*)	≤0,4 (60 В)	≥1000 (3 В; 5 А)	—	≤0,5	—	—	TO-3
BDX64A	Si, p-n-p, ЭБ	117	7	80	5	12 (16*)	≤0,4 (80 В)	≥1000 (3 В; 5 А)	—	≤0,5	—	—	TO-3
BDX64B	Si, p-n-p, ЭБ	117	7	100	5	12 (16*)	≤0,4 (100 В)	≥1000 (3 В; 5 А)	—	≤0,5	—	—	TO-3
BDX66	Si, p-n-p, ЭБ	150	7	60	5	16 (20*)	≤1 (60 В)	≥1000 (3 В; 10 А)	—	≤0,2	—	—	TO-3
BDX66A	Si, p-n-p, ЭБ	150	7	80	5	16 (20*)	≤1 (80 В)	≥1000 (3 В; 10 А)	—	≤0,2	—	—	TO-3
BDX66B	Si, p-n-p, ЭБ	150	7	100	5	16 (20*)	≤1 (100 В)	≥1000 (3 В; 10 А)	—	≤0,2	—	—	TO-3
BDX86	Si, p-n-p, ЭБ	100	10	45	5	10 (15*)	≤0,5 (45 В)	750...18000 (3 В; 4 А)	130 (3 В)	≤0,5	≤0,5	1	TO-3
BDX86A	Si, p-n-p, ЭБ	100	10	60	5	10 (15*)	≤0,5 (60 В)	750...18000 (3 В; 4 А)	130 (3 В)	≤0,5	≤0,5	1	TO-3
BDX86B	Si, p-n-p, ЭБ	100	10	80	5	10 (15*)	≤0,5 (80 В)	750...18000 (3 В; 4 А)	130 (3 В)	≤0,5	≤0,5	1	TO-3
BDX86C	Si, p-n-p, ЭБ	100	10	100	5	10 (15*)	≤0,5 (100 В)	750...18000 (3 В; 4 А)	130 (3 В)	≤0,5	≤0,5	1	TO-3
BDX88	Si, p-n-p, ЭБ	120	10	45	5	12 (18*)	≤0,5 (45 В)	≥750 (3 В; 6 А)	140 (3 В)	≤0,25	≤0,33	0,8	TO-3
BDX88A	Si, p-n-p, ЭБ	120	10	60	5	12 (18*)	≤0,5 (60 В)	≥750 (3 В; 6 А)	140 (3 В)	≤0,25	≤0,33	0,8	TO-3
BDX88B	Si, p-n-p, ЭБ	120	10	80	5	12 (18*)	≤0,5 (80 В)	≥750 (3 В; 6 А)	140 (3 В)	≤0,25	≤0,33	0,8	TO-3
BDX88C	Si, p-n-p, ЭБ	120	10	100	5	12 (18*)	≤0,5 (100 В)	≥750 (3 В; 6 А)	140 (3 В)	≤0,25	≤0,33	0,8	TO-3
MJ2500	Si, p-n-p	150	≥1	60	5	10	≤1 (60 В)	≥1000 (3 В; 5 А)	—	≤0,4	≤0,6	—	TO-3
MJ2501	Si, p-n-p	150	≥1	80	5	10	≤1 (80 В)	≥1000 (3 В; 5 А)	—	≤0,4	≤0,6	—	TO-3
MJ4030	Si, p-n-p	150	10	60	5	16	≤1 (60 В)	≥1000 (3 В; 10 А)	—	≤0,25	—	—	TO-3
MJ4031	Si, p-n-p	150	10	80	5	16	≤1 (80 В)	≥1000 (3 В; 10 А)	—	≤0,25	—	—	TO-3
MJ4032	Si, p-n-p	150	10	100	5	16	≤1 (100 В)	≥1000 (3 В; 10 А)	—	≤0,25	—	—	TO-3
2SB650H	Si, p-n-p, Э	100	—	100	7	15 (20*)	≤0,1 (100 В)	1000...20000 (3 В; 8 А)	—	≤0,2	≤0,23	8*	TO-3
2SB693H	Si, p-n-p, Э	125	—	100	7	20 (30*)	≤1 (100 В)	1000...20000 (3 В; 10 А)	—	≤0,2	≤0,3	8*	TO-3
2N6050	Si, p-n-p	150	≥4	60	5	12 (20*)	≤0,5** (60 В)	≥750 (3 В; 6 А)	≤500 (10 В)	≤0,33	≤0,33	—	TO-3
2N6051	Si, p-n-p	150	≥4	80	5	12 (20*)	≤0,5** (80 В)	≥750 (3 В; 6 А)	≤500 (10 В)	≤0,33	≤0,33	—	TO-3
2N6052	Si, p-n-p	150	≥4	100	5	12 (20*)	≤0,5** (100 В)	≥750 (3 В; 6 А)	≤500 (10 В)	≤0,33	≤0,33	—	TO-3
2N6285	Si, p-n-p	160	≥4	60	5	20 (40*)	≤0,5** (60 В)	≥750 (3 В; 10 А)	≤600 (10 В)	≤0,2	≤0,2	—	TO-3
2N6286	Si, p-n-p	160	≥4	80	5	20 (40*)	≤0,5** (80 В)	≥750 (3 В; 10 А)	≤600 (10 В)	≤0,2	≤0,2	—	TO-3
2N6287	Si, p-n-p	160	≥4	100	5	20 (40*)	≤0,5** (100 В)	≥750 (3 В; 10 А)	≤600 (10 В)	≤0,2	≤0,2	—	TO-3
КТ827А	Si, n-p-n, МПЭ	125	≥4	100	5	20 (40*)	≤3* (100 В)	750...18000 (3 В; 10 А)	≤400 (10 В)	≤0,2	≤0,2	≤4,5; ≤6*	КТ-9
КТ827Б	Si, n-p-n, МПЭ	125	≥4	80	5	20 (40*)	≤3* (80 В)	750...18000 (3 В; 10 А)	≤400 (10 В)	≤0,2	≤0,2	≤4,5; ≤6*	КТ-9
КТ827В	Si, n-p-n, МПЭ	125	≥4	60	5	20 (40*)	≤3* (60 В)	750...18000 (3 В; 10 А)	≤400 (10 В)	≤0,2	≤0,2	≤4,5; ≤6*	КТ-9
BDX63	Si, n-p-n, ЭБ	90	7	80	5	8 (12*)	≤0,2 (60 В)	≥750 (3 В; 8 А)	—	≤0,66	≤0,8	—	TO-3
BDX63A	Si, n-p-n, ЭБ	90	7	100	5	8 (12*)	≤0,2 (80 В)	≥750 (3 В; 8 А)	—	≤0,66	≤0,8	—	TO-3
BDX65	Si, n-p-n, ЭБ	117	7	80	5	12 (16*)	≤0,4 (60 В)	1500 (3 В; 10 А)	—	≤0,5	≤0,6	—	TO-3
BDX65A	Si, n-p-n, ЭБ	117	7	100	5	12 (16*)	≤0,4 (80 В)	≥1000 (3 В; 10 А)	—	≤0,5	≤0,6	—	TO-3
BDX67	Si, n-p-n, ЭБ	150	7	80	5	16 (20*)	≤1 (60 В)	≥1000 (3 В; 10 А)	—	≤0,2	≤0,3	—	TO-3
BDX67A	Si, n-p-n, ЭБ	150	7	100	5	16 (20*)	≤1 (80 В)	≥1000 (3 В; 10 А)	—	≤0,2	≤0,3	—	TO-3

Заказ № 1141

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K, т\,max}$, $P^*_{K, и\,max}$, Вт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K, и\,max}$, А	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мА	$h_{21Э}$	$C_к$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$r_{бэ\,нас}$, Ом, $\tau^*_к$, пс	$t_{рас}$, $t^*_{выкл}$, $t^{**}_{сп}$, мкс	Корпус
BDX85	Si, n-p-n, ЭБ	100	10	45	5	10 (15*)	⩽0,5 (45 В)	750...18000 (3 В; 4 А)	120 (4 В)	⩽0,5	⩽0,5	2	TO-3
BDX85A	Si, n-p-n, ЭБ	100	10	60	5	10 (15*)	⩽0,5 (60 В)	750...18000 (3 В; 4 А)	120 (4 В)	⩽0,5	⩽0,5	2	TO-3
BDX85B	Si, n-p-n, ЭБ	100	10	80	5	10 (15*)	⩽0,5 (80 В)	750...18000 (3 В; 4 А)	120 (4 В)	⩽0,5	⩽0,5	2	TO-3
BDX85C	Si, n-p-n, ЭБ	100	10	100	5	10 (15*)	⩽0,5 (100 В)	750...18000 (3 В; 4 А)	120 (4 В)	⩽0,5	⩽0,5	2	TO-3
BDX87	Si, n-p-n, ЭБ	120	10	45	5	12 (18*)	⩽0,5 (45 В)	750...18000 (3 В; 4 А)	110 (4 В)	⩽0,25	⩽0,33	1	TO-3
BDX87A	Si, n-p-n, ЭБ	120	10	60	5	12 (18*)	⩽0,5 (60 В)	750...18000 (3 В; 4 А)	110 (4 В)	⩽0,25	⩽0,33	1	TO-3
BDX87B	Si, n-p-n, ЭБ	120	10	80	5	12 (18*)	⩽0,5 (80 В)	750...18000 (3 В; 4 А)	110 (4 В)	⩽0,25	⩽0,33	1	TO-3
BDX87C	Si, n-p-n, ЭБ	120	10	100	5	12 (18*)	⩽0,5 (100 В)	750...18000 (3 В; 4 А)	110 (4 В)	⩽0,25	⩽0,33	1	TO-3
MJ3000	Si, n-p-n, Э	150	⩾1	60	5	10	⩽1* (60 В)	⩾1000 (3 В; 5 А)	—	⩽0,4	—	—	TO-3
MJ3001	Si, n-p-n, Э	150	⩾1	80	5	10	⩽1* (60 В)	⩾1000 (3 В; 5 А)	—	⩽0,4	—	—	TO-3
MJ3520	Si, n-p-n, Д	150	⩾2	40	5	15 (30*)	⩽2** (40 В)	⩾500 (5 В; 4 А)	⩽600 (10 В)	⩽0,4	—	—	TO-3
MJ3521	Si, n-p-n, Д	150	⩾2	100	5	15 (30*)	⩽2** (100 В)	⩾500 (5 В; 4 А)	⩽600 (10 В)	⩽0,36	⩽0,35	—	TO-3
MJ4033	Si, n-p-n	150	—	60	5	16	⩽1* (60 В)	⩾1000 (3 В; 10 А)	—	⩽0,25	—	—	TO-3
MJ4034	Si, n-p-n	150	—	80	5	16	⩽1* (80 В)	⩾1000 (3 В; 10 А)	—	⩽0,25	—	—	TO-3
MJ4035	Si, n-p-n	150	—	100	5	16	⩽1* (100 В)	⩾1000 (3 В; 10 А)	—	⩽0,25	—	—	TO-3
2N6057	Si, n-p-n	150	⩾4	60	5	12 (20*)	⩽1** (60 В)	750...18000 (3 В; 6 А)	⩽300 (10 В)	⩽0,25	⩽0,33	—	TO-3
2N6058	Si, n-p-n	150	⩾4	80	5	12 (20*)	⩽1** (80 В)	750...18000 (3 В; 6 А)	⩽300 (10 В)	⩽0,25	⩽0,33	—	TO-3
2N6059	Si, n-p-n	150	⩾4	100	5	12 (20*)	⩽1** (100 В)	750...18000 (3 В; 6 А)	⩽300 (10 В)	⩽0,25	⩽0,33	—	TO-3
2N6282	Si, n-p-n	150	⩾4	60	5	20 (40*)	⩽0,5** (60 В)	750...18000 (3 В; 10 А)	⩽400 (10 В)	⩽0,2	⩽0,2	—	TO-3
2N6283	Si, n-p-n	150	⩾4	80	5	20 (40*)	⩽0,5** (80 В)	750...18000 (3 В; 10 А)	⩽400 (10 В)	⩽0,2	⩽0,2	—	TO-3
2N6284	Si, n-p-n	150	⩾4	100	5	20 40*)	⩽0,5** (80 В)	750...18000 (3 В; 10 А)	⩽400 (10 В)	⩽0,2	⩽0,2	—	TO-3
КТ829А	Si, n-p-n, МП	60	⩾4	100	5	8 (12*)	⩽1,5* (100 В)	⩾750 (3 В; 3 А)	—	⩽0,57	—	—	КТ-28
КТ829Б	Si, n-p-n, МП	60	⩾4	80	5	8 (12)	⩽1,5* (80 В)	⩾750 (3 В; 3 А)	—	⩽0,57	—	—	КТ-28
КТ829В	Si, n-p-n, МП	60	⩾4	60	5	8 (12*)	⩽1,5* (60 В)	⩾750 (3 В; 3 А)	—	⩽0,57	—	—	КТ-28
КТ829Г	Si, n-p-n, МП	60	⩾4	45	5	8 (12*)	⩽1,5* (60 В)	⩾750 (3 В; 3 А)	—	⩽0,57	—	—	КТ-28
BD263	Si, n-p-n, Э	36	⩾1	80	5	6	—	⩾750 (3 В; 1,5 А)	—	—	—	—	TO-126
BD263A	Si, n-p-n, Э	36	⩾1	100	5	6	—	⩾750 (3 В; 1,5 А)	—	—	—	—	TO-126
BD331	Si, n-p-n, Э	60	7	60	5	6 (10*)	⩽0,2 (60 В)	⩾750 (3 В; 3 А)	—	⩽0,66	—	—	SOT-82
BD333	Si, n-p-n, Э	60	7	80	5	6 (10*)	⩽0,2 (80 В)	⩾750 (3 В; 3 А)	—	⩽0,66	—	—	SOT-82
BD335	Si, n-p-n, Э	60	7	100	5	6 (10*)	⩽0,2 (100 В)	⩾750 (3 В; 3 А)	—	⩽0,66	—	—	SOT-82
BD643	Si, n-p-n, Э	62,5	7	60	5	8 (12*)	⩽0,2 (60 В)	⩾750 (3 В; 4 А)	⩽75 (10 В)	⩽0,66	—	2*	TO-220
BD645	Si, n-p-n, Э	62,5	7	80	5	8 (12*)	⩽0,2 (80 В)	⩾750 (3 В; 3 А)	⩽75 (10 В)	⩽0,66	—	2*	TO-220
BD647	Si, n-p-n, Э	62,5	7	100	5	8 (12*)	⩽0,2 (100 В)	⩾750 (3 В; 3 А)	⩽75 (10 В)	⩽0,66	—	2*	TO-220
BD675	Si, n-p-n, ЭБ	40	⩾1	45	5	4 (7*)	⩽0,2 (45 В)	⩾750 (3 В; 1,5 А)	—	⩽1,6	⩽1,6	—	TO-126
BD675A	Si, n-p-n, ЭБ	40	⩾1	45	5	4 (7*)	⩽0,2 (45 В)	⩾750 (3 В; 2 А)	—	⩽1,4	⩽1,25	—	TO-126
BD677	Si, n-p-n, ЭБ	40	⩾1	60	5	4 (7*)	⩽0,2 (60 В)	⩾750 (3 В; 1,5 А)	—	⩽1,6	⩽1,6	—	TO-126
BD677A	Si, n-p-n, ЭБ	40	⩾1	60	5	4 (7*)	⩽0,2 (60 В)	⩾750 (3 В; 2 А)	—	⩽1,4	⩽1,25	—	TO-126

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K,\tau\,max}$, $P^*_{K,и\,max}$, Вт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$; $f^{**}_{h21э}$; МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$; В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,и\,max}$, А	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мА	$h_{21Э}$	$C_к$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$r_{бэ\,нас}$, Ом, $\tau^*_к$, пс	$t_{рас}$, $t^*_{выкл}$, $t^{**}_{сп}$, мкс	Корпус
BD679	Si, n-p-n, ЭБ	40	≥1	80	5	4 (7*)	≤0,2 (80 В)	≥750 (3 В; 1,5 А)	—	≤1,6	≤1,6	—	ТО-126
BD679A	Si, n-p-n, Э	40	≥1	80	5	4 (7*)	≤0,2 (80 В)	≥750 (3 В; 2 А)	—	≤1,4	≤1,25	—	ТО-126
BD681	Si, n-p-n, Э	40	≥1	100	5	4 (7*)	≤0,2 (100 В)	≥750 (3 В; 1,5 А)	—	≤1,6	—	—	ТО-126
2SD686	Si, n-p-n, Э	30	—	100	5	4	≤0,02 (100 В)	≥1000 (2 В; 3 А)	—	≤0,5	≤0,66	—	ТО-220
2SD691	Si, n-p-n, Э	40	—	100	6	6	≤0,01 (100 В)	500...3000 (4 В; 1 А)	—	≤0,57	—	—	ТО-220
2SD692	Si, n-p-n, Э	50	—	100	6	6	≤0,01 (100 В)	500...3000 (4 В; 1 А)	—	≤0,57	—	—	ТО-220
BDW23	Si, n-p-n, ЭБ	50	8	45	5	6 (8*)	≤0,2 (45 В)	≥750 (3 В; 2 А)	—	≤0,5	—	1,2	ТО-220
BDW23A	Si, n-p-n, ЭБ	50	8	60	5	6 (8*)	≤0,2 (60 В)	≥750 (3 В; 2 А)	—	≤0,5	—	1,2	ТО-220
BDW23B	Si, n-p-n, ЭБ	50	8	80	5	6 (8*)	≤0,2 (80 В)	≥750 (3 В; 2 А)	—	≤0,5	—	1,2	ТО-220
BDW23C	Si, n-p-n, ЭБ	50	8	100	5	6 (8*)	≤0,2 (100 В)	≥750 (3 В; 2 А)	—	≤0,5	—	1,2	ТО-220
BDX53	Si, n-p-n, ЭБ	60	7	45	5	8 (12*)	≤0,2 (45 В)	≥750 (3 В; 3 А)	—	≤0,66	≤0,8	1,5	ТО-220
BDX53A	Si, n-p-n, ЭБ	60	7	60	5	8 (12*)	≤0,2 (60 В)	≥750 (3 В; 3 А)	—	≤0,66	≤0,8	1,5	ТО-220
BDX53B	Si, n-p-n, ЭБ	60	7	80	5	8 (12*)	≤0,2 (80 В)	≥750 (3 В; 3 А)	—	≤0,66	≤0,8	1,5	ТО-220
BDX53C	Si, n-p-n, ЭБ	60	7	100	5	8 (12*)	≤0,2 (100 В)	≥750 (3 В; 3 А)	—	≤0,66	≤0,8	1,5	ТО-220
BD265	Si, n-p-n, ЭБ	40	≥4	80	5	4	—	≥1000 (2 А)	—	—	—	—	ТО-220
BD265A	Si, n-p-n, ЭБ	40	≥4	100	5	4	—	≥1000 (2 А)	—	—	—	—	ТО-220
BD267	Si, n-p-n, ЭБ	55	≥1	80	—	8	—	≥750 (3 В; 3 А)	—	—	—	—	ТО-220
BD267A	Si, n-p-n, ЭБ	55	≥1	100	—	8	—	≥750 (3 В; 3 А)	—	—	—	—	ТО-220
КТ834А	Si, n-p-n, МП	100	4	500* (0,1 к)	8	15 (20*)	≤3* (500 В)	≥150 (5 В; 5 А)	100 (150 В)	≤0,13	2	≤1,2**	КТ-9
КТ834Б	Si, n-p-n, МП	100	4	450* (0,1 к)	8	15 (20*)	≤3* (450 В)	≥150 (5 В; 5 А)	100 (150 В)	≤0,13	2	≤1,2**	КТ-9
КТ834В	Si, n-p-n, МП	100	4	400* (0,1 к)	8	15 (20*)	≤3* (400 В)	≥150 (5 В; 5 А)	100 (150 В)	≤0,13	2	≤1,2**	КТ-9
2SD605	Si, n-p-n, ДМ	80	—	600	10	8	≤0,5 (600 В)	≥200 (2 В; 4 А)	—	≤0,27	—	—	ТО-3
2SD685	Si, n-p-n, ДМ	100	—	600	5	10	≤0,5 (600 В)	≥100 (2 В; 8 А)	90 (50 В)	≤0,25	≤0,31	12	ТО-3
SDN6000	Si, n-p-n	96	—	400	—	15 (20*)	≤1* (400 В)	≥150 (5 В; 5 А)	—	≤0,15	—	≤2,5; ≤1**	ТО-3
SDN6001	Si, n-p-n	96	—	450	—	15 (20*)	≤1* (450 В)	≥150 (5 В; 5 А)	—	≤0,15	—	≤2,5; ≤1**	ТО-3
SDN6002	Si, n-p-n	96	—	500	—	15 (20*)	≤1* (500 В)	≥150 (5 В; 5 А)	—	≤0,15	—	≤2,5; ≤1**	ТО-3
SDN6251	Si, n-p-n	84	—	400	—	10 (15*)	≤1* (400 В)	≥100 (5 В; 5 А)	—	≤0,2	—	≤2,5; ≤1**	ТО-3
SDN6252	Si, n-p-n	84	—	450	—	10 (15*)	≤1* (450 В)	≥100 (5 В; 5 А)	—	≤0,2	—	≤2,5; ≤1**	ТО-3
SDN6253	Si, n-p-n	84	—	500	—	10 (15*)	≤1* (500 В)	≥100 (5 В; 5 А)	—	≤0,2	—	≤2,5; ≤1**	ТО-3

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, Вт	$f_{гр}$, МГц	$U_{КБО\,проб}$, В	$U_{ЭБ\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,\,и\,max}$, А	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭК}$, $I^{**}_{КЭR}$, мА	$h_{21Э}$	$C_к$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$\tau_к$, пс, $r^*_б$, Ом	$P_{вых}$, P^*_{PEP}, Вт	$K_р$, дБ	КПД, %	$f_{раб}$, МГц	$U_{ип}$, В	Корпус
КТ610А	Si, n-p-n, ПЭ	1,5 (50°C)	⩾1000	26	4	0,3	⩽0,5 (26 В)	50...300 (10 В; 0,15 А)	⩽4,1 (10 В)	—	⩽55	—	—	—	—	—	41
КТ610Б	Si, n-p-n, ПЭ	1,5 (50°C)	⩾700	26	4	0,3	⩽0,5 (26 В)	20...300 (10 В; 0,15 А)	⩽4,1 (10 В)	—	⩽22	—	—	—	—	—	41
2N6135	Si, n-p-n, ПЭ	2,5	⩾1100	35	3,5	0,25	⩽10 (18 В)	25...300 (18 В; 80 мА)	⩽3 (30 В)	—	⩽20	—	—	—	—	—	Х-110
BFW16	Si, n-p-n, ПЭ	1,5	⩾1000	40	2	0,15 (0,3*)	⩽1 (20 В)	25 (5 В; 0,15 А)	—	⩽5	—	—	—	—	—	—	ТО-39
КТ606А	Si, n-p-n, ПЭ	2,5 (40°C)	⩾350	60	4	0,4 (0,8*)	⩽1,5** (60 В)	⩾15 (10 В; 0,10 А)	⩽10 (28 В)	⩽5	⩽10	⩾0,8	⩾4	⩾35	400	28	42
КТ606Б	Si, n-p-n, ПЭ	2,5 (40°C)	⩾300	60	4	0,4 (0,8*)	⩽1,5** (60 В)	⩾15 (10 В; 0,10 А)	⩽10 (28 В)	⩽5	⩽12	⩾0,6	⩾3	—	400	28	42
2N5090	Si, n-p-n, ПЭ	5 (75°C)	⩾500	55	3,5	0,4	⩽0,1 (55 В)	10...200 (5 В; 0,05 А)	⩽3,5 (30 В)	⩽10	—	⩾1,2	7,8	⩾45	400	28	ТО-60
RFD401	Si, n-p-n, ПЭ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	8	—	400	28	ТО-60
КТ904А	Si, n-p-n, ПЭ	5 (40°C)	⩾350	60	4	0,8 (1,5*)	⩽15* (60 В)	—	⩽12 (28 В)	⩽5	⩽15	⩾3	⩾4,8	—	400	28	42
КТ904Б	Si, n-p-n, ПЭ	5 (40°C)	⩾300	60	4	0,8 (1,5*)	⩽15* (60 В)	—	⩽12 (28 В)	⩽5	⩽20	⩾2,5	⩾4	—	400	28	42
2N3375	Si, n-p-n, ПЭ	11,6	500	65	4	0,5 (1,5*)	⩽0,1 (30 В)	⩾10 (5 В; 0,25 А)	⩽10 (30 В)	⩽2	10*	{ ⩾3 ⩾7,5	⩾4,8 5,6	⩾40 ⩾65	400 100	28 28	ТО-60
RFD421	Si, n-p-n, ПЭ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	—	400	28	ТО-60
ММ3375	Si, n-p-n, ПЭ	11,6	—	65	4	1,5	⩽0,1 (65 В)	—	⩽10 (30 В)	⩽2	—	{ 3 8	4,8 —	— —	400 100	28 28	ТО-60
2SC598	Si, n-p-n, ПЭ	10	⩾300	65	4	1,5	⩽0,1 (30 В)	⩾20 (10 В; 0,5 А)	⩽10 (10 В)	—	—	{ 3,5 8	5,4 —	— —	400 175	28 28	ТО-60
2SC549	Si, n-p-n, ПЭ	10	500	65	4	1,5	⩽0,1** (30 В)	—	⩽10 (30 В)	⩽2	—	3	—	—	400	28	ТО-60
2SC542	Si, n-p-n, ПЭ	11,6	450	65	4	1,5	⩽0,005 (30 В)	25 (4 В; 0,5 А)	7 (30 В)	—	—	6 3,5	7,8 —	— —	175 400	28	ТО-60
2SC635	Si, n-p-n, ПЭ	10	⩾300	65	4	1,5	⩽0,003 (18 В)	⩾15 (10 В; 0,5 А)	10 (18 В)	—	10*	4	6	—	175	18	ТО-60

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, Вт	$f_{гр}$, МГц	$U_{КБО\,проб}$, В	$U_{ЭБ\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,и\,max}$, А	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭК}$, $I^{**}_{КЭR}$, мА	$h_{21Э}$	$C_к$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$\tau_к$, пс, $r^*_б$, Ом	$P_{вых}$, P^*_{PEP}, Вт	K_p, дБ	КПД, %	$f_{раб}$, МГц	$U_{ип}$, В	Корпус
КТ907А	Si, n-p-n, ПЭ	13,5	⩾350	60	4	1 (3*)	⩽3* (60 В)	—	⩽20 (30 В)	⩽4	⩽15	⩾9	3,5	⩾45	400	28	42
КТ907Б	Si, n-p-n, ПЭ	13,5	⩾300	60	4	1 (3*)	⩽3* (60 В)	—	⩽20 (30 В)	⩽4	⩽25	⩾7	2,5	⩾45	400	28	42
2N3733	Si, n-p-n, ПЭ	23	⩾250	65	4	3*	⩽0,5 (65 В)	⩾5 (5 В; 1 А)	⩽20 (30 В)	⩽2	6,5*	⩾10 14,5	⩾4 5,8	⩾45 ⩾60	400 260	28 28	ТО-60
2N4440	Si, n-p-n, ПЭ	11,6	⩾400	65	4	1,5	⩽0,1 (65 В)	⩾3 (5 В; 1,35 А)	⩽10 (30 В)	⩽2	10*	⩾5 6,5	⩾4,8 5,7	⩾45 ⩾55	400 225	28 28	ТО-60
MSA7505	Si, n-p-n, ПЭ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	⩾10	4,2	—	400	28	ТО-60
2SC553	Si, n-p-n, ПЭ	20	⩾200	65	4	3	⩽0,25** (30 В)	—	⩽20 (30 В)	⩽2	—	10	—	—	400	28	ТО-60
2SC543	Si, n-p-n, ПЭ	23	400	65	4	3	⩽0,012 (30 В)	25 (4 В; 1 А)	14 (30 В)	—	—	14,5 6	6 —	— —	175 400	 28	ТО-60
КТ920А	Si, n-p-n, ПЭ	5 (50°C)	⩾400	36	4	0,5 (1*)	⩽2* (36 В)	—	⩽15 (10 В)	—	⩽20	⩾2	⩾8,5	55	175	12,6	43
КТ920Б	Si, n-p-n, ПЭ	10 (50°C)	⩾400	36	4	1 (2*)	⩽4* (36 В)	—	⩽25 (10 В)	—	⩽20	⩾5	⩾6,5	55	175	12,6	43
КТ920В	Si, n-p-n, ПЭ	25 (50°C)	⩾400	36	4	3 (7*)	⩽7,5* (36 В)	—	⩽75 (10 В)	—	⩽20	⩾20	⩾4,8	55	175	12,6	43
КТ920Г	Si, n-p-n, ПЭ	25 (50°C)	⩾350	36	4	3 (7*)	⩽7,5* (36 В)	—	⩽75 (10 В)	—	⩽20	⩾15	⩾4,8	55	175	12,6	43
2N5995	Si, n-p-n, ПЭ	10,7 (75°C)	—	36	3,5	1,5	⩽5 (36 В)	—	⩽80 (12 В)	—	—	⩾7	⩾9,7	65	175	12,5	МТ-78
2N5996	Si, n-p-n, ПЭ	35,7 (75°C)	—	36	3,5	5	⩽15 (36 В)	—	⩽100 (12 В)	—	—	⩾15	⩾4,5	75	175	12,5	МТ-78
2N6080	Si, n-p-n, ПЭ	12	—	36	4	1	⩽0,25 (15 В)	⩾5 (5 В; 0,25 А)	⩽20 (15 В)	—	—	4	⩾12	50	175	12,5	МТ-72
2N6081	Si, n-p-n, ПЭ	31	—	36	4	2,5	⩽0,5 (15 В)	⩾5 (5 В; 0,5 А)	⩽85 (15 В)	—	—	15	⩾6,3	50	175	12,5	МТ-72
BLY63	Si, n-p-n, ПЭ	17	—	36	4	5	0,1	10...120 (5 В; 0,25 А)	—	—	—	15	4,7	70	175	13	ТО-117
BLW18	Si, n-p-n, ПЭ	20	⩾120	36	4	2*	—	40 (5 В; 0,5 А)	⩽18 (13 В)	0,35	—	⩾5	⩾10	60	175	11,5	ТО-117
BLY88A	Si, n-p-n, ПЭ	32	700	36	4	2,5 (7,5*)	—	⩾5 (5 В; 0,5 А)	⩽30 (15 В)	0,6	—	⩾15	⩾7,5	65	175	13,5	МТ-72
КТ922А	Si, n-p-n, ПЭ	8 (40°C)	⩾300	65* (0,1 к)	4	0,8 (1,5*)	⩽5* (65 В)	—	⩽15 (28 В)	—	⩽20	⩾5	⩾10	⩾50	175	28	43
КТ922Б	Si, n-p-n, ПЭ	20 (40°C)	⩾300	65* (0,1 к)	4	1,5 (4,5*)	⩽20* (65 В)	—	⩽35 (28 В)	—	⩽20	⩾20	⩾7,4	⩾50	175	28	43

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, Вт	$f_{гр}$, МГц	$U_{КБО\,проб}$, В	$U_{ЭБ\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,и\,max}$, А	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭК}$, $I^{**}_{КЭR}$, мА	$h_{21Э}$	$C_к$, пФ	$\tau_{кэ\,нас}$, Ом	$\tau_к$, пс, $r^*_б$, Ом	$P_{вых}$, P^*_{PEP}, Вт	$K_р$, дБ	КПД, %	$f_{раб}$, МГц	$U_{ип}$, В	Корпус
КТ922В	Si, n-p-n, ПЭ	40 (40°С)	⩾300	65* (0,1 к)	4	3 (9*)	⩽40* (65 В)	—	⩽65 (28 В)	—	⩽25	⩾40	⩾6	⩾50	175	28	43
КТ922Г	Si, n-p-n, ПЭ	20 (40°С)	⩾300	65* (0,1 к)	4	1,5 (4,5*)	⩽20* (65 В)	—	⩽35 (28 В)	—	⩽20	⩾17	⩾7	⩾50	175	28	43
КТ922Д	Si, n-p-n, ПЭ	40 (40°С)	⩾250	65* (0,1 к)	4	3 (9*)	⩽40* (65 В)	—	⩽65 (28 В)	—	⩽25	⩾35	⩾5,5	⩾50	175	28	43
2N5641	Si, n-p-n, ПЭ	15	⩾300	65	4	1	⩽1 (30 В)	⩾5 (5 В; 0,1 А)	⩽15 (30 В)	—	—	7	⩾8,4	⩾60	175	28	МТ-71
2N5642	Si, n-p-n, ПЭ	30	⩾250	65	4	3	⩽1 (30 В)	⩾5 (5 В; 0,2 А)	⩽35 (30 В)	—	—	20	⩾8,2	⩾60	175	28	МТ-72
2N5643	Si, n-p-n, ПЭ	60	⩾200	65	4	5	⩽1 (30 В)	⩾5 (5 В; 0,5 А)	⩽65 (30 В)	—	—	40	⩾7,6	⩾60	175	28	МТ-72
BLW24	Si, n-p-n, ПЭ	25	⩾300	60	4	2*	—	⩾5 (5 В; 2 А)	⩽25 (25 В)	⩽1	—	⩾17	8	⩾60	176	28	ТО-117
2N4128	Si, n-p-n, ПЭ	40	⩾200	60	4	4	1	10...80 (5 В; 0,2 А)	—	—	—	24	6	—	175	25	МТ-59
2N4127	Si, n-p-n, ПЭ	25	⩾300	60	4	2	0,5	10...80 (5 В; 0,2 А)	—	⩽1	—	13,5	7,5	—	175	25	МТ-59
КТ909А	Si, n-p-n, ПЭ	27	⩾350	60* (0,01 к)	3,5	2 (4*)	⩽30* (60 В)	—	⩽30 (28 В)	—	⩽20	⩾20	—	⩾55	500	28	44
КТ909Б	Si, n-p-n, ПЭ	54	⩾500	60* (0,01 к)	3,5	4 (8*)	⩽60* (60 В)	—	⩽60 (28 В)	—	⩽20	⩾40	—	⩾55	500	28	44
КТ909В	Si, n-p-n, ПЭ	27	⩾300	60* (0,01 к)	3,5	2 (4*)	⩽30* (60 В)	—	⩽35 (28 В)	—	⩽30	⩾15	—	⩾40	500	28	44
КТ909Г	Si, n-p-n, ПЭ	54	⩾450	60* (0,01 к)	3,5	4 (8*)	⩽60* (60 В)	—	⩽60 (28 В)	—	⩽30	⩾30	—	⩾40	500	28	44
2N5177	Si, n-p-n, ПЭ	40	500	60	3,5	4	10	10...150 (5 В; 0,1 А)	—	—	—	25	5	60	500	28	MD-36
2N5178	Si, n-p-n, ПЭ	70	500	60	3,5	8	20	10...150 (5 В; 0,2 А)	—	—	—	50	4	60	500	28	MD-36
PT6670	Si, n-p-n, ПЭ	30	—	55	—	4	—	—	—	—	—	20	5	60	500	28	ТО-129
PT6680	Si, n-p-n, ПЭ	20	—	60	—	3	—	—	—	—	—	10	7	50	500	28	ТО-129
КТ913А	Si, n-p-n, ПЭ	4,7 (55°С)	⩾900	55	3,5	0,5 (1*)	⩽25* (55 В)	⩾10 (10 В; 0,5 А)	⩽7 (28 В)	—	⩽18	⩾3	⩾2	⩾40	1000	28	41
КТ913Б	Si, n-p-n, ПЭ	8 (70°С)	⩾900	55	3,5	1 (2*)	⩽50* (55 В)	⩾10 (10 В; 0,5 А)	⩽12 (28 В)	—	⩽15	⩾5	⩾2	⩾40	1000	28	41

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, Вт	$f_{гр}$, МГц	$U_{КБО\,проб}$, В	$U_{ЭБ\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,\,и\,max}$, А	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭК}$, $I^{**}_{КЭR}$, мА	$h_{21Э}$	$C_к$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$\tau_к$, пс $r^*_б$, Ом	$P_{вых}$, P^*_{PEP}, Вт	K_p, дБ	КПД, %	$f_{раб}$, МГц	$U_{ип}$, В	Корпус
КТ913В	Si, n-p-n, ПЭ	12	⩾900	55	3,5	1 (2*)	⩽50* (55 В)	⩾10 (10 В; 0,5 А)	⩽14 (28 В)	—	⩽15	⩾10	⩾2	⩾50	1000	28	41
2N4430	Si, n-p-n, ПЭ	10	600	55	3,5	1	2	20...200 (5 В; 0,1 А)	—	—	—	2,5	5	⩾35	1000	28	ТО-129
2N4431	Si, n-p-n, ПЭ	18	600	55	3,5	2	4	20...200 (5 В; 0,1 А)	—	—	—	5	5,2	⩾35	1000	28	ТО-129
RFD410	Si, n-p-n, ПЭ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	5,2	—	1000	28	ТО-129
RFD420	Si, n-p-n, ПЭ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	—	1000	28	ТО-129
2SC978	Si, n-p-n, ПЭ	18	1300	55	3,5	1,2	0,5	10...180 (28 В; 50 мА)	—	—	—	⩾5	4	⩾60	1000	28	МТ-83
BLX92	Si, n-p-n, ПЭ	6	1200	65	4	0,7 (2*)	—	⩾10 (5 В; 0,1 А)	—	1,7	—	2,5	5,5	—	1000	28	МТ-84
BLX93	Si, n-p-n, ПЭ	12,5	1200	65	4	1 (3*)	—	10...35 (5 В; 1 А)	—	1,7	—	5	5,2	—	1000	28	МТ-84
NE1010E-28	Si, n-p-n, ПЭ	25	—	50	3,5	2,5	1 (28 В)	20...180 (10 В; 0,5 А)	8 (28 В)	—	—	10	6	—	1000	28	ТО-128
2SC977	Si, n-p-n, ПЭ	10	1300	55	3,5	0,6	0,3	10...180 (28 В; 50 мА)	—	—	—	⩾2,5	⩾5	⩾30	1000	28	МТ-83
2N5764	Si, n-p-n, ПЭ	10	—	55	3,5	0,75	5	⩾20 (5 В; 0,1 А)	—	—	—	3	6	40	1000	28	МТ-77
2N5765	Si, n-p-n, ПЭ	19	—	55	3,5	1,5	7,5	⩾20 (5 В; 0,1 А)	—	—	—	5	6	40	1000	28	МТ-77
КТ911А	Si, n-p-n, ПЭ	3	⩾900	55	3	0,4	⩽5 (55 В)	—	⩽10 (28 В)	⩽5	⩽25	⩾0,8	⩾2,5	—	1800	28	45
КТ911Б	Si, n-p-n, ПЭ	3	⩾750	55	3	0,4	⩽5 (55 В)	—	⩽10 (28 В)	⩽5	⩽25	⩾0,8	⩾2,5	—	1000	28	45
КТ911В	Si, n-p-n, ПЭ	3	⩾900	40	3	0,4	⩽5 (40 В)	—	⩽10 (28 В)	⩽5	⩽50	⩾0,8	⩾2	—	1800	28	45
КТ911Г	Si, n-p-n, ПЭ	3	⩾750	40	3	0,4	⩽5 (40 В)	—	⩽10 (28 В)	⩽5	⩽100	⩾0,8	⩾2	—	1000	28	45
2N4429	Si, n-p-n, ПЭ	5	⩾700	55	3,5	0,425	1	20...200 (5 В; 50 мА)	—	—	—	1	5	⩾35	1000	28	МТ-59
2N4976	Si, n-p-n, ПЭ	5	1000	55	3,5	0,4	5	20...250 (5 В; 50 мА)	—	—	—	1	5	⩾25	2000	28	ТО-129

Тип прибора	Материал, структура, технология	$P_{K\,max}$, Вт	$f_{гр}$, МГц	$U_{КБО\,проб}$, В	$U_{ЭБ\,проб}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,и\,max}$, А	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭК}$, $I^{**}_{КЭR}$, мА	$h_{21Э}$	$C_к$, пФ	$r_{кэ\,нас}$, Ом	$\tau_к$, пс, $r^*_б$, Ом	$P_{вых}$, P^*_{PEP}, Вт	K_p, дБ	КПД, %	$f_{раб}$, МГц	$U_{ип}$, В	Корпус
2N5481	Si, n-p-n, ПЭ	5	—	50	3	0,4	2	20...250 (5 А; 50 мА)	—	—	—	1	6	⩾25	2000	28	МТ-74
2SC976	Si, n-p-n, ПЭ	5	1300	55	3,5	0,4	⩽0,1 (28 В)	10 (28 В; 20 мА)	—	—	—	1	5,2	30	1000	28	МТ-83
КТ902А	Si, n-p-n, Д	30 (50°С)	⩾35	65 (110 имп)	5	5	⩽10 (70 В)	⩾15 (10 В; 2 А)	⩽300 (10 В)	⩽1	—	20	⩾7	—	10	27	37
КТ902АМ	Si, n-p-n, Д	30 (50°С)	⩾35	65 (110 имп)	5	5	⩽10 (70 В)	⩾15 (10 В; 2 А)	⩽300 (10 В)	⩽1	—	20	⩾7	—	10	27	18
2SC101A	Si, n-p-n, М	35	20	70	5	5	1	30 (10 В; 0,5 А)	—	—	—	—	—	—	—	—	ТО-66
BD121	Si, n-p-n, Д	45	60	60	6	5	0,1	15 (10 В; 0,1 А)	—	⩽0,65	—	—	—	—	—	—	ТО-3
BD123	Si, n-p-n, Д	45	60	90	6	5	0,1	15 (10 В; 0,1 А)	—	⩽0,65	—	—	—	—	—	—	ТО-3
2SD68	Si, n-p-n, М	50	40	60	5	5	⩽10 (60 В)	60 (5 В; 1 А)	—	0,3	—	—	—	—	—	—	ТО-3
КТ912А	Si, n-p-n, П	30 (85°С)	⩾90	70* (0,01 к)	5	20	⩽50* (70 В)	10...50 (10 В; 5 А)	—	⩽0,12	—	⩾70*	⩾10	⩾50	30	27	46
КТ912Б	Si, n-p-n, П	30 (85°С)	⩾90	70* (0,01 к)	5	20	⩽50* (70 В)	20...100 (10 В; 5 А)	—	⩽0,12	—	⩾70*	⩾10	⩾50	30	27	46
2N5070	Si, n-p-n, ПЭ	70	⩾100	65	4	3,3 (10*)	⩽10 (60 В)	10...100 (5 В; 3 А)	⩽85 (30 В)	—	—	⩾25*	⩾13	⩾40	30	28	ТО-60
2N6093	Si, n-p-n, ПЭ	83,3	⩾90	70	3,5	10	⩽30* (60 В)	⩾20 (6 В; 5 А)	⩽250 (30 В)	—	—	⩾75*	⩾13	⩾40	30	28	МТ-67
40675	Si, n-p-n, ПЭ	100 (50°С)	—	65	3,5	10 (30*)	⩽30* (60 В)	—	⩽250 (30 В)	—	—	⩾75*	⩾13	⩾40	30	28	МТ-67
КТ903А	Si, n-p-n, МП	30 (60*)	⩾120	60 (80 имп)	4	3 (5*)	⩽10* (70 В)	15...70 (10 В; 2 А)	⩽180 (30 В)	⩽1,25	—	⩾10	⩾4,8	—	50	30	37
КТ903Б	Si, n-p-n, МП	30 (60*)	⩾120	60 (80 имп)	4	3 (5*)	⩽10* (70 В)	40...180 (10 В; 2 А)	⩽180 (30 В)	⩽1,25	—	⩾10	⩾4,8	—	50	30	37
2N2947	Si, n-p-n, ПЭ	25	⩾100	60	3	1,5	⩽1 (50 В)	6...60 (2 В; 0,4 А)	⩽60 (25 В)	⩽0,5	—	15	7	⩾60	30	25	ТО-3
2N2948	Si, n-p-n, ПЭ	25	⩾100	40	2	1,5	⩽1 (30 В)	2,5...100 (2 В; 0,4 А)	⩽60 (25 В)	⩽0,5	—	15	7	⩾60	30	25	ТО-3
2SC517	Si, n-p-n, ПЭ	10	⩾150	60*	4	2	⩽0,01 (30 В)	10...140 (5 В; 0,5 А)	⩽50 (10 В)	—	—	6	7,8	—	50	24	ТО-37

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ДИОДЫ

4.1. БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДИОДОВ

Буквенное обозначение параметра		Термин
отечественное	зарубежное	
$U_{пр}$	U_F	Постоянное прямое напряжение
$U_{обр}$	U_R	Постоянное обратное напряжение
$I_{пр}$	I_F	Постоянный прямой ток
$I_{обр}$	I_R	Постоянный обратный ток
$C_д$	C_{tot}	Общая емкость диода
$t_{вос}$	t_{rr}	Время восстановления обратного сопротивления
$U_{обр\ max}$	$U_{R\ max}$	Максимально допустимое постоянное обратное напряжение
$I_{пр,\ ср\ max}$	$I_{F\ max}$	Максимально допустимый средний прямой ток
$\Delta U_{ст}$	ΔU_z	Допустимый разброс напряжения стабилизации
$U_{ст}$	U_z	Напряжение стабилизации
$I_{ст}$	I_z	Ток стабилизации
P_{max}	P_{max}	Максимально допустимая рассеиваемая мощность стабилитрона
$r_{ст}$	r_z	Дифференциальное сопротивление стабилитрона
ТКН ($\alpha_{U_{ст}}$)	α_{U_z} (S_z)	Температурный коэффициент напряжения стабилизации

4.2. ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ДИОДЫ И ИХ ЗАРУБЕЖНЫЕ АНАЛОГИ

ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ ДИОДЫ МАЛОЙ МОЩНОСТИ

Тип прибора	Материал	$U_{обр\ max}$, В	$I_{пр,\ ср\ max}$, мА	$U_{пр}$, В	$I_{пр}$, мА	$I_{обр}$, мкА, при $U_{обр\ max}$ ($T_{окр}$=25°С)	$I_{обр}$, мкА	$U_{обр}$, В	$T_{окр}$, °С	T_{max}, °С	Корпус
Д10	Ge	10	16	1,5	3	100	200	10	60	60	22
1S426	Ge	10	20	1	2	—	100	6	25	75J	A-1
DR464	Ge	12	30	1	50	—	100	5	25	85A	DO-7
SED107	Ge	15	20	1	4,5	—	220	10	25	85	DO-7
AA112	Ge	15	24	1,3	20	—	40	10	25	100J	A-1
AA112P	Ge	15	24	1,3	20	—	40	10	25	100J	A-1
AA138	Ge	15	12	1,3	20	—	50	10	25	100J	A-1
Д9В	Ge	30	20	1	10	250	800	20	60	60	1
GD72E3	Ge	25	20	1	2	—	100	10	25	60A	F-65
GD72E4	Ge	25	20	1	2	—	20	10	25	60A	F-65
GD72E5	Ge	25	20	1	2	—	11	10	25	60A	F-65
OA90	Ge	20	10	1,5	10	—	650	20	60	75A	A-1
1N87T	Ge	25	30	1,0	5	—	200	25	25	90	DO-7
AAZ10	Ge	25	30	1,5	10	—	—	—	—	—	DO-7
GPM2NA	Ge	30	15	0,46	1,2	—	1000	30	25	—	—
1S75	Ge	30	25	1	2,5	—	50	10	25	70	A-1
1N295X	Ge	30	20	1	4,5	—	385	24	25	85	DO-7
AA137	Ge	30	12	1,3	20	—	50	10	25	100	A-1
Д102	Si	50	30	2	2	10	100	50	100	100	4
1N210	Si	47	27	1	3,5	0,1	10	47	100	150A	C-1
1N388	Si	47	27	1	3,5	0,1	10	47	100	150A	DO-7
1N1844	Si	47	30	1	4,5	—	—	—	—	150A	C-12
BA179	Si	50	25	0,9	1	1	10	50	70	100A	L-8
CA50	Si	50	35	1	15	—	0,5	10	55	150A	C-18
CB50	Si	50	35	1	15	—	2	10	55	150A	C-18
616C	Si	52	30	1	3	—	40	40	125	150A	C-3

Продолжение

Тип прибора	Материал	$U_{обр\ max}$, В	$I_{пр,\ ср\ max}$, мА	$U_{пр}$, В	$I_{пр}$, мА	$I_{обр}$, мкА, при $U_{обр\ max}$ ($T_{окр}=25°C$)	$I_{обр}$, мкА	$U_{обр}$, В	$T_{окр}$, °C	T_{max}, °C	Корпус
1N211	Si	56	23	1	2,7	—	50	56	100	150A	C-1
1N389	Si	56	23	1	2,7	—	50	56	100	100	DO-7
Д101	Si	75	30	2	2	10	150	75	100	150A	4
618C	Si	75	25	1	1,5	—	40	68	125	150A	C-3
1N213	Si	82	16	1	1,5	1	50	82	100	150A	C-1
1N391	Si	82	16	1	1,5	1	50	82	100	150A	DO-7
PD133	Si	85	30	1	10	—	40	60	100	150	A-2
1N212	Si	68	19	1	2	1	50	68	100	150A	C-1
Д2Д	Ge	75	16	1	4,5	250	1000	50	60	60	17
SD11F	Ge	75	15	1	5	—	500	50	25	85	M-236
1N74	Ge	75	22	1,5	15	—	50	10	25	70A	M-4
AA113P	Ge	60	10	1,4	20	500	120	30	25	100	A-1
КД103А	Si	75	100	1	50	1	50	75	125	125	3
1N483	Si	70	100	1,1	100	—	30	60	150	200A	A-1
BA128	Si	75	75	1,0	50	—	100	50	100	125A	DO-7
MT462A	Si	70	150	1,0	100	—	30	60	150	175A	A-60
GSM53	Si	80	100	1,1	100	—	30	60	150	150	A-2
Д223А	Si	100	50	1	50	1	50	100	120	120	4
CA100	Si	100	35	1	15	—	0,5	10	55	150A	C-18
CB100	Si	100	35	1	15	—	2	10	55	150A	C-18
Д223Б	Si	150	50	1	50	1	50	150	100	100	4
14P2	Si	150	40	1	1	—	100	—	125	125A	DO-7
AD150	Si	150	40	1	1	—	100	150	150	170A	DO-7
1N458	Si	150	55	1	7	—	5	125	150	200	A-1
1N5209	Si	150	55	1	7	—	5	125	150	200S	DO-35
MT458	Si	150	50	1	7	—	5	125	150	175A	A-60
AE150	Si	150	60	1	10	—	100	150	150	170A	ДО-7
BAW32B	Si	150	60	1	10	—	20	150	125	125J	DO-7
24J2	Si	150	60	1,3	60	—	20	150	125	125J	DO-7
Д207	Si	200	100	1	100	100	200	200	100	100	6
1TT3003	Si	200	100	1	100	—	—	175	150	175A	DO-35
1N485	Si	180	100	1,1	100	—	30	175	150	200A	DO-7
HSP1001	Si	175	120	1,0	100	—	5	150	150	175A	A-1
TMD45	Si	200	75	1,0	100	—	30	200	100	150A	A-21
ZS21	Si	200	100	1,5	100	—	5	200	100	150A	C-1
BA147/220	Si	220	100	1	50	—	75	150	100	150J	DO-7
1N486	Si	225	100	1,1	100	—	50	225	150	200A	DO-7
КД102А	Si	250	100	1	50	0,1	50	250	100	100	3
O102	Si	270	125	1,0	100	0,1	—	—	—	150J	C-18
O112	Si	270	125	1,0	100	0,1	—	—	—	150J	C-18
КД104А	Si	300	10	1	10	3	100	300	70	70	3
1N219	Si	270	7,5	4	3	5	100	270	100	150A	C-1
1N1632	Si	270	3,8	6	1,5	—	33	156	100	25A	M-204
HGR30	Si	300	1	1,1	1	10	50	300	100	175A	A-196
1N354	Si	325	15	1	20	—	20	300	125	—	C-12
1N220	Si	330	7	4	2	—	100	330	100	150A	C-1
1N1849	Si	330	7,5	4	3	—	—	—	—	150A	C-12
Д208	Si	300	100	1	100	100	200	300	100	100	6
BA147/300	Si	300	100	1	50	3	100	200	100	150J	DO-7
DR699	Si	300	100	1	50	1 (200)	—	—	—	150J	DO-7
1N487	Si	300	100	1,1	100	—	50	300	150	200A	DO-7
ZS22	Si	300	100	1,5	100	—	5	300	100	150A	C-1
Д226В	Si	300	300	1	300	100	300	200	80	80	5
DT230H1	Si	300	250	1,1	250	1	100	250	100	200	DO-35
MC51	Si	300	200	0,9	30	0,1	5	300	100	150A	DO-7
1N487A	Si	300	200	1,0	100	0,1	25	300	150	200A	DO-7
ZC53	Si	300	200	1,1	200	0,5	5	300	100	150A	C-1
BAW14	Si	300	200	1,2	200	0,1	10	300	100	175	DO-35
BAW14TF24	Si	300	200	1,2	200	0,1	10	300	100	150	DO-35
TF24	Si	300	200	1,2	200	0,1	10	300	100	175	DO-35
ZS123	Si	300	250	1,1	250	5	50	300	100	100A	DO-7
O502	Si	300	250	1,2	250	5	—	—	—	125	A-1
MC030	Si	300	200	1	400	0,2	15	300	150	175A	A-2
MC030A	Si	300	200	1	400	—	5	300	150	175A	A-2
PS632	Si	320	200	1	200	—	50	300	150	200	DO-14
PS633	Si	320	200	1	200	—	25	300	150	200	DO-14
BAY21	Si	350	200	1	100	—	25	300	100	150J	DO-7
Д209	Si	400	100	1	100	100	200	400	100	100	6
1N488	Si	380	100	1,1	100	0,25	50	380	150	200A	DO-7
DR698	Si	400	100	1	50	1	—	—	—	—	DO-7

Продолжение

Тип прибора	Материал	$U_{обр\ max}$, В	$I_{пр,\ ср\ max}$, мА	$U_{пр}$, В	$I_{пр}$, мА	$I_{обр}$, мкА, при $U_{обр\ max}$ ($T_{окр}=25°C$)	$I_{обр}$, мкА	$U_{обр}$, В	$T_{окр}$, °C	T_{max}, °C	Корпус
DR695	Si	400	100	1	100	—	50	300	100	—	DO-7
PD910	Si	400	100	1	100	—	10	400	25	200	A-188
ZS24	Si	400	100	1,5	100	100	5	400	100	150A	C-1
Д7Ж	Si	400	300	0,5	300	100	1000	130	70	70	6
1N533	Si	400	300	2	300	15	—	—	—	150A	DO-3
P4H5	Si	400	300	1	300	10	500	400	100	175	M-343
1N443	Si	400	300	1,5	300	1,5	—	—	—	165A	DO-2
1N604	Si	400	300	1,5	400	1,5	—	—	—	170S	DO-2
S106	Si	400	300	1,2	300	100	—	—	—	100S	A-54
COD1554	Si	400	250	1,1	400	10	—	—	—	100	A-52
S19	Si	400	250	1,2	400	1,5 мА	—	—	—	150A	A-54
S219	Si	400	250	1,3	400	100	—	—	—	—	A-54
M70B	Si	400	250	1,2	250	10	—	—	—	175	A-3
CER70B	Si	400	250	1,2	250	10	200	400	100	150A	DO-27
Д210	Si	500	100	1	100	100	200	500	100	100	6
PD911	Si	500	100	1	100	—	10	500	25	200S	A-188
1S206	Si	500	100	1,2	100	—	10	400	25	150	A-1
1N873	Si	500	100	0,6	100	—	20	500	25	200S	A-1
S205	Si	500	100	1,2	150	—	100	500	100	—	A-54
P2K5	Si	500	100	1	100	—	500	500	100	175	M-343
Д211	Si	600	100	1	100	100	200	600	100	100	6
PD912	Si	600	100	1	100	—	10	600	25	200S	A-188
1N874	Si	600	100	0,6	100	—	20	600	—	200S	A-1
10R6B	Si	600	100	2	100	—	500	600	150	175	—
PS2415	Si	600	100	2	5	—	5	600	—	—	C-15
S206	Si	600	100	1,2	150	—	100	600	—	—	A-54
1S1224	Si	600	100	1,5	100	—	5	600	25	100J	A-54
1S2352	Si	600	100	1,5	100	—	5	600	—	100	—
P2M5	Si	600	100	1	100	10	500	600	100	175	M-343
1N2373	Si	600	100	3	100	10	—	—	—	150	A-1
КД105В	Si	600	300	1	300	100	300	450	85	85	7
BAY89	Si	600	250	1	100	—	30	500	100	150	DO-7
COD1556	Si	600	250	1,1	400	10	—	—	—	100	A-52
M71B	Si	600	250	1,2	—	10	—	—	—	175	A-3
CER71B	Si	600	250	1,2	250	—	200	600	100	150	DO-27
1N535	Si	600	300	2	300	20	—	—	—	150	DO-3
1N1257	Si	600	300	1	300	—	500	600	125	165A	A-53
1S2310	Si	600	300	1,2	500	10	—	—	—	125J	A-53
P4M5	Si	600	300	1	300	10	500	600	100	175	M-343
1N445	Si	600	300	1,5	300	2	500	600	100	150A	DO-2
1N606	Si	600	300	1,5	200	25	—	—	—	170S	DO-1
1N606A	Si	600	300	1,5	400	2,5	—	—	—	170S	DO-1
МД217	Si	800	100	1	100	75	150	800	100	100	5
MR80	Si	800	100	1	100	—	10	800	100	150	DO-4
PD914	Si	800	100	1	100	—	10	800	25	200S	A-188
1N876	Si	800	100	0,6	100	—	20	800	—	200S	A-188
PS2416	Si	800	100	2	5	10	—	—	—	—	C-15
S208	Si	800	100	1,2	150	100	—	—	—	—	A-54
1N1407	Si	800	0,125	5	0,12	10	100	800	150	150	A-53
КД105Г	Si	800	300	1	300	100	300	600	85	85	7
O507	Si	800	250	1,2	250	5	—	—	—	125	A-1
1N1259	Si	800	270	1	270	—	500	800	125	165A	A-53
1N2505	Si	800	300	1,5	200	20	200	800	150	150A	A-6
S28	Si	800	300	1,2	500	500	—	800	—	—	A-54
BY157	Si	800	300	1,2	300	1	50	800	25	125A	DO-29
S234	Si	800	250	1,3	400	200	—	—	—	65A	A-54
M72B	Si	800	250	1,2	—	10	—	—	—	175	A-3
CER72C	Si	800	250	1,2	250	10	200	800	100	150A	DO-27
1N560	Si	800	250	1,8	250	15	380	800	125	140A	DO-3
МД218	Si	1000	100	1	100	75	150	1000	100	100	5
PD915	Si	900	100	1	100	0,05	10	900	25	200S	A-188
MR90	Si	900	100	1	100	—	10	900	100	150	Z-3
MR100	Si	1000	100	1	100	—	10	1000	100	150	Z-3
PD116	Si	1000	100	1	50	—	10	1000	25	200S	A-188
PD916	Si	1000	100	1	100	—	10	1000	25	200S	A-188
1N365	Si	1000	100	2	200	—	250	1000	100	150C	DO-2
1N878	Si	1000	100	0,6	100	—	20	1000	—	200S	A-1
1N3282	Si	1000	100	2,5	100	—	10	1000	100	150A	DO-7
10R10B	Si	1000	100	2	100	—	500	900	150	175	—
100D10	Si	1000	100	3	100	—	10	1000	100	150A	DO-7

Продолжение

Тип прибора	Материал	$U_{обр\ max}$, В	$I_{пр,\ ср\ max}$, мА	$U_{пр}$, В	$I_{пр}$, мА	$I_{обр}$, мкА, при $U_{обр\ max}$ ($T_{окр}=25°C$)	$I_{обр}$, мкА	$U_{обр}$, В	$T_{окр}$, °C	T_{max}, °C	Корпус
100K10	Si	1000	100	3	100	—	10	1000	100	150A	DO-7
PS2417	Si	1000	100	2	5	10	—	—	—	—	C-15
S210	Si	1000	100	1,2	150	100	—	—	—	—	A-54
1S1225A	Si	1000	100	1,5	100	5	—	—	—	100J	—
1S2354	Si	1000	100	1,5	100	5	—	—	—	100	—
VB10	Si	1000	100	5	100	—	5	1000	100	150A	A-1
VG1	Si	1000	100	5	100	—	40	1000	100	150A	A-1
EZ100	Si	1000	100	9	100	2	100	1000	100	125A	A-3
1N2374	Si	1000	100	3	100	—	—	—	—	100A	A-1

Примечание. Максимальная температура: A — окружающей среды; C — корпуса; J — перехода; S — хранения.

ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ ДИОДЫ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ

Тип прибора	Материал	$U_{обр\ max}$, В	$I_{пр,\ ср\ max}$, А	$U_{пр}$, В	$I_{пр}$, А	$I_{обр}$, мкА, при $U_{обр\ max}$ ($T_{окр}=25°C$)	$I_{обр}$, мА	$U_{обр}$, В	$T_{окр}$, °C	T_{max}, °C	Корпус
КД204В	Si	50	0,6	1,4	0,6	500	0,5	50	85	85	8
ZS30A	Si	50	0,5	1,1	0,5	—	15	50	100	160A	A-44
ZS30B	Si	50	0,5	1,1	0,5	5 мА	50	50	100	160A	A-44
A2A4	Si	50	0,475	1,2	0,5	1 мА	0,5	50	150	175	A-84
1N1251	Si	50	0,5	1	0,5	—	0,5	50	125	165	A-53
1N2080	Si	50	0,5	0,75	0,5	350	—	—	—	150	A-53
BR205	Si	50	0,5	1,1	0,5	5 мА	—	—	—	150	M-533
КД202Б	Si	35	3,5	0,9	3,5	800	0,8	50	120	130	9
1S442	Si	20	3	3	1,5	—	—	—	—	150	S-4
Д305	Ge	50	10	0,35	10	2,5 мА	0,2	50	70	70	10
UT5105	Si	50	7,5	1	5	—	0,3	50	100	175A	S-277
MS5	Si	50	7,5	1	7,5	—	—	—	—	150	DO-4
ZR20	Si	50	8	1,2	5	—	0,2	50	100	150	S-235
ZR200	Si	50	8	1,2	5	5 мА	0,2	50	100	150A	S-61
PA05	Si	50	8	1	2	—	0,1	50	100	150	M-542
E5A3	Si	50	8	1,3	8	—	1	50	150	175	DO-4
1N2793	Si	50	8	1,25	15	—	5	50	150	150C	DO-5
UT6105	Si	50	9	1	6	—	0,3	50	100	175A	S-277
1N2246	Si	50	10	0,6	10	—	1	50	100	150	DO-4
1N2246A	Si	50	10	0,6	10	—	0,5	50	150	150	DO-4
1N2247	Si	50	10	0,6	10	—	1	50	150	200	DO-4
1N2247A	Si	50	10	0,6	10	—	0,5	50	150	150	S-35
Д229В	Si	100	0,4	1	0,4	200	0,5	100	85	85	11
1N667	Si	100	0,4	1	0,4	—	0,2	150	100	175	DO-7
AM410	Si	100	0,4	1,2	0,4	—	0,3	100	150	150	DO-7
BYX60-100	Si	100	0,4	1,15	0,4	—	0,05	100	100	125	DO-7
M14	Si	100	0,4	1	0,4	—	—	100	150	200	DO-7
PS410	Si	100	0,4	1,5	0,5	—	0,5	100	150	200	A-60
1P644	Si	100	0,4	1	0,4	—	—	—	—	150	A-1
K2B5	Si	100	0,4	2	0,4	—	0,5	100	100	150	—
P5D5	Si	100	0,4	1	0,4	—	0,5	100	100	175	M-343
1N324	Si	100	0,4	2	0,65	—	0,3	100	100	200	DO-2
1N324A	Si	100	0,4	0,6	0,65	—	0,01	100	100	200	DO-2
AM12	Si	100	0,4	1,25	0,4	—	0,3	100	150	125	DO-4
MT14	Si	100	0,4	1,2	0,4	—	0,1	100	150	200	DO-7
1N339	Si	100	0,4	2	0,8	—	0,1	100	150	175	DO-4
1N348	Si	100	0,4	2	0,8	—	0,5	100	150	175	DO-4
SG105	Si	100	0,45	1,1	0,5	—	0,3	100	150	150	C-42
Д229Ж	Si	100	0,7	1	0,7	200	0,5	100	85	85	11
5E1	Si	100	0,7	1	0,5	—	0,2	100	125	125	A-35
1N1487	Si	100	0,75	0,55	0,25	—	0,4	100	125	140	DO-3
1N2073	Si	100	0,75	—	—	—	0,25	100	100	—	A-53
1N2104	Si	100	0,75	1,2	0,75	300	—	—	—	200	A-53
1N3238	Si	100	0,75	2,2	0,75	—	0,5	100	150	—	A-1
A3B1	Si	100	0,75	—	—	—	0,5	100	150	175	A-84
B3B5	Si	100	0,75	0,5	—	—	0,5	100	150	175	A-1
B3B9	Si	100	0,75	0,5	—	—	0,5	100	150	175	A-1
BR41	Si	100	0,75	1,1	0,75	—	—	—	—	150	M-533

Продолжение

Тип прибора	Материал	$U_{обр\ max}$, В	$I_{пр,\ ср\ max}$, А	$U_{пр}$, В	$I_{пр}$, А	$I_{обр}$, мкА, при $U_{обр\ max}$ ($T_{окр}=25°C$)	$I_{обр}$, мА	$U_{обр}$, В	$T_{окр}$, °C	T_{max}, °C	Корпус
COD1531	Si	100	0,75	1,1	0,8	—	—	—	—	150	A-52
MB258	Si	100	0,75	1	0,4	—	0,06	100	100	175	A-60
MB270	Si	100	0,75	1,2	0,5	—	0,075	100	100	175	A-60
S91A	Si	100	0,75	0,9	1,2	—	1,4	—	100	—	A-54
TS1	Si	100	0,75	1,2	0,75	—	—	—	—	125	A-1
UT112	Si	100	0,75	1,2	0,5	—	0,75	100	100	—	A-146
XS10	Si	100	0,75	—	—	—	—	—	—	—	A-54
ZS171	Si	100	0,75	1,2	0,75	—	0,15	100	100	150	A-52
ZR61	Si	100	0,75	1,1	0,75	—	0,15	100	100	150	A-42
7E1	Si	100	0,75	1,1	0,75	—	0,05	110	100	175	DO-27
7J1	Si	100	0,75	1,1	0,75	—	0,05	110	100	175	DO-15
1N440B	Si	100	0,75	1,5	0,75	—	100	100	150	165	DO-3
1N537	Si	100	0,75	1	0,5	—	0,2	100	150	150	DO-3
1N1081A	Si	100	0,75	1	1	—	—	—	—	—	DO-3
1N1645	Si	100	0,75	0,5	0,25	—	0,4	100	150	165	A-53
1N2091	Si	100	0,75	0,5	0,5	—	0,25	100	85	100	M-21
1N2610	Si	100	0,75	1,1	0,5	—	0,5	100	150	175	A-31
1N4364	Si	100	0,75	1,1	0,75	—	0,3	100	175	175	DO-3
1S031	Si	100	0,75	1,25	—	—	—	—	—	150	A-89
1S40	Si	100	0,75	1,2	1	250	—	—	—	150	DO-1
1S100	Si	100	0,75	1	—	—	—	—	—	150	A-89
A3B3	Si	100	0,75	1,1	0,5	—	0,3	100	150	175	A-84
A100	Si	100	0,75	1	0,75	—	—	—	—	100	A-3
D100	Si	100	0,75	1	0,75	—	—	—	—	175	A-50
DK751	Si	100	0,75	1,2	0,75	—	0,1	100	100	175	DO-27
H100	Si	100	0,75	1	0,75	—	—	—	—	175	DO-3
M68	Si	100	0,75	1,2	—	—	—	—	—	175	A-3
P100A	Si	100	0,75	1	1	—	—	—	—	150	DO-29
SD91A	Si	100	0,75	1,3	1,2	—	0,5	100	100	125	DO-3
SM10	Si	100	0,75	1,1	0,5	—	—	—	—	175	A-84
SW1SS	Si	100	0,75	1,1	0,75	—	—	—	—	120	—
TK10	Si	100	0,75	1,1	0,5	—	0,3	100	150	175	A-84
1N2859	Si	100	0,75	1,2	0,5	—	0,4	100	100	125	—
CER68	Si	100	0,75	1,2	0,75	—	0,2	100	100	150	DO-27
MR1337-2	Si	100	0,75	1,1	1	—	25	100	25	—	A-31
S81	Si	100	0,75	1,2	1,2	20	—	100	—	—	A-54
1N1556	Si	100	0,75	1,4	0,6	—	1	100	100	150	DO-2
AM010	Si	100	0,75	1	25	—	0,3	100	150	150	DO-7
КД208А	Si	100	0,5	1	1	50	0,2	100	85	85	7
1N2289	Si	100	1,5	0,6	1,5	—	0,5	100	150	150	DO-35
1N2289A	Si	100	1,5	0,6	1,5	—	0,1	100	150	150	DO-4
1N2290A	Si	100	1,5	0,6	1,5	—	0,1	100	150	150	DO-4
1N2638	Si	100	1,5	1,3	1,5	—	0,3	—	100	165	M-124
1S020	Si	100	1,5	1,25	5	—	0,05	100	100	150	A-89
A7B1	Si	100	1,5	0,5	—	—	0,5	100	150	175	A-84
A7B5	Si	100	1,5	0,5	—	—	0,5	100	150	175	A-84
A7B9	Si	100	1,5	0,5	—	—	0,5	100	150	175	A-84
A121-1t	Si	100	1,5	1,1	1	—	—	—	—	150	M-531
A132-1t	Si	100	1,5	1,1	1	—	—	—	—	150	M-532
A168-1t	Si	100	1,5	1,1	1	—	—	—	—	125	M-575
B7B1	Si	100	1,5	0,5	—	—	0,5	100	150	175	A-1
B7B5	Si	100	1,5	0,5	—	—	0,5	100	150	175	A-1
B7B9	Si	100	1,5	0,5	—	—	0,5	100	150	175	A-1
BR81D	Si	100	1,5	1,1	1	—	—	—	—	150	M-536
COD15314	Si	100	1,5	1,1	0,8	—	—	—	—	150	M-45
M1B1	Si	100	1,5	0,5	—	—	5	50	150	175	A-1
M1B5	Si	100	1,5	0,5	—	—	5	100	150	175	A-1
M1B9	Si	100	1,5	0,5	—	—	5	100	150	175	A-1
MB236	Si	100	1,5	1	0,8	—	0,015	100	100	175	A-60
SA1M1	Si	100	1,5	2	10	—	0,3	100	150	150	DO-27
S11	Si	100	1,5	1	1,5	—	—	—	—	150	A-1
SR11	Si	100	1,5	1	1,5	—	0,2	100	100	150	A-6
SR11T	Si	100	1,5	1	1,5	—	0,2	100	100	150	S-164
ZS271	Si	100	1,5	1,2	1,5	—	0,15	100	100	150	A-52
ZL103M	Si	100	1,5	1,34	7,5	—	0,11	100	100	125	S-33
1N4817	Si	100	1,5	1,3	1,5	—	0,25	100	40	170	DO-27
S2A10	Si	100	1,5	1,05	1,5	—	1,6	100	25	150	A-56
S2H1	Si	100	1,5	—	—	—	0.3	50	120	170	DO-27
B40C2000-1500Sit	Si	100	1,5	1	1,1	—	—	—	—	125	M-673
1S1071	Si	100	1,5	1	1,5	—	0,1	100	150	150	A-52

Продолжение

Тип прибора	Материал	$U_{обр\ max}$, В	$I_{пр,\ ср\ max}$, А	$U_{пр}$, В	$I_{пр}$, А	$I_{обр}$, мкА, при $U_{обр\ max}$ ($T_{окр}=25°C$)	$I_{обр}$, мА	$U_{обр}$, В	$T_{окр}$, °C	T_{max}, °C	Корпус
1,5E1	Si	100	1,5	1,1	1,5	—	0,05	110	100	175	DO-27
1,5J1	Si	100	1,5	1,1	1,5	—	0,05	110	100	175	DO-15
P100B	Si	100	1,5	1	1	—	—	—	—	170	DO-27
P150B	Si	100	1,5	1	1	—	—	—	—	150	DO-27
S1,5-01	Si	100	1,5	1	1,5	10	—	100	25	125	—
SE1, 5SS	Si	100	1,5	1,1	1,5	—	—	—	—	120	M-99
1N1563	Si	100	1,5	1,2	0,5	—	0,5	100	100	175	C-12
1N2391	Si	100	1,5	1,2	1,5	—	0,3	100	150	150	A-32
1N2400	Si	100	1,5	1,2	1,5	—	0,3	100	150	150	C-8
1N2409	Si	100	1,5	1,2	1,5	—	0,3	100	150	150	C-9
1N2418	Si	100	1,5	1,2	1,5	—	0,3	100	150	150	F-8
1S1849	Si	100	1,5	0,9	0,75	—	—	—	—	120	M-594
1N5392	Si	100	1,5	1,4	1,5	—	0,3	100	150	170	DO-15
1N2847	Si	100	1,5	0,65	0,5	—	0,4	100	150	165	S-35
CTN100	Si	100	1,5	1	—	—	—	—	—	175	M-594
CTP100	Si	100	1,5	1	—	—	—	—	—	175	M-594
VB100	Si	100	1,5	1	—	—	—	—	—	175	M-594
1N1115	Si	100	1,5	0,65	1,5	—	0,4	100	150	170	DO-4
1N1053	Si	100	1,5	1,5	1,5	1 мА	—	—	100	150	A-167
1N1085	Si	100	1,5	1,5	1,5	2 мА	—	—	100	150	F-22
1N1450	Si	100	1,5	1	2,4	—	5	100	25	190	S-41
1N1617	Si	100	1,5	1,2	1,5	—	5	100	25	100	A-52
1WS1	Si	100	1,5	1,5	5	—	1,5	100	125	125	A-19
1N1446	Si	100	1,5	1,3	1,8	—	2	100	25	175	S-41
КД202Г	Si	70	3,5	0,9	3,5	800	0,8	100	120	130	9
1S444	Si	60	3	1,5	3	—	—	—	—	110	S-4
Д304	Si	100	5	0,3	5	2 мА	10	50	70	70	—
1N1613	Si	100	5	1,5	10	—	—	—	—	175	DO-4
1N2290	Si	100	5	0,5	5	—	0,5	100	150	150	S-35
500R1B	Si	100	5	2	5	—	1	100	150	175	—
5BR1	Si	100	5	—	—	—	—	—	—	125	M-530
5PM1	Si	100	5	2	5	—	0,05	100	150	150	M-585
PE10	Si	100	5	1	2,5	—	—	—	—	—	M-40
S5A1	Si	100	5	1,1	5	1 мА	—	100	—	150	A-1
1N1059	Si	100	5	1,5	5	1 мА	—	100	—	170	S-67
1N1065	Si	100	5	1,5	5	1 мА	—	100	—	170	S-66
1N1071	Si	100	5	1,5	5	1 мА	—	100	—	170	S-68
1N1089	Si	100	5	1,5	5	2 мА	—	100	—	170	F-22
1N1089A	Si	100	5	1,5	5	—	5	100	100	—	F-73
10F5	Si	100	5	1,1	13	—	10	100	25	175J	S-41
SJ103 (E, K)	Si	100	5	1	0,75	—	0,3	100	150	150A	DO-4
URE100X	Si	100	5	1,5	10	2 мА	5	100	150	150	M-249
URF100X	Si	100	5	1,5	10	2 мА	5	100	150	150	M-249
URG100X	Si	100	5	1,5	10	2 мА	5	100	150	150	M-249
ESP5100	Si	100	5	1,2	3	—	0,011	100	150	150C	A-3
366B	Si	100	5	1,1	5	—	10	100	180	180J	S-27
1N1613A	Si	100	5	1,1	6	—	0,5	100	150	190J	DO-4
E3B3	Si	100	5	1,3	5	—	1	100	150	175	DO-4
Д242	Si	100	10	1,2	10	3 мА	3	100	100	125	10
1N2248	Si	100	10	0,6	10	—	1	100	150	150	DO-4
1N2248A	Si	100	10	0,6	10	—	0,5	100	150	150	DO-4
1N2249	Si	100	10	0,6	10	—	1	100	150	150	S-35
1N2249A	Si	100	10	0,6	10	—	0,5	100	150	150	S-35
BR101A	Si	100	10	1,2	5	10	—	—	110	150	M-538
DD4521	Si	100	10	1	10	10	—	100	25	150	S-19
G1010	Si	100	10	1,1	10	—	3	100	125	150A	DO-4
MA231	Si	100	10	—	—	—	4,5	125	125	150	S-74
P1010	Si	100	10	1,1	10	—	3	100	125	150	S-95
SJ104 (E, K)	Si	100	100	1	0,75	—	1,5	100	200	200C	DO-4
10PM1	Si	100	10	2	10	—	32	100	150	150J	M-586
1N1621	Si	100	10	1,2	10	—	5	100	25	100A	S-43
1S240	Si	100	10	1,5	30	—	0,05	100	100	175S	S-61
R611	Si	100	10	1,3	10	—	0,2	100	160	160C	M-249
S420	Si	100	10	1,5	30	—	0,05	100	100	175A	S-24
1S161	Si	100	10	1,6	50	—	6	100	175	175	S-103
11R1S	Si	100	10	1,6	50	6	—	100	175	175J	S-103
SA1AN12	Si	100	10	0,47	10	—	2	100	—	150J	DO-4
D1010	Si	100	10	—	—	—	0,3	100	125	125B	S-4
S1AN12	Si	100	10	0,5	9,5	—	2	—	125	150J	DO-4
367B	Si	100	10	1,2	10	—	10	100	180	180C	S-27

Продолжение

Тип прибора	Материал	$U_{обр\ max}$, В	$I_{пр,\ ср\ max}$, А	$U_{пр}$, В	$I_{пр}$, А	$I_{обр}$, мкА, при $U_{обр\ max}$ ($T_{окр}=25°C$)	$I_{обр}$, мА	$U_{обр}$, В	$T_{окр}$, °C	T_{max}, °C	Корпус
1N249	Si	100	10	1,5	25	—	5	100	150	175S	DO-5
40109	Si	100	10	0,6	10	—	2	100	150	175C	DO-4
F2B3	Si	100	10	1,3	30	—	1	100	150	175J	DO-5
Д303	Si	150	3	0,35	3	—	4	50	70	70	10
UR215	Ge	150	2	1	2	1 мА	0,05	150	100	—	A-146
1N2350	Si	150	3	1,1	1	—	—	—	—	150A	S-19
1S1660	Si	150	3	1,2	3	—	1	150	150	150J	S-336
3C15	Si	150	3	1,1	6	—	0,5	150	150	190	DO-4
КД204Б	Si	200	0,35	1,4	0,6	100	1	200	85	85	8
1N531	Si	200	0,3	2	0,3	70	—	200	—	150	DO-3
B80C300	Si	200	0,3	1,1	1	100	—	—	—	125	M-671
1N1703	Si	200	0,3	1,7	1	—	0,3	200	100	125	A-53
P4F5	Si	200	0,3	1	0,3	—	0,5	200	100	175	M-343
1N441	Si	200	0,3	1,5	0,3	—	0,75	—	200	165	DO-2
1N602A	Si	200	0,3	1,5	0,4	10	—	—	200	170S	DO-1
КД205Г	Si	200	0,5	1	0,5	100	0,2	200	85	85A	12
A2C4	Si	200	0,475	1,2	0,5	10	0,5	200	150	175	A-84
1N1253	Si	200	0,5	1	0,5	—	0,5	200	125	165	A-53
1N2082	Si	200	0,5	0,75	0,5	350	—	200	—	150A	A-53
1N3228	Si	200	0,5	3,3	0,5	—	0,5	200	150	—	A-1
BR22	Si	200	0,5	1,1	0,5	50	—	200	—	150	M-533
COD15524	Si	200	0,5	1,1	0,4	10 мА	—	200	—	100	M-45
D25C	Si	200	0,5	1,2	0,5	—	0,15	200	125	150	A-100
J200	Si	200	0,5	1,1	0,5	—	—	200		175	DO-7
MB259	Si	200	0,5	1	0,2	1 мА	0,06	200	100	175	A-60
MTO20A	Si	200	0,5	1	0,5	25 мА	5	200	150	175	A-60
S17	Si	200	0,5	1,2	0,8	100 мА	—	200	—	150	A-54
S17A	Si	200	0,5	1,2	0,8	50	—	200	—	—	A-54
PS120	Si	200	0,5	1,5	0,5	—	0,5	200	150	200A	A-47
1N5215	Si	200	0,5	1,2	1	—	0,2	200	75	175A	A-31
1S1221	Si	200	0,5	0,95	0,5	30	—	200	25	120J	A-31
S2E20	Si	200	0,5	0,95	0,5	30	—	200	—	120	A-185
5E2	Si	200	0,5	1,1	0,5	—	0,05	200	100	175	DO-27
5J2	Si	200	0,5	1,1	0,5	—	0,05	200	100	175	DO-15
20AS	Si	200	0,5	1,15	0,5	10	—	200	—	100A	DO-3
M69C	Si	200	0,5	1,2	—	10	—	—	—	175	A-3
P6F5	Si	200	0,5	1	0,5	10	0,5	200	100	175	M-343
SE05S	Si	200	0,1	1,1	0,5	10	—	200	—	120	M-98
SW05S	Si	200	0,5	1,1	0,5	10	—	200	—	120J	A-221
1N1709	Si	200	0,5	1,3	1	—	0,4	200	150	125A	A-53
SD1Z	Si	200	0,5	1	1,5	—	—	—	—	100S	A-221
1S1942	Si	200	0,5	1,2	0,5	—	0,4	200	125	125J	A-1
1S312	Si	200	0,5	1,1	1	10 мА	—	200	25	150	TO-1
DD003	Si	200	0,5	0,82	0,5	—	0,01	200	100	100A	A-3
1N3748	Si	200	0,5	1,5	0,5	5 мА	—	200	—	150A	A-1
CER69C	Si	200	0,5	1,2	0,5	—	0,2	200	100	150A	DO-27
1T502	Si	200	0,5	1,2	0,3	—	0,25	200	100	100A	A-3
2T502	Si	200	0,5	1,2	0,3	—	0,25	200	100	100A	DO-1
3T502	Si	200	0,5	1,2	0,3	—	0,25	200	100	100A	DO-13
4T502	Si	200	0,5	1,2	0,3	—	0,25	200	100	100A	DO-7
ERD200	Si	200	0,5	1,2	0,3	—	0,25	200	100	100A	M-166
1N551	Si	200	0,5	1,5	0,5	1 мА	—	200	—	150A	DO-4
1N1031	Si	200	0,5	1,5	0,5	200 мА	—	200	—	150A	A-73
20S5	Si	200	0,5	1,3	1,8	—	2	200	25	175	S-41
S101	Si	200	0,5	1	0,8	100	—	200	—	175	A-54
S222	Si	200	0,5	1	0,8	—	0,3	200	150	150A	A-54
S252	Si	200	0,5	1,2	0,8	—	0,5	200	100	100A	A-84
TKF20	Si	200	0,5	1,1	1	—	0,5	200	100	100A	A-84
1N3082	Si	200	0,5	1	0,75	—	0,2	200	150	200A	A-84
1N3545	Si	200	0,6	1	0,5	—	0,75	200	175	200A	A-1
КД205Л	Si	200	0,7	1	0,7	100	0,2	200	85	85	12
5E2	Si	200	0,7	1	0,5	—	0,2	200	125	125J	A-35
5MA2	Si	200	0,625	0,92	0,63	—	0,2	200	100	140J	F-29
1N1488	Si	200	0,75	0,55	0,25	—	0,3	200	125	140	DO-3
1N2069A	Si	200	0,75	1,2	0,5	—	0,2	200	100	100A	A-1
1N2105	Si	200	0,75	1,2	0,75	300	—	200	—	200	A-53
1N3239	Si	200	0,75	2,2	0,75	—	0,5	200	150	—	A-1
1N3656	Si	200	0,75	1,2	0,5	—	0,3	200	100	200	A-60
75R2B	Si	200	0,75	2	0,75	—	0,5	200	100	175	—
A3C1	Si	200	0,75	0,5	—	1 мА	0,5	200	150	175A	A-84

Продолжение

Тип прибора	Материал	$U_{обр\ max}$, В	$I_{пр,\ ср\ max}$, А	$U_{пр}$, В	$I_{пр}$, А	$I_{обр}$, мкА, при $U_{обр\ max}$ ($T_{окр}=25°C$)	$I_{обр}$, мА	$U_{обр}$, В	$T_{окр}$, °C	T_{max}, °C	Корпус
A3C5	Si	200	0,75	0,5	—	5 мА	0,5	200	150	175A	A-84
A3C9	Si	200	0,75	0,5	—	—	0,5	200	150	175A	A-84
B3C1	Si	200	0,75	0,5	—	5 мА	0,5	200	150	175A	A-1
B3C9	Si	200	0,75	0,5	—	10	0,5	200	150	175A	A-1
BR42	Si	200	0,75	1,1	0,75	5	—	—	—	150	M-533
COD1532	Si	200	0,75	1,1	0,8	1	—	200	—	150	A-52
MB260	Si	200	0,75	1	0,4	1	0,06	200	100	175	A-60
MB271	Si	200	0,75	1,2	0,5	2	75	200	100	175A	A-60
PT520	Si	200	0,75	1,5	0,5	—	0,5	200	100	125A	DO-2
S92A	Si	200	0,75	0,9	1,2	950	—	200	—	—	A-54
TS2	Si	200	0,75	1,2	0,75	5	—	—	—	125A	A-1
UP12069	Si	200	0,75	1,2	0,5	10	0,2	200	100	100	A-1
UP12069A	Si	200	0,75	1	0,5	5	0,5	200	100	100	A-1
UT113	Si	200	0,75	1,2	0,5	2	75	200	100	—	A-146
XS17	Si	200	0,75	—	—	—	0,1	200	—	—	A-54
XS17A	Si	200	0,75	—	—	—	—	200	—	—	—
ZS172	Si	200	0,75	1,2	0,75	5	150	200	100	150A	A-52
ZR62	Si	200	0,75	1,1	0,75	10	0,15	200	100	150A	A-42
7E2	Si	200	0,75	1,1	0,75	2	0,05	220	100	175	DO-27
7J2	Si	200	0,75	1,1	0,75	2	0,05	220	100	175	DO-15
1N441B	Si	200	0,75	1,5	0,75	—	—	200	150	165A	DO-3
1N538	Si	200	0,75	1	0,5	10	0,2	200	150	150A	DO-3
1N1082A	Si	200	0,75	1	1	10	—	200	—	—	F-22
1N1647	Si	200	0,75	0,5	0,25	—	0,3	200	150	165	A-53
1N2092	Si	200	0,75	0,5	0,5	—	0,25	200	85A	100A	M-21
1N2611	Si	200	0,65	1,1	0,5	10	0,5	200	150	175A	A-31
1N4365	Si	200	0,75	1,1	0,75	1	0,3	200	175	175	DO-3
1S032	Si	200	0,75	1,25	—	2	—	200	—	150A	A-89
1S41	Si	200	0,75	1,2	1	5	0,25	200	150	150J	DO-1
1S101	Si	200	0,75	1,0	—	10	—	200	—	150A	A-89
2G8	Si	200	0,75	1,1	0,75	—	—	200	—	150A	DO-3
A3C3	Si	200	0,75	1,1	0,5	10	0,3	300	150	175A	A-84
D200	Si	200	0,75	1	0,75	5	—	200	—	175	A-50
DK752	Si	200	0,75	1,2	0,75	10	0,1	200	100	175A	DO-27
H200	Si	200	0,75	1	0,75	5	—	200	—	175	DO-3
M69	Si	200	0,75	1,2	—	10	—	—	—	175	A-3
P200A	Si	200	0,75	1	1	10	—	200	—	150	DO-29
SD92A	Si	200	0,75	1,3	1,2	—	2,5	200	100	125	DO-3
SM20	Si	200	0,75	1,1	0,5	10	—	200	—	175	A-84
SW1S	Si	200	0,75	1,1	0,75	—	—	—	—	120	—
TK20	Si	200	0,75	1,1	0,5	—	0,3	200	150	175C	A-84
1N1440	Si	200	0,75	1	0,75	—	1	200	55	150A	A-1
1N2482	Si	200	0,75	1,2	0,75	—	1	200	55	150A	A-3
1N3277	Si	200	0,75	1,2	0,75	5	—	200	—	150A	A-1
1N2860	Si	200	0,75	1,2	0,5	—	0,4	200	100	125A	—
1N3193	Si	200	0,75	1,2	0,5	5	0,2	200	75	100A	A-50
1N3253	Si	200	0,75	1,2	0,750	5	0,2	200	75	100A	—
1N3639	Si	200	0,75	1,2	0,75	—	0,2	200	75	100A	DO-13
CER69	Si	200	0,75	1,2	0,75	10	0,2	200	100	150A	DO-27
1N1557	Si	200	0,75	1,4	0,6	—	1	200	100A	150	DO-2
Д243Б	Si	200	5	1,5	5	3	3	200	100	125	10
1N2230	Si	200	5	0,6	1,5	—	0,5	200	150	150	DO-4
1N2230A	Si	200	5	0,5	5	—	0,35	200	150	150	DO-4
1N2231	Si	200	5	0,5	1,5	—	0,5	200	150	150	S-35
1N2231A	Si	200	5	0,6	5A	—	0,35	200	150	150	S-35
1S751	Ge	200	5	0,75	5A	5 мА	—	200	25	85J	C-63
5PM2	Si	200	5	2	5A	—	50	200	150	150J	M-585
PE20	Si	200	5	1	2,5	5	—	200	—	—	M-40
S5A2	Si	200	5	1,1	5	1	—	200	—	150C	A-1
1N1061	Si	200	5	1,5	5	1 мА	—	200	—	170C	S-67
1N1067	Si	200	5	1,5	5	1 мА	—	200	170	170C	S-68
1N1073	Si	200	5	1,5	5	1 мА	—	200	—	170C	S-68
1N1090	Si	200	5	1,5	5	2	—	200	—	170C	F-22
SJ203 (E, K)	Si	200	5	1	0,75	10	0,3	200	150	150A	DO-4
ESP5200	Si	200	5	1,2	3	10	0,9	200	150	150C	A-3
366D	Si	200	5	1,1	5	—	10	200	180	180J	S-27
1N1614A	Si	200	5	1,1	6	—	0,5	200	150	190J	DO-4
E3C3	Si	200	5	1,3	5	10 мА	1	200	150	175	DO-4
F1C3	Si	200	5	1,3	30	—	1	200	150	175J	DO-5
Д243	Si	200	10	1,2	10	3 мА	3	100	200	125	10

Продолжение

Тип прибора	Материал	$U_{обр\ max}$, В	$I_{пр, ср\ max}$, А	$U_{пр}$, В	$I_{пр}$, А	$I_{обр}$, мкА, при $U_{обр\ max}$ ($T_{окр}=21°C$)	$I_{обр}$, мА	$U_{обр}$, В	$T_{окр}$, °C	T_{max}, °C	Корпус
1N2786	Si	200	10	1,2	10	—	10	200	150	150A	DO-5
1N2250	Si	200	10	0,6	10	—	1	200	150	150	DO-4
1N2250A	Si	200	10	0,6	10	—	0,5	200	150	150	DO-4
1N2251	Si	200	100	0,6	10	—	1	200	150	150	S-35
1N2251A	Si	200	10	0,6	10	—	0,5	200	150	150	S-35
BR102A	Si	200	10	1,2	5	10	—	220	—	150	M-538
DD4523	Si	200	10	1	10	10	—	200	25	150	S-19
G2010	Si	200	10	1,1	10	—	3	200	125	150A	DO-4
MA232	Si	200	10	—	—	—	4,5	125	125	150	S-74
MA240	Si	200	10	—	—	—	4,5	300	125	150	M-38
P2010	Si	200	10	1,1	10	—	3	200	125	150	S-95
SJ204 (E, K)	Si	200	10	1	0,75	10	1,5	200	200	200	DO-4
1OPM2	Si	200	10	2	10	—	25	200	150	150J	M-586
62R2	Si	200	10	1,1	10	—	6	200	150	150	DO-4
1N1622	Si	200	10	1,2	10	—	5	200	25	100A	S-43
1N4436	Si	200	10	1	10	—	0,2	200	160	160C	M-249
1S421	Si	200	10	1,5	30	—	0,05	200	100	175	S-61
R602	Si	200	10	1,3	10	—	0,2	200	160C	160C	M-249
R612	Si	200	10	1,3	10	—	0,2	200	160C	160C	M-24
R421	Si	200	10	1,5	30	—	0,05	200	100	175A	S-24
1S162	Si	200	10	1,6	30	—	5	200	175	175	S-103
11R2S	Si	200	10	1,6	50	—	5	200	175	175J	S-103
S2AN12	Si	200	10	0,5	9,5	—	2	—	125	150J	DO-4
367D	Si	200	10	1,2	10	—	10	200	180	180J	S-27
1N250	Si	200	10	1,5	25	—	5	200	150	175S	DO-5
40110	Si	200	10	0,6	10	—	1,5	200	150	175C	DO-4
E6C3	Si	200	10	1,3	10	—	1	200	150	175	DO-4
F2C3	Si	200	100	1,3	30	—	1	200	150	175J	DO-5
КД205В	Si	300	0,5	1	0,5	100	0,2	300	85	85	12
1N1254	Si	300	0,5	1	0,5	—	0,5	300	125	165A	A-53
1N2083	Si	300	0,5	0,75	0,5	350	—	300	—	150A	A-53
COD15534	Si	300	0,5	1,1	0,4	10	—	300	—	100	M-45
MB261	Si	300	0,5	1	0,2	—	0,06	300	100	175A	A-60
MT030	Si	300	0,5	1	0,5	2 мА	15	300	150	175A	A-60
MT030A	Si	300	0,5	1	0,5	—	5	300	150	175A	A-60
S31	Si	300	0,5	1,2	0,8	100	—	300	—	—	A-54
PS130	Si	300	0,5	1,5	0,5	—	0,5	300	150	300A	A-47
5E3	Si	300	0,5	1,1	0,5	—	50	300	100	175	DO-27
5J3	Si	300	0,5	1,1	0,5	—	50	330	100	175	DO-15
30AS	Si	300	0,5	1,15	0,5	10	—	330	—	100A	DO-3
P6G5	Si	300	0,5	1	0,5	—	0,5	300	100	175	M-343
1N1710	Si	300	0,5	1,3	1	—	0,4	300	150	125A	A-53
1S313	Si	300	0,5	1,1	1	10	—	300	25	150	TO-1
1T503	Si	300	0,5	1,2	0,3	10	0,25	300	100	100A	A-3
2T503	Si	300	0,5	1,2	0,3	10	0,25	300	100	100A	DO-1
3T503	Si	300	0,5	1,2	0,3	10	0,25	300	100	100A	DO-13
4T503	Si	300	0,5	1,2	0,3	10	0,25	300	100	100A	DO-7
ERD300	Si	300	0,5	1,2	0,3	10	0,25	300	100	100A	M-166
1N552	Si	300	0,5	1,5	0,5	1,5	—	300	—	150A	DO-4
1N1032	Si	300	0,5	1,5	0,5	200	—	300	—	150A	A-73
1N1083	Si	300	0,5	1,5	0,5	2	—	300	—	150A	F-22
1S559	Si	300	0,5	1,1	0,5	50	300	300	—	150A	C-42
30S5	Si	300	0,5	1,3	1,8	—	2	300	25	175J	S-41
S223	Si	300	0,5	1	0,8	2	300	300	150	—	A-54
S253	Si	300	0,5	1,2	0,8	—	0,5	300	100	—	A-54
Д229К	Si	300	0,7	1	0,7	200	0,5	300	85	85	11
A2D1	Si	300	0,6	1,5	—	1	0,5	300	150	175A	A-84
A2D5	Si	300	0,6	0,5	—	5	0,5	300	150	175A	A-84
A2D9	Si	300	0,6	0,5	—	10	0,5	300	150	175A	A-84
B2D1	Si	300	0,6	0,5	—	1	0,5	300	150	175A	A-1
B2D5	Si	300	0,6	0,5	—	5	0,5	300	150	175A	A-1
B2D9	Si	300	0,6	0,5	—	10	0,5	300	150	175A	A-1
ER31	Si	300	0,6	1,25	0,5	—	75	300	100	150A	A-3
1N1694	Si	300	0,6	0,6	0,25	—	0,5	300	100	115A	DO-3
1S148	Si	300	0,6	1,2	0,6	30	0,25	300	100	120S	A-50
P7G5	Si	300	0,6	1	0,6	—	0,5	300	100	175	M-343
SD93	Si	300	0,6	1,5	0,9	—	1	300	100	125A	DO-3
SM230	Si	300	0,6	1,2	0,95	10	—	300	—	150	A-84
1N1489	Si	300	0,75	0,55	0,25	—	0,3	300	125	140A	DO-3
1N2106	Si	300	0,75	1,2	0,75	300 мА	—	300	—	200	A-53

19 Заказ № 1141

Продолжение

Тип прибора	Материал	$U_{обр\ max}$, В	$I_{пр,\ ср\ max}$, А	$U_{пр}$, В	$I_{пр}$, А	$I_{обр}$, мкА, при $U_{обр\ max}$ ($T_{окр}=25°C$)	$I_{обр}$, мА	$U_{обр}$, В	$T_{окр}$, °C	T_{max}, °C	Корпус
A3D1	Si	300	0,75	0,5	—	1	0,5	300	150	175A	A-84
A3D5	Si	300	0,75	0,5	—	5	0,5	300	150	175A	A-84
A3D9	Si	300	0,75	0,5	—	10	0,5	300	150	175A	A-84
B3D1	Si	300	0,75	0,5	—	1	0,5	300	150	175A	A-1
B3D5	Si	300	0,75	0,5	—	5	0,5	300	150	175A	A-1
B3D9	Si	300	0,75	0,5	—	10	0,5	300	150	175A	A-1
COD1533	Si	300	0,75	1,1	0,8	1	—	300	—	150	A-52
MB253	Si	300	0,75	1	0,4	200	15	300	100	175A	A-60
MB262	Si	300	0,75	1	0,4	1	0,06	300	100	175A	A-60
MB272	Si	300	0,75	1,2	0,5	2	75	300	100	175A	A-60
PT530	Si	300	0,75	1,5	0,5	—	0,5	300	100	125A	DO-2
S93A	Si	300	0,75	0,9	1,2	600 мА	—	300	—	—	A-54
UT114	Si	300	0,75	1,2	0,5	2	75	300	100	—	A-146
UT212	Si	300	0,75	1	0,4	200	15	300	100	175A	A-146
ZR63	Si	300	0,75	1,1	0,75	10	0,15	300	100	150A	A-42
7E3	Si	300	0,75	1,1	0,75	2	50	330	100	175	DO-27
7J3	Si	300	0,75	1,1	0,75	2	50	330	100	175	DO-15
1N442B	Si	300	0,75	1,5	0,75	1	200	300	—	165A	DO-3
1B539	Si	300	0,75	1	0,5	10	0,2	300	150A	150A	DO-3
1N1083A	Si	300	0,75	1	1	10	—	300	—	—	F-22
1N1649	Si	300	0,75	0,5	0,25	—	0,3	300	150A	165A	A-53
1N2093	Si	300	0,75	0,5	0,5	—	0,25	300	85	100A	M-21
1N2612	Si	300	0,75	1,1	0,5	10	0,5	300	150	175A	A-31
1N4366	Si	300	0,75	1,1	0,75	1	0,3	300	175	175	DO-3
1S42	Si	300	0,75	1,2	1,2	5	0,25	300	150	150J	DO-1
3G8	Si	300	0,75	1,1	0,75	1	—	300	—	150A	DO-3
A3D3	Si	300	0,75	1,1	0,5	10	0,3	300	150	175A	A-84
A300	Si	300	0,75	1	0,75	5	—	300	—	100	A-50
DK753	Si	300	0,75	1,2	0,75	10	0,1	300	100	175A	DO-27
H300	Si	300	0,75	1	0,75	5	—	300	—	175	DO-3
SD93A	Si	300	0,75	1,3	1,2	—	0,5	300	100	125A	DO-3
SM30	Si	300	0,75	1,1	0,5	10	—	300	—	175	A-84
TK30	Si	300	0,75	1,1	0,5	—	0,3	300	150	175C	A-84
1N1441	Si	300	0,75	1	0,75	—	1	300	55	150A	A-1
D1646	Si	300	0,75	1,2	1,2	—	15 мкА	300	100	150A	A-1
MP1337-4	Si	300	0,75	1,1	1	—	25	300	25	175A	A-31
S26	Si	300	0,75	1,2	1,2	0,2	—	300	—	—	A-54
S83	Si	300	0,75	1,2	1,2	20	—	300	—	—	A-54
1N1558	Si	300	0,75	1,4	0,6	—	1	300	100	150	DO-2
AM030	Si	300	0,75	1	25 мА	—	0,3	300	140	150A	DO-7
Д245Б	Si	300	5	1,5	5	3 мА	3	300	100	125	143
1N2232	Si	300	5	0,6	1,5	—	0,5	300	150	150	DO-4
1N2232A	Si	300	5	0,6	5	—	0,35	300	150	150	DO-4
1N2233	Si	300	5	0,6	1,5	—	0,5	300	150	150	S-35
1N2233A	Si	300	5	0,6	5	—	0,35	300	150	150	S-35
BY118	Si	300	5	1,2	14	1	—	300	—	150J	C-50
S5A3	Si	300	5	1,1	5	1 мА	—	300	—	150C	A-1
1N1062	Si	300	5	1,5	5	1 мА	—	300	—	170C	S-67
1N1068	Si	300	5	1,5	5	1	—	300	—	170C	S-66
1N1074	Si	300	5	1,5	5	1	—	300	—	170C	S-68
1N1091	Si	300	5	1,5	5	2	—	300	—	170C	F-22
30F5	Si	300	5	1,1	13	—	10	300	25	175J	S-41
ESP5300	Si	300	5	1,2	3	10	0,9	300	150	150C	A-3
366F	Si	300	5	1,1	5	—	10	300	180	180J	S-27
E3E3	Si	300	5	1,3	5	10 мА	1	300	150	175	DO-4
F1E3	Si	300	5	1,3	30	—	1	300	150	175	DO-5
SL3	Si	300	5	1,1	5	5	—	300	—	175C	DO-4
Д245	Si	300	10	1,2	10	3 мА	3	300	200	125	10
1N2252	Si	300	10	0,6	10	—	1	300	150	150	DO-4
1N2252A	Si	300	10	0,6	10	—	0,5	300	150	150	DO-4
1N2253	Si	300	10	0,6	10	—	1	300	150	150	S-35
1N2253A	Si	300	100	0,6	10	—	0,5	300	150	150	S-35
G3010	Si	300	10	1,1	10	—	3	300	125	150A	DO-4
P3010	Si	300	10	1,1	10	—	3	300	125	150A	S-95
SJ304 (E, K)	Si	300	10	1	0,75	—	1,5	300	200	200C	DO-4
1N1623	Si	300	10	1,2	10	—	5	300	25	100A	S-43
1S163	Si	300	10	1,6	50	—	3	300	175	175	S-103
11R3S	Si	300	10	1,6	50	3 мА	—	300	175	175J	S-103
BYX42/300	Si	300	10	1,4	15	—	0,2	300	125	175J	DO-4
D3010	Si	300	10	1,5	10	—	0,3	200	125	125	S-4

Продолжение

Тип прибора	Материал	$U_{обр\ max}$, В	$I_{пр,\ ср\ max}$, А	$U_{пр}$, В	$I_{пр}$, А	$I_{обр}$, мкА, при $U_{обр\ max}$ ($T_{окр}=25°C$)	$I_{обр}$, мА	$U_{обр}$, В	$T_{окр}$, °С	T_{max}, °С	Корпус
S3AN12	Si	300	10	0,5	9,5	—	2	300	125	150J	DO-4
367F	Si	300	10	1,2	10	—	10	—	180	180J	S-27
1N2023	Si	300	10	1,5	25	—	5	300	150	175C	DO-5
40111	Si	300	10	0,6	10	75	1,5	300	150	175C	DO-4
BYY67	Si	300	10	0,8	10	—	2	300	125	125C	S-72
BYY68	Si	300	10	0,8	10	—	2	300	125	125C	S-72
E6E3	Si	300	10	1,3	10	10	1	300	150	175	DO-4
F2E3	Si	300	10	1,3	30	—	1	300	150	175J	DO-5
Д229Е	Si	400	0,4	1	0,4	2	0,5	400	85	85	11
1N647	Si	400	0,4	1	0,4	—	0,02	400	100	150A	A-1
1N673	Si	400	0,4	1	0,25	1	—	300	—	200	A-87
1N113	Si	400	0,4	1	0,4	20	0,01	400	100	150A	A-1
AM440	Si	400	0,4	1,2	0,4	—	0,3	400	150	150A	DO-7
BYX60-400	Si	400	0,4	1,2	0,4	500	50 мкА	400	100A	125A	DO-7
M4HZ	Si	400	0,4	1	0,4	10	—	400	125	150C	DO-7
PS440	Si	400	0,4	1,5	0,5	—	0,5	400	150	200A	A-60
1P647	Si	400	0,4	1	0,4	5	—	400	—	150	A-1
4D4	Si	400	0,4	1,3	1	—	0,3 мкА	400	100	150A	A-52
P5H5	Si	400	0,4	1	0,4	10	0,5	400	100	175	M-343
AM42	Si	400	0,4	1,25	0,4	—	0,3	400	150	125A	DO-4
MT44	Si	400	0,4	1,2	0,4	—	0,1	400	150	200A	DO-7
S/102	Si	400	0,4	1,2	0,65	—	100 мкА	400	100	—	A-54
1N255	Si	400	0,4	1,5	0,5	10	—	350	—	135A	S-11
1N332	Si	400	0,4	2	0,8	—	0,2	400	150	175B	DO-4
1N341	Si	400	0,4	2	0,8	—	0,5	400	150	175B	DO-4
КД205Б	Si	400	0,5	1	0,5	100	0,2	400	85	85	10
A2E4	Si	400	0,5	1,2	0,5	1	0,5	400	150	175	A-84
MA215	Si	400	0,5	1	0,5	12	—	400	—	70A	C-18
1N1255	Si	400	0,5	1	0,5	—	0,5	400	125	165A	A-53
1N2084	Si	400	0,5	0,75	0,5	0,35	—	400	—	150A	A-53
BR24	Si	400	0,5	1,1	0,5	5	—	440	—	150	M-533
COD15544	Si	400	0,5	1,1	0,4	10	—	400	—	100	M-45
D45C	Si	400	0,5	1,2	0,5	—	0,15	400	125	150	A-100
J400	Si	400	0,5	1,1	0,5	5	—	400	25	175A	DO-7
MB263	Si	400	0,5	1	0,2	1	0,06	400	100	175A	A-60
MT040	Si	400	0,5	1	0,5	200 мА	15 мкА	400	150	175	A-60
MT040A	Si	400	0,5	1	0,5	25 мА	5 мкА	400	150	175A	A-60
S16	Si	400	0,5	1,2	0,8	100	—	400	—	150A	A-54
S16A	Si	400	0,5	1,2	0,8	50	—	400	—	—	A-64
S235	Si	400	0,5	1,2	0,8	150	—	400	—	—	A-54
PS140	Si	400	0,5	1,5	0,5	—	0,5	400	150	200A	A-47
1N5216	Si	400	0,5	1,2	1	—	0,2	400	75	175A	A-31
5E4	Si	400	0,5	1,1	0,5	2	50 мкА	440	100	175	DO-2
5J4	Si	400	0,5	1,1	0,5	2	50 мкА	440	100	175	DO-15
40AS	Si	400	0,5	1,15	0,5	10	—	400	—	100A	DO-3
M70C	Si	400	0,5	1,2	—	10	—	—	—	175	A-3
P6H5	Si	400	0,5	1	0,5	10	0,5	400	100	175	M-343
SE05A	Si	400	0,5	1,1	0,5	10	—	400	—	120	M-98
SW05A	Si	400	0,5	1,1	0,5	10	—	400	—	120	A-221
1N1711	Si	400	0,5	1,1	0,5	—	0,4	400	150	125A	A-53
DD056	Si	400	0,5	1	1	1	—	400	—	—	A-3
SD1	Si	400	0,5	1	1,5	10	—	400	—	100S	A-221
1S1943	Si	400	0,5	1,2	0,5	—	0,4	400	125	125J	A-1
1S314	Si	400	0,5	1,1	1	10	—	400	—	150	TO-1
1S1230	Si	400	0,5	1,1	1	10	—	400	—	150	DO-1
DD006	Si	400	0,5	0,82	0,5	—	0,01	400	100	100A	A-3
1N1763	Si	400	0,5	3	0,5	100	1	400	100	100A	A-53
1N3749	Si	400	0,5	1,5	0,5	5	—	400	—	150A	A-1
CER70C	Si	400	0,5	1,2	0,5	10	0,2	400	100	100A	DO-27
1T504	Si	400	0,5	1,2	0,3	10	0,25	400	100	100A	A-3
2T504	Si	400	0,5	1,2	0,3	10	0,25	400	100	100A	DO-1
3T504	Si	400	0,5	1,2	0,3	10	0,25	400	100	100A	DO-13
4T504	Si	400	0,5	1,2	0,3	10	0,25	400	100	100A	DO-7
ERD400	Si	400	0,5	1,2	0,3	10	0,25	400	100	100A	M-166
1N553	Si	400	0,5	1,5	0,5	2	—	400	—	150A	DO-4
1N1033	Si	400	0,5	1,5	0,5	200	—	400	—	150A	A-73
1N1084	Si	400	0,5	1,5	0,5	2 мА	—	400	—	150A	F-22
1N1169A	Si	400	0,5	1,2	0,8	100	—	400	25	150	DO-2
40S5	Si	400	0,5	1,3	1,8	—	2	400	25	175J	S-41
EG100	Si	400	0,5	1	0,5	10	—	400	—	125A	DO-29

Продолжение

Тип прибора	Материал	$U_{обр\ max}$, В	$I_{пр,\ ср\ max}$, А	$U_{пр}$, В	$I_{пр}$, А	$I_{обр}$, мкА, при $U_{обр\ max}$ ($T_{окр}=25°C$)	$I_{обр}$, мА	$U_{обр}$, В	$T_{окр}$, °С	T_{max}, °С	Корпус
S100	Si	400	0,5	1	0,8	100	—	400	—	—	А-54
S105	Si	400	0,5	1,2	0,55	25	—	400	—	—	А-54
S108	Si	400	0,5	2	0,65	250	—	400	—	—	А-54
S224	Si	400	0,5	1	0,8	2	300 мкА	400	150	—	А-54
S254	Si	400	0,5	1,2	0,8	—	500 мкА	400	100	—	А-54
TKF40	Si	400	0,5	1,1	1	10	0,5	400	100	175А	А-84
1N3083	Si	400	0,5	1	0,75	—	0,2	400	150	200А	А-84
Д229Л	Si	400	0,7	1	0,7	200	0,5	400	120	120	11
1N3547	Si	400	0,6	1	0,5	200	0,75	400	175	200А	А-1
A2E1	Si	400	0,6	0,5	—	1	0,5	400	150	175А	А-84
A2E5	Si	400	0,6	0,5	—	5	0,5	400	150	175А	А-84
A2E9	Si	400	0,6	0,5	—	10	0,5	400	150	175А	А-84
B2E1	Si	400	0,6	0,5	—	1	0,5	400	150	150А	А-1
B2E5	Si	400	0,6	0,5	—	5	0,5	400	150	150А	А-1
B2E9	Si	400	0,6	0,5	—	10	0,5	400	150	175	А-1
ER41	Si	400	0,6	1,25	0,5	—	75 мкА	400	100	150А	А-3
S5M2	Si	400	0,6	—	—	1	0,05	400	125	125	DO-14
S16B	Si	400	0,6	1,2	0,95	10	—	400	—	—	А-54
S243	Si	400	0,6	1,2	0,95	100	—	400	—	—	А-54
1N1695	Si	400	0,6	0,6	0,25	—	0,5	400	100	115А	DO-3
1N149	Si	400	0,6	1,2	0,6	30	0,25	400	100	120	А-50
5D4	Si	400	0,6	1,2	3	—	50	400	100	150	А-1
P7H5	Si	400	0,6	1	0,6	10	0,5	400	100	175	М-343
SD94	Si	400	0,6	1,5	0,9	—	0,8	400	100	125А	DO-3
SM210	Si	400	0,6	1,2	0,95	10	—	400	—	150	А-84
CY40	Si	400	0,6	1,15	0,5	—	—	400	—	150	А-31
5MA4	Si	400	0,625	0,92	0,63	—	0,2	400	100	140J	F-29
BY158	Si	400	0,650	1,3	0,65	10	100 мкА	400	60	130А	DO-29
1N1490	Si	400	0,75	0,55	0,25	—	0,3	400	125	140А	DO-3
1N2070	Si	400	0,75	1,2	0,5	10	0,2	400	100	100А	А-1
1N2070A	Si	400	0,75	1	0,5	5	0,5	400	100	100А	А-1
1N2107	Si	400	0,75	1,2	0,5	10	0,3	400	100	200А	А-60
1N3240	Si	400	0,75	2,2	0,75	—	0,5	400	150	—	А-1
1N3657	Si	400	0,75	1,2	0,5	10	0,3	400	100	200А	А-60
A3E1	Si	400	0,75	0,5	—	1	0,5	400	150	175А	А-84
A3E5	Si	400	0,75	0,5	—	5	0,5	400	150	175А	А-84
A3E9	Si	400	0,75	0,5	—	10	0,5	400	150	175А	А-84
B3E1	Si	400	0,75	0,5	—	1	0,5	400	150	175А	А-1
B3E5	Si	400	0,75	0,5	—	5	0,5	400	150	175А	А-1
B3E9	Si	400	0,75	0,5	—	10	0,5	400	150	175А	А-1
BR44	Si	400	0,75	1,1	0,75	5	—	400	—	150	М-533
COD1534	Si	400	0,75	1,1	0,8	1	—	400	—	150	А-52
DD236	Si	400	0,75	1	0,75	—	1	400	25	100А	DO-3
DD266	Si	400	0,75	1	0,3	—	50 мкА	400	100	—	DO-3
ED3004A	Si	400	0,75	—	—	10	30 мкА	400	100	100А	А-1
MB254	Si	400	0,75	1	0,4	0,2	15 мкА	400	100	175А	А-60
MB273	Si	400	0,75	1,2	0,5	2	75 мкА	400	100	175А	А-60
PT540	Si	400	0,75	1,5	0,5	—	0,5	400	100	125А	DO-2
TS4	Si	400	0,75	1,2	0,75	5	—	—	—	125	А-1
UP12070	Si	400	0,75	1,2	0,5	10	200 мкА	400	100	100	А-1
UP12070A	Si	400	0,75	1	0,5	5	0,5	400	100	100А	А-1
UT115	Si	400	0,75	1,2	0,5	2	75 мкА	400	100	—	А-146
UT213	Si	400	0,75	1	0,4	200	15 мкА	400	100	175А	А-146
ZS174	Si	400	0,75	1,2	0,75	5	150 мкА	400	100	150А	А-52
ZR64	Si	400	0,75	1,1	0,75	10	0,15	400	100	150А	А-42
7E4	Si	400	0,75	1,1	0,75	2	50 мкА	440	100	175	DO-27
7J4	Si	400	0,75	1,1	0,75	2	50 мкА	440	100	175	DO-15
1N443B	Si	400	0,75	1,5	0,75	1,5	200	400	150	165А	DO-3
1N540	Si	400	0,75	1	0,5	10 мА	0,2	400	150	150А	DO-3
1N1651	Si	400	0,75	0,5	0,25	—	0,3	400	150	165А	А-53
1N2094	Si	400	0,75	0,5	0,5	—	0,25	400	85	100А	М-21
1N2613	Si	400	0,75	1,1	0,5	10	0,5	400	150	175А	А-31
1N4367	Si	400	0,75	1,1	0,75	1	0,3	400	175	175	DO-3
1S034	Si	400	0,75	1	—	10	—	400	—	150А	А-89
1S43	Si	400	0,75	1,2	1	5	0,25	400	150	150	DO-1
1S103	Si	400	0,75	1	—	10	—	400	—	150А	А-89
4G8	Si	400	0,75	1,1	0,75	1,5	—	400	—	150А	DO-3
A3E3	Si	400	0,75	1,1	0,5	10	—	400	150	175А	А-84
A400	Si	400	0,75	1	0,75	5	—	400	—	100	А-3
D400	Si	400	0,75	1	0,75	5	—	400	—	175	А-50

Продолжение

Тип прибора	Материал	$U_{обр\ max}$, В	$I_{пр,\ ср\ max}$, А	$U_{пр}$, В	$I_{пр}$, А	$I_{обр}$, мкА, при $U_{обр\ max}$ ($T_{окр}=25°C$)	$I_{обр}$, мА	$U_{обр}$, В	$T_{окр}$, °C	T_{max}, °C	Корпус
DK754	Si	400	0,75	1,2	0,75	10	100 мкА	400	100	175A	DO-27
H400	Si	400	0,75	1	0,75	5	—	400	—	175	DO-3
P400A	Si	400	0,75	1	1	10	—	400	—	150	DO-29
S1A	Si	400	0,75	1,1	0,75	10	—	400	—	120	A-6
SD94A	Si	400	0,75	1,3	1,2	—	0,4	400	100	125A	DO-3
SD500	Si	400	0,75	1,2	0,5	—	0,7	500	100	125A	A-6
SM40	Si	400	0,75	1,1	0,5	10	—	400	—	175	A-84
TK40	Si	400	0,75	1,1	0,5	—	0,3	400	150	175C	A-84
1N2483	Si	400	0,75	1,2	0,75	—	1	400	55	150A	A-3
1N2487	Si	400	0,75	1	—	1 мА	—	400	—	150	A-6
1N3278	Si	400	0,75	1,2	0,75	5	—	400	—	150A	A-1
1N2862	Si	400	0,75	1,2	0,5	—	0,3	400	100	125A	DO-1
1N3194	Si	400	0,75	1,2	0,5	5	0,2	400	75	100A	A-50
1N3254	Si	400	0,75	1,2	0,5	5	0,2	400	75	100A	A-50
1N3640	Si	400	0,75	1,2	0,75	—	0,2	400	75	100A	DO-13
CER70	Si	400	0,75	1,2	0,75	10	0,2	400	100	150A	DO-27
D1647	Si	400	0,75	1,2	1,2	200	15 мкА	400	100	150A	A-1
MP1337-5	Si	400	0,75	1,1	1	—	25	400	25	175A	A-31
S84	Si	400	0,75	1,2	1,2	20	—	400	—	—	A-54
1N1559	Si	400	5	1,4	0,6	—	1	400	100	150	DO-2
Д246Б	Si	400	5	1,5	5	3 мА	3	400	100	125	10
1N2234	Si	400	5	0,6	1,5	—	0,5	400	150	150	DO-4
1N2234A	Si	400	5	0,6	5	—	0,35	400	150	150	DO-4
1N2235	Si	400	5	0,6	1,5	—	0,5	400	150	150	S-35
1N2235A	Si	400	5	0,6	5	—	0,35	400	150	150	S-35
SKN5/04	Si	400	5	1	10	—	—	—	—	190A	S-35
5PM4	Si	400	5	2	5	—	50 мкА	400	150	150J	M-585
PE40	Si	400	5	1	2,5	5	—	400	—	—	M-40
S5A4	Si	400	5	1,1	5	1	—	400	—	150C	A-1
1N1063	Si	400	5	1,5	5	1 мА	—	400	—	170C	S-67
1N1069	Si	400	5	1,5	5	1 мА	—	400	—	170C	S-66
1N1075	Si	400	5	1,5	5	1 мА	—	400	—	170C	S-68
1N1092	Si	400	5	1,5	5	2 мА	—	400	—	170C	F-22
1N1092A	Si	400	5	1,5	5	—	5	400	100	—	F-73
40F5	Si	400	5	1,1	13	—	10	400	25	175J	S-41
VRE400X	Si	400	5	1,5	10	—	5	400	150	150	M-249
VRF400X	Si	400	5	1,5	10	2 мА	5	400	150	150	M-249
VRG400X	Si	400	5	1,5	10	2 мА	5	400	150	150	M-249
ESP5400	Si	400	5	1,2	3	10	900 мкА	400	150	150C	A-3
366H	Si	400	5	1,1	5	—	10	400	180	180J	S-27
1N1615A	Si	400	5	1,1	6	—	0,5	400	150	190J	DO-4
E3G3	Si	400	5	1,3	5	10	1	400	150	175	DO-4
F1G3	Si	400	5	1,3	20	—	1	400	150	175	DO-5
Д246	Si	400	10	1,2	10	3 мА	3	400	100	125	10
1N2254	Si	400	10	0,6	10	—	1	400	150	150	DO-4
1N2254A	Si	400	10	0,6	10	—	0,5	400	150	150	DO-4
1N2255	Si	400	10	0,6	10	—	1	400	150	150	S-35
1N2255A	Si	400	10	0,6	10	—	0,5	400	150	150	S-35
BR104A	Si	400	10	1,2	5	10	—	440	—	150	M-538
DD4526	Si	400	10	1	10	10	—	400	25	150	S-19
G4HZ	Si	400	10	1,1	10	—	3	400	125	150C	DO-4
G4010	Si	400	10	1,1	10	—	3	400	125	150A	DO-4
P4HZ	Si	400	10	1,1	10	—	3 мкА	400	125	125C	S-95
P4010	Si	400	10	1,1	10	—	3	400	125	150A	S-95
SJ404 (E, K)	Si	400	10	1	0,75	10	1,5	400	200	200C	DO-4
10PM4	Si	400	10	2	10	—	13	400	150	150J	M-586
64R2	Si	400	10	1,1	10	—	3	400	150	150C	DO-4
1N1624	Si	400	10	1,2	10	—	5	400	25	100A	S-43
1N4437	Si	400	10	1	10	—	0,2	400	160	160C	M-249
1S423	Si	400	10	1,5	30	—	50 мкА	400	100	175	S-61
R604	Si	400	10	1,3	10	—	0,2	400	160	160C	M-249
R614	Si	400	10	1,3	10	—	0,2	400	160	160C	M-249
S423	Si	400	10	1,5	30	—	50 мкА	400	100	175A	24
1S164	Si	400	10	1,6	50	—	12	400	175	175	S-103
11R4S	Si	400	10	1,6	50	2 мА	—	400	175	175J	S-103
SA4AN12	Si	400	10	0,470	10	—	2	400	—	150J	DO-4
D4010	Si	400	10	1,5	10	—	0,3	400	125	125B	S-4
S4AN12	Si	400	10	0,5	9,5	—	2	—	125	150J	DO-4
367H	Si	400	10	1,2	10	—	10	400	180	180J	S-27
1N2025	Si	400	10	1,5	25	—	5	400	150	175C	DO-5

Продолжение

Тип прибора	Материал	$U_{обр\ max}$, В	$I_{пр,\ ср\ max}$, А	$U_{пр}$, В	$I_{пр}$, А	$I_{обр}$, мкА, при $U_{обр\ max}$ ($T_{окр}=25°C$)	$I_{обр}$, мА	$U_{обр}$, В	$T_{окр}$, °C	T_{max}, °C	Корпус
40112	Si	400	10	0,6	10	75	1	400	150	175C	DO-7
E6G3	Si	400	10	1,3	10	75	1	400	150	175	DO-4
F2G3	Si	400	10	1,3	30	—	1	400	150	175J	DO-5
КД205Е	Si	500	0,3	1	0,3	100	0,2	500	85	85	10
COD1555	Si	500	0,25	1,1	0,4	10	—	500	—	100	A-52
S19A	Si	500	0,25	1,2	0,4	1,5 мА	—	500	—	—	A-54
M500B	Si	500	0,25	1,2	0,4	10	—	—	—	175	A-3
CER500B	Si	500	0,26	1,2	0,25	10	0,2	500	100	150A	DO-27
1N320	Si	500	0,25	2	0,4	—	—	—	—	200	DO-2
1N534	Si	500	0,3	2	0,3	17	—	500	—	150A	DO-3
1N1706	Si	500	0,3	1,7	1	—	0,3	500	100	125A	A-53
P4K5	Si	500	0,3	1	0,3	10	0,5	500	100	175	M-343
1N444	Si	500	0,3	1,5	0,3	1,7 мА	—	500	—	150A	DO-2
1N605	Si	500	0,3	1,5	0,2	25	—	500	—	170S	DO-1
1N605A	Si	500	0,3	1,5	0,4	2	—	500	—	170S	DO-1
1N1256	Si	500	0,32	1	0,32	—	0,5	500	125	165A	A-53
КД205А	Si	500	0,5	1	0,5	100	0,2	500	85	85	10
A2F4	Si	500	0,475	1,2	0,5	1	0,5	500	150	175	A-84
1N2085	Si	500	0,5	0,75	0,5	350	—	500	—	150A	A-53
1N3184	Si	500	0,5	1	0,25	0,3	0,02	500	100	150A	M-82
COD15554	Si	500	0,5	1,1	0,4	10	—	500	—	100	M-45
MB265	Si	500	0,5	1	0,2	1	0,06	500	100	175A	A-60
MT050	Si	500	0,5	1	0,5	—	15 мкА	500	150	175A	A-60
MT050A	Si	500	0,5	1	0,5	—	5 мкА	500	150	175A	A-60
S15	Si	500	0,5	1,2	0,8	15	—	500	—	—	A-54
S18A	Si	500	0,5	1,2	0,8	50	—	500	—	—	A-54
PS150	Si	500	0,5	1,5	0,5	—	0,5	500	150	200A	A-47
5E5	Si	500	0,5	1,1	0,5	2	50 мкА	550	100	175	DO-27
5J5	Si	500	0,5	1,1	1,5	2	50 мкА	550	100	175	DO-15
50AS	Si	500	0,5	1,15	0,5	10	—	500	—	100A	DO-3
M500C	Si	500	0,5	1,2	—	10	—	—	—	175	A-3
P6K5	Si	500	0,5	1	0,5	10	0,5	500	100	175	M-343
1N1712	Si	500	0,5	1,3	1	—	0,4	500	150	125A	A-53
1S315	Si	500	0,5	1,1	1	10	—	500	25	150	TO-1
1S1231	Si	500	0,5	1,1	1	10	—	250	25	150	DO-1
1N1764	Si	500	0,5	3	0,5	100	1	500	100	100A	A-53
CER500C	Si	500	0,5	1,2	0,5	10	0,2	500	100	150A	DO-27
S18	Si	500	0,5	1,2	0,8	100	—	500	—	—	A-54
1T505	Si	500	0,5	1,2	0,3	10	0,25	500	100	100A	A-3
2T505	Si	500	0,5	1,2	0,3	10	0,25	500	100	100A	DO-1
3T505	Si	500	0,5	1,2	0,3	10	0,25	500	100	100A	DO-13
4T505	Si	500	0,5	1,2	0,3	10	0,25	500	100	100A	DO-7
ERD500	Si	500	0,5	1,2	0,3	10	0,25	500	100	100A	M-166
1N554	Si	500	0,5	1,5	0,5	3,5	—	500	—	150A	DO-4
1S558	Si	500	0,5	1,1	0,5	50	—	500	—	150A	C-42
50M	Si	500	0,5	1,5	—	—	2	500	—	150	F-22
50S5	Si	500	0,5	1,3	1,8	—	2	500	25	175	S-41
EG100H	Si	500	0,5	1	0,5	10 мА	—	500	—	125A	DO-29
S255	Si	500	0,5	1,2	0,8	—	500 мкА	500	100	—	A-54
Д247Б	Si	500	5	1,5	5	3 мА	3	500	100	125	10
1N2236	Si	500	5	0,6	1,5	—	0,5	500	150	150	DO-4
1N2237	Si	500	5	0,6	1,5	—	0,5	500	150	150	S-35
1N2237A	Si	500	5	0,6	5	350	—	500	150	150	S-35
S5A5	Si	500	5	1,1	5	1	—	500	—	500	A-1
50F5	Si	500	5	1,1	13	—	10	500	25	175J	S-41
50LF	Si	500	5	1,5	5	—	5	500	100	—	F-73
366K	Si	500	5	1,1	5	—	10	500	180	180J	S-27
407K	Si	500	5	1,1	5	—	2	500	175	175J	DO-4
E3H3	Si	500	5	1,3	5	10	1	500	150	175	DO-4
F1H3	Si	500	5	1,3	30	—	1	500	150	175J	DO-5
КД206Б	Si	500	10	1,2	1	700	1,5	500	125	125	12
1N2256	Si	500	10	0,6	10	—	1	500	150	150	DO-4
1N2256A	Si	500	10	0,6	10	—	0,5	500	150	150	DO-4
1N2257	Si	500	10	0,6	10	—	1	500	150	150	S-35
1N2257A	Si	500	10	0,6	10	—	0,5	500	150	150	S-35
G5010	Si	500	10	1,1	10	—	3	500	125	150A	DO-4
P5010	Si	500	10	1,1	10	—	3	500	125	150A	S-95
50J2P	Si	500	10	1,3	10	2,5 мА	—	500	—	—	S-43
1S165	Si	500	10	1,6	50	—	2	500	175	175	S-103
SA5AN12	Si	500	10	0,47	10	—	2	500	—	150J	DO-4

Продолжение

Тип прибора	Материал	$U_{обр\ max}$, В	$I_{пр,\ ср\ max}$, А	$U_{пр}$, В	$I_{пр}$, А	$I_{обр}$, мкА, при $U_{обр\ max}$ ($T_{окр}$=25°C)	$I_{обр}$, мА	$U_{обр}$, В	$T_{окр}$, °C	T_{max}, °C	Корпус
D5010	Si	500	10	1,5	10	—	0,3	500	125	125B	S-4
S5AN12	Si	500	10	0,5	9,5	—	2	—	125	150J	DO-4
367K	Si	500	10	1,2	10	—	10	500	180	180J	S-27
408K	Si	500	10	1,2	10	—	2	500	175	175J	DO-4
40113	Si	500	10	0,6	10	75	0,85	500	150	175C	DO-4
E6H3	Si	500	10	1,3	10	10	1	500	150	175	DO-4
F2H3	Si	500	10	1,3	30	—	1	500	150	175J	DO-5
TR501	Si	500	10	1,5	25	—	1	500	150	175S	DO-5
КД205Ж	Si	600	0,5	1	0,5	100	0,2	600	85	85	10
1N2086	Si	600	0,5	0,75	0,5	350	—	600	—	150	A-53
BR26	Si	600	0,5	1,1	0,5	5	—	660	—	150	M-533
COD15564	Si	600	0,5	1,1	0,4	10	—	600	—	100	M-45
D65C	Si	600	0,5	1,2	0,5	—	0,15	600	125	150A	A-100
J600	Si	600	0,5	1,1	0,5	5	—	600	25	175A	DO-7
MB267	Si	600	0,5	1	0,2	1	0,06	600	100	175A	A-60
MT060	Si	600	0,5	1	0,5	0,2	25	600	150	175A	A-60
MT060A	Si	600	0,5	1	0,5	—	5 мкА	600	150	175A	A-60
S23A	Si	600	0,5	1,2	1,2	50	—	600	—	—	A-54
S30	Si	600	0,5	1,2	0,8	1	—	600	—	150A	A-54
PS160	Si	600	0,5	1,5	0,5	—	0,5	600	150	200A	A-47
1N5217	Si	600	0,5	1,2	1	—	0,2	600	75	175A	A-31
S2E60	Si	600	0,5	0,95	0,5	30	—	600	—	120	A-185
5E6	Si	600	0,5	1,1	0,5	2	50 мкА	660	100	175	DO-27
5J6	Si	600	0,5	1,1	0,5	2	50 мкА	660	100	175	DO-15
60AS	Si	600	0,5	1,15	0,5	10	—	600	—	100A	DO-3
P6M5	Si	600	0,5	1	0,5	10	0,5	600	100	175	M-343
SE05B	Si	600	0,5	1,1	0,5	10	—	600	—	130A	M-98
SW05B	Si	600	0,5	1,1	0,5	10	—	600	—	120	A-221
SD1A	Si	600	0,5	1	1,5	10	—	600	—	100S	A-221
1S1944	Si	600	0,5	1,2	0,5	—	0,4	600	125	125J	A-1
1S1232	Si	600	0,5	1,1	1	10	—	600	25	150	DO-1
1N3750	Si	600	0,5	1,5	0,5	5	—	600	—	150A	A-1
40808	Si	600	0,5	1,2	1	5	0,2	600	150	175A	DO-26
CER710	Si	600	0,5	1,2	0,5	10	0,2	600	100	150A	DO-27
1T506	Si	600	0,5	1,2	0,3	10	0,25	600	100	100A	DO-3
2T506	Si	600	0,5	1,2	0,3	10	0,25	600	100	100A	DO-1
3T506	Si	600	0,5	1,2	0,3	10	0,25	600	100	100A	DO-13
4T506	Si	600	0,5	1,2	0,3	10	0,25	600	100	100A	DO-7
ERD600	Si	600	0,5	1,2	0,3	10	0,25	600	100	100A	M-166
1N555	Si	600	0,5	1,5	0,5	5	—	600	—	150A	DO-4
60M	Si	600	0,5	1,5	—	—	2	600	—	150	F-22
60S5	Si	600	0,5	1,3	1,8	—	2	600	25	175J	S-41
S256	Si	600	0,5	1,2	0,8	—	0,5	600	100	—	A-54
Д248Б	Si	600	5	1,5	5	3 мА	3	600	100	125	10
1N1616	Si	600	5	1,5	10	—	—	—	—	175A	DO-8
1N2238	Si	600	5	0,6	1,5	—	0,5	600	150	150	DO-8
1N2238A	Si	600	5	0,6	5	—	0,35	600	150	150	DO-4
1N2239	Si	600	5	0,6	1,5	—	0,5	600	150	150	S-35
1N2239A	Si	600	5	0,6	5	—	0,35	600	150	150	S-35
G65HZ	Si	600	5	1,2	5	—	2	600	125	—	S-19
5PM6	Si	600	5	2	5	—	50 мкА	600	150	150J	M-585
PE60	Si	600	5	1	2,5	5	—	600	—	—	M-40
S5A6	Si	600	5	1,1	5	1	—	600	—	150C	A-1
S20-06	Si	600	5	1,1	60	50	—	600	25	150	S-19
60F5	Si	600	5	1,1	13	—	10	600	25	175J	S-41
60LF	Si	600	5	1,5	5	—	5	600	100	—	F-73
SJ603 (E, K)	Si	600	5	1	0,75	10	0,3	600	150	150A	DO-4
366M	Si	600	5	1,1	5	—	10	600	180	180J	S-27
1N1616A	Si	600	5	1,1	6	—	0,5	600	150	190J	DO-4
407M	Si	600	5	1,1	5	—	2	600	175	175J	DO-4
E3K3	Si	600	5	1,3	5	10	1	600	150	175	DO-4
F1K3	Si	600	5	1,3	50	—	1	600	150	175J	DO-4
MR60	Si	600	5	1	4,5	20	—	—	—	185B	DO-4
КД206В	Si	600	10	1,2	1	700	1,5	600	125	125	12
1N2258	Si	600	10	0,6	10	—	1	600	150	150	DO-4
1N2258A	Si	600	10	0,6	10	—	0,5	600	150	150	DO-4
1N2259	Si	600	10	0,6	10	—	1	600	150	150	S-35
1N2259A	Si	600	10	0,6	10	—	0,5	600	150	150	S-35
BR106A	Si	600	10	1,2	5	10	—	650	—	150J	M-538
P6HZ	Si	600	10	1,1	10	—	3	600	125	150C	DO-4

Продолжение

Тип прибора	Материал	$U_{обр\ max}$, В	$I_{пр,\ ср\ max}$, А	$U_{пр}$, А	$I_{пр}$, А	$I_{обр}$, мкА, при $U_{обр\ max}$ ($T_{окр}$=25°С)	$I_{обр}$, мА	$U_{обр}$, В	$T_{окр}$, °С	T_{max}, °С	Корпус
P6010	Si	600	10	1,1	10	—	3	600	125	150A	S-95
SJ604 (E, K)	Si	600	10	1	0,75	10	1,5	600	200	200C	DO-4
10PM6	Si	600	10	2	10	—	8	600	150	150	M-586
0604	Si	600	10	1,4	30	100	—	300	—	150J	S-87
66R2	Si	600	10	1,1	10	—	2	600	150	150C	DO-4
66R2S	Si	600	10	1,1	10	—	2	600	150	150C	DO-4
1N4438	Si	600	10	1	10	—	0,2	600	160	160C	M-249
1S425	Si	600	10	1,5	30	—	50 мкА	600	100	175	S-61
R606	Si	600	10	1,3	10	—	200 мкА	600	160	160C	M-249
R616	Si	600	10	1,3	10	—	200 мкА	600	160	160C	M-249
S425	Si	600	10	1,5	30	—	50 мкА	600	100	175A	S-24
1S166	Si	600	10	1,6	50	—	1,5	600	175	175	S-103
SA6AN12	Si	600	10	0,47	10	—	2	600	—	150	DO-4
BYX42/600	Si	600	10	1,4	15	—	0,2	400	125	175J	DO-4
D6010	Si	600	10	1,5	1,5	—	0,3	600	125	125B	S-4
S6AN12	Si	600	10	0,5	9,5	—	2	—	125	150J	DO-4
367M	Si	600	10	1,2	10	—	10	600	180	180J	S-27
408M	Si	600	10	1,2	10	—	2	600	175	175J	DO-4
40114	Si	600	10	0,6	10	75	0,75	600	150	175C	DO-4
E6K3	Si	600	10	1,3	10	10	1	600	150	175	DO-4
F2K3	Si	600	10	1,3	30	—	1	600	150	175J	DO-5
КД205И	Si	700	0,3	1	0,3	100	0,2	700	85	85	10
B250C300	Si	700	0,3	1,1	1	100	—	—	—	125J	M-671
1N2878	Si	700	0,250	2	0,25	0,5	—	700	—	150S	M-122
1N1258	Si	700	0,28	1	0,28	—	0,5	700	125	165A	A-53
КД203Г	Si	700	10	1	10	1,5 мА	1,5	1000	100	100	143
S7AN12	Si	700	10	0,5	9,5	—	2	125	—	150J	DO-4
408P	Si	700	10	1,2	10	—	2	700	175	175J	DO-4
E6M3	Si	700	10	1,3	10	10	1	700	150	175	DO-4
F2M3	Si	700	10	1,3	30	—	1	700	150	175J	DO-5
КД210Б	Si	800	10	1	10	1,5 мА	1,5	800	100	125	6
1N2260	Si	800	10	0,6	10	—	5	800	150	150	DO-4
1N2260A	Si	800	10	0,6	10	—	0,5	800	150	150	DO-4
1N2261	Si	800	10	0,6	10	—	0,5	800	150	150	35
BR108A	Si	800	10	1,2	5	10	—	850	—	150	M-538
G8HZ	Si	800	10	1,1	10	—	3	800	125	150C	DO-4
P8010	Si	800	10	1,1	10	—	3	800	125	150A	DO-4
P8HZ	Si	800	10	1,1	10	—	3 мкА	800	125	125C	S-95
P8010	Si	800	10	1,1	10	—	3	800	125	150A	S-95
10PM8	Si	800	10	2	10	—	7	800	150	150J	M-586
68R2	Si	800	10	1,1	10	—	1	800	150	150J	DO-4
68R2S	Si	800	10	1,1	10	—	1	800	150	150C	DO-4
1N4439	Si	800	10	1,2	10	—	1	800	100	160A	M-249
1N427	Si	800	10	1,5	30	—	0,05	800	100	175S	S-61
S427	Si	800	10	1,5	30	—	50 мкА	800	100	175A	S-24
1S544	Si	800	10	1,6	50	—	1,4	800	175	175	S-103
SA8AN12	Si	800	10	0,47	10	—	2	800	—	150J	DO-4
D8010	Si	800	10	1,5	10	—	0,3	800	125	125	S-4
S8AN12	Si	800	10	0,5	9,5	—	—	—	—	150	DO-4
408S	Si	800	10	1,2	10	—	—	—	—	175J	DO-4
40115	Si	800	10	0,6	10	75 мкА	—	—	—	175C	DO-4
E6N3	Si	800	10	1,3	10	10 мкА	—	—	—	175	DO-4
F2N3	Si	800	10	1,3	10	—	—	—	—	175J	DO-5

Примечание. Максимальная температура: A — окружающей среды; B — контакта, C — корпуса, J — перехода, S — хранения.

СТАБИЛИТРОНЫ

Тип прибора	$\Delta U_{ст}$, %	$U_{ст}$, В	P_{max}, мВт	$r_{ст}$, Ом	$I_{ст}$, мА	$\alpha_{U_{ст}} \cdot 10^{-2}$, %/°С	T_{max}, °С	Корпус
КС133А	10	3,3 (10 мА)	300	180	3	—11	125	17
1N5518B	5	3,3 (20 мА)	400	26	—	7	100A	DO-14
1N5518C	2	3,3 (20 мА)	400	26	—	—	175A	DO-7
1N5518D	1	3,3 (20 мА)	400	26	—	—	175A	DO-7
1S2033	10	3,3 (5 мА)	400	150	—	7	150A	A-1
1S2033A	5	3,3 (5 мА)	400	120	—	7	150A	A-1
1S7033	10	3,3 (5 мА)	400	150	—	7	150A	A-1
1S7033A	5	3,3 (5 мА)	400	100	—	7	175A	A-1

Продолжение

Тип прибора	$\Delta U_{ст}$, %	$U_{ст}$, В	P_{max}, мВт	$r_{ст}$, Ом	$I_{ст}$, мА	$\alpha U_{ст} \cdot 10^{-2}$, %/°C	T_{max}, °C	Корпус
1S7033B	15	3,3 (5 мА)	400	200	—	7	150A	A-1
2A44	10	3,3 (10 мА)	400	80	—	7	200	A-159
5508	5	3,3 (5 мА)	400	80	—	6,5	125A	A-1
BZX46C3V3	5	3,3 (20 мА)	400	28	—	6	175	DO-35
BZX55C3V3	5	3,3 (5 мА)	400	75	—	6,3	150A	DO-35
BZX83C3V3	5	3,3 (5 мА)	400	90	—	6	175J	DO-35
BZY85B3V3	2	3,3 (5 мА)	400	80	—	6,5	150J	DO-7
BZY88C33	5	3,3 (5 мА)	400	85	—	—	150J	DO-7
C6102	10	3,3 (5 мА)	400	60	—	—	175	M-185
HS7033	5	3,3 (5 мА)	400	—	—	—	175A	DO-7
KS033A	5	3,3 (5 мА)	400	100	—	10	150A	DO-7
KS033B	10	3,3 (5 мА)	400	150	—	2	150A	DO-7
LP33H	5	3,3 (5 мА)	400	100	—	6,6	150	DO-7
MZC3,3A10	—	3,3 (15 мА)	400	47	—	7	175J	M-468
Z5A3,3	1	3,3 (5 мА)	400	80	—	7	200J	A-1
Z5B3,3	5	3,3 (5 мА)	400	80	—	7	200J	A-1
Z5C3,3	10	3,3 (5 мА)	400	80	—	7	200J	A-1
Z5D3,3	15	3,3 (5 мА)	400	80	—	7	200J	A-1
ZF3,3	5	3,3 (5 мА)	400	80	—	6	150J	DO-7
ZG3,3	10	3,3 (5 мА)	400	100	—	6,5	150J	DO-7
ZP3,3	5	3,3 (5 мА)	400	80	—	5,5	150J	DO-7
KC139A	10	3,9 (10 мА)	300	180	3	—10	125	23
1N1927	1	3,9 (5 мА)	200	11	—	6	150A	A-82
1N4622	5	3,9 (0,25 мА)	250	1600	—	—	200A	DO-14
1N4686	5	3,9 (0,05 мА)	250	—	—	—	200A	DO-14
1103	1	3,9 (10 мА)	250	60	—	5	150J	C-18
BZY85C39	5	3,9 (5 мА)	2502	85	—	—	150J	DO-7
HS2039	5	3,9 (5 мА)	250	—	—	—	175A	DO-7
KS2039A	5	3,9 (5 мА)	250	100	—	7	150A	DO-7
KS2039B	10	3,9 (5 мА)	250	110	—	8	150A	DO-7
MGLA39 (A, B)	—	3,9 (20 мА)	250	15	—	4,9	150	A-2
MR39 (C — H)	5	3,9 (5 мА)	250	90	—	—	250	DO-7
MZ4622	—	3,9 (0,25 мА)	250	1600	—	—	200J	DO-7
PD6004A	—	3,9 (10 мА)	250	50	—	—	150	A-109
PD6045	5	3,9 (10 мА)	250	42	—	—	150	A-2
KC147A	10	4,7 (10 мА)	300	160	3	—9...+1	100	23
1N4624	5	4,7 (0,25 мА)	250	1500	—	—	200	DO-14
1N4688	5	4,7 (0,05 мА)	250	—	—	—	200A	DO-14
1104	10	4,7 (10 мА)	250	45	—	2	150J	C-18
BZY83C4V7	5	4,7 (5 мА)	250	90	—	1	150J	C-1
BZY83D4V7	10	4,7 (5 мА)	250	90	—	—	150J	C-1
BZY85C4V7	5	4,7 (5 мА)	250	70	—	1	150J	A-171
GLA47(A, B)	—	4,7 (10 мА)	250	10	—	1,8	175	DO-7
HS2047	5	4,7 (5 мА)	250	—	—	—	175A	DO-7
KS2047A	5	4,7 (5 мА)	250	85	—	5	150A	DO-7
KS2047B	10	4,7 (5 мА)	250	90	—	6	150A	DO-7
LAC2002	10	4,7 (10 мА)	250	15	—	—	—	M-520
MR47(C—H)	5	4,7 (5 мА)	250	80	—	—	250	DO-7
MZ4A	10	4,7 (25 мА)	250	25	—	1	150J	DO-7
MZ4624	—	4,7 (0,25 мА)	250	1500	—	—	200J	DO-7
PD6006A	—	4,7 (10 мА)	250	45	—	—	150	A-109
PD6047	5	4,7 (10 мА)	250	32	—	—	150	A-2
PD6202	10	4,7 (10 мА)	250	15	—	—	—	A1-109
OAZ240	5	4,7 (1 мА)	278	370	—	20	150J	A-24
BZY56	5	4,7 (1 мА)	280	370	—	—	150J	A-3
OAZ200	5	4,7 (1 мА)	300	420	—	4,2	150J	C-1
Z1D4,7	—	4,7 —	300	75	—	—	150J	C-29
KC156A	10	5,6 (10 мА)	300	160	3	—5...+5	100	17
Z1550	5	5,6 (5 мА)	300	45	—	—	150S	C-29
Z1555	5	5,6 (5,5 мА)	300	40	—	—	150S	C-29
Z1560	5	5,6 (6 мА)	300	37	—	—	150S	C-29
Z1565	5	5,6 (6,5 мА)	300	33	—	—	150S	C-29
Z1570	5	5,6 (7 мА)	300	30	—	—	150S	C-29
Z1A5,6	1	5,6 (5 мА)	320	—	—	6	150A	C-29
Z1B5,6	5	5,6 (5 мА)	320	40	—	6	150A	C-29
Z1C5,6	10	5,6 (5 мА)	320	40	—	6	150A	C-29
Z1D5,6	15	5,6 (5 мА)	320	40	—	6	150A	C-29
KC168B	0,5	6,8 (10 мА)	150	120	3	±5	100	17
1N1984	10	6,8 (5 мА)	150	7	—	3	150	C-1
1N1984A	5	6,8 (5 мА)	150	7	—	3	150	C-1
1N1984B	1	6,8 (5 мА)	150	7	—	3	150	C-1
653C3	5	6,8 (5 мА)	150	4	—	4,1	150A	C-3
AZ6,8	5	6,8 (5 мА)	150	20	—	—	170A	DO-7

Тип прибора	$\Delta U_{ст}$, В	$U_{ст}$, В	P_{max}, мВт	$r_{ст}$, Ом	$I_{ст}$, мА	$\alpha U_{ст} \cdot 10^{-2}$, %/°C	T_{max}, °C	Корпус
BZ6,8	5	6,8 (5 мА)	150	—	—	—	170A	DO-7
Z6,8	5	6,8 (5 мА)	150	—	—	—	150A	C-18
ZZ6,8	5	6,8 (5 мА)	150	60	—	—	150A	C-18
KC168A	10	6,8 (10 мА)	300	120	3	−6...+6	100	17
1N710A	—	6,8 (25 мА)	250	4,7	3,8	—	175A	DO-7
1N4099	5	6,8 (0,25 мА)	250	200	—	—	200J	DO-7
1106	10	6,8 (10 мА)	250	8	—	3	150	C-18
BLVA168	7	6,8 (0,25 мА)	250	350	—	—	150A	A-9
BLVA168A	3	6,8 (0,25 мА)	250	350	—	—	150A	A-9
BLVA168B	2	6,8 (0,25 мА)	250	350	—	—	150A	A-9
BLVA168C	1	6,8 (0,25 мА)	250	350	—	—	150A	A-9
BLVA468	7	6,8 (0,25 мА)	250	—	—	—	150A	A-9
BLVA468A	3	6,8 (0,25 мА)	250	—	—	—	150A	A-9
BLVA468B	2	6,8 (0,25 мА)	250	—	—	—	150A	A-9
BLVA468C	1	6,8 (0,25 мА)	250	—	—	—	150A	A-9
BZX58C6V8	5	6,8 (10 мА)	250	7	—	3	150A	DO-7
BZY83C6V8	5	6,8 (5 мА)	250	8	—	7	150J	C-1
BZY83D6V8	10	6,8 (5 мА)	250	15	—	7	150J	C-1
BZY83C6V8	5	6,8 (5 мА)	250	8	—	7	150J	A-171
KS2068A	5	6,8 (5 мА)	250	15	—	6	150A	DO-7
KS2068B	10	6,8 (5 мА)	250	40	—	6	150A	DO-7
MZ6A	10	6,8 (15 мА)	250	8	—	3	150A	DO-7
PD6010A	—	6,8 (5 мА)	250	25	—	—	150	A-109
PD6051	5	6,8 (10 мА)	250	7	—	—	150	A-2
PD6206	10	6,8 (1 мА)	250	50	—	—	—	A-109
OAZ244	5	6,8 (1 мА)	278	5	—	27	150J	A-24
BZY60	5	6,8 (1 мА)	280	5	—	—	150J	A-3
MC6010A	—	6,8 (10 мА)	300	14	—	—	175	A-3
OAZ204	5	6,8 (1 мА)	300	180	—	3,7	150J	C-1
Z1A6,8	1	6,8 (5 мА)	320	8	—	7	150A	C-29
Z1B6,8	5	6,8 (5 мА)	320	8	—	7	150A	C-29
Z1C6,8	10	6,8 (5 мА)	320	8	—	7	150A	C-29
Z1D6,8	15	6,8 (5 мА)	320	8	—	7	150A	C-29
LDZ70/6A8	5	6,8 (20 мА)	360	5	—	—	150J	M-401
KC170A	0,35	7 (10 мА)	150	90	3	±1	100	18
653C4	5	7 (5 мА)	150	5	—	4,2	150A	C-3
KC175A	0,5	7,5 (5 мА)	150	70	3	±4	100	18
BZX84C7V5	5	7,5 (5 мА)	110	20	—	5,3	125J	M-500
9607	5	7,5 (1 мА)	120	100	—	4	150	C-29
AZ7,5	5	7,5 (5 мА)	150	15	—	—	170A	DO-7
BZ7,5	5	7,5 (5 мА)	150	35	—	—	170A	DO-7
Z7,5	5	7,5 (5 мА)	150	40	—	—	150A	C-18
ZZ7,5	5	7,5 (5 мА)	150	40	—	—	150A	C-18
KC182C	0,6	8,2 (5 мА)	150	30	3	5	100	18
1N1985	10	8,2 (5 мА)	150	15	—	6	150	C-1
1N1985A	5	8,2 (5 мА)	150	15	—	6	150	C-1
1N1985B	1	8,2 (5 мА)	150	15	—	6	150	C-1
AZ8,2	5	8,2 (5 мА)	150	20	—	—	170A	DO-7
BZ8,2	5	8,2 (5 мА)	150	50	—	—	170A	DO-7
LZ8,2	10	8,2 (5 мА)	150	40	—	—	170A	DO-7
Z8,2	5	8,2 (5 мА)	150	40	—	—	150A	C-18
ZZ8,2	5	8,2 (5 мА)	150	40	—	—	150A	C-18
KC190A	—	9 (5 мА)	125	22	1	8	125	19
KS77	5	9 (5 мА)	57	35	—	—	125A	DO-7
KS77B	5	9 (5 мА)	57	35	—	—	100A	DO-7
KS78	5	9 (5 мА)	57	35	—	—	125A	DO-7
KS78B	5	9 (5 мА)	57	35	—	—	100A	DO-7
654C9	5	9 (5 мА)	150	12	—	5,2	150A	C-3
Д818A	20	9 (10 мА)	300	100	3	±2,3	100	20
1N764-3	5	9 (10 мА)	250	12	—	5	150	DO-7
1S334	7	9 (10 мА)	250	20	—	7	150J	A-1
1S472	10	9 (15 мА)	250	15	—	5,5	150J	DO-7
HR90	5	9 (5 мА)	250	20	—	—	175A	DO-7
MZ1009	7	9 (10 мА)	250	—	—	6	175J	DO-7
SV131	5	9 (10 мА)	250	15	—	5,7	150	DO-7
SVM91	5	9 (7,5 мА)	250	75	—	1	100	DO-7
SVM905	5	9 (7,5 мА)	250	75	—	0,5	100	DO-7
SVM9010	5	9 (7,5 мА)	250	50	—	0,1	100	DO-7
SVM9011	5	9 (7,5 мА)	250	20	—	0,1	100	DO-7
SVM9020	5	9 (7,5 мА)	250	50	—	0,2	100	DO-7
SVM9021	5	9 (7,5 мА)	250	20	—	0,2	100	DO-7
SZ9	7	9 (5 мА)	250	20	—	0,75	150J	C-1
KC191A	0,6	9,1 (5 мА)	150	30	9	6	100	18

Продолжение

Тип прибора	$\Delta U_{ст}$, %	$U_{ст}$, В	P_{max}, мВт	$r_{ст}$, Ом	$I_{ст}$, мА	$\alpha U_{ст} \cdot 10^{-2}$, %/°C	T_{max}, °C	Корпус
BZX84C9V1	5	9,1 (5 мА)	110	20	—	6,5	125J	M-500
AZ9,1	5	9,1 (5 мА)	150	20	—	—	170A	DO-7
BZ9,1	5	9,1 (5 мА)	150	60	—	—	170A	DO-7
Z9,1	5	9,1 (5 мА)	150	40	—	—	150A	C-18
ZZ9,1	5	9,1 (5 мА)	150	40	—	—	150A	C-18
КС196А	5	9,6 (10 мА)	200	70	3	+0,5	100	20
BLVA195	5	9,5 (0,25 мА)	250	500	—	3,8	150A	A-9
BLVA195A	2	9,5 (0,25 мА)	250	500	—	3,8	150A	A-9
BLVA195B	1	9,5 (0,25 мА)	250	500	—	3,8	150A	A-9
BLVTA195C	1	9,5 (0,25 мА)	250	500	—	3,8	150A	A-9
BLVA495	5	9,5 (0,25 мА)	250	350	—	3,8	150A	A-9
BLVA495A	2	9,5 (0,25 мА)	250	350	—	3,8	150A	A-9
BLVA495B	1	9,5 (0,25 мА)	250	350	—	3,8	150A	A-9
BLVA495C	1	9,5 (0,25 мА)	250	350	—	3,8	150A	A-9
SV132	5	9,5 (10 мА)	250	15	—	5,7	150	DO-7
КС210Б	0,7	10 (5 мА)	150	35	3	7	100	18
BZX84C10	5	10 (5 мА)	110	25	—	—	125J	M-500
1N1986	10	10 (5 мА)	150	22	—	6,5	150	C-1
1N1986A	5	10 (5 мА)	150	22	—	6,5	150	C-1
1N1986B	1	10 (5 мА)	150	22	—	6,5	150	C-1
655C9	5	10 (5 мА)	150	15	—	5,2	150A	C-3
AZ10	5	10 (5 мА)	150	25	—	—	170A	DO-7
Z10	5	10 (5 мА)	150	50	—	—	150A	C-18
ZZ10	5	10 (5 мА)	150	60	—	—	150A	C-18
Д811	—	10...12 (5 мА)	280	—	—	9,5	100	17
1S473	10	11 (15 мА)	250	20	—	6,5	150J	DO-7
1111	10	11 (5 мА)	250	30	—	7	150J	C-18
BZX59C11	5	11 (5 мА)	250	18	—	7	150A	DO-7
BZX69C11	5	11 (5 мА)	250	40	—	6	175A	DO-7
BZY83C11	5	11 (5 мА)	250	20	—	8	150J	C-1
BZY85C11	5	11 (5 мА)	250	20	—	8	150	A-171
HR11	5	11 (5 мА)	250	30	—	—	175A	DO-7
HS2110	5	11 (5 мА)	250	—	—	—	175A	DO-7
KS2110A	5	11 (5 мА)	250	40	—	8	150A	DO-7
KS2110B	10	11 (5 мА)	250	60	—	8	150A	DO-7
PD6056	5	11 (5 мА)	250	11	—	—	150	A-2
SV134	5	11 (5 мА)	250	50	—	6,3	150	DO-7
SZ11	6	11 (5 мА)	250	35	—	8,2	150J	C-1
MC6015A	—	11 (10 мА)	300	23	—	—	175	A-2
Z1A11	1	11 (5 мА)	320	20	—	8	150A	C-29
Z1B11	5	11 (5 мА)	320	20	—	8	150A	C-29
Z1C11	10	11 (5 мА)	320	20	—	8	150A	C-29
КС211Ж	0,6	11 (5 мА)	125	200	0,5	9,2	125	4
PZZ11	5	11 (5 мА)	80	100	—	—	125A	C-18
BZX84C11	5	11 (5 мА)	110	30	—	—	125J	M-500
AZX84C11	5	11 (5 мА)	110	30	—	—	125J	M-500
AZ11	5	11 (5 мА)	150	30	—	—	170A	DO-7
Z11	5	11 (5 мА)	150	55	—	—	150A	C-18
ZZ11	5	11 (5 мА)	150	70	—	—	150A	C-18
КС213Б	0,9	13 (5 мА)	150	45	3	8	100	18
AZ13	5	13 (5 мА)	150	45	—	—	170A	DO-7
Z13	5	13 (5 мА)	150	70	—	—	150A	C-18
ZZ13	5	13 (5 мА)	150	90	—	—	150A	C-18
КС215Ж	0,8	15 (2 мА)	125	300	0,5	10	125	4
1N1988	10	15 (1 мА)	150	50	—	8,8	150	C-1
1N1988A	5	15 (1 мА)	150	50	—	8,8	150	C-1
1N988B	1	15 (1 мА)	150	50	—	8,8	150	C-1
AZ15	10	15 (5 мА)	150	55	—	—	170A	DO-7
Z15	5	15 (5 мА)	150	110	—	—	150A	C-18
ZZ15	10	15 (5 мА)	150	130	—	—	150A	C-18
КС218Ж	1	18 (2 мА)	125	350	0,5	10	125	4
RZ18	5	18 (2 мА)	80	160	—	—	150A	C-18
RZZ18	10	18 (5 мА)	80	210	—	—	150A	C-18
1N1989	10	18 (1 мА)	150	70	—	9,2	150	C-1
1N1989A	5	18 (1 мА)	150	70	—	9,2	150	C-1
1N1989B	1	18 (1 мА)	150	70	—	9,2	150	C-1
КС222Ж	1,1	22 (2 мА)	125	300	0,5	10	125	4
RZ22	5	22 (2 мА)	80	320	—	—	150A	C-18
RZZ22	10	22 (5 мА)	80	340	—	—	150A	C-18
1N1990	10	22 (1 мА)	150	100	—	9,4	150	C-1
1N1990A	5	22 (1 мА)	150	100	—	9,4	150	C-1
1N1990B	1	22 (1 мА)	150	100	—	9,4	150	C-1
AZ22	10	22 (5 мА)	150	100	—	—	170A	DO-7

Продолжение

Тип прибора	$\Delta U_{ст}$, %	$U_{ст}$, В	P_{max}, мВт	$r_{ст}$, Ом	$I_{ст}$, мА	$\alpha U_{ст}\cdot10^{-2}$, %/°C	T_{max}, °C	Корпус
Z22	5	22 (2 мА)	150	320	—	—	150A	C-18
ZZ22	10	11 (5 мА)	150	340	—	—	150A	C-18
KC433A	10	3,3 (30 мА)	1 Вт	180	3	—10	100	17
VZ33CH	5	3,3 (50 мА)	1	14	—	7,3	150	DO-13
Z4A3,3	1	3,3 (100 мА)	1	4	—	9	150J	A-1
Z4B3,3	5	3,3 (100 мА)	1	4	—	9	150J	A-1
Z4C3,3	10	3,3 (100 мА)	1	4	—	9	150J	A-1
Z3D3,3	15	3,3 (100 мА)	1	4	—	9	150J	A-1
7708	5	3,3 (100 мА)	1,1	7	—	6,5	125A	A-1
KC439A	10	3,9 (30 мА)	1	180	3	—10	100	17
VZ39CH	5	3,9 (50 мА)	1	12	—	4,5	150J	DO-13
Z4A3,9	5	3,9 (100 мА)	1	4	—	6	150J	A-1
Z4C3,9	10	3,9 (100 мА)	1	4	—	6	150	A-1
KC447A	10	4,7 (30 мА)	1	180	3	—8...+3	100	17
BZX29C4V7	5	4,7 (50 мА)	1	8	—	2	175J	A-1
BZX85C4V7	5	4,7 (45 мА)	1	13	—	1	150A	DO-15
VZ47CH	5	4,7 (50 мА)	1	10	—	1,5	150	DO-13
Z4A4,7	1	4,7 (4 м0)	1	4	—	6	150J	A-1
Z4B4,7	5	4,7 (100 мА)	1	4	—	6	150J	A-1
Z4C4,7	10	4,7 (100 мА)	1	4	—	6	150J	A-1
Z4D4,7	15	4,7 (100 мА)	1	4	—	6	150J	A-1
Z4,7	—	4,7 (53 мА)	1	8	—	2	175	DO-27
ZEC4,7	20	4,7 (40 мА)	1	11	—	0	165	DO-27
ZM4,7	—	4,7 (53 мА)	1	8	—	2	175	DO-41
KC456A	10	5,6 (30 мА)	1	145	3	0; 5	100	17
1N1520A	—	5,6 (35 мА)	1	10	3	3	200S	DO-3
1N1765	10	5,6 (100 мА)	1	1,2	—	—	175A	DO-13
1N1765A	5	5,6 (100 мА)	1	1,2	—	—	175A	DO-13
1N3827	10	5,6 (45 мА)	1	5	—	2	175A	A-31
1N3827A	5	5,6 (45 мА)	1	5	—	2	175A	A-31
JAN1N3827A	5	5,6 (45 мА)	1	5	—	4	175A	A-31
1N4655	5	5,6 (45 мА)	1	600	—	4	200A	DO-15
1N4734	10	5,6 (45 мА)	1	5	—	—	200A	A-1
1N4734A	5	5,6 (45 мА)	1	5	—	—	200A	A-1
BZX29C5V6	5	5,6 (50 мА)	1	5	—	2	175J	A-1
BZX85C5V6	5	5,6 (45 мА)	1	7	—	3	150A	DO-15
CZ5,6	—	5,6 (60 мА)	1	10	—	2	175	DO-15
FPZ5V6	—	5,6 (43 мА)	1	100	—	3	—	A-31
VZ56CH	5	5,6 (50 мА)	1 Вт	8	—	1,5	150	DO-13

Примечания. 1. В скобках указан режим измерения параметра $U_{ст}(I_{ст})$. 2. Максимальная температура: A — окружающей среды; J — перехода; S — хранения.

ИМПУЛЬСНЫЕ ДИОДЫ

Тип прибора	Материал	$U_{обр}$, В	$t_{вос}$, нс	$I_{обр}$, мА	$C_д$, пФ, при $U_{обр}$=0В	$I_{обр}$, мкА, при $U_{обр\,max}$	$U_{пр}$, В	$I_{пр\,max}$, мА	T_{max}, °C	Корпус
КД503В	Si	10	50 (10 мА; 10 В)	2	6	1	1,3 (10 мА)	10	70	15
CG84H	Ge	12	40 (10 мА; 10 В)		2,4	38	0,6 (40 мА)	—	—	A-1
МД3Б	Ge	10	150 (20 мА; 10 В)	1	2,5	150	1,2 (3 мА)	7	55	1
1N4008	Ge	12	70 (10 мА; 1 В)		3	100	0,5 (10 мА)		90	DO-7
КД521Д	Si	12	4 (10 мА; 10 В)	2	10	1	1 (50 мА)	50	125	—
Q12200	Si	12	3 (10 мА)	1	—	—	0,65 (10 мА)	—	75A	DO-7
Q12-200A	Si	12	3 (10 мА)	1	—	—	0,6 (0 мА)	—	75A	DO-7
Q12-200B	Si	12	3 (10 мА)	1	—	—	0,8 (20 мА)	—	75A	DO-7
Q12-200C	Si	12	3 (10 мА)	1	—	—	0,9 (30 мА)	—	75A	DO-7
Q12-200D	Si	12	3 (10 мА)	1	—	—	1 (50 мА)	—	75A	DO-7
Q12-200T	Si	12	3 (10 мА)	1	—	—	1 (150 мА)	—	75A	DO-7
Q12-300	Si	12	3 (10 мА)	1	—	—	1 (10 мА)	—	75A	DO-7
Q12-300A	Si	12	3 (10 мА)	1	—	—	1 (20 мА)	—	75A	DO-7
Q12-300B	Si	12	3 (10 мА)	1	—	—	1 (30 мА)	—	75A	DO-7
КД512А	Si	15	1 (10 мА; 10 В)	2	1	5	1 (10 мА)	20	100	15
ZS140	Si	15	2 (10 мА; 5 В)	—	2	1	0,9 (10 мА)	250	175A	DO-7
МД3А	Ge	15	100 (20 мА; 10 В)	1	1	100	1 (5 мА)	12	70	1
3FD121	Ge	15	75 (10 мА)	—	—	10	0,8 (10 мА)	30	85	DO-7
OA92	Ge	15	100 (5 мА; 5 В)	—	0,5	2,5	0,6 (3 мА)	10	75A	A-3
Д18	Ge	20	100 (50 мА; 10 В)	—	0,5	50	1 (20 мА)	16	60	8

Продолжение

Тип прибора	Материал	$U_{обр}$, В	$t_{вос}$, нц	$I_{обр}$, мА	$C_д$, пФ, при $U_{обр}=0В$	$I_{обр}$, мкА, при $U_{обр\ max}$	$U_{пр}$, В	$I_{пр\ max}$, мА	T_{max}, °C	Корпус
1S307	Ge	20	100 (2 мА)	0,2	—	25	0,75 (75 мА)	100	90A	A-1
CGD309	Ge	20	100 (50 мА)	—	—	—	1 (0,3 мА)	—	90A	A-1
T16	Si	20	100 (10 мА)	10	10	1	1 (5 мА)	25	100	DO-16
Д310	Ge	20	300 (500 мА; 20 В)	—	15	20	0,6 (600 мА)	500	70	22
1N695	Ge	20	300 (5 мА; 20 В)	—	—	—	1 (100 мА)	100	75A	DO-7
1N996	Ge	20	300 (5 мА; 10 В)	0,5	—	15	0,8 (40 мА)	50	100	DO-7
1N770	Ge	20	350 (5 мА; 10 В)	—	—	15	0,5 (15 мА)	40	90	DO-7
КД503А	Si	30	10 (10 мА; 10 В)	2	5	4	1 (10 мА)	20	125	15
1N4147	Si	30	10 (10 мА; 10 В)	1	6	5	1 (30 мА)	—	150	DO-7
1N5720	Si	30	10 (10 мА)	10	6	0,5	1 (50 мА)	—	200	DO-35
HD4101	Ge	30	10 (10 мА)	1	0,6	20	1 (10 мА)	30	90A	DO-7
HMG4147	Si	30	10 (10 мА; 10 В)	1	6	10	1 (30 мА)	—	—	M-208
HS1395	Si	30	10 (10 мА)	10	6	50	1,1 (10 мА)	75	175A	DO-7
SG9150	Si	30	10 (10 мА; 1 В)	10	10	1	1 (10 мА)	—	150J	DO-35
Д311	Ge	30	50 (50 мА; 10 В)	1	1,5	100	0,4 (10 мА)	40	70	8
AAY32	Ge	30	50 (10 мА; 1 В)	—	1,5	70	1 (110 мА)	110	85J	DO-7
КД521Г	Si	30	4 (10 мА; 10 В)	2	10	1	1 (50 мА)	50	125	16
1N904	Si	30	4 (10 мА; 5 В)	—	1	0,1	1 (10 мА)	—	150S	A-1
1N905A	Si	30	4 (10 мА; 5 В)	—	1	0,1	1 (20 мА)	300	175A	A-1
1N905AM	Si	30	4 (10 мА; 5 В)	—	1	0,1	1 (20 мА)	—	—	A-2
1N905M	Si	30	4 (10 мА; 5 В)	—	1	0,1	1 (10 мА)	—	—	A-2
1N906A	Si	30	4 (10 мА; 5 В)	—	2,5	0,1	1 (20 мА)	300	175	A-1
1N906AM	Si	30	4 (10 мА; 5 В)	—	2,5	0,1	1 (20 мА)	—	—	A-2
1N906M	Si	30	4 (10 мА; 5 В)	—	2,5	0,1	1 (10 мА)	—	—	A-2
1N907	Si	30	4 (10 мА; 5 В)	—	2,5	0,1	1 (10 мА)	—	150S	A-1
1N3067	Si	30	4 (10 мА; 1 В)	—	4	0,1	1 (5 мА)	—	200S	DO-7
1N1219	Si	30	4 (10 мА)	10	—	0,1	0,8 (10 мА)	100	175	DO-7
1N1220	Si	30	4 (10 мА)	10	—	0,1	1 (100 мА)	300	175	DO-7
1N1473	Si	30	4 (10 мА)	10	—	0,1	0,8 (10 мА)	100	125	DO-7
BAV54-30	Si	30	4 (10 мА; 6 В)	6	4		1 (10 мА)	200	200J	DO-35
BAW63A	Si	30	4 (10 мА; 6 В)	—	4	0,1	0,9 (10 мА)		175J	M-470
GP330	Si	30	4 (10 мА; 6 З)	1	3	0,05	1 (300 мА)	250	175	DO-35
HDS9010	Si	30	4 (10 мА)	10	3	0,1	1 (10 мА)	75	175A	A-1
HMG904	Si	30	4 (10 мА; 5 В)	1	1	0,1	1 (10 мА)	—	—	M-203
HMG904A	Si	30	4 (10 мА; 5 В)	1	1	0,1	1 (20 мА)	—	—	M-203
HMG907	Si	30	4 (10 мА; 5 В)	1	2,5	0,1	1 (10 мА)	—	—	M-203
HMG907A	Si	30	4 (10 мА; 5 В)	1	2,5	0,1	1 (20 мА)	—	—	M-203
HMG3596	Si	30	4 (10 мА; 10 В)	1	1	0,1	1 (30 мА)	—	—	M-203
HS9010	Si	30	4 (10 мА)	10	3	0,1	1 (10 мА)	75	—	DO-7
MC53	Si	30	4 (10 мА; 6 В)	1	4	0,1	1 (20 мА)	—	—	M-409
MC905	Si	30	4 (10 мА; 5 В)	1	1	0,1	1 (10 мА)	—	175	A-2
MC905A	Si	30	4 (10 мА; 5 В)	1	1	0,1	1 (20 мА)	—	175A	A-2
MC906	Si	30	4 (10 мА; 5 В)	1	2,5	0,1	1 (10 мА)	—	175A	A-2
MC906A	Si	30	4 (10 мА; 5 В)	1	2,5	0,1	1 (20 мА)	—	175A	A-2
MC5321	Si	30	4 (10 мА; 6 В)	—	4	1	1 (30 мА)	100	125	A-243
MGD72	Si	30	4 (10 мА)	10	4	0,2	1 (30 мА)	220	200J	DO-35
SFD43	Si	30	4 (10 мА; 6 В)	—	4	0,2	1,1 (10 мА)	150	200	—
SFD83	Si	30	4 (10 мА; 6 В)	—	4	0,2	1,1 (10 мА)	75	175	DO-7
КД509А	Si	50	4 (10 мА; 10 В)	2	4	5	1,1 (100 мА)	100	120	13
1N903A	Si	50	4 (10 мА; 5 В)	1	1	0,1	1 (20 мА)	300	175A	A-1
1N903AM	Si	50	4 (10 мА; 5 В)	—	1	0,1	1 (20 мА)	—	—	A-2
1N903M	Si	50	4 (10 мА; 5 В)	—	1	0,1	1 (10 мА)	—	—	A-2
1N908A	Si	50	4 (10 мА; 5 В)	1	2,5	0,1	1 (20 мА)	300	175A	A-1
1N908AM	Si	50	4 (10 мА; 5 В)	—	2,5	0,1	1 (20 мА)	—	—	A-2
1N3064	Si	50	4 (10 мА)	10	2	0,1	1 (10 мА)	75	200	A-1
1N3600	Si	50	4 (200 мА)	200	2,5	0,1	1 (200 мА)	—	105A	DO-7
1N3873	Si	50	4 (10 мА)	10	4	0,1	0,96 (150 мА)	150	175A	DO-7
1N3873H	Si	50	4 (10 мА)	10	4	5	1,1 (150 мА)	150	175A	DO-7
1N3954	Si	50	4 (10 мА)	200	3,2	0,1	1 (200 мА)	—	—	DO-7
1N4306	Si	50	4 (10 мА)	10	2	0,05	1 (50 мА)	75	150A	M-117
1N4307	Si	50	4 (10 мА)	10	2	0,05	1 (50 мА)	75	150A	M-118
1N4454	Si	50	4 (10 мА)	10	2	0,1	1 (10 мА)	75	200S	A-1
1N4532	Si	50	4 (10 мА)	10	2	0,1	1 (10 мА)	75	150A	A-1
BAX13	Si	50	4 (10 мА; 6 В)	10	3	0,025	0,7 (2 мА)	75	200J	A-257
BAX13A	Si	50	4 (10 мА; 6 В)	1	3	0,025	0,7 (2 мА)	75	200J	DO-35
BAX80	Si	50	4 (10 мА; 6 В)	1	4	0,03	1 (10 мА)	150	200J	DO-35
BAY38	Si	50	4 (10 мА; 1 В)	1	2	0,05	1 (50 мА)	115	175	DO-7
BAY63	Si	50	4 (10 мА)	10	4	0,1	1 (100 мА)	115	200J	DO-7
BAY71	Si	50	4 (10 мА)	10	2	0,1	1 (20 мА)	75	175A	DO-7
BAY74	Si	50	4 (200 мА)	200	3	0,1	1 (200 мА)	200	175A	DO-7

Продолжение

Тип прибора	Материал	$U_{обр}$, В	$t_{вос}$, нс	$I_{обр}$, мА	$C_д$, пФ, при $U_{обр}=0В$	$I_{обр}$, мкА, при $U_{обр\ max}$	$U_{пр}$, В	$I_{пр\ max}$, мА	T_{max}, °C	Корпус
BSA71	Si	50	4 (10 мА; 5 В)	1	2	0,1	1 (50 мА)	100	150A	A-1
FD100	Si	50	4 (10 мА)	10	2	0,1	1 (10 мА)	75	175A	DO-7
GP350	Si	50	4 (10 мА; 6 В)	1	3	0,05	1 (300 мА)	250	175	DO-35
HDS9009	Si	50	4 (10 мА)	10	2	0,1	1 (20 мА)	75	175A	A-1
HMG3600	Si	50	4 (200 мА)	200	2,5	0,1	1 (200 мА)	—	—	M-208
HMG3873	Si	50	4 (10 мА; 10 В)	1	4	0,1	0,85 (20 мА)	—	—	M-208
HMG3954	Si	50	4 (200 мА)	200	3,2	0,1	1 (200 мА)	—	—	M-208
HMG4150	Si	50	4 (200 мА)	200	2,5	0,1	1 (200 мА)	—	—	M-208
HMG4322	Si	50	4 (200 мА)	200	1,5	0,1	1 (200 мА)	—	—	M-208
HS9009	Si	50	4 (10 мА)	10	2	0,1	1 (20 мА)	75	175A	DO-7
1TT44	Si	50	4 (10 мА; 6 В)	1	4	0,1	1 (10 мА)	75	200J	A-15
MA4303	Si	50	4 (10 мА; 5 В)	—	1,5	0,03	1 (10 мА)	50	200A	A-2
MA4304	Si	50	4 (10 мА; 5 В)	1	1,5	0,03	1 (10 мА)	50	200A	A-2
MA4305	Si	50	4 (10 мА; 5 В)	1	1,5	0,03	1 (10 мА)	50	200A	A-2
MA4306	Si	50	4 (10 мА; 5 В)	1	1,5	0,025	1 (10 мА)	50	200A	A-2
MC58	Si	50	4 (10 мА; 6 В)	1	4	0,05	1 (150 мА)	—	—	M-409
MC103	Si	50	4 (10 мА; 6 В)	1	—	—	1 (10 мА)	—	—	A-1
MC903	Si	50	4 (10 мА; 5 В)	1	1	0,1	1 (10 мА)	—	175A	A-2
MC903A	Si	50	4 (10 мА; 5 В)	1	1	0,1	1 (20 мА)	—	175A	A-2
MC908	Si	50	4 (10 мА; 5 В)	1	2,5	0,1	1 (10 мА)	—	175A	A-2
MC908A	Si	50	4 (10 мА; 5 В)	1	2,5	0,1	1 (20 мА)	—	175A	A-2
MHD616	Si	50	4 (10 мА)	10	2	0,1	0,85 (10 мА)	150	200	A-1
SG5100	Si	50	4 (10 мА; 6 В)	1	4	0,25	1 (400 мА)	250	175A	DO-7
SG5250	Si	50	4 (10 мА; 6 В)	3	6	0,025	0,9 (100 мА)	200	175A	DO-7
TMD50	Si	50	4 (10 мА; 6 В)	3	4	0,5	1 (10 мА)	20	150S	A-2
USA55191/1	Si	50	4 (10 мА; 6 В)	—	5	—	1 (10 мА)	50	150	M-273
Д220	Si	50	500 (30 мА; 30 В)	0,4	15	—	1,5 (50 мА)	50 мА	100	4
1N3121	Ge	50	500 (30 мА; 35 В)	—	4	150	1,1 (150 мА)	110	60A	A-1
26P1	Ge	50	500 (30 мА; 35 В)	0,75	—	50	2 (20 мА)	—	—	DO-7
HMG626A	Si	50	500 (30 мА; 35 В)	—	—	0,1	1,5 (10 мА)	—	—	M-208
RPX50	Si	50	500 (1 мА; 30 В)	—	—	—	1,5 (1 мА)	1 A	150	A-31
КД521Б	Si	50	4 (10 мА; 10 В)	2	10	1	1 (50 мА)	50	125	16
BAW63	Si	60	4 (10 мА; 5 В)	—	4	1	0,9 (10 мА)	—	175J	M-470
GP360	Si	60	4 (10 мА; 6 В)	1	3	0,05	1 (300 мА)	250	175	DO-35
LDD5	Si	60	4 (10 мА; 6 В)	1	3	0,05	1 (50 мА)	75	150J	M-401
LDD10	Si	60	4 (10 мА; 6 В)	1	3	0,05	1 (50 мА)	75	150J	M-401
LDD15	Si	60	4 (10 мА; 6 В)	1	3	0,05	1 (50 мА)	75	150J	M-401
LDD50	Si	60	4 (10 мА; 6 В)	1	3	0,1	1 (50 мА)	75	150J	M-401
MC59	Si	60	4 (10 мА; 6 В)	1	2,5	0,1	1 (200 мА)	—	—	M-409
MT705	Si	60	4 (10 мА; 6 В)	1	3,5	0,1	1 (100 мА)	200	175A	A-60
MC55	Si	60	3 (10 мА; 6 В)	1	6	0,1	1 (200 мА)	—	—	M-409
MCPD521A	Si	60	3 (10 мА)	0,2	6	0,1	1 (200 мА)	—	150A	M-411
MCPD521B	Si	60	3 (10 мА)	0,2	6	0,1	1 (200 мА)	—	150A	M-411
MCPD521C	Si	60	3 (10 мА)	0,2	6	0,1	1 (200 мА)	—	150A	M-277
Д219A	Si	70	500 (30 мА; 30 В)	0,4	15	1	1 (50 мА)	500	100	7
DR482	Ge	70	400 (25 мА; 35 В)	—	—	15	1 (100 мА)	—	—	DO-7
1N192	Ge	70	500 (30 мА; 35 В)	0,7	1	250	1 (5 мА)	30	90	A-1
DR500	Ge	70	500 (5 мА; 40 В)	—	—	12	1 (20 мА)	—	—	DO-7
SG221	Si	70	500 (20 мА; 40 В)	—	2	0,25	1,5 (30 мА)	55	150A	A-1
Д312A	Ge	75	500 (50 мА; 10 В)	1	3	100	0,5 (10 мА)	500	60	22
AAZ15	Ge	75	350 (10 мА; 0 В)	100	2	25	0,45 (10 мА)	—	85J	DO-7
1N627A	Si	75	500 (30 мА; 35 В)	—	—	0,1	1,5 (10 мА)	—	—	DO-7
1N777	Ge	75	500 (30 мА; 40 В)	—	10	125	1 (100 мА)	—	90A	DO-7
PD127	Si	75	500 (5 мА; 40 В)	—	2	5	1 (100 мА)	60	200A	A-2
КД521A	Si	75	4 (10 мА; 10 В)	2	10	1	1 (50 мА)	500	125	15
1N914A	Si	75	4 (10 мА; 6 В)	1	2	0,025	1 (20 мА)	75	150A	A-60
1N914B	Si	75	4 (10 мА; 6 В)	1	4	0,025	1 (100 мА)	75	150A	A-1
1N914M	Si	75	4 (10 мА; 6 В)	—	—	0,025	1 (10 мА)	—	—	—
1N916A	Si	75	4 (10 мА; 6 В)	1	2	0,025	1 (20 мА)	75	150A	DO-7
1N916B	Si	75	4 (10 мА; 6 В)	1	2	0,025	1 (30 мА)	150	200S	DO-7
1N3063	Si	75	4 (10 мА; 1 В)	10	2	0,1	0,85 (10 мА)	—	200S	DO-7
1N3064	Si	75	4 (10 мА; 1 В)	10	2	0,1	1 (10 мА)	—	200S	DO-7
1N3064M	Si	75	4 (10 мА; 1 В)	10	2	0,1	1 (10 мА)	—	200S	A-2
1N3065	Si	75	4 (10 мА; 1 В)	10	1,5	0,1	1 (20 мА)	—	—	DO-7
1N3604	Si	75	4 (1 P)	10	2	0,05	1 (50 мА)	—	200S	DO-7
1N3606	Si	75	4 (10 мА)	10	2	0,05	0,55 (0,1 мА)	—	200S	DO-7
1N3607	Si	75	4 (10 мА)	10	2	0,05	1 (50 мА)	—	200S	M-50
1N4148	Si	75	4 (10 мА; 6 В)	1	4	0;025	1 (10 мА)	—	200S	DO-35
1N4149	Si	75	4 (10 мА; 6 В)	1	2	0,025	1 (10 мА)	—	200S	DO-35
1N5151	Si	75	4 (10 мА)	10	2	0,05	1 (50 мА)	—	200S	DO-35

Продолжение

Тип прибора	Материал	$U_{обр}$, В	$t_{вос}$, нс	$I_{обр}$, мА	$C_д$, пФ, при $U_{обр}=0$ В	$I_{обр}$, мкА, при $U_{обр\,max}$	$U_{пр}$, В	$I_{пр\,max}$, мА	T_{max}, °C	Корпус
1N4153	Si	75	4 (10 мА)	10	2	0,05	0,88 (20 мА)	—	200S	DO-35
1N4305	Si	75	4 (10 мА)	10	2	0,1	0,85 (10 мА)	—	200S	DO-35
1N4446	Si	75	4 (10 мА; 6 В)	—	4	0,025	1 (20 мА)	—	200S	DO-35
1N4447	Si	75	4 (10 мА; 6 В)	—	2	0,025	1 (20 мА)	—	200S	DO-35
1N4448	Si	75	4 (10 мА; 6 В)	—	4	0,025	1 (100 мА)	—	200S	DO-35
1N4449	Si	75	4 (10 мА; 6 В)	—	2	0,025	1 (30 мА)	—	200S	DO-35
1N4531	Si	75	4 (10 мА; 6 В)	1	4	0,025	1 (10 мА)	—	200S	A-1
1N5318	Si	75	4 (10 мА; 6 В)	10	2,5	0,1	1 (200 мА)	125	150A	DO-34
BAW62	Si	75	4 (10 мА; 1 В)	1	2	0,025	1 (100 мА)	100	200J	DO-35
BAX91C/TF102	Si	75	4 (10 мА)	10	3	0,1	1 (10 мА)	50	175A	DO-35
BAX95TF600	Si	75	4 (10 мА)	10	3	0,1	1 (200 мА)	200	175	DO-35
FD600	Si	75	4 (200 мА)	200	2,5	0,1	0,62 (1 мА)	200	150A	DO-7
FDN600	Si	75	4 (10 мА)	10	2,5	0,1	1 (200 мА)	125	150A	DO-34
HMG3064	Si	75	4 (10 мА; 10 В)	1	2	0,1	1 (10 мА)	—	—	M-208
HMG3598	Si	75	4 (10 мА; 10 В)	1	2(0)	0,1	0,85 (10 мА)	—	—	M-208
HMG4319	Si	75	4 (10 мА; 6 В)	1	1(0)	0,1	1 (100 мА)	—	—	M-208
HS9501	Si	75	4 (10 мА)	10	4(0)	0,1	—	350	200A	A-1
HS9504	Si	75	4 (10 мА)	10	4(0)	0,1	—	250	200A	A-1
HS9507	Si	75	4 (10 мА)	10	4(0)	0,1	—	150	200A	A-1
1TT33	Si	75	4 (10 мА; 6 В)	1	4(0)	0,05	1 (10 мА)	75	200J	A-1
MA4307	Si	75	4 (10 мА; 5 В)	1	2(0)	0,05	1 (30 мА)	100	200J	A-2
MA4308	Si	75	4 (10 мА; 5 В)	1	2(0)	0,05	1 (30 мА)	—	—	A-2
MC52	Si	75	4 (10 мА; 6 В)	1	2(0)	0,1	0 (10 мА)	—	—	M-409
MC433	Si	75	4 (10 мА)	10	2(0)	0,05	1 (50 мА)	—	175A	A-2
MGD73	Si	75	4 (10 мА; 6 В)	—	2(0)	0,4	1 (10 мА)	200	200J	DO-35
MHD611	Si	75	4 (10 мА; 6 В)	1	4(0)	0,025	1 (20 мА)	150	200	A-1
MHD612	Si	75	4 (10 мА; 6 В)	1	4(0)	0,025	1 (100 мА)	150	200	A-1
MHD614	Si	75	4 (10 мА; 6 В)	1	2(0)	0,025	1 (20 мА)	150	200	A-1
MHD615	Si	75	4 (10 мА; 6 В)	1	2(0)	0,025	1 (30 мА)	150	200	A-1
MMC1001	Si	75	4 (10 мА; 6 В)	1	2(0)	0,05	0,92 (70 мА)	—	200S	A-188
MMC1002	Si	75	4 (IPмА; 6 В)	1	2(0)	0,05	0,95 (70 мА)	—	200S	A-188
MMC1003	Si	75	4 (10 мА; 6 В)	100	2	0,05	1 (70 мА)	—	200S	A-188
MMC1004	Si	75	4 (10 мА; 6 В)	1	3	0,05	1 (150 мА)	—	200S	A-188
MMC1005	Si	75	4 (10 мА; 6 В)	1	3	0,05	1 (70 мА)	—	200S	A-188
MMC1006	Si	75	4 (10 мА; 6 В)	1	4	0,05	1 (70 мА)	—	200S	A-188
MMC1007	Si	75	4 (10 мА; 6 В)	1	4	0,05	1,5 (150 мА)	—	200S	A-188
SG5200	Si	75	4 (10 мА; 6 В)	1	4	0,25	1 (400 мА)	250	175A	DO-7
SG5260	Si	75	4 (100 мА; 6 В)	3	6	0,025	0,9 (100 мА)	200	175A	DO-7
TH4148	Si	75	4 (10 мА)	10	4	0,25	1 (10 мА)	200	175S	M-639
TMD914	Si	75	4 (10 мА; 6 В)	3	4	5	1 (10 мА)	20	150S	A-2
TMD916	Si	75	4 (10 мА; 6 В)	3	4	5	1 (10 мА)	20	150S	—
Д220Б	Si	100	500 (30 мА; 30 В)	0,4	15	1	1,5 (50 мА)	500	100	4
1N662	Si	100	500 (5 мА; 40 В)	—	3	1	1 (10 мА)	40	150A	A-1
1N662A	Si	100	500 (5 мА; 40 В)	—	—	—	1 (100 мА)	—	—	A-167
1N663	Si	100	500 (5 мА; 40 В)	—	3	5	1 (100 мА)	—	150A	A-1
JAN1N663	Si	100	500 (5 мА)	—	3	0,025	1 (100 мА)	100	150A	A-1
1N844	Si	100	500 (30 мА; 35 В)	—	—	0,1	1 (200 мА)	—	—	A-1
HMG662	Si	100	500 (5 мА; 40 В)	—	3	0,02	1 (10 мА)	—	—	M-208
HMG662A	Si	100	500 (5 мА; 40 В)	—	—	1	1 (100 мА)	—	—	M-208
HMG663	Si	100	500 (5 мА; 40 В)	—	3	5	1 (100 мА)	—	150A	A-1
1N844	Si	100	500 (30 мА; 35 В)	—	—	0,1	1 (200 мА)	—	—	A-1
DR402	Si	100	500 (30 мА; 35 В)	—	—	—	5 (20 мА)	—	—	DO-7
HMG664	Si	100	500 (30 мА; 35 В)	—	—	0,1	1 (200 мА)	—	175A	A-2
PD126	Si	100	500 (5 мА; 40 В)	—	2	0,02	1 (10 мА)	30	150A	A-2
RPX100	Si	100	500 (1 мА; 30 В)	—	—	3	1 (1,5 мА)	1 A	150A	A-31
RPX100A	Si	100	500 (1 мА; 30 В)	—	—	3	1,5 (1 A)	1 A	150A	A-31

Примечания. 1. Режимы измерения параметров $t_{вос}$ ($I_{пр}$; $U_{обр}$) и $U_{пр}$($I_{пр}$) приведены в скобках. 2. Максимальная температура: A — окружающей среды; J — перехода; S — хранения.

Зарубежные транзисторы и их отечественные аналоги

Тип зарубежного транзистора	Отечественный аналог	Страница	Тип зарубежного транзистора	Отечественный аналог	Страница
AC107	ГТ115А	66	AD163	П217	208
AC116	МП25А	78	AD164	ГТ403Б	168
AC117	ГТ402И	166	AD169	ГТ403Е	168
AC121	МП20А	76	AD262	П213	204
AC122	ГТ115Г	66	AD263	П214А	204
AC124	ГТ402И	166	AD301	ГТ703Г	206
AC125	МП20Б	74	AD302	П216	208
AC126	МП20Б	76	AD303	П217	208
AC127	ГТ404Б	170	AD304	П217	208
AC128	ГТ402И	166	AD312	П216	208
AC132	МП20Б, ГТ402Е	76	AD313	П217	208
AC138	ГТ402И	166	AD314	П217, ГТ701А	208
AC139	ГТ402И	166	AD325	П210Б, ГТ701А	210
AC141	ГТ404Б	170	AD431	П213	204
AC141B	ГТ404Б	170	AD436	П213	204
AC142	ГТ402И	166	AD438	П214А	204
AC150	МГТ108Д	70	AD439	П215	204
AC152	ГТ402И	166	AD457	П214А	204
AC160	П28	66	AD465	П213Б	204
AC170	МГТ108Г	70	AD467	П214А	204
AC171	МГТ108Г	70	AD469	П215	204
AC176	ГТ404А	170	AD542	ГТ701А, П217	208
AC181	ГТ404Б	170	AD545	П210Б	210
AC182	МП20Б	76	AD1202	П213Б	202
AC183	МП36А, МП38А	80	AD1203	П214Б	202
AC184	ГТ402И	166	ADP665	ГТ403Б	168
AC185	ГТ404Г	170	ADP666	ГТ403Г	168
AC187	ГТ404Б	170	ADP670	П201АЭ	202
AC188	ГТ402Е	166	ADP671	П201АЭ	202
AC540	МП39Б	72	ADP672	П202Э	202
AC541	МП39Б	72	ADY27	ГТ703В	206
AC542	МП39Б, МП41А	72	AF106	ГТ328Б	110
ACY24	МП26Б	78	AF106A	ГТ328В	110
ACY33	ГТ402И	166	AF109	ГТ328А	110
AD130	П217	206	AF139	ГТ346Б	112
AD131	П217	206	AF178	ГТ309Б	100
AD132	П217	206	AF200	ГТ328А	110
AD138	П216	208	AF201	ГТ328А	110
AD139	П213	204	AF202	ГТ328А	110
AD142	П210Б	208	AF239	ГТ346А	112
AD143	П210В	208	AF239S	ГТ346А	112
AD145	П210В, П216В	210	AF240	ГТ346Б	112
AD148	ГТ703В	206	AF251	ГТ346А	112
AD149	ГТ703В	206	AF252	ГТ346А	112
AD150	ГТ703Г	206	AF253	ГТ328А	110
AD152	ГТ403Б	168	AF256	ГТ328Б	110
AD155	ГТ403Е	168	AF260	П29А	82
AD161	ГТ705Д	212	AF261	П30	82
AD162	ГТ703Г	206	AF266	МП20А, МП42Б	80

Тип зарубежного транзистора	Отечественный аналог	Страница	Тип зарубежного транзистора	Отечественный аналог	Страница
AF271	ГТ322В	96	AUY28	П217	208
AF272	ГТ322В	96	AUY35	ГТ806А	214
AF275	ГТ322Б	96	AUY38	ГТ806В	214
AF279	ГТ330Ж	114	BC100	КТ605А	182
AF280	ГТ330И	114	BC101	КТ301Е	118
AF426	ГТ322Б	96	BC107A	КТ342А	134
AF427	ГТ322Б	98	BC107AP	КТ3102А	136
AF428	ГТ322Б	98	BC107B	КТ342Б	134
AF429	ГТ322Б	98	BC107BP	КТ310Б	136
AF430	ГТ322В	98	BC108A	КТ342А	134
AFY11	ГТ313А	110	BC108AP	КТ3102В	136
AFY12	ГТ328Б	110	BC108B	КТ342Б	134
AFY13	ГТ305В	102	BC108BP	КТ310В	136
AFY15	П30	82	BC108C	КТ342В	134
AFY29	ГТ305Б	102	BC108CP	КТ3102Г	136
AFZ11	ГТ309Б	100	BC109B	КТ342Б	134
AL100	ГТ806В	214	BC109BP	КТ3102Д	136
AL102	ГТ806В	214	BC109C	КТ342В	134
AL103	ГТ806Б	214	BC109CP	КТ3102Е	136
ASX11	МП42Б	80	BC119	КТ630Д	180
ASX12	МП42Б	80	BC139	КТ933Б	238
ASY26	МП20А, МП42А	80	BC140	КТ630Г	174
ASY31	МП42А	80	BC141	КТ630Г	174
ASY33	МП20А, МП42А	80	BC142	КТ630Г	180
ASY34	МП20А, МП42А	80	BC143	КТ933Б	238
ASY35	МП20А, МП42Б	80	BC146-01	КТ373А	146
ASY70	МП42	80	BC146-02	КТ373Б	146
ASY76	ГТ403Б	168	BC146-03	КТ373В	146
ASY77	ГТ403Г	168	BC147A	КТ373А	146
ASY80	ГТ403Б	168	BC147B	КТ373Б	146
ASZ15	ГТ701А, П217А	206	BC148A	КТ373А	146
ASZ16	П217А	206	BC148B	КТ373Б	146
ASZ17	П217А	206	BC148C	КТ373В	146
ASZ18	ГТ701А, П217В	206	BC149B	КТ373Б	146
ASZ1015	П217В	208	BC149C	КТ373В	146
ASZ1016	П217В	208	BC157	КТ361Г	128
ASZ1017	П217В	208	BC158A	КТ349В	150
ASZ1018	П217В	208	BC160-6	КТ933Б	238
AT270	МП20А, МП42Б	80	BC161-6	КТ933А	238
AT275	МП20А, МП42Б	80	BC167A	КТ373А	144
AU103	ГТ810А	212	BC167B	КТ373Б	144
AU104	ГТ810А	212	BC168A	КТ373А	144
AU107	ГТ810А	212	BC168B	КТ373Б	144
AU108	ГТ806Б	214	BC168C	КТ373В	144
AU110	ГТ806Д	214	BC169B	КТ373Б	144
AU113	ГТ810А	212	BC169C	КТ373В	144
AUY10	ГТ905А, П608А	272	BC170A	КТ375Б	122
AUY18	П214А	202	BC170B	КТ375Б	122
AUY19	П217	208	BC171A	КТ373А	144
AUY20	П217	208	BC171B	КТ373Б	144
AUY21	П210Б	208	BC172A	КТ373А	144
AUY21A	П210Б	210	BC172B	КТ373Б	144
AUY22	П210Б	208	BC172C	КТ373В	144
AUY22A	П210Б	210	BC173B	КТ373В	144

Тип зарубежного транзистора	Отечественный аналог	Страница	Тип зарубежного транзистора	Отечественный аналог	Страница
BC173C	КТ373Б	144	BC318	КТ3102Б	138
BC177AP	КТ3107А	140	BC319	КТ3102Е	138
BC177VIP	КТ3107Б	140	BC320A	КТ3107Б	142
BC178A	КТ349В	150	BC320B	КТ3107Д	142
BC178AP	КТ310В	140	BC321A	КТ3107Б	142
BC178BP	КТ3107Д	140	BC321B	КТ3107И	142
BC178VIP	КТ3107В	140	BC321C	КТ3107К	142
BC179AP	КТ3107Е	142	BC322B	КТ3107Ж	142
BC179BP	КТ3107Ж	142	BC322C	КТ3107Л	142
BC182A	КТ3102А	134	BC355	КТ352Б	126
BC182B	КТ3102Б	134	BC355A	КТ352А	126
BC182C	КТ3102Б	136	BC382B	КТ3102Б	136
BC183A	КТ3102А	136	BC382C	КТ3102Г	136
BC183B	КТ3102Б	136	BC383B	КТ3102Д	136
BC183C	КТ3102Б, КТ3102Г	136	BC383C	КТ3102Е	136
BC184A	КТ3102Д	136	BC384B	КТ3102Д	136
BC184B	КТ3102Е	136	BC384C	КТ3102Е	136
BC192	КТ351Б	124	BC451	КТ3102В	136
BC212A	КТ3107Б	140	BC452	КТ3102Б	136
BC212B	КТ3107И	140	BC453	КТ3102Д	136
BC212C	КТ3107К	140	BC454A	КТ3107Б	142
BC213A	КТ3107Б	140	BC454B	КТ3107И	142
BC213B	КТ3107И	140	BC454C	КТ3107К	142
BC213C	КТ3107К	140	BC455A	КТ3107Г	142
BC216	КТ351А	124	BC455B	КТ3107Д	142
BC216A	КТ351А	124	BC455C	КТ3107К	142
BC218	КТ340Б	130	BC456A	КТ3107Е	142
BC218A	КТ340Б	130	BC456B	КТ3107Ж	142
BC226	КТ351Б	124	BC456C	КТ3107Л	142
BC226A	КТ351Б	124	BC513	КТ345А	126
BC234	КТ342А	134	BC521	КТ3102Д	138
BC234A	КТ342А	134	BC521C	КТ3102Д	138
BC235	КТ342Б	134	BC526A	КТ3107И	142
BC235A	КТ342Б	134	BC526B	КТ3107И	142
BC237A	КТ3102А	136	BC526C	КТ3107К	142
BC237B	КТ3102Б	136	BC527-6	КТ644А	190
BC238A	КТ3102А, КТ3102В	136	BC527-10	КТ644Б	190
BC238B	КТ3102В	136	BC547A	КТ3102А	138
BC238C	КТ3102Г	136	BC547B	КТ3102Б	138
BC239B	КТ3102Д	136	BC547C	КТ3102Г	138
BC239C	КТ3102Е	136	BC548A	КТ3102А	138
BC250A	КТ361А	126	BC548B	КТ3102В	138
BC250B	КТ361Б	126	BC548C	КТ3102Г	138
BC285	П308	116	BC549A	КТ3102Д	138
BC286	КТ630Г	180	BC549B	КТ3102Д	138
BC300	КТ630Б	174	BC549C	КТ3102Е	138
BC307A	КТ3107Б	140	BC557	КТ361Д	128
BC307B	КТ3107И	140	BC557A	КТ3107А	142
BC308A	КТ3107Г	140	BC557B	КТ3107И	142
BC308B	КТ3107Д	140	BC558	КТ3107Д	142
BC308C	КТ3107К	140	BC558A	КТ3107Г	142
BC309B	КТ3107Е	140	BC558B	КТ3107Д	142
BC309C	КТ3107Л	140	BC559	КТ3107Ж	142
BC317	КТ3102А	138	BCF29	КТ3129В9	158

Тип зарубежного транзистора	Отечественный аналог	Страница	Тип зарубежного транзистора	Отечественный аналог	Страница
BCF30	КТ3129Г9	158	BCY42	КТ312Б	118
BCF32	КТ3130В9	158	BCY43	КТ312В	118
BCF33	КТ3130Е9	158	BCY54	КТ501К	90
BCF70	КТ3129Г9	158	BCY56	КТ3102Б	136
BCF81	КТ3130Б9	158	BCY57	КТ3102Е	136
BCP627A	КТ373А	146	BCY58A	КТ342А	134
BCP627B	КТ373Б	146	BCY58B	КТ342Б	134
BCP627C	КТ373В	146	BCY58C	КТ342Б	134
BCP628A	КТ373А	146	BCY58D	КТ342В	134
BCP628B	КТ373Б	146	BCY59-VII	КТ3102А	136
BCP628C	КТ373В	146	BCY59-VIII	КТ3102Б	136
BCV71	КТ3130А9	160	BCY59-IX	КТ3102Б	136
BCV72	КТ3130Б9	160	BCY59-X	КТ3102Д	136
BCW29	КТ3129В9	158	BCY65-VII	КТ3102А	138
BCW30	КТ3129Г9	158	BCY65-VIII	КТ3102Б	138
BCW31	КТ3130В9	158	BCY65-IX	КТ3102Б	138
BCW32	КТ3130В9	158	BCY69	КТ342В	134
BCW33	КТ3130Г9	160	BCY70	КТ3107А	140
BCW47	КТ373А	146	BCY71	КТ3107Е	140
BCW48	КТ373Б, КТ373В	146	BCY72	КТ3107В	140
BCW49	КТ373Б, КТ373В	146	BCY78	КТ3107Д	140
BCW57	КТ361Г	128	BCY79	КТ3102Б	140
BCW58	КТ361Е	128	BCY90	КТ208Е	88
BCW60A	КТ3130А9	160	BCY90B	КТ501Г	92
BCW60B	КТ3130Б9	160	BCY91	КТ208Е	88
BCW60C	КТ3130В9	160	BCY91B	КТ501Г	92
BCW60D	КТ3130Е9	160	BCY92	КТ208Е	88
BCW61A	КТ3129В9	158	BCY93	КТ208К	88
BCW61B	КТ3129Г9	158	BCY93B	КТ501Л	92
BCW61C	КТ3129Г9	158	BCY94	КТ208К	88
BCW69	КТ3129Б9	158	BCY94B	КТ501Л	92
BCW70	КТ3129Г9	158	BCY95	КТ208К	88
BCW71	КТ3130А9	160	BCY95B	КТ501М	92
BCW72	КТ3130Б9	160	BD109	КТ805Б	218
BCW81	КТ3130Б9	160	BD115	КТ604Б	188
BCW89	КТ3129Б9	158	BD121	КТ902А	270
BCX70G	КТ3130А9	160	BD123	КТ805Б, КТ902А	270
BCX70H	КТ3130Б9	160	BD131	КТ943В	244
BCX70J	КТ3130В9	160	BD132	КТ932Б	242
BCX70K	КТ3130В9	160	BD135-6	КТ943А	244
BCX71G	КТ3129Б9	158	BD136	КТ626А	200
BCX71H	КТ3129Г9	158	BD137-6	КТ943Б	244
BCX71J	КТ3139Г9	158	BD138	КТ626Б	200
BCY10	КТ208Е	88	BD139-6	КТ943В	244
BCY11	КТ208Л	88	BD140	КТ626В	200
BCY12	КТ208Д	88	BD142	КТ819БМ	234
BCY30	КТ208Л	88	BD148	КТ805Б	218
BCY31	КТ208М	88	BD149	КТ805Б	218
BCY32	КТ208М	88	BD165	КТ815А	222
BCY33	КТ208Г	88	BD166	КТ814Б	220
BCY34	КТ208Г	88	BD167	КТ815Б	222
BCY38	КТ501Д	90	BD168	КТ814В	220
BCY39	КТ501М	90	BD169	КТ815В	222
BCY40	КТ501Д	90	BD170	КТ814Г	220

21 Заказ № 1141

Тип зарубежного транзистора	Отечественный аналог	Страница	Тип зарубежного транзистора	Отечественный аналог	Страница
BD175	КТ817Б	226	BD377	КТ943Б	244
BD176	КТ816Б	224	BD379	КТ943В	244
BD177	КТ817В	226	BD386	КТ644Б	190
BD178	КТ816В	224	BD433	КТ817А	226
BD179	КТ817Г	226	BD434	КТ816А	224
BD180	КТ816Г	224	BD435	КТ817А	226
BD181	КТ819БМ	232	BD436	КТ816А	224
BD182	КТ819ВМ	232	BD437	КТ817Б	226
BD183	КТ819ГМ	232	BD438	КТ816Б	224
BD201	КТ819В	232	BD439	КТ817В	226
BD202	КТ818Б	228	BD440	КТ816В	224
BD203	КТ819Г	232	BD441	КТ817Г	226
BD204	КТ818В	228	BD442	КТ816Г	224
BD216	КТ809А	244	BD533	КТ819Б	234
BD220	КТ817Г	226	BD534	КТ818Б	230
BD221	КТ817В	226	BD535	КТ819В	234
BD222	КТ817Г	226	BD536	КТ818В	230
BD223	КТ837Н	240	BD537	КТ819Г	234
BD224	КТ837Ф	240	BD538	КТ818Г	230
BD225	КТ837С	240	BD611	КТ817А	226
BD226	КТ943А	244	BD612	КТ816А	224
BD227	КТ639Б	192	BD613	КТ817А	226
BD228	КТ943Б	244	BD614	КТ816А	224
BD229	КТ639Д	192	BD615	КТ817Б	226
BD230	КТ943В	244	BD616	КТ816Б	224
BD233	КТ817Б	226	BD617	КТ817В	226
BD234	КТ816Б	224	BD618	КТ816В	224
BD235	КТ817В	226	BD619	КТ817Г	226
BD236	КТ816В	224	BD620	КТ816Г	224
BD237	КТ817Г	226	BD643	КТ829В	258
BD238	КТ816Г	224	BD645	КТ829Б	258
BD239	КТ817В	226	BD647	КТ829А	258
BD239A	КТ817В	226	BD663	КТ819А	234
BD239B	КТ817Г	226	BD664	КТ818Б	230
BD240	КТ816Г	224	BD675	КТ829Г	258
BD240A	КТ816В	224	BD675A	КТ829Г	258
BD240B	КТ816Г	224	BD677	КТ829В	258
BD253	КТ809А	244	BD677A	КТ829В	258
BD263	КТ829Б	258	BD679	КТ829Б	260
BD263A	КТ829А	258	BD679A	КТ829Б	260
BD265	КТ829Б	260	BD681	КТ829А	260
BD265A	КТ829А	260	BD705	КТ819А	234
BD267	КТ829Б	260	BD706	КТ818Б	230
BD267A	КТ829А	260	BD707	КТ819В	234
BD291	КТ819А	234	BD708	КТ818В	230
BD292	КТ818А	228	BD709	КТ819Г	234
BD293	КТ819Б	234	BD710	КТ818Г	230
BD294	КТ818Б	228	BD711	КТ819Г	234
BD295	КТ819В	236	BD712	КТ818Г	230
BD296	КТ818В	230	BD813	КТ815А	222
BD331	КТ829В	258	BD814	КТ814А	220
BD333	КТ829Б	258	BD815	КТ815Б	222
BD335	КТ829А	258	BD816	КТ814В	220
BD375	КТ943А	244	BD817	КТ815В	222

Тип зарубежного транзистора	Отечественный аналог	Страница	Тип зарубежного транзистора	Отечественный аналог	Страница
BD818	КТ814Г	220	BDX10	КТ819ГМ	234
BD825	КТ646А	194	BDX10C	КТ819ГМ	234
BD826	КТ639Б	192	BDX13C	КТ819БМ	234
BD827	КТ646А	194	BDX18	КТ818ГМ	232
BD828	КТ638Д	192	BDX25	КТ802А, КТ808А	248
BD840	КТ639В	192	BDX53	КТ829Г	260
BD842	КТ639Д	192	BDX53A	КТ829В	260
BD933	КТ817Б	226	BDX53B	КТ829Б	260
BD934	КТ816Б	224	BDX53C	КТ829А	260
BD935	КТ817В	226	BDX62	КТ825Д	256
BD936	КТ816В	224	BDX62A	КТ825Г	256
BD937	КТ817Г	226	BDX62B	КТ825Г	256
BD938	КТ816Г	224	BDX63	КТ827Б	256
BD944	КТ837Ф	240	BDX63A	КТ827А	256
BD946	КТ837Ф	240	BDX64	КТ825Д	256
BD948	КТ837Ф	240	BDX64A	КТ825Г	256
BD949	КТ819Б	238	BDX64B	КТ825Г	256
BD950	КТ818Б	230	BDX65	КТ827Б	256
BD951	КТ819В	238	BDX65A	КТ827А	256
BD952	КТ818В	230	BDX66	КТ825Д	256
BD953	КТ819Г	234	BDX66A	КТ825Г	256
BD954	КТ818Г	230	BDX66B	КТ825Г	256
BDT91	КТ819Б	236	BDX67	КТ827Б	256
BDT92	КТ818Б	230	BDX67A	КТ827А	256
BDT93	КТ819В	236	BDX71	КТ819В	234
BDT94	КТ818В	230	BDX73	КТ819Г	234
BDT95	КТ819Г	236	BDX77	КТ819Г	232
BDT96	КТ818Г	230	BDX78	КТ818Г	228
BDV91	КТ819Б	236	BDX85	КТ827В	258
BDV92	КТ818Б	230	BDX85A	КТ827В	258
BDV93	КТ819В	236	BDX85B	КТ827Б	258
BDV94	КТ818В	230	BDX85C	КТ827А	258
BDV95	КТ819Г	236	BDX86	КТ825Б	256
BDV96	КТ818Г	230	BDX86A	КТ825Б	256
BDW21	КТ819АМ	234	BDX86B	КТ825Г	256
BDW21A	КТ819БМ	234	BDX86C	КТ825Г	256
BDW21B	КТ819ВМ	234	BDX87	КТ827В	258
BDW21C	КТ819ГМ	234	BDX87A	КТ827В	258
BDW22	КТ818БМ	230	BDX87B	КТ827Б	258
BDW22A	КТ818ВМ	230	BDX87C	КТ827А	258
BDW22B	КТ818ГМ	230	BDX88	КТ825Д	256
BDW22C	КТ818ГМ	230	BDX88A	КТ825Д	256
BDW23	КТ829Г	260	BDX88B	КТ825Г	256
BDW23A	КТ829В	260	BDX88C	КТ825Г	256
BDW23B	КТ829Б	260	BDX91	КТ819БМ	236
BDW23C	КТ829А	260	BDX92	КТ818БМ	230
BDW51	КТ819АМ	234	BDX93	КТ819БМ	236
BDW51A	КТ819ВМ	234	BDX94	КТ818ВМ	230
BDW51B	КТ819ГМ	234	BDX95	КТ819ГМ	238
BDW51C	КТ819ГМ	234	BDX96	КТ818ГМ	230
BDW52	КТ818БМ	230	BDY12	КТ805Б	218
BDW52A	КТ818ВМ	230	BDY13	КТ805Б	218
BDW52B	КТ818ГМ	232	BDY20	КТ819ГМ	236
BDW52C	КТ818ГМ	232	BDY23	КТ803А	248

Продолжение

Тип зарубежного транзистора	Отечественный аналог	Страница	Тип зарубежного транзистора	Отечественный аналог	Страница
BDY24	КТ803А	246	BF480	КТ3120А	164
BDY25	КТ812В	252	BF615	КТ940Б	198
BDY34	КТ943А	244	BF617	КТ940А	198
BDY38	КТ819ГМ	236	BF680	КТ3109А	164
BDY60	КТ805А	218	BF970	КТ3109В	164
BDY61	КТ805Б	218	BF979	КТ3109А	164
BDY71	КТ808БМ	246	BFJ57	КТ602Б	200
BDY72	КТ802А	248	BFJ70	КТ339В	122
BDY73	КТ819ГМ	236	BFJ93	КТ342Б	134
BDY78	КТ805Б	218	BFJ98	КТ611Г	190
BDY79	КТ802А	248	BFP177	КТ611В	190
BDY90	КТ908А, КТ945А	254	BFP178	КТ611Г	190
BDY91	КТ908А, КТ945А	254	BFP179A	КТ611Г	190
BDY92	КТ908А, КТ908Б	250	BFP179B	КТ611Б	190
BDY93	КТ704Б, КТ828Б	216	BFP179C	КТ618А	182
BDY94	КТ704Б, КТ812А	216	BFP719	КТ315А	120
BDY95	КТ704Б	216	BFP720	КТ315Б	120
BF111	КТ611А	188	BFP721	КТ315В	120
BF114	КТ611Г	188	BFP722	КТ315Г	120
BF137	КТ611Г	190	BFR34	КТ372Б	156
BF140A	КТ611В	190	BFR34A	КТ372Б	156
BF173	КТ339В	122	BFR90	КТ371А	160
BF177	КТ602А	200	BFS62	КТ368А	152
BF178	КТ611Г	188	BFW16	КТ610А	262
BF179B	КТ611Б	188	BFW30	КТ399А	162
BF179C	КТ618А	182	BFW45	КТ611Г	190
BF186	КТ611Г	190	BFW89	КТ351Б	124
BF197	КТ339Г	122	BFW90	КТ351Б	124
BF199	КТ339АМ	122	BFW91	КТ351Б	124
BF208	КТ339А	122	BFW92	КТ382Б	162
BF223	КТ339В	122	BFX12	КТ326А	152
BF240	КТ312В	120	BFX13	КТ326Б	152
BF254	КТ339АМ	—	BFX29	КТ933Б	238
BF257	КТ611Г	188	BFX30	КТ933Б	238
BF258	КТ604Б, КТ940Б	186	BFX44	КТ340В	130
BF259	КТ604Б	186	BFX65	КТ3102Е	140
BF273	КТ339А	122	BFX73	КТ368А	154
BF291	КТ611Г	190	BFX84	КТ630Г	180
BF297	КТ940В	198	BFX85	КТ630Г	180
BF298	КТ940А	198	BFX86	КТ630Д	180
BF299	КТ940А	198	BFX87	КТ933Б	238
BF305	КТ611Г	188	BFX88	КТ933Б	238
BF306	КТ339В	122	BFX89	КТ355А	156
BF311	КТ339Б	122	BFX94	КТ3117А	148
BF330	КТ339В	122	BFY19	КТ326Б	152
BF336	КТ611Г	188	BFY34	КТ630Г	176
BF337	КТ604Б	186	BFY45	КТ611Г	188
BF338	КТ940А	186	BFY46	КТ630Д	176
BF457	КТ940В	196	BFY50	КТ630Г	176
BF458	КТ940Б	196	BFY51	КТ630Д	176
BF459	КТ940А	196	BFY52	КТ630Д	176
BF469	КТ940Б	196	BFY53	КТ630Д	176
BF470	КТ940А	196	BFY55	КТ630Г	176
BF471	КТ605БМ, КТ940А	182	BFY56	КТ630Г	176

Продолжение

Тип зарубежного транзистора	Отечественный аналог	Страница	Тип зарубежного транзистора	Отечественный аналог	Страница
BFY56A	КТ630Г	176	BSW66A	КТ630Г	180
BFY56B	КТ630Г	176	BSW67	КТ630А	178
BFY65	КТ611Г	188	BSW67A	КТ630А	180
BFY66	КТ355А	156	BSW68	КТ630В	178
BFY67A	КТ630А	178	BSW68A	КТ630В	180
BFY67C	КТ630А	178	BSW88A	КТ375А	122
BFY68	КТ630Е	178	BSX21	П308	116
BFY68A	КТ630Б	178	BSX32	КТ928Б	196
BFY78	КТ368А	154	BSX38	КТ340Б	—
BFY80	КТ601А, П308	116	BSX38A	КТ340А	128
BFY90	КТ399А	162	BSX45	КТ630Г	178
BLW18	КТ920Б	264	BSX45-6	КТ630Г	180
BLW24	КТ922Г	266	BSX45-10	КТ630Г	180
BLX92	КТ913А	268	BSX45-16	КТ630Б	180
BLX93	КТ913Б	268	BSX46	КТ630Г	178
BLY47	КТ808А	246	BSX46-6	КТ630Г	180
BLY47A	КТ808А	246	BSX46-10	КТ630Г	180
BLY48	КТ808А	246	BSX46-16	КТ630Б	180
BLY48A	КТ808А	246	BSX47	КТ630Б	178
BLY49	КТ809А	244	BSX47-6	КТ630А	180
BLY49A	КТ809А	244	BSX47-10	КТ630Б	180
BLY50	КТ809А	244	BSX51	КТ340В	130
BLY50A	КТ809А	244	BSX52	КТ340В	130
BLY63	КТ920Г	264	BSX53A	КТ340А	128
BLY88A	КТ920Г	264	BSX59	КТ928А	196
BSJ36	КТ351Б	124	BSX60	КТ928А	196
BSJ63	КТ340Б	130	BSX61	КТ928А	196
BSS27	КТ928А	196	BSX62	КТ801Б	214
BSS28	КТ928Б	196	BSX63	КТ801А	214
BSS29	КТ928А	196	BSX66	КТ306А, КТ306Д	130
BSS38	КТ503Е, КТ602АМ	94	BSX67	КТ306А, КТ306Д	130
BSS42	КТ630А	178	BSX72	КТ630Д	180
BSS68	КТ502Е	92	BSX75	КТ3117А	148
BSV15-6	КТ639Г	194	BSX79A	КТ342А, КТ3117А	134
BSV15-10	КТ639Д	194	BSX79B	КТ342Б	134
BSV15-16	КТ639В	194	BSX80	КТ375Е	122
BSV16	КТ639Д	194	BSX81A	КТ375А	122
BSV49A	КТ351Б	124	BSX89	КТ616А	184
BSV59-VIII	КТ3117А	—	BSX97	КТ3117А	148
BSW19	КТ343Б	150	BSXP59	КТ928А	196
BSW20	КТ361Г	128	BSXP60	КТ928А	196
BSW21	КТ343Б	150	BSXP61	КТ928А	196
BSW27	КТ928А	196	BSXP87	КТ340В	130
BSW36	КТ603Б	182	BSY17	КТ616Б	184
BSW39-6	КТ630Г	178	BSY18	КТ616Б	184
BSW39-10	КТ630Г	178	BSY26	КТ340В	128
BSW39-16	КТ630Г	180	BSY27	КТ340В	128
BSW41	КТ616А	182	BSY34	КТ608А	186
BSW51	КТ928Б	196	BSY38	КТ340В	128
BSW52	КТ928Б	196	BSY39	КТ340Б	128
BSW61	КТ3117А	148	BSY40	КТ343А	150
BSW62	КТ3117А	148	BSY41	КТ343Б	150
BSW65	КТ630Г	178	BSY51	КТ630Д	176
BSW66	КТ630Г	178	BSY52	КТ630Е	176

Продолжение

Тип зарубежного транзистора	Отечественный аналог	Страница	Тип зарубежного транзистора	Отечественный аналог	Страница
BSY53	КТ630Г	176	EFT250	П217	208
BSY54	КТ630Г	176	EFT306	МП40	72
BSY55	КТ630А	176	EFT307	МП40	72
BSY56	КТ630Б	176	EFT308	КТ208Б	88
BSY58	КТ608А	186	EFT311	МП20А	76
BSY62	КТ616Б	184	EFT312	МП20А	76
BSY72	КТ352А	126	EFT313	МП20Б	78
BSY73	КТ312Б	118	EFT317	П401	104
BSY79	П309	116	EFT319	П401	106
BSY95	КТ340В	128	EFT320	П401	106
BSY95A	КТ340В	128	EFT321	МП20А	78
BSYP62	КТ340В	130	EFT322	МП20А	78
BSYP63	КТ340В	130	EFT323	МП20Б	78
BSZ10	КТ104Б	84	EFT331	МП20А	74
BSZ11	КТ104Б	84	EFT332	МП20А	74
BSZ12	КТ203А	86	EFT333	МП20Б	74
BU106	КТ812Б	250	EFT341	МП21Д	74
BU108	КТ839А	252	EFT342	МП21Д	74
BU120	КТ809А	244	EFT343	МП21Д	74
BU123	КТ802А	248	GC100	ГТ109А	64
BU126	КТ704Б, КТ828А	216	GC101	ГТ109А	64
BU129	КТ809А	244	GC112	МП26А	78
BU132	КТ704А	216	GC116	МГТ108Д	70
BU133	КТ704Б, КТ828А	216	GC117	МГТ108Д	70
BU204	КТ838А	238	GC118	МГТ108Д	70
BU205	КТ838А	238	GC121	МП20А, МП39Б	76
BU207	КТ838А	238	GC122	МП20А	76
BU207A	КТ838А	238	GC123	МП21Г	76
BU208A	КТ838А	238	GC500	ГТ402Д	166
BU326	КТ828А, КТ840А	240	GC501	ГТ402Е	166
BU326A	КТ828А, КТ840А	242	GC502	ГТ402И	166
BU409	КТ812Б	252	GC507	МП20А	74
BU606	КТ840А	242	GC508	МП20Б	74
BU607	КТ840Б	242	GC509	ПМ21Г	74
BU608	КТ848А	242	GC510K	ГТ403Е	168
BUX77	КТ908А	250	GC512K	ГТ403Е	168
BUX82	КТ812А	252	GC515	МП20А	76
BUX83	КТ812А	252	GC516	МП20А	76
BUX97	КТ828А	252	GC517	МП20Б	76
BUX97A	КТ828А	252	GC518	МП20Б	76
BUX97B	КТ828А	252	GC519	МП20Б	76
BUY18	КТ840А	242	GC525	МП35А, МП36А	82
BUY43	П702	220	GC526	МП36А, МП37А	82
BUY46	П702А	220	GC527	МП36А, МП38А	82
BUY55	КТ808А	246	GCN55	МП20А	76
BUYP52	КТ802А	248	GCN56	МП21Г	76
BUYP53	КТ802А	248	GD160	П213Б	204
BUYP54	КТ803А	248	GD170	П213Б	204
D41D1	КТ626А	200	GD175	П213Б	204
D41D4	КТ626Б	200	GD180	П214А	204
D41D7	КТ626В	200	GD240	П213	204
EFT212	П216	208	GD241	П213	204
EFT213	П216	208	GD242	П214А	204
EFT214	П217	208	GD243	П214А	204

Продолжение

Тип зарубежного транзистора	Отечественный аналог	Страница	Тип зарубежного транзистора	Отечественный аналог	Страница
GD244	П215	204	KSY63	КТ616Б	184
GD607	ГТ404Г	170	KSY81	КТ347Б	152
GD608	ГТ404Б	170	KU601	КТ801Б	214
GD609	ГТ404Б	170	KU602	КТ801А	214
GD617	П201АЭ	202	KU605	КТ812В	252
GD618	П201АЭ	202	KU606	КТ808А	246
GD619	П203Э	202	KU607	КТ812В	252
GF126	ГТ309Г	100	KU611	КТ801Б	214
GF128	ГТ309Б	100	KU612	КТ801А	214
GF130	ГТ309Д	100	KUY12	КТ812В	252
GF145	ГТ346А	112	MA909	МП26А	78
GF147	ГТ346А	112	MA910	МП26А	78
GF501	ГТ313Б	110	MJ420	КТ618А	182
GF502	ГТ313А	110	MJ480	КТ803А	248
GF503	ГТ313Б	110	MJ481	КТ803А	248
GF504	ГТ313А	110	MJ2500	КТ825Д	256
GF505	ГТ328Б	110	MJ2501	КТ825Г	256
GF506	ГТ328Б	112	MJ3000	КТ827В	258
GF507	ГТ346Б	112	MJ3001	КТ827Б	258
GF514	ГТ313Б, ГТ322А	96	MJ3480	КТ839А	254
GF515	ГТ322А	96	MJ3520	КТ827В	258
GF516	ГТ322А	96	MJ3521	КТ827А	258
GF517	ГТ322Б	96	MJ4030	КТ825Д	256
GFY50	ГТ322Б	96	MJ4031	КТ825Г	256
GS109	МП42А	80	MJ4032	КТ825Г	256
GS111	МП42Б	80	MJ4033	КТ827В	258
GS112	МП25А	78	MJ4034	КТ827Б	258
GS121	МП42	—	MJ4035	КТ827А	258
KC147	КТ373А, КТ373Б	148	MJE3055	КТ819Б	234
KC148	КТ373А, КТ373Б	148	MM404	МП42Б	80
KC149	КТ373Б, КТ373В	148	MM1748	КТ316А	132
KC507	КТ342Б	134	MM3000	КТ602А	200
KC508	КТ342Б	134	MM3001	КТ611В	190
KC509	КТ342Б	134	MM3375	КТ904Б	262
KD601	КТ803А	248	MM8006	КТ399А	164
KD602	КТ808А	246	MM8007	КТ399А	164
KF173	КТ339В	122	MMT2857	КТ382Б	162
KF503	КТ602Б	200	MMT8015	КТ382А	162
KF504	КТ611Г	188	MPS404	КТ209Е	90
KF507	КТ617А	184	MPS404A	КТ209К	90
KSA539R	КТ502В	92	MPS706	КТ645А	194
KSA539O	КТ502Г	92	MPS706A	КТ375А	122
KSA539Y	КТ502Г	92	MPS834	КТ306ВМ	130
KSA545R	КТ502Д	92	MPS2711	КТ503А	94
KSA545O	КТ502Г, КТ502Д	92	MPS2712	КТ503Б	94
KSA545Y	КТ502Г, КТ502Д	92	MPS2713	КТ306БМ	130
KSC853R	КТ503Г, КТ503Д	94	MPS2714	КТ306БМ	130
KSC853O	КТ503Г	94	MPS3638	КТ351А	124
KSC853Y	КТ503Г	94	MPS3638A	КТ351А	124
KSD227O	КТ503Б	94	MPS3639	КТ357А	150
KSD227Y	КТ503Б	94	MPS3640	КТ347Б	152
KSY21	КТ616Б	184	MPS3702	КТ3107Д	144
KSY34	КТ608А	186	MPS3703	КТ3107А	144
KSY62	КТ606Б	184	MPS3705	КТ645А	194

Тип зарубежного транзистора	Отечественный аналог	Страница	Тип зарубежного транзистора	Отечественный аналог	Страница
MPS3707	КТ3102Д	138	OC169	ГТ322Б	96
MPS3708	КТ3102В	138	OC170	ГТ309Г, ГТ322Б	100
MPS3709	КТ3102А	138	OC171	ГТ309Г	100
MPS3710	КТ3102В	138	OC200	КТ104Г	84
MPS3711	КТ3102Г	138	OC201	КТ104Б	84
MPS6512	КТ3102Д	140	OC202	КТ104В	84
MPS6513	КТ3102Д	140	OC203	КТ203А	86
MPS6514	КТ3102Д	140	OC204	КТ208Г	88
MPS6515	КТ3102Д	140	OC205	КТ208Л	88
MPS6516	КТ3107Е	144	OC206	КТ208Г	88
MPS6517	КТ3107Е	144	OC207	КТ208А	88
MPS6518	КТ3107Ж	144	OC1016	ГТ703В	206
MPS6519	КТ3107Л	144	OC1044	ГТ109Е	64
MPS6530	КТ645А	194	OC1045	ГТ109Д	64
MPS6532	КТ645А	194	OC1070	МП40А	72
MPS6562	КТ350А	124	OC1071	МП39Б, МП40А	72
MPS6563	КТ350А	124	OC1072	МП39Б, МП41А	72
MPS6565	КТ645А	194	OC1074	МП20А	76
MPS6566	КТ645А	194	OC1075	МП41А, МП39Б	72
MPS6571	КТ3102Г	138	OC1076	МП20А, МП42Б	80
MPSA09	КТ3102Б	138	OC1077	МП21Г	76
MPS-H37	КТ339АМ	122	OC1079	МП20А	76
MPSL07	КТ363А	154	PBC107A	КТ373А	144
MPSL08	КТ363А	154	PBC107B	КТ373Б	144
MPSU01	КТ807Б	216	PBC108A	КТ373А	144
MPSU01A	КТ807Б	216	PBC108B	КТ373В	144
MPSU05	КТ807Б	216	PBC108C	КТ373В	144
MPSU06	КТ807Б	216	PBC109B	КТ373Б	144
MPSU07	КТ807А	216	PBC109C	КТ373В	144
MPSU51	КТ639Б	192	PN2484	КТ3102Б, КТ3102Д	138
MPSU51A	КТ639Б	192	PT6670	КТ909Г	266
MPSU55	КТ639Г	192	PT6680	КТ909В	266
MPSU56	КТ626Б, КТ639Б	192	RED401	КТ606Б	262
MSA7575	КТ907А	264	RED410	КТ913А	268
NE1010E-28	КТ913Б	268	RED420	КТ913Б	268
NKT11	МГТ108Г	70	RED421	КТ904А	262
NKT73	МГТ108Б	70	SC206D	КТ373А	146
OC25	П216	208	SC206E	КТ373Б	146
OC26	ГТ703Д	206	SC206F	КТ373В	146
OC27	ГТ703Г	206	SC207D	КТ373А	146
OC28	П217	210	SC207E	КТ373Б	146
OC30	П201Э	202	SC207F	КТ373Б	146
OC35	П217	210	SD1300	КТ399А	164
OC41	П29	82	SD1301	КТ399А	164
OC42	П29А	82	SDN6000	КТ834В	260
OC57	ГТ109А	64	SDN6001	КТ834Б	260
OC58	ГТ109Б	64	SDN6002	КТ834А	260
OC59	ГТ109В	64	SDN6251	КТ834В	260
OC60	ГТ109В	64	SDN6252	КТ834Б	260
OC70	МП40А	72	SDN6253	КТ834А	260
OC71	МП40А	72	SDT3207	КТ908Б	250
OC75	МП40А, МП41А	72	SDT3208	КТ908А	250
OC76	МП40А	72	SDT7012	КТ908Б	250
OC77	МП26Б	78	SDT7013	КТ908А	250

Тип зарубежного транзистора	Отечественный аналог	Страница	Тип зарубежного транзистора	Отечественный аналог	Страница
SF21	КТ617А	184	SFT240	П217	208
SF22	КТ617А	184	SFT250	ГТ701А, П217	208
SF121A	КТ617А	184	SFT251	МП20А, МП39Б	76
SF121B	КТ617В	184	SFT252	МП20А, МП39Б	76
SF122A	КТ617А	184	SFT253	МП20А, МП39Б	76
SF122B	КТ617А	184	SFT306	МП39Б	72
SF123A	КТ602В	200	SFT307	КТ208В	88
SF123B	КТ602Г	200	SFT308	КТ208В	88
SF123C	КТ602Г	200	SFT316	П422	104
SF126A	КТ617А	184	SFT319	П416	104
SF126B	КТ617А	184	SFT320	П416	104
SF126C	КТ617А	184	SFT321	МП20А	76
SF128A	КТ630Г	178	SFT322	МП20Б	76
SF128B	КТ630Г	178	SFT323	МП20Б	76
SF128C	КТ630Г	178	SFT325	ГТ402И	166
SF128D	КТ630Г	178	SFT351	МП39Б	72
SF129A	КТ630А	178	SFT352	МП39Б	72
SF129B	КТ630А	178	SFT353	МП39Б	72
SF129C	КТ630А	178	SFT354	П422	104
SF129D	КТ630Б	178	SFT357	П422	104
SF131E	КТ3102В	138	SFT358	П423	104
SF131F	КТ3102Г	138	SFT377	ГТ404Ж	170
SF132E	КТ3102Б	138	SS106	КТ340В	128
SF132F	КТ3102Г	138	SS108	КТ340В	128
SF136D	КТ342А	134	SS109	КТ340В	130
SF136E	КТ342Б	134	SS125	КТ617А	184
SF136F	КТ342В	134	SS126	КТ608А	—
SF137D	КТ342А	134	SS216	КТ340Г, КТ375Б	122
SF137E	КТ342Б	134	SS218	КТ340Г, КТ375Б	122
SF137F	КТ342В	134	SS219	КТ340Г, КТ375Б	122
SF150B	КТ611Г	190	SSY20	КТ617А	186
SF150C	КТ611Г	190	T241	МП20А	76
SF215C	КТ373А, КТ375Б	122	T242	МП21В	76
SF215D	КТ373А	122	T243	МП21Г	76
SF215E	КТ373Б	122	T316H	П402, П416А	106
SF216C	КТ373Г, КТ375А	122	T317	П401	106
SF216D	КТ373А	122	T319	П401	106
SF216E	КТ373Б	122	T320	П401	106
SFT124	КТ501Е	90	T321N	МП37А, МП38	80
SFT125	КТ501Е	90	T322N	МП37Б	80
SFT130	КТ501Е	90	T323N	МП38А	80
SFT131	КТ501Е	90	T354H	П403, П416А	106
SFT143	КТ501Ж	90	T357H	П403А	106
SFT144	КТ501И	90	T358H	П403	104
SFT145	КТ501Ж	90	TCH98	КТ208Е	88
SFT146	КТ501И	92	TCH98B	КТ501К	92
SFT163	П423	104	TCH99	КТ208К	88
SFT187	КТ602А	200	TCH99B	КТ501М	92
SFT212	ГТ703Г	206	TG2	МГТ108А	70
SFT213	ГТ703Г	206	TG3A	МГТ108В	70
SFT214	П217	208	TG3F	МГТ108Г	70
SFT223	МП20Б	76	TG4	МГТ108А	70
SFT238	П216	208	TG5	ГТ115Б	66
SFT239	П217	208	TG5E	ГТ115А, П27	66

Продолжение

Тип зарубежного транзистора	Отечественный аналог	Страница	Тип зарубежного транзистора	Отечественный аналог	Страница
TG50	МП20А	76	2N61B	МП21Д	74
TG51	МП21Г	76	2N61C	МП21Г	74
TG52	МП20А	76	2N65	МП20А	74
TG53	МП20А	76	2N77	ГТ109Б	64
TG55	МП20А	76	2N94	МП38	82
TIP29	КТ815А	222	2N104	МП40А	72
TIP29A	КТ815Б	222	2N105	ГТ109Б	64
TIP29B	КТ815В	222	2N107	ГТ115А	66
TIP29C	КТ815Г	222	2N109	МП20Б	74
TIP30	КТ814А	220	2N123	МП42Б	80
TIP30A	КТ814Б	220	2N128	ГТ310Д	94
TIP30B	КТ814В	220	2N130	МГТ108А	70
TIP30C	КТ814Г	220	2N131	МГТ108Б	70
TIP31	КТ817А	226	2N131A	МГТ108Б	70
TIP31A	КТ817Б	228	2N132	МГТ108В	70
TIP31B	КТ817В	228	2N132A	МГТ108В	70
TIP31C	КТ817Г	228	2N133	МГТ108Б	70
TIP32	КТ816А	224	2N139	ГТ109Е	64
TIP32A	КТ816Б	224	2N175	П27	66
TIP32B	КТ816В	224	2N178	П216Б	206
TIP32C	КТ816Г	224	2N186A	МП20А, МП25Б	78
TIP41	КТ819А	236	2N189	МП25А	78
TIP41A	КТ819Б	236	2N190	МП25А	78
TIP41B	КТ819В	236	2N191	МП25Б	78
TIP41C	КТ819Г	236	2N193	МП38	80
TIP61	КТ815А	222	2N206	МГТ108А	70
TIP61A	КТ815Б	222	2N207	МГТ108Г	70
TIP61B	КТ815В	222	2N207A	МГТ108Г	70
TIP61C	КТ815Г	222	2N207B	МГТ108Г	70
TIP62	КТ814А	220	2N215	МП40А	72
TIP62A	КТ814Б	220	2N218	ГТ109Е	64
TIP62B	КТ814В	220	2N220	П27А	66
TIP62C	КТ814Г	220	2N237	МП40А	72
TIX3024	ГТ341Б	116	2N265	МГТ108Г	70
TIXM101	ГТ341А	116	2N273	МП39А	72
TIXM103	ГТ362А	116	2N283	МП40А	72
TIXM104	ГТ341В	116	2N326	ГТ705В	212
TIX3024	ГТ341Б	116	2N331	МП39Б	72
ZT2475	КТ316Б	132	2N368	МП40А	72
2N43	МП25Б	78	2N369	МП41А	72
2N44	МП25Б	78	2N404	МП42Б	80
2N44A	МП40А	72	2N405	МП39А	72
2N45	МП40А	72	2N406	МП39А	72
2N45A	МП40А	72	2N444	МП35	80
2N59	МП20А, МП20Б	74	2N444A	МП35	80
2N59A	МП20А, МП20Б	74	2N445	МП38	80
2N59B	МП21Д	74	2N445A	МП37	80
2N59C	МП21Д	74	2N456	П210В	208
2N60	МП20Б	74	2N457	П210Б	208
2N60A	МП20В	74	2N458	П201Б	208
2N60B	МП21Д	74	2N497	КТ630Д	174
2N60C	МП21Г	74	2N498	КТ630Г	174
2N61	МП20А	74	2N499A	ГТ305А	102
2N61A	МП20В	74	2N501	ГТ305А	102

Продолжение

Тип зарубежного транзистора	Отечественный аналог	Страница	Тип зарубежного транзистора	Отечественный аналог	Страница
2N502A	ГТ313А	108	2N784A	КТ340В	130
2N502B	ГТ313А	108	2N794	ГТ308А	106
2N503	ГТ310Б	94	2N795	ГТ308А	106
2N506	ГТ115Б	66	2N796	ГТ308Б	106
2N535A	ГТ115В	66	2N797	ГТ311И	114
2N535B	ГТ115В	66	2N834	КТ340В	128
2N536	ГТ115Г	66	2N835	КТ340В	128
2N554	П216В	206	2N842	КТ301Д	118
2N555	П216В	206	2N843	КТ301В, КТ301Ж	118
2N560	П307В	116	2N844	КТ601А, П307В	172
2N581	МП42А	80	2N845	КТ601А, П308	172
2N591	ГТ115Г	66	2N869	КТ352А	126
2N602	П416	104	2N869A	КТ347А	152
2N603	П416	104	2N914	КТ616Б	148
2N604	П416А	104	2N915	КТ342Г	134
2N653	МП20А	76	2N916	КТ342А	134
2N654	МП20А	76	2N917	КТ368Б	154
2N655	МП20Б	76	2N918	КТ368А	152
2N656	КТ630Д	172	2N919	КТ340В	130
2N657	КТ630Г	172	2N920	КТ340В	130
2N696	КТ630Д	174	2N923	КТ203Б	84
2N697	КТ630Д	174	2N924	КТ203Б	84
2N698	КТ630А	174	2N929	КТ342А	134
2N699	КТ630А	174	2N930	КТ342А	134
2N700	ГТ313Б, ГТ376А	110	2N943	КТ203Б	84
2N700A	ГТ376А	112	2N944	КТ203Б	84
2N702	КТ312А	118	2N955	ГТ311И	114
2N703	КТ312В	118	2N955A	ГТ311И	114
2N705	ГТ320В	108	2N978	КТ350А	124
2N706A	КТ340В	128	2N979	ГТ305А	102
2N708	КТ340В	130	2N980	ГТ305А	102
2N709	КТ316Б	132	2N987	ГТ322Б	96
2N709A	КТ316Б	132	2N990	ГТ322В	96
2N710	КТ320В	108	2N991	ГТ322В	96
2N711	КТ320В	108	2N993	ГТ322В	96
2N711A	ГТ320Б	108	2N995	КТ352А	126
2N711B	ГТ320Б	108	2N996	КТ352А	126
2N726	КТ349А	150	2N1024	КТ104Б	84
2N727	КТ349Б	150	2N1027	КТ104Б	84
2N728	КТ312В	118	2N1028	КТ104А	84
2N729	КТ312Б	120	2N1051	КТ604А	172
2N734	КТ601А, П307	116	2N1175	МП20Б	76
2N735	КТ601А, П307А	116	2N1204	КТ312Г	108
2N735A	КТ601А, П307А	172	2N1204A	ГТ321Г	108
2N738	П309	116	2N1218	ГТ705Г	212
2N739	П308	116	2N1219	КТ104Г	84
2N741	ГТ313В	110	2N1220	КТ104А	84
2N741A	ГТ313А	110	2N1221	КТ104Г	84
2N743	КТ340В	128	2N1222	КТ104А	84
2N744	КТ340В	128	2N1223	КТ104А	84
2N753	КТ340Б	128	2N1292	ГТ705В	212
2N754	П307В	116	2N1300	ГТ308А	106
2N755	П308	116	2N1301	ГТ308А	106
2N780	КТ312Б	118	2N1303	МП20А	76

Тип зарубежного транзистора	Отечественный аналог	Страница	Тип зарубежного транзистора	Отечественный аналог	Страница
2N1321	ГТ705В	212	2N1864	П417	98
2N1329	ГТ705В	212	2N1865	П417Б	100
2N1353	МП42А	80	2N1889	КТ630Г	174
2N1354	МП42Б	80	2N1890	КТ630Б	174
2N1384	ГТ321Д	108	2N1893	КТ630А	172
2N1387	КТ301Б	118	2N1924	МП21Г	76
2N1390	КТ301Д	118	2N1925	МП21Г	76
2N1413	МП39Б, МП20А	74	2N1926	МП21Д	76
2N1414	МП39Б, МП20А	74	2N1958	КТ608А	186
2N1415	МП20А, МП39Б	74	2N1959	КТ608Б	186
2N1420	КТ630Е	174	2N2020	КТ3117А	148
2N1494А	ГТ321Г	108	2N2048	ГТ308Б	106
2N1499А	ГТ305А	102	2N2048А	ГТ308Б	106
2N1499В	ГТ305Б	102	2N2089	П403, П416А	106
2N1500	ГТ305Г	102	2N2102	КТ630А	174
2N1507	КТ630Е	174	2N2102А	КТ630А	174
2N1524	П422	104	2N2137А	ГТ701А	210
2N1526	П422	104	2N2138А	ГТ701А	210
2N1564	КТ601А	172	2N2142А	ГТ701А	210
2N1565	КТ601А	172	2N2143А	ГТ701А	210
2N1566	КТ602Г, П307Б	116	2N2147	ГТ905А	212
2N1566А	КТ602Б	200	2N2148	ГТ905Б	212
2N1572	П309	116	2N2192	КТ630Е	174
2N1573	П308	116	2N2192А	КТ630Е	174
2N1574	П308	116	2N2193	КТ630Г	174
2N1585	ГТ311Ж	114	2N2193А	КТ630Г	174
2N1613	КТ630Г	172	2N2194	КТ630Д	174
2N1643	КТ104А	84	2N2194А	КТ630Д	174
2N1681	МП42Б	80	2N2195	КТ630Д	176
2N1683	ГТ308Б	106	2N2199	ГТ305А	102
2N1700	КТ801Б	214	2N2200	ГТ305Б	102
2N1701	П702	220	2N2217	КТ928А	196
2N1702	КТ803А	248	2N2218	КТ928Б	196
2N1711	КТ630Г, КТ630Е	172	2N2218А	КТ928Б	196
2N1714	П701А	216	2N2219	КТ928Б	196
2N1716	П701А	216	2N2219А	КТ928Б	196
2N1726	П701А	98	2N2221	КТ3117А	148
2N1727	П417	98	2N2221А	КТ3117А	148
2N1728	П417А	98	2N2222	КТ3117А	148
2N1742	ГТ313Б	108	2N2224	КТ608Б	186
2N1743	ГТ313А	110	2N2236	КТ617А	184
2N1745	ГТ305Б	102	2N2237	КТ603Б, КТ608Б	182
2N1746	П417	98	2N2242	КТ340В	128
2N1747	П417	98	2N2243	КТ630А	172
2N1748	ГТ305В	102	2N2243А	КТ630А	174
2N1752	П417	98	2N2270	КТ630Д	174
2N1754	ГТ305А	102	2N2273	ГТ305Б	102
2N1785	П417А	98	2N2274	КТ203Б	86
2N1786	П417	100	2N2275	КТ203Б	86
2N1787	П417	100	2N2276	КТ203В	86
2N1838	КТ617А	184	2N2277	КТ203В	86
2N1839	КТ617А	184	2N2297	КТ630Г	176
2N1840	КТ617А	184	2N2360	ГТ376А	112
2N1854	ГТ308Б	106	2N2361	ГТ376А	112

Тип зарубежного транзистора	Отечественный аналог	Страница	Тип зарубежного транзистора	Отечественный аналог	Страница
2N2372	КТ203В	86	2N2999	ГТ341В	116
2N2373	КТ203В	86	2N3010	КТ316Б	132
2N2400	ГТ308Б	106	2N3012	КТ347Б	152
2N2405	КТ630Б	174	2N3015	КТ928А	196
2N2410	КТ928А	196	2N3019	КТ630В	176
2N2411	КТ352А	126	2N3020	КТ630В	176
2N2412	КТ352А	126	2N3053	КТ608Б, КТ630Д	174
2N2415	ГТ376А	112	2N3054	КТ805Б	218
2N2416	ГТ376А	112	2N3054А	КТ803А	248
2N2428	МП41А	72	2N3055	КТ819ГМ	232
2N2432	КТ201Б	84	2N3055Е	КТ819ГМ	234
2N2432А	КТ201Б	84	2N3107	КТ630Б	174
2N2475	КТ316Б	132	2N3108	КТ630Г	174
2N2482	ГТ311И	114	2N3109	КТ630Б	174
2N2483	КТ3102Б	138	2N3110	КТ630Г	174
2N2484	КТ3102Д	138	2N3114	КТ611Г	188
2N2537	КТ928Б	196	2N3121	КТ351А	124
2N2538	КТ928Б	196	2N3127	ГТ328А, ГТ376А	110
2N2539	КТ3117А	148	2N3209	КТ347А	152
2N2615	КТ325А	154	2N3210	КТ616Б	184
2N2616	КТ325Б	154	2N3248	КТ352А	126
2N2617	КТ201А	84	2N3249	КТ345Б	126
2N2635	ГТ320В	108	2N3250	КТ313Б	148
2N2659	П214А	202	2N3250А	КТ313Б	148
2N2660	П215	204	2N3267	ГТ376А	112
2N2661	П215	204	2N3279	ГТ328А	110
2N2665	П214А	204	2N3280	ГТ328А	110
2N2666	П214А	204	2N3281	ГТ328Б	110
2N2667	П215	204	2N3282	ГТ328В	110
2N2696	КТ351А	124	2N3283	ГТ328А	112
2N2708	КТ325Б	154	2N3284	ГТ328Б	112
2N2711	КТ315Ж	120	2N3286	ГТ328Б	112
2N2712	КТ315Б	120	2N3299	КТ608Б	186
2N2784	КТ316Б	132	2N3301	КТ3117А	148
2N2811	КТ908Б	250	2N3302	КТ3117А	148
2N2813	КТ908А	250	2N3304	КТ337А	152
2N2835	П213	202	2N3375	КТ904А	262
2N2836	ГТ703Д	206	2N3390	КТ373В	146
2N2857	КТ399А	162	2N3391	КТ373Б	146
2N2868	КТ630Д	176	2N3392	КТ373А	146
2N2890	КТ801А	214	2N3393	КТ373А	146
2N2891	КТ801А	214	2N3394	КТ363Г	146
2N2894	КТ347Б	152	2N3397	КТ315Е	120
2N2906	КТ313А	148	2N3399	ГТ346Б	112
2N2906А	КТ313А	148	2N3440S	КТ904А	198
2N2907	КТ313Б	148	2N3441	КТ802А	248
2N2907А	КТ313Б	148	2N3442	КТ945А	—
2N2947	КТ903А	270	2N3451	КТ337А	152
2N2948	КТ903А	270	2N3545	КТ343Б	150
2N2958	КТ608Б	186	2N3546	КТ363А	154
2N2987	КТ630Г	174	2N3570	КТ399А	162
2N2988	КТ630В	174	2N3571	КТ399А	162
2N2989	КТ630Г	174	2N3572	КТ399А	162
2N2990	КТ630В	174	2N3576	КТ347А	152

Тип зарубежного транзистора	Отечественный аналог	Страница	Тип зарубежного транзистора	Отечественный аналог	Страница
2N3583	КТ704В	216	2N4232	П702	218
2N3584	КТ809А	244	2N4233	П702	218
2N3585	КТ704А, КТ704Б	216	2N4237	КТ801А	214
2N3600	КТ368А	152	2N4238	КТ801Б	214
2N3605	КТ375Б	124	2N4239	КТ801А	214
2N3606	КТ375Б	124	2N4240	КТ704А, КТ704Б	216
2N3607	КТ375Б	124	2N4260	КТ363А	154
2N3611	ГТ701А	210	2N4261	КТ363Б	154
2N3613	ГТ701А	210	2N4301	КТ908А	250
2N3702	КТ345Б	126	2N4314	КТ933А	238
2N3709	КТ358А, КТ373А	118	2N4400	КТ645А	194
2N3710	КТ358В, КТ373А	118	2N4429	КТ911Б	268
2N3711	КТ3102В	136	2N4430	КТ913А	268
2N3712	КТ611Г	188	2N4431	КТ913Б	268
2N3722	КТ608Б	186	2N4440	КТ907Б	264
2N3724	КТ608Б	186	2N4898	КТ932Б	242
2N3730	ГТ810А	212	2N4899	КТ932Б	242
2N3732	ГТ905А	212	2N4900	КТ932А	242
2N3733	КТ907А	264	2N4910	П702А	218
2N3738	КТ809А	244	2N4911	П702	218
2N3739	КТ809А	244	2N4912	П702	218
2N3740	КТ923Б	242	2N4913	КТ808А	246
2N3741	КТ816Г, КТ932А	242	2N4914	КТ808А	246
2N3742	КТ604Б	186	2N4915	КТ808А	246
2N3766	КТ805Б	218	2N4924	КТ611Г	188
2N3767	КТ805Б	218	2N4925	КТ611Г	188
2N3839	КТ399А	162	2N4926	КТ604Б	186
2N3878	КТ908А	250	2N4927	КТ604Б	188
2N3879	КТ908А	250	2N4960	КТ928Б	196
2N3880	КТ399А	164	2N4976	КТ911А	268
2N3883	ГТ320Б	108	2N5031	КТ399А	164
2N3903	КТ375А	122	2N5032	КТ399А	164
2N3904	КТ375А, КТ375Б	122	2N5043	ГТ329Б	114
2N3905	КТ361Г	128	2N5044	ГТ329А	114
2N3906	КТ361Г	128	2N5050	КТ802А	248
2N3964	КТ3107Л	142	2N5051	КТ802А	248
2N4030	КТ933Б	238	2N5052	КТ802А	248
2N4031	КТ933А	238	2N5056	КТ347Б	152
2N4034	КТ326Б, КТ347А	152	2N5067	КТ803А	248
2N4036	КТ933А	238	2N5068	КТ803А	248
2N4037	КТ933Б	238	2N5069	КТ803А	248
2N4046	КТ608Б	186	2N5070	КТ912А	270
2N4077	ГТ705Д	212	2N5090	КТ606А	262
2N4123	КТ3102А	136	2N5177	КТ909А	266
2N4124	КТ3102Д	136	2N5178	КТ909Б	266
2N4125	КТ361Б	128	2N5179	КТ399А	164
2N4126	КТ3107Ж	142	2N5188	КТ608Б	—
2N4127	КТ922Г	266	2N5190	КТ817А	226
2N4128	КТ922Д	266	2N5191	КТ817В	226
2N4138	КТ201Б	84	2N5192	КТ817Г	226
2N4207	КТ337Б	152	2N5193	КТ816А, КТ818А	224
2N4208	КТ337Б	152	2N5194	КТ816В, КТ818В	224
2N4209	КТ363А	154	2N5195	КТ816Г, КТ818Г	224
2N4231	П702	218	2N5202	КТ908А	250

Тип зарубежного транзистора	Отечественный аналог	Страница	Тип зарубежного транзистора	Отечественный аналог	Страница
2N5209	КТ3102Д	138	2N6077	КТ812Б	250
2N5210	КТ3102Е	138	2N6078	КТ812Б	250
2N5219	КТ375Б	122	2N6079	КТ812А	250
2N5221	КТ351А	124	2N6080	КТ920Б	264
2N5223	КТ375Б	122	2N6081	КТ920Г	264
2N5226	КТ350А	124	2N6093	КТ912Б	270
2N5228	КТ357А	150	2N6099	КТ819В	236
2N5239	КТ812Б	250	2N6101	КТ819Г	236
2N5240	КТ812А	250	2N6107	КТ818Г	232
2N5313	КТ908А	250	2N6109	КТ818В	232
2N5315	КТ908А	250	2N6111	КТ818А	232
2N5317	КТ908А	250	2N6121	КТ817А	228
2N5319	КТ908А	250	2N6122	КТ817В	228
2N5354	КТ351А	124	2N6123	КТ817Г	228
2N5365	КТ351А	124	2N6124	КТ839Ф	240
2N5366	КТ351Б	124	2N6125	КТ839С	240
2N5427	КТ808А	246	2N6126	КТ839Н	240
2N5429	КТ808А	246	2N6129	КТ819Б	236
2N5447	КТ345Б	126	2N6130	КТ819В	236
2N5481	КТ911А	270	2N6131	КТ819Г	236
2N5490	КТ819Б	234	2N6132	КТ818Б	232
2N5492	КТ819В	234	2N6133	КТ818В	232
2N5494	КТ819В	234	2N6134	КТ818Г	232
2N5496	КТ819Г	236	2N6135	КТ610А	262
2N5641	КТ922А	266	2N6178	КТ943Д	244
2N5642	КТ922Б	266	2N6179	КТ943Б	244
2N5643	КТ922В	266	2N6180	КТ932А	242
2N5652	КТ372В	156	2N6181	КТ932А	242
2N5681	КТ630Г	176	2N6246	КТ818ВМ	230
2N5682	КТ630А	176	2N6247	КТ818ГМ	230
2N5764	КТ913А	268	2N6248	КТ818ГМ	230
2N5765	КТ913Б	268	2N6253	КТ819БМ	234
2N5771	КТ363АМ	154	2N6260	КТ805Б	218
2N5838	КТ840Б	242	2N6263	КТ802А	248
2N5839	КТ840Б	242	2N6264	КТ802А	248
2N5840	КТ840А	242	2N6282	КТ827В	258
2N5842	КТ355А	156	2N6283	КТ827Б	258
2N5845	КТ645А	194	2N6284	КТ827А	258
2N5851	КТ355А	156	2N6285	КТ825Д	256
2N5852	КТ355А	156	2N6286	КТ825Г	256
2N5887	ГТ701А, П216	210	2N6287	КТ825Г	256
2N5888	ГТ701А, П216	210	2N6288	КТ819А	236
2N5889	ГТ701А, П216	210	2N6289	КТ819А	236
2N5890	ГТ701А, П216Г	210	2N6290	КТ819В	236
2N5891	ГТ701А, П217	210	2N6291	КТ819В	236
2N5995	КТ920Г	264	2N6292	КТ819Г	236
2N5996	КТ920Г	264	2N6293	КТ819Г	236
2N6011	КТ835Б	240	2N6304	КТ399А	164
2N6050	КТ825Д	256	2N6305	КТ399А	164
2N6051	КТ825Г	256	2N6371	КТ819БМ	234
2N6052	КТ825Г	256	2N6372	КТ808ГМ	246
2N6057	КТ827В	258	2N6373	КТ808ГМ	246
2N6058	КТ827Б	258	2N6374	КТ808БМ	246
2N6059	КТ827А	258	2N6469	КТ818БМ	230

Продолжение

Тип зарубежного транзистора	Отечественный аналог	Страница	Тип зарубежного транзистора	Отечественный аналог	Страница
2N6470	КТ819БМ	236	2SA246	ГТ305В	102
2N6471	КТ819ВМ	236	2SA254	ГТ109Е	64
2N6472	КТ819ГМ	236	2SA255	ГТ109Д	64
2NU72	ГТ403Б	168	2SA256	ГТ322Б	96
2NU73	ГТ703Б	206	2SA257	ГТ322В	96
2NU74	ГТ701А, П210А	210	2SA258	ГТ322В	96
2SA40	ГТ124Б	66	2SA259	ГТ322В	96
2SA49	ГТ109Е	64	2SA260	ГТ310А	94
2SA50	П30	82	2SA266	ГТ309Г	100
2SA52	ГТ109Е	64	2SA267	ГТ309Г	100
2SA53	ГТ109Д	64	2SA268	ГТ309Д	100
2SA58	ГТ322Б	98	2SA269	ГТ309Д	100
2SA60	ГТ322Б	98	2SA270	ГТ309Г	100
2SA65	ГТ125В	68	2SA271	ГТ309Г	100
2SA69	ГТ309Е	102	2SA272	ГТ309А	100
2SA70	ГТ309Е	102	2SA277	ГТ124В	66
2SA71	ГТ309Е	102	2SA279	ГТ305Б, П416Б	104
2SA72	ГТ322В	98	2SA282	ГТ125В, ГТ125Г	68
2SA73	ГТ322В	98	2SA285	ГТ322Б	98
2SA78	ГТ321Д	108	2SA286	ГТ322Б	98
2SA92	ГТ322Б	98	2SA287	ГТ322Б	98
2SA93	ГТ322В	98	2SA321	ГТ322В	94
2SA101	ГТ322В	96	2SA322	ГТ322В	94
2SA102	ГТ322В	96	2SA338	ГТ322В	94
2SA103	ГТ322В	96	2SA339	ГТ322Б	94
2SA104	ГТ322Б	96	2SA340	ГТ322Б	96
2SA105	ГТ310Е	94	2SA341	ГТ322Б	96
2SA106	ГТ310Е	94	2SA342	ГТ322Б	96
2SA107	ГТ310Д	94	2SA343	ГТ309Б	100
2SA108	П422	104	2SA350	П422	104
2SA109	П422	102	2SA351	П422	104
2SA110	П422	102	2SA352	П422	104
2SA111	П422	102	2SA354	П422	104
2SA112	П422	104	2SA355	П422	104
2SA116	ГТ310В	94	2SA374	П609А	172
2SA117	ГТ310Д	94	2SA391	ГТ125В	68
2SA118	ГТ310Д	94	2SA396	ГТ125Г	68
2SA173	ГТ125Б	68	2SA400	ГТ309Г	100
2SA174	ГТ125Б	68	2SA412	ГТ308Б	106
2SA195	ГТ124А	66	2SA414	ГТ125Б	68
2SA204	ГТ125Б	68	2SA416	П605А	170
2SA205	ГТ125Д	68	2SA422	ГТ346Б	112
2SA206	ГТ125Б	68	2SA440	ГТ313А	110
2SA211	ГТ125А	68	2SA467	КТ351Б	124
2SAA212	ГТ125А	68	2SA490	КТ816Б	224
2SA219	ГТ322В	96	2SA494G	КТ349В	150
2SA221	ГТ322Б	96	2SA495	КТ357Г	150
2SA223	ГТ322В	96	2SA495G	КТ357Г	150
2SA229	ГТ313А	110	2SA496	КТ639Б	194
2SA230	ГТ313А	110	2SA500	КТ352А	126
2SA234	ГТ309Б	100	2SA504	КТ933А	238
2SA235	ГТ309Б	100	2SA505	КТ639Д	194
2SA236	ГТ322В	98	2SA522	КТ326Б	152
2SA237	ГТ322В	98	2SA530	КТ313Б	148

Продолжение

Тип зарубежного транзистора	Отечественный аналог	Страница	Тип зарубежного транзистора	Отечественный аналог	Страница
2SA537	КТ933Б	238	2SA1033C	КТ3107Д	144
2SA555	КТ361Е	128	2SA1033D	КТ3107К	144
2SA556	КТ361Е	128	2SA1052B	КТ3129Б9	158
2SA559	КТ352А	126	2SA1052C	КТ3129Г9	158
2SA564	КТ3107Д, КТ3107К	142	2SA1052D	КТ3129Г9	158
2SA564A	КТ3107И	142	2SA1090	КТ313Б	148
2SA568	КТ345В	126	2SA1356	КТ626А	200
2SA603	КТ313Е	148	2SB12	ГТ124А	66
2SA628	КТ357Г	150	2SB13	ГТ124А	66
2SA640	КТ3107К, КТ3107И	142	2SB15	ГТ125А	68
2SA641	КТ3107Л	142	2SB32	МП39А	72
2SA670	КТ816В	224	2SB33	МП41А	72
2SA671	КТ816Б	224	2SB37	МП41А	72
2SA673	КТ350А	124	2SB39	ГТ115А	66
2SA715B	КТ639В	192	2SB40	МП42Б	80
2SA715C	КТ639В	192	2SB43	ГТ125В	68
2SA715D	КТ639В	192	2SB44	ГТ124В	66
2SA718	КТ313Б	148	2SB47	МГТ108Г,	68
2SA733	КТ3107И	142		МГТ108Д	68
2SA738B	КТ639В	192	2SB48	ГТ125Б	68
2SA738C	КТ639В	192	2SB49	ГТ125В	68
2SA738D	КТ639В	192	2SB54	ГТ124Г	66
2SA741H	КТ352А	126	2SB55	ГТ125Г	68
2SA743	КТ639Г	192	2SB56	ГТ125Г	68
2SA743A	КТ639Г	192	2SB57	МГТ108Б	70
2SA750	КТ3107К	142	2SB60	МП41А	72
2SA755A	КТ932Б	242	2SB61	МП41А	72
2SA755B	КТ932Б	242	2SB75	ГТ125В	68
2SA768	КТ816В	224	2SB90	ГТ109Г	64
2SA769	КТ816Г	224	2SB97	ГТ109В	64
2SA779K	КТ639В	192	2SB110	ГТ124А	66
2SA780AK	КТ639Д	192	2SB111	ГТ124Б	66
2SA781K	КТ345Б	126	2SB112	ГТ124В	66
2SA811C5	КТ3129Б9	158	2SB113	ГТ124В	66
2SA811C6	КТ3129Г9	158	2SB114	ГТ124Б	66
2SA812M4	КТ3129Б9	158	2SB115	ГТ124В	66
2SA812M5	КТ3129Б9	158	2SB116	ГТ124Г	66
2SA815	КТ814Г	220	2SB117	ГТ124Г	68
2SA844C	КТ3107И	142	2SB120	МП41А	72
2SA844D	КТ3107И	142	2SB130	П201АЭ	202
2SA876H	КТ313Б	148	2SB135	ГТ124В	68
2SA962A	КТ639Д	192	2SB136	МП20Б, МП25А	78
2SA999	КТ3107И	142	2SB136A	МП20Б, МП25А	78
2SA999L	КТ3107И	142	2SB170	МП39А, МП40А	72
2SA1015	КТ3107Б	142	2SB171	МП40А	72
2SA1029B	КТ3107Г	142	2SB172	МП20А, МП25Б	78
2SA1029C	КТ3107Д	142	2SB173	МП39А	72
2SA1029D	КТ3107И	142	2SB175	МП41А	72
2SA1030B	КТ3107Б	142	2SB176	МП20Б, МП25Б	78
2SA1030C	КТ3107Д	144	2SB180A	П201АЭ	202
2SA1031B	КТ3107Г	144	2SB181A	П202Э	202
2SA1031C	КТ3107Ж	144	2SB200	МП20А, МП25Б	78
2SA1031D	КТ3107Ж	144	2SB201	МП20А, МП25Б	78
2SB114	КТ3107Г	144	2SB261	ГТ115А	66

22 Заказ № 1141

Тип зарубежного транзистора	Отечественный аналог	Страница	Тип зарубежного транзистора	Отечественный аналог	Страница
2SB262	ГТ115В	66	2SC66	КТ611Г	190
2SB263	МП25Б	78	2SC67	КТ340В	130
2SB302	ГТ109Е	64	2SC68	КТ340В	130
2SB303	ГТ115Г	66	2SC101A	КТ902А	270
2SB335	МГТ108В	70	2SC105	КТ312Б	118
2SB336	МГТ108В	70	2SC108A	КТ630Г	180
2SB361	ГТ806А	212	2SC109A	КТ928Б	196
2SB362	ГТ806Б	212	2SC131	КТ616Б	184
2SB367	П201АЭ	202	2SC132	КТ616Б	184
2SB368	П201АЭ	202	2SC133	КТ616Б	184
2SB400	МГТ108Г	70	2SC134	КТ616А	184
2SB434	КТ837Р	240	2SC135	КТ616А	184
2SB434G	КТ837Р	240	2SC137	КТ616Б	184
2SB435	КТ837У	240	2SC151H	КТ603А	182
2SB435G	КТ837Р	240	2SC170	КТ306Д	132
2SB439	МП39Б, МП41А	74	2SC171	КТ306Д	132
2SB440	МП39Б, МП41А	74	2SC172	КТ306Д	132
2SB443A	МГТ108Г	70	2SC188	КТ617А	184
2SB443B	МГТ108Г	70	2SC247	КТ602Г	200
2SB444A	МГТ108Г	70	2SC249	КТ602Б	200
2SB444B	МГТ108Г	70	2SC253	КТ325А	154
2SB448	П201АЭ	202	2SC281	КТ312В	118
2SB456	П202Э	202	2SC282	КТ630Д	118
2SB466	П201АЭ	202	2SC306	КТ312В	176
2SB467	П202Э	202	2SC307	КТ630Г	176
2SB468	ГТ810А	212	2SC308	КТ630Г	176
2SB473	П201АЭ	202	2SC309	КТ630А	176
2SB481	П201АЭ	202	2SC310	КТ630В	176
2SB497	МГТ108Е	70	2SC366G	КТ645А	194
2SB551H	КТ932Б	242	2SC367G	КТ645А	194
2SB553	КТ818В	232	2SC370	КТ375Б	122
2SB558	КТ818ГМ	232	2SC371	КТ375Б	122
2SB595	КТ816Г	224	2SC372	КТ375Б	122
2SB596	КТ816Г	222	2SC390	КТ368А	154
2SB650H	КТ925Г	256	2SC395A	КТ616А	184
2SB693H	КТ925Г	256	2SC400	КТ306В	132
2SB709	КТ3129Д9	158	2SC401	КТ358В	118
2SB709A	КТ3129Г9	158	2SC402	КТ358В	—
2SB754	КТ818Б	232	2SC403	КТ358Б	118
2SB834	КТ835Б, КТ837В	240	2SC404	КТ358Б	118
2SB906	КТ835Б, КТ837В	240	2SC454B	КТ3102В	138
2SB996	КТ816Г	222	2SC454C	КТ3102В	138
2SB1016	КТ818Г	232	2SC454D	КТ3102В	138
2SB1017	КТ816Г	222	2SC458	КТ3102В	138
2SB1018	КТ818Г	232	2SC458LGB	КТ3102Д	138
2SB1019	КТ818В	232	2SC458LGC	КТ3102Д	138
2SC33	КТ312Б	118	2SC458LGD	КТ3102Д	140
2SC40	КТ316Г	132	2SC458KB	КТ3102В	140
2SC41	КТ802А	248	2SC458KC	КТ3102В	140
2SC42	КТ802А	248	2SC458KD	КТ3102В	140
2SC43	КТ802А	248	2SC481	КТ630Д	176
2SC44	КТ803А	248	2SC482	КТ617А	184
2SC64	КТ601А	172	2SC493	КТ803А	248
2SC65	КТ611В	190	2SC497	КТ630Б	174

Тип зарубежного транзистора	Отечественный аналог	Страница	Тип зарубежного транзистора	Отечественный аналог	Страница
2SC498	КТ630Б	174	2SC978	КТ913Б	268
2SC503	КТ630Г	174	2SC1000GTM	КТ3102Б	136
2SC504	КТ630Г	176	2SC1008	КТ630Д	176
2SC505	КТ618А	182	2SC1008A	КТ630Б	176
2SC506	КТ611Б	190	2SC1044	КТ355А	156
2SC507	КТ611Г	190	2SC1056	КТ605Б	182
2SC508	КТ802А	248	2SC1090	КТ372А	156
2SC510	КТ630В	176	2SC1111	КТ802А	248
2SC512	КТ630Г	176	2SC1112	КТ802А	248
2SC517	КТ903А	270	2SC1113	КТ808А	246
2SC519A	КТ802А	248	2SC1114	КТ812Б	252
2SC520A	КТ802А	248	2SC1145	КТ808БМ	246
2SC521A	КТ803А	248	2SC1172	КТ839А	254
2SC525	П701А	216	2SC1172A	КТ839А	254
2SC538	КТ3102Г	136	2SC11172B	КТ839А	254
2SC538A	КТ3102Б	136	2SC1173	КТ943А	244
2SC543	КТ907Б	264	2SC1260	КТ399А	162
2SC549	КТ904Б	262	2SC1317	КТ645А	194
2SC553	КТ907Б	264	2SC1440	КТ945А	254
2SC563	КТ339Г	122	2SC1454	КТ812Б	252
2SC583	КТ368Б	154	2SC1504	КТ809А	244
2SC594	КТ608А	186	2SC1550	КТ940Б	198
2SC598	КТ904А	262	2SC1566	КТ940Б	198
2SC601	КТ306Б	132	2SC1569	КТ940А	198
2SC612	КТ325В	154	2SC1576	КТ812А, КТ828Б	250
2SC618	КТ325А	154	2SC1617	КТ812Б	250
2SC618A	КТ325А	154	2SC1618	КТ808А	246
2SC620	КТ375А	124	2SC1619	КТ808А	246
2SC633	КТ315Б	120	2SC1619A	КТ808А	246
2SC634	КТ315Г	120	2SC1622D6	КТ3130Б9	160
2SC635	КТ904Б	262	2SC1622D7	КТ3130Б9	160
2SC641	КТ315Г	120	2SC1623L	КТ3130А9	160
2SC642	КТ904А	—	2SC1624	КТ943В	244
2SC712	КТ375Б	124	2SC1625	КТ943В	244
2SC727	П307Б	116	2SC1815	КТ3102Б	136
2SC752GTM	КТ645А	194	2SC1826	КТ817Г	228
2SC779	КТ809А	244	2SC1827	КТ817Г	228
2SC788	КТ618А	182	2SC1828	КТ828А	252
2SC790	КТ817Б	228	2SC1846	КТ645А	194
2SC793	КТ803А	248	2SC1894	КТ839А	254
2SC796	КТ603А	182	2SC1895	КТ839А	254
2SC809	КТ325В	154	2SC1896	КТ839А	254
2SC815	КТ645А	194	2SC2036	КТ646А	194
2SC825	КТ809А	244	2SC2068	КТ940А	198
2SC828	КТ3102В	136	2SC2121	КТ828А	252
2SC828A	КТ3102Б	136	2SC2137	КТ812А, КТ828Б	252
2SC829	КТ358Б	118	2SC2138	КТ812А	252
2SC893	П701А	216	2SC2231	КТ940В	198
2SC900	КТ3102Г	138	2SC2231A	КТ940В	198
2SC923	КТ3102Г	138	2SC2242	КТ940А	198
2SC945	КТ3102Д	138	2SC2258	КТ940Б	198
2SC959S	КТ630Б	176	2SC2404	КТ3130Г9	160
2SC976	КТ911Г	270	2SC2405	КТ3130Г9	160
2SC977	КТ913А	268	2SC2431	КТ945А	254

Продолжение

Тип зарубежного транзистора	Отечественный аналог	Страница	Тип зарубежного транзистора	Отечественный аналог	Страница
2SC2456	КТ940А	198	2SD691	КТ829А	260
2SC2562	КТ805АМ	218	2SD692	КТ829А	260
2SC2611	КТ604БМ	188	2SD716	КТ819ГМ	234
2SC2790	КТ828А	252	2SD820	КТ839А	254
2SC2790A	КТ828А	252	2SD821	КТ839А	254
2SC2791	КТ828А	252			
2SC2794	КТ943Б	244	2SD822	КТ839А	254
2SC3335	КТ940Б	198	2SD843	КТ819ГМ	234
2SC3419	КТ646А	194	2SD867	КТ808АМ	246
2SC3422	КТ805АМ	218	2SD877	КТ802А	248
2SC3423	КТ940В	198	2SD880	КТ817В	228
2SC3424	КТ940Б	198	2SD1279	КТ839А	254
2SD31	МП35	82	2SD1354	КТ817В	226
2SD32	МП38А	82	2SD1356	КТ817Г	226
2SD33	МП38А	82	2SD1406	КТ817В	226
2SD37	МП37А	82	2SD1408	КТ817Г	226
2SD47	КТ908А	250	2Т3531	КТ602А, П308	116
2SD68	КТ902А	270	2Т3532	КТ602А, П308	116
2SD72	ГТ404И	170	2Т3674	КТ355А	156
2SD75	МП36А, МП38	80	2Т3841	КТ343А	150
2SD75A	МП36А, МП37А	80	3NU72	ГТ403Б	168
2SD127	ГТ404Е	170	3NU73	ГТ703Г	206
2SD127A	ГТ404Б	170	3NU74	ГТ701А, П210А	210
2SD128	ГТ404И	170	4NU72	ГТ403Б	168
2SD128A	ГТ404И	170	4NU73	ГТ703Д	206
2SD146	П702А	220	4NU74	ГТ701А, П210А	210
2SD147	П702	220	5NU72	ГТ403Е	168
2SD148	П702	220	5NU73	П213	204
2SD195	МП38А	82	5NU74	ГТ701А, П210А	210
2SD201	КТ808А	246	6NU73	П215	204
2SD202	КТ808А	246	6NU74	ГТ701А, П210Б	210
2SD203	КТ808А	246	7NU73	П215	204
2SD234	КТ817А	228	7NU74	ГТ701А, П210Б	210
2SD235	КТ817Б	228	101NU70	МП35	82
2SD292	КТ817В	—	102NU70	МП35	82
2SD526	КТ817Г	228	103NU70	МП37	82
2SD601	КТ3130В9	160	104NU70	МП36А	82
2SD601A	КТ3130Б9	160	105NU70	МП36А	82
2SD605	КТ834А	260	106NU70	МП36А, МП37А	82
2SD640	КТ828Б	252	107NU70	МП36А, МП38А	82
2SD668	КТ611БМ	190	152NU70	МП36А, МП38	82
2SD668A	КТ611БМ	190	153NU70	МП36А	82
2SD675A	КТ945А	254	154NU70	МП38	82
2SD685	КТ834А	260	155NU70	МП38А	82
2SD686	КТ829А	260	40675	КТ912Б	270

Зарубежные диоды и их отечественные аналоги

Тип зарубежного диода	Отечественный аналог	Страница	Тип зарубежного диода	Отечественный аналог	Страница
A2A4	КД204В	278	AM030	Д229В	291
A2C4	КД205Г	284	AM12	Д229В	279
A2D1	Д229К	289	AM42	Д229Е	292
A2D5	КД205В	289	AM410	Д229В	279
A2D9	КД205В	289	AM440	Д245	292
A2E1	Д229Л	294	AZ6,8	КС168В	305
A2E3	Д229Л	—	AZ7,5	КС175А	307
A2E4	КД205Б	292	AZ8,2	КС182А	307
A2E5	Д229Л	294	AZ9,1	КС191А	308
A2E9	Д229Л	294	AZ10	КС210Б	308
A2F4	КД205А	298	AZ11	КС211Ж	309
A3B1	Д229Ж	279	AZ13	КС213Б	309
A3B3	Д229Ж	280	AZ15	КС215Ж	309
A3B5	Д229Ж	279	AZ22	КС222Ж	309
A3B9	Д229Ж	279	AZX84S11	КС211Ж	309
A3C1	КД205Л	285	B2D5	Д229К	289
A3C3	КД205Л	287	B2D9	Д229К	289
A3C5	КД205Л	286	B2E1	Д229Л	294
A3C9	КД205Л	286	B2E5	Д229Л	294
A3D1	Д229К	290	B2E9	Д229Л	294
A3D3	Д229К	290	B3B5	Д229Ж	279
A3D5	Д229К	290	B3B9	Д229Ж	279
A3D9	Д229К	290	B3C1	КД205Л	286
A3E1	Д246Б	295	B3C9	КД205Л	286
A3E3	Д229Л	295	B3D1	Д229К	290
A3E5	Д246Б	295	B3D5	Д229К	290
A3E9	Д246Б	295	B3D9	Д229К	290
A7B1	КД208А	281	B3E1	Д246Б	295
A7B5	КД208А	281	B3E5	Д246Б	295
A7B9	КД208А	281	B3E9	Д246Б	295
A100	Д229Ж	280	B7B1	КД208А	281
A121-1t	КД208А	281	B7E5	КД208А	281
A132-1t	КД208А	281	B7B9	КД208А	281
A168-1t	КД208А	281			
A300	Д229К	290			
A400	Д229Л	295			
AA112	Д10	273	1500Sit	КД208А	281
AA112P	Д10	273	B80C300	КД204Б	284
AA113P	Д101	274	B250C300	КД205И	302
AA137	Д9В	273	BA128	КД103А	274
AA138	Д10	273	BA147/220	Д207	275
AAY32	Д311	312	BA147/300	Д208	275
AAZ10	Д9В	273	BA179	Д102	273
AAZ15	Д312А	315	BAV54-30	КД521Г	312
AD150	Д223Б	274	BAW14	Д226В	275
			BAW14TF24	Д226В	275
AE150	Д223Б	274	BAW32B	Д223Б	274
AM010	Д229Ж	281	BAW62	КД521А	316

Тип зарубежного диода	Отечественный аналог	Страница	Тип зарубежного диода	Отечественный аналог	Страница
BAW63	КД521Б	315	BZ6,8	КС168В	306
BAW63A	КД521Г	312	BZ7,5	КС175А	307
BAX13	КД509А	313	BZ8,2	КС182А	307
BAX13A	КД509А	313	BZ9,1	КС191А	308
BAX80	КД509А	313	BZX29C4V7	КС447А	310
BAX91C/TF102	КД521А	316	BZX29C5V6	КС456А	311
BAX95/TF600	КД521А	316	BZX29C35V6	Д246	—
BAY21	Д226В	275	BZX46C3V3	КС133А	304
BAY38	КД509А	313	BZX55C3V3	КС133А	304
BAY63	КД509А	313	BZX58C6V8	КС168А	306
BAY71	КД509А	313	BZX59C11	Д811	308
BAY74	КД509А	313	BZX69C11	Д811	308
BAY89	КД105А	277	BZX83C3V3	КС133А	304
BLYA168	КС168А	306	BZX84C7V5	КС175А	307
BLVA168A	КС168А	306	BZX84C7V8	КС175А	—
BLVA168B	КС168А	306	BZX84C9V1	КС191А	308
BLVA168C	КС168А	306	BZX84C10	КС210Б	308
BLVA195	КС196А	308	BZX84C11	КС211Ж	309
BLVA195A	КС196А	308	BZX85C4V7	КС447А	310
BLVA195B	КС196А	308	BZX85C5V6	КС456А	311
BLVA195C	КС196А	308	BZY56	КС147А	305
BLVA468	КС168А	306	BZY60	КС168А	306
BLVA468A	КС168А	306	BZY83C4V7	КС147А	305
BLVA468B	КС168А	306	BZY83C6V8	КС168А	306
BLVA468C	КС168А	306	BZY83C11	Д811	308
BLVA495	КС196А	308	BZY83D4V7	КС147А	305
BLVA495A	КС196А	308	BZY83D6V8	КС168А	306
BLVA495B	КС196А	308	BZY85B3V3	КС133А	304
BLVA495C	КС196А	308	BZY85C4V7	КС147А	305
BR22	КД205Г	284	BZY85C11	Д811	308
BR24	КД205Б	292	BZY85C39	КС139А	304
BR26	КД205Ж	300	BZY88C33	КС133А	304
BR41	Д229Ж	279	C4010	Д102	273
BR42	КД205Л	286	C6102	КС133А	304
BR44	Д246Б	295	CA50	Д102	273
BR81D	КД208А	281	CA100	Д223А	274
BR101A	Д242	283	CB50	Д102	273
BR102A	Д243	288	CB100	Д223А	274
BR104A	Д246	297	CER68	Д229Ж	281
BR106A	КД206В	301	CER69	КД205Г	287
BR108A	КД210Б	303	CER69C	КД105В	285
BR205	КД204В	278	CER70	КД105В	296
BSA71	КД509А	314	CER70B	Д7Ж	276
BY118	Д245Б	291	CER70C	КД205Б	293
BY157	КД105Г	277	CER71B	КД105В	277
BY158	Д229Л	294	CER72C	КД205Е	277
BYX42/300	Д245	291	CER500B	КД205Е	298
BYX42/600	КД206В	302	CER500C	КД205А	299
BYX60-100	Д229В	279	CER710	КД205Ж	301
BYX60-400	Д229Е	292	CG84H	КД503В	311
BYY67	Д245	292	CGD309	МД3А	312
BYY68	Д245	292	COD1531	Д229Ж	280

Тип зарубежного диода	Отечественный аналог	Страница	Тип зарубежного диода	Отечественный аналог	Страница
COD1532	КД205Л	286	E3H3	Д247Б	299
COD1533	Д229К	290	E3K3	Д248Б	301
COD1534	Д229Л	295	E5A3	Д305	279
COD1554	Д7Ж	276	E6B3	Д242	283
COD1555	КД205Е	298	E6C3	Д243	288
COD1556	КД105В	277	E6E3	Д245	292
COD15314	КД208А	281	E6G3	Д246	298
COD15524	КД205Г	284	E6H3	КД206Б	300
COD15534	КД205В	289	E6K3	КД206В	302
COD15544	КД205Б	293	E6M3	КД203Г	302
COD15554	КД205А	298	E6N3	КД210Б	303
COD15564	КД205Ж	300	ED3004A	Д229Л	295
CTN100	КД208А	282	EG100	КД205Б	293
CTP100	КД208А	282	EG100H	КД205А	299
CY40	Д246Б	294	EPD300	КД205В	289
CZ5,6	КС456А	311	ER31	Д229К	289
D2D	Д101	—	ER41	Д229Л	294
D25C	КД205Г	284	ERD200	КД205Г	285
D45C	КД205Б	293	ERD400	КД205Б	293
D65C	КД205Ж	300	ERD300	КД205В	289
D100	Д229Ж	280	ERD500	КД205А	299
D200	КД205Л	287	ERD600	КД205Ж	301
D400	Д229Л	295	ESP5100	Д304	283
D1010	Д242	283	ESP5200	Д243Б	287
D1646	Д229К	291	ESP5300	Д245Б	291
D1647	Д229Л	296	ESP5400	Д246Р	297
D3010	Д245	291	EZ100	МД218	278
D4010	Д246	297	F1C3	Д243Б	287
D5010	КД206Б	300	F1E3	Д245Б	291
D6010	КД206В	302	F1G3	Д246Б	297
D8010	КД210Б	303	F1H3	Д247Б	299
DD003	КД205Г	285	F1K3	Д248Б	301
DD006	КД205Б	293	F2B3	Д242	284
DD056	КД205Б	293	F2C3	Д243	288
DD236	Д246Б	295	F2E3	Д245	292
DD266	Д246Б	295	F2G3	Д246	298
DD4521	Д242	283	F2H3	КД206Б	300
DD4523	Д243	288	F2K3	КД206В	302
DD4526	Д246	297	F2M3	КД203Г	302
DK751	Д229Ж	280	F2N3	КД210Б	303
DK752	КД205Л	287	F3C3	Д243Б	287
DK753	Д229К	290	F3G3	Д246Б	297
DK754	Д229Л	296	FD100	КД509А	314
DR402	Д220Б	317	FD600	КД521А	316
DR464	Д10	273	FDN600	КД521А	316
DR482	Д219А	315	FPZ5V6	КС456А	311
DR500	Д219А	315	G4HZ	Д246	297
DR695	Д209	276	G8HZ	КД210Б	303
DR698	Д209	275	G65HZ	Д248Б	301
DR699	Д208	275	G1010	Д242	283
DT230H1	Д226В	275	G2010	Д243	288
E3B3	Д304	283	G3010	Д245	291
E3C3	Д243Б	287	G4010	Д246Б	297
E3E3	Д245Б	291			

Тип зарубежного диода	Отечественный аналог	Страница
G5010	КД206Б	299
G8010	КД210Б	303
GD72E3	Д9В	273
GD72E4	Д9Б	273
GD72E5	Д9В	273
GLA47A	КС147А	305
GLA47B	КС147А	305
GP330	КД521Г	313
GP350	КД509А	314
GP360	КД521Б	315
GPM2NA	Д9В	273
GSM53	КД103А	274
H100	Д229Ж	280
H200	КД205Л	287
H300	Д229К	290
H400	Д229Л	296
H6010	КД206В	301
HD4101	КД503А	312
HDS9009	КД509А	314
HDS9010	КД521Г	313
HGR30	КД104А	275
HMG626A	Д220	314
HMG662	Д220Б	317
HMG662A	Д220Б	317
HMG663	Д220Б	317
HMG664	Д220Б	317
HMG844	Д220Б	317
HMG904	КД521Г	313
HMG904A	КД521Г	313
HMG907	КД521Г	313
HMG907A	КД521Г	313
HMG3064	КД521А	316
HMG3596	КД521Г	313
HMG3598	КД521Г	316
HMG3600	КД509А	314
HMG3873	КД509А	314
HMG3954	КД509А	314
HMG4147	КД503А	312
HMG4150	КД509А	314
HMG4319	КД521А	316
HMG4322	КД509А	314
HR11	Д811	308
HR90	Д818А	307
HS033A	КС133А	304
HS033B	КС133А	304
HS1395	КД503А	312
HS2039	КС139А	304
HS2047	КС147А	305
HS2110	Д811	308
HS7033	КС133А	304
HS9009	КД509А	314
HS9010	КД521Г	313
HS9501	КД521А	316
HS9504	КД521А	316
HS9507	КД521А	316
HSP1001	Д207	275
HGR30	КД104А	275
J200	КД205Г	284
J400	КД205Б	293
J600	КД205Ж	300
JAN1N633	Д220Б	317
JAN1N3827A	КС456А	310
JE2	КД205Б	292
K2B5	Д229В	279
KS033A	КС133А	304
KS033B	КС133А	304
KS77	КС190А	307
KS78	КС190А	307
KS78B	КС190А	307
KS2039A	КС139А	304
KS2039B	КС139А	304
KS2047A	КС147А	305
KS2047B	КС147А	305
KS2068A	КС168А	306
KS2068B	КС168А	306
KS2110A	Д811	308
KS2110B	Д811	309
LAC2002	КС147А	305
LDD5	КД521Б	315
LDD10	КД521Б	315
LDD15	КД521Б	315
LDD50	КД521Б	315
LDZ70/6A8	КС168А	306
LR33H	КС133А	304
LZ8,2	КС182А	307
M14	Д229В	279
M1B1	КД208А	281
M1B5	КД208А	281
M1B9	КД208А	281
M4HZ	Д229Е	292
M68	Д229Ж	280
M69	КД205Л	287
M69C	КД205Г	285
M70B	Д7Ж	276
M70C	КД205Б	293
M71B	Д211	277
M72B	КД105В	277
M500B	КД205Е	298
M500C	КД205А	298
MA215	КД205В	292
MA231	Д242	283
MA232	Д243	288
MA240	Д243	288
MA4303	КД509А	314
MA4304	КД509А	314
MA4305	КД509А	314
MA4306	КД509А	314
MA4307	КД521А	316

Тип зарубежного диода	Отечественный аналог	Страница
MA4308	КД521А	316
MB236	КД208А	281
MB253	Д229К	290
MB254	Д229Л	295
MB258	Д229Ж	280
MB259	КД205Г	284
MB260	КД205Л	286
MB261	КД205В	288
MB262	Д229К	290
MB263	КД205Б	293
MB264	Д229Л	295
MB265	КД205А	298
MB267	КД205Ж	300
MB270	Д229Ж	280
MB271	КД205Л	286
MB272	Д229К	290
MB273	Д229Л	295
MC030	Д226В	275
MC030A	Д226В	275
MC51	Д226В	275
MC52	КД521А	316
MC53	КД521Г	313
MC55	КД521Б	315
MC58	КД509А	314
MC59	КД521Б	315
MC103	КД509А	314
MC108	КД509А	—
MC433	КД521А	316
MC903	КД509А	314
MC903A	КД509А	314
MC905	КД521Г	313
MC905A	КД521Г	313
MC906	КД521Г	313
MC906A	КД521Г	313
MC908	КД509А	314
MC908A	КД509А	314
MC5321	КД521Г	313
MC6010A	КД168А	306
MC6015A	Д811	309
MCPD521A	КД521Б	315
MCPD521B	КД521Б	315
MCPD521C	КД521Б	315
MGD72	КД521Г	313
MGD73	КД521А	316
MGLA39A	КС139А	304
MGLA39B	КС139А	304
MHD611	КД521А	316
MHD612	КД521А	316
MHD614	КД521А	316
MHD615	КД521А	316
MHD616	КД509А	314
MMC1001	КД521А	316
MMC1002	КД521А	317
MMC1003	КД521А	317
MMC1004	КД521А	317
MMC1005	КД521А	317
MMC1006	КД521А	317
MMC1007	КД521А	317
MP1337-4	Д229К	291
MP1337-5	Д229Л	296
MR39C-H	КС139А	304
MR47C-H	КС147А	305
MR60	Д248Б	301
MR80	МД217	277
MR90	МД218	277
MR100	МД218	277
MR1337-2	Д229Ж	281
MR1337-4	Д229К	291
MR1337-5	Д229Л	296
MS5	Д305	279
MT020A	КД205Г	284
MT030	КД205В	289
MT030A	КД205Б	289
MT040	КД205В	293
MT040A	КД205Б	293
MT050	КД205А	298
MT050A	КД205А	298
MT060	КД205Ж	300
MT060A	КД205Ж	300
MT14	Д229В	279
MT44	Д229Е	292
MT458	Д223Б	274
MT462A	КД103А	274
MT705	КД521Б	315
MZ4A	КС147А	305
MZ6A	КС168А	306
MZ1009	Д818А	307
MZ4622	КС139А	304
MZ4624	КС147А	305
MZC3,3A10	КС133А	304
O102	КД102А	275
O112	КД102А	275
O502	Д226В	275
O507	КД105Г	277
O604	КД206В	302
OA90	Д9В	273
OA92	МД3А	311
OAZ200	КС147А	305
OAZ204	КС168А	306
OAZ240	КС147А	305
OAZ244	КС168А	306
P2K5	Д210	276
P2M5	Д211	276
P4F5	КД204Б	284
P4H5	Д7Ж	276
P4HZ	Д246	297
P4K5	КД205Е	298

Тип зарубежного диода	Отечественный аналог	Страница
P4M5	КД105В	277
P5D5	Д229В	279
P5H5	Д229Е	292
P6F5	КД205Г	285
P6G5	КД205В	289
P6H5	КД205Б	293
P6HZ	КД206В	301
P6K5	КД205А	299
P6M5	КД205Ж	300
P7G5	Д229К	289
P7H5	Д246Б	294
P8HZ	КД210Б	303
P100A	Д229Ж	280
P100B	КД208А	282
P150B	КД208А	282
P200A	КД205Л	287
P400A	Д229Л	296
P665	КД205В	289
P1010	Д242	283
P2010	Д243	288
P3010	Д245	291
P4010	Д246	297
P5010	КД206Б	299
P6010	КД206В	302
P8010	КД210Б	303
PA05	Д305	279
PD116	МД218	277
PD126	Д220Б	317
PD127	Д312А	315
PD133	Д101	274
PD910	Д209	276
PD911	Д210	276
PD912	Д211	276
PD914	МД217	277
PD915	МД218	277
PD916	МД218	277
PD6004A	КС139А	304
PD6006A	КС147А	305
PD6010A	КС168А	306
PD6045	КС139А	305
PD6047	КС147А	305
PD6051	КС168А	306
PD6056	Д811	309
PD6202	КС147А	305
PD6206	КС168А	306
PE10	Д304	283
PE20	Д243Б	287
PE40	Д246Б	296
PE60	Д248Б	301
PS120	КД205Г	284
PS130	КД205В	288
PS140	КД205Б	293
PS150	КД205А	298

Тип зарубежного диода	Отечественный аналог	Страница
PS160	КД205Ж	300
PS410	Д229В	279
PS440	Д229Е	292
PS632	Д226В	275
PS633	Д226В	275
PS2415	Д211	276
PS2416	МД217	277
PS2417	МД218	278
PT520	КД205Л	286
PT530	Д229К	290
PT540	Д229Л	295
PZZ11	КС211Ж	309
Q12-200	КД521Д	311
Q12-200A	КД521Д	311
Q12-200B	КД521Д	311
Q12-200C	КД521Д	311
Q12-200D	КД521Д	311
Q12-200T	КД521Д	311
Q12-300	КД521Д	311
Q12-300A	КД521Д	311
Q12-300B	КД521Д	311
R421	Д243	288
R602	Д243	288
R604	Д246	297
R606	КД206В	302
R611	Д242	283
R612	Д243	288
R614	Д246	297
R616	КД206В	302
RPX50	Д220	314
RPX100	Д220Б	317
RPX100A	Д220Б	317
PZ18	КС218Ж	309
RZ22	КС222Ж	309
RZZ11	КС211Ж	—
RZZ18	КС218Ж	309
RZZ22	КС222Ж	309
S1A	Д229Л	296
S1AN12	Д242	283
S1,5-0,1	КД208А	282
S2A10	КД208А	281
S2AN12	Д243	288
S2H1	КД208А	281
S2E20	КД205Г	285
S2E60	КД205Ж	300
S3AN12	Д245	292
S4AN12	Д246	297
S5A1	Д304	283
S5A2	Д243Б	287
S5A3	Д245Б	291
S5A4	Д246Б	296

Тип зарубежного диода	Отечественный аналог	Страница
S5A5	Д247Б	299
S5A6	Д248Б	301
S5AN12	КД206Б	300
S5M2	Д229Л	294
S6AN12	КД206В	302
S7AN12	КД203Г	302
S8AN12	КД210Б	303
S11	КД208А	281
S15	КД205А	298
S16	КД205Б	293
S16A	КД205Б	293
S16B	Д229Л	294
S17	КД205Г	284
S17A	КД205Г	284
S18	КД205А	299
S18A	КД205А	298
S19	Д7Ж	276
S19A	КД205Е	298
S20-06	Д248Б	301
S23A	КД205Ж	300
S26	Д229К	291
S28	КД105Г	277
S30	КД205Ж	300
S31	КД205В	289
S81	Д229Ж	281
S83	Д229К	291
S84	Д229Ж	296
S91A	Д229Ж	280
S92A	КД205Л	285
S93A	Д229К	290
S100	КД205Г	294
S101	КД205Г	285
S102	Д229Е	292
S105	КД205Б	294
S106	Д7Ж	276
S108	КД205Б	294
S125	КД206В	302
S205	Д210	276
S206	Д211	276
S208	МД217	277
S210	МД218	278
S219	Д7Ж	276
S222	КД205Г	285
S223	КД205В	289
S224	КД205Б	294
S234	КД105Г	277
S235	КД205Г	293
S243	Д229Л	294
S252	КД205Г	285
S253	КД205В	289
S254	КД205Б	294
S255	КД205Ж	299
S256	КД205Ж	301
S420	Д242	283

Тип зарубежного диода	Отечественный аналог	Страница
S423	Д246	297
S425	КД206Б	302
S427	КД210Б	303
SA1AN12	Д242	283
SA1N12	КД208А	—
SA1M1	КД208А	281
SA4AN12	КД246	297
SA5AN12	КД206Б	299
SA6AN12	КД206В	302
SA8AN12	КД210Б	303
SD1	КД205Б	293
SD1A	КД205Ж	300
SD1Z	КД205Г	285
SD11F	Д101	274
SD91A	Д229Ж	280
SD92A	КД205Л	286
SD93	Д229К	289
SD93A	Д229К	290
SD94	Д229Л	294
SD94A	Д229Л	296
SD500	Д229Л	296
SE05A	КД205Б	293
SE05B	КД205Ж	300
SE05S	КД205Г	285
SE1,5	КД208А	—
SE1,5SS	КД208А	282
SED107	Д10	273
SFD43	КД521Г	313
SFD83	КД521Г	313
SG105	Д229В	279
SG221	Д219А	315
SG5100	КД509А	314
SG5200	КД521А	317
SG5250	КД521Г	314
SG5260	КД521А	317
SG9150	КД503А	312
SJ103E	Д304	283
SJ103K	Д304	283
SJ104E	Д242	283
SJ104K	Д242	283
SJ203E	Д243Б	287
SJ203K	Д243Б	287
SJ204E	Д243	288
SJ204K	Д243	288
SJ304E	Д245	—
SJ304K	Д245	291
SJ404E	Д246	291
SJ404K	Д246	297
SJ603E	Д248Б	301
SJ603K	Д248Б	301

Продолжение

Тип зарубежного диода	Отечественный аналог	Страница
SJ604E	КД206В	302
SJ604K	КД206В	302
SKN5/04	Д246Б	296
SL3	Д245Б	291
SL103M	Д245Б	—
SM10	Д229Ж	280
SM20	КД205Л	287
SM30	Д229К	291
SM40	Д229Л	296
SM230	Д229К	289
SM240	Д229Л	294
SR11	КД208А	281
SR11T	КД208А	281
SR20	Д305	279
SV131	Д818А	307
SV132	КС196А	308
SV134	Д811	309
SVM91	Д818А	307
SVM905	Д818А	307
SVM9010	Д818А	307
SVM9011	Д818А	307
SVM9020	Д818А	307
SVM9021	Д818А	307
SW05A	КД205Б	293
SW05B	КД205Ж	300
SW05S	КД205Г	285
SW1S	Д229Ж	287
SW1SS	КД205Л	280
SZ9	Д818А	307
SZ11	Д811	309
T16	МД3А	312
TH4148	КД521А	317
TF24	Д226В	275
TK10	Д229Ж	281
TK20	КД205Л	287
TK30	Д229К	291
TK40	Д229Л	296
TKF20	КД205Г	285
TKF40	КД205Б	294
TMD45	Д207	275
TMD50	КД509А	314
TMD914	КД521А	317
TMD916	КД521А	317
TR501	КД206Б	300
TS1	Д229Ж	280
TS2	КД205Л	286
TS4	Д229Л	295
UP12069	КД205Л	286
UP12069A	КД205Л	286
UP12070	Д229Л	295
UP12070A	Д229Л	295
UR215	Д303	284

Тип зарубежного диода	Отечественный аналог	Страница
URE100X	Д304	283
URF100X	Д304	283
URG100X	Д304	283
USA55191/1	КД509А	314
UT112	Д229Ж	280
UT113	КД205Л	286
UT114	Д229К	290
UT115	Д229Л	295
UT212	Д229К	290
UT213	Д229Л	295
UT5105	Д305	279
UT6105	Д305	279
VB10	МД218	278
VB100	КД208А	282
VG1	МД218	278
VRE400X	Д246Б	297
VRF400X	Д246Б	297
XRG400X	Д246Б	297
VZ33CH	КС433А	310
VZ39CH	КС439А	310
VZ47CH	КС447А	310
VZ56CH	КС456А	311
XS10	Д229Ж	280
XS17	КД205Л	286
XS17A	КД205Л	286
Z1550	КС156А	305
Z1555	КС156А	305
Z1560	КС156А	305
Z1565	КС156А	305
Z1570	КС156А	305
Z1A5,6	КС156А	305
Z1B6,8	КС168А	306
Z1A11	Д811	309
Z1B5,6	КС156А	305
Z1B6,8	КС168А	306
Z1B11	Д811	309
Z1C5,6	КС156А	305
Z1B6,8	КС168А	306
Z1C11	Д811	309
Z1D4,7	КС147А	305
Z1C5,6	КС156А	305
Z1C6,8	КС168А	306
Z3D3,3	КС433А	310
Z4A3,3	КС433А	310
Z4B3,3	КС433А	310
Z4A3,9	КС439А	310
Z4A4,7	КС447А	310
Z4B3,9	КС439А	310
Z4B4,7	КС447А	310
Z4C3,3	КС433А	310
Z4C3,9	КС439А	310
Z4C4,7	КС447А	310
Z4D3,3	КС433А	310
Z4D4,7	КС447А	310
Z4,7	КС447А	310

Продолжение

Тип зарубежного диода	Отечественный аналог	Страница
Z5A3,3	КС433А	304
Z5B3,3	КС133А	304
Z5C3,3	КС133А	304
Z5D3,3	КС133А	304
Z6,8	КС168В	306
Z7,5	КС175А	307
Z8,2	КС182А	307
Z9,1	КС191А	308
Z10	КС210Б	308
Z11	КС211Ж	309
Z13	КС213Б	309
Z15	КС215Ж	309
Z22	КС222Ж	310
Z47CH	КС447А	—
ZC53	Д226В	275
ZEC4,7	КС447А	310
ZF3,3	КС113А	304
ZG3,3	КС133А	304
ZL103M	КД208А	281
ZM4,7	КС447А	310
ZP3,3	КС133А	304
ZR20	Д305	279
ZS24	Д209	276
ZR61	Д229Ж	280
ZR62	КД205Л	286
ZR63	Д229К	290
ZR64	Д229Л	295
ZS30B	КД204В	278
ZR200	Д305	279
ZS21	Д207	275
ZS22	Д208	275
ZS24	Д209	276
ZS30A	КД204В	278
ZS123	Д226В	275
ZS140	КД512А	311
ZS171	Д229Ж	280
ZS172	КД205Л	286
ZS174	Д229Л	295
ZS271	КД208А	281
ZZ6,8	КС168В	305
ZZ7,5	КС175А	307
ZZ8,2	КС182А	307
ZZ9,1	КС191А	308
ZZ10	КС210В	308
ZZ11	КС211Ж	309
ZZ13	КС213В	309
ZZ15	КС215Ж	309
ZZ22	КС222Ж	310
1B539	Д229К	290
1N74	Д101	274
1N87T	Д9В	273
1N113	Д245	292
1N149	Д229Л	293

Тип зарубежного диода	Отечественный аналог	Страница
1N192	Д219А	315
1N210	Д102	273
1N211	Д102	274
1N212	Д101	274
1N213	Д101	274
1N219	КД104А	275
1N220	КД104А	275
1N249	Д242	284
1N250	Д243	288
1N255	Д229Е	292
1N295X	Д9В	273
1N320	КД205Е	298
1N324	Д229В	279
1N324A	Д229В	279
1N332	Д229Е	292
1N339	Д229В	279
1N341	Д229Е	292
1N348	Д229В	279
1N354	КД104А	275
1N365	МД218	277
1N388	Д102	273
1N389	Д102	274
1N391	Д101	274
1N391	Д101	274
1N427	КД210Б	303
1N440B	Д229Ж	280
1N441	КД204Б	284
1N441B	КД205Л	286
1N442B	Д229К	290
1N443	Д7Ж	276
1N443B	Д229Л	295
1N444	КД205Е	298
1N445	КД105В	277
1N458	Д223Б	274
1N483	КД103А	274
1N485	Д207	275
1N486	Д207	275
1N487	Д208	275
1N487A	Д226В	275
1N488	Д209	275
1N531	КД204Б	284
1N533	КД205Б	293
1N534	КД205Е	298
1N535	КД105В	277
1N537	Д229Ж	280
1N538	КД205Л	286
1N539	Д229К	290
1N540	Д229Л	295
1N551	КД205Г	285
1N552	КД205В	289
1N553	Д7Ж	276
1N554	КД205А	299
1N555	КД205Ж	301
1N560	КД105Г	277

Продолжение

Тип зарубежного диода	Отечественный аналог	Страница	Тип зарубежного диода	Отечественный аналог	Страница
1N602	КД204Б	284	1N1069	Д246Б	296
1N602A	КД204Б	284	1N1071	Д304	283
1N604	Д7Ж	276	1N1073	Д243Б	287
1N605	КД205Е	298	1N1074	Д245Б	291
1N605A	КД205Е	298	1N1075	КД246Б	297
1N606	КД105В	277	1N1081A	Д229Ж	280
1N606A	КД105В	277	1N1082A	КД205Л	286
1N627A	Д312А	315	1N1083	КД205В	289
1N647	Д229Е	292	1N1083A	Д229К	290
1N662	Д220Б	317	1N1084	КД205Б	293
1N662A	Д220Б	317	1N1085	КД208А	282
1N663	Д220Б	317	1N1089	Д304	283
1N667	Д229В	279	1N1089A	Д304	283
1N673	Д229Е	292	1N1090	Д243Б	287
1N695	Д310	312	1N1091	Д245Б	291
1N770	Д310	312	1N1092	Д246Б	296
1N710A	КС168А	306	1N1092A	Д246Б	296
1N764-3	Д818А	307	1N1115	КД208А	282
1N777	Д312А	315	1N1169A	КД205Б	293
1N844	Д220Б	317	1N1219	КД521Г	312
1N873	Д210	276	1N1220	КД521Г	312
1N874	Д211	276	1N1251	КД204В	278
1N876	МД217	277	1N1253	КД205Г	284
1N878	МД218	277	1N1254	КД205В	288
1N903A	КД509А	313	1N1255	КД205Б	292
1N903AM	КД509А	313	1N1256	КД205Е	298
1N903M	КД509А	313	1N1257	КД105В	277
1N904	КД521Г	312	1N1258	КД205И	302
1N905A	КД521Г	312	1N1259	КД105Г	277
1N905AM	КД521Г	312	1N1407	МД217	277
1N905M	КД521Г	312	1N1440	КД205Л	287
1N906A	КД521Г	312	1N1441	Д229К	291
1N906AM	КД521Г	312	1N1446	КД208А	282
1N906M	КД521Г	312	1N1450	КД208А	282
1N907	КД521Г	312	1N1473	КД521Г	312
1N908A	КД509А	313	1N1487	Д229Ж	279
1N908AM	КД509А	313	1N1488	КД205Л	285
1N914A	КД521А	315	1N1489	КД205Л	289
1N914B	КД521А	315	1N1490	Д229Л	294
1N914M	КД521А	315	1N1520A	КС456А	310
1N916A	КД521А	315	1N1556	Д229Ж	281
1N916B	КД521А	315	1N1557	КД205Л	287
1N996	Д310	312	1N1558	Д229К	291
1N1031	КД205Г	285	1N1559	Д229Л	296
1N1032	КД205В	289	1N1563	КД208А	282
1N1033	КД205Б	293	1N1613	Д304	282
1N1053	КД208А	282	1N1613A	Д304	283
1N1059	Д304	283	1N1614A	Д243Б	287
1N1061	Д243Б	287	1N1615A	Д246Б	297
1N1062	Д245Б	291	1N1616	Д248Б	301
1N1063	Д246Б	296	1N1616A	Д248Б	301
1N1065	Д304	283	1N1617	КД208А	282
1N1067	Д243В	287	1N1621	Д242	283
1N1068	Д245Б	291	1N1622	Д243	288

Продолжение

Тип зарубежного диода	Отечественный аналог	Страница	Тип зарубежного диода	Отечественный аналог	Страница
1N1623	Д245	291	1N2093	Д229К	290
1N1624	Д246	297	1N2094	Д229Л	295
1N1632	КД104А	275	1N2104	Д229Ж	279
1N1645	Д229Ж	280	1N2105	КД205Л	285
1N1647	КД205Л	286	1N2106	Д229К	289
1N1649	Д229К	290	1N2107	Д229К	295
1N1651	Д229Л	294	1N2230	Д243Б	287
1N1694	Д229К	289	1N2230A	Д243Б	287
1N1695	Д229Л	294	1N2231	Д243Б	287
1N1703	КД204Б	284	1N2231A	Д243Б	287
1N1706	КД205Е	298	1N2232	Д245Б	291
1N1709	КД205Г	285	1N2232A	Д245Б	291
1N1710	КД205В	288	1N2233	Д245Б	291
1N1711	КД205В	293	1N2233A	Д245Б	291
1N1712	КД205А	299	1N2234	Д246Б	296
1N1763	КД205Б	293	1N2234A	Д246Б	296
1N1764	КД205А	299	1N2235	Д246Б	296
1N1765	КС456А	310	1N2235A	Д246Б	296
1N1765A	КС456А	310	1N2236	Д247Б	299
1N1844	Д102	273	1N2237	Д247Б	299
1N1849	КД104А	275	1N2237A	Д247Б	299
1N1927	КС139А	304	1N2238	Д248Б	301
1N1984	КС168В	305	1N2238A	Д248Б	301
1N1984A	КС168В	305	1N2239	Д248Б	301
1N1984B	КС168В	305	1N2239A	Д248Б	301
1N1985	КС182А	307	1N2246	Д305	279
1N1985A	КС182А	307	1N2246A	Д305	279
1N1985B	КС182А	307	1N2247	Д305	279
1N1986	КС210Б	308	1N2247A	Д305	279
1N1986A	КС210Б	308	1N2248	Д242	283
1N1986B	КС210Б	308	1N2248A	Д242	283
1N1988	КС215Ж	309	1N2249	Д242	283
1N1988A	КС215Ж	309	1N2249A	Д242	283
1N1988B	КС215Ж	309	1N2250	Д243	288
1N1989	КС218Ж	309	1N2250A	Д243	288
1N1989A	КС218Ж	309	1N2251	Д243	288
1N1989B	КС218Ж	309	1N2251A	Д243	288
1N1990	КС222Ж	309	1N2252	Д245	291
1N1990A	КС222Ж	309	1N2252A	Д245	291
1N1990B	КС222Ж	309	1N2253	Д245	291
1N2023	Д245	292	1N2253A	Д245	291
1N2025	Д246	297	1N2254	Д246	297
1N2069A	КД205Л	285	1N2254A	Д246	297
1N2070	Д229Л	294	1N2255	Д246	297
1N2070A	Д229Л	294	1N2255A	Д246	297
1N2073	Д229Ж	279	1N2256	КД206Б	299
1N2080	КД204В	278	1N2256A	КД206Б	299
1N2082	КД205Г	284	1N2257	КД206Б	299
1N2083	КД205В	288	1N2257A	КД206Б	299
1N2084	КД205Б	292	1N2258	КД206В	301
1N2085	КД205А	298	1N2258A	КД206В	301
1N2086	КД205Ж	300	1N2259	КД206В	301
1N2091	Д229Ж	280	1N2259A	КД206В	301
1N2092	КД205Л	286	1N2260	КД210Б	303

Тип зарубежного диода	Отечественный аналог	Страница	Тип зарубежного диода	Отечественный аналог	Страница
1N2260A	КД210Б	303	1N3600	КД509А	313
1N2261	КД210Б	303	1N3604	КД521А	315
1N2289	КД208А	281	1N3606	КД521А	315
1N2289A	КД208А	281	1N3607	КД521А	315
1N2290	Д304	282	1N3639	КД205Л	287
1N2290A	КД208А	—	1N3640	Д229Л	296
1N2350	Д303	284	1N3656	КД205Л	285
1N2373	Д211	276	1N3657	Д220Л	295
1N2374	МД218	278	1N3748	КД205Г	285
1N2391	КД208А	282	1N3749	КД205Б	293
1N2400	КД208А	282	1N3750	КД205Ж	301
1N2409	КД208А	282	1N3827	КС456А	310
1N2418	КД208А	282	1N3827A	КСА456А	310
1N2482	КД205Л	287	1N3873	КД509А	313
1N2483	Д229Л	296	1N3873H	КД509А	313
1N2487	Д229Л	296	1N3954	КД509А	313
1N2505	КД105Г	277	1N4008	МД3Б	311
1N2610	Д229Ж	280	1N4099	КС168А	306
1N2611	КД205Л	286	1N4147	КД503А	312
1N2612	Д229К	290	1N4148	КД521А	315
1N2613	Д229Л	295	1N4149	КД521А	315
1N2638	КД208А	281	1N4153	КД521А	316
1N2786	Д243	288	1N4305	КД521А	316
1N2793	Д305	279	1N4306	КД509А	313
1N2847	КД208А	282	1N4307	КД509А	313
1N2859	Д229Ж	281	1N4364	Д229Ж	280
1N2860	КД205Л	287	1N4365	КД205Л	286
1N2862	Д229Л	296	1N4366	Д229К	290
1N2878	КД205И	302	1N4367	Д229Л	295
1N2879	КД205И	302	1N4436	Д243	288
1N3063	КД521А	315	1N4437	Д246	297
1N3064	КД509А	313	1N4438	КД206В	302
1N3064M	КД521А	315	1N4439	КД210Б	303
1N3065	КД521А	315	1N4446	КД521А	316
1N3067	КД521Г	312	1N4447	КД521А	316
1N3082	КД205Г	285	1N4448	КД521А	316
1N3083	КД205Б	294	1N4449	КД521А	316
1N3121	Д220	314	1N4454	КД509А	313
1N3184	КД205А	298	1N4531	КД521А	316
1N3193	КД205Л	287	1N4532	КД509А	313
1N3194	Д229Л	296	1N4622	КС139А	304
1N3228	КД205Г	284	1N4624	КС147А	305
1N3229	КД205А	298	1N4655	КС456А	310
1N3238	Д229Ж	279	1N4686	КС139А	304
1N3239	КД205Л	285	1N4688	КС147А	305
1N3240	Д229Л	295	1N4734	КС456А	310
1N3253	КД205Л	287	1N4734A	КС456А	310
1N3254	Д229Л	296	1N4817	КД208А	281
1N3270	Д246Б	296	1N5151	КД521А	315
1N3277	КД205Л	287	1N5209	Д223Б	274
1N3278	Д229Л	296	1N5215	КД205Г	284
1N3282	МД218	277	1N5216	КД205Б	293
1N3545	КД205Г	285	1N5217	КД205Ж	300
1N3547	Д229Л	—	1N5318	КД521А	316

Тип зарубежного диода	Отечественный аналог	Страница	Тип зарубежного диода	Отечественный аналог	Страница
1N5392	КД208А	282	1S1224	Д211	276
1N4153	КД521А	315	1S1225A	МД218	278
1N5151	КД521А	315	1S1230	КД205Б	293
1N5518B	КС133А	303	1S1231	КД205А	299
1N5518C	КС133А	303	1S1232	КД205Ж	300
1N5518D	КС133А	303	1S1473	КД521Г	312
1N5720	КД503А	312	1S1660	Д303	284
1P644	Д229В	279	1S1763	КД205Б	292
1P647	Д229Е	292	1S1849	КД208А	282
1S020	КД208А	281	1S1942	КД205Г	285
1S031	Д229Ж	280	1S1943	КД205Б	293
1S032	КД205Л	285	1S1944	КД205Ж	300
1S034	Д229Л	294	1S2033	КС133А	303
1S40	Д229Ж	280	1S2033A	КС133А	303
1S41	КД205Л	286	1S2310	КД105В	277
1S42	Д229К	290	1S2352	Д211	276
1S43	Д229Л	294	1S2354	МД21	278
1S75	Д9В	273	1S7033	КС133А	303
1S100	Д229Ж	280	1S7033A	КС133А	303
1S101	КД205Л	286	1S7033B	КС133А	304
1S103	Д229Л	294	1T502	КД205Г	285
1S113	Д229Е	292	1T503	КД205В	289
1S148	Д229К	289	1T504	КД205Б	293
1S161	Д242	283	1T505	КД205А	299
1S162	Д243	288	1T506	КД205Ж	301
1S163	Д245	291	1TT44	КД509А	314
1S164	Д246	297	1TT33	КД512А	316
1S165	КД206Б	299	1TT3003	Д207	274
1S166	КД206В	302	1WS1	КД208А	282
1S206	Д210	276	1,5E1	КД208А	282
1S240	Д242	283	1,5J1	КД208А	282
1S307	Д18	312	2A44	КС133А	304
1S312	КД205Г	285	2G8	КД205Л	286
1S313	КД205В	289	2T502	КД205Г	285
1S314	КД205Б	293	2T503	КД205В	289
1S315	КД205А	299	2T504	КД205Б	293
1S334	Д818А	307	2T505	КД205А	299
1S421	Д243	288	2T506	КД205Ж	301
1S423	Д246	297	3C15	Д303	284
1S425	КД206В	302	3FD121	МД3А	311
1S426	Д10	273	3G8	Д229К	290
1S427	КД210Б	302	3T502	КД205Г	285
1S442	КД202Б	278	3T503	КД205В	289
1S444	КД208А	282	3T504	КД205Б	293
1S472	КС190А	307	3T505	КД205А	299
1S473	Д811	308	3T506	КД205Ж	301
1S544	КД210Б	303	4D4	Д229Е	292
1S558	КД205А	299	4G8	Д229Л	295
1S559	КД205В	289	4T502	КД205Г	285
1S751	Д243Б	287	4T503	КД205В	289
1S1071	КД208А	281	4T504	КД205Б	293
1S1219	КД521Г	312	4T505	КД205А	299
1S1220	КД521Г	312	4T506	КД205Ж	301
1S1221	КД205Г	284	5BR1	Д304	282

23 Заказ № 1141

Тип зарубежного диода	Отечественный аналог	Страница	Тип зарубежного диода	Отечественный аналог	Страница
5D4	К246Б	294	60AS	КД205Ж	300
5E1	Д229Ж	279	60F5	Д248Б	301
5E2	КД205Г	285	60LF	Д248Б	301
5E3	КД205В	289	60M	КД205Ж	301
5E4	КД205Б	293	60S5	КД205Ж	301
5E5	КД205А	298	62R2	Д243	288
5E6	КД205Ж	300	64R2	Д246	297
5J2	КД205Г	285	66R2	КД206В	302
5J3	КД205В	289	66R2S	КД206В	302
5J4	КД205Б	293	68R2	КД210Б	303
5J5	КД205А	298	68R2S	КД210Б	303
5J6	КД205Ж	300	72R2B	КД205Л	285
5MA2	КД205Л	285	75R2B	КД205Л	285
5MA4	Д246Б	294	100D10	МД218	277
5PM1	Д304	283	100K10	МД218	278
5PM2	Д243Б	287	366B	Д304	283
5PM4	Д246Б	296	366D	Д243Б	287
5PM6	Д248Б	301	366F	Д245Б	291
7E1	Д229Ж	280	366H	Д246Б	297
7E2	КД205Л	286	366K	Д247Б	299
7E3	Д229К	290	366M	Д248Б	301
7E4	Д229Л	295	367B	Д242	283
7J1	Д229Ж	280	367D	Д243	288
7J2	КД205Л	286	367F	Д245	292
7J3	Д229К	290	367H	Д246	297
7J4	Д229Л	295	367K	КД206Б	300
10F5	Д304	283	367M	КД206В	302
10PM1	Д242	283	407K	Д247Б	299
10PM2	Д243	—	407M	Д248Б	301
10PM4	Д246	297	408K	КД206Б	300
10PM6	КД206В	302	408M	КД206В	302
10PM8	КД210Б	303	408P	КД203Г	302
10R6B	Д211	276	408S	КД210Б	303
10R10B	МД218	277	500R1B	Д304	282
11R1S	Д242	283	616C	Д102	273
11R2S	Д243	288	618C	Д101	274
11R3S	Д245	291	653C3	КС168В	305
11R4S	Д246	297	653C4	КС170А	307
14P2	Д223Б	274	654C9	КСМ190А	307
20AS	КД205Г	285	655C9	КС210Б	308
20SS	КД205Г	285	1103	КС133А	304
24J2	Д223Б	274	1104	КС147А	305
26P1	Д220	314	1106	КС168А	306
30AS	КД205В	289	1111	Д811	308
30F5	Д245Б	291	5508	КС133А	304
30S5	КД205В	289	7708	КС433А	310
40AS	КД205Б	293	9607	КС175А	307
40F5	Д246Б	297	40109	Д242	284
40S5	КД205Б	293	40110	Д243	288
50AS	КД205А	298	40111	Д245	292
50F5	Д247Б	299	40112	Д246	298
50J2P	КД206Б	299	40113	КД206Б	300
50LF	Д247Б	299	40114	КД206В	302
50M	КД205А	299	40115	КД210Б	303
50S5	КД205А	299	40808	КД205Ж	301

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Перечень отечественных транзисторов, включенных в справочник

Тип транзистора	Страница	Тип транзистора	Страница	Тип транзистора	Страница
ГТ109	64	КТ343	150	КТ812	250
ГТ115	66	КТ345	126	КТ814	220
ГТ124	66	КТ347	150	КТ815	220
ГТ125	68	КТ349	150	КТ816	222
ГТ305	102	КТ350	124	КТ817	224
ГТ308	106	КТ351	124	КТ818	228
ГТ309	100	КТ352	124	КТ819	232
ГТ310	94	КТ355	156	КТ825	254
ГТ311	114	КТ357	148	КТ827	256
ГТ313	108	КТ358	118	КТ828	252
ГТ320	108	КТ361	126	КТ829	258
ГТ321	106	КТ363	154	КТ834	260
ГТ322	94	КТ368	152	КТ835	238
ГТ328	110	КТ371	160	КТ837	240
ГТ329	114	КТ372	156	КТ838	238
ГТ330	114	КТ373	144	КТ839	252
ГТ338	47	КТ375	122	КТ840	240
ГТ341	114	КТ382	162	КТ902	270
ГТ346	112	КТ399	162	КТ903	270
ГТ362	116	КТ501	90	КТ904	262
ГТ376	112	КТ502	92	КТ907	264
ГТ402	166	КТ503	92	КТ908	250
ГТ403	166	КТ601	172	КТ909	266
ГТ404	168	КТ602	198	КТ911	268
ГТ405	166	КТ603	182	КТ912	270
ГТ406	168	КТ604	186	КТ913	266
ГТ701	210	КТ605	180	КТ920	264
ГТ703	204	КТ606	262	КТ922	264
ГТ705	210	КТ608	186	КТ928	194
ГТ806	212	КТ610	262	КТ932	242
ГТ810	212	КТ611	188	КТ933	238
ГТ905	212	КТ616	182	КТ940	196
КТ104	84	КТ617	184	КТ943	242
КТ201	82	КТ618	182	КТ945	254
КТ203	84	КТ626	200	КТ3102	134
КТ208	86	КТ630	172	КТ3107	140
КТ209	88	КТ639	190	КТ3109	164
КТ301	118	КТ644	190	КТ3117	148
КТ306	130	КТ645	194	КТ3120	164
КТ312	118	КТ646	194	КТ3129	156
КТ313	148	КТ704	216	КТ3130	158
КТ315	120	КТ801	214	МГТ108	68
КТ316	132	КТ802	248	МП20	74
КТ325	154	КТ803	248	МП21	74
КТ326	152	КТ805	218	МП25	78
КТ337	152	КТ807	216	МП26	78
КТ339	120	КТ808	244	МП35	80
КТ340	128	КТ809	244	МП36	80
КТ342	132				

Тип транзистора	Страница	Тип транзистора	Страница	Тип транзистора	Страница
МП37	80	П203	202	П403	104
МП38	80	П210	208	П416	104
МП39	70	П213	202	П417	98
МП40	70	П214	202	П422	102
МП41	70	П215	202	П423	102
МП42	78	П216	206	П605	170
П27	64	П217	206	П606	170
П28	64	П307	116	П607	170
П29	82	П308	116	П608	170
П30	82	П309	116	П609	172
П201	202	П401	104	П701	214
П202	202	П402	104	П702	218

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Перечень отечественных диодов, включенных в справочник

Тип диода	Страница	Тип диода	Страница	Тип диода	Страница
Д2Д	274	Д303	284	КД509А	313
Д7Ж	276	Д304	282	КД512А	311
Д9В	273	Д305	279	КД521А	315
Д10	273	Д310	312	КД521Б	315
Д18	311	Д311	312	КД521Г	312
Д101	274	Д312А	315	КД521Д	311
Д102	273	Д811	308	КС133А	303
Д207	274	Д818А	307	КС139А	304
Д208	275	КД102А	275	КС147А	305
Д209	275	КД103А	274	КС156А	305
Д210	276	КД104А	275	КС168А	306
Д211	276	КД105В	276	КС168В	305
Д219А	315	КД105Г	277	КС170А	307
Д220Б	317	КД202Б	278	КС175А	307
Д223А	274	КД202Г	282	КС182С	307
Д223Б	274	КД203Г	302	КС190А	307
Д226В	275	КД204Б	284	КС191А	307
Д229В	279	КД204В	278	КС196А	308
Д229Е	292	КД205А	298	КС210Б	308
Д229Ж	279	КД205Б	292	КС211Ж	309
Д229К	289	КД205В	288	КС215Ж	309
Д229Л	294	КД205Г	284	КС218Ж	309
Д242	283	КД205Е	298	КС222Ж	309
Д243	287	КД205Ж	300	КС433А	310
Д243Б	287	КД205И	302	КС439А	310
Д245	291	КД205Л	285	КС447А	310
Д245Б	291	КД206Б	299	КС456А	310
Д246	297	КД206В	301	МД3А	311
Д246Б	296	КД208А	281	МД3Б	311
Д247Б	299	КД210Б	302	МД217	277
Д248Б	301	КД503А	312	МД218	277
		КД503В	311		

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Буквенные обозначения транзисторов зарубежных фирм

Буквенное обозначение	Фирма	Буквенное обозначение	Фирма
A	AEC	BD	ASI, BEL, CSD, CSC, ML, PEC, RTC, RFT, SA, Unitra
AC	BEL, CSD, EI, GPD, ML PEC, RTC, SA, V, WDI	BDP	Unitra
ACY	CSD, EI, GPD, HSE, Thom, SA	BDV	ML, PEC, RTC, SGS, V
AD	ASI, BEL, CSD, EI, GPD, ML, PEC, RTC, SA, V WDI	BDW	CSD, IPS, ML, PEC, RTC, SGS, SSE, SDI, V
ADP	Unitra	BDX	BEL, CSC, CSD, FEL, IPS ML, SGS, RTC, PEC, V
ADY	GPD	BDY	IPS, HSE, ML, PEC, RTC, SDI, Tel, SGS, Unitra, V
ADZ	CSD, GPD	BE	BE
AF	EI, GTC, HSE, IDI, ML, PEC, RTC, Unitra, V, WDI	BEL	BEL
AFY	EI	BF	AEC, ASI, BEL, FEL, CDI, CSD, Acr, CSC, EI, IDI, KRD, IC, HSE, MIS, PEC, RET, RTC, Tel, V, WDI, Unitra
AL	CSD, GPD	BFE	Unitra
AM	AMI	BFN	RTC, SA
AMF	AMI	BFP	SA, Unitra, TI
AP	Acr, ASC	BFQ	AEC, FEL, ML, RTC, PEC, V
ASY	CSD, GPD, Unitra	BFR	AEC, ASI, CSD, IC, ML, PEC, RTC, SA, Thom, Unitra, V, MDI
ASZ	BEL, CSD, GPD, WDI	BFS	AEC, ASI, FEL, HSE, ML, PEC, RTC, Thom, Unitra, SA, V, WDI
AT	AI	BFT	ASI, FEL, ML, PEC, RTC, SA, SGS, Tel, Thom, V
AU	CSD, GPD	BFV	TI
AUY	CSD, GPD, HSE	BFW	AEC, ASI, BEL, CDI, CSC, CSD, ML, PEC, RTC, Unitra, V, WDI
B	AI, STI, Thom	BFX	ASI, CDI, CSD, CSC, FEL, IDI, HSE, GTC, ML, PEC, RTC, SGS, Tel, V, WDI
BAL	AI	BFY	ASI, CSD, CSC, CDI, HSE IDI, FEL, ML, PEC, SGS, Tel, V, WDI
BAM	AI	BGY	ML, PEC, RTC
BAP	AI	BLU	ML, PEC, RTC, V
BC	AEC, ASI, BEL, CDI, EI, CSC, CSD, FEL, IDI, ITT, KPD, MEL, ML, PEC, RTC, SA, SGS, Thom, Unitra, V	BLV	ML, PEC, RTC, V
BCE	Unitra	BLW	ML, PEC, RTC, V
BCF	AEC, ML, PEC, RTC, Thom, V		
BCP	Unitra		
BCV	AEC, FEL, ML, RTC, Thom, SA, V		
BCW	AEC, ASI, CSD, CSC, FEL, ML, PEC, RTC, SA, SEC, Thom, Unitra V, WDI		
BCX	AEC, ASI, CSD, CSC, FEL, ITT, ML, PEC, RTC, SA, SEC, Thom, V, WDI		
BGY	AEC, ASI, CSD, CSC, ML, PEC, RTC, V, WDI		

Буквенное обозначение	Фирма
BLX	ML, PEC, RTC, SDI, V
BLY	HSE, ML, PEC, RTC, V
BM	Syn
BP	Syn
BR	MEL, SDI
BRT	Sem, TRW
BRY	ML, PEC, RTC, V
BS	ITT, ML, PEC, RTC, V
BSJ	EI
BSR	AEC, ML, PEC, RTC, Thom, V
BSS	AEC, ASI, CSD, FEL, IDI
	ML, PEC, RTC, SA, V, WDI
BST	AEC, ML, PEC, RTC, V
BSV	AEC, CSD, FEL, ML, PEC, RTC, SA, SGS, Thom, V, WDI, Tel
BSW	AEC, ML, MIS, PEC, RTC, SGS, Tel, Unitra, V
BSX	ASI, CDI, CSD, CSC, EI, HSE, IDI, ML, MIS, PEC, RTC, SGS, Tel, Unitra, V, WDI
BSXP	Unitra
BSY	ASI, CDI, CSC, HSE, IDI, FEL, ML, PEC, RTC, SGS, Tel, V
BT	RS
BU	ASI, CSD, DTC, GTC, HSE, KPD, ML, NEC, PEC, PPI, RTC, SDI, SGS, Tel, Thom, Unitra, V, WDI
BUC	Mot
BUP	Unitra
BUR	SGS, Sem
BUS	ML, PEC, RTC, Thom, V
BUT	ML, PEC, RTC, SGS, Tel, V
BUV	ML, PEC, RTC, SDI, SGS, Tel, Thom, V
BUW	CSD, ML, PEC, RTC, SGS, SDI, Thom, V
BUX	CSD, FEL, KPD, ML, PEC, RTC, SGS, SDI, Tel, Thom, Unitra, UC, V, WDI
BUYP	PPI, Unitra
BUY	ASI, FEL, CSD, HSE, RTC, SGS, SDI, WDI
BUZ	ML, PEC, RTC, SA, SGS, V

Буквенное обозначение	Фирма
BZW	SA
C	ASI, Acr, TCI, TI, WDI
CA	GPD
CD	Syn
CDI	GPD
CF	Syn
CIL	CDI
CK	STI
CM	TCI
CP	TCI
CQT	GPD
CS	ASI, NSC, WDI
CST	GPD
CT	SEC
CTR	GPD, STI
CV	SEM
CX	ASI, WDI
D	Acr, CSC, GE, Mot, NSC, SGS, PPI, STI, TI, WEC
DA	GPD, WEC
DB	WEC
DC	DI
DD	AMS
DI	DI
DM	AMS
DMP	ML, PEC, RTC, V
DN	DI, SI
DP	DI
DQN	DI
DT	MED
DTG	ASI, DTC, GPD, STI, WDI
DTN	DI
DTS	ASI, CSD, DTC, SPC, SSI, TI, WDI
DV	SI
DVD	SI
E	NSC, SDI, WDI
ED	NSC
EN	ASI, CSD, IDI, STI, WDI
ERS	ETC
ESM	MIS, Thom
ETP	ETC
FC	SEC
FGT	FEL
FMMT	FEL
FM	Acr, NSC
FN	SI
FOS	ITT
FT	FS, Mot, STI
FTR	FS
GC	RET, Tesla
GD	RET, Tesla

Буквенное обозначение	Фирма
GE	CSC, CSD, GE
GET	GE
GF	RET, Tesla
GFY	Tesla
GS	RET, Tesla
GSDB	GSI
GSDS	GSI
GSDU	GSI
GSRU	GSI
GSTU	GSI
GT	GDC, HSE
H	Syn
HA	GDC
HEP	Mot
HEPF	Mot
HEPS	Mot
HP	HP
HS	GE, SEC
HSE	HSE
HT	FEL
HV	BEL
IDA	IDI
IDB	IDI
IDC	IDI
IDD	IDI
IDI	IDI
IMF	II, NSC
IR	IR
IRF	FS, IR, Mot, RCA, SGS, SI
IRFD	IR
IRFF	IR
IRF2	IR
IT	II
ITE	II, NSC
J	IC, II, Mot, NSC, SI, SDI
JA	ITT
JC	ITT
JE	NEC
JH	SDI
JO	TRW
K	ASI, HSE, KMC, WDI
KA	Tesla
KB	WEC
KC	Tesla
KD	KMC, Tesla, WEC
KE	NSC, SWI, WDI, WEC
KF	MA, Tesla
KFY	Tesla
KJ	MA
KM	ASI, WDI
KN	KPD
KP	KPD

Буквенное обозначение	Фирма
KS	Tesla, WEC
KSP	PPC
KSY	Tesla
KU	Tesla
KUY	Tesla
L	ASI, WDI
LDA	AEC
LOT	TRW
LS	SI
LT	NSC
M	ASI, II, WDI
MA	ASI, HSE, MEL, Mot, STI, WDI
MC	PIC
MD	CSC, Mot, PIC
MDS	Mot
MEM	GI, SDI
MEU	MEL
MF	Mot, PIC, STI
MFE	CSC, Mot, SDI, SI
MFEC	Mot
MG	TC
MGM	Mot
MGP	Mot
MH	MEL, WDI
MHA	FS
MJ	ASI, CSC, CSD, IDI, GTC, IPS, Mot, PPI, RCA, SGS, STC, STI, TI, WDI
MJE	ASI, CSD, CSC, GTC, IDI, MEC, Mot, NSC, PPI, SGS, STI, Thom, WDI
MJEC	Mot
MJH	Mot
MM	ASI, CSC, HSE, Mot, STI, WDI
MMBA	Mot, SEC
MMBC	Mot, SEC
MMBF	Mot, NSC
MMBPU	Mot
MMBR	Mot
MMBT	Mot, NSC, SEC
MMBTA	Mot, SEC
MMBTH	Mot, NSC
MMBTS	Mot
MMC	Mot
MMCF	Mot
MMF	Mot
MMCM	Mot
MMT	Mot
MN	STI
MP	GPD, MPS, MEL, STC

Продолжение

Буквенное обозначение	Фирма	Буквенное обозначение	Фирма
MPF	MEL, Mot, NSC, SDI, SI, WDI	NTM	NEC
MPS	FEL, FS, CSC, CSD, IDI, GE, Mot, NSC, RC, SEC, STI, TI, Thom, WDI	OC	GPD, HSE, GTC, STI, TI
MPSA	CSD, FEL, FS, GE, IDI, MEL, Mot, NSC, RC, SEC, STI, TI, Thom, WDI	ON	ML, PEC, RTC, V
MPSC	Mot	P	Cherry, NSC, SDI, SI, SSDI, WDI
MPSD	CSC, CSD, GE, MEL, Mot, RC, SEC, STI, WDI	PA	Philco
MPSH	CSC, CSD, FS, GE, IDI, MEL, Mot, NSC, SEC, STI, WDI	PB	Philco
MPSK	CSC, SEC	PBM	Philco
MPSL	CSC, FS, GE, IDI, Mot, NSC, SEC, STI, TI, WDI	PC	Philco
MPSU	Mot, SPE, WDI	PD	DI, Philco
MPSUC	Mot	PE	FS, Philco, NSC, PPI
MPSW	Mot, NSC	PEC	PPI
MPU	GE, Mot	PET	STI
MPX	Mot	PF	NSC
MRF	DTC, Mot	PG	SEC
MRFC	Mot	PH	AEC, ML, PEC, RTC, V
MS	TI	PL	TI
MSA	FS	PMD	CSD, LS
MSB	WDI	PMS	LS
MSP	HSE, STI	PN	CSC, CSD, FS, MEL, NSC, RC, SSDI, SSI
MST	HSE, STI	PT	BEL, PTI, SSDI, TRW
MT	FS, MEL, PTI	Q	HSE
MTA	Mot	R	WDI
MTE	Mot	RCA	RCA
MTH	Mot	RCP	STI
MTM	Mot, SGS	RCS	RCA
MTP	FS, Mot, SGS	RFD	FEL
MTS	Mot	RFH	RCA
MTU	MEL	RFK	RCA
MU	GE, Mot	RFL	RCA
N	Cherry, KPD, TI	RFM	RCA
NA	NSC	RFP	RCA
NB	NSC	RRF	RCA
NDF	NSC	RT	RTC
NF	II, MEL, NSC, SI, TS	S	Acr, SSDI, TC, UA
NKT	HSE	SC	GPD, RET, PIC
NPC	Thom	SCA	PIC
NPD	NSC	SD	ML, RET, RTC, Tel, SI, Thom, V
NR	NSC	SDF	SDI
NS	NSC	SDC	GPD
NSD	NSC, WDI	SDM	SDI
NSDU	NSC	SDN	STC
NSE	NSC	SDP	STC
NT	NEC	SDT	CSC, GPD, SDI, SSDI
		SE	ASI, CSD, FS, IDI, GTC, Mot, NSC, SEC, STI, WDI
		SF	PIC, RFT
		SFN	SDI
		SFT	MIS, PIC, Thom
		SGS	SGS

Продолжение

Буквенное обозначение	Фирма	Буквенное обозначение	Фирма
SGSP	SGS	TIP	ASI, CSC, CSD, FEL, GTC, IDI, MEC, MEL, Mot, ML, NSC, PPI, PEC, RCA, RTC, SGS, SDI, STI, TI, V, WDI
SHA	SSI	TIPC	Mot
SK	RCA, STI	TIPL	TI
SL	PSE	TIS	DIC, IDI, MEL, NSC, SDI, STI, TI, WDI
SM	RET	TIX	TI
SMBT	SA	TIXM	TI
SO	Thom	TIXP	PTI
SOR	Thom	TIXS	TI
SP	RS, SDI	TL	Thom
SPC	SPC	TMP	SEC
SPK	SDI	TN	NSC, MEL, Supertex, TCI, TI
SPM	SDI	TP	SEC
SPT	SSI	TPE	SEC
SQ	SEM	TPP	SEC
SQD	SEM	TPS	SEC
SRF	FEL	TPV	TRW
SRL	STC	TQ	SEC
SRLP	STC	TR	GDC, HSE, HVS, ME, STI
SRM	STC	TRF	TI
SRS	STC, STI	TRL	GDC, HSE, STI
SS	RFT, SSI	TRM	GDC, HVS, HSE, STI
SSP	SSI	TRS	GDC, HSE, HVS, SSDI, STI
SSX	PIC	TRSP	GDC, HSE, HVS, SSDI, STI
ST	NSC, STI, TC	TRW	TRW
STA	STC	TS	TI
STC	PTI	TSB	TC
STI	STI	TZ	SEC
STIP	STI	U	IFC, II, NSC, Mot, SI, SDI, UC, WDI
STM	STI	UC	Mot, SDI
STP	STI	UMIL	Acr
STS	STC	UMT	UC
SU	RFT, SGS, TSC	UPT	UC
SV	NSC	UTV	Acr
SVN	SDI	V	SGS, UA
SVT	SDI, SSDI, STI, TRW	VAM	Acr
SWT	SECI	VCR	II, SI
T	SEM	VMIL	Acr
TBC	TC	VMOB	Acr
TBF	TC	VMP	SI
TC	MED	VN	II, SDI, SI, Supertex
TCH	TAG	VNM	SDI
TCS	TI	VNN	SDI
TEC	TC	VNP	SDI
TED	TC	VP	SDI, Supertex
TF	MED		
TG	Unitra		
TH	SEC, Thom		
THA	Thom		
THB	Thom		
THX	Thom		
THY	Thom		
TI	HSE, STI, TI, WDI		

Буквенное обозначение	Фирма	Буквенное обозначение	Фирма
VQ	Supertex	6NU	Tesla
VTV	Acr	7NU	Tesla
W	WDI	101NU	Tesla
WT	WEC	102NU	Tesla
XGS	GSI	103NU	Tesla
XGSA	GSI	104NU	Tesla
XGSQ	GSI	105NU	Tesla
XGSR	GSI	106NU	Tesla
ZTD	FEL	107NU	Tesla
ZT	FEL	152NU	Tesla
ZTX	FEL	153NU	Tesla
ZVN	FEL	154NU	Tesla
2NU	Tesla	155NU	Tesla
3NU	Tesla	156NU	Tesla
4NU	Tesla	2T	EE
5NU	Tesla		

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Буквенные обозначения диодов зарубежных фирм

Буквенное обозначение	Фирма	Буквенное обозначение	Фирма
A	AII, EII, GDC, GE, IRC, HL, MDP, NJS, Sem, SSI	AY	EI
AA	AEI, CSR, ITT, Mist, ML, PEC SA, Sem, STI, Tel, Thom, V	AZ	EI
AAP	Unitra	B	BB, EII, FE, MEL, RG, UC
AAY	ML, Unitra	BA	AEI, EI, EII, FE, FSC, SGS, HS, ITT, ML, NAS, PEC, PI, SA, Tel, Thom, V, WDI, Unitra
AAZ	EI, Mist, PI, Thom	BAE	Unitra
AB	Sem	BAL	SA, Thom
AC	Sem	BAP	Unitra
AD	SE	BAR	EII, SA, Thom, Unitra
AE	AS, ML	BAS	AEI, ML, PEC, RTC, SA, Thom, V
AEY	ML	BAT	AEI, ML, PEC, RTC, Thom, V
AF	DTC	BAV	AEI, FEL, FSC, ITT, ML, PEC, RTC, SA, SEC, Tel, Thom, V
AGP	GIC	BAVP	Unitra
AP	APD	BAW	AEI, FEL, FSC, ML, PEC, RTC, V, SA, SEC, Tel, Thom, Unitra
AR	AS, GIC		
ARF	AS		
AS	Atl		
ASZ	SL		
AU	HL		
AW	HL		

Буквенное обозначение	Фирма	Буквенное обозначение	Фирма
BAX	FSG, ITT, ML, PEC, RTC, SGS, Thom, V	BZX	AEI, CDI, CSDC, FE, FEL, ITT, ML, NAS, PEC, RTG, SA, SEC, Tel, Thom, Unitra, V
BAY	FSC, ML, PEC, SA, Tel, Thom, Unitra	BZY	AEI, EI, FE, ML, PEC, RTC, SA, SCL, Thom, V
BAYP	Unitra	BZYP	Unitra
BB	IRC, ITT, HL, PEC, Thom, Unitra	BZZ	PEC
BBP	Unitra	C	BB, CODI, HL, SCL, UC
BBY	PEC	CA	RCA
BCD	EII	CAX	UC
BD	MED, RC	CAY	ML
BFW	STI	CB	EDI
BH	EDI	CD	CDI, MSC
BOD	BB	CER	SDI, SI
BOV	BB	CF	CODI
BP	EI	CFR	CODI
BPH	RCC	CG	GIC
BPHV	RCC	CH	SA, Thom
BQ	EI	CIL	TCI
BR	EII, RL, TRW	CL	CODI
BRV	RCC	CLR	CODI
BS	IRC, LEC	CLVA	TRW
BXY	ML	CND	CODI
BXYP	Unitra	CNM	CODI
BY	AEI, BEL, EDI, EI, FE, ITT, LEC, ML, NAS, PEC, RTC, SA, SGS, Thom, WDI	COD	CODI
BYD	PEC	CP	EDI
BYM	PEC	CR	SCL
BYP	Unitra	CRD	CODI
BYQ	PEC	CRG	CODI
BYR	PEC	CRHG	SSDI
BYS	SA	CRS	CODI
BYT	PEC, Thom	CRT	CODI
BYV	ML, PEC, RTC, Tel, Thom, V	CSB	CSDC
BYM	AEI, FEL, ML, PEC, RTC, Tel, Thom, V	CSKB	SII
BYX	CSDC, MED, ML, NAS, PEC RTC, SCL, Thom, V	CTM	SE
BYY	CSDC, ML, Tel	CTR	MDP
BYYP	Unitra	CTU	SE
BZ	AEI, CSDC, EI, NJRC, RC, Tel	CTZC	Sem
BZD	PEC, SA	CXY	ML
BZP	Unitra	CY	Thom
BZT	PEC, RTC	CZ	CSR
BZV	FEL, ML, PEC, RTG, SA, Thom, V	D	SEM, Sem, TEI, Tel, Tel, Thom
BZW	PEC, RTC, SA, SGS, Thom, V	DA	GE, LEC, Rohm, Tel
BZWP	Unitra	DAC	SL
		DBA	San
		DB	SL
		DCA	San
		DD	CODI, LEC, Tel
		DE	DI, GE
		DF	CODI, DI
		DFA	San

Буквенное обозначение	Фирма	Буквенное обозначение	Фирма
DFB	San	EZ	NJRC
DFC	San	F	EII, NEC, Samtech, SDI, STSI, Thom
DG	GIC, Unitra	FA	FSC
DHA	San	FB	FE
DHB	San	FC	SE
DHD	GE	FD	FSC, GS, MEC, PSI
DHR	Thom	FDC	FSC
DI	DI, MEL	FDH	FSC
DK	Unitra	FE	GIC, GS
DL	SDI	FF	GS, Samtech
DMG	Unitra	FG	GS
DNN	Thom	FH	FSC
DR	BEL, HS, EDI, STI	FJT	FSC
DRN	Thom	FM	Samtech
DRX	BEL	FR	RL
DS	BB, MED, San	FS	Mist, RCC, Thom
DSA	BB, San	FSA	FSC
DSD	BB	FSN	RCC
DSF	MED	FSY	FE
DSH	AII	FWL	Sem
DSR	TRW	FWLA	Sem
DSZ	MED, TRW	FWLC	Sem
DT	GDC, GE	FWLD	Sem
DTZ	Thom	FZD	Thom
DZ	GE, San	G	APD, EII, GIC, UC, Thom
DZG	Unitra	GA	RFT, Tesla
E	EII, STSI	GAY	Tesla
EA	ED	GD	PSI, SA
EC	EDI	GEM	ML
ED	OEC, Sem	GER	GDC, GE
EF	EDI	GEX	ML
EG	EDI	GFA	San
EGP	GIC	GFB	San
EH	EDI	GFD	San
EK	EDI	GFE	San
EM	ITT	GH	SEC
EQ	Thom	GHV	GSI, SE
EQA	FEC	GI	GIC
EQB	FEC	GLA	CODI
ER	GDC, Thom	GLT	Thom
ERA	FEC	GM	GIC, SE
ERB	FEC	GMP	GSI
ERC	FEC	GP	GIC, RFT
ERD	FEC	GR	Thom
ESAB	FEC	GS	Thom
ESAC	FEC	GSA	San
ESAD	FEC	GSB	San
ESDA	GSI	GSD	GSS
ESJA	FEC	GSV	GSI, GSS
ESM	Thom	GSZ	SL
ESP	ESPI	GU	GPD, SE
ESZ	SL	GY	RFT
EV	Thom		
EW	Thom		

Буквенное обозначение	Фирма	Буквенное обозначение	Фирма
GZ	Thom	IN	CD
GZA	San	IRD	IRC
GZB	San	IRWC	SL
H	EII, HL, MDP, Sem, VSI	IS	QC, San
HA	MENA, Sem, UC	ISS	HL
HAB	EDI	ISV	HL
HB	Sem	ITT	ITT
HC	Atl, SDI, SE, Sem	J	Atl, EII, HL, MEL, SDI
HCR	LT	JD	PSI
HCV	SDI	JKV	CSDC
HD	PSI, STI	K	CODI, EII, MA, MEL
HF	SE	KA	Tesla
HG	STI	KBCTD	GIC
HM	Harris	KBCTP	GIC
HMG	Semicoa	KBF	GIC
HP	CODI, HP	KBL	GIC
HPA	CODI	KBP	GIC
HR	CODI	KBPC	GIC
HS	MENA, Tel, UC	KBPS	GIC
HSCH	HP	KD	EE, PPC, PSI
HSE	HS	KGB	BB
HSKE	SII	KGD	BB
HSM	HL	KHP	EDI
HTR	Thom	KL	CODI
HTV	MENA	KLR	CODI
HV	Atl, HL, MENA, SDI, SE, Sem	KS	FEL
HVC	Sem, STSI	KSA	IRC
HVE	UC	KSD	GE
HVF	UC	KSL	IRC
HVFS	UC	KU	Thom
HVG	GIC	KV	EDI, FSI
HVH	UC	KVF	EDI
HVHF	UC	KVP	EDI
HVHJ	UC	KX	UC
HVHS	UC	KXS	UC
HVJX	UC	KY	Tesla
HVPR	GIC	KYZ	Tesla
HVR	SDI, SE	KZ	FSI, IRC, STSI, Tesla
HVRG	CODI	KZZ	Tesla
HVS	SE	L	HL, Samtech, SCL
HVT	SE	LA	IRC, Sem, UC
HVX	UC	LAA	Sem
HW	Sem	LAB	Sem
HX	MENA	LAC	Sem
HZ	HL	LB	IRC
ICT	GSI	LC	IRC, GSI, UC
ICTE	GSI, Mot, Thom	LCC	Sem
ID	IDC	LCD	EDI
IDA	IDC	LCE	GSI
IDBG	SL	LCS	UC
IDCG	SL	LD	CODI, IRC
IDDG	SL	LDD	Amp
		LDZ	Amp
		LE	IRC

Буквенное обозначение	Фирма
LFD	EDI
LHC	EDI
LK	EDI
LM	NSC, UC
LMS	UC
LMZ	GSI, SI
LNA	CODI
LPM	SI
LS	UC
LWA	TRW
M	EII, MED, Samtech, SDI, TC, Thom
MA	MA, MEC, UC
MB	MED, MS, SE
MBD	Mot.
MBI	Mot.
MBR	Mot.
MC	MS, Thom.
MCL	Mot.
MCLT	Mot.
MCV	SDI
MD	MEC, OEC, SL, Thom., UC
MDA	Mot.
MDD	BB
MDX	UC
ME	Thom.
MF	MED
MFE	MED
MGLA	CODI
MH	SDI
MHD	GE
MHF	BB
MHO	BB
MHV	CODI
MI	SE
ML	MS
MLNA	CODI
MLV	CODI
MMB	SEC
MMD	Mot.
MO	TAG
MR	GE, TAG, GIC
MPD	GE
MPI	Mot.
MPR	TAG
MPT	GSI
MPTE	GSI, Mot.
MPZ	Mot.
MQ	SCL
MR	CODI, Mot., SE, SI
MRD	CODI
MRF	CODI
MS	CODI, SDI, UC
MSD	Mot., SEC

Буквенное обозначение	Фирма
MSK	SII
MSZ	SL
MT	MS, TAG
MTR	TAG
MTZ	MS, Rohm
MU	Thom.
MUR	Mot.
MV	SDI
MVAM	Mot.
MVS	Mot.
MX	MS, UC
MXS	UC
MZ	MED, Mot., MS
MZA	MEC
MZC	Mot.
MZD	Thom.
MZL	MEC
N	HL
NBS	NAE
NCR	NAE
ND	CODI
NLA	NEI
NPC	Thom
NS	SDI
NSD	SDI
NSR	NAE
NSS	NAE
NTD	EDI
NV	RCC
OA	BEL, ME, ML, Mist, PEC, SL, RTC, Tesla, V
ODB	SL
ODC	SL
ODD	SL
OF	RTC
OSB	RTC, V
OSM	RTC, V
OSS	RTC, V
P	EII, GSI, HL, GIC, PI, Sem, Thom
PAD	TSC
PBC	EDI
PBR	EDI
PBT	EDI
PBY	PSDI
PD	EDI, PI, TRW
PDR	PSDI
PE	EDI
PF	SE, Thom
PEC	Thom
PFG	PI
PFR	PSDI, Thom
PFZ	Thom
PFZD	Thom
PH	ML, PEC

Буквенное обозначение	Фирма
PHR	PSDI
PHSD	PEC
PIP	GSI
PK	PI
PKK	PI
PL	LEC, Thom
PLE	Thom
PLQ	Thom
PLR	Thom
PM	MED, TRW
PMA	UC
PMB	UC
PMC	UC
PMD	PI, UC
PME	UC
PMR	LS
PR	ITT, PI, SSS, Thom
PS	TRW
PSZ	SL
PT	TAG
PTC	MDP
PTR	TAG
PTS	TAG
PTSR	TAG
PW	MEL
PY	Thom
PZD	Thom
Q	IDC
R	CODI, MEL, Mot, Samtech, SCL, Thom, VSI, WEC
RA	EDI, SE, WEC
RB	SE
RBA	RL
RBC	RL
RBD	RL
RC	RCC, SE
RCD	EDI
RCP	RCC
RD	APD, NEC
REG	RCC
RF	EDI, SE
RFD	EDI
RG	GIC, Thom
RGM	GIC
RGP	GIC
RH	SE
RHC	EDI
RHR	EDI
RIB	EDI
RIG	RCC
RK	EDI
RKB	GIC
RKBP	GIC

Буквенное обозначение	Фирма
RKBPC	GIC
RL	EDI, RL
RM	MEC, SE
RN	Thom
RO	SCL, SE
RP	GIC, SSDI, Thom
RPP	Thom
RS	RL
RTD	EDI
RTF	Thom
RU	SE
RV	EDI
RVP	EDI
RW	GIC
RY	RCC
RZ	Thom
S	GS, HL, MDP, MED, MEL, SA, Samtech, SE, Sem, STSI, WS
SA	GSI, RET, SE, SL, WS
SAM	RFT
SAX	RFT
SAY	RFT
SAZ	RFT
SB	GIC, RL, SE
SBEA	Samtech
SBEB	Samtech
SBEC	Samtech
SBMA	Samtech
SBMB	Samtech
SBMC	Samtech
SBR	Samtech, Sem
SBT	MED
SC	Samtech, SE, SL, Sem
SCA	Samtech
SCAJ	Samtech
SCAS	Samtech
SCBA	Samtech
SCBAR	Samtech
SCBH	Samtech
SCBK	Samtech
SCBR	Samtech
SCDA	Samtech
SCDAR	Samtech
SCDAS	Samtech
SCDE	Samtech
SCF	Samtech
SCFC	Samtech
SHC	Samtech
SCHC	Samtech
SCHF	Samtech
SCHJ	Samtech
SCHS	Samtech
SCKV	Samtech

Буквенное обозначение	Фирма
SCM	Samtech
SCMS	Samtech
SCMW	Samtech
SCNA	Samtech
SCNAS	Samtech
SCNE	Samtech
SCPA	Samtech
SCPB	Samtech
SCPD	Samtech
SCPE	Samtech
SCPH	Samtech
SCPN	Samtech
SCPP	Samtech
SCSDF	Samtech
SCSDFF	Samtech
SCSDL	Samtech
SCSDM	Samtech
SCSF	Samtech
SCSFF	Samtech
SCSHF	Samtech
SCSHM	Samtech
SCSM	Samtech
SCSNF	Samtech
SCSNFF	Samtech
SCSNL	Samtech
SCSNM	Samtech
SCSPF	Samtech
SCSPFF	Samtech
SCSPL	Samtech
SCSPM	Samtech
SD	DII, ITT, OEC, PEC, SL, Mot, TRW
SDA	SSDI, Sem
SDFF	Samtech
SDH	Samtech
SDR	SSDI, CODI
SER	SSDI
SES	UC
SF	CODI, NAE, SE
SFC	NAE
SFD	Mist, Thom
SFF	Samtech
SFM	Samtech
SFMS	Samtech
SG	SE
SGA	SE
SGB	SE
SGF	SE
SGM	SE
SH	Samtech, SE, SL
SHVM	Samtech
SI	MDP, Samtech, Sem
SIB	FEC
SIST	SMC

Буквенное обозначение	Фирма
SISTE	SMC
Siek	BHP
SIF	Samtech
SIM	ML
SK	SII
SKB	SII
SKBB	SII
SKD	SII
SKE	SII
SKHM	SII
SKKD	SII
SKN	SII
SKNA	SII
SKR	SII
SKS	SII
SKSA	SII
SKV	SII
SKXA	SII
SL	CODI, Sem, SSD
SLC	Sem
SLCE	Sem
SLD	SDI
SLDHV	SDI
SLF	CODI
SIZ	MED
SM	CODI, OEC, Samtech, Sem, SL, WS
SMER	Samtech
SMHF	Samtech
SMHR	Samtech
SN	SII
SNFF	Samtech
SNR	SE
SO	Sem
SOD	SDI, SSII
SODSPC	SDI
SP	CODI
SPC	SDI
SPCHV	SDI
SPD	CODI, SSDI
SPDA	CODI
SPFF	Samtech
SR	MEC, SE, Sem, SL
SRB	OEC
SRF	OEC
SRP	GIC
SRS	SSD
SRSFR	SSD
SS	OEC, Samtech, SE, SMC
SSCDA	SSD
SSCNA	SSD
SSCPA	SSD
SSH	Sem
SSiB	SA

Буквенное обозначение	Фирма
SSiC	SA
SSiD	SA
SSiE	SA
SSiF	SA
SSiG	SA
SSiK	SA
SSiL	SA
SSiN	SA
SSiP	SA
SSP	SDI
ST	APD, EC, IRC, STSI, Samtech
STB	APD, GE
STF	Samtech
STFF	Samtech
STV	SE
SU	MED
SUES	Sem
SV	GIC, NEC, SE, Sem, SEM, SMC, Thom, VEC
SVD	TRW
SW	WS
SX	ML, Samtech, UC
SXS	UC
SY	RFT, Samtech, SE
SZ	ML, PS, RFT, SA, SL, SMC
SZL	SA
SZX	RFT
SZY	RFT
T	GS, HL, SDI, Sem
TA	SDI
TAV	SDI
TCR	TS
TD	SE
TFR	TC
THD	SEC
TI	UC
TID	TI, UC
TIDM	TI
TIR	UC
TJ	SDI
TMPD	SEC
TR	EDI
TS	MS, Samtech, SDI
TSC	TSI
TSD	SEC
TSV	SDI
TSZ	SL
TV	Tel, Thom
TVP	TRW
TVPC	TRW
TVR	TC
TVS	UC

Буквенное обозначение	Фирма
TZ	Rohm, STSI
TZB	Sem
TZC	Sem
TZV	Sem
μPA	NEC
U	HL
UDC	UC
UDE	UC
UDF	UC
UDZ	UC
UES	Sem, UC
UF	SE
UFB	UC
UFS	UC
UGB	BB, UC
UGD	UC
UGE	BB
UGF	UC
UHV	CSDC
UPI	UPI
UR	UC
US	UC
USB	UC
USD	UC
USR	MS, SA, UC
USS	UC
UT	UC
UTR	UC
UTX	UC
UZ	UC
V	GE, HL, Sem, VEC, VSI
VA	VSI
VB	BB, MDP, VSI
VC	VSI
VE	VSI
VF	Sem, VSI
VG	VSI
VGB	BB
VGF	BB
VH	VSI
VHE	VSI
VHP	RCC
VJ	VSI
VK	VSI
VKP	VSI
VL	VSI
VM	VSI
VR	DII, MED, SE, STSI
VRU	SCL
VS	Sem, VSI
VSB	VSI
VSF	RFT
VSH	SL
VSK	VSI

24 Заказ № 1141

Буквенное обозначение	Фирма	Буквенное обозначение	Фирма
VT	VSI	1NZ	Tesla
VTA	VSI	1P	FE, ITT
VTC	VSI	1QE	TC
VTD	VSI	1R	TC
VTE	VSI	1RM	Thom
VTH	VSI	1S	AM, CEIL, FL, FSC, HL MEC, NEC, San, SEM, TC, Rohm
VX	UC	1SF	Samtech
VXS	UC	1SM	SL
VY	VSI	1SR	Rohm, SE
VYA	VSI	1SS	FL, HL, HS, NEC, Rohm, TC
VYB	VSI	1SV	HL, NEC
VYC	VSI	1SX	SCL
VYD	VSI	1SZ	NEC, TC
VYH	VSI	1T	CEIL, SC
VZ	MED	1Z	SC
W	FE, GIC, HL, VSI	2A	SSDI
WAC	SL	2AA	CEIL, Mist, PEC
WBC	SL	2AF	IRC
WCN	GIC	2ASLD	SDI
WG	ITT	2B	SSDI, TC
WL	FE, GIC	2C	SSDI
WO	MEL	2D	TC
WZ	NJRC	2DL	IRC
X	Samtech, SCL, Thom	2DS	LEC
XF	RCC	2EZ	MS, SA
XM	Thom	2FB	CODI
XS	Sem	2G	CEIL, SDI, TC
Z	IRC, SCL, SMC, TRW	2KBP	GIC
ZA	Sem	2KZ	STSI
ZB	MDP, Sem	2L	EII
ZBC	Sem	2OA	Mist
ZC	FEL, LEC, Sem	2R	SSDI
ZCC	Sem	2SB	CODI
ZD	ITT	2SBF	CODI
ZDX	FEL	2SD	SL
ZE	EI	2SF	Samtech
ZF	EI, Thom	2SFD	Mist
ZG	EI	2SFF	Samtech
ZGP	GIC	2SM	SL
ZH	Sem	2VR	STSI
ZJ	TC	2W	GIC
ZPD	FE, ITT	3A	SDI
ZPU	ITT	3AF	STSI
ZPY	ITT	3B	TC
ZR	EI, SCL	3C	SDI
ZS	FEL, SCL	3CC	TC
ZSA	SCL	3CD	TC
ZSY	SCL	3D	TC
ZTE	ITT	3DD	CODI
ZTK	ITT	3DF	CODI
ZX	ITT	3DH	TC
ZY	ITT		
ZZ	FE, ITT		
ZZY	ITT		

Буквенное обозначение	Фирма	Буквенное обозначение	Фирма
3DZ	TC	3EZ	SA
3E	Atl	3F	IRC

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

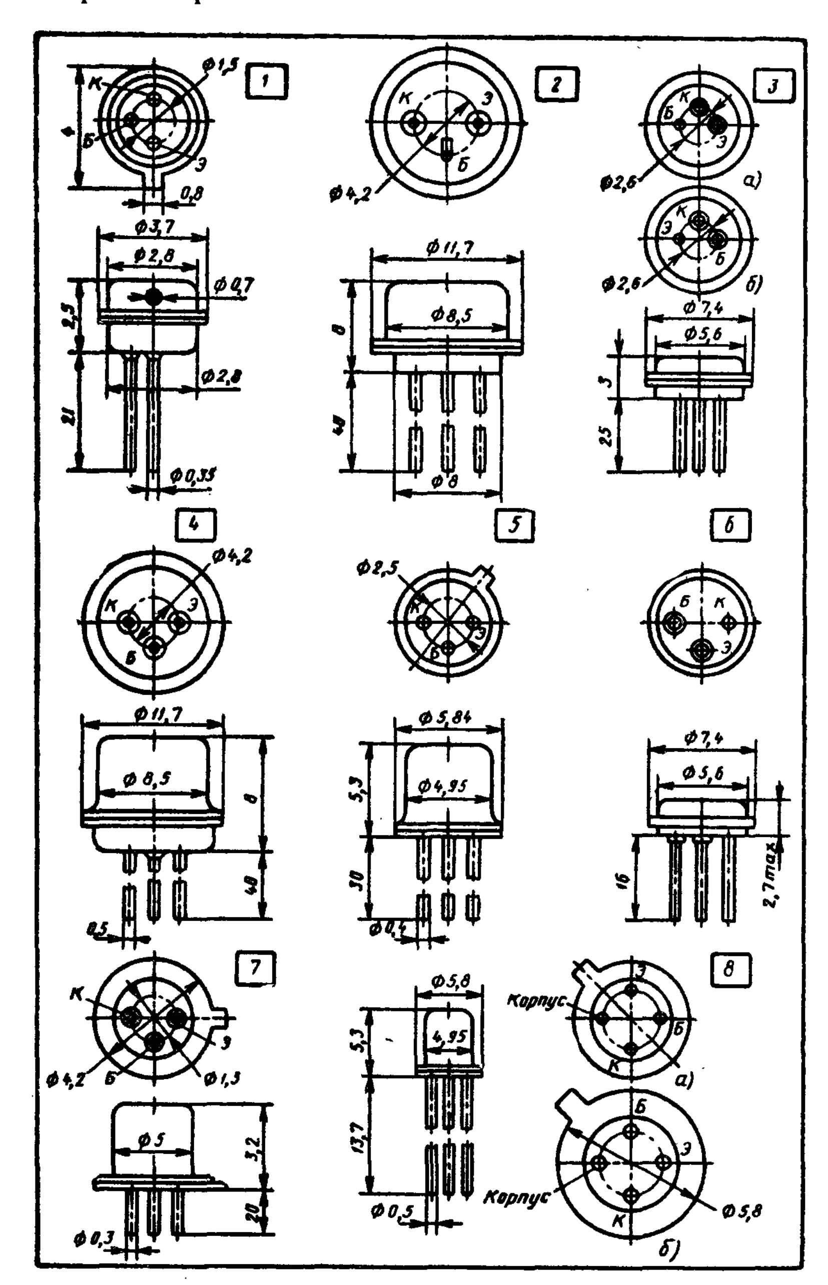
Сокращенные обозначения зарубежных фирм

Буквенное обозначение	Фирма, страна	Буквенное обозначение	Фирма, страна
Acr	Acrian, Inc., США	CSC	Crimson Semiconductor Corp., США
AEC	Amperex Electronic Corp., США	CSD	Central Semiconductor Div., США
AEI	Amex Electronics, Inc., США	CSDC	Conditioning Semiconductor Devices Corp., США
AI	Avantek, Inc., США	CSR	CSR Industries, Inc., США
AII	Alpha Industries, Inc., США	DI	Dionics, Inc., США
AM	American Microsemiconductor, США	DII	Datel-Intersil, Inc., США
AMI	American Microsemiconductor, Inc., США	DTC	Diode Transistor Comp., США
Amp	Amperex Electronic Corp., США	EC	Eastron Corp., США
AMS	American Microsystems, Inc., США	ED	EETECH Div., США
APD	American Power Devices, США	EDI	Electronics Devices, Inc., США
AS	Ansaldo S. p. A, Италия	EE	Електронни Элементи, БНР
ASI	Advanced Semiconductors, Inc., США	EI	Elektronska Industrija (Iskra), Югославия
Atl	Atlantic Semiconductors, Inc., США	EII	Edal Ind., Inc., США
BB	Brown Boveri, ФРГ	ESPI	Elite Semiconductor Products, Inc., США
BE	Boeing Electronics, Швейцария	ETC	Electronic Transistors Corp., США
BEL	Bharat Electronics., Ltd., Индия	FE	Fagar Electrotechnica, Испания
CD	Compensated Devices, Inc., США	FEL	Ferranti Electronics, Ltd., Англия
CDI	Continental Device India, Ltd., Индия	FEC	Fujitsu Electric, Япония
CEIL	Calbert Electronics Inter., Ltd., США	FS	Fairchild Semiconductor Corp., США
Cherry	Cherry Semiconductor Corp., США	GDC	General Diode Corp., США
CODI	CODI Semiconductor Corp., США	GE	General Electric Corp., США
		GIC	General Instrument Corp., США

Буквенное обозначение	Фирма, страна	Буквенное обозначение	Фирма, страна
GPD	Germanium Power Devices Corp., США	MED	Marconi Electronic Devices, Англия
GS	Gentron Corp., США	MEL	Microelectronics, Ltd., Гонконг
GSI	General Semiconductor Industries, Inc., США	MENA	Murata-Erie North American Corp., США
CSS	Cold Star Semiconductors, Ltd., Ю. Корея	MIS	Mistral SPA, Италия
GTC	General Transistor Corp., США	Mist	Mistral, Италия
Harris	Harris Semiconductor, США	ML	Mullard, Ltd., Англия
HL	Hitachi Ltd., Япония	Mot	Motorola Semiconductor Products, Inc., США
HP	Hewlett Packard, США	MPS	Micro Power Systems, США
HS	Hybrid Semiconductors, США	MS	Microsemiconductor Corp., США
HSE	Hybrid Semiconductor Electronic, Inc., США	NAE	NAE, Inc., США
HVS	High Voltage Semiconductor, США	NAS	North American Semiconductor, ФРГ
IC	Interfet Corp., США	NEC	Nippon Electric Comp., Япония
IDC	International Diode Corp., США	NEI	National Electronics Inc., США
IDI	International Devices, Inc., США	NJRG	New Japan Radio Comp., Япония
II	Intersil, Inc., США	NJS	New Jersey Semiconductor Prod., США
IPS	International Power Semiconductors, Индия	NSC	National Semiconductor Corp., США
IR	International Rectifier Semiconductor, США	OEC	Origin Electric Comp., Япония
IRC	International Rectifier Corp., США	PEC	Philips Electronic Comp., Голландия
ITT	Intermetall (der Deutsche ITT), ФРГ	Philco	Philco Radio Televisao, Бразилия
KMC	KMC Semiconductor Corp., США	PI	Parametric Ind., США
KPD	Keltron Power Devices, Индия	PIC	Piher International Corp., Испания
LEC	Lucas Electrical Comp., Англия	PPC	PPC Products Corp., США
LS	Lambda Semiconductors, США	PPI	Pecor President Interprises Corp., США
LT	Lansdale Transistor, США	PS	Piher Semiconductors, Испания
MA	Microwave Associates, США	PSDI	Punjal Semiconductor Devices, Ltd., Индия
MDP	Mallory Distributor Products, США	PSE	Plessey Semiconductors, Англия
ME	Mitsubishi Electric Corp., Япония	PSI	Power Semiconductors, Inc., США
MEC	Matsushita Electronics Corp., Япония	PTI	Power Tech, Inc., США
MECJ	Mitsubishi Electric Corp., Япония	QC	Quantrad Corp., США
		RC	Raytheon Comp., США
		RCA	RCA Corp., США

Буквенное обозначение	Фирма, страна	Буквенное обозначение	Фирма, страна
RCC	Rectifier Component Corp., США	SSII	Solid State Industries, Inc., США
RFT	RFT, ГДР	SSS	Solid State Systems, США
RL	Rectron Ltd., Китай	STC	Silicon Transistor Corp., США
Rohm	Rohm Corp., Япония	STI	Semiconductor Technology, Inc., США
RS	Raytheon Semiconductor, США	STSI	ST — Semicon. Inc., США
RTC	RTC La Radiotechnique, Франция	Supertex	Supertex, Inc., США
SA	Siemens Aktiengesellschaft, ФРГ	Syn	Syntar Inductries, Inc., США
Samtech	Samtech Corp., Япония	TAG	TAG Semiconductor, Ltd., Швейцария
San	Sanyo Electric Comp., США	TC	Toshiba Corp., Япония
SC	Sony Corp., Япония	TCI	Teledyne Crystalonics, Inc., США
SCL	Semitron Cricklade, Ltd., Англия	TEI	Teccor Electronics, Inc., США
SDI	Solitron Devices, Inc., США	Tel	Telefunken Electronic, ФРГ
SE	Sanken Electric Comp., США	Tesla	Tesla, ЧССР
Semicoa	Semicoa, США	Thom	Thomson — CSF, Франция
SEC	Spraque Electric Comp., США	TI	Texas Instruments, Inc., США
SECI	Swampscott Electronics Comp., США	TRW	TRW Semiconductor, Inc., США
SEM	Shindengen Electric Mfg., Япония	TS	Teledyne Semiconductor, США
Sem	Semicon, Inc., США	TSI	Transistor Specialtys, Inc., США
SGS	SGS — Ates, Италия	UA	United Aircraft, США
SI	Siliconix, Inc., США	UC	Unitrode Corp., США
SII	Semikron International, Inc., США	Unitra	Unitra, ПНР
SL	Semiconductors, Ltd., Индия	UPI	UPI Semiconductors, США
SMC	Schauer Manufacturing Corp., США	V	Valvo, ФРГ
SPC	Solid Power Corp., США	VEC	Victory Engineering Corp., США
SPE	Space Power Electronics, Inc., США	VSI	Varo Semiconductor, Inc., США
SSD	Sensitron Semiconductor Div., США	WDI	Walbern Devices, Inc., США
SSDI	Solid State Devices, Inc., США	WEC	Westinghouse Electric Corp., США
SSE	Solid State Electronics Comp., США	WS	Westcode Semiconductors, Англия
SSI	Solid State Industries, Inc., США		

Габаритные чертежи корпусов отечественных и зарубежных транзисторов



17 а) 1-К, 2-Б, 3-Э
б) 1-К, 2-Э, 3-Б

18

19

20

21

корпус

22

23

24

25

26

27

28

29

30

а)

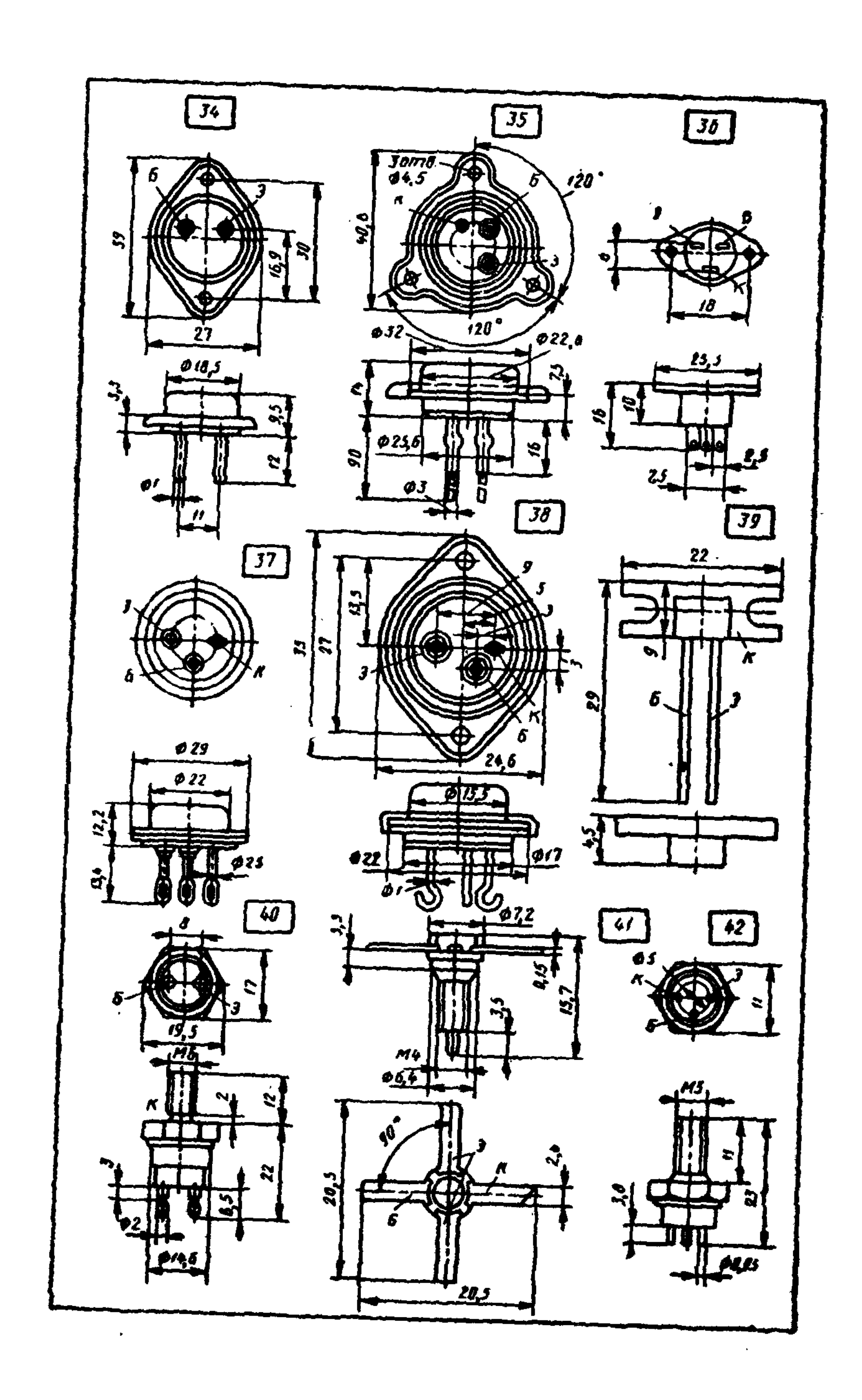
б)

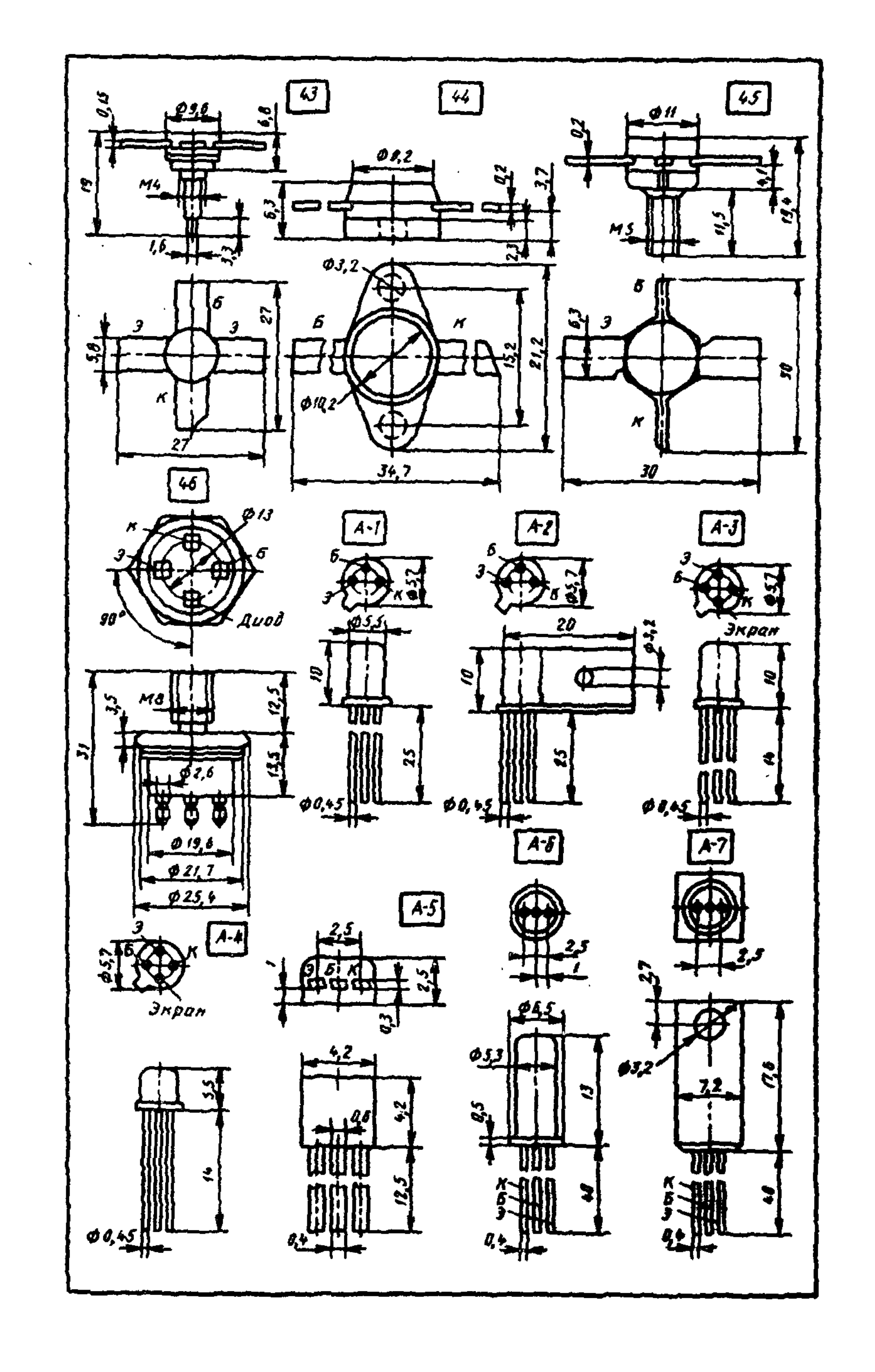
31

32

2 отв Ф3,2

33


34
35
36
37
38
39
40
41
42


43
44
45
46
A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7
Диод
Экран

МД-6

МД-9

МД-10

К-корпус

МД-11

МД-17

МД-23

МД-29

МД-36

ММ-10

ММ-11

МТ-29

ММ-12

ММ-13

МТ-59

МТ-67

МТ-71

MT-72

MT-74

MT-77

MT-78

MT-83

MT-84

OV-4

OV-9

OV-16

R-8

R-9

R-10

R-13

R-18

R-19

R-31

R-32

R-38

Корпус

R-55

R-60

R-64

R-67

R-96

Корпус

R-122

R-134

R-139

R-146

Корпус

SOT-9

SOT-23

SOT-37

SOT-82

SOT-89

TO-1

Цветная метка

TO-1A

TO-2

TO-3

TO-5

TO-7

Корпус

25 Заказ № 1141

ТО-8

ТО-9

ТО-10

ТО-11

ТО-12

ТО-13

ТО-17

ТО-18

ТО-22

ТО-23

ТО-24

ТО-29

ТО-31

ТО-37

ТО-39

ТО-40

ТО-41

ТО-44

ТО-46 ТО-50 ТО-52

ТО-38 ТО-60 ТО-61

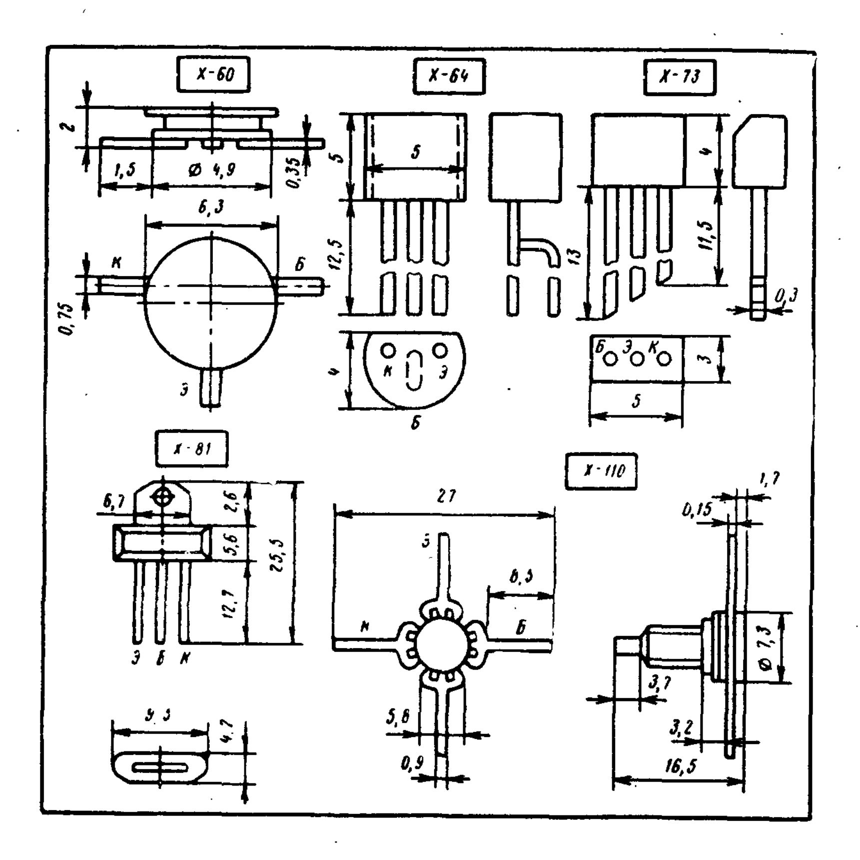
ТО-66 ТО-72 ТО-92

ТО-98 ТО-117 ТО-126

ТО-128 ТО-129

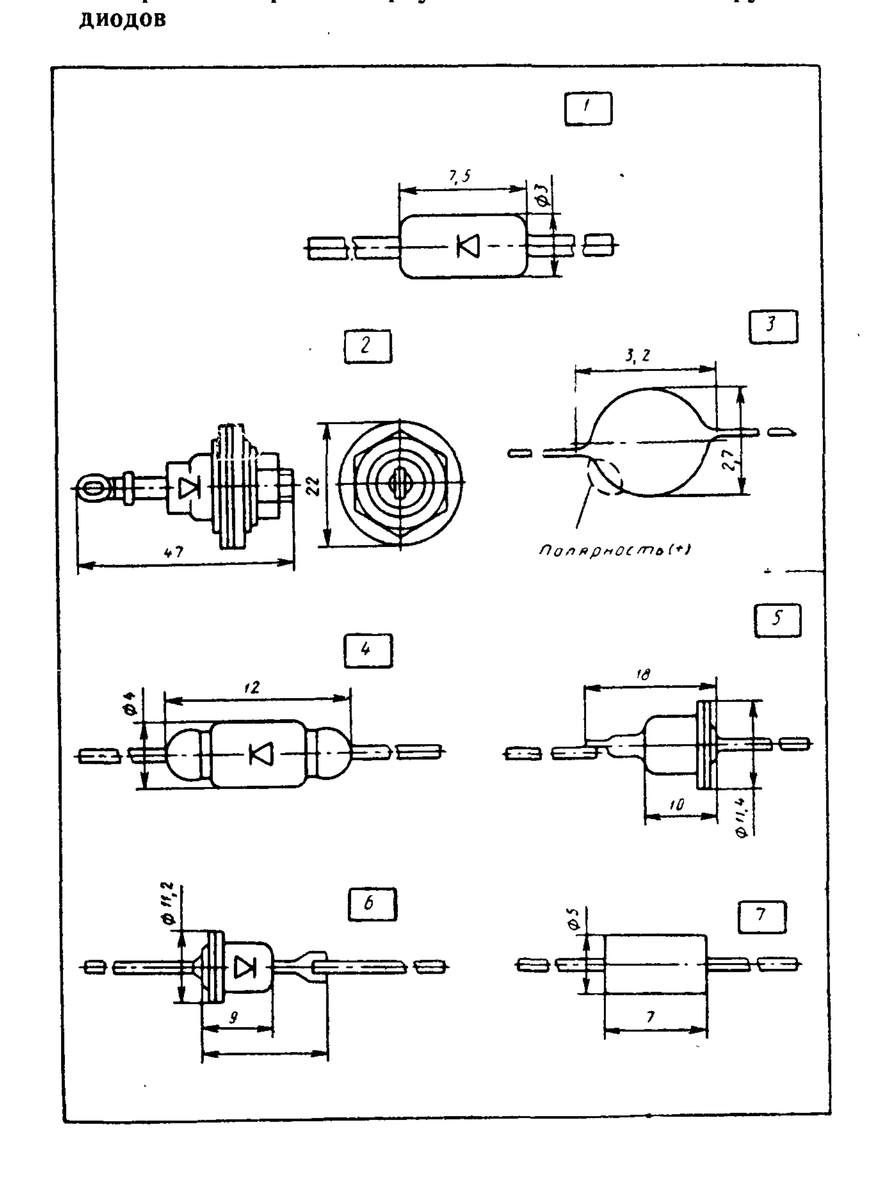
ТО-202 ТО-220

U-26
2,5
Ф 4,8
1,8
1
Э
К
7
6
5,6
Б
U-37
1,1
Э К Б
3,2
6
4,7
9
U-78
1,9
ф 4,7
0,6
К
6,3
2,1
Э
Э
6,5
Б
U-94
4,1
1,2
3,6
12,5
Б К Э
2,1
X-9
Б
Э
К
6,0
17,1
40
X-20
Э К Б
4
5
5
12,7
X-47
Б
Э
К
ф 6,1
15
25,8
22
X-51
0,6
11,9
10,2
8,1
15,2
Э
Б
К
4,7
X-55
4,2
К
Б
Э
5,2
4,3
12,7
4,8



ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Габаритные чертежи корпусов отечественных и зарубежных диодов



8
20,32
11,5
11
12,8
9
37
Ф13
14
10
44
Ф27,5
14
11
Ф11
35
12
20
11,5
Ф12,8
14
13
20,1
11,5
Ф12,8
15
14
7
18
38
15
7,5
Ф3
16
3,8
17
15
Ф7
9

18

14

6

Точка только для КС170А

R4

19

10 11 12

9 1

9,6

8 2

7 3

6 5 4

9,6

20

Ф7

9

15

Б

0,52

Ф 0,95

А

21

22

16 max

12

Ф11,2

Ф4

А-1

Ф12

20

Полярность указана цветным кодом

А-2

3,8

1

А-3

10,9

Ф6,1

А-6

Ф7,1

27

А-19

Ф5

8,7

А-21

Ф2,6

6,7

А-31

22,2

Ф9,7

А-32

12,7

Ф6,1

А-35

3,2

Ф9,5

А-42

Ф6,9

8,9

А-44

7,9

Ф3,8

А-47

Ф6,35

22,5

А-50

10,3

Ф6,1

А-52

11

Ф18,7

А-53

7,8

Ф6,8

А-54

Ф6,3

7,1

А-56

Полярность

А56а - анод

А56b - катод

21

Ф6,9

А-60

Ф21,6

4,4

А-73

Ф12,7

11

А-83

6,0

13

А-84

5,6

Ф5,8

А-87

5,8

Ф3,4

A-89

A · катод
A89a - анод
A89b - анод
A89c - анод

16,6
Φ7,9

A-100
15
5,4

A-146
8,9
Φ3,7

A-185
Φ10,1
5,9

A-188
1,5
2,54

A-196
40
Φ3,8

A-221
11,9

C-1
16
Φ6,8

C-3
7,9
19
Φ18,3

C-8
Φ10,4
6,3
Катод

C-9
катод
Φ12,7

C-12
Φ8,6
38

C-15
Φ15
6,3

C-18
Φ7
14
К

C-41
Φ8,4
6,3
К

C-42
Φ49
11,4

C-50
Катод
20
29
Анод

C-63
Корпус
Анод
21
24,5
Φ16

DO-1
10,1
18,3

DO-3
10,1
18,3

DO-2
22,9
Φ0,8

DO-4
20,3
Φ10,7

DO-5
Φ16,94
12,70
25,4

DO-7
7,0
2,67

DO-13
7,45
14,47
25,4

DO-14, DO-15
3,2
6,7

DO-26
6,6
10,4

DO-27
5,3
9,5

DO-29
3,8
9,1

DO-34
1,27
2,1

DO-35
2,3
5,0

F-8
17,3

F-22
9,7
Φ18

F-29
25,4

F-65
Φ4,9
20

F-73
Φ12,7
29

М4

Ф 26
30,2
К

М-21

11
10,3
К

М-38

Полярность
12,8
10,6

М38 - анод
М38а - анод
М38ВВ - анод
М38аа - катод

М-40

7,1
17,5
11,9
− +

М-45

19
14,3

М-82

23,9
14,5

М-98

13
6
+ −

М-99

30
30

М-117

31 max
16

М-118

11,9
12,5

М-122

46
13,5
+ −

М-124

25,4
40
40
К

М-139

27,5
Ф 25
Анод

М-166

14,3
11

М-204

Ф 16,2
25,4
Катод

М-208

1,5

М-221

63
25,4
25,4
54

М-236

5
14,2

М-343

6,35
3,2

М-530

22

М-531

11,2

М-532

19
19

М-533

11,2
7,9
7,9

М-536

17,6
6,3
11,9
11,9
Желтый
Красный
Черный

М-538

51
41

М-542

+ −
11
41,5
41,5

18,3

М-671

1,5

M594

M594 a, c

M594 c

M594 b

12,71

6,3

M673

40

10

21

+

−

M585

2,93

2,93

16

M586

57

50,8

S4

30

φ17

Катод

S19

12,7

φ12,9

S23

Анод

88

12,7

S24

17

φ7,8

Катод

S27

15

φ9,5

S33

21,4

φ9,5

Катод

S35

21,4

Катод

12,7

S41a

24,9

φ11,2

Катод

S43

14,3

25

Катод

S53

φ23,7

16,6

Анод

S66

11

φ14,3

Анод

S67

11

φ14,3

Анод

S68

21,4

17,4

Анод

S72

240

19

S74

24

φ14,9

S87

95

5,6

S103

22

φ8,3

Катод

S164

K

15,8

9,6

S235

19

9,1

S277

11,7

Катод

4,83

S336

23,9

10,1

TO-1

10,4

φ6,1